



PIC18F2423/2523/4423/4523

数据手册

采用 12 位 A/D 和纳瓦技术的
28/40/44 引脚
增强型闪存单片机

请注意以下有关 Microchip 器件代码保护功能的要点:

- Microchip 的产品均达到 Microchip 数据手册中所述的技术指标。
- Microchip 确信: 在正常使用的情况下, Microchip 系列产品是当今市场上同类产品中最安全的产品之一。
- 目前, 仍存在着恶意、甚至是非法破坏代码保护功能的行为。就我们所知, 所有这些行为都不是以 Microchip 数据手册中规定的操作规范来使用 Microchip 产品的。这样做的人极可能侵犯了知识产权。
- Microchip 愿与那些注重代码完整性的客户合作。
- Microchip 或任何其他半导体厂商均无法保证其代码的安全性。代码保护并不意味着我们保证产品是“牢不可破”的。

代码保护功能处于持续发展之中。Microchip 承诺将不断改进产品的代码保护功能。任何试图破坏 Microchip 代码保护功能的行为均可视为违反了《数字器件千年版权法案 (Digital Millennium Copyright Act)》。如果这种行为导致他人在未经授权的情况下, 能访问您的软件或其他受版权保护的成果, 您有权依据该法案提起诉讼, 从而制止这种行为。

提供本文档的中文版本仅为为了便于理解。请勿忽视文档中包含的英文部分, 因为其中提供了有关 Microchip 产品性能和使用情况的有用信息。Microchip Technology Inc. 及其分公司和相关公司、各级主管与员工及事务代理机构对译文中可能存在的任何差错不承担任何责任。建议参考 Microchip Technology Inc. 的英文原版文档。

本出版物中所述的器件应用信息及其他类似内容仅为为您提供便利, 它们可能由更新之信息所替代。确保应用符合技术规范, 是您自身应负的责任。Microchip 对这些信息不作任何明示或暗示、书面或口头、法定或其他形式的声明或担保, 包括但不限于针对其使用情况、质量、性能、适销性或特定用途的适用性的声明或担保。Microchip 对因这些信息及使用这些信息而引起的后果不承担任何责任。如果将 Microchip 器件用于生命维持和 / 或生命安全应用, 一切风险由买方自负。买方同意在由此引发任何一切伤害、索赔、诉讼或费用时, 会维护和保障 Microchip 免于承担法律责任, 并加以赔偿。在 Microchip 知识产权保护下, 不得暗中或以其他方式转让任何许可证。

商标

Microchip 的名称和徽标组合、Microchip 徽标、Accuron、dsPIC、KEELOQ、KEELOQ 徽标、microID、MPLAB、PIC、PICmicro、PICSTART、PRO MATE、PowerSmart、rfPIC 和 SmartShunt 均为 Microchip Technology Inc. 在美国和其他国家或地区的注册商标。

AmpLab、FilterLab、Linear Active Thermistor、Migratable Memory、MXDEV、MXLAB、PS 徽标、SEEVAL、SmartSensor 和 The Embedded Control Solutions Company 均为 Microchip Technology Inc. 在美国的注册商标。

Analog-for-the-Digital Age、Application Maestro、CodeGuard、dsPICDEM、dsPICDEM.net、dsPICworks、ECAN、ECONOMONITOR、FanSense、FlexROM、fuzzyLAB、In-Circuit Serial Programming、ICSP、ICEPIC、Mindi、MiWi、MPASM、MPLAB Certified 徽标、MPLIB、MPLINK、PICkit、PICDEM、PICDEM.net、PICLAB、PICKtail、PowerCal、PowerInfo、PowerMate、PowerTool、REAL ICE、rfLAB、rfPICDEM、Select Mode、Smart Serial、SmartTel、Total Endurance、UNI/O、WiperLock 和 ZENA 均为 Microchip Technology Inc. 在美国和其他国家或地区的商标。

SQTP 是 Microchip Technology Inc. 在美国的服务标记。

在此提及的所有其他商标均为各持有公司所有。

© 2007, Microchip Technology Inc. 版权所有。

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
== ISO/TS 16949:2002 ==

Microchip 位于美国亚利桑那州 Chandler 和 Tempe、位于俄勒冈州 Gresham 及位于加利福尼亚州 Mountain View 的全球总部、设计中心和晶圆生产厂均于通过了 ISO/TS-16949:2002 认证。公司在 PIC[®] 单片机与 dsPIC[®] 数字信号控制器、KEELOQ[®] 跳码器件、串行 EEPROM、单片机外设、非易失性存储器 and 模拟产品方面的质量体系流程均符合 ISO/TS-16949:2002。此外, Microchip 在开发系统的设计和和生产方面的质量体系也已通过了 ISO 9001:2000 认证。



MICROCHIP

PIC18F2423/2523/4423/4523

采用 12 位 A/D 和纳瓦技术的 28/40/44 引脚增强型闪存单片机

外设特点:

- 最多 13 路通道的 12 位模数转换器模块 (A/D):
 - 自动采样功能
 - 可在休眠模式下进行转换
- 带有输入多路选择的双模拟比较器
- 高灌 / 拉电流: 25 mA/25 mA
- 3 个可编程外部中断
- 4 个输入电平变化中断
- 多达两个捕捉 / 比较 / PWM (CCP) 模块, 一个具有自动关闭的功能 (28 引脚器件)
- 增强型捕捉 / 比较 / PWM (ECCP) 模块 (仅限 40/44 引脚器件):
 - 1、2 或 4 路 PWM 输出
 - 可选择极性
 - 可编程死区时间
 - 自动关闭和自动重启
- 主同步串行口 (Master Synchronous Serial Port, MSSP) 模块, 支持 3 线 SPI (所有 4 种模式) 和 I²C™ 主 / 从模式
- 增强型 USART 模块:
 - 支持 RS-485、RS-232 和 LIN 1.2
 - 使用内部振荡器模块的 RS-232 工作模式 (无需外部晶振)
 - 检测到起始位自动唤醒
 - 自动波特率检测

功耗管理模式:

- 运行: CPU 工作, 外设打开
- 空闲: CPU 不工作, 外设打开
- 休眠: CPU 不工作, 外设关闭
- 空闲模式时电流可降至 5.8 μ A (典型值)
- 休眠模式时电流可降至 0.1 μ A (典型值)
- Timer1 振荡器: 1.8 μ A, 32 kHz, 2V
- 看门狗定时器: 2.1 μ A
- 双速振荡器启动

灵活的振荡器结构:

- 4 种晶振模式, 频率最高为 25 MHz
- 4 倍频锁相环 (Phase Lock Loop, PLL) (可用于晶振和内部振荡器)
- 两种外部 RC 模式, 频率最高为 4 MHz
- 两种外部时钟模式, 频率最高为 25 MHz
- 内部振荡器模块:
 - 8 个可由用户选择的频率, 从 31 kHz 到 8 MHz
 - 当与 PLL 结合使用时可提供较宽的时钟频率范围, 从 31 kHz 到 32 MHz
 - 用户可对该电路进行调节以补偿频率漂移
- 辅助振荡器使用 Timer1 (工作频率为 32 kHz)
- 故障保护时钟监视器:
 - 当外部时钟停止工作时自动切换到内部振荡器

单片机特性:

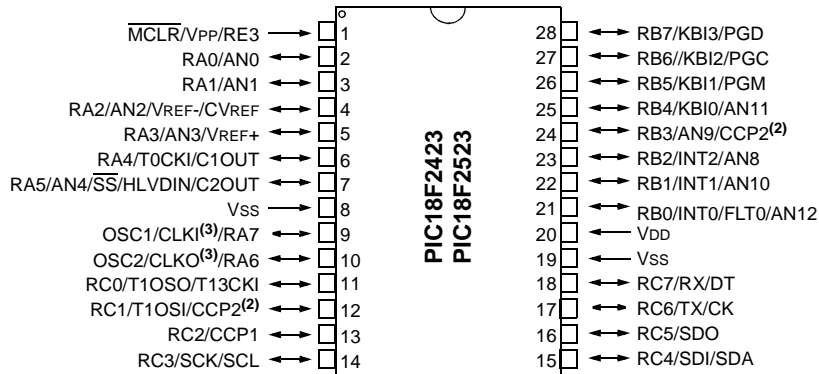
- 优化的 C 编译器架构:
 - 为优化可重入代码而设计的可选的扩展指令集
- 可进行 100,000 次擦写操作的增强型闪存程序存储器 (典型值)
- 可进行 1,000,000 次擦写操作的数据 EEPROM 存储器 (典型值)
- 闪存 / 数据 EEPROM 保存时间: 100 年 (典型值)
- 可在软件控制下自编程
- 中断优先级
- 8 x 8 单周期硬件乘法器
- 扩展型看门狗定时器 (Watchdog Timer, WDT):
 - 可编程周期从 4 ms 到 131s
- 通过两个引脚进行单电源在线串行编程 (In-Circuit Serial Programming™, ICSP™)
- 通过两个引脚进行在线调试 (In-Circuit Debug, ICD)
- 工作电压范围: 2.0V 到 5.5V
- 可编程 16 级高 / 低压检测 (High/Low-Voltage Detection, HLVD) 模块:
 - 支持高 / 低压检测中断
- 可编程欠压复位 (Brown-out Reset, BOR):
 - 带软件使能选项

器件	程序存储器		数据存储器		I/O	12 位 A/D (通道)	CCP/ ECCP (PWM)	MSSP		EUSART	比较器	8/16 位定时器
	闪存 (字节)	单字指令数	SRAM (字节)	EEPROM (字节)				SPI	主控 I ² C™			
PIC18F2423	16K	8192	768	256	25	10	2/0	有	有	1	2	1/3
PIC18F2523	32K	16384	1536	256	25	10	2/0	有	有	1	2	1/3
PIC18F4423	16K	8192	768	256	36	13	1/1	有	有	1	2	1/3
PIC18F4523	32K	16384	1536	256	36	13	1/1	有	有	1	2	1/3

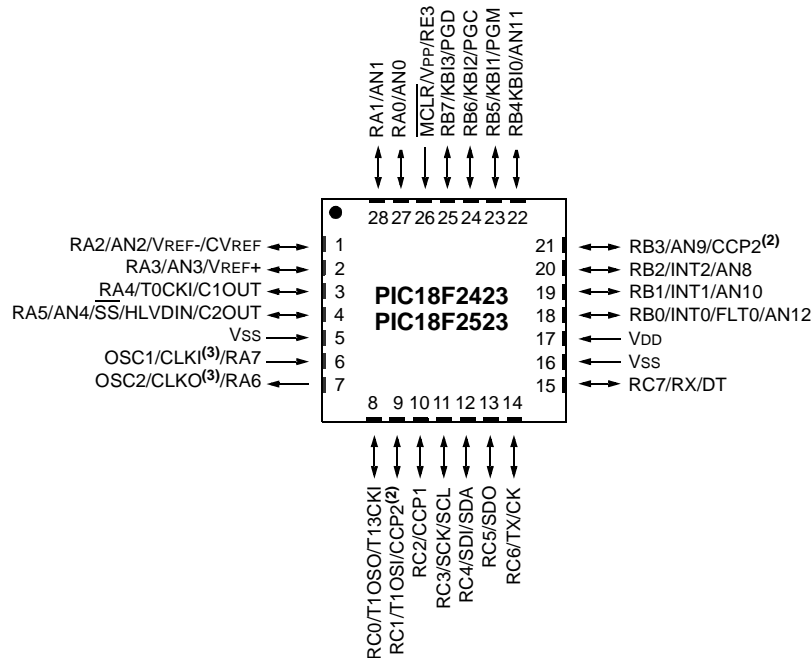
PIC18F2423/2523/4423/4523

引脚示意图

28 引脚 PDIP 和 SOIC



28 引脚 QFN⁽¹⁾

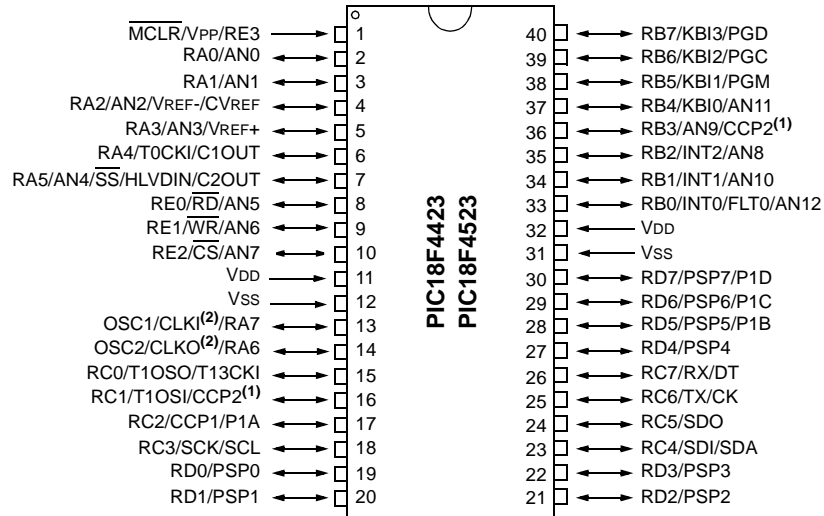


- 注 1: 建议将 QFN 封装器件底部的焊垫连接到 Vss。
 2: RB3 是与 CCP2 复用的备用引脚。
 3: OSC1/CLKI 和 OSC2/CLKO 仅在某些振荡器模式下，并且这两个引脚不用作数字 I/O 引脚时才可用。更多信息，请参见第 2.0 节“振荡器配置”。

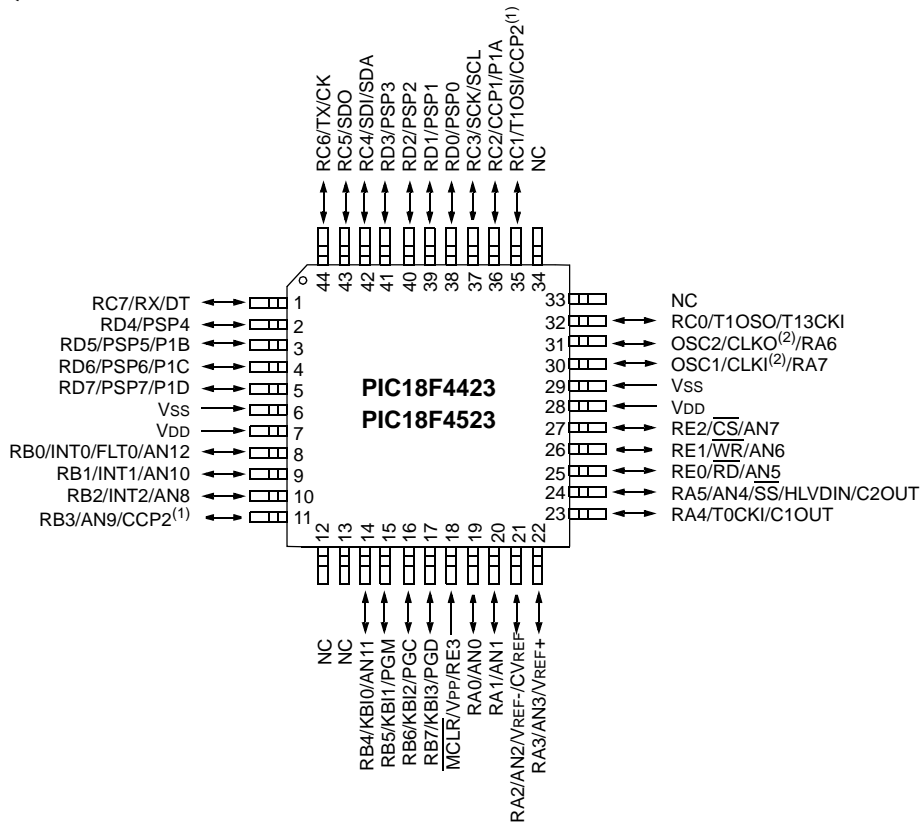
PIC18F2423/2523/4423/4523

引脚示意图 (续)

40 引脚 PDIP



44 引脚 TQFP

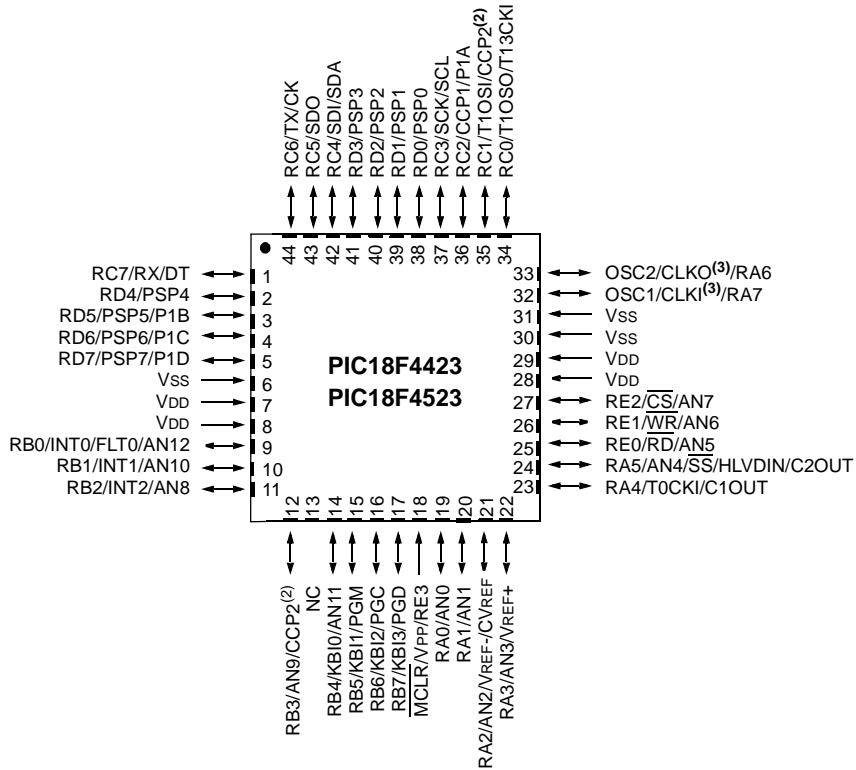


- 注
- 1: RB3 是与 CCP2 复用的备用引脚。
 - 2: OSC1/CLKI 和 OSC2/CLKO 仅在某些振荡器模式下，并且这两个引脚不用作数字 I/O 引脚时才可用。更多信息，请参见第 2.0 节“振荡器配置”。

PIC18F2423/2523/4423/4523

引脚示意图 (续)

44 引脚 QFN⁽¹⁾



- 注
- 1: 建议将 QFN 封装器件底部的焊垫连接到 Vss。
 - 2: RB3 是与 CCP2 复用的备用引脚。
 - 3: OSC1/CLKI 和 OSC2/CLKO 仅在某些振荡器模式下，并且这两个引脚不用作数字 I/O 引脚时才可用。更多信息，请参见第 2.0 节“振荡器配置”。

PIC18F2423/2523/4423/4523

目录

1.0 器件概述	7
2.0 振荡器配置	23
3.0 功耗管理模式	33
4.0 复位	41
5.0 存储器构成	53
6.0 闪存程序存储器	73
7.0 数据 EEPROM 存储器	83
8.0 8 x 8 硬件乘法器	89
9.0 中断	91
10.0 I/O 端口	105
11.0 Timer0 模块	123
12.0 Timer1 模块	127
13.0 Timer2 模块	133
14.0 Timer3 模块	135
15.0 捕捉 / 比较 / PWM (CCP) 模块	139
16.0 增强型捕捉 / 比较 / PWM (ECCP) 模块	147
17.0 主同步串行口 (MSSP) 模块	161
18.0 增强型通用同步 / 异步收发器 (EUSART)	205
19.0 12 位模数转换器 (A/D) 模块	227
20.0 比较器模块	237
21.0 比较器参考电压模块	243
22.0 高 / 低压检测 (HLVD)	247
23.0 CPU 的特殊功能	253
24.0 指令集汇总	271
25.0 开发支持	321
26.0 电气特性	325
27.0 直流和交流特性图表	363
28.0 封装信息	365
附录 A: 版本历史	373
附录 B: 器件差异	373
附录 C: 转换注意事项	374
附录 D: 从低档器件移植到增强型器件	374
附录 E: 从中档器件移植到增强型器件	375
附录 F: 从高档器件移植到增强型器件	375
索引	377
Microchip 网站	387
变更通知客户服务	387
客户支持	387
读者反馈表	388
PIC18F2423/2523/4423/4523 产品标识体系	389

致客户

我们旨在提供最佳文档供客户正确使用 Microchip 产品。为此，我们将不断改进出版物的内容和质量，使之更好地满足您的要求。出版物的质量将随新文档及更新版本的推出而得到提升。

如果您对本出版物有任何问题和建议，请通过电子邮件联系我公司 TRC 经理，电子邮件地址为 CTRC@microchip.com，或将本数据手册后附的《读者反馈表》传真到 86-21-5407 5066。我们期待您的反馈。

最新数据手册

欲获得本数据手册的最新版本，请查询我公司的网站：

<http://www.microchip.com>

查看数据手册中任意一页下边角处的文献编号即可确定其版本。文献编号中数字串后的字母是版本号，例如：DS30000A是DS30000的A版本。

勘误表

现有器件可能带有一份勘误表，描述了实际运行与数据手册中记载内容之间存在的细微差异以及建议的变通方法。一旦我们了解到器件 / 文档存在某些差异时，就会发布勘误表。勘误表上将注明其所适用的硅片版本和文件版本。

欲了解某一器件是否存在勘误表，请通过以下方式之一查询：

- Microchip 网站 <http://www.microchip.com>
- 当地 Microchip 销售办事处（见最后一页）

在联络销售办事处时，请说明您所使用的器件型号、硅片版本和数据手册版本（包括文献编号）。

客户通知系统

欲及时获知 Microchip 产品的最新信息，请到我公司网站 www.microchip.com 上注册。

1.0 器件概述

本文档涉及以下器件的具体信息：

- PIC18F2423
- PIC18F2523
- PIC18F4423
- PIC18F4523

该系列具备所有 PIC18 单片机固有的优点，即以实惠的价格提供出色的计算性能，以及高耐用性的增强型闪存程序存储器。除了这些优点之外，PIC18F2423/2523/4423/4523 系列还增强了器件设计，使得该系列单片机成为许多高性能以及功耗敏感应用的明智选择。

1.1 新的内核特性

1.1.1 纳瓦技术

PIC18F2423/2523/4423/4523 系列的所有器件具有一系列能显著降低工作时的功耗的功能。主要包含以下几项：

- **备用运行模式：**通过将 Timer1 或内部振荡器模块作为单片机时钟源，可使代码执行时的功耗降低大约 90%。
- **多种空闲模式：**单片机还可在其 CPU 内核禁止而外设仍然工作的情况下工作。处于这些状态时，功耗能降得更低，只有正常工作时的 4%。
- **动态模式切换：**在器件工作期间可由用户代码调用功耗管理模式，允许用户将节能的理念融入到他们的应用软件设计中。
- **关键模块低功耗：**Timer1 和看门狗定时器模块的功耗需求可降至最小。具体数值请参见第 26.0 节“电气特性”。

1.1.2 多个振荡器选项和特性

PIC18F2423/2523/4423/4523 系列的所有器件可提供 10 个不同的振荡器选项，使用户在开发应用硬件时有很大的选择范围。这些选项包括：

- 4 种晶振模式，使用晶振或陶瓷谐振器。
- 两种外部时钟模式，提供使用两个引脚（振荡器输入引脚和四分频时钟输出引脚）或一个引脚（振荡器输入引脚，四分频时钟输出引脚重新分配为通用 I/O 引脚）的选项。
- 两种外部 RC 振荡器模式，具有与外部时钟模式相同的引脚选项。
- 一个内部振荡器模块，它提供一个 8 MHz 的时钟源和一个 INTRC 时钟源（近似值为 31 kHz），并有 6 种时钟频率可供用户选择（从 125 kHz 到 4 MHz），总共 8 种时钟频率。此选项可以空出两个振荡器引脚作为额外的通用 I/O 引脚。
- 一个锁相环（PLL）倍频器，可在高速晶振和内部振荡器模式下使用，使来自 HS 时钟源的时钟速度最高达到 40 MHz。PLL 和内部振荡器配合使用，可以向用户提供频率范围从 31 kHz 到 32 MHz 的时钟速度选择，而且不需要使用外部晶振或时钟电路。

除了可用作时钟源外，内部振荡器模块还提供了一个稳定的参考源，为此系列器件增加了以下功能以使器件更可靠地工作：

- **故障保护时钟监视器：**该部件持续监视主时钟源，将其与内部振荡器提供的参考信号作比较。如果时钟发生了故障，单片机会将时钟源切换到内部振荡器模块，使器件可继续工作或安全地关闭应用。
- **双速启动：**该功能允许在上电复位或从休眠模式唤醒时将内部振荡器用作时钟源，直到主时钟源可用为止。

PIC18F2423/2523/4423/4523

1.2 其他特殊功能

- **12 位 A/D 转换器：**该模块具备可编程采集时间，从而不必在选择通道和启动转换之间等待一个采样周期，因而减少了代码开销。
- **存储器耐用性：**程序存储器和数据 EEPROM 的增强型闪存单元经评测，可以耐受数万次擦写，程序存储器高达 100,000 次，EEPROM 高达 1,000,000 次。在不刷新的情况下，数据保存时间保守地估计在 40 年以上。
- **自编程能力：**这些器件能在内部软件控制下写入各自的程序存储器空间。通过使用受保护的引导区（位于程序存储器的顶端）中的自举程序，可创建能在现场进行自我更新的应用程序。
- **扩展指令集：**PIC18F2423/2523/4423/4523 系列在 PIC18 指令集的基础上进行了可选择扩展，添加了 8 条新指令和变址寻址模式。此扩展可以使用一个器件配置选项使能，它是为优化可重用应用程序代码而特别设计的，这些代码原来是使用高级语言（如 C 语言）开发的。
- **增强型 CCP 模块：**在 PWM 模式下，该模块提供用于控制半桥或全桥驱动器的 1、2 或 4 路调制输出。其他功能包括自动关闭，用于在中断或其他条件下禁止 PWM 输出；自动重启，一旦条件清除后重新激活输出。
- **增强型可寻址 USART：**该串行通信模块可进行标准的 RS-232 通信并支持 LIN 总线协议。其他增强功能包括自动波特率检测和分辨率更高的 16 位波特率发生器。当单片机使用内部振荡器模块时，EUSART 为与外界对话的应用提供稳定的通信方式，而无需使用外部晶振也无需额外的功耗。
- **扩展型看门狗定时器 (WDT)：**该增强型版本增加了一个 16 位预分频器，可以提供在工作电压和温度变化时保持稳定的扩展超时范围。超时周期的具体数值请参见第 26.0 节“电气特性”。

1.3 系列中各成员的详细说明

PIC18F2423/2523/4423/4523 系列器件具有 28 引脚和 40/44 引脚封装形式。图 1-1 和图 1-2 分别为这两类器件的框图。

这两类器件在以下五个方面存在差异：

1. 闪存程序存储器（PIC18F2423/4423 器件为 16 KB，PIC18F2523/4523 器件为 32 KB）。
2. A/D 通道（28 引脚器件有 10 路，40/44 引脚器件有 13 路）。
3. I/O 端口（28 引脚器件有 3 个双向端口，40/44 引脚器件有 5 个双向端口）。
4. CCP 和增强型 CCP 实现（28 引脚器件有 2 个标准的 CCP 模块，40/44 引脚器件有 1 个标准的 CCP 模块和 1 个 ECCP 模块）。
5. 并行从动端口（仅存在于 40/44 引脚器件）。

本系列器件的所有其他功能都是相同的。表 1-1 总结了这些功能。

表 1-2 和表 1-3 给出了本系列中所有器件的引脚说明。

PIC18F2423/2523/4423/4523 系列器件仅提供低压器件，用“LF”表示（如 PIC18LF2423），其工作电压 V_{DD} 范围为 2.0V 到 3.6V。

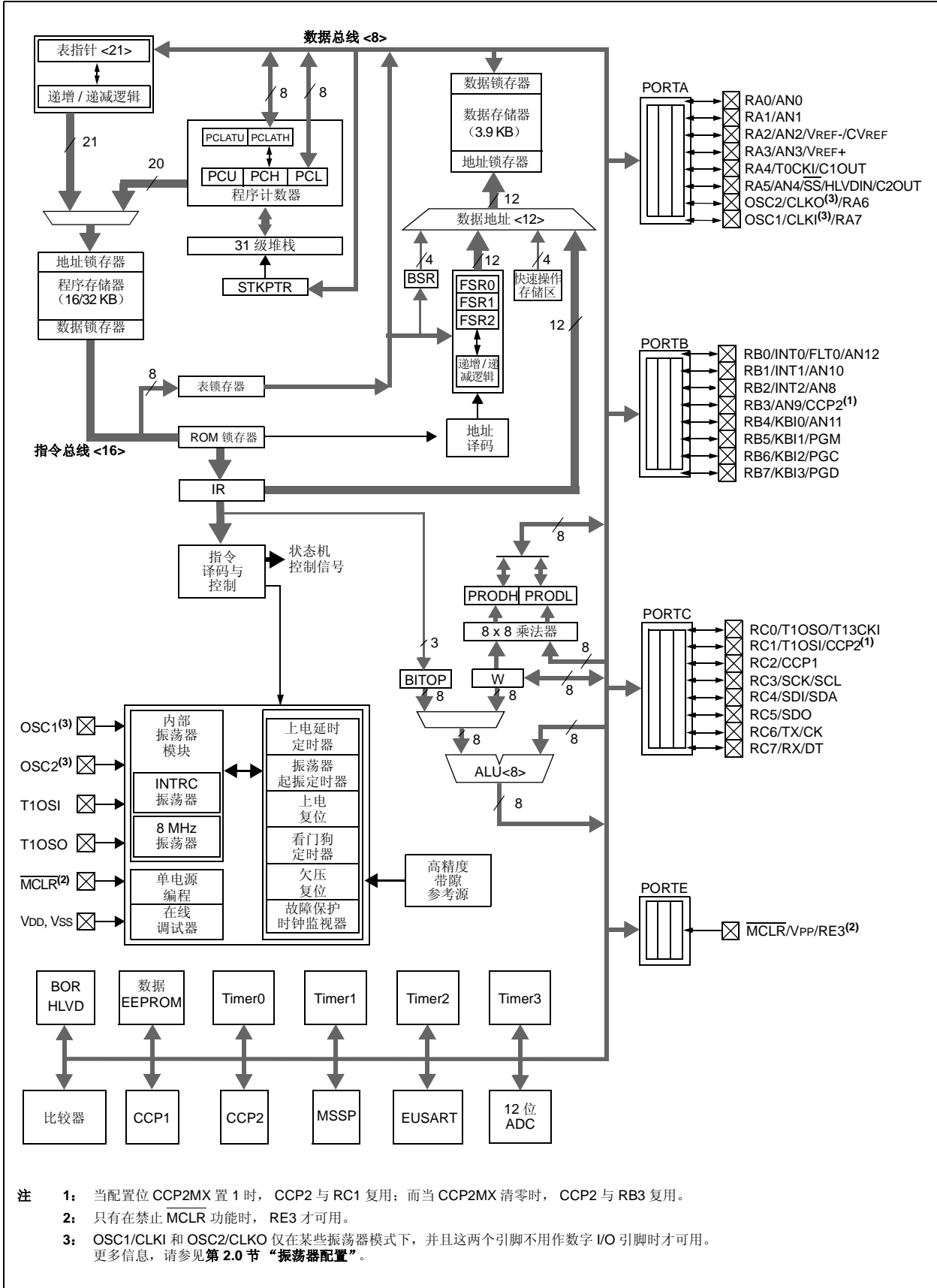
PIC18F2423/2523/4423/4523

表 1-1: 器件特性

特性	PIC18F2423	PIC18F2523	PIC18F4423	PIC18F4523
工作频率	DC – 40 MHz	DC – 40 MHz	DC – 40 MHz	DC – 40 MHz
程序存储器 (字节数)	16384	32768	16384	32768
程序存储器 (指令数)	8192	16384	8192	16384
数据存储器 (字节数)	768	1536	768	1536
数据 EEPROM 存储器 (字节数)	256	256	256	256
中断源	19	19	20	20
I/O 端口	端口 A, B, C, (E)	端口 A, B, C, (E)	端口 A, B, C, D, E	端口 A, B, C, D, E
定时器	4	4	4	4
捕捉 / 比较 / PWM 模块	2	2	1	1
增强型捕捉 / 比较 / PWM 模块	0	0	1	1
串行通信	MSSP 和增强型 USART	MSSP 和增强型 USART	MSSP 和增强型 USART	MSSP 和增强型 USART
并行通信 (PSP)	无	无	有	有
12 位模数转换模块	10 路输入通道	10 路输入通道	13 路输入通道	13 路输入通道
复位 (和延时)	POR、BOR、 RESET 指令、 堆栈满、堆栈 下溢 (PWRT 和 OST)、 MCLR (可选) 和 WDT	POR、BOR、 RESET 指令、 堆栈满、堆栈 下溢 (PWRT 和 OST)、 MCLR (可选) 和 WDT	POR、BOR、 RESET 指令、 堆栈满、堆栈 下溢 (PWRT 和 OST)、 MCLR (可选) 和 WDT	POR、BOR、 RESET 指令、 堆栈满、堆栈 下溢 (PWRT 和 OST)、 MCLR (可选) 和 WDT
可编程高 / 低压检测	有	有	有	有
可编程欠压复位	有	有	有	有
指令集	75 条指令; 使能了扩展指令集后总共为 83 条指令	75 条指令; 使能了扩展指令集后总共为 83 条指令	75 条指令; 使能了扩展指令集后总共为 83 条指令	75 条指令; 使能了扩展指令集后总共为 83 条指令
封装	28 引脚 PDIP 28 引脚 SOIC 28 引脚 QFN	28 引脚 PDIP 28 引脚 SOIC 28 引脚 QFN	40 引脚 PDIP 44 引脚 QFN 44 引脚 TQFP	40 引脚 PDIP 44 引脚 QFN 44 引脚 TQFP

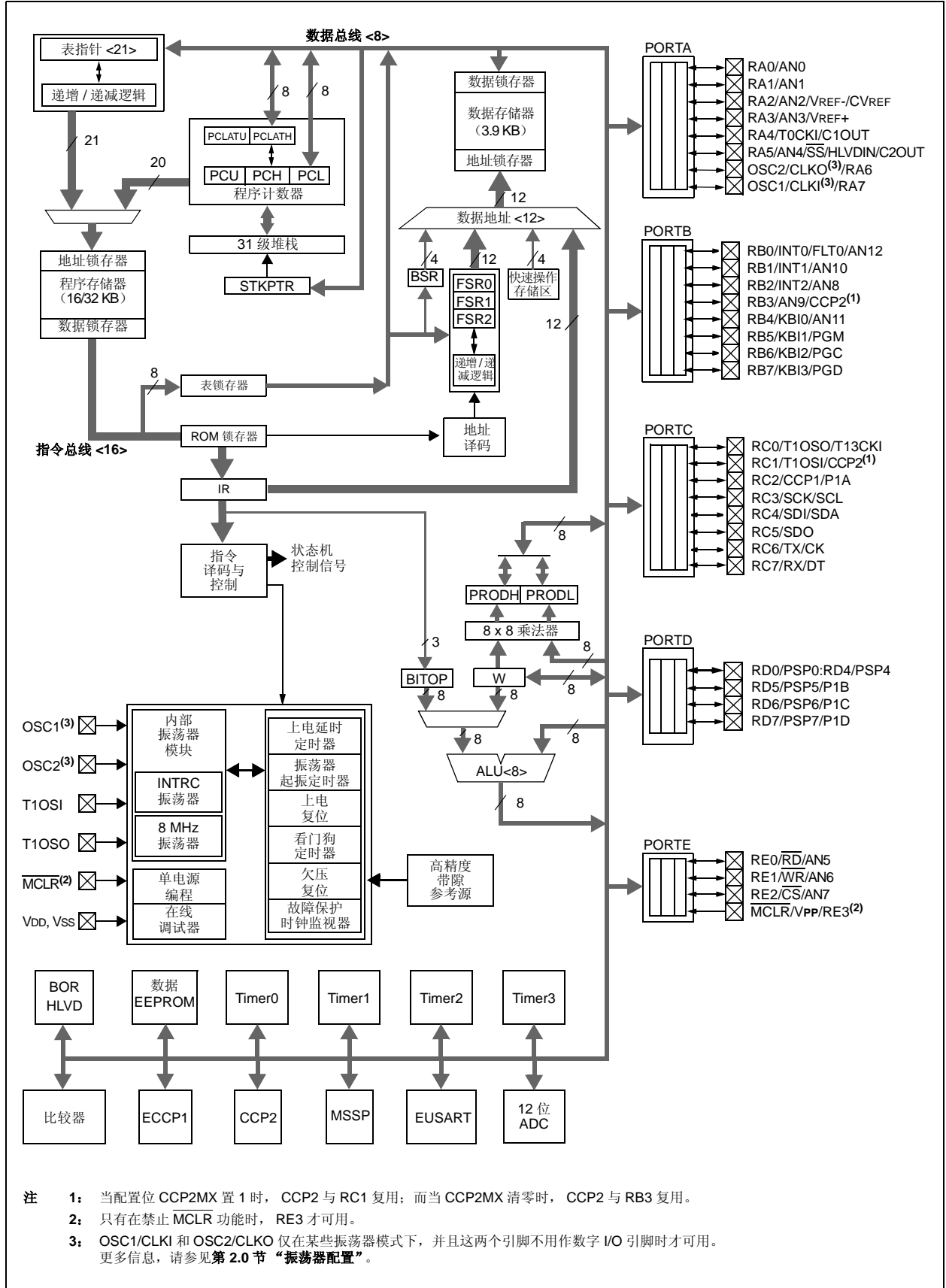
PIC18F2423/2523/4423/4523

图 1-1: PIC18F2423/2523 (28 引脚) 框图



PIC18F2423/2523/4423/4523

图 1-2: PIC18F4423/4523 (40/44 引脚) 框图



PIC18F2423/2523/4423/4523

表 1-2: PIC18F2423/2523 引脚说明

引脚名称	引脚号		引脚类型	缓冲器类型	说明
	PDIP, SOIC	QFN			
MCLR/VPP/RE3 MCLR VPP RE3	1	26	I P I	ST ST	主复位（输入）或编程电压（输入）。 主复位输入。此引脚为低电平时，器件复位。 编程电压输入。 数字输入。
OSC1/CLKI/RA7 OSC1 CLKI RA7	9	6	I I I/O	ST CMOS TTL	振荡器晶振或外部时钟输入。 振荡器晶振或外部时钟源输入。 在 RC 模式下带 ST 缓冲器，否则带 CMOS 缓冲器。 外部时钟源输入。总是与 OSC1 引脚功能复用。 （见相关的 OSC1/CLKI 和 OSC2/CLKO 引脚信息。） 通用 I/O 引脚。
OSC2/CLKO/RA6 OSC2 CLKO RA6	10	7	O O I/O	— — TTL	振荡器晶振或时钟输出。 振荡器晶振输出。在晶振模式下，该引脚与晶振或谐振器相连。 在 RC 模式下，OSC2 引脚输出 CLKO 信号，该信号是 OSC1 引脚上信号的 4 分频，该频率等于指令周期的倒数。 通用 I/O 引脚。

图注: TTL = TTL 兼容输入
ST = CMOS 电平的施密特触发器输入
O = 输出
CMOS = CMOS 兼容输入或输出
I = 输入
P = 电源

注 1: 当配置位 CCP2MX 置 1 时，对 CCP2 使用默认引脚分配。
注 2: 当配置位 CCP2MX 清零时，对 CCP2 使用备用引脚分配。

PIC18F2423/2523/4423/4523

表 1-2: PIC18F2423/2523 引脚说明 (续)

引脚名称	引脚号		引脚类型	缓冲器类型	说明
	PDIP, SOIC	QFN			
RA0/AN0 RA0 AN0	2	27	I/O I	TTL 模拟	PORTA 是双向 I/O 端口。 数字 I/O。 模拟输入 0。
RA1/AN1 RA1 AN1	3	28	I/O I	TTL 模拟	数字 I/O。 模拟输入 1。
RA2/AN2/VREF-/CVREF RA2 AN2 VREF- CVREF	4	1	I/O I I O	TTL 模拟 模拟 模拟	数字 I/O。 模拟输入 2。 A/D 参考电压 (低电压) 输入。 比较器参考电压输出。
RA3/AN3/VREF+ RA3 AN3 VREF+	5	2	I/O I I	TTL 模拟 模拟	数字 I/O。 模拟输入 3。 A/D 参考电压 (高电压) 输入。
RA4/T0CKI/C1OUT RA4 T0CKI C1OUT	6	3	I/O I O	ST ST —	数字 I/O。 Timer0 外部时钟输入。 比较器 1 的输出。
RA5/AN4/SS/HLVDIN/ C2OUT RA5 AN4 SS HLVDIN C2OUT	7	4	I/O I I I O	TTL 模拟 TTL 模拟 —	数字 I/O。 模拟输入 4。 SPI 从动选择输入。 高 / 低压检测输入。 比较器 2 的输出。
RA6					请参见 OSC2/CLKO/RA6 引脚信息。
RA7					请参见 OSC1/CLKI/RA7 引脚信息。

图注: TTL = TTL 兼容输入
ST = CMOS 电平的施密特触发器输入
O = 输出
CMOS = CMOS 兼容输入或输出
I = 输入
P = 电源

- 注 1: 当配置位 CCP2MX 置 1 时, 对 CCP2 使用默认引脚分配。
注 2: 当配置位 CCP2MX 清零时, 对 CCP2 使用备用引脚分配。

PIC18F2423/2523/4423/4523

表 1-3: PIC18F4423/4523 引脚说明

引脚名称	引脚号			引脚类型	缓冲器类型	说明
	PDIP	QFN	TQFP			
MCLR/VPP/RE3 MCLR VPP RE3	1	18	18	I P I	ST ST	主复位（输入）或编程电压（输入）。 主复位输入。此引脚为低电平时，器件复位。 编程电压输入。 数字输入。
OSC1/CLKI/RA7 OSC1 CLKI RA7	13	32	30	I I I/O	ST CMOS TTL	振荡器晶振或外部时钟输入。 振荡器晶振或外部时钟源输入。 在 RC 模式下带 ST 缓冲器，否则为模拟。 外部时钟源输入。总是与 OSC1 引脚功能复用。 （见相关的 OSC1/CLKI 和 OSC2/CLKO 引脚信息。） 通用 I/O 引脚。
OSC2/CLKO/RA6 OSC2 CLKO RA6	14	33	31	O O I/O	— — TTL	振荡器晶振或时钟输出。 振荡器晶振输出。在晶振模式下，该引脚与晶振或 谐振器相连。 在 RC 模式下，OSC2 引脚输出 CLKO 信号，该信号 是 OSC1 引脚上信号的 4 分频，该频率等于指令周期 的倒数。 通用 I/O 引脚。

图注: TTL = TTL 兼容输入
ST = CMOS 电平的施密特触发器输入
O = 输出
CMOS = CMOS 兼容输入或输出
I = 输入
P = 电源

注 1: 当配置位 CCP2MX 置 1 时，对 CCP2 使用默认引脚分配。
注 2: 当配置位 CCP2MX 清零时，对 CCP2 使用备用引脚分配。

PIC18F2423/2523/4423/4523

表 1-3: PIC18F4423/4523 引脚说明 (续)

引脚名称	引脚号			引脚类型	缓冲器类型	说明
	PDIP	QFN	TQFP			
RA0/AN0 RA0 AN0	2	19	19	I/O I	TTL 模拟	PORTA 是双向 I/O 端口。 数字 I/O。 模拟输入 0。
RA1/AN1 RA1 AN1	3	20	20	I/O I	TTL 模拟	数字 I/O。 模拟输入 1。
RA2/AN2/VREF-/CVREF RA2 AN2 VREF- CVREF	4	21	21	I/O I I O	TTL 模拟 模拟 模拟	数字 I/O。 模拟输入 2。 A/D 参考电压 (低电压) 输入。 比较器参考电压输出。
RA3/AN3/VREF+ RA3 AN3 VREF+	5	22	22	I/O I I	TTL 模拟 模拟	数字 I/O。 模拟输入 3。 A/D 参考电压 (高电压) 输入。
RA4/T0CKI/C1OUT RA4 T0CKI C1OUT	6	23	23	I/O I O	ST ST —	数字 I/O。 Timer0 外部时钟输入。 比较器 1 的输出。
RA5/AN4/ \overline{SS} /HLVDIN/ C2OUT RA5 AN4 SS HLVDIN C2OUT	7	24	24	I/O I I I O	TTL 模拟 TTL 模拟 —	数字 I/O。 模拟输入 4。 SPI 从动选择输入。 高 / 低压检测输入。 比较器 2 的输出。
RA6						请参见 OSC2/CLKO/RA6 引脚信息。
RA7						请参见 OSC1/CLKI/RA7 引脚信息。

图注: TTL = TTL 兼容输入
ST = CMOS 电平的施密特触发器输入
O = 输出
CMOS = CMOS 兼容输入或输出
I = 输入
P = 电源

- 注 1: 当配置位 CCP2MX 置 1 时, 对 CCP2 使用默认引脚分配。
注 2: 当配置位 CCP2MX 清零时, 对 CCP2 使用备用引脚分配。

PIC18F2423/2523/4423/4523

表 1-3: PIC18F4423/4523 引脚说明 (续)

引脚名称	引脚号			引脚类型	缓冲器类型	说明
	PDIP	QFN	TQFP			
RB0/INT0/FLT0/AN12 RB0 INT0 FLT0 AN12	33	9	8	I/O I I I	TTL ST ST 模拟	PORTB 是双向 I/O 端口。PORTB 在所有输入端都可软件编程为内部弱上拉。 数字 I/O。 外部中断 0。 增强型 CCP1 的 PWM 故障输入。 模拟输入 12。
RB1/INT1/AN10 RB1 INT1 AN10	34	10	9	I/O I I	TTL ST 模拟	数字 I/O。 外部中断 1。 模拟输入 10。
RB2/INT2/AN8 RB2 INT2 AN8	35	11	10	I/O I I	TTL ST 模拟	数字 I/O。 外部中断 2。 模拟输入 8。
RB3/AN9/CCP2 RB3 AN9 CCP2 ⁽¹⁾	36	12	11	I/O I I/O	TTL 模拟 ST	数字 I/O。 模拟输入 9。 捕捉 2 输入 / 比较 2 输出 / PWM 2 输出。
RB4/KBI0/AN11 RB4 KBI0 AN11	37	14	14	I/O I I	TTL TTL 模拟	数字 I/O。 电平变化中断引脚。 模拟输入 11。
RB5/KBI1/PGM RB5 KBI1 PGM	38	15	15	I/O I I/O	TTL TTL ST	数字 I/O。 电平变化中断引脚。 低电压 ICSP™ 编程使能引脚。
RB6/KBI2/PGC RB6 KBI2 PGC	39	16	16	I/O I I/O	TTL TTL ST	数字 I/O。 电平变化中断引脚。 在线调试器和 ICSP 编程时钟引脚。
RB7/KBI3/PGD RB7 KBI3 PGD	40	17	17	I/O I I/O	TTL TTL ST	数字 I/O。 电平变化中断引脚。 在线调试器和 ICSP 编程数据引脚。

图注: TTL = TTL 兼容输入
ST = CMOS 电平的施密特触发器输入
O = 输出
CMOS = CMOS 兼容输入或输出
I = 输入
P = 电源

注 1: 当配置位 CCP2MX 置 1 时, 对 CCP2 使用默认引脚分配。
注 2: 当配置位 CCP2MX 清零时, 对 CCP2 使用备用引脚分配。

PIC18F2423/2523/4423/4523

表 1-3: PIC18F4423/4523 引脚说明 (续)

引脚名称	引脚号			引脚类型	缓冲器类型	说明
	PDIP	QFN	TQFP			
RC0/T1OSO/T13CKI RC0 T1OSO T13CKI	15	34	32	I/O O I	ST — ST	PORTC 是双向 I/O 端口。 数字 I/O。 Timer1 振荡器输出。 Timer1/Timer3 外部时钟输入。
RC1/T1OSI/CCP2 RC1 T1OSI CCP2 ⁽²⁾	16	35	35	I/O I I/O	ST CMOS ST	数字 I/O。 Timer1 振荡器输入。 捕捉 2 输入 / 比较 2 输出 / PWM 2 输出。
RC2/CCP1/P1A RC2 CCP1 P1A	17	36	36	I/O I/O O	ST ST —	数字 I/O。 捕捉 1 输入 / 比较 1 输出 / PWM 1 输出。 增强型 CCP1 输出。
RC3/SCK/SCL RC3 SCK SCL	18	37	37	I/O I/O I/O	ST ST ST	数字 I/O。 SPI 模式的同步串行时钟输入 / 输出。 I ² C™ 模式的同步串行时钟输入 / 输出。
RC4/SDI/SDA RC4 SDI SDA	23	42	42	I/O I I/O	ST ST ST	数字 I/O。 SPI 数据输入。 I ² C 数据 I/O。
RC5/SDO RC5 SDO	24	43	43	I/O O	ST —	数字 I/O。 SPI 数据输出。
RC6/TX/CK RC6 TX CK	25	44	44	I/O O I/O	ST — ST	数字 I/O。 EUSART 异步发送。 EUSART 同步时钟 (见 RX/DT 引脚信息)。
RC7/RX/DT RC7 RX DT	26	1	1	I/O I I/O	ST ST ST	数字 I/O。 EUSART 异步接收。 EUSART 同步数据 (见 TX/CK 引脚信息)。

图注: TTL = TTL 兼容输入
ST = CMOS 电平的施密特触发器输入
O = 输出
CMOS = CMOS 兼容输入或输出
I = 输入
P = 电源

- 注 1: 当配置位 CCP2MX 置 1 时, 对 CCP2 使用默认引脚分配。
注 2: 当配置位 CCP2MX 清零时, 对 CCP2 使用备用引脚分配。

PIC18F2423/2523/4423/4523

表 1-3: PIC18F4423/4523 引脚说明 (续)

引脚名称	引脚号			引脚类型	缓冲器类型	说明
	PDIP	QFN	TQFP			
RD0/PSP0 RD0 PSP0	19	38	38	I/O I/O	ST TTL	PORTD 是双向 I/O 端口或与微处理器端口接口的并行从动端口 (PSP)。当使能 PSP 模块时, 这些引脚具有 TTL 输入缓冲器。 数字 I/O。 并行从动端口数据。
RD1/PSP1 RD1 PSP1	20	39	39	I/O I/O	ST TTL	数字 I/O。 并行从动端口数据。
RD2/PSP2 RD2 PSP2	21	40	40	I/O I/O	ST TTL	数字 I/O。 并行从动端口数据。
RD3/PSP3 RD3 PSP3	22	41	41	I/O I/O	ST TTL	数字 I/O。 并行从动端口数据。
RD4/PSP4 RD4 PSP4	27	2	2	I/O I/O	ST TTL	数字 I/O。 并行从动端口数据。
RD5/PSP5/P1B RD5 PSP5 P1B	28	3	3	I/O I/O O	ST TTL —	数字 I/O。 并行从动端口数据。 增强型 CCP1 输出。
RD6/PSP6/P1C RD6 PSP6 P1C	29	4	4	I/O I/O O	ST TTL —	数字 I/O。 并行从动端口数据。 增强型 CCP1 输出。
RD7/PSP7/P1D RD7 PSP7 P1D	30	5	5	I/O I/O O	ST TTL —	数字 I/O。 并行从动端口数据。 增强型 CCP1 输出。

图注: TTL = TTL 兼容输入
ST = CMOS 电平的施密特触发器输入
O = 输出
CMOS = CMOS 兼容输入或输出
I = 输入
P = 电源

- 注 1: 当配置位 CCP2MX 置 1 时, 对 CCP2 使用默认引脚分配。
注 2: 当配置位 CCP2MX 清零时, 对 CCP2 使用备用引脚分配。

PIC18F2423/2523/4423/4523

表 1-3: PIC18F4423/4523 引脚说明 (续)

引脚名称	引脚号			引脚类型	缓冲器类型	说明
	PDIP	QFN	TQFP			
RE0/ $\overline{\text{RD}}$ /AN5 RE0 RD AN5	8	25	25	I/O I I	ST TTL 模拟	PORTE 是双向 I/O 端口。 数字 I/O。 并行从动端口的读控制 (见 $\overline{\text{WR}}$ 和 $\overline{\text{CS}}$ 引脚信息)。 模拟输入 5。
RE1/ $\overline{\text{WR}}$ /AN6 RE1 WR AN6	9	26	26	I/O I I	ST TTL 模拟	数字 I/O。 并行从动端口的写控制 (见 $\overline{\text{CS}}$ 和 $\overline{\text{RD}}$ 引脚信息)。 模拟输入 6。
RE2/ $\overline{\text{CS}}$ /AN7 RE2 CS AN7	10	27	27	I/O I I	ST TTL 模拟	数字 I/O。 并行从动端口的片选控制 (见 $\overline{\text{RD}}$ 和 $\overline{\text{WR}}$ 引脚信息)。 模拟输入 7。
RE3	—	—	—	—	—	请参见 $\overline{\text{MCLR}}/\text{VPP}/\text{RE3}$ 引脚信息。
Vss	12, 31	6, 30, 31	6, 29	P	—	逻辑和 I/O 引脚的参考地。
VDD	11, 32	7, 8, 28, 29	7, 28	P	—	逻辑和 I/O 引脚的正电源。
NC	—	13	12, 13, 33, 34	—	—	无连接。

图注: TTL = TTL 兼容输入
ST = CMOS 电平的施密特触发器输入
O = 输出
CMOS = CMOS 兼容输入或输出
I = 输入
P = 电源

- 注 1: 当配置位 CCP2MX 置 1 时, 对 CCP2 使用默认引脚分配。
注 2: 当配置位 CCP2MX 清零时, 对 CCP2 使用备用引脚分配。

PIC18F2423/2523/4423/4523

注:

2.0 振荡器配置

2.1 振荡器类型

PIC18F2423/2523/4423/4523 器件可以在 10 种不同的振荡器模式下工作。通过编程配置寄存器 1H 中的配置位 FOSC3:FOSC0，用户可以选择这 10 种模式中的一种模式：

1. LP 低功耗晶振模式
2. XT 晶振 / 谐振器模式
3. HS 高速晶振 / 谐振器模式
4. HSPLL 使能 PLL 的高速晶振 / 谐振器模式
5. RC 外部电阻 / 电容振荡器模式，通过 RA6 引脚输出 Fosc/4 信号
6. RCIO 外部电阻 / 电容振荡器模式，RA6 用作 I/O 引脚
7. INTIO1 内部振荡器模式，通过 RA6 引脚输出 Fosc/4 信号，RA7 用作 I/O 引脚
8. INTIO2 内部振荡器模式，RA6 和 RA7 均用作 I/O 引脚
9. EC 带 Fosc/4 输出的外部时钟模式
10. ECIO RA6 用作 I/O 引脚的外部时钟模式

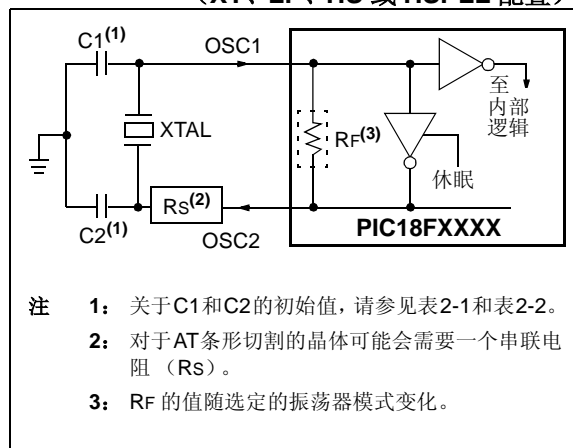
2.2 晶振 / 陶瓷谐振器

在 XT、LP、HS 或 HSPLL 振荡器模式下，晶振或陶瓷谐振器与 OSC1 和 OSC2 引脚相连来产生振荡信号。图 2-1 显示了引脚连接方式。

振荡器的设计要求使用平行切割的晶体。

注： 使用顺序切割的晶体，可能会使振荡器产生的频率超出晶体制造厂商所给出的参数范围。

图 2-1: 晶振 / 陶瓷谐振器工作原理 (XT、LP、HS 或 HSPLL 配置)



- 注**
- 1: 关于 C1 和 C2 的初始值，请参见表 2-1 和表 2-2。
 - 2: 对于 AT 条形切割的晶体可能会需要一个串联电阻 (Rs)。
 - 3: Rf 的值随选定的振荡器模式变化。

表 2-1: 陶瓷谐振器的电容选择

使用的典型电容值:			
模式	频率	OSC1	OSC2
XT	3.58 MHz	15 pF	15 pF

上述电容值仅供设计参考。

要达到理想的振荡器工作状态，可能需要不同的电容值。用户应当在应用要求的 VDD 和温度范围内测试振荡器的性能。

更多信息，请参见表 2-2 下方的“注”。

注： 如果使用的谐振器频率超过 3.6 MHz，建议使用 HS 模式而不使用 XT 模式。HS 模式可以在单片机标称的任何 VDD 电压下使用。如果选用 HS 模式，则振荡器的增益有可能过驱动谐振器。因此在 OSC2 引脚和谐振器之间应串联一个电阻。建议先尝试使用 330Ω 的 Rs。

PIC18F2423/2523/4423/4523

表 2-2: 晶振的电容选择

振荡器类型	晶振频率	已测试的典型电容值:	
		C1	C2
LP	32 kHz	18 pF	18 pF
XT	1 MHz	15 pF	15 pF
	4 MHz	15 pF	15 pF
HS	4 MHz	15 pF	15 pF
	10 MHz	15 pF	15 pF
	20 MHz	15 pF	15 pF
	25 MHz	15 pF	15 pF

上述电容值仅供设计参考。

已使用下面列出的晶振在基本的启动和运行过程中对这些电容值作了测试。这些值未经过优化。

要达到理想的振荡器工作状态，可能需要不同的电容值。用户应当在应用要求的 VDD 和温度范围内测试振荡器的性能。

更多信息，请参见本表下方的“注”。

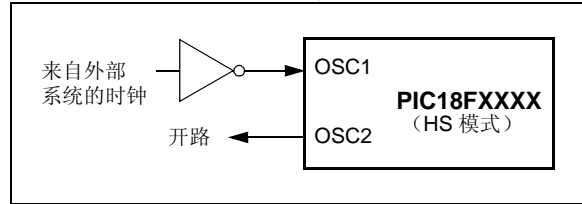
使用的晶振:

32 kHz	4 MHz
25 MHz	10 MHz
1 MHz	20 MHz

- 注 1:** 当工作电压 VDD 低于 3V，或在任何电压下使用频率高于 3.6 MHz 的陶瓷谐振器时，可能需要使用 HS 振荡器模式或切换到晶振模式。
- 2:** 因为每种谐振器 / 晶振都有其自身特性，用户应当向谐振器 / 晶振制造厂商询问外部元件的适当值。
- 3:** 可能需要使用 Rs 以避免对音叉式晶振造成过驱动，例如在 LP 模式下常用的晶振或 Timer1 振荡器。Rs 也可用于在其他模式下降低晶振驱动，在这些模式下，波形失真可能成为一个问题。请参见 AN949, “Making Your Oscillator Work”。
- 4:** 请始终在应用要求的 VDD 和温度范围下验证振荡器性能。关于测试方法，请参见 AN949, “Making Your Oscillator Work”。

如图 2-2 所示，在 HS 模式下，OSC1 引脚也可以连接外部时钟源。

图 2-2: 外部时钟输入工作原理 (HS 振荡器配置)

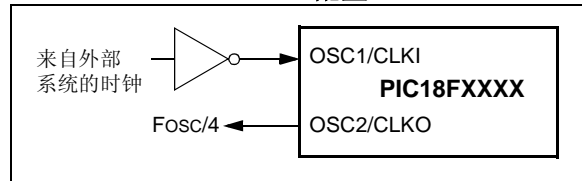


2.3 外部时钟输入

EC 和 ECIO 振荡器模式要求 OSC1 引脚与一个外部时钟源相连。在上电复位后或从休眠模式退出后，不需要振荡器起振时间。

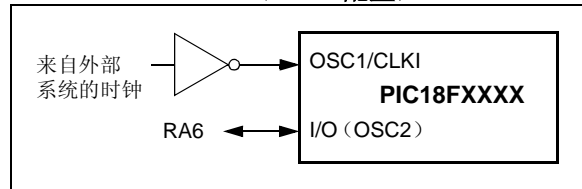
在 EC 振荡器模式下，由 OSC2 引脚输出振荡器频率的 4 分频信号。此信号可用于测试或同步其他逻辑。图 2-3 显示了 EC 振荡器模式的引脚连接方式。

图 2-3: 外部时钟输入工作原理 (EC 配置)



ECIO 振荡器模式的工作方式类似于 EC 模式，不同之处在于 OSC2 引脚变成了一个额外的通用 I/O 引脚。该 I/O 引脚成为 PORTA 的 bit 6 (RA6)。图 2-4 显示了 ECIO 振荡器模式下的引脚连接方式。

图 2-4: 外部时钟输入工作原理 (ECIO 配置)



2.4 RC 振荡器

对于对时序要求不高的应用，适当选择 RC 和 RCIO 器件能更好地节约成本。实际的振荡器频率由以下几个因素决定：

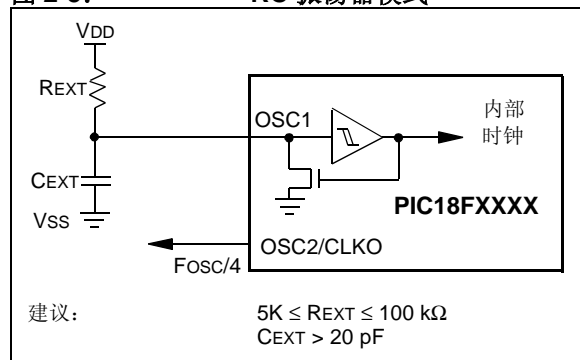
- 供电电压
- 外部电阻 (REXT) 和电容 (CEXT) 的值
- 工作温度

给定同样的器件、工作电压和温度以及元件值，振荡的频率仍然会各不相同。这些频率上的差异是由以下因素引起的：

- 正常生产工艺的差异
- 不同封装类型引线电容的不同（尤其当 CEXT 值较小时）
- REXT 和 CEXT 在容限范围内的数值波动

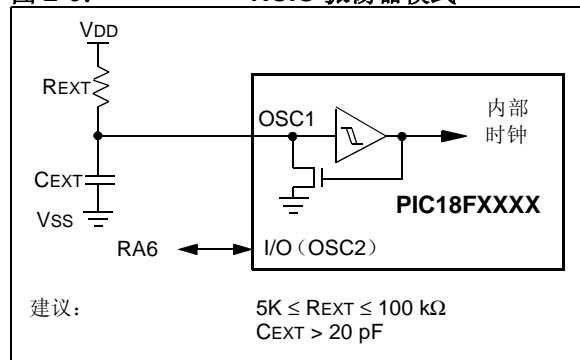
在 RC 振荡器模式下，由 OSC2 引脚输出振荡器频率的 4 分频信号。此信号可用于测试或同步其他逻辑。图 2-5 显示了外接 R/C 组合电路的连接方式。

图 2-5: RC 振荡器模式



RCIO 振荡器模式（图 2-6）的工作方式类似于 RC 模式，不同之处在于 OSC2 引脚变成了一个额外的通用 I/O 引脚。该 I/O 引脚成为 PORTA 的 bit 6 (RA6)。

图 2-6: RCIO 振荡器模式



2.5 PLL 倍频器

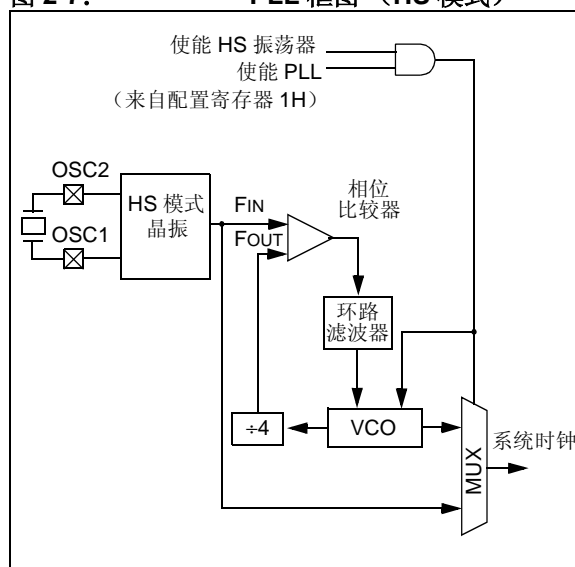
如果用户希望使用低频振荡电路或通过晶振将器件频率调节至其最高额定频率，可以选择使用锁相环 (PLL) 电路。对于担心高频晶振引起 EMI 或需要内部振荡器提供高速时钟的用户而言，这样做可能有用。

2.5.1 HSPLL 振荡器模式

HSPLL 模式使用 HS 模式振荡器产生最高 10 MHz 的频率。然后 PLL 将振荡器输出频率 4 倍频，从而产生最高 40 MHz 的内部时钟频率。PLLEN 位在此振荡器模式下不可用。

仅当将 FOSC3:FOSC0 配置位编程为 HSPLL 模式 (= 0110) 时，晶振才可以使用 PLL。

图 2-7: PLL 框图 (HS 模式)



2.5.2 PLL 和 INTOSC

当 INTOSC 配置为主时钟源时，内部振荡器模块也可以使用 PLL。在此配置下，用软件使能 PLL 并产生最高为 32 MHz 的时钟输出。第 2.6.4 节“INTOSC 模式下的 PLL”描述了使用 PLL 的 INTOSC 的工作原理。

PIC18F2423/2523/4423/4523

2.6 内部振荡器模块

PIC18F2423/2523/4423/4523 器件含有可产生两种不同时钟信号的内部振荡器模块。这两种信号均可充当单片机的时钟源，从而无需在 OSC1 和 / 或 OSC2 引脚上使用外部振荡电路。

主输出 (INTOSC) 是一个 8 MHz 的时钟源，可以用于直接驱动器件时钟。它还可以驱动一个后分频器，该分频器可提供从 31 kHz 到 4 MHz 的时钟频率。当选择了 125 kHz 到 8 MHz 的时钟频率时，使能 INTOSC 输出，如果需要，还可提供 31 kHz。

另一个时钟源是内部 RC 振荡器 (INTRC)，它提供了标称值为 31 kHz 的输出。如果选择 INTRC 作为器件的时钟源，它就会被使能；当使能以下任一功能时，也将自动使能 INTRC：

- 上电延时定时器
- 故障保护时钟监视器
- 看门狗定时器

第 23.0 节 “CPU 的特殊功能” 将详细讨论以上功能。

通过配置 OSCCON 寄存器 (第 30 页) 的 IRCF 位，可以选择时钟源频率 (INTOSC 直接频率、INTRC 直接频率或 INTOSC 后分频器频率)。此外，31 kHz 时钟可以由 INTOSC 或 INTRC 时钟源提供，取决于 INTSRC 位 (OSCTUNE<7>)。

2.6.1 INTIO 模式

使用内部振荡器作为时钟源可以不需要使用两个外部振荡器引脚，从而可将它们用作数字 I/O。目前有两种不同的配置：

- 在 INTIO1 模式下，OSC2 引脚输出 $F_{osc}/4$ ，而 OSC1 引脚充当 RA7，用于数字输入和输出。
- 在 INTIO2 模式下，OSC1 充当 RA7，OSC2 充当 RA6，两者都用于数字输入和输出。

2.6.2 INTOSC 输出频率

出厂时已校准了内部振荡器模块使之能够产生 8.0 MHz 的 INTOSC 输出频率。

INTRC 振荡器的工作独立于 INTOSC 时钟源。电压和温度变化导致的 INTOSC 变化并不一定会使 INTRC 变化，反之亦然。

2.6.3 OSCTUNE 寄存器

内部振荡器的输出已在出厂前经过校准，但仍可以在用户应用中调整。这是通过写 OSCTUNE 寄存器 (寄存器 2-1) 完成的。

当修改了 OSCTUNE 寄存器后，INTOSC 的频率将改变为新的频率。INTOSC 时钟会在 1 ms 内稳定下来。在频率改变期间，代码会继续执行。不会有任何迹象表明时钟频率发生了改变。

OSCTUNE 寄存器也有 INTSRC 和 PLEN 位，它们控制内部振荡器模块的某些功能。当选择了 31 kHz 频率后，用户可通过 INTSRC 位选择用作时钟源的内部振荡器。在 **第 2.7.1 节 “振荡器控制寄存器”** 中对此进行了更详细的说明。

在内部振荡器模式下，PLEN 位控制 PLL 倍频器的工作。

2.6.4 INTOSC 模式下的 PLL

内部振荡器模块可以通过使用 4x 倍频器来产生比一般内部振荡器所能产生的时钟速度更快的器件时钟速度。当使能时，PLL 最高可产生 32 MHz 的时钟速度。

与 HSPLL 模式不同，PLL 由软件控制。控制位 PLEN (OSCTUNE<6>) 用来使能或禁止其工作。

在以下情况下，PLL 可以与 INTOSC 配合使用：

1. 主时钟为 INTOSC 时钟源 (在 CONFIG1H<3:0> 中选取)，以及
2. 选择 4 或 8 MHz INTOSC 输出。

只有当上述两个条件都满足时，才能写入 PLEN 位。

2.6.5 INTOSC 频率漂移

出厂时将内部振荡器模块的输出 (INTOSC) 校准为 8 MHz。但是，此频率可能会随着 V_{DD} 电压或温度的改变而发生漂移，这一点可能会以各种方式影响控制器的运行。通过修改 OSCTUNE 寄存器的值可以调节 INTOSC 的频率。这不会对 INTRC 时钟源的频率造成影响。

调节 INTOSC 时钟源需要了解何时调节、调节的方向以及在某些情况下的调整量。**第 2.6.5.1 节 “用 EUSART 进行补偿”**、**第 2.6.5.2 节 “用定时器进行补偿”** 和 **第 2.6.5.3 节 “在捕捉模式下用 CCP 模块进行补偿”** 讨论了三种补偿技术，但是也可使用其他技术。

PIC18F2423/2523/4423/4523

2.7 时钟源与振荡器切换

与早期的PIC18器件一样，PIC18F2423/2523/4423/4523系列包含允许将器件时钟源从主振荡器切换到备用低频时钟源的功能。PIC18F2423/2523/4423/4523器件提供了两个备用时钟源。当使能备用时钟源时，可以使用多种功耗管理工作模式。

基本上，这些器件都有3种时钟源：

- 主振荡器
- 辅助振荡器
- 内部振荡器模块

主振荡器包括外部晶振和谐振器模式、外部RC模式、外部时钟模式和内部振荡器模块。特定的模式由FOSC3:FOSC0配置位定义。这些模式的详细信息已在本章前面的内容中作过介绍。

辅助振荡器是指那些不与OSC1或OSC2引脚连接的外部时钟源。即使在控制器处于功耗管理模式时这些时钟源仍可继续工作。

PIC18F2423/2523/4423/4523器件将Timer1振荡器作为辅助振荡器。此振荡器（在所有功耗管理模式中）通常是实时时钟等功能的时基。

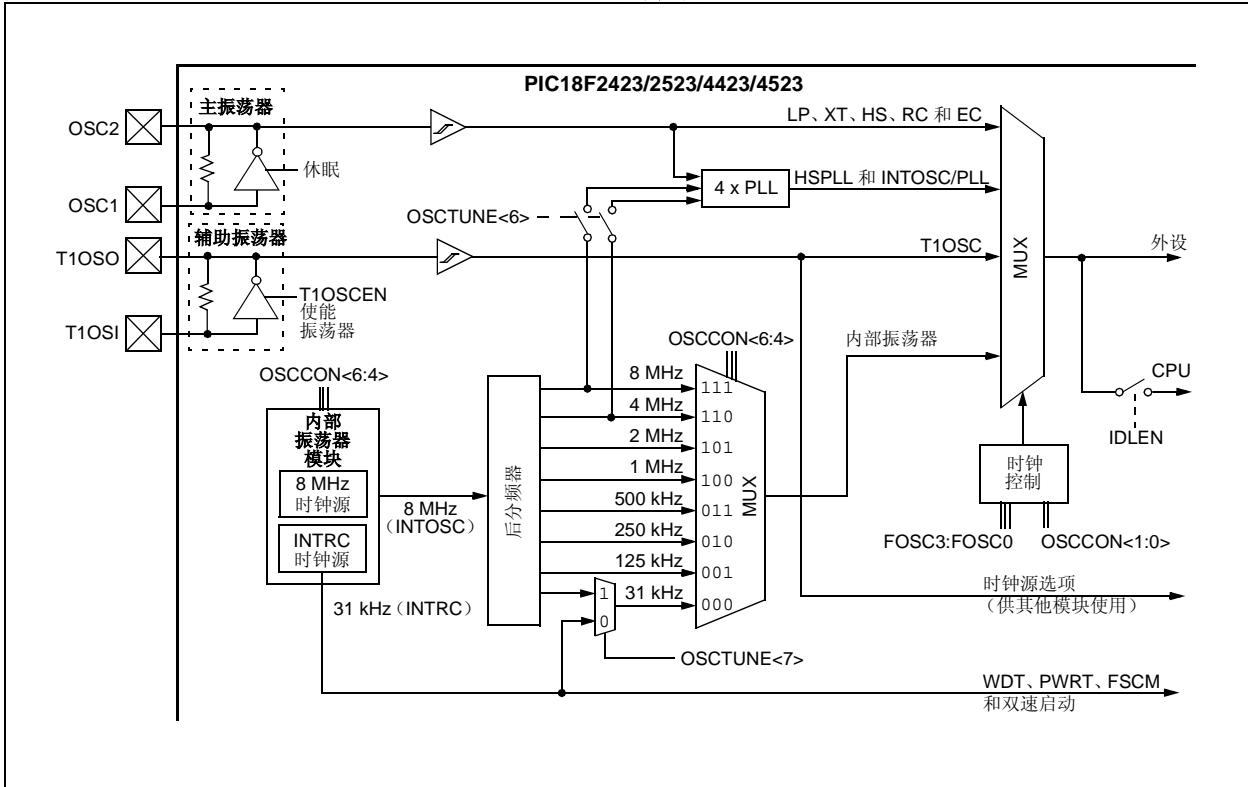
大部分情况下，在RC0/T1OSO/T13CKI和RC1/T1OSI引脚之间接有一个32.768 kHz的时钟晶振。与LP模式振荡电路类似，在每个引脚与地之间均接有负载电容。

将在第12.3节“Timer1振荡器”中详细讨论Timer1振荡器。

除了作为主时钟源之外，**内部振荡器模块**还可以作为功耗管理模式的时钟源。INTRC源也可作为几种特殊功能部件（例如WDT和故障保护时钟监视器）的时钟源。

图2-8显示了PIC18F2423/2523/4423/4523器件的时钟源。关于配置寄存器的详细信息，请参见第23.0节“CPU的特殊功能”。

图 2-8: PIC18F2423/2523/4423/4523 时钟框图



2.7.1 振荡器控制寄存器

OSCCON 寄存器（寄存器 2-2）控制全功耗模式和功耗管理模式下器件时钟工作的多个方面。

系统时钟选择位 SCS1:SCS0 用于选择时钟源。可用的时钟源包括主时钟（由 FOSC3:FOSC0 配置位定义）、辅助时钟（Timer1 振荡器）和内部振荡器模块。当写入一个或多个位之后，接着是一段很短的时钟转换间隔，然后时钟源会立即改变。在所有形式的复位中 SCS 位都会被清零。

内部振荡器频率选择位（IRCF2:IRCF0）选择内部振荡器模块的输出频率来驱动器件时钟。这些频率可以是 INTRC 时钟源的频率、INTOSC 时钟源的频率（8 MHz）或 INTOSC 后分频器产生的频率之一（31.25 kHz 到 4 MHz）。如果器件时钟由内部振荡器模块提供，改变这些位的状态会使内部振荡器输出立即改变。器件复位时，内部振荡器模块的默认输出频率设置为 1 MHz。

当选定了 31 kHz 的标称输出频率（IRCF2:IRCF0 = 000）时，用户可以选择用作时钟源的内部振荡器。这通过 OSCTUNE 寄存器中的 INTSRC 位（OSCTUNE<7>）完成。将该位置 1 选择 INTOSC 作为时钟源，并通过使能 INTOSC 后分频器的 256 分频输出，使该时钟源输出 31.25 kHz 的时钟信号。将 INTSRC 位清零选择 INTRC（标称值为 31 kHz）作为时钟源，同时禁止 INTOSC 时钟源。

此选项使用户能选择可调节且更精确的 INTOSC 作为时钟源，同时以非常低的时钟速度运行以节省功耗。无论 INTSRC 的设置如何，INTRC 总是作为看门狗定时器和故障保护时钟监视器之类功能部件的时钟源。

OSTS、IOFS 和 T1RUN 位指出当前提供器件时钟的是哪一个时钟源。OSTS 位置 1 表明振荡器起振定时器已超时且主时钟在主时钟模式下作为器件时钟。IOFS 位置 1 表明内部振荡器模块已稳定并在 RC 时钟模式下提供器件时钟。T1RUN 位（T1CON<6>）置 1 表明 Timer1 振荡器正在辅助时钟模式下提供器件时钟。在功耗管理模式下，任何时候这 3 个位中只有一个会置 1。如果这些位都没有置 1，则表示当前时钟源是 INTRC，或 INTOSC 刚刚起振且尚未稳定。

IDLEN 位决定当执行 SLEEP 指令时器件是进入休眠模式还是某个空闲模式。

第 3.0 节“功耗管理模式”更详细地讨论了 OSCCON 寄存器中标志位和控制位的使用。

注 1: 要选择辅助时钟源，必须使能 Timer1 振荡器。通过将 Timer1 控制寄存器中的 T1OSCEN 位（T1CON<3>）置 1，可以使能 Timer1 振荡器。如果未使能 Timer1 振荡器，则选择辅助时钟源的任何尝试都会被忽略。

2: 建议在 Timer1 振荡器稳定工作之后再选择辅助时钟，否则当 Timer1 振荡器起振时可能会发生很长的延时。

2.7.2 振荡器转换

PIC18F2423/2523/4423/4523 器件包含了防止在切换时钟源时发生时钟“毛刺”的电路。在切换时钟时，器件时钟会有短暂的停顿。该停顿的时间长度是旧时钟源的两个周期加上新时钟源的三到四个周期的和。此公式假设新时钟源是稳定的。

第 3.1.2 节“进入功耗管理模式”详细讨论了时钟转换。

PIC18F2423/2523/4423/4523

寄存器 2-2: **OSCCON: 振荡器控制寄存器**

R/W-0	R/W-1	R/W-0	R/W-0	R ⁽¹⁾	R-0	R/W-0	R/W-0
IDLEN	IRCF2	IRCF1	IRCF0	OSTS	IOFS	SCS1	SCS0
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位 W = 可写位 U = 未实现位, 读为 0
-n = POR 值 1 = 置 1 0 = 清零 x = 未知

- bit 7 **IDLEN:** 空闲使能位
1 = 执行 SLEEP 指令后器件进入空闲模式
0 = 执行 SLEEP 指令后器件进入休眠模式
- bit 6-4 **IRCF2:IRCF0:** 内部振荡器频率选择位
111 = 8 MHz (由 INTOSC 直接驱动时钟)
110 = 4 MHz
101 = 2 MHz
100 = 1 MHz⁽³⁾
011 = 500 kHz
010 = 250 kHz
001 = 125 kHz
000 = 31 kHz (来自 INTOSC/256 或直接来自 INTRC) ⁽²⁾
- bit 3 **OSTS:** 振荡器起振延时状态位 ⁽¹⁾
1 = 振荡器起振定时器延时已结束; 主振荡器正在运行
0 = 振荡器起振定时器延时正在进行; 主振荡器尚未就绪
- bit 2 **IOFS:** INTOSC 频率稳定位
1 = INTOSC 频率已稳定
0 = INTOSC 频率尚未稳定
- bit 1-0 **SCS1:SCS0:** 系统时钟选择位
1x = 内部振荡器模块
01 = 辅助 (Timer1) 振荡器
00 = 主振荡器

- 注 1: 复位状态取决于 IESO 配置位的状态。
 2: 时钟源由 INTSRC 位 (OSCTUNE<7>) 选择, 请参见上文。
 3: 复位时 INTOSC 的默认输出频率。

2.8 功耗管理模式对各种时钟源的影响

当选定了 PRI_IDLE 模式后，指定的主振荡器会继续运行而不中断。对于所有其他功耗管理模式，使用 OSC1 引脚的振荡器会被禁止。OSC1 引脚（以及由振荡器使用的 OSC2 引脚）将会停止振荡。

在辅助时钟模式下（SEC_RUN 和 SEC_IDLE），Timer1 振荡器作为器件时钟源工作。如果需要，Timer1 振荡器也可以运行在所有功耗管理模式下为 Timer1 或 Timer3 提供时钟。

在内部振荡器模式下（RC_RUN 和 RC_IDLE），由内部振荡器模块提供器件时钟。无论是哪种功耗管理模式，31 kHz 的 INTRC 输出均可被直接用来提供时钟并且可使能来支持多种特殊的功能部件（关于 WDT、故障保护时钟监视器和双速启动的更多信息，请参见第 23.2 节“看门狗定时器（WDT）”、第 23.3 节“双速启动”和第 23.4 节“故障保护时钟监视器”）。8 MHz 的 INTOSC 输出可以直接用于为器件提供时钟，或者也可先由后分频器进行分频再用作器件时钟。如果直接由 INTRC 输出提供时钟，则会禁止 INTOSC 输出。

如果选择了休眠模式，所有的时钟源都会被停止。因为休眠模式消除了所有晶体管的开关电流，休眠模式能实现最小的器件电流消耗（仅泄漏电流）。

在休眠期间使能任何片上功能都将增加休眠时的电流消耗。要支持 WDT 工作，需要使能 INTRC。Timer1 振荡器可以用来为实时时钟提供时钟源。不需要器件时钟源

的其他功能部件也可以工作（即，MSSP 从器件、PSP、INTn 引脚等）。在第 26.2 节“直流特性：掉电和供电电流”中列出了可能显著增加电流消耗的外设。

2.9 上电延时

由两个定时器控制上电延时，这样大多数应用都无需外接复位电路。上电延时可以确保在器件电源稳定（常规环境下）和主时钟稳定工作之前器件保持在复位状态。关于上电延时的更多信息，请参见第 4.5 节“器件复位定时器”。

第一个定时器是上电延时定时器（PWRT），在上电时它提供了固定的延迟时间（表 26-10 中的参数 33）。通过清零（= 0）PWRTEN 配置位可使能它。

第二个定时器是振荡器起振定时器（OST），用于在晶振稳定前使芯片保持在复位状态（LP、XT 和 HS 模式）。OST 在计数 1024 个振荡周期后允许振荡器为器件提供时钟。

当选定 HSPLL 振荡器模式时，器件将在 HS 模式下的 OST 延时之后另外再保持 2 ms 的复位状态，这样可使 PLL 锁定为输入时钟频率。

POR 之后有一个 TcSD 间隔的延时（表 26-10 中的参数 38），在此延时期间控制器为执行指令做好了准备。此延时与其他延时同时发生。当将 EC、RC 或 INTIO 模式之一用作主时钟源时，这可能是唯一的延时。

表 2-3: 休眠模式下 OSC1 和 OSC2 引脚的状态

振荡器模式	OSC1 引脚	OSC2 引脚
RC 和 INTIO1	悬空，应经外部电阻上拉为高电平	处于逻辑低电平（时钟 4 分频输出）
RCIO	悬空，应经外部电阻上拉为高电平	配置为 PORTA 的 bit 6
INTIO2	配置为 PORTA 的 bit 7	配置为 PORTA 的 bit 6
ECIO	悬空，连接外部时钟源	配置为 PORTA 的 bit 6
EC	悬空，连接外部时钟源	处于逻辑低电平（时钟 4 分频输出）
LP、XT 和 HS	反馈反相器被禁止，处于静止电平	反馈反相器被禁止，处于静止电平

注：关于由休眠和 MCLR 复位引起的延时，请参见第 4.0 节“复位”中的表 4-2。

PIC18F2423/2523/4423/4523

注:

3.0 功耗管理模式

PIC18F2423/2523/4423/4523 器件总共提供 7 种工作模式，可以更高效地进行功耗管理。这些工作模式提供了多种选择，可在资源受限的应用（即，电池供电的设备）中节省功耗。

功耗管理模式有三种类别：

- 运行模式
- 空闲模式
- 休眠模式

这些类别定义了需要为器件的哪些部分提供时钟，有时还需要定义时钟的速度。运行和空闲模式可以使用三种时钟源（主时钟源、辅助时钟源或内部振荡器）中的任意一种；而休眠模式则不使用时钟源。

功耗管理模式包括几个由早期的 PIC[®] 器件提供的节省功耗的功能。其中之一就是其他 PIC18 器件也提供的时钟切换功能，该功能允许使用 Timer1 振荡器代替主振荡器。节省功耗的功能还包括所有 PIC 器件都提供的休眠模式，在该模式下，器件所有的时钟都停止。

3.1 选择功耗管理模式

选择功耗管理模式之前需要先做出两个决定：是否为 CPU 提供时钟源以及选择何种时钟源。IDLEN 位（OSCCON<7>）控制是否为 CPU 提供时钟源，而 SCS1:SCS0 位（OSCCON<1:0>）选择时钟源。表 3-1 总结了各个模式下的位设置、时钟源和受影响的模块。

表 3-1: 功耗管理模式

模式	OSCCON 位		模块时钟		可用时钟和振荡器源
	IDLEN ⁽¹⁾	SCS1:SCS0<1:0>	CPU	外设	
休眠	0	N/A	关闭	关闭	无——所有时钟被禁止
PRI_RUN	N/A	00	提供时钟	提供时钟	主时钟——LP、XT、HS、HSPLL、RC、EC 和内部振荡器模块 ⁽²⁾ 。 这是正常的全功耗执行模式。
SEC_RUN	N/A	01	提供时钟	提供时钟	辅助时钟——Timer1 振荡器
RC_RUN	N/A	1x	提供时钟	提供时钟	内部振荡器模块 ⁽²⁾
PRI_IDLE	1	00	关闭	提供时钟	主时钟——LP、XT、HS、HSPLL、RC 和 EC
SEC_IDLE	1	01	关闭	提供时钟	辅助时钟——Timer1 振荡器
RC_IDLE	1	1x	关闭	提供时钟	内部振荡器模块 ⁽²⁾

注 1: 当执行 SLEEP 时，IDLEN 的值得到反映。

2: 包含 INTOSC 和 INTOSC 后分频器以及 INTRC 时钟源。

3.1.1 时钟源

SCS1:SCS0 位允许为功耗管理模式在三个时钟源中任选其一。它们是：

- 主时钟，由 FOSC3:FOSC0 配置位定义
- 辅助时钟（Timer1 振荡器）
- 内部振荡器模块（用于 RC 模式）

3.1.2 进入功耗管理模式

可以通过装载 OSCCON 寄存器从一种功耗管理模式切换到另一种功耗管理模式。SCS1:SCS0 位选择要使用的时钟源。更改这些位会导致立即切换到一个新的时钟源（假定新时钟源正在运行）。此切换可能会引起时钟转换延时。第 3.1.3 节“时钟转换和状态指示”及其后续章节将会讨论这些问题。

执行 SLEEP 指令可以触发进入功耗管理空闲模式或休眠模式。最后实际进入哪个模式由 IDLEN 位的状态决定。

更改功耗管理模式并不总是要求设置所有的位，而是取决于当前的模式和将要切换到的模式。通过在发出 SLEEP 指令之前更改振荡器选择位或更改 IDLEN 位可完成多种模式转换。如果已经正确配置了 IDLEN 位，可能只需执行 SLEEP 指令就可实现模式切换。

PIC18F2423/2523/4423/4523

3.1.3 时钟转换和状态指示

在两个时钟源之间进行转换所需的时间长度是旧时钟源的两个周期与新时钟源的三到四个周期的和。此公式假设新时钟源是稳定的。

以下三位用于指明当前的时钟源及其状态。它们是：

- OSTS (OSCCON<3>)
- IOFS (OSCCON<2>)
- T1RUN (T1CON<6>)

一般来说，在一个给定的功耗管理模式中，这三个位中只有一个位会置 1。当 OSTS 位置 1 时，表明由主时钟提供器件时钟。当 IOFS 位置 1 时，表明由 INTOSC 输出提供稳定的 8 MHz 的时钟源到分频器，实际上由分频器驱动器件时钟。当 T1RUN 位置 1 时，表明由 Timer1 振荡器提供时钟源。如果这些位均不置 1，则表明要么由 INTRC 时钟源为器件提供时钟信号，要么 INTRC 时钟源尚未稳定。

如果用 FOSC3:FOSC0 配置位将内部振荡器模块配置为主时钟源，则在 PRI_RUN 或 PRI_IDLE 模式中，OSTS 和 IOFS 位可能同时置 1。这表示主时钟 (INTOSC 输出) 正在产生稳定的 8 MHz 输出。进入工作频率相同的另一个功耗管理 RC 模式将清零 OSTS 位。

注 1: 在仅修改 IRCF 位时应该特别小心。如果 VDD 电压小于 3V，可以选择比低 VDD 电压所能支持的时钟速度更高的速度。违反 VDD/FOSC 规范会导致器件运行不正常 (见图 26-1 和图 26-2)。

2: 执行 SLEEP 指令并不一定会将器件置于休眠模式。它只是作为触发条件，让器件进入休眠模式或一种空闲模式，具体何种模式由 IDLEN 位的设置决定。

3.1.4 多条 SLEEP 命令

使用 SLEEP 指令调用功耗管理模式时，具体进入何种模式由该指令执行时 IDLEN 位的设置决定。如果执行了另一条 SLEEP 指令，器件将进入由此时 IDLEN 位指定的功耗管理模式。如果 IDLEN 位已更改，器件将进入由新的设置指定的新的功耗管理模式。进入和退出空闲模式不会影响 IDLEN 位的状态。

3.2 运行模式

在运行模式中，内核和外设的时钟都是激活的。这些运行模式之间的区别就在于时钟源的不同。

3.2.1 PRI_RUN 模式

PRI_RUN 模式是单片机的正常全功耗执行模式。除非使能了双速启动 (详细信息，请参见第 23.3 节“双速启动”)，该模式也是器件复位后的默认模式。在此模式下，OSTS 位置 1。如果内部振荡器模块为主时钟源，IOFS 位也可能置 1 (见第 2.7.1 节“振荡器控制寄存器”)。

3.2.2 SEC_RUN 模式

SEC_RUN 模式与其他 PIC18 器件提供的“时钟切换”功能兼容。在此模式下，CPU 和外设将 Timer1 振荡器作为时钟源。这允许用户在使用高精度时钟源的情况下仍可获得较低的功耗。

通过将 SCS1:SCS0 位置为 01 进入 SEC_RUN 模式。器件时钟源被切换到 Timer1 振荡器 (见图 3-1)，主振荡器被关闭，T1RUN 位 (T1CON<6>) 被置 1 并且 OSTS 位被清零。

注: Timer1 振荡器应该在进入 SEC_RUN 模式之前就已经运行了。如果在 SCS1:SCS0 位被置为 01 时 T1OSCEN 位没有置 1，就不会进入 SEC_RUN 模式。如果 Timer1 振荡器已经被使能，但没有开始运行，器件时钟将会延时直到该振荡器起振。在这种情况下，最初的振荡器运行很不稳定，可能会导致无法预料的结果。

在从 SEC_RUN 模式转换到 PRI_RUN 模式期间，外设和 CPU 继续使用 Timer1 振荡器作为时钟源，直到主时钟启动。当主时钟准备好以后，时钟切换回主时钟 (见图 3-2)。当时钟切换完成后，T1RUN 位被清零，OSTS 位被置 1 并且由主时钟提供器件时钟。这种唤醒不会影响 IDLEN 和 SCS 位。Timer1 振荡器继续运行。

图 3-1: 进入 SEC_RUN 模式的转换时序

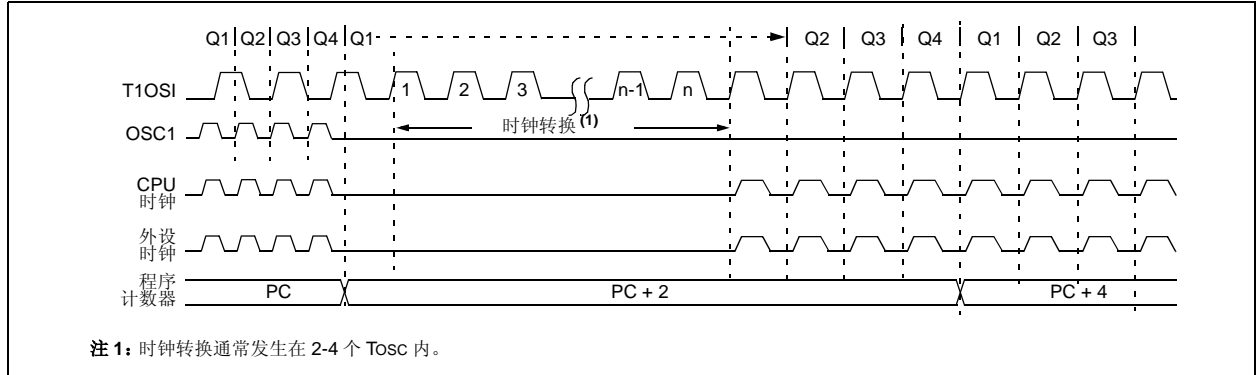
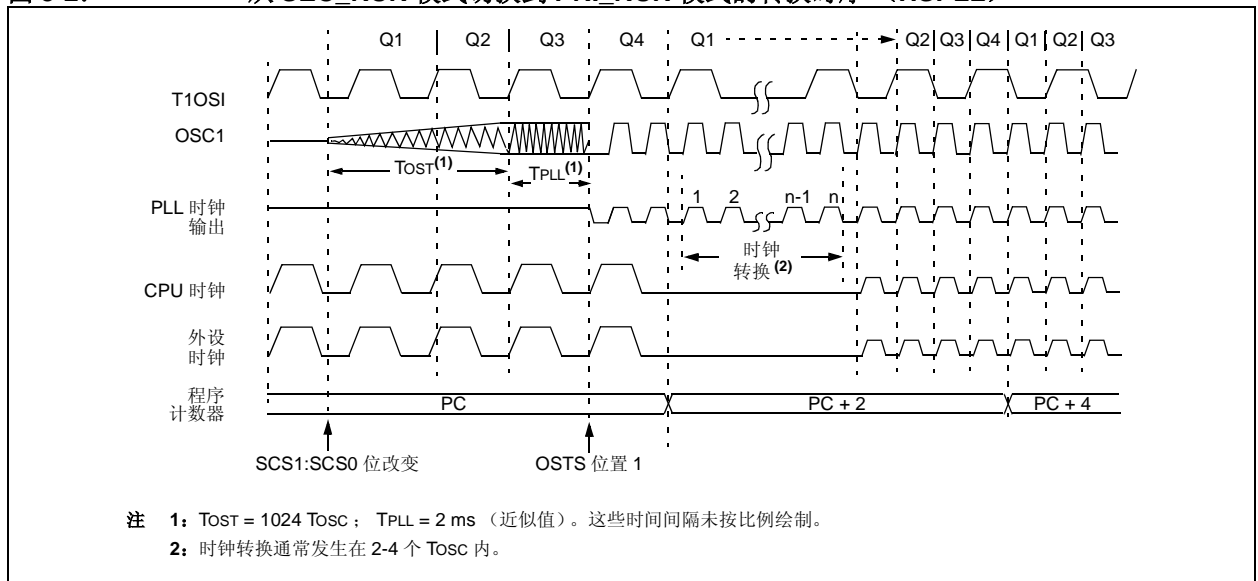


图 3-2: 从 SEC_RUN 模式切换到 PRI_RUN 模式的转换时序 (HSPLL)



3.2.3 RC_RUN 模式

在 RC_RUN 模式下，内部振荡器模块使用 INTOSC 多路开关的输出作为 CPU 和外设的时钟源。在此模式下，主时钟关闭。在使用 INTRC 时钟源时，此模式是在代码执行期间所有运行模式中最节省功耗的运行模式。它非常适用于对时序要求不高或者不是一直需要高速时钟的应用。

如果主时钟源为内部振荡器模块 (INTRC 或 INTOSC)，在代码执行期间，PRI_RUN 和 RC_RUN 这两种模式区别不大。但是在进入和退出 RC_RUN 模式时会发生时钟切换延时。因此，如果主时钟源为内部振荡器模块，建议不要使用 RC_RUN 模式。

通过将 SCS1 位置 1 可以进入此模式。虽然 SCS0 位可以被忽略，但还是建议将 SCS0 位清零，从而保证与未来器件的软件兼容性。当将时钟源切换到 INTOSC 多路开关 (见图 3-3) 时，主振荡器将被关闭并且 OST1 位被清零。在任何时候更改 IRCF 位可以立即更改时钟速度。

注: 在仅修改 IRCF 位时应该特别小心。如果 V_{DD} 电压小于 3V，可以选择比低 V_{DD} 电压所能支持的时钟速度更高的速度。违反 V_{DD}/F_{OSC} 规范会导致器件运行不正常 (见图 26-1 和图 26-2)。

PIC18F2423/2523/4423/4523

如果 IRCF 位和 INTSRC 位均被清零，将禁止 INTOSC 输出并且 IOFS 位将保持清零；不会有当前时钟源的任何指示。由 INTRC 时钟源提供器件时钟。

如果 IRCF 位从全清零状态发生改变（因而使能 INTOSC 输出），或者 INTSRC 被置 1，在 INTOSC 输出稳定后 IOFS 位将被置 1。在一个 TIOBST 间隔之后，INTOSC 时钟源趋于稳定，此时器件时钟继续运行。

如果之前的 IRCF 为一个非零值，或者在设置 SCS1 之前 INTSRC 已经置 1 并且 INTOSC 已达到稳定，那么 IOFS 位将保持置 1 状态。

在从 RC_RUN 模式转换到 PRI_RUN 模式期间，在主时钟处于启动状态时，器件将继续使用 INTOSC 多路开关的输出作为时钟源。当主时钟准备好以后，时钟切换到主时钟（见图 3-4）。当时钟切换完成后，IOFS 位被清零，OSTS 位被置 1 并且由主时钟提供器件时钟。这种切换不会影响 IDLEN 和 SCS 位。如果使能了 WDT 或故障保护时钟监视器，INTRC 时钟源将继续运行。

图 3-3: 到 RC_RUN 模式的转换时序

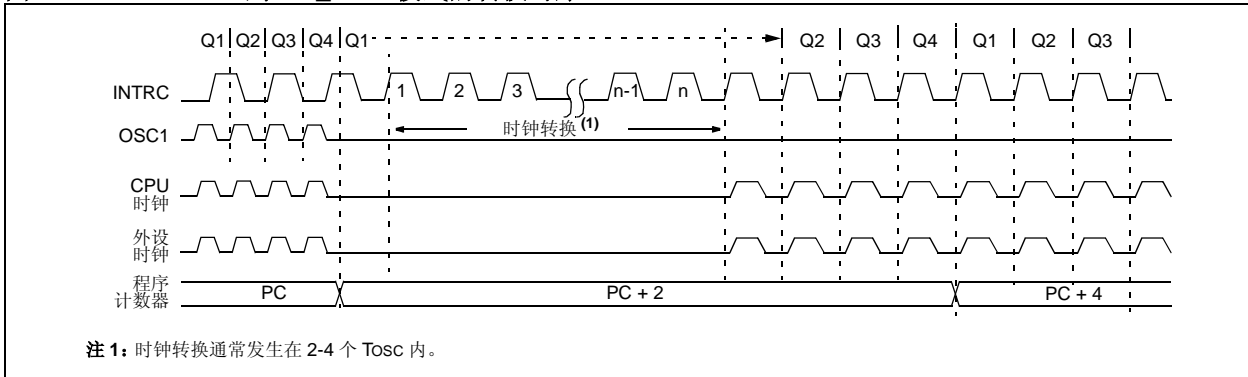
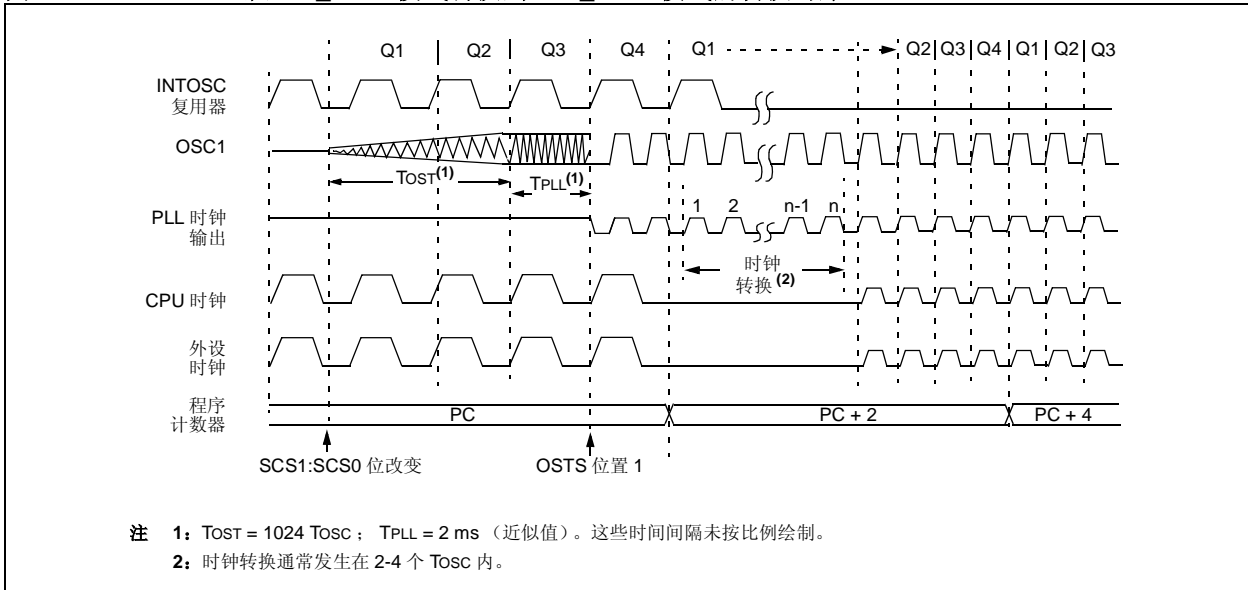


图 3-4: 从 RC_RUN 模式切换到 PRI_RUN 模式的转换时序



3.3 休眠模式

PIC18F2423/2523/4423/4523 器件的功耗管理休眠模式和所有其他 PIC 器件提供的传统休眠模式相同。通过清零 IDLEN 位（器件复位时的默认状态）并执行 SLEEP 指令即可进入此模式。这将关闭所选择的振荡器（见图 3-5），并将所有的时钟源状态位清零。

从任何其他模式进入休眠模式不需要切换时钟。这是因为单片机一旦进入休眠模式就不需要时钟了。如果选择了 WDT, INTRC 时钟源将继续工作。如果使能了 Timer1 振荡器，它也将继续运行。

当在休眠模式中发生唤醒事件时（通过中断、复位或 WDT 超时），在时钟源（通过 SCS1:SCS0 位选择）准备好之前器件将没有时钟源（见图 3-6），或者如果使能了双速启动或故障保护时钟监视器，它将使用内部振荡器模块作为时钟源（见第 23.0 节“CPU 的特殊功能”）。在这两种情况下，当由主时钟提供器件时钟时，OSTS 位将置 1。这种唤醒不会影响 IDLEN 和 SCS 位。

3.4 空闲模式

空闲模式允许在外设继续工作的同时关闭单片机的 CPU。选择特定的空闲模式允许用户进一步管理功耗。

如果在执行 SLEEP 指令时，IDLEN 位被置为 1，外设将使用由 SCS1:SCS0 位选择的时钟源，而 CPU 没有时钟源。时钟源状态位不受影响。将 IDLEN 置 1 并执行 SLEEP 指令可以从给定的运行模式快速切换到相应的空闲模式。

如果选择了 WDT, INTRC 时钟源将继续工作。如果使能了 Timer1 振荡器，它也将继续运行。

由于 CPU 没有执行指令，器件只能通过中断、WDT 超时或复位从空闲模式退出。当发生唤醒事件时，CPU 会在其准备好执行代码前延时一个 T_{cSD} 间隔（表 26-10 中的参数 38）。当 CPU 开始执行代码时，它将沿用当前空闲模式所使用的时钟源。例如，当从 RC_IDLE 模式唤醒时，将使用内部振荡器模块为 CPU 和外设提供时钟（即 RC_RUN 模式）。这种唤醒不会影响 IDLEN 和 SCS 位。

当处于任何空闲模式或休眠模式中时，WDT 超时会导致 WDT 唤醒并进入当前由 SCS1:SCS0 位指定的运行模式。

图 3-5: 进入休眠模式的转换时序

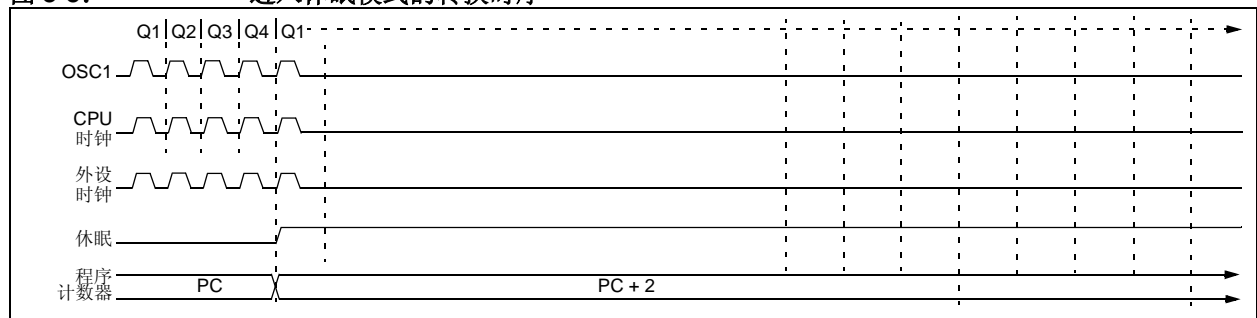
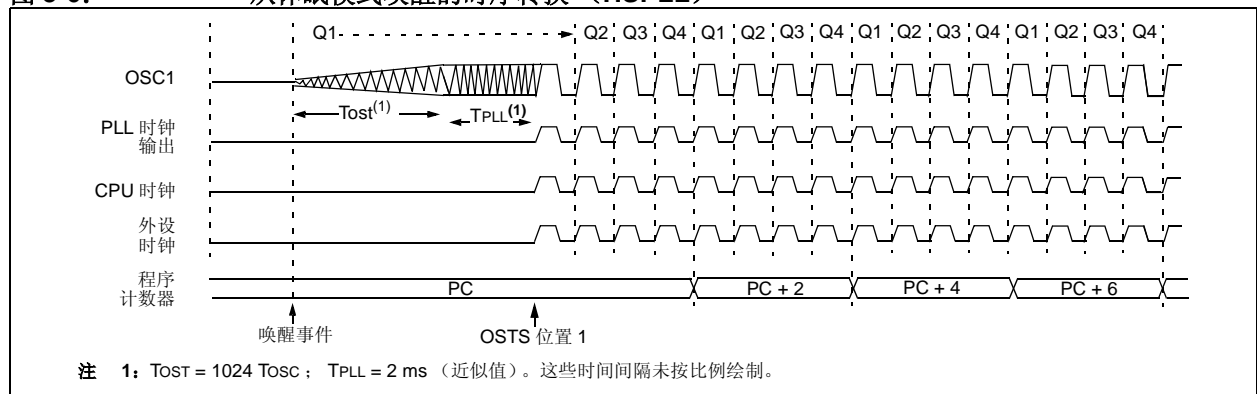


图 3-6: 从休眠模式唤醒的时序转换 (HSPLL)



注 1: T_{OST} = 1024 T_{OSC}; T_{PLL} = 2 ms (近似值)。这些时间间隔未按比例绘制。

PIC18F2423/2523/4423/4523

3.4.1 PRI_IDLE 模式

在三种低功耗空闲模式中，只有该模式不会禁止主器件时钟。由于时钟源不需要“热身”或是从其他振荡器转换过来，选用此模式可以使对时间要求较高的应用以最快的速度恢复器件运行并使用较精确的主时钟源。

可以通过将 IDLEN 位置 1 并执行 SLEEP 指令以实现从 PRI_RUN 模式进入 PRI_IDLE 模式。如果器件在另一种运行模式，可以先将 IDLEN 位置 1，然后清零 SCS 位并执行 SLEEP。虽然 CPU 已被禁止，但外设仍继续使用由 FOSC3:FOSC0 配置位指定的主时钟源为其提供时钟信号。OSTS 位保持置 1（见图 3-7）。

当发生唤醒事件时，由主时钟源为 CPU 提供时钟。在唤醒事件和代码执行开始之间需要一个 T_{CSD} 间隔的延时。该延时用来让 CPU 做好执行指令的准备。在唤醒之后，OSTS 位保持置 1 状态。这种唤醒不会影响 IDLEN 和 SCS 位（见图 3-8）。

3.4.2 SEC_IDLE 模式

在 SEC_IDLE 模式下，CPU 被禁止，但外设继续将 Timer1 振荡器作为时钟源。可以通过将 IDLEN 位置 1 并执行 SLEEP 指令从 SEC_RUN 模式进入此模式。如果器件处于另一种运行模式，首先将 IDLEN 位置 1，然后将 SCS1:SCS0 置为 01 并执行 SLEEP。当时钟源切换到 Timer1 振荡器时，主振荡器关闭，OSTS 位被清零并且 T1RUN 位置 1。

当唤醒事件发生时，外设继续将 Timer1 振荡器作为时钟源。唤醒事件发生后经过一个 T_{CSD} 时间间隔，CPU 开始执行代码并使用 Timer1 振荡器作为其时钟源。这种唤醒不会影响 IDLEN 和 SCS 位。Timer1 振荡器继续运行（见图 3-8）。

注： Timer1 振荡器应该在进入 SEC_IDLE 模式之前就已经运行了。如果执行 SLEEP 指令时 T1OSCEN 位没有置 1，就会忽略 SLEEP 指令并不会进入 SEC_IDLE 模式。如果使能了 Timer1 振荡器，但它尚未运行，外设时钟将会延时直到该振荡器起振。在这种情况下，最初的振荡器运行很不稳定，可能会导致无法预料的结果。

图 3-7: 进入空闲模式的转换时序

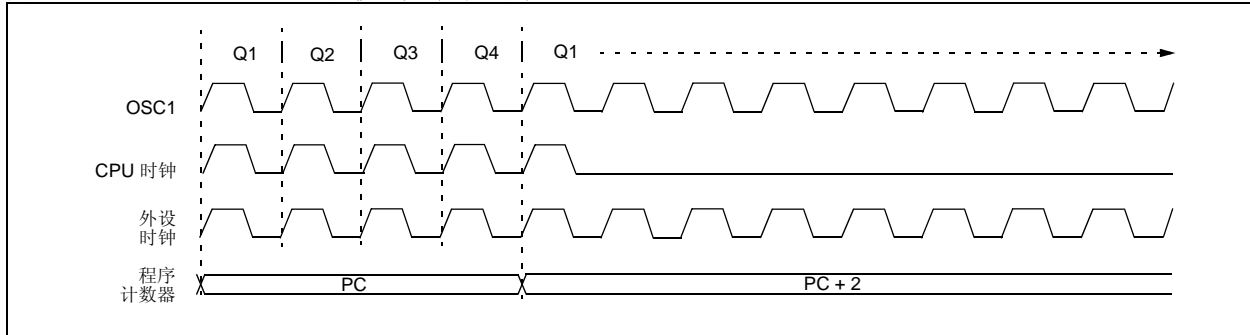
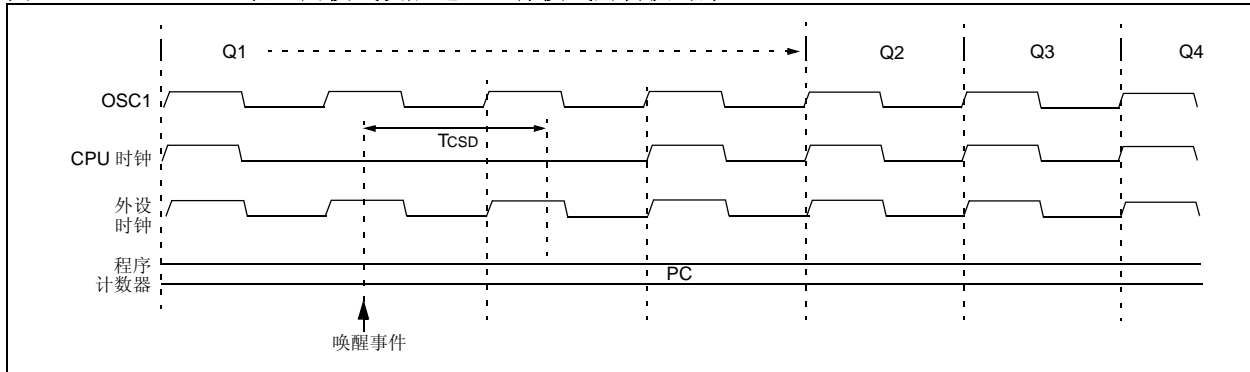


图 3-8: 从空闲模式唤醒进入运行模式的转换时序



3.4.3 RC_IDLE 模式

RC_IDLE 模式禁止 CPU，但仍继续由使用 INTOSC 多路开关的内部振荡器模块为外设提供时钟。该模式允许在空闲期间对功耗进行控制。

可以通过将 IDLEN 位置 1 并执行 SLEEP 指令从 RC_RUN 模式进入此模式。如果器件处于另一种运行模式，可以先将 IDLEN 位置 1，然后再将 SCS1 位置 1 并执行 SLEEP。虽然 SCS0 的值常常被忽略，但仍建议将其清零，这将保证与未来器件的软件兼容性。通过在执行 SLEEP 指令之前修改 IRCF 位可以使用 INTOSC 多路开关来选择更高的时钟频率。当时钟源切换到 INTOSC 多路开关时，主振荡器被关闭，OSTS 位被清零。

如果 IRCF 位被设置为任何非零值，或者 INTSRC 位被置 1，就会使能 INTOSC 输出。在一个 TIOBST 间隔（表 26-10 中的参数 39）之后 INTOSC 输出将趋于稳定，随后 IOFS 位置 1。外设的时钟继续运行直到 INTOSC 时钟源趋于稳定。如果之前的 IRCF 位为一个非零值或者在执行 SLEEP 指令之前 INTSRC 已置 1，并且当前 INTOSC 源已经稳定，IOFS 位将保持置 1 状态。如果 IRCF 和 INTSRC 位全部清零，就不会使能 INTOSC 输出，IOFS 位将保持清零状态，此时将不会有当前时钟源的任何指示。

当唤醒事件发生时，外设继续将 INTOSC 多路开关作为时钟源。在唤醒事件后的 Tcsd 间隔之后，CPU 开始使用 INTOSC 多路开关作为时钟源执行代码。这种唤醒不会影响 IDLEN 和 SCS 位。如果使能了 WDT 或故障保护时钟监视器，INTRC 时钟源将继续运行。

3.5 退出空闲和休眠模式

由中断、复位或 WDT 超时触发从休眠模式或任何空闲模式的退出。本节将讨论从功耗管理模式退出的触发方式。在每种功耗管理模式中我们已经讨论过其时钟源系统的作用（见第 3.2 节“运行模式”、第 3.3 节“休眠模式”和第 3.4 节“空闲模式”）。

3.5.1 通过中断退出

任何可用的中断源都可导致器件从空闲模式或休眠模式退出到运行模式。要使能此功能，必须将对应 INTCON 或 PIE 寄存器中的中断源允许位置 1 来允许中断源。当相应的中断标志位置 1 时，触发退出操作。

当通过中断从空闲或休眠模式退出时，如果 GIE/GIEH 位（INTCON<7>）置 1，程序就会跳转到中断向量处执行代码。否则代码就会顺序执行或重新开始执行，而不跳转（见第 9.0 节“中断”）。

唤醒事件之后需要一个固定的 Tcsd 间隔的延时，器件才会退出休眠和空闲模式。CPU 需要此延时来准备执行代码。在延时后的第一个时钟周期重新开始执行指令。

3.5.2 通过 WDT 超时退出

WDT 超时根据超时发生时器件所处的不同功耗管理模式会引发不同的操作。

如果器件不在执行代码（所有空闲模式和休眠模式），超时将导致从功耗管理模式退出（见第 3.2 节“运行模式”和第 3.3 节“休眠模式”）。如果器件正在执行代码（所有运行模式），超时将导致 WDT 复位（见第 23.2 节“看门狗定时器（WDT）”）。

执行 SLEEP 或 CLRWDT 指令、当前选择的时钟源失效（如果使能了故障保护监视器）以及如果器件时钟源为内部振荡器模块，修改 OSCCON 寄存器中的 IRCF 位，均将清零 WDT 定时器和后分频器。

3.5.3 通过复位退出

通常，器件通过振荡器起振定时器（OST）保持在复位状态，直到主时钟就绪。主时钟就绪后，OSTS 位置 1，器件开始执行代码。如果以内部振荡器模块作为新的时钟源，则 IOFS 位将置 1。

从复位状态退出到开始执行代码之间的延迟时间由唤醒前后的时钟源以及主时钟振荡器的类型（如果新的时钟源为主时钟）决定。表 3-2 总结了退出延时。

可以在主时钟就绪之前开始执行代码。如果使能了双速启动（见第 23.3 节“双速启动”）或故障保护时钟监视器（见第 23.4 节“故障保护时钟监视器”），器件可以在复位源被清除之后马上开始执行代码。由内部振荡器模块驱动的 INTOSC 多路开关的输出作为代码执行的时钟源。执行代码时，由内部振荡器模块提供时钟源直到主时钟就绪；或者在主时钟就绪前进入功耗管理模式，随后将关闭主时钟。

PIC18F2423/2523/4423/4523

3.5.4 在没有振荡器起振延时的情况下退出
从某些功耗管理模式退出完全不需要 OST 延时。有以下两种情形：

- 主时钟源不停止的 PRI_IDLE 模式
- 主时钟源不是 LP、XT、HS 或 HSPLL 中的任意一种模式

在这些情况下，要么主时钟源已经在运行 (PRI_IDLE)，要么它本来就不需要振荡器起振延时 (RC、EC 和 INTIO 振荡器模式)。但是，当器件退出休眠和空闲模式时，在唤醒事件之后仍然需要一个固定的 TcSD 间隔的延时，以便让 CPU 准备好执行代码。在延时后的第一个时钟周期重新开始执行指令。

表 3-2: 通过复位从休眠模式或任何空闲模式唤醒的退出延时 (按时钟源分类)

唤醒之前的时钟源	唤醒之后的时钟源	退出延时	时钟就绪状态位 (OSCON)
主器件时钟 (PRI_IDLE 模式)	LP、XT 或 HS	TcSD ⁽¹⁾	OSTS
	HSPLL		
	EC 或 RC		IOFS
	INTOSC ⁽²⁾		
T1OSC 或 INTRC ⁽¹⁾	LP、XT 或 HS	TOST ⁽³⁾	OSTS
	HSPLL	TOST + t _{rc} ⁽³⁾	
	EC 或 RC	TcSD ⁽¹⁾	IOFS
	INTOSC ⁽¹⁾	TIOBST ⁽⁴⁾	
INTOSC ⁽²⁾	LP、XT 或 HS	TOST ⁽⁴⁾	OSTS
	HSPLL	TOST + t _{rc} ⁽³⁾	
	EC 或 RC	TcSD ⁽¹⁾	IOFS
	INTOSC ⁽¹⁾	无	
无 (休眠模式)	LP、XT 或 HS	TOST ⁽³⁾	OSTS
	HSPLL	TOST + t _{rc} ⁽³⁾	
	EC 或 RC	TcSD ⁽¹⁾	IOFS
	INTOSC ⁽¹⁾	TIOBST ⁽⁴⁾	

- 注 1: 当从休眠模式和所有空闲模式唤醒时都需要 TcSD (参数 38) 延时，该延时与所需的其他延时并行 (见第 3.4 节“空闲模式”)。复位时，INTOSC 默认值为 1 MHz。
- 2: 包括 INTOSC 8 MHz 时钟源和后分频器产生的频率。
- 3: TOST 是振荡器起振定时器的延迟时间 (参数 32)。t_{rc} 是 PLL 锁定延时定时器的延迟时间 (参数 F12)。后者也被称为 TPLL。
- 4: 在 INTOSC 稳定周期——TIOBST (参数 39) 延时期间，代码继续执行。

4.0 复位

PIC18F2423/2523/4423/4523 器件有以下几种不同的复位方式：

- a) 上电复位 (POR)
- b) 正常工作状态下的 MCLR 复位
- c) 功耗管理模式下的 MCLR 复位
- d) 看门狗定时器 (WDT) 复位 (执行程序期间)
- e) 可编程欠压复位 (BOR)
- f) RESET 指令
- g) 堆栈满复位
- h) 堆栈下溢复位

本节将讨论由 MCLR、POR 和 BOR 产生的复位，并涉及各种启动定时器的工作方式。堆栈复位事件将在第 5.1.2.4 节“堆栈满和下溢复位”中讨论。WDT 复位将在第 23.2 节“看门狗定时器 (WDT)”中讨论。

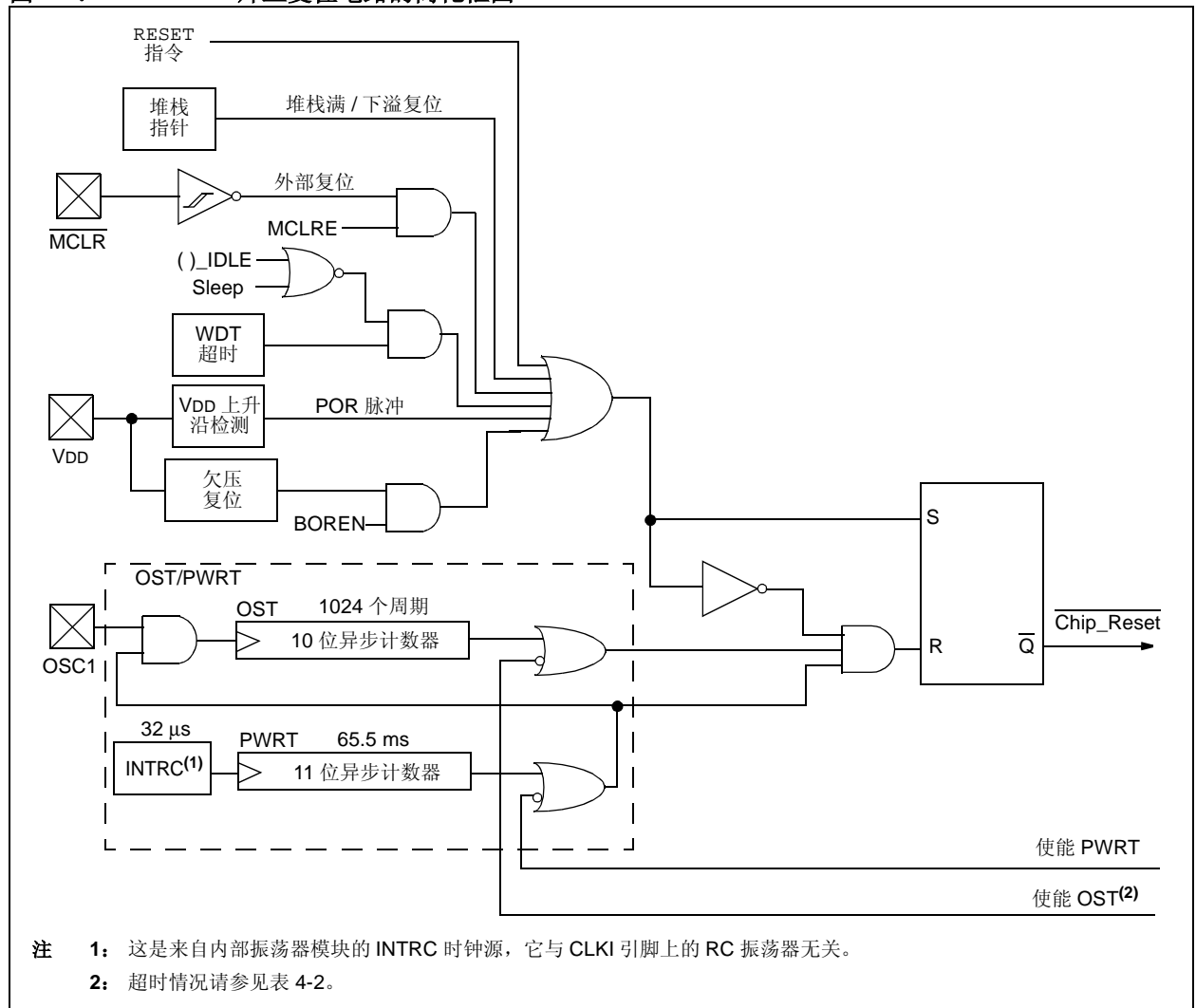
图 4-1 给出了片上复位电路的简化框图。

4.1 RCON 寄存器

通过 RCON 寄存器 (寄存器 4-1) 跟踪器件复位事件。该寄存器的低 5 位表明是否已经发生了特定的复位事件。在大多数情况下，只能通过事件将这些位清零，而且必须在事件发生后由应用程序将它们置 1。需要读取所有这些标志位来确定刚发生的复位的类型。在第 4.6 节“寄存器的复位状态”中对此进行了更详细的说明。

RCON 寄存器中还有设置中断优先级的控制位 (IPEN) 和对 BOR 进行软件控制的控制位 (SBOREN)。在第 9.0 节“中断”中讨论了中断优先级。在第 4.4 节“欠压复位 (BOR)”中讨论了 BOR。

图 4-1: 片上复位电路的简化框图



PIC18F2423/2523/4423/4523

寄存器 4-1: RCON: 复位控制寄存器

R/W-0	R/W-1 ⁽¹⁾	U-0	R/W-1	R-1	R-1	R/W-0 ⁽²⁾	R/W-0
IPEN	SBOREN	—	\overline{RI}	\overline{TO}	\overline{PD}	\overline{POR}	\overline{BOR}
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位	W = 可写位	U = 未实现位, 读为 0
-n = POR 值	1 = 置 1	0 = 清零
		x = 未知

bit 7	IPEN: 中断优先级使能位 1 = 使能中断优先级 0 = 禁止中断优先级 (PIC16CXXX 兼容模式)
bit 6	SBOREN: BOR 软件使能位 ⁽¹⁾ <u>如果 BOREN1:BOREN0 = 01:</u> 1 = 使能 BOR 0 = 禁止 BOR <u>如果 BOREN1:BOREN0 = 00、10 或 11:</u> 该位被禁止并读为 0。
bit 5	未实现: 读为 0
bit 4	\overline{RI}: RESET 指令标志位 1 = 未执行 RESET 指令 (只能由固件置 1) 0 = 已执行了 RESET 指令, 导致器件复位 (必须在发生复位后由软件置 1)
bit 3	\overline{TO}: 看门狗超时标志位 1 = 通过上电、CLRWDT 指令或 SLEEP 指令置 1 0 = 发生了 WDT 超时溢出
bit 2	\overline{PD}: 掉电检测标志位 1 = 通过上电或 CLRWDT 指令置 1 0 = 通过执行 SLEEP 指令置 1
bit 1	\overline{POR}: 上电复位状态位 ⁽²⁾ 1 = 未发生上电复位 (只能由固件置 1) 0 = 已发生上电复位 (必须在发生上电复位后由软件置 1)
bit 0	\overline{BOR}: 欠压复位状态位 1 = 未发生欠压复位 (只能由固件置 1) 0 = 已发生欠压复位 (必须在发生欠压复位后由软件置 1)

- 注 1:** 如果使能了 SBOREN 位, 其复位状态为 1; 否则为 0。
注 2: \overline{POR} 的实际复位值由器件复位的类型决定。更多信息, 请参见本寄存器下方的“注”和第 4.6 节“寄存器的复位状态”。

- 注 1:** 建议在检测到上电复位后, 将 \overline{POR} 位置 1, 以便继续检测后续的上电复位。
注 2: 当 \overline{BOR} 为 0 并且 \overline{POR} 为 1 时 (假定在 \overline{POR} 之后立即用软件将 \overline{POR} 置 1), 可以说已发生了欠压复位。

4.2 主复位 ($\overline{\text{MCLR}}$)

$\overline{\text{MCLR}}$ 引脚提供了用外部硬件触发器件复位的方法。将该引脚拉低可以产生复位信号。这些器件在 $\overline{\text{MCLR}}$ 复位路径上有一个噪声滤波器，该滤波器检测并滤除小的干扰脉冲。

任何内部复位，包括 WDT 复位，均不能将 $\overline{\text{MCLR}}$ 引脚驱动为低电平。

在 PIC18F2423/2523/4423/4523 器件中，可以用 MCLRE 配置位禁止 $\overline{\text{MCLR}}$ 输入。当禁止 $\overline{\text{MCLR}}$ 时，该引脚将成为一个数字输入引脚。更多信息，请参见第 10.5 节“PORTE、TRISE 和 LATE 寄存器”。

4.3 上电复位 (POR)

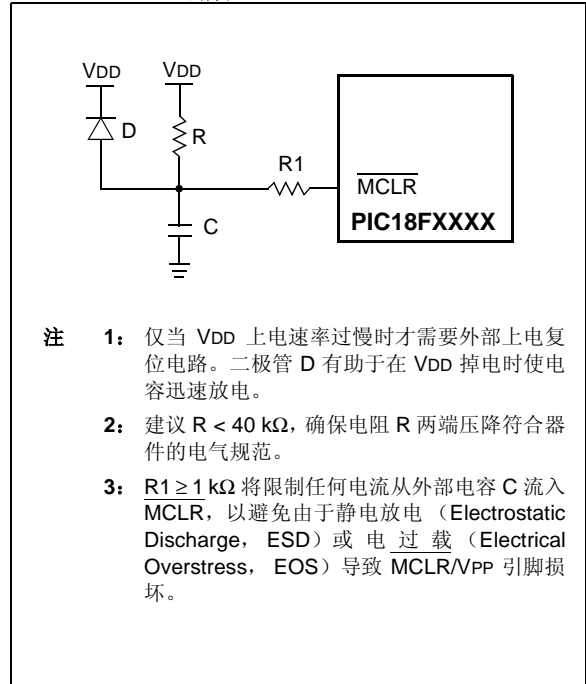
只要当 VDD 上升到某个门限时，就会在片上产生上电复位脉冲。这使得 VDD 达到满足器件正常工作的数值时，器件会以初始化状态启动。

为了利用 POR 电路，需要将 $\overline{\text{MCLR}}$ 引脚通过一个电阻（阻值范围为 1 k Ω 到 10 k Ω ）连接到 VDD。这样可以省去产生上电复位延时通常所需的外部 RC 元件。VDD 的最小上升速率已指定（参数 D004）。上升速率缓慢的情况，请参见图 4-2。

当器件开始正常工作（即，退出复位状态）时，器件的工作参数（电压、频率和温度等）必须得到满足，以确保其正常工作。如果不满足这些条件，那么器件必须保持在复位状态，直到满足工作条件为止。

POR 事件由 POR 位 (RCON<1>) 捕获。每当发生 POR 时，该位的状态就会被置为 0；任何其他复位事件均不能改变它。任何硬件事件均不能将 POR 复位为 1。要捕获多个事件，用户必须在 POR 之后用软件手动将该位复位为 1。

图 4-2: 外部上电复位电路 (VDD 缓慢上电的情况)



PIC18F2423/2523/4423/4523

4.4 欠压复位 (BOR)

PIC18F2423/2523/4423/4523 器件带有一个 BOR 电路，它将为用户提供一系列配置和节能选项。BOR 由 BORV1:BORV0 和 BOREN1:BOREN0 配置位控制。总共有 4 种 BOR 配置，归纳在表 4-1 中。

BOR 门限值由 BORV1:BORV0 位设置。如果使能了 BOR，当 VDD 跌落到低于 VBOR（参数 D005）的时间大于 TBOR（参数 35）就会复位器件。如果 VDD 跌落到 VBOR 以下的时间小于 TBOR 可能发生也可能不会发生复位。发生欠压复位以后，芯片将保持这种状态，直至 VDD 上升到 VBOR 以上。

如果使能了上电延时定时器，则它将在 VDD 上升到超过 VBOR 之后开始工作，并使芯片在延时 TPWRT（参数 33）期间保持复位。如果在上电延时定时器运行过程中，VDD 电压降到了 VBOR 以下，芯片将重新回到欠压复位状态并且上电延时定时器会恢复为初始状态。一旦 VDD 电压上升到 VBOR 以上，上电延时定时器将重新执行延时。

BOR 和上电延时定时器（PWRT）是分别配置的。使能 BOR 复位并不会自动使能 PWRT。

4.4.1 用软件使能 BOR

当 BOREN1:BOREN0 = 01 时，用户可以用软件使能或禁止 BOR。这可通过控制位 SBOREN（RCON<6>）完成。如前所述，将 SBOREN 置 1 可使能 BOR。清零 SBOREN 将完全禁止 BOR。SBOREN 位只工作在这个模式，其他情况下它将读为 0。

用软件控制 BOR 位可使用户能更灵活地定制应用程序以使其适应环境，而无需通过对器件重新编程来更改 BOR 配置。它还允许用户通过减少 BOR 消耗的电流，用软件调节器件的功耗。虽然 BOR 的电流通常很小，但是它可能对低功耗应用有一些影响。

注： 即使当 BOR 受软件控制时，BOR 复位电平仍将由 BORV1:BORV0 配置位设置。该值不能用软件更改。

4.4.2 检测 BOR

使能 BOR 后，当发生 BOR 或 POR 事件时，BOR 位总是复位为 0。因此只通过读 BOR 位的状态很难确定是否发生过 BOR 事件。更可靠的方法是同时检查 POR 和 BOR 的状态。假定在发生任何 POR 事件后，POR 位被立即用软件复位为 1。如果 BOR 为 0 同时 POR 为 1，那么就可以断定已经发生了 BOR 事件。

4.4.3 在休眠模式下禁止 BOR

当 BOREN1:BOREN0 = 10 时，BOR 受硬件控制并且像前面描述的那样工作。每当器件进入休眠模式时，就会自动禁止 BOR。当器件返回到任何其他工作模式时，又将自动重新使能 BOR。

此模式使应用能在有效执行代码的同时从欠压状态恢复，这也是器件最需要 BOR 保护的状况。同时，通过消除增加的 BOR 电流，可以省去休眠模式下的额外功耗。

表 4-1: BOR 配置

BOR 配置		SBOREN (RCON<6>) 的状态	BOR 操作
BOREN1	BOREN0		
0	0	无关位	禁止 BOR；必须对配置位重新编程才能使能 BOR。
0	1	可用	用软件使能 BOR；工作模式由 SBOREN 控制。
1	0	无关位	用硬件在运行和空闲模式下使能 BOR，在休眠模式下禁止。
1	1	无关位	用硬件使能 BOR。

4.5 器件复位定时器

PIC18F2423/2523/4423/4523 器件包含了三个独立的片上定时器，有助于调节上电复位过程。它们的主要功能是确保在代码执行之前器件时钟稳定。这些定时器是：

- 上电延时定时器（PWRT）
- 振荡器起振定时器（OST）
- PLL 锁定延时定时器

4.5.1 上电延时定时器（PWRT）

PIC18F2423/2523/4423/4523 器件的上电延时定时器（PWRT）是一个 11 位计数器，它使用 INTRC 时钟源作为时钟输入。该定时器可产生大约 $2048 \times 32 \mu\text{s} = 65.6 \text{ ms}$ 的时间间隔。PWRT 计数期间，器件保持在复位状态。

上电延时时间取决于 INTRC 时钟，并且由于温度和工艺的不同，不同器件的延迟时间也将各不相同。详情请参见直流参数 33。

通过清零 $\overline{\text{PWRTE}}\text{N}$ 配置位可使能 PWRT。

4.5.2 振荡器起振定时器（OST）

在 PWRT 延时（参数 33）结束以后，由振荡器起振定时器（OST）提供 1024 个振荡周期（来自 OSC1 输入）的延时，从而确保晶振或谐振器已起振并足够稳定可以为控制器提供时钟。振荡器可能需要更长时间以满足其频率容差规范。

只有在 XT、LP、HS 和 HSPLL 模式下，并且仅当发生上电复位或从大多数功耗管理模式退出时，才启用 OST 延时。

4.5.3 PLL 锁定延时定时器

当在 PLL 模式下使能 PLL 时，上电复位后的延时时序与其他振荡器模式略有不同。在 PLL 模式下需要使用一个独立的定时器来提供一段足够让 PLL 锁定到主振荡器频率的固定延时。PLL 锁定延时（TPLL）通常为 2 ms，且在振荡器起振延时后发生。

4.5.4 延时时序

上电延时时序如下：

1. 清除 POR 脉冲。
2. 启用 PWRT 延时（如果使能）。
3. 启用 OST 延时。振荡器在此周期的开始起振。
4. PLL 锁定延时（如果使用 HSPLL 模式）。

总延迟时间将取决于振荡器的配置和 PWRT 的状态。图 4-3、图 4-4、图 4-5、图 4-6 和图 4-7 各自描述了不同的上电延时时序，其中上电延时定时器被使能，并且器件工作在 HS 振荡器模式下。图 4-3 到图 4-6 也适用于在 XT 或 LP 模式下工作的器件。对于工作在 RC 模式下的器件以及禁止了 PWRT 的器件，将根本没有延时。

由于延时是由 POR 脉冲触发的，因此如果 $\overline{\text{MCLR}}$ 保持足够长时间的低电平，所有延时都将结束。将 $\overline{\text{MCLR}}$ 电平拉高后器件将立即开始执行代码（图 4-5）。这对于测试或同步多个并行工作的 PIC18FXXXX 器件是非常有用的。

表 4-2: 不同情形下的延时

振荡器配置	上电复位 ⁽²⁾ 和欠压复位		从功耗管理模式退出
	$\overline{\text{PWRTE}}\text{N} = 0$	$\overline{\text{PWRTE}}\text{N} = 1$	
HSPLL	$66 \text{ ms}^{(1)} + 1024 \text{ T}_{\text{osc}} + 2 \text{ ms}^{(2)}$	$1024 \text{ T}_{\text{osc}} + 2 \text{ ms}^{(2)}$	$1024 \text{ T}_{\text{osc}} + 2 \text{ ms}^{(2)}$
HS、XT 和 LP	$66 \text{ ms}^{(1)} + 1024 \text{ T}_{\text{osc}}$	$1024 \text{ T}_{\text{osc}}$	$1024 \text{ T}_{\text{osc}}$
EC 和 ECIO	$66 \text{ ms}^{(1)}$	—	—
RC 和 RCIO	$66 \text{ ms}^{(1)}$	—	—
INTIO1 和 INTIO2	$66 \text{ ms}^{(1)}$	—	—

注 1: 66 ms（65.5 ms）是上电延时定时器（PWRT）延迟时间的标称值。

注 2: 2 ms 是 PLL 锁定所需的标称时间。

PIC18F2423/2523/4423/4523

图 4-3: 上电延时时序 ($\overline{\text{MCLR}}$ 连接到 VDD, VDD 电压上升时间 $< \text{TPWRT}$)

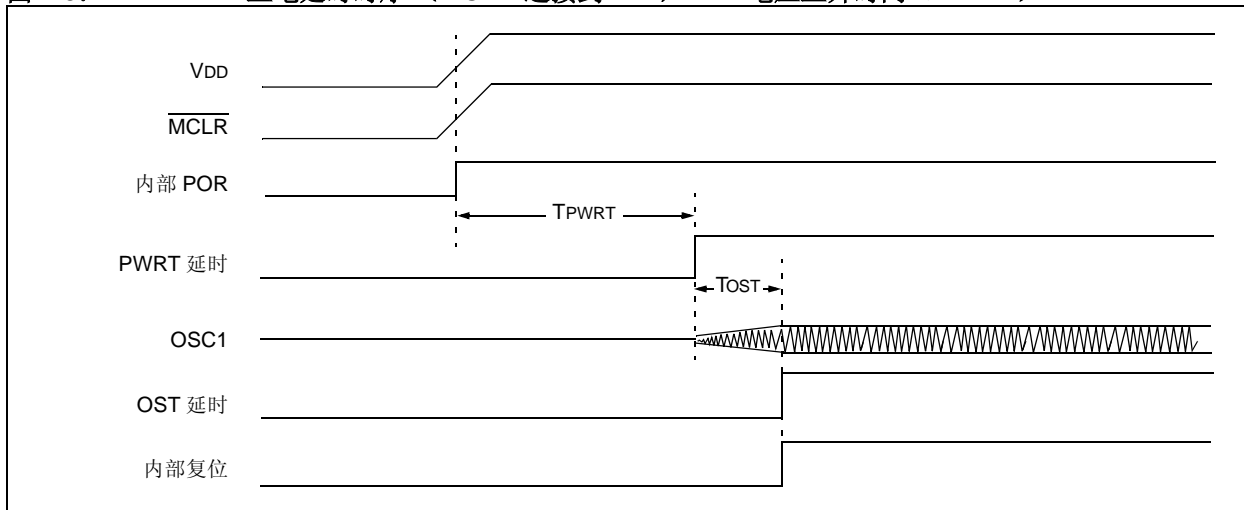


图 4-4: 上电延时时序 ($\overline{\text{MCLR}}$ 在 TOST 结束之前上升)

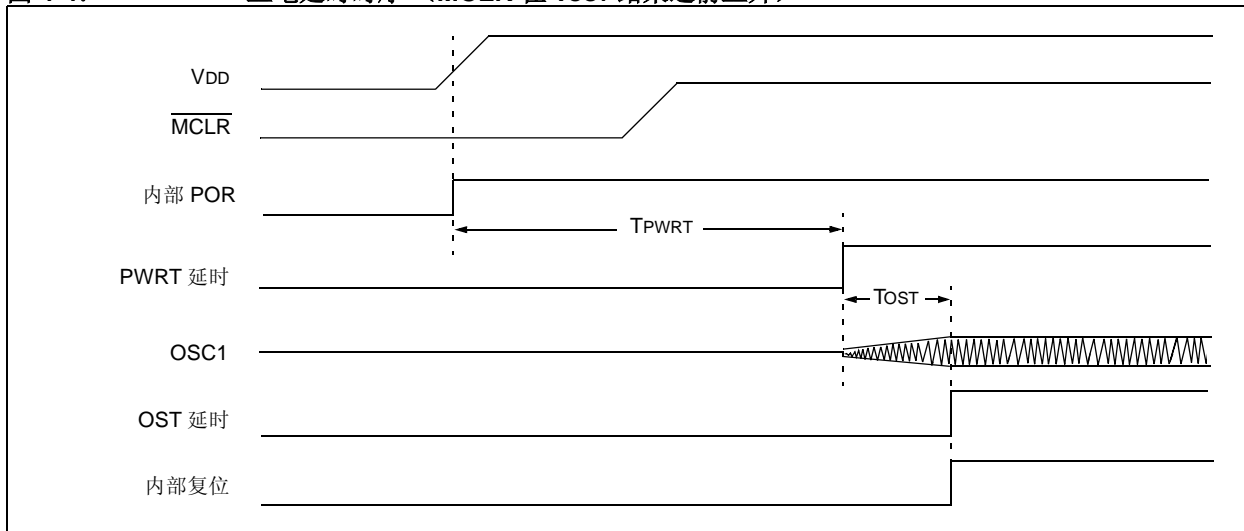
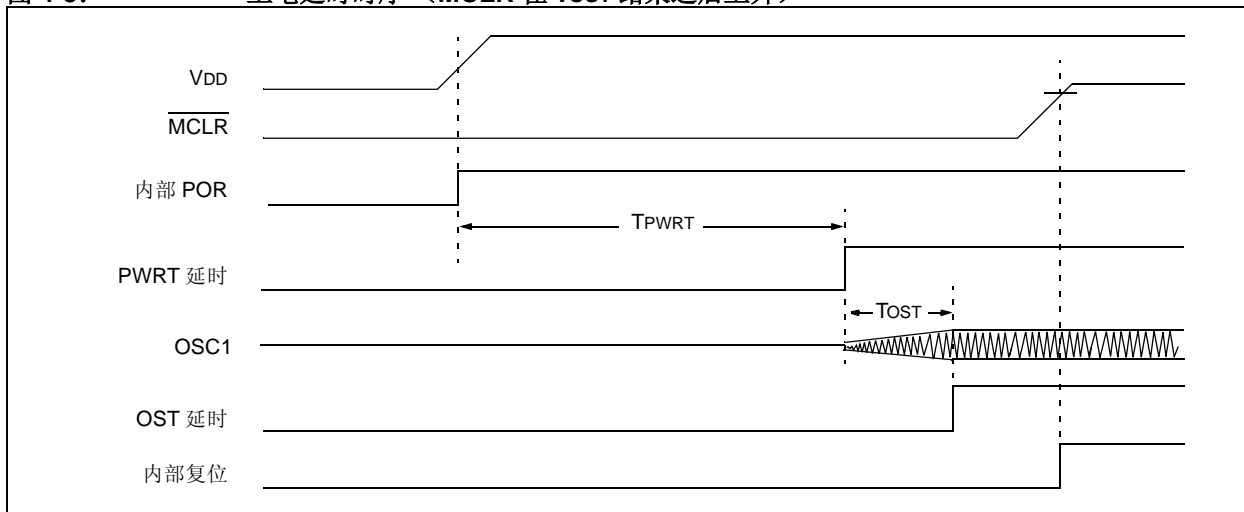


图 4-5: 上电延时时序 ($\overline{\text{MCLR}}$ 在 TOST 结束之后上升)



PIC18F2423/2523/4423/4523

图 4-6: 缓慢 VDD 上升时间 ($\overline{\text{MCLR}}$ 连接到 VDD, VDD 电压上升时间 > TPWRT)

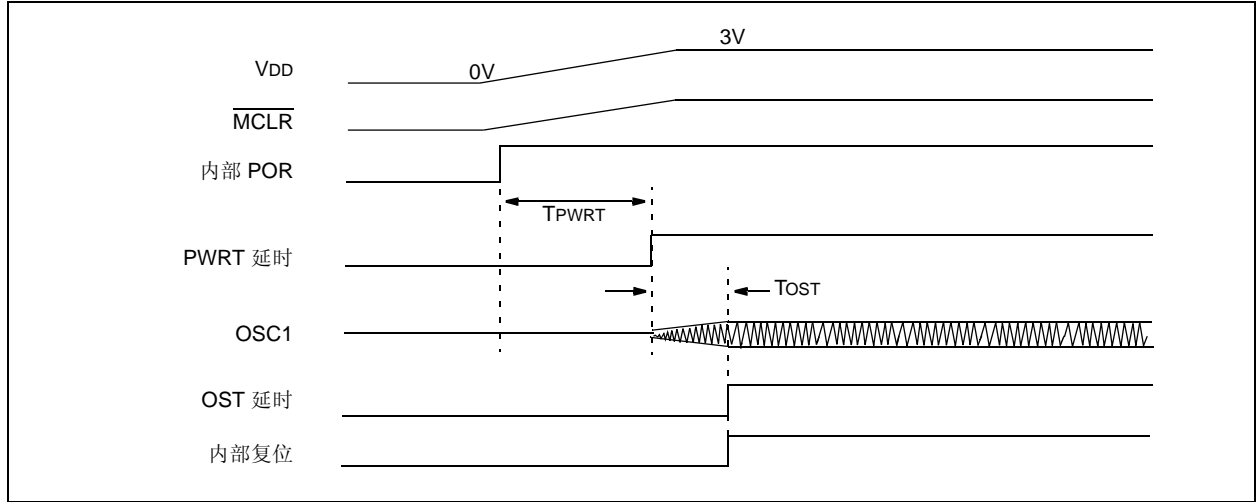
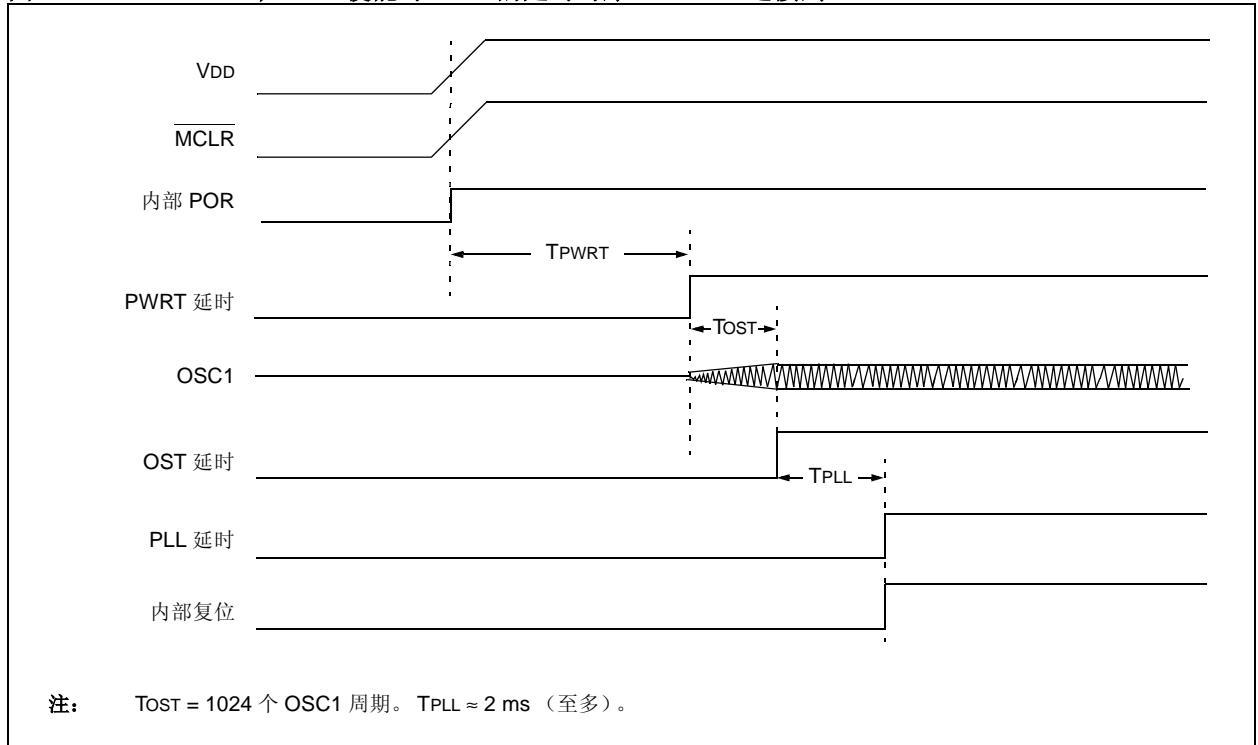


图 4-7: 在 PLL 使能时 POR 的延时时序 ($\overline{\text{MCLR}}$ 连接到 VDD)



PIC18F2423/2523/4423/4523

4.6 寄存器的复位状态

大多数寄存器不受复位的影响。在 POR 时这些寄存器的状态不确定，而在其他复位时它们的状态不变。而剩余寄存器则根据不同的复位类型被强制为“复位状态”。

大多数寄存器不受 WDT 唤醒的影响，这是因为 WDT 唤醒被视为对正常工作的恢复。如表 4-3 所示，RCON 寄存器中的状态位：RI、TO、PD、POR 和 BOR，在不同的复位情形中会分别被置 1 或清零。可在软件中使用这些状态位判断复位的性质。

表 4-4 描述了所有特殊功能寄存器的复位状态。可以将这些复位状态分类为上电和欠压复位、主复位、WDT 复位以及 WDT 唤醒。

表 4-3: RCON 寄存器的状态位、含义以及初始化状态

条件	程序计数器	RCON 寄存器					STKPTR 寄存器	
		RI	TO	PD	POR	BOR	STKFUL	STKUNF
上电复位	0000h	1	1	1	0	0	0	0
RESET 指令	0000h	0	u	u	u	u	u	u
欠压复位	0000h	1	1	1	u	0	u	u
功耗管理运行模式下的 MCLR 复位	0000h	u	1	u	u	u	u	u
功耗管理空闲和休眠模式下的 MCLR 复位	0000h	u	1	0	u	u	u	u
全功耗或功耗管理运行模式期间的 WDT 超时	0000h	u	0	u	u	u	u	u
全功耗执行期间的 MCLR 复位	0000h	u	u	u	u	u	u	u
堆栈满复位 (STVREN = 1)	0000h	u	u	u	u	u	1	u
堆栈下溢复位 (STVREN = 1)	0000h	u	u	u	u	u	u	1
堆栈下溢错误 (不是真正的复位, STVREN = 0)	0000h	u	u	u	u	u	u	1
功耗管理空闲或休眠模式下的 WDT 超时	PC + 2	u	0	0	u	u	u	u
通过中断从功耗管理模式退出	PC + 2 ⁽¹⁾	u	u	0	u	u	u	u

图注: u = 不变

注 1: 当器件被中断唤醒且 GIEH 或 GIEL 置 1 时，PC 装入中断向量 (008h 或 0018h)。

注 2: 当软件使能 BOR 时 (BOREN1:BOREN0 配置位 = 01 且 SBOREN = 1)，POR 位的复位状态是 1 且所有其他复位不能改变该状态。否则，其复位状态是 0。

PIC18F2423/2523/4423/4523

表 4-4: 所有寄存器的初始化状态

寄存器	适用器件				上电复位, 欠压复位	MCLR 复位, WDT 复位, RESET 指令, 堆栈复位	通过 WDT 或 中断唤醒器件
	2423	2523	4423	4523			
TOSU	2423	2523	4423	4523	---0 0000	---0 0000	---0 uuuu ⁽³⁾
TOSH	2423	2523	4423	4523	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu ⁽³⁾
TOSL	2423	2523	4423	4523	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu ⁽³⁾
STKPTR	2423	2523	4423	4523	00-0 0000	uu-0 0000	uu-u uuuu ⁽³⁾
PCLATU	2423	2523	4423	4523	---0 0000	---0 0000	---u uuuu
PCLATH	2423	2523	4423	4523	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
PCL	2423	2523	4423	4523	0000 0000	0000 0000	PC + 2 ⁽²⁾
TBLPTRU	2423	2523	4423	4523	--00 0000	--00 0000	--uu uuuu
TBLPTRH	2423	2523	4423	4523	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
TBLPTRL	2423	2523	4423	4523	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
TABLAT	2423	2523	4423	4523	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
PRODH	2423	2523	4423	4523	xxxx xxxx	uuuu uuuu	uuuu uuuu
PRODL	2423	2523	4423	4523	xxxx xxxx	uuuu uuuu	uuuu uuuu
INTCON	2423	2523	4423	4523	0000 000x	0000 000u	uuuu uuuu ⁽¹⁾
INTCON2	2423	2523	4423	4523	1111 -1-1	1111 -1-1	uuuu -u-u ⁽¹⁾
INTCON3	2423	2523	4423	4523	11-0 0-00	11-0 0-00	uu-u u-uu ⁽¹⁾
INDF0	2423	2523	4423	4523	N/A	N/A	N/A
POSTINC0	2423	2523	4423	4523	N/A	N/A	N/A
POSTDEC0	2423	2523	4423	4523	N/A	N/A	N/A
PREINC0	2423	2523	4423	4523	N/A	N/A	N/A
PLUSW0	2423	2523	4423	4523	N/A	N/A	N/A
FSR0H	2423	2523	4423	4523	---- 0000	---- 0000	---- uuuu
FSR0L	2423	2523	4423	4523	xxxx xxxx	uuuu uuuu	uuuu uuuu
WREG	2423	2523	4423	4523	xxxx xxxx	uuuu uuuu	uuuu uuuu
INDF1	2423	2523	4423	4523	N/A	N/A	N/A
POSTINC1	2423	2523	4423	4523	N/A	N/A	N/A
POSTDEC1	2423	2523	4423	4523	N/A	N/A	N/A
PREINC1	2423	2523	4423	4523	N/A	N/A	N/A
PLUSW1	2423	2523	4423	4523	N/A	N/A	N/A

图注: u = 不变, x = 未知, - = 未实现位 (读为 0), q = 值取决于具体条件。阴影单元表示不适用于指定器件。

- 注
- 1: INTCONx 或 PIRx 寄存器中的一位或多位会受到影响 (引起唤醒)。
 - 2: 当器件被中断唤醒且 GIEL 或 GIEH 位被置 1 时, PC 装入中断向量 (0008h 或 0018h)。
 - 3: 当器件被中断唤醒且 GIEL 或 GIEH 位被置 1 时, 用 PC 的当前值更新 TOSU、TOSH 和 TOSL。将 STKPTR 修改为指向硬件堆栈的下一个存储单元。
 - 4: 具体条件下的复位值, 请参见表 4-3。
 - 5: 根据所选择的振荡器模式使能 PORTA、LATA 和 TRISA 中的 bit 6 和 bit 7。如果未被配置为 PORTA 引脚, 则它们将被禁止并读为 0。

PIC18F2423/2523/4423/4523

表 4-4: 所有寄存器的初始化状态 (续)

寄存器	适用器件				上电复位, 欠压复位	MCLR 复位, WDT 复位, RESET 指令, 堆栈复位	通过 WDT 或 中断唤醒器件
	2423	2523	4423	4523			
FSR1H	2423	2523	4423	4523	---- 0000	---- 0000	---- uuuu
FSR1L	2423	2523	4423	4523	xxxx xxxx	uuuu uuuu	uuuu uuuu
BSR	2423	2523	4423	4523	---- 0000	---- 0000	---- uuuu
INDF2	2423	2523	4423	4523	N/A	N/A	N/A
POSTINC2	2423	2523	4423	4523	N/A	N/A	N/A
POSTDEC2	2423	2523	4423	4523	N/A	N/A	N/A
PREINC2	2423	2523	4423	4523	N/A	N/A	N/A
PLUSW2	2423	2523	4423	4523	N/A	N/A	N/A
FSR2H	2423	2523	4423	4523	---- 0000	---- 0000	---- uuuu
FSR2L	2423	2523	4423	4523	xxxx xxxx	uuuu uuuu	uuuu uuuu
STATUS	2423	2523	4423	4523	--x xxxx	--u uuuu	--u uuuu
TMR0H	2423	2523	4423	4523	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
TMR0L	2423	2523	4423	4523	xxxx xxxx	uuuu uuuu	uuuu uuuu
T0CON	2423	2523	4423	4523	1111 1111	1111 1111	uuuu uuuu
OSCCON	2423	2523	4423	4523	0100 q000	0100 q000	uuuu uuqu
HLVDCON	2423	2523	4423	4523	0-00 0101	0-00 0101	u-uu uuuu
WDTCON	2423	2523	4423	4523	---- --0	---- --0	---- --u
RCON ⁽⁴⁾	2423	2523	4423	4523	0q-1 11q0	0q-q qqqu	uq-u qqqu
TMR1H	2423	2523	4423	4523	xxxx xxxx	uuuu uuuu	uuuu uuuu
TMR1L	2423	2523	4423	4523	xxxx xxxx	uuuu uuuu	uuuu uuuu
T1CON	2423	2523	4423	4523	0000 0000	u0uu uuuu	uuuu uuuu
TMR2	2423	2523	4423	4523	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
PR2	2423	2523	4423	4523	1111 1111	1111 1111	1111 1111
T2CON	2423	2523	4423	4523	-000 0000	-000 0000	-uuu uuuu
SSPBUF	2423	2523	4423	4523	xxxx xxxx	uuuu uuuu	uuuu uuuu
SSPADD	2423	2523	4423	4523	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
SSPSTAT	2423	2523	4423	4523	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
SSPCON1	2423	2523	4423	4523	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
SSPCON2	2423	2523	4423	4523	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu

图注: u = 不变, x = 未知, - = 未实现位 (读为 0), q = 值取决于具体条件。阴影单元表示不适用于指定器件。

- 注
- 1: INTCONx 或 PIRx 寄存器中的一位或多位会受到影响 (引起唤醒)。
 - 2: 当器件被中断唤醒且 GIEL 或 GIEH 位被置 1 时, PC 装入中断向量 (0008h 或 0018h)。
 - 3: 当器件被中断唤醒且 GIEL 或 GIEH 位被置 1 时, 用 PC 的当前值更新 TOSU、TOSH 和 TOSL。将 STKPTR 修改为指向硬件堆栈的下一个存储单元。
 - 4: 具体条件下的复位值, 请参见表 4-3。
 - 5: 根据所选择的振荡器模式使能 PORTA、LATA 和 TRISA 中的 bit 6 和 bit 7。如果未被配置为 PORTA 引脚, 则它们将被禁止并读为 0。

PIC18F2423/2523/4423/4523

表 4-4: 所有寄存器的初始化状态 (续)

寄存器	适用器件				上电复位, 欠压复位	MCLR 复位, WDT 复位, RESET 指令, 堆栈复位	通过 WDT 或 中断唤醒器件
	2423	2523	4423	4523			
ADRESH	2423	2523	4423	4523	xxxx xxxx	uuuu uuuu	uuuu uuuu
ADRESL	2423	2523	4423	4523	xxxx xxxx	uuuu uuuu	uuuu uuuu
ADCON0	2423	2523	4423	4523	--00 0000	--00 0000	--uu uuuu
ADCON1	2423	2523	4423	4523	--00 0qqq	--00 0qqq	--uu uuuu
ADCON2	2423	2523	4423	4523	0-00 0000	0-00 0000	u-uu uuuu
CCPR1H	2423	2523	4423	4523	xxxx xxxx	uuuu uuuu	uuuu uuuu
CCPR1L	2423	2523	4423	4523	xxxx xxxx	uuuu uuuu	uuuu uuuu
CCP1CON	2423	2523	4423	4523	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
	2423	2523	4423	4523	--00 0000	--00 0000	--uu uuuu
CCPR2H	2423	2523	4423	4523	xxxx xxxx	uuuu uuuu	uuuu uuuu
CCPR2L	2423	2523	4423	4523	xxxx xxxx	uuuu uuuu	uuuu uuuu
CCP2CON	2423	2523	4423	4523	--00 0000	--00 0000	--uu uuuu
BAUDCON	2423	2523	4423	4523	01-0 0-00	01-0 0-00	--uu uuuu
ECCP1DEL	2423	2523	4423	4523	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
ECCP1AS	2423	2523	4423	4523	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
	2423	2523	4423	4523	0000 00--	0000 00--	uuuu uu--
CVRCON	2423	2523	4423	4523	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
CMCON	2423	2523	4423	4523	0000 0111	0000 0111	uuuu uuuu
TMR3H	2423	2523	4423	4523	xxxx xxxx	uuuu uuuu	uuuu uuuu
TMR3L	2423	2523	4423	4523	xxxx xxxx	uuuu uuuu	uuuu uuuu
T3CON	2423	2523	4423	4523	0000 0000	uuuu uuuu	uuuu uuuu
SPBRGH	2423	2523	4423	4523	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
SPBRG	2423	2523	4423	4523	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
RCREG	2423	2523	4423	4523	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
TXREG	2423	2523	4423	4523	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
TXSTA	2423	2523	4423	4523	0000 0010	0000 0010	uuuu uuuu
RCSTA	2423	2523	4423	4523	0000 000x	0000 000x	uuuu uuuu
EEADR	2423	2523	4423	4523	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
EEDATA	2423	2523	4423	4523	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
EECON2	2423	2523	4423	4523	0000 0000	0000 0000	0000 0000
EECON1	2423	2523	4423	4523	xx-0 x000	uu-0 u000	uu-0 u000

图注: u = 不变, x = 未知, - = 未实现位 (读为 0), q = 值取决于具体条件。阴影单元表示不适用于指定器件。

- 注
- 1: INTCONx 或 PIRx 寄存器中的一位或多位会受到影响 (引起唤醒)。
 - 2: 当器件被中断唤醒且 GIEL 或 GIEH 位被置 1 时, PC 装入中断向量 (0008h 或 0018h)。
 - 3: 当器件被中断唤醒且 GIEL 或 GIEH 位被置 1 时, 用 PC 的当前值更新 TOSU、TOSH 和 TOSL。将 STKPTR 修改为指向硬件堆栈的下一个存储单元。
 - 4: 具体条件下的复位值, 请参见表 4-3。
 - 5: 根据所选择的振荡器模式使能 PORTA、LATA 和 TRISA 中的 bit 6 和 bit 7。如果未被配置为 PORTA 引脚, 则它们将被禁止并读为 0。

PIC18F2423/2523/4423/4523

表 4-4: 所有寄存器的初始化状态 (续)

寄存器	适用器件				上电复位, 欠压复位	MCLR 复位, WDT 复位, RESET 指令, 堆栈复位	通过 WDT 或 中断唤醒器件
	2423	2523	4423	4523			
IPR2	2423	2523	4423	4523	11-1 1111	11-1 1111	uu-u uuuu
PIR2	2423	2523	4423	4523	00-0 0000	00-0 0000	uu-u uuuu ⁽¹⁾
PIE2	2423	2523	4423	4523	00-0 0000	00-0 0000	uu-u uuuu
IPR1	2423	2523	4423	4523	1111 1111	1111 1111	uuuu uuuu
	2423	2523	4423	4523	-111 1111	-111 1111	-uuu uuuu
PIR1	2423	2523	4423	4523	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu ⁽¹⁾
	2423	2523	4423	4523	-000 0000	-000 0000	-uuu uuuu ⁽¹⁾
PIE1	2423	2523	4423	4523	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
	2423	2523	4423	4523	-000 0000	-000 0000	-uuu uuuu
OSCTUNE	2423	2523	4423	4523	0q-0 0000	00-0 0000	uu-u uuuu
TRISE	2423	2523	4423	4523	0000 -111	0000 -111	uuuu -uuu
TRISD	2423	2523	4423	4523	1111 1111	1111 1111	uuuu uuuu
TRISC	2423	2523	4423	4523	1111 1111	1111 1111	uuuu uuuu
TRISB	2423	2523	4423	4523	1111 1111	1111 1111	uuuu uuuu
TRISA ⁽⁵⁾	2423	2523	4423	4523	1111 1111 ⁽⁵⁾	1111 1111 ⁽⁵⁾	uuuu uuuu ⁽⁵⁾
LATE	2423	2523	4423	4523	---- -xxx	---- -uuu	---- -uuu
LATD	2423	2523	4423	4523	xxxx xxxx	uuuu uuuu	uuuu uuuu
LATC	2423	2523	4423	4523	xxxx xxxx	uuuu uuuu	uuuu uuuu
LATB	2423	2523	4423	4523	xxxx xxxx	uuuu uuuu	uuuu uuuu
LATA ⁽⁵⁾	2423	2523	4423	4523	xxxx xxxx ⁽⁵⁾	uuuu uuuu ⁽⁵⁾	uuuu uuuu ⁽⁵⁾
PORTE	2423	2523	4423	4523	---- xxxx	---- uuuu	---- uuuu
PORTD	2423	2523	4423	4523	xxxx xxxx	uuuu uuuu	uuuu uuuu
PORTC	2423	2523	4423	4523	xxxx xxxx	uuuu uuuu	uuuu uuuu
PORTB	2423	2523	4423	4523	xxxx xxxx	uuuu uuuu	uuuu uuuu
PORTA ⁽⁵⁾	2423	2523	4423	4523	xx0x 0000 ⁽⁵⁾	uu0u 0000 ⁽⁵⁾	uuuu uuuu ⁽⁵⁾

图注: u = 不变, x = 未知, - = 未实现位 (读为 0), q = 值取决于具体条件。阴影单元表示不适用于指定器件。

- 注
- 1: INTCONx 或 PIRx 寄存器中的一位或多位会受到影响 (引起唤醒)。
 - 2: 当器件被中断唤醒且 GIEL 或 GIEH 位被置 1 时, PC 装入中断向量 (0008h 或 0018h)。
 - 3: 当器件被中断唤醒且 GIEL 或 GIEH 位被置 1 时, 用 PC 的当前值更新 TOSU、TOSH 和 TOSL。将 STKPTR 修改为指向硬件堆栈的下一个存储单元。
 - 4: 具体条件下的复位值, 请参见表 4-3。
 - 5: 根据所选择的振荡器模式使能 PORTA、LATA 和 TRISA 中的 bit 6 和 bit 7。如果未被配置为 PORTA 引脚, 则它们将被禁止并读为 0。

PIC18F2423/2523/4423/4523

5.0 存储器构成

PIC18 增强型单片机器件有三种类型的存储器:

- 程序存储器
- 数据 RAM
- 数据 EEPROM

由于是哈佛架构的器件, 数据和程序存储器使用不同的总线, 因而可同时访问这两种存储器空间。出于实用目的, 可将数据 EEPROM 当作外设器件, 因为它可以通过一组控制寄存器进行寻址和访问。

第 6.0 节“闪存程序存储器”提供了关于闪存程序存储器操作的更多详细信息。数据 EEPROM 将单独在第 7.0 节“数据 EEPROM 存储器”中讨论。

5.1 程序存储器构成

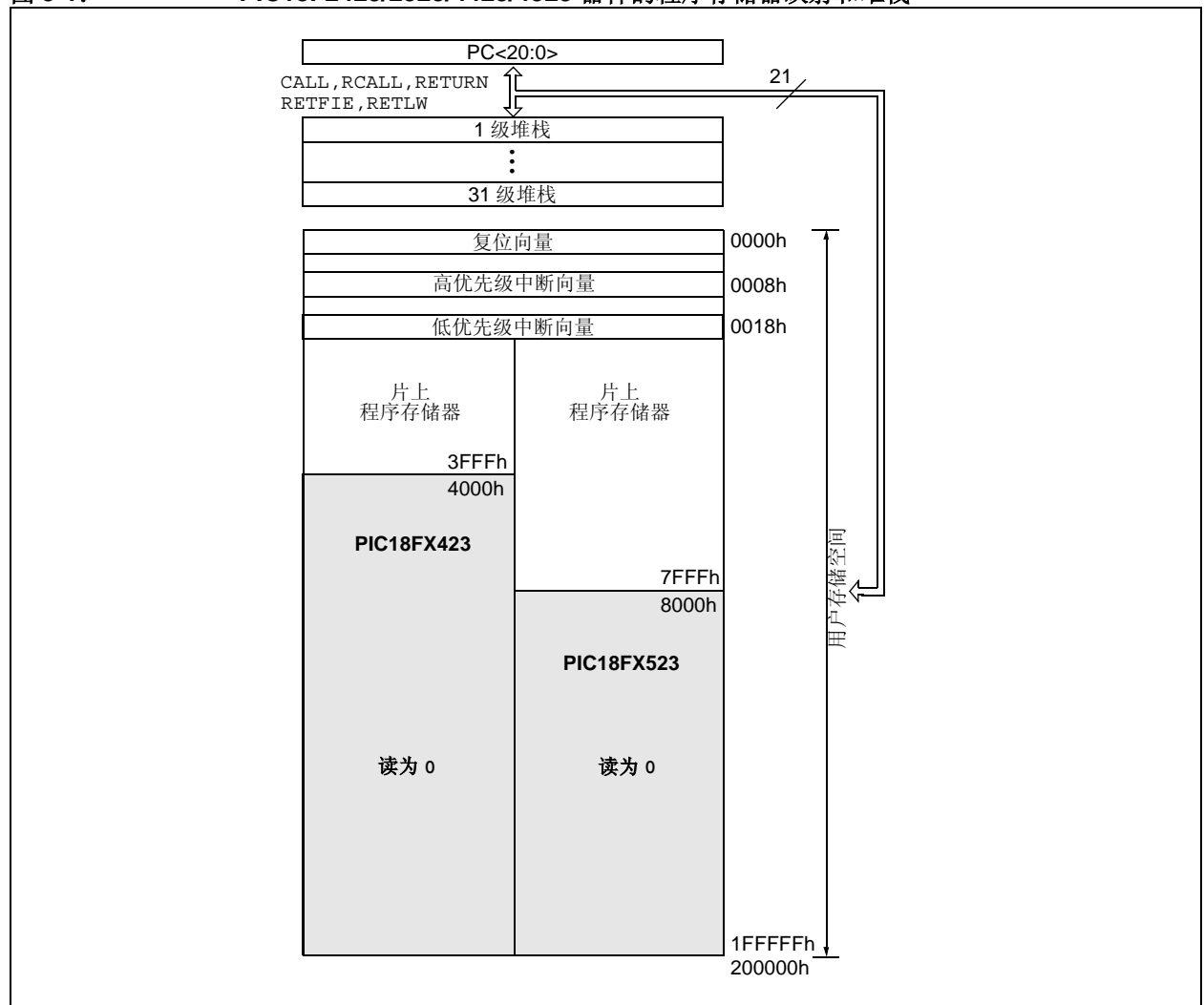
PIC18 单片机具有 21 位程序计数器, 可以对 2 MB 的程序存储空间进行寻址。访问物理实现存储器的上边界和这个 2 MB 地址之间的存储单元会返回全 0 (NOP 指令)。

PIC18F2423 和 PIC18F4423 各有 16 KB 的闪存存储器, 可以存储最多 8,192 条单字指令。PIC18F2523 和 PIC18F4523 各有 32 KB 的闪存存储器, 可以存储最多 16,384 条单字指令。

PIC18 器件有两个中断向量。复位向量地址为 0000h, 中断向量地址为 0008h 和 0018h。

图 5-1 给出了 PIC18F2423/2523/4423/4523 器件的程序存储器映射。

图 5-1: PIC18F2423/2523/4423/4523 器件的程序存储器映射和堆栈



PIC18F2423/2523/4423/4523

5.1.1 程序计数器

程序计数器（Program Counter, PC）指定欲取出执行的指令的地址。PC 为 21 位宽，保存在三个不同的 8 位寄存器中。存储低字节的寄存器称为 PCL 寄存器，该寄存器可读写。存储高字节的寄存器，即 PCH 寄存器，存储 PC<15:8> 位；该寄存器不可直接读写。更新 PCH 寄存器的操作是通过 PCLATH 寄存器实现的。存储最高字节的寄存器称为 PCU。该寄存器存储 PC<20:16> 位；它也不能直接读写。更新 PCU 寄存器的操作是通过 PCLATU 寄存器实现的。

PCLATH 和 PCLATU 的内容通过写 PCL 的任何操作传送到程序计数器。同样，程序计数器的两个高字节通过读 PCL 的操作传送到 PCLATH 和 PCLATU。这对于计算 PC 的偏移量很有用处（见第 5.1.4.1 节“计算 GOTO”）。

PC 是按字节寻址程序存储器的。为了防止 PC 不能正确获取字指令，需要将 PCL 的最低有效位固定取值为 0。PC 每次递增 2 来寻址程序存储器中的顺序指令。

CALL、RCALL、GOTO 和程序转移指令直接写入程序计数器。对于这些指令，PCLATH 和 PCLATU 的内容不会传送到程序计数器。

5.1.2 返回地址堆栈

返回地址堆栈允许保存最多 31 个程序调用地址和中断向量。当执行 CALL、RCALL 指令或响应中断时，PC 值会被压入该堆栈。而在执行 RETURN、RETLW 或 RETFIE 指令时，PC 值会从堆栈弹出。PCLATU 和 PCLATH 不受 RETURN 或 CALL 指令的影响。

通过 21 位的 RAM 和一个 5 位的堆栈指针 STKPTR 来实现 31 字的堆栈操作。堆栈既不占用程序存储器空间，也不占用数据存储器空间。堆栈指针是可读写的，并且通过栈顶的特殊功能寄存器可以读写栈顶地址。也可以使用这些寄存器将数据压入堆栈或者从堆栈弹出。

执行 CALL 类型的指令时，执行进栈操作：首先堆栈指针递增 1，并且将 PC 的内容写入堆栈指针所指向的存储单元（PC 已经指向 CALL 指令的下一条指令）。执行 RETURN 类型的指令时，执行出栈操作：STKPTR 所指向的存储单元的内容会被传送给 PC，然后堆栈指针递减 1。

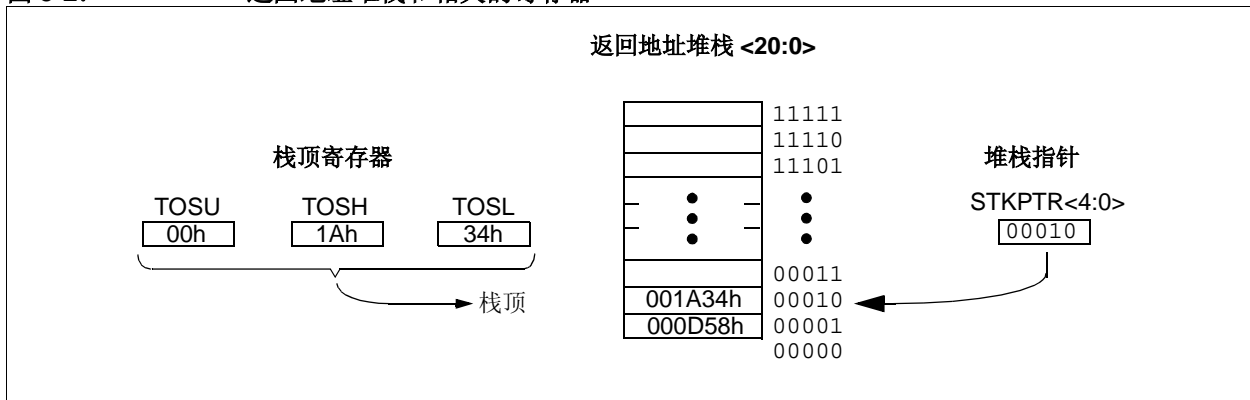
所有复位后，堆栈指针均会初始化为 00000。堆栈指针值 00000 不指向任何 RAM 单元；它仅仅是一个复位值。状态位表明堆栈是否已满，是否已溢出或下溢。

5.1.2.1 访问栈顶

只可读写返回地址堆栈的栈顶（Top-of-Stack, TOS）。有三个寄存器 TOSU:TOSH:TOSL 用于保存由 STKPTR 寄存器所指向的堆栈单元的内容（图 5-2）。这可以让用户在必要时实现软件堆栈。在 CALL、RCALL 或中断后，软件可以通过读取 TOSU:TOSH:TOSL 寄存器来读取压入堆栈的值。这些值可以被存放到由用户定义的软件堆栈。返回时，软件将这些值存回 TOSU:TOSH:TOSL 并执行返回。

为防止意外的堆栈操作，访问堆栈时用户必须禁止全局中断允许位。

图 5-2: 返回地址堆栈和相关的寄存器



5.1.2.2 返回堆栈指针 (STKPTR)

STKPTR 寄存器 (寄存器 5-1) 包含堆栈指针值、STKFUL (堆栈满) 状态位和 STKUNF (堆栈下溢) 状态位。堆栈指针值可为 0 到 31 范围内的值。向堆栈压入值前, 堆栈指针递增 1; 而从堆栈弹出值后, 堆栈指针递减 1。复位时, 堆栈指针值为零。用户可以读写堆栈指针的值。实时操作系统 (Real-Time Operating System, RTOS) 可以利用此特性对返回堆栈进行维护。

向堆栈压入 PC 值 31 次 (且没有值从堆栈弹出) 后, STKFUL 位置 1。通过软件或 POR 使 STKFUL 位清零。

由 STVREN (堆栈溢出复位使能) 配置位的状态决定堆栈满时将执行的操作。(关于器件配置位的说明, 请参见第 23.1 节“配置位”。) 如果 STVREN 位置 1 (默认), 第 31 次进栈将把 (PC + 2) 值压入堆栈, 将 STKFUL 位置 1 并复位器件。STKFUL 位将保持置 1, 而堆栈指针将被清零。

如果 STVREN 值清零, 第 31 次进栈时 STKFUL 位将会置 1, 堆栈指针值递增到 31。任何其他进栈操作都不会覆盖第 31 次进栈的值, 并且 STKPTR 将保持为 31。

当堆栈弹出次数足够卸空堆栈时, 下一次出栈会向 PC 返回一个零值, 并将 STKUNF 位置 1, 而堆栈指针则保持为零。STKUNF 位将保持置 1, 直到由软件清零或发生 POR 为止。

注: 下溢时, 将零值返回给 PC, 会使程序指向复位向量, 此时可以验证堆栈状态并采取相应的操作。这与复位不同, 因为下溢时 SFR 的内容不受影响。

5.1.2.3 PUSH 和 POP 指令

由于栈顶是可以读写的, 因此将值压入堆栈或从堆栈弹出而不影响程序的正常执行是非常理想的。PIC18 指令集包含两条指令 PUSH 和 POP, 使用这两条指令可在软件控制下对 TOS 执行操作。然后就可以修改 TOSU、TOSH 和 TOSL, 将数据或返回地址压入堆栈。

PUSH 指令将当前的 PC 值压入堆栈。执行该指令会使堆栈指针递增 1 并将当前的 PC 值装入堆栈。

POP 指令通过将堆栈指针递减 1 来放弃当前的 TOS 值。然后前一个入栈的值就成为了 TOS 值。

寄存器 5-1: STKPTR: 堆栈指针寄存器

R/C-0	R/C-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
STKFUL ⁽¹⁾	STKUNF ⁽¹⁾	—	SP4	SP3	SP2	SP1	SP0
bit 7							bit 0

图注:	C = 可清零位	U = 未实现位, 读为 0
R = 可读位	W = 可写位	0 = 清零
-n = POR 值	1 = 置 1	x = 未知

- bit 7 **STKFUL:** 堆栈满标志位 ⁽¹⁾
1 = 堆栈满或溢出
0 = 堆栈未满或未溢出
- bit 6 **STKUNF:** 堆栈下溢标志位 ⁽¹⁾
1 = 发生堆栈下溢
0 = 未发生堆栈下溢
- bit 5 **未实现:** 读为 0
- bit 4-0 **SP4:SP0:** 堆栈指针值位

注 1: 通过用户软件或 POR 清零 bit 7 和 bit 6。

PIC18F2423/2523/4423/4523

5.1.2.4 堆栈满和下溢复位

通过将配置寄存器 4L 中的 STVREN 位置 1，来使能在堆栈溢出或下溢时的器件复位。当 STVREN 置 1 时，堆栈满或堆栈下溢状态会将相应的 STKFUL 或 STKUNF 位置 1，然后使器件复位。当 STVREN 清零时，堆栈满或堆栈下溢状态会将相应的 STKFUL 或 STKUNF 位置 1，但不会使器件复位。只能通过用户软件或上电复位使 STKFUL 或 STKUNF 位清零。

5.1.3 快速寄存器堆栈

为 STATUS、WREG 和 BSR 寄存器提供的快速寄存器堆栈具有从中断“快速返回”的功能。每个寄存器的堆栈只有一级且不可读写。当处理器转入中断向量处执行时，它装入对应寄存器的当前值。所有中断源都会将值压入堆栈寄存器。如果使用 RETFIE, FAST 指令从中断返回，这些寄存器中的值就会重新装回相关的寄存器。

如果同时允许低优先级中断和高优先级中断，从低优先级中断返回时，无法可靠地使用堆栈寄存器。如果在低优先级中断提供服务时，发生了高优先级中断，则低优先级中断存储在堆栈寄存器中的值将被覆盖。在为低优先级中断提供服务时，用户必须用软件保存关键寄存器的值。

如果未使用中断优先级，所有中断都可以使用快速寄存器堆栈从中断返回。如果没有使用中断，快速寄存器堆栈可以用于在子程序调用结束时恢复 STATUS、WREG 和 BSR 寄存器。要在子程序调用中使用快速寄存器堆栈，必须执行 CALL label 和 FAST 指令将 STATUS、WREG 和 BSR 寄存器的内容存入快速寄存器堆栈。然后执行 RETURN 和 FAST 指令从快速寄存器堆栈恢复这些寄存器。

例 5-1 给出了一个在子程序调用和返回期间使用快速寄存器堆栈的源代码示例。

例 5-1: 快速寄存器堆栈代码示例

```
CALL SUB1, FAST      ;STATUS, WREG, BSR
                    ;SAVED IN FAST REGISTER
                    ;STACK
    .
    .
SUB1    .
    .
        RETURN, FAST ;RESTORE VALUES SAVED
                    ;IN FAST REGISTER STACK
```

5.1.4 程序存储器中的查找表

有的编程场合需要在程序存储器中创建数据结构或查找表。对于 PIC18 器件，可以用两种方式实现查找表：

- 计算 GOTO
- 表读

5.1.4.1 计算 GOTO

计算 GOTO 是通过向程序计数器加一个偏移量来实现的。例 5-2 给出了一个示例。

使用 ADDWF PCL 指令和一组 RETLW nn 指令可以创建一个查找表。在调用该表前，会先将查找表中的偏移量装入 W 寄存器。被调用子程序的第一条指令应该是 ADDWF PCL 指令。接下去执行的一条是 RETLW nn 指令，它将值 nn 返回给调用函数。

偏移量 (WREG 中) 指定程序计数器应该增加的字节数，其值应该为 2 的倍数 (LSb = 0)。

在这种方式中，每个指令存储单元只能存储一个数据字节，并且要求返回地址堆栈还有空闲存储单元。

例 5-2: 使用偏移量计算 GOTO

```
MOVWF  OFFSET, W
CALL   TABLE
ORG    nn00h
TABLE  ADDWF  PCL
       RETLW nnh
       RETLW nnh
       RETLW nnh
       .
       .
       .
```

5.1.4.2 表读与表写

有一种更好的方法可以将数据存储在程序存储器中，这种方法允许在每个指令存储单元存储 2 个字节的数据。

使用表读和表写，每个程序字可以存储 2 个字节的查找表数据。表指针 (TBLPTR) 寄存器指定字节地址，而表锁存 (TABLAT) 寄存器存储从程序存储器中读取或写入的数据。一次只能向程序存储器或从程序存储器传送一个字节。

第 6.1 节“表读与表写”将进一步讨论表读和表写操作。

5.2 PIC18 指令周期

5.2.1 时钟分配

来自内部或外部时钟源的单片机时钟输入都将在内部被四分频以产生四个互不重叠的正交时钟信号 (Q1、Q2、Q3 和 Q4)。在单片机内部，程序计数器在每个 Q1 递增；在 Q4 期间，从程序存储器取指令并将指令锁存到指令寄存器中。指令的译码和执行在下一个 Q1 到 Q4 周期完成。图 5-3 所示为时钟和指令执行的流程图。

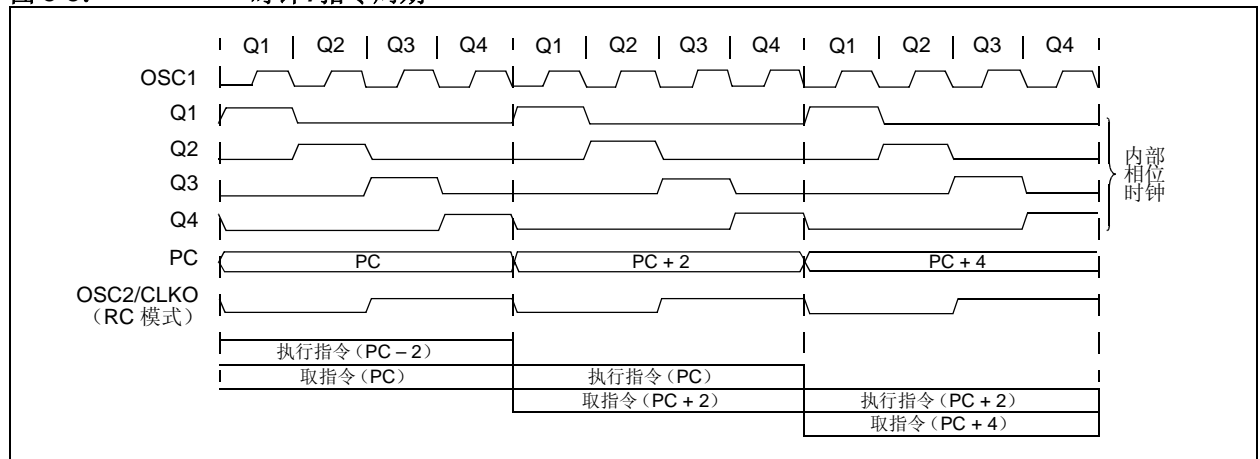
5.2.2 指令流 / 流水线

一个“指令周期”由 4 个 Q 周期组成：Q1 到 Q4。取指令和执行指令是以流水线方式进行的，用一个指令周期来取指令，而用另一个指令周期译码和执行指令。但由于是流水线操作，所以每条指令的等效执行时间都是一个指令周期。如果某条指令改变了程序计数器（如 GOTO），则需要两个指令周期才能完成该指令（例 5-3）。

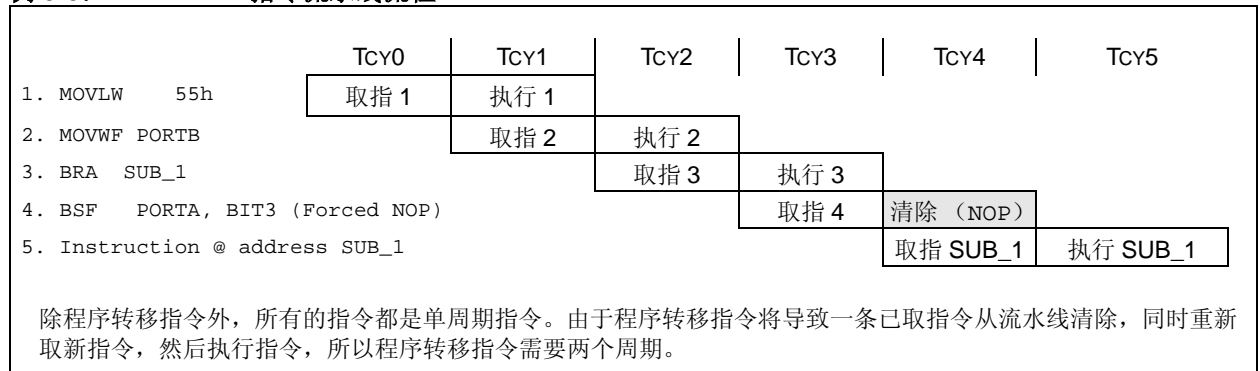
取指周期中：程序计数器（PC）在 Q1 周期递增 1，开始取指令。

指令执行周期中：在 Q1 周期，将所取指令锁存到指令寄存器（IR）。在随后的 Q2、Q3 和 Q4 周期中译码并执行该指令。其中读数据存储器（读操作数）发生在 Q2 周期，写操作（写目标寄存器）发生在 Q4 周期。

图 5-3: 时钟 / 指令周期



例 5-3: 指令流水线流程



PIC18F2423/2523/4423/4523

5.2.3 程序存储器中的指令

程序存储器按字节寻址。指令以 2 字节或 4 字节的形式存储在程序存储器中。指令字的最低有效字节始终存储在地址为偶数的程序存储单元中 (LSb = 0)。要保证正确指向指令存储单元, PC 必须以 2 为单位递增, 并且 LSb 总是读为 0 (见第 5.1.1 节“程序计数器”)。

图 5-4 给出了如何将指令字存储在程序存储器中的一个示例。

CALL 和 GOTO 指令在指令中嵌入了程序存储器的绝对地址。由于指令总是按字边界存储, 因而指令所包含的数据为一个字地址。字地址会写入 PC<20:1>, 用于访问程序存储器中的目标字节地址。图 5-4 中的指令 #2 给出了指令 GOTO 0006h 在程序存储器中的编码。程序转移指令也采取同样的方式对相对地址偏移量进行编码。存储在转移指令中的偏移量代表单字指令数, PC 将以此作为偏移量跳转到指定的地址单元。第 24.0 节“指令集汇总”提供了指令集的更多详细信息。

图 5-4: 程序存储器中的指令

			LSB = 1	LSB = 0	字地址 ↓
程序存储器 字节存储单元 →					000000h
					000002h
					000004h
					000006h
指令 1:	MOVLW	055h	0Fh	55h	000008h
指令 2:	GOTO	0006h	EFh	03h	00000Ah
			F0h	00h	00000Ch
指令 3:	MOVFF	123h, 456h	C1h	23h	00000Eh
			F4h	56h	000010h
					000012h
					000014h

5.2.4 双字指令

标准的 PIC18 指令集有 4 条双字指令: CALL、MOVFF、GOTO 和 LSRF。这些指令第二个字的高 4 位均为 1111; 其他 12 位是立即数数据, 通常为一个数据存储器地址。

指令的高 4 位为 1111, 用于代表一条特殊的 NOP 指令。指令顺序执行的正确顺序为: 执行完第一个字之后立即按顺序访问并使用第二个字中的数据。如果由于某些原

因跳过了第一个字而自动执行指令的第二个字, 那么将作为一条 NOP 指令执行。如果双字指令跟在修改 PC 的条件指令后, 就有必要执行此操作。例 5-4 给出了它的执行过程。

注: 关于扩展指令集中的双字指令信息, 请参见第 5.6 节“PIC18 指令执行和扩展指令集”。

例 5-4: 双字指令

情形 1:		
目标代码	源代码	
0110 0110 0000 0000	TSTFSZ	REG1 ; is RAM location 0?
1100 0001 0010 0011	MOVFF	REG1, REG2 ; No, skip this word
1111 0100 0101 0110		; Execute this word as a NOP
0010 0100 0000 0000	ADDWF	REG3 ; continue code
情形 2:		
目标代码	源代码	
0110 0110 0000 0000	TSTFSZ	REG1 ; is RAM location 0?
1100 0001 0010 0011	MOVFF	REG1, REG2 ; Yes, execute this word
1111 0100 0101 0110		; 2nd word of instruction
0010 0100 0000 0000	ADDWF	REG3 ; continue code

5.3 数据存储器构成

注： 当使能了 PIC18 扩展指令集时，数据存储器某些方面的操作会有所改变。更多信息，请参见第 5.5 节“数据存储器 and 扩展指令集”。

PIC18 器件中的数据存储器是用静态 RAM 实现的。每个数据存储器寄存器有 12 位地址，可存储数据达 4096 个字节。存储空间被分为 16 个存储区，每个存储区包含 256 个字节。PIC18F2423/2523/4423/4523 器件实现了所有 16 个存储区。图 5-5 给出了 PIC18F2423/2523/4423/4523 器件的数据存储器构成。

数据存储器由特殊功能寄存器（Special Function Register, SFR）和通用寄存器（General Purpose Register, GPR）组成。SFR 用于单片机和外设功能模块的控制和状态指示，GPR 则用于在用户应用程序中存储数据和暂存中间结果。任何未实现存储单元均读为 0。

这样的指令集和架构支持跨存储区的操作。可以通过直接、间接或变址寻址模式访问整个数据存储器。本章后面的部分将讨论寻址模式。

为确保能在一个周期内访问常用寄存器（SFR 和某些 GPR），PIC18 器件实现了一个快速操作存储区。该存储区是一个 256 字节的存储空间，它可实现对 SFR 和 GPR Bank 0 的低地址单元的快速访问，而无需使用 BSR。第 5.3.2 节“快速操作存储区”提供了对于快速操作 RAM 的详细说明。

5.3.1 存储区选择寄存器（BSR）

容量较大的数据存储器需要高效的寻址机制，以便对所有地址进行快速访问。理想状况下，这意味着不必为每次读写操作提供完整地址。PIC18 器件是使用 RAM 存储区机制实现快速访问的。这种机制将存储空间分成连续的 16 个 256 字节的存储区。根据不同的指令，可以通过完整的 12 位地址直接寻址每个存储单元，或通过 8 位的低字节地址和 4 位存储区指针寻址每个存储单元。

PIC18 指令集中的大部分指令都使用存储区指针，也就是存储区选择寄存器（Bank Select Register, BSR）。SFR 保存该存储单元地址的高 4 位，而指令本身则包括存储单元地址的低 8 位。只使用 BSR 的低 4 位（BSR3:BSR0），不使用高 4 位；它们始终读为 0 且不能被写入。可以通过使用 MOVLB 指令直接装载 BSR。

BSR 的值代表数据存储器中的存储区；指令中的 8 位指向存储区中的存储单元，可以将它看作距离存储区下边界的偏移量。图 5-7 显示了 BSR 的值与数据存储器中的存储区之间的关系。

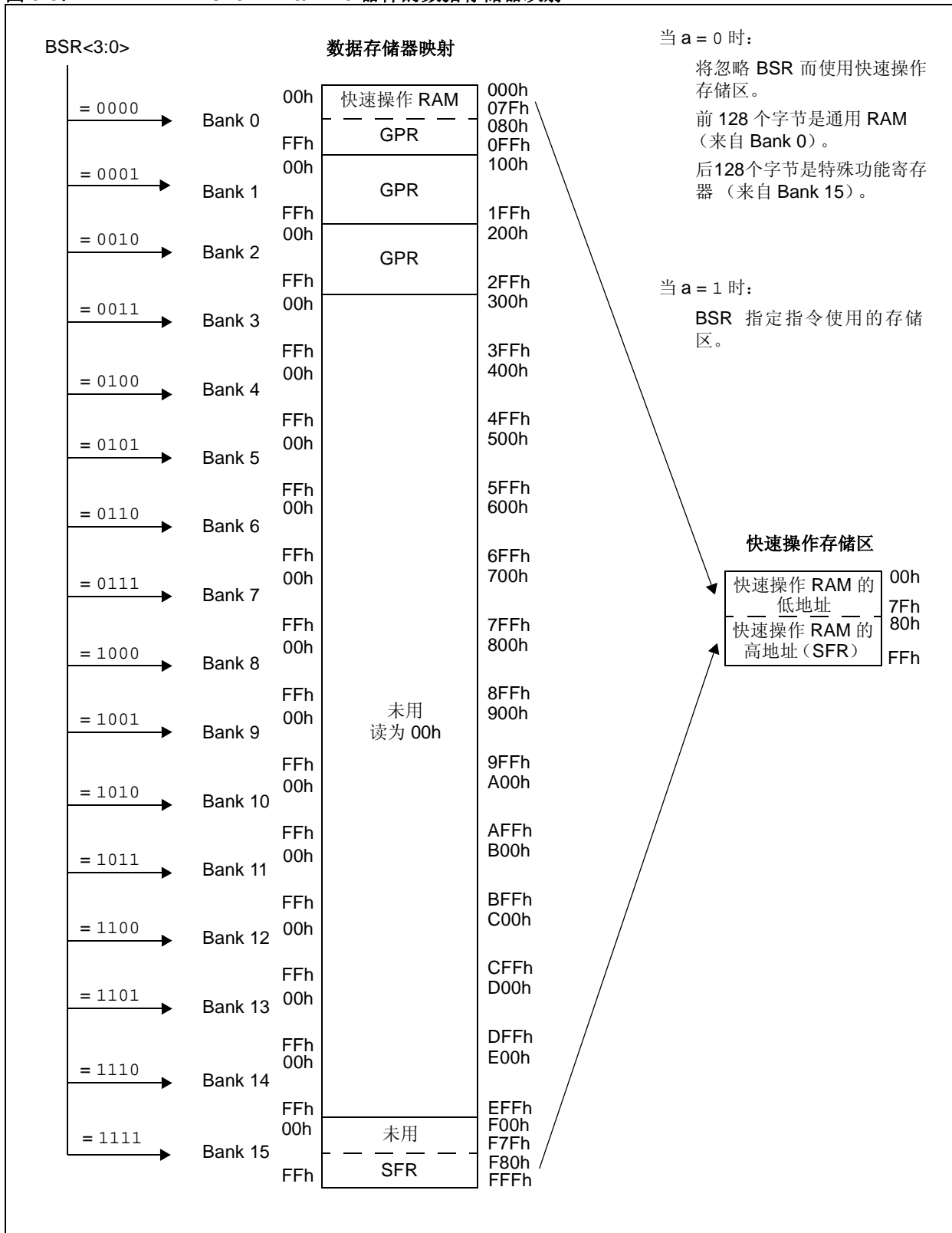
由于最多可有 16 个寄存器共享同一个低字节地址，用户必须非常小心以确保在执行数据读或写之前选择了正确的存储区。例如，当 BSR 为 0Fh 时将程序数据写入地址为 F9h 的 8 位地址单元，将导致程序计数器的复位。

当选择存储区时，只有实际实现的存储区才可以读写。对未实现存储区进行的写操作将被忽略，而读这些存储区会返回 0。虽然是这样，STATUS 寄存器仍然会受到影响，好像操作是成功的。图 5-5 和图 5-6 中的数据存储器映射指出了已实现的存储区。

在 PIC18 的核心指令集中，只有 MOVFF 指令指定源寄存器和目标寄存器的完整 12 位地址。该指令在执行时完全忽略 BSR。所有其他指令仅包含作为操作数的低字节地址，而且必须使用 BSR 或快速操作存储区来定位目标寄存器。

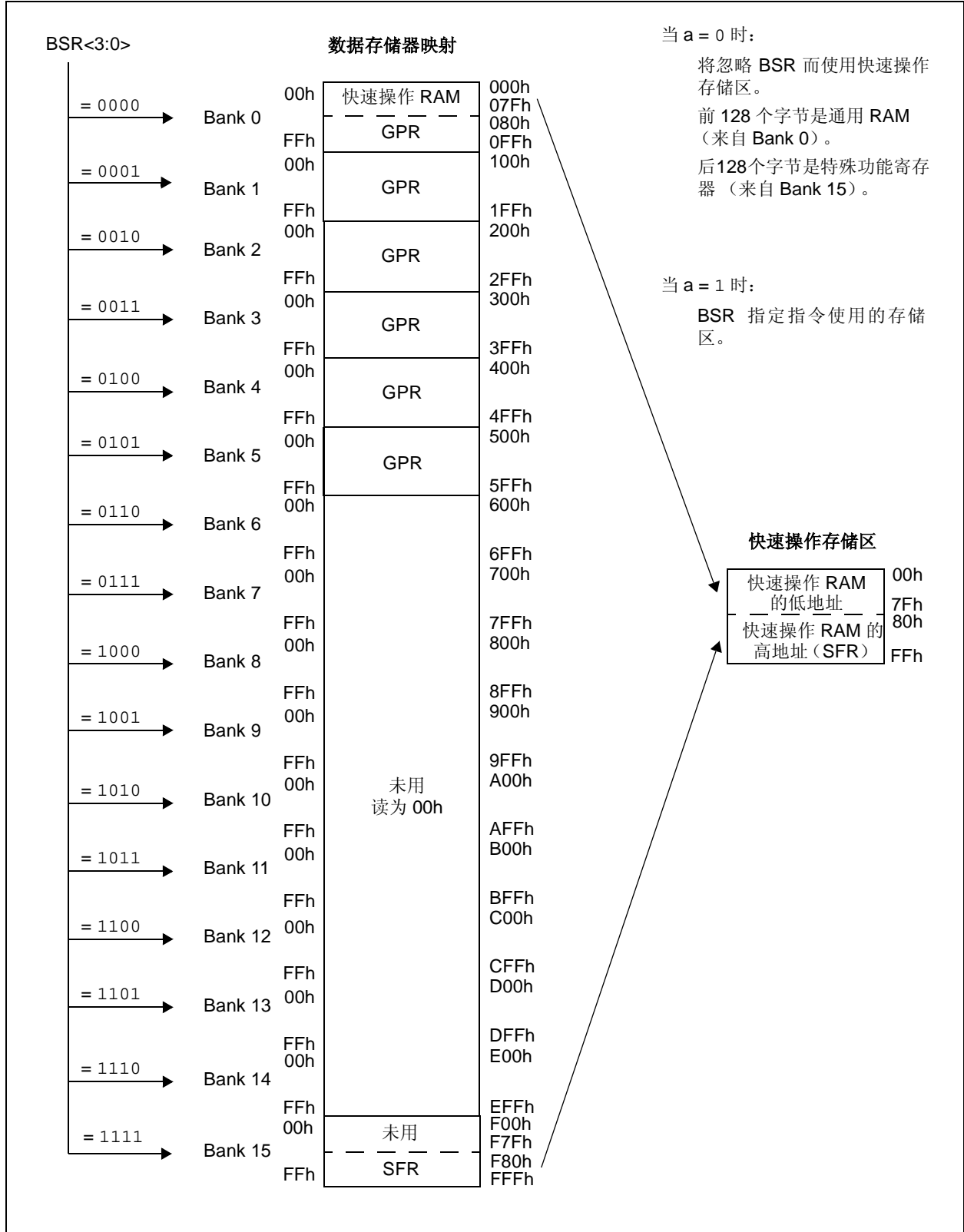
PIC18F2423/2523/4423/4523

图 5-5: PIC18F2423/4423 器件的数据存储器映射



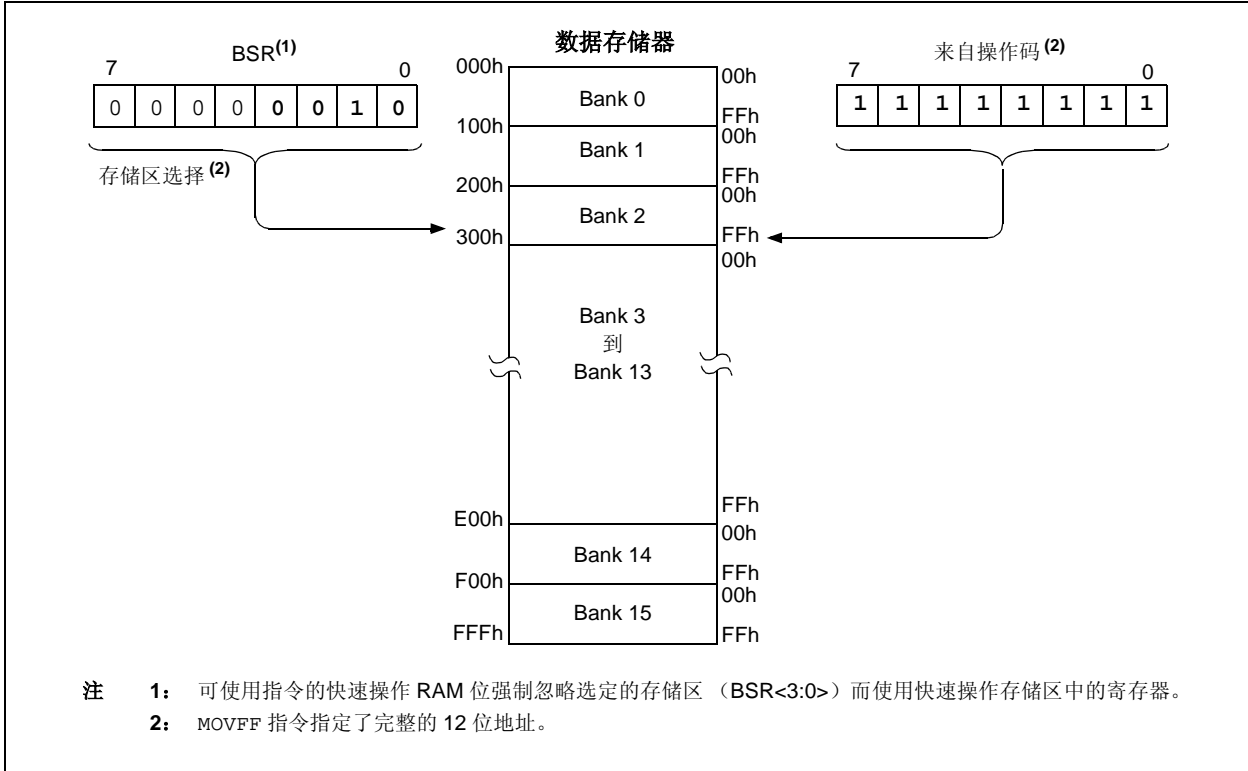
PIC18F2423/2523/4423/4523

图 5-6: PIC18F2523/4523 器件的数据存储器映射



PIC18F2423/2523/4423/4523

图 5-7: 使用存储区选择寄存器 (指向 0x02FF 的直接寻址)



5.3.2 快速操作存储区

使用 BSR 和在指令中包含 8 位地址，用户可以寻址数据存储器整个空间，但这同时也意味着用户必须始终确保选择了正确的存储区。否则，可能会从错误的存储单元读取数据或将数据写入错误的存储单元。如果本来希望对一个 GPR 执行写操作，却将结果写入了一个 SFR，后果是非常严重的。但是在每次对数据存储器进行读或写操作时确认和 / 或更改 BSR 会降低效率。

为了简化对大多数常用数据存储单元的访问，在数据存储器中配置了快速操作存储区，这样可以允许用户访问被映射的存储区而无需指定 BSR。快速操作存储区由 Bank 0 的前 128 个字节 (00h-7Fh) 和 Bank 15 的后 128 个字节 (80h-FFh) 组成。低半部分称为“快速操作 RAM”，由 GPR 组成。高半部分则被映射为器件的 SFR。这两个区域被连续地映射到快速操作存储区并且可以用一个 8 位地址进行线性寻址 (图 5-5)。

快速操作存储区由包含快速操作 RAM 位 (指令中的“a”参数) 的 PIC18 核心指令使用。当“a”等于 1 时，指令使用 BSR 和包含在操作码中的 8 位地址对数据存储器寻址。当“a”为 0 时，强制指令使用快速操作存储区地址映射，此时完全忽略 BSR 的当前值。

此“强制”寻址模式可使指令在一个周期内对数据地址进行操作，而不需要首先更新 BSR。这意味着用户可以更高效地对 8 位地址为 80h 或以上的 SFR 进行求值和操作。地址低于 80h 的快速操作 RAM 非常适合于存储那些用户可能需要快速访问的数据值，如直接计算结果或常用程序变量。快速操作 RAM 也可实现更加快速和高效的现场保护和变量切换。

使能扩展的指令集 (XINST 配置位 = 1) 时的快速操作存储区映射略有不同。在第 5.5.3 节“在立即数变址寻址模式下映射快速操作存储区”中对此进行了更详细的讨论。

5.3.3 通用寄存器文件

PIC18 器件的 GPR 区中包含了分区存储区。这部分存储区为数据 RAM，所有指令均可使用它。GPR 区从 Bank 0 的最低地址 (地址 000h) 开始向上直到 SFR 区的最低地址。上电复位不会初始化 GPR，并且其他复位也不会改变其内容。

PIC18F2423/2523/4423/4523

5.3.4 特殊功能寄存器

特殊功能寄存器（SFR）是 CPU 和外设模块用来控制器件操作的寄存器。这些寄存器以静态 RAM 的形式实现。SFR 从数据存储器的顶部（FFFh）开始向下延伸，它占据了 Bank 15 上半部分的空间（F80h 到 FFFh）。表 5-1 和表 5-2 列出了这些寄存器。

可以将 SFR 归类为两组：与“内核”器件功能（ALU、复位和中断）相关的寄存器和与外设功能相关的寄存器。复位和中断寄存器在相关的章节中进行讨论，本章后面的部分将对 ALU 的 STATUS 寄存器进行说明。与外设操作相关的寄存器将在相应外设的章节中进行说明。

SFR 通常分布在功能受其控制的外设中。未使用的 SFR 单元是未实现的，读为 0。

表 5-1: PIC18F2423/2523/4423/4523 器件的特殊功能寄存器映射

地址	名称	地址	名称	地址	名称	地址	名称
FFFh	TOSU	FDfH	INDF2 ⁽¹⁾	FBFh	CCPR1H	F9Fh	IPR1
FFEh	TOSH	FDEh	POSTINC2 ⁽¹⁾	FBEh	CCPR1L	F9Eh	PIR1
FFDh	TOSL	FDDh	POSTDEC2 ⁽¹⁾	FBDh	CCP1CON	F9Dh	PIE1
FFCh	STKPTR	FDCh	PREINC2 ⁽¹⁾	FBCh	CCPR2H	F9Ch	— ⁽²⁾
FFBh	PCLATU	FDBh	PLUSW2 ⁽¹⁾	FBHh	CCPR2L	F9Bh	OSCTUNE
FFAh	PCLATH	FDAh	FSR2H	FBAh	CCP2CON	F9Ah	— ⁽²⁾
FF9h	PCL	FD9h	FSR2L	FB9h	— ⁽²⁾	F99h	— ⁽²⁾
FF8h	TBLPTRU	FD8h	STATUS	FB8h	BAUDCON	F98h	— ⁽²⁾
FF7h	TBLPTRH	FD7h	TMR0H	FB7h	ECCP1DEL ⁽³⁾	F97h	— ⁽²⁾
FF6h	TBLPTRL	FD6h	TMR0L	FB6h	ECCP1AS ⁽³⁾	F96h	TRISE ⁽³⁾
FF5h	TABLAT	FD5h	T0CON	FB5h	CVRCON	F95h	TRISD ⁽³⁾
FF4h	PRODH	FD4h	— ⁽²⁾	FB4h	CMCON	F94h	TRISC
FF3h	PRODL	FD3h	OSCCON	FB3h	TMR3H	F93h	TRISB
FF2h	INTCON	FD2h	HLVDCON	FB2h	TMR3L	F92h	TRISA
FF1h	INTCON2	FD1h	WDTCON	FB1h	T3CON	F91h	— ⁽²⁾
FF0h	INTCON3	FD0h	RCON	FB0h	SPBRGH	F90h	— ⁽²⁾
FEFh	INDF0 ⁽¹⁾	FCFh	TMR1H	FAFh	SPBRG	F8Fh	— ⁽²⁾
FEeh	POSTINC0 ⁽¹⁾	FCEh	TMR1L	FAEh	RCREG	F8Eh	— ⁽²⁾
FEDh	POSTDEC0 ⁽¹⁾	FCDh	T1CON	FADh	TXREG	F8Dh	LATE ⁽³⁾
FECh	PREINC0 ⁽¹⁾	FCCh	TMR2	FACh	TXSTA	F8Ch	LATD ⁽³⁾
FEbh	PLUSW0 ⁽¹⁾	FCBh	PR2	FABh	RCSTA	F8Bh	LATC
FEAh	FSR0H	FCAh	T2CON	FAAh	— ⁽²⁾	F8Ah	LATB
FE9h	FSR0L	FC9h	SSPBUF	FA9h	EEADR	F89h	LATA
FE8h	WREG	FC8h	SSPADD	FA8h	EEDATA	F88h	— ⁽²⁾
FE7h	INDF1 ⁽¹⁾	FC7h	SSPSTAT	FA7h	EECON2 ⁽¹⁾	F87h	— ⁽²⁾
FE6h	POSTINC1 ⁽¹⁾	FC6h	SSPCON1	FA6h	EECON1	F86h	— ⁽²⁾
FE5h	POSTDEC1 ⁽¹⁾	FC5h	SSPCON2	FA5h	— ⁽²⁾	F85h	— ⁽²⁾
FE4h	PREINC1 ⁽¹⁾	FC4h	ADRESH	FA4h	— ⁽²⁾	F84h	PORTE ⁽³⁾
FE3h	PLUSW1 ⁽¹⁾	FC3h	ADRESL	FA3h	— ⁽²⁾	F83h	PORTD ⁽³⁾
FE2h	FSR1H	FC2h	ADCON0	FA2h	IPR2	F82h	PORTC
FE1h	FSR1L	FC1h	ADCON1	FA1h	PIR2	F81h	PORTB
FE0h	BSR	FC0h	ADCON2	FA0h	PIE2	F80h	PORTA

- 注 1: 这不是实际存在的寄存器。
 注 2: 未实现的寄存器，读为 0。
 注 3: 28 引脚器件不包含此寄存器。

PIC18F2423/2523/4423/4523

表 5-2: 寄存器文件汇总 (PIC18F2423/2523/4423/4523)

寄存器名称	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	POR/BOR 时的值	详情请见 (页):		
TOSU	—	—	—	栈顶最高字节 (TOS<20:16>)					---0 0000	49, 54		
TOSH	栈顶高字节 (TOS<15:8>)								0000 0000	49, 54		
TOSL	栈顶低字节 (TOS<7:0>)								0000 0000	49, 54		
STKPTR	STKFUL	STKUNF	—	SP4	SP3	SP2	SP1	SP0	00-0 0000	49, 55		
PCLATU	—	—	—	PC<20:16> 的保持寄存器					---0 0000	49, 54		
PCLATH	PC<15:8> 的保持寄存器								0000 0000	49, 54		
PCL	PC 低字节 (PC<7:0>)								0000 0000	49, 54		
TBLPTRU	—	—	bit 21	程序存储器表指针最高字节 (TBLPTR<20:16>)							--00 0000	49, 76
TBLPTRH	程序存储器表指针高字节 (TBLPTR<15:8>)								0000 0000	49, 76		
TBLPTRL	程序存储器表指针低字节 (TBLPTR<7:0>)								0000 0000	49, 76		
TABLAT	程序存储器表锁存器								0000 0000	49, 76		
PRODH	乘积寄存器的高字节								xxxx xxxx	49, 89		
PRODL	乘积寄存器的低字节								xxxx xxxx	49, 89		
INTCON	GIE/GIEH	PEIE/GIEL	TMR0IE	INT0IE	RBIE	TMR0IF	INT0IF	RBIF	0000 000x	49, 93		
INTCON2	RBPV	INTEDG0	INTEDG1	INTEDG2	—	TMR0IP	—	RBIP	1111 -1-1	49, 94		
INTCON3	INT2IP	INT1IP	—	INT2IE	INT1IE	—	INT2IF	INT1IF	11-0 0-00	49, 95		
INDF0	使用 FSR0 的内容寻址数据存储器——FSR0 的值不变 (不是实际存在的寄存器)								N/A	49, 69		
POSTINC0	使用 FSR0 的内容寻址数据存储器——FSR0 的值后递增 (不是实际存在的寄存器)								N/A	49, 69		
POSTDEC0	使用 FSR0 的内容寻址数据存储器——FSR0 的值后递减 (不是实际存在的寄存器)								N/A	49, 69		
PREINC0	使用 FSR0 的内容寻址数据存储器——FSR0 的值预递增 (不是实际存在的寄存器)								N/A	49, 69		
PLUSW0	使用 FSR0 的内容寻址数据存储器——FSR0 的值预递增 (不是实际存在的寄存器), FSR0 的偏移量由 W 寄存器提供								N/A	49, 69		
FSR0H	—	—	—	—	间接数据存储器地址指针 0 的高字节				---- 0000	49, 69		
FSR0L	间接数据存储器地址指针 0 的低字节								xxxx xxxx	49, 69		
WREG	工作寄存器								xxxx xxxx	49		
INDF1	使用 FSR1 的内容寻址数据存储器——FSR1 的值不变 (不是实际存在的寄存器)								N/A	49, 69		
POSTINC1	使用 FSR1 的内容寻址数据存储器——FSR1 的值后递增 (不是实际存在的寄存器)								N/A	49, 69		
POSTDEC1	使用 FSR1 的内容寻址数据存储器——FSR1 的值后递减 (不是实际存在的寄存器)								N/A	49, 69		
PREINC1	使用 FSR1 的内容寻址数据存储器——FSR1 的值预递增 (不是实际存在的寄存器)								N/A	49, 69		
PLUSW1	使用 FSR1 的内容寻址数据存储器——FSR1 的值预递增 (不是实际存在的寄存器), FSR1 的偏移量由 W 寄存器提供								N/A	49, 69		
FSR1H	—	—	—	—	间接数据存储器地址指针 1 的高字节				---- 0000	50, 69		
FSR1L	间接数据存储器地址指针 1 的低字节								xxxx xxxx	50, 69		
BSR	—	—	—	—	存储区选择寄存器				---- 0000	50, 59		
INDF2	使用 FSR2 的内容寻址数据存储器——FSR2 的值不变 (不是实际存在的寄存器)								N/A	50, 69		
POSTINC2	使用 FSR2 的内容寻址数据存储器——FSR2 的值后递增 (不是实际存在的寄存器)								N/A	50, 69		
POSTDEC2	使用 FSR2 的内容寻址数据存储器——FSR2 的值后递减 (不是实际存在的寄存器)								N/A	50, 69		
PREINC2	使用 FSR2 的内容寻址数据存储器——FSR2 的值预递增 (不是实际存在的寄存器)								N/A	50, 69		
PLUSW2	使用 FSR2 的内容寻址数据存储器——FSR2 的值预递增 (不是实际存在的寄存器), FSR2 的偏移量由 W 寄存器提供								N/A	50, 69		
FSR2H	—	—	—	—	间接数据存储器地址指针 2 的高字节				---- 0000	50, 69		
FSR2L	间接数据存储器地址指针 2 的低字节								xxxx xxxx	50, 69		
STATUS	—	—	—	N	OV	Z	DC	C	---x xxxx	50, 67		

- 图注: x = 未知, u = 不变, - = 未实现, q = 值取决于具体条件
- 1: SBOREN 位仅在 BOREN1:BOREN0 配置位 = 01 时可用; 否则, 它被禁止且读为 0。请参见第 4.4 节“欠压复位 (BOR)”。
 - 2: 这些寄存器和/或位在 28 引脚器件上未实现, 读为 0。提供的是 40/44 引脚器件的复位值; 各未实现位表示为 -。
 - 3: 只有在特定的振荡器配置中才可使用 PLEN 位; 否则, 它被禁止并读为 0。请参见第 2.6.4 节“INTOSC 模式下的 PLL”。
 - 4: 只有在禁止主复位 (MCLRRE 配置位 = 0) 时才可使用 RE3 位; 否则, RE3 读为 0。该位是只读的。
 - 5: 根据不同的主振荡器模式, 可将 RA6/RA7 及其相关的锁存器及方向位分别配置为端口引脚。这些位在禁止时读为 0。

PIC18F2423/2523/4423/4523

表 5-2: 寄存器文件汇总 (PIC18F2423/2523/4423/4523) (续)

寄存器名称	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	POR/BOR 时的值	详情请见 (页):
TMR0H	Timer0 寄存器的高字节								0000 0000	50, 125
TMR0L	Timer0 寄存器的低字节								xxxx xxxx	50, 125
T0CON	TMR0ON	T08BIT	T0CS	T0SE	PSA	T0PS2	T0PS1	T0PS0	1111 1111	50, 123
OSCCON	IDLEN	IRCF2	IRCF1	IRCF0	OSTS	IOFS	SCS1	SCS0	0100 q000	30, 50
HLVDCON	VDIRMAG	—	IRVST	HLVDEN	HLVDL3	HLVDL2	HLVDL1	HLVDL0	0-00 0101	50, 251
WDTCON	—	—	—	—	—	—	—	SWDTEN	--- --0	50, 263
RCON	IPEN	SBOREN ⁽¹⁾	—	RI	TO	PD	POR	BOR	0q-1 11q0	42, 48, 102
TMR1H	Timer1 寄存器的高字节								xxxx xxxx	50, 131
TMR1L	Timer1 寄存器的低字节								xxxx xxxx	50, 131
T1CON	RD16	T1RUN	T1CKPS1	T1CKPS0	T1OSCEN	T1SYNC	TMR1CS	TMR1ON	0000 0000	50, 127
TMR2	Timer2 寄存器								0000 0000	50, 134
PR2	Timer2 周期寄存器								1111 1111	50, 134
T2CON	—	T2OUTPS3	T2OUTPS2	T2OUTPS1	T2OUTPS0	TMR2ON	T2CKPS1	T2CKPS0	-000 0000	50, 133
SSPBUF	MSSP 接收缓冲器 / 发送寄存器								xxxx xxxx	50, 169, 170
SSPADD	I ² C™ 从动模式下的 MSSP 地址寄存器。I ² C 主控模式下的 MSSP 波特率重载寄存器。								0000 0000	50, 170
SSPSTAT	SMP	CKE	D/A	P	S	R/W	UA	BF	0000 0000	50, 162, 171
SSPCON1	WCOL	SSPOV	SSPEN	CKP	SSPM3	SSPM2	SSPM1	SSPM0	0000 0000	50, 163, 172
SSPCON2	GCEN	ACKSTAT	ACKDT/ADMSK5	ACKEN/ADMSK4	RCEN/ADMSK3	PEN/ADMSK2	RSEN/ADMSK1	SEN	0000 0000	50, 173
ADRESH	A/D 结果寄存器的高字节								xxxx xxxx	51, 236
ADRESL	A/D 结果寄存器的低字节								xxxx xxxx	51, 236
ADCON0	—	—	CHS3	CHS2	CHS1	CHS0	GO/DONE	ADON	--00 0000	51, 227
ADCON1	—	—	VCFG1	VCFG0	PCFG3	PCFG2	PCFG1	PCFG0	--00 0qqq	51, 228
ADCON2	ADFM	—	ACQT2	ACQT1	ACQT0	ADCS2	ADCS1	ADCS0	0-00 0000	51, 229
CCPR1H	捕捉 / 比较 / PWM 寄存器 1 的高字节								xxxx xxxx	51, 140
CCPR1L	捕捉 / 比较 / PWM 寄存器 1 的低字节								xxxx xxxx	51, 140
CCP1CON	P1M1 ⁽²⁾	P1M0 ⁽²⁾	DC1B1	DC1B0	CCP1M3	CCP1M2	CCP1M1	CCP1M0	0000 0000	51, 139, 147
CCPR2H	捕捉 / 比较 / PWM 寄存器 2 的高字节								xxxx xxxx	51, 140
CCPR2L	捕捉 / 比较 / PWM 寄存器 2 的低字节								xxxx xxxx	51, 140
CCP2CON	—	—	DC2B1	DC2B0	CCP2M3	CCP2M2	CCP2M1	CCP2M0	--00 0000	51, 139
BAUDCON	ABDOVF	RCIDL	—	SCKP	BRG16	—	WUE	ABDEN	01-0 0-00	51, 208
ECCP1DEL	PRSEN	PDC6 ⁽²⁾	PDC5 ⁽²⁾	PDC4 ⁽²⁾	PDC3 ⁽²⁾	PDC2 ⁽²⁾	PDC1 ⁽²⁾	PDC0 ⁽²⁾	0000 0000	51, 157
ECCP1AS	ECCPASE	ECCPAS2	ECCPAS1	ECCPAS0	PSSAC1	PSSAC0	PSSBD1 ⁽²⁾	PSSBD0 ⁽²⁾	0000 0000	51, 157
CVRCON	CVREN	CVROE	CVRR	CVRSS	CVR3	CVR2	CVR1	CVR0	0000 0000	51, 243
CMCON	C2OUT	C1OUT	C2INV	C1INV	CIS	CM2	CM1	CM0	0000 0111	51, 237
TMR3H	Timer3 寄存器的高字节								xxxx xxxx	51, 137
TMR3L	Timer3 寄存器的低字节								xxxx xxxx	51, 137
T3CON	RD16	T3CCP2	T3CKPS1	T3CKPS0	T3CCP1	T3SYNC	TMR3CS	TMR3ON	0000 0000	51, 135

- 图注: x = 未知, u = 不变, - = 未实现, q = 值取决于具体条件
- 注:
- 1: SBOREN 位仅在 BOREN1:BOREN0 配置位 = 01 时可用; 否则, 它被禁止且读为 0。请参见第 4.4 节“欠压复位 (BOR)”。
 - 2: 这些寄存器和 / 或在 28 引脚器件上未实现, 读为 0。提供的是 40/44 引脚器件的复位值; 各未实现位表示为 -。
 - 3: 只有在特定的振荡器配置中才可使用 PLEN 位; 否则, 它被禁止并读为 0。请参见第 2.6.4 节“INTOSC 模式下的 PLL”。
 - 4: 只有在禁止主复位 (MCLR 配置位 = 0) 时才可使用 RE3 位; 否则, RE3 读为 0。该位是只读的。
 - 5: 根据不同的主振荡器模式, 可将 RA6/RA7 及其相关的锁存器及方向位分别配置为端口引脚。这些位在禁止时读为 0。

PIC18F2423/2523/4423/4523

表 5-2: 寄存器文件汇总 (PIC18F2423/2523/4423/4523) (续)

寄存器名称	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	POR/BOR 时的值	详情请见 (页):	
SPBRGH	EUSART 波特率发生器寄存器的高字节								0000 0000	51, 210	
SPBRG	EUSART 波特率发生器寄存器的低字节								0000 0000	51, 210	
RCREG	EUSART 接收寄存器								0000 0000	51, 218	
TXREG	EUSART 发送寄存器								0000 0000	51, 216	
TXSTA	CSRC	TX9	TXEN	SYNC	SENDB	BRGH	TRMT	TX9D	0000 0010	51, 206	
RCSTA	SPEN	RX9	SREN	CREN	ADDEN	FERR	OERR	RX9D	0000 000x	51, 207	
EEADR	EEPROM 地址寄存器								0000 0000	51, 74, 83	
EEDATA	EEPROM 数据寄存器								0000 0000	51, 74, 83	
EECON2	EEPROM 控制寄存器 2 (不是实际存在的寄存器)								0000 0000	51, 74, 83	
EECON1	EEPGD	CFG5	—	FREE	WRERR	WREN	WR	RD	xx-0 x000	51, 74, 84	
IPR2	OSCFIP	CMIP	—	EEIP	BCLIP	HLVDIP	TMR3IP	CCP2IP	11-1 1111	52, 101	
PIR2	OSCFIF	CMIF	—	EEIF	BCLIF	HLVDIF	TMR3IF	CCP2IF	00-0 0000	52, 97	
PIE2	OSCFIE	CMIE	—	EEIE	BCLIE	HLVDIE	TMR3IE	CCP2IE	00-0 0000	52, 99	
IPR1	PSPIP ⁽²⁾	ADIP	RCIP	TXIP	SSPIP	CCP1IP	TMR2IP	TMR1IP	1111 1111	52, 100	
PIR1	PSPIF ⁽²⁾	ADIF	RCIF	TXIF	SSPIF	CCP1IF	TMR2IF	TMR1IF	0000 0000	52, 96	
PIE1	PSPIE ⁽²⁾	ADIE	RCIE	TXIE	SSPIE	CCP1IE	TMR2IE	TMR1IE	0000 0000	52, 98	
OSCTUNE	INTSRC	PLLEN ⁽³⁾	—	TUN4	TUN3	TUN2	TUN1	TUN0	0q-0 0000	27, 52	
TRISE ⁽²⁾	IBF	OBF	IBOV	PSPMODE	—	TRISE2	TRISE1	TRISE0	0000 -111	52, 118	
TRISD ⁽²⁾	PORTD 数据方向控制寄存器								1111 1111	52, 114	
TRISC	PORTC 数据方向控制寄存器								1111 1111	52, 111	
TRISB	PORTB 数据方向控制寄存器								1111 1111	52, 108	
TRISA	TRISA7 ⁽⁵⁾	TRISA6 ⁽⁵⁾	PORTA 数据方向控制寄存器					1111 1111	52, 105		
LATE ⁽²⁾	—	—	—	—	—	PORTE 数据锁存寄存器 (读和写数据锁存器)		----	-xxx	52, 117	
LATD ⁽²⁾	PORTD 数据锁存寄存器 (读和写数据锁存器)								xxxx xxxx	52, 114	
LATC	PORTC 数据锁存寄存器 (读和写数据锁存器)								xxxx xxxx	52, 111	
LATB	PORTB 数据锁存寄存器 (读和写数据锁存器)								xxxx xxxx	52, 108	
LATA	LATA7 ⁽⁵⁾	LATA6 ⁽⁵⁾	PORTA 数据锁存寄存器 (读和写数据锁存器)					xxxx xxxx	52, 105		
PORTE	—	—	—	—	RE3 ⁽⁴⁾	RE2 ⁽²⁾	RE1 ⁽²⁾	RE0 ⁽²⁾	----	xxxx	52, 117
PORTD ⁽²⁾	RD7	RD6	RD5	RD4	RD3	RD2	RD1	RD0	xxxx xxxx	52, 114	
PORTC	RC7	RC6	RC5	RC4	RC3	RC2	RC1	RC0	xxxx xxxx	52, 111	
PORTB	RB7	RB6	RB5	RB4	RB3	RB2	RB1	RB0	xxxx xxxx	52, 108	
PORTA	RA7 ⁽⁵⁾	RA6 ⁽⁵⁾	RA5	RA4	RA3	RA2	RA1	RA0	xx0x 0000	52, 105	

图注: x = 未知, u = 不变, — = 未实现, q = 值取决于具体条件

- 注
- 1: SBOREN 位仅在 BOREN1:BOREN0 配置位 = 01 时可用; 否则, 它被禁止且读为 0。请参见第 4.4 节“欠压复位 (BOR)”。
 - 2: 这些寄存器和 / 或位在 28 引脚器件上未实现, 读为 0。提供的是 40/44 引脚器件的复位值; 各未实现位表示为 -。
 - 3: 只有在特定的振荡器配置中才可使用 PLLEN 位; 否则, 它被禁止并读为 0。请参见第 2.6.4 节“INTOSC 模式下的 PLL”。
 - 4: 只有在禁止主复位 (MCLRE 配置位 = 0) 时才可使用 RE3 位; 否则, RE3 读为 0。该位是只读的。
 - 5: 根据不同的主振荡器模式, 可将 RA6/RA7 及其相关的锁存器及方向位分别配置为端口引脚。这些位在禁止时读为 0。

5.3.5 STATUS 寄存器

如寄存器 5-2 所示，STATUS 寄存器包含 ALU 的算术运算状态。和任何其他 SFR 一样，它也可以作为任何指令的操作数。

如果一条影响 Z、DC、C、OV 或 N 位的指令以 STATUS 寄存器作为目标寄存器，将不会将指令的结果写入 STATUS 寄存器，而是根据指令的执行更新 STATUS 寄存器。因此，当执行一条把 STATUS 寄存器作为目标寄存器的指令后，STATUS 寄存器的结果可能和预想的不一样。例如，CLRF STATUS 将 Z 位置 1 并保持其余状态位不变（000u u1uu）。

因此，建议仅使用 BCF、BSF、SWAPF、MOVFF 和 MOVWF 指令来改变 STATUS 寄存器，因为这些指令不会影响 STATUS 寄存器中的 Z、C、DC、OV 或 N 位。

关于其他不会影响状态位的指令，请参见表 24-2 和表 24-3 中的指令集汇总。

注： 在减法运算中，C 和 DC 位分别作为借位位和半借位位。

寄存器 5-2: STATUS 寄存器

U-0	U-0	U-0	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x
—	—	—	N	OV	Z	DC ⁽¹⁾	C ⁽²⁾
bit 7							bit 0

图注：

R = 可读位	W = 可写位	U = 未实现位，读为 0
-n = POR 值	1 = 置 1	0 = 清零
		x = 未知

- bit 7-5 **未实现：** 读为 0
- bit 4 **N：** 负标志位
此位用于有符号的算术运算（二进制补码）。它表明结果是否为负（ALU MSB = 1）。
1 = 结果为负
0 = 结果为正
- bit 3 **OV：** 溢出标志位
此位用于有符号的算术运算（二进制补码）。表明溢出了 7 位二进制数的范围，溢出将导致符号位（bit 7）发生改变。
1 = 有符号算术运算中发生溢出（本次运算）
0 = 未发生溢出
- bit 2 **Z：** 全零标志位
1 = 算术运算或逻辑运算的结果为零
0 = 算术运算或逻辑运算的结果不为零
- bit 1 **DC：** 半进位 / 借位位 ⁽¹⁾
用于 ADDWF、ADDLW、SUBLW 和 SUBWF 指令：
1 = 结果的第 4 个低位发生了进位
0 = 结果的第 4 个低位未发生进位
- bit 0 **C：** 进位 / 借位位 ⁽²⁾
用于 ADDWF、ADDLW、SUBLW 和 SUBWF 指令：
1 = 结果中最高位发生了进位
0 = 结果中最高位未发生进位

- 注 1：** 对于借位，极性是相反的。减法是通过加上第二个操作数的二进制补码来执行的。对于移位指令（RRF 和 RLF），此位装入源寄存器的 bit 4 或 bit 3。
- 注 2：** 对于借位，极性是相反的。减法是通过加上第二个操作数的二进制补码来执行的。对于移位指令（RRF 和 RLF），此位装入源寄存器的最高位或最低位。

PIC18F2423/2523/4423/4523

5.4 数据寻址模式

注： 当使能 PIC18 扩展指令集时，PIC18 核心指令集中某些指令的执行会发生改变。更多信息，请参见第 5.5 节“数据存储器和扩展指令集”。

程序存储器只能用一种方式寻址（通过程序计数器），而数据存储空间可用多种方式寻址。大部分指令的寻址模式都是固定的。其他指令可能使用最多三种模式，根据它们所使用的操作数和是否使能了扩展指令集而定。

这些寻址模式为：

- 固有寻址
- 立即数寻址
- 直接寻址
- 间接寻址

当使能了扩展指令集（XINST 配置位 = 1）时，还可使用另外一种寻址模式，即立即数变址寻址模式。第 5.5.1 节“使用立即数偏移量进行变址寻址”将更详细讨论它的操作。

5.4.1 固有寻址和立即数寻址

很多 PIC18 控制指令根本不需要任何参数。执行这些指令要么对整个器件造成影响，要么仅隐式地对一个寄存器进行操作。此寻址模式称为固有寻址。例如指令 SLEEP、RESET 和 DAW。

其他指令的工作方式与此类似，但需要操作码中有其他显式的参数。由于需要一些立即数作为参数，这种寻址模式被称为立即数寻址。例如 ADDLW 和 MOVLW，它们分别向 W 寄存器加或传送一个立即数。其他立即数寻址指令，例如 CALL 和 GOTO，包含一个 20 位的程序存储器地址。

5.4.2 直接寻址

直接寻址模式在操作码中指定操作的全部或部分源地址和 / 或目标地址。这些选项由指令附带的参数指定。

在 PIC18 核心指令集中，针对位和针对字节的指令默认情况下使用直接寻址模式。所有这些指令都包含某个 8 位的立即数地址作为其最低有效字节。此地址指定数据 RAM 的某个存储区中寄存器的地址（第 5.3.3 节“通用寄存器文件”）或快速操作存储区（第 5.3.2 节“快速操作存储区”）中作为指令数据源的存储单元地址。

快速操作 RAM 位“a”决定地址的解析方式。当“a”为 1 时，BSR（第 5.3.1 节“存储区选择寄存器（BSR）”）的内容将和指令中指定的地址一起用于确定寄存器的完整 12 位地址。当“a”为 0 时，此地址将被解析为快速操作存储区中的一个寄存器。使用快速操作 RAM 的寻址模式有时也被称为强制寻址模式。

有几条指令，例如 MOVFF，在操作码中包含完整的 12 位地址（源地址或目标地址）。在这些情况下，BSR 被完全忽略。

保存操作结果的目标寄存器由目标位“d”确定。当“d”为 1 时，结果被存回源寄存器并覆盖原来的内容。当“d”为 0 时，结果被存储在 W 寄存器中。没有“d”参数的指令的目标寄存器隐含在指令中，这些指令的目标寄存器是正在操作的目标寄存器或 W 寄存器。

5.4.3 间接寻址

间接寻址模式允许用户访问数据存储区中的存储单元而无需在指令中给出一个固定的地址。这种寻址模式是通过使用文件选择寄存器（File Select Register, FSR）作为指向被读写单元的指针实现的。由于 FSR 本身作为特殊功能寄存器位于 RAM 中，因此也可在程序控制下直接对其进行操作。这使得 FSR 对于在数据存储区中实现诸如表和数组等数据结构时非常有用。

也可以通过间接文件操作数（Indirect File Operand, INDF）进行间接寻址。这种操作允许自动递增、递减指针或向指针加偏移量值，从而自动操作指针的值。它通过使用循环提高代码执行效率，如例 5-5 所示的清零整个 RAM 存储区的操作。

例 5-5: 使用间接寻址清零 RAM (BANK 1)

	LFSR	FSR0, 100h ;
NEXT	CLRF	POSTINC0 ; Clear INDF
		; register then
		; inc pointer
	BTFSS	FSR0H, 1 ; All done with
		; Bank1?
	BRA	NEXT ; NO, clear next
CONTINUE		; YES, continue

5.4.3.1 FSR 寄存器和 INDF 操作数

间接寻址的核心是三组寄存器：FSR0、FSR1和FSR2。每组寄存器都含有一对8位寄存器：FSRnH和FSRnL。FSRnH寄存器的高4位未使用，因此每对FSR只保存一个12位值，从而可以线性寻址数据存储器的整个空间。因此，FSR寄存器对被用作数据存储器的地址指针。

间接寻址是通过一组间接文件操作数（INDF0 到 INDF2）完成的。这些操作数可被看作“虚拟”寄存器：它们被映射到 SFR 空间而不是通过物理方式实现的。对特定的 INDF 寄存器执行读或写操作实际上访问的是与之对应的一对 FSR 寄存器。例如，读 INDF1 就是读 FSR1H:FSR1L 指向地址中的数据。使用 INDF 寄存器作为操作数的指令实际上使用相应FSR的内容作为指向指令目标地址的指针。INDF 操作数只是使用该指针的一种简便方法。

由于间接寻址使用完整的12位地址，因此没有必要确定数据RAM区。所以BSR的当前内容和快速操作RAM位对于确定目标地址没有影响。

5.4.3.2 FSR 寄存器和 POSTINC、POSTDEC、PREINC 以及 PLUSW

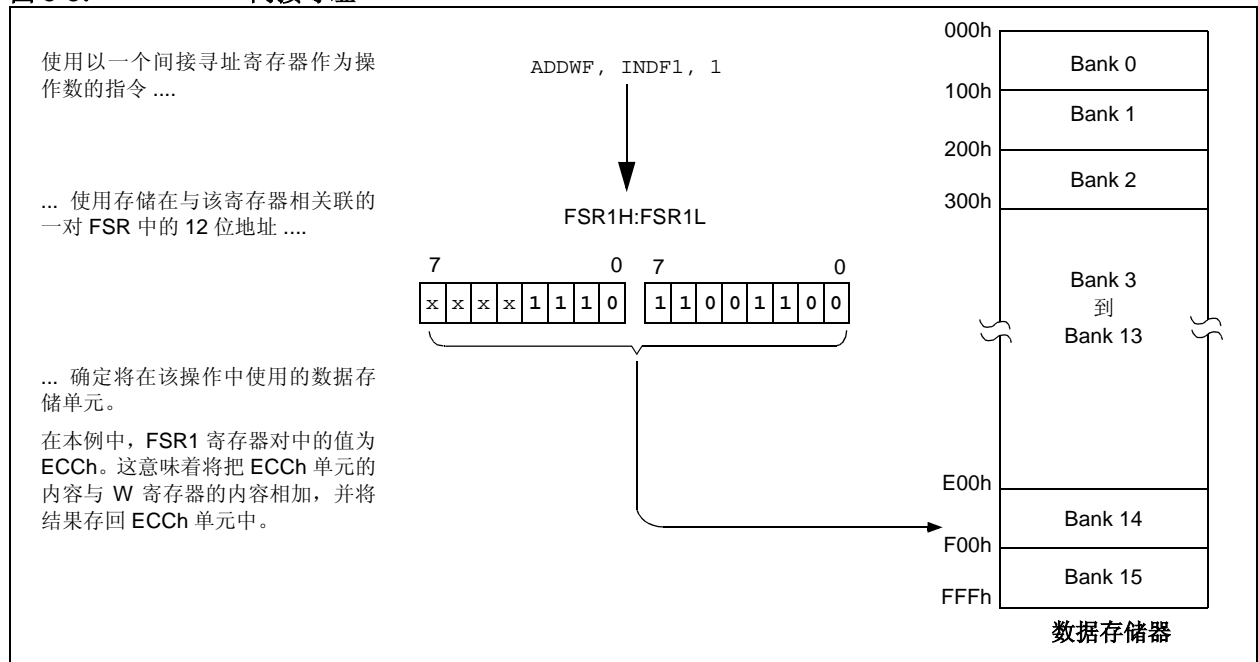
除了 INDF 操作数之外，每对 FSR 寄存器还有 4 个额外的间接操作数。和 INDF 一样，它们也都是不能直接读写的“虚拟”寄存器。访问这些寄存器实际上访问的是与之相关的一对 FSR 寄存器，并对其所存储的数值进行特定的操作。这些寄存器是：

- POSTDEC: 访问 FSR 的值，然后将它自动递减 1
- POSTINC: 访问 FSR 的值，然后将它自动递增 1
- PREINC: 将 FSR 的值递增 1，然后在操作中使用该值
- PLUSW: 将 W 寄存器中的有符号值（从 -127 到 128）与 FSR 寄存器中的值相加，并在操作中使用得到的新值

访问 INDF 寄存器时使用 FSR 寄存器中的值而不会更改该值。同样，访问 PLUSW 寄存器是将 W 寄存器中的值作为 FSR 的偏移量。该操作不会改变这两个寄存器中的值，而访问其他虚拟寄存器均会更改 FSR 寄存器的值。

使用 POSTDEC、POSTINC 和 PREINC 对 FSR 进行操作会影响整对寄存器：即 FSRnL 寄存器从 FFh 到 00h 溢出并向 FSRnH 寄存器进位。但这些操作的结果不会更改 STATUS 寄存器中的标志位（如 Z、N 和 OV 等）。

图 5-8: 间接寻址



PLUSW 寄存器可用于在数据存储空间中实现变址寻址。通过控制 W 寄存器中的值，用户可以访问相对当前指针地址有固定偏移量的地址单元。在某些应用中，该功能可用于在数据存储内部实现某些强大的程序控制结构，如软件堆栈。

5.4.3.3 通过 FSR 对其他 FSR 进行操作

在某些特殊情况下，间接寻址操作以其他 FSR 或虚拟寄存器作为目标寄存器。例如，使用 FSR 指向一个虚拟寄存器会导致操作不成功。假设如下特殊情况：FSR0H:FSR0L 保存的是 INDF1 的地址 FE7h。尝试使用 INDF0 作为操作数读取 INDF1 的值，将返回 00h。尝试使用 INDF0 作为操作数写入 INDF1，将会导致执行一条 NOP 指令。

另一方面，使用虚拟寄存器对一对 FSR 寄存器进行写操作可能会产生与预期不同的结果。在这些情况下，会将值写入一对 FSR 寄存器，但 FSR 不会递增或递减。因此，写入 INDF2 或 POSTDEC2 时会把同样的值写入 FSR2H:FSR2L。

由于 FSR 是映射到 SFR 空间中的物理寄存器，所以可以通过直接寻址来对它们进行操作。用户在使用这些寄存器时应特别小心，尤其是在代码使用间接寻址的方式时。

同样，通常允许通过间接寻址对所有其他 SFR 进行操作。用户在进行此类操作时应特别小心，以免不小心更改设置从而影响器件操作。

5.5 数据存储器和扩展指令集

使能 PIC18 扩展指令集 (XINST 配置位 = 1) 显著改变了数据存储及其寻址的某些方面。特别是许多 PIC18 核心指令使用快速操作存储区的方式有所不同。这是由于扩展指令集引入了对数据存储空间的新的寻址模式。

同样需要了解哪些部分保持不变。数据存储空间的大小及其线性寻址模式都不会改变。SFR 映射也保持不变。PIC18 核心指令也仍然以直接和间接寻址模式进行操作；固有和立即数指令操作照旧。FSR0 和 FSR1 的间接寻址模式也保持不变。

5.5.1 使用立即数偏移量进行变址寻址

使能 PIC18 扩展指令集将更改快速操作 RAM 中使用 FSR2 寄存器对进行间接寻址的方式。在适当的条件下，使用快速操作存储区的指令（即绝大多数针对位和针对字节的指令）可以利用指令中的偏移量来执行变址寻址。这种特殊的寻址模式称为使用立即数偏移量的变址寻址或立即数变址寻址模式。

使用扩展指令集时，这种寻址模式有如下要求：

- 强制使用快速操作存储区 (a = 0)；且
- 文件地址参数要小于或等于 5Fh。

在这些条件下，指令的文件地址不会被解析为地址的低字节（在直接寻址中和 BSR 一起使用），或快速操作存储区中的 8 位地址，而是被解析为由 FSR2 指定的地址指针的偏移量。将该偏移量与 FSR2 的内容相加以获得操作的目标地址。

5.5.2 受立即数变址寻址模式影响的指令

任何采用直接寻址模式的 PIC18 核心指令均有可能受到立即数变址寻址模式的影响，包括所有针对字节和针对位的指令，或标准 PIC18 指令集中几乎一半的指令。仅使用固有或立即数寻址模式的指令不受影响。

此外，如果针对字节和针对位的指令使用快速操作存储区（快速操作 RAM 位为 1）或包含 60h 或以上的文件地址，它们也不受影响。符合这些条件的指令会像以前一样执行。图 5-9 显示了当使能扩展指令集时，各种寻址模式之间的对比。

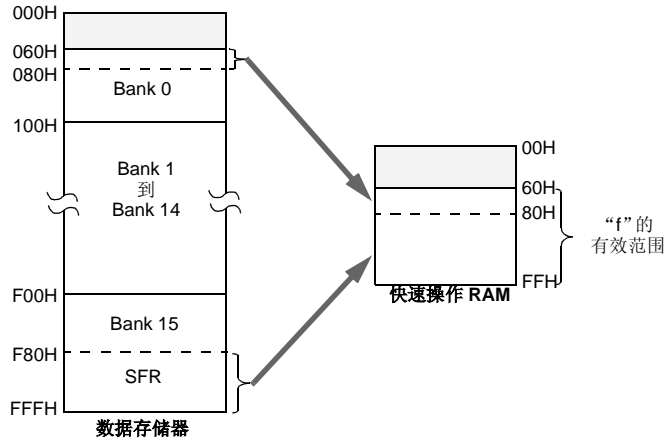
那些想要在立即数变址寻址模式中使用针对位或针对字节的指令的用户，应该注意此模式下汇编语法的改变。在第 24.2.1 节“扩展指令的语法”中对此进行了更详细的说明。

图 5-9: 针对位和针对字节的指令的寻址模式对比 (使能了扩展指令集)

示例指令: `ADDWF, f, d, a` (操作码: `0010 01da ffff ffff`)

当 a = 0 且 f ≥ 60h 时:

此指令以直接强制模式执行。“f”被解析为快速操作 RAM 中 060h 到 0FFh 之间的地址, 该地址位于数据存储器的 060h 到 07Fh (Bank 0) 和 F80h 到 FFFh (Bank 15) 中。
不可用此模式寻址地址低于 60h 的单元。

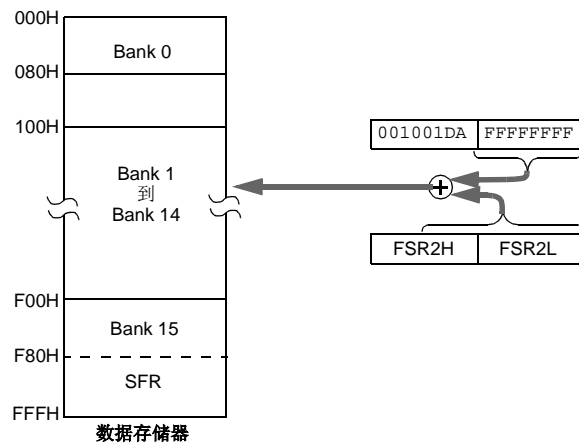


当 a = 0 且 f ≤ 5Fh 时:

此指令以立即数变址寻址模式执行。“f”被解析为 FSR2 中地址值的偏移量。将这两个值相加可以得到指令的目标寄存器的地址。此地址可以在数据存储空间的任何地方。

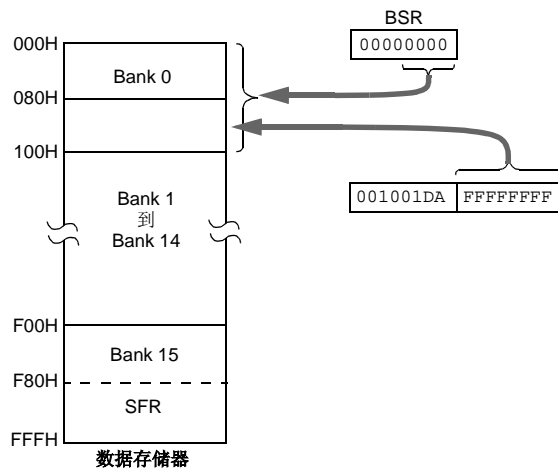
注意在此模式中, 正确的语法如下:

`ADDWF [k], d`
其中“k”就是“f”。



当 a = 1 (f 可为任何值) 时:

指令以直接寻址模式 (也称为直接长地址寻址模式) 执行。“f”被解析为数据存储区中的一个地址。存储区由存储区选择寄存器 (BSR) 指定。此地址可以位于数据存储空间的任何实现分区存储区中。



PIC18F2423/2523/4423/4523

5.5.3 在立即数变址寻址模式下映射快速操作存储区

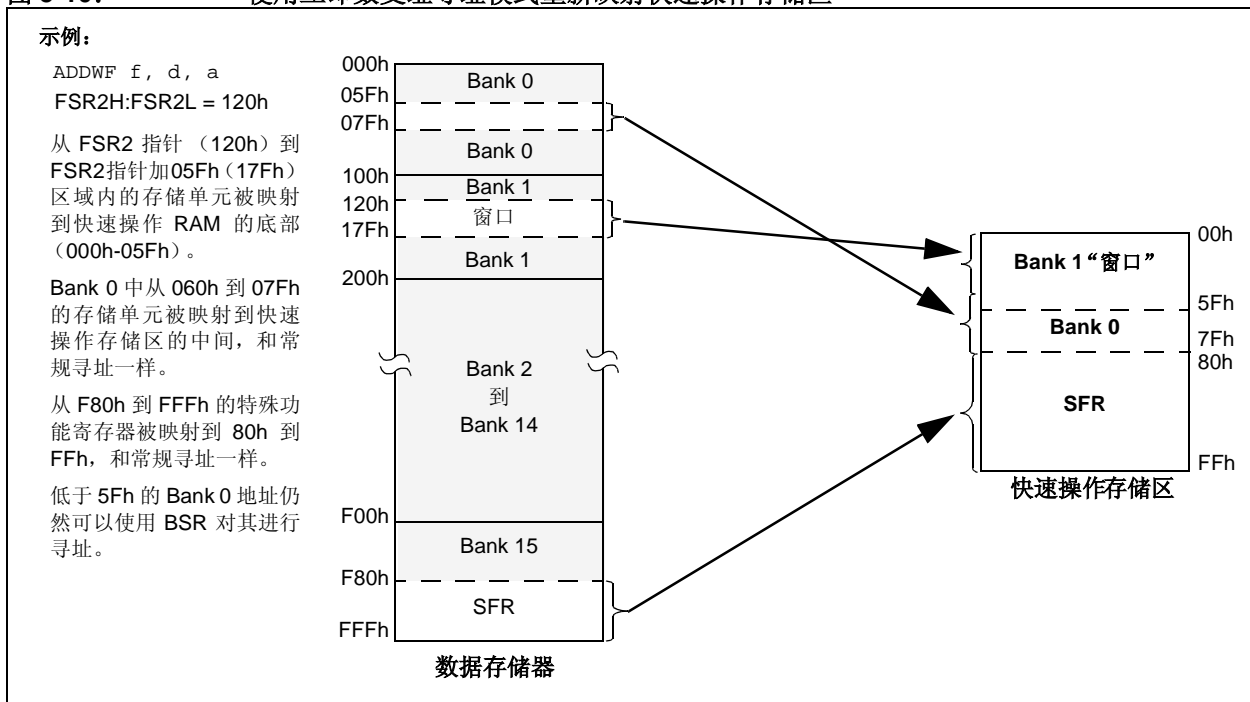
使用立即数变址寻址模式能有效改变快速操作 RAM 前 96 个存储单元 (00h 到 5Fh) 的映射方式。此模式映射 Bank 0 的内容和由用户定义的、可位于数据存储空间中任何地方的“窗口”内容，而不仅仅映射 Bank 0 低半部分的内容。FSR2 的值定义映射到窗口的地址的下边界，而上边界则由 FSR2 加 95 (5Fh) 决定。地址为 5Fh 以上的快速操作 RAM 的映射方法如前所述 (见第 5.3.2 节“快速操作存储区”)。图 5-10 显示了在此寻址模式下重新映射的快速操作存储区示例。

快速操作存储区的重新映射仅适用于立即数变址寻址模式。使用 BSR (快速操作 RAM 位为 1) 的操作和以前一样继续使用直接寻址模式。

5.6 PIC18 指令执行和扩展指令集

使能扩展指令集将额外添加 8 条其他命令到现有的 PIC18 指令集中。这些指令如第 24.2.2 节“扩展指令集”中所述执行。

图 5-10: 使用立即数变址寻址模式重新映射快速操作存储区



6.0 闪存程序存储器

正常工作状态下，闪存程序存储器在整个 VDD 范围内都是可读写可擦除的。

读程序存储器时，每次读取一个字节。写程序存储器时，每次写入一个 32 字节的块。擦除程序存储器时，每次擦除一个 64 字节的块。用户代码不能执行批量擦除操作。

在擦写程序存储器时，系统会停止取指令直到操作完成。擦写期间不能访问该程序存储器，因此也就无法执行代码。由内部编程定时器来终止程序存储器的擦写操作。

写入程序存储器的值不一定非要是有效指令。执行存储无效指令的程序存储单元会导致执行 NOP。

6.1 表读与表写

为了读写程序存储器，有两个操作指令可供处理器在程序存储器空间和数据 RAM 之间移动字节：

- 表读 (TBLRD)
- 表写 (TBLWT)

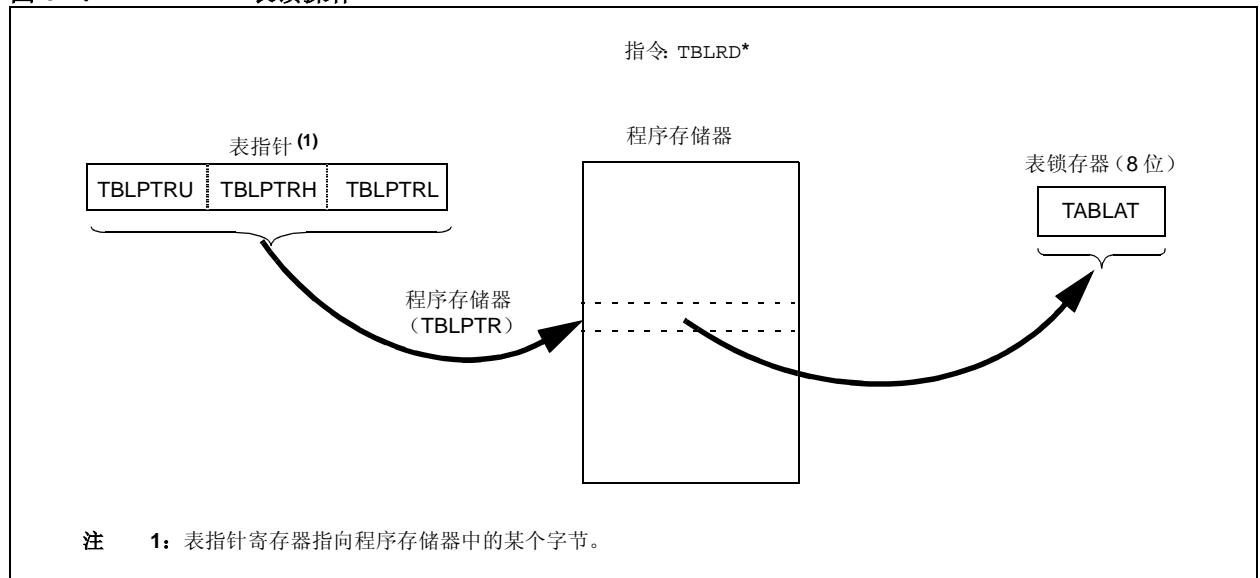
程序存储空间为 16 位宽，而数据 RAM 空间为 8 位宽。表读和表写操作通过一个 8 位寄存器 (TABLAT) 在这两个存储器空间之间传送数据。

表读操作从程序存储器获取数据并将其放入数据 RAM 空间。图 6-1 显示了程序存储器和数据 RAM 之间的一次表读操作。

表写操作将数据存储空间中的数据存入程序存储器的保持寄存器。第 6.5 节“写闪存程序存储器”详细介绍了将保持寄存器内容写入程序存储器的过程。图 6-2 显示了程序存储器和数据 RAM 之间的一次表写操作。

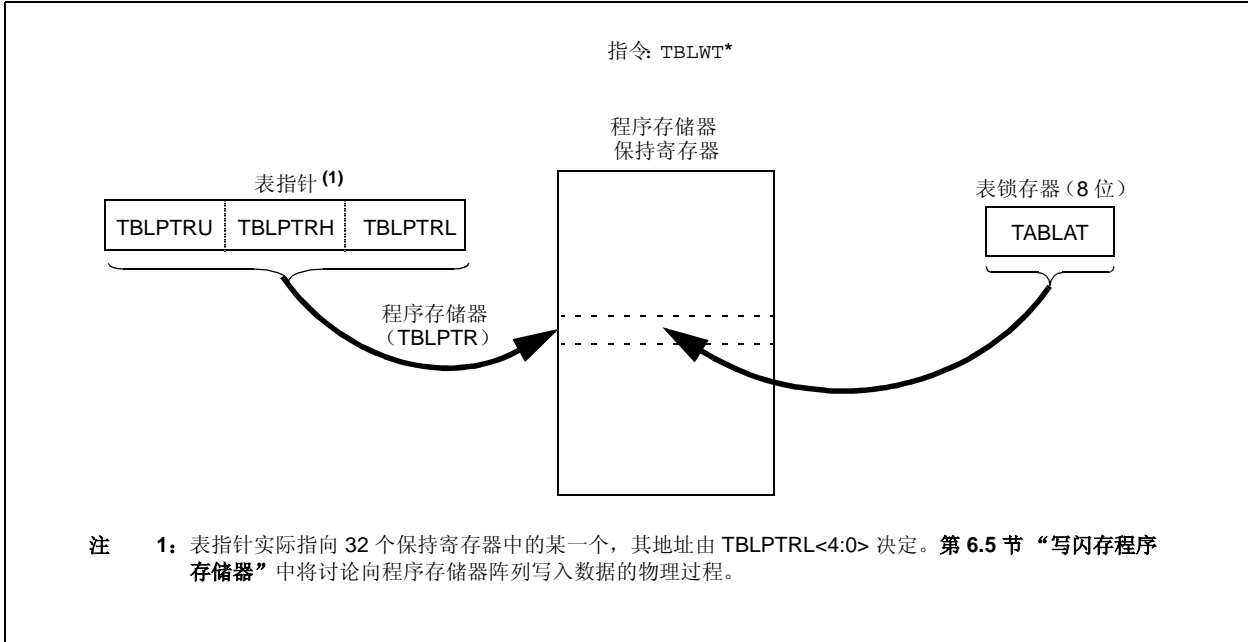
表操作以字节为单位。包含数据而非程序指令的表块不需要按字对齐。因此，表块可以在任何字节地址开始和结束。如果使用表写操作向程序存储器写入可执行代码，程序指令必须按字对齐。

图 6-1: 表读操作



PIC18F2423/2523/4423/4523

图 6-2: 表写操作



6.2 控制寄存器

TBLRD 和 TBLWT 指令要用到几个控制寄存器。包括:

- EECON1 寄存器
- EECON2 寄存器
- TABLAT 寄存器
- TBLPTR 寄存器

6.2.1 EECON1 和 EECON2 寄存器

EECON1 寄存器 (寄存器 6-1) 是存储器访问的控制寄存器。EECON2 寄存器不是实际存在的寄存器, 专用于存储器的擦写操作。读 EECON2 将得到全 0。

控制位 EEPGD 决定访问的是程序存储器还是数据 EEPROM 存储器。当清零时, 后续的操作将访问数据 EEPROM 存储器。当置 1 时, 任何后续操作都将针对程序存储器进行。

控制位 CFGS 决定访问的是配置 / 校准寄存器还是程序存储器 / 数据 EEPROM 存储器。当置 1 时, 不管 EEPGD 的值如何, 后续操作将访问配置寄存器 (见第 23.0 节“CPU 的特殊功能”)。当清零时, 则由 EEPGD 来选择访问的存储器。

当 FREE 位置 1 时, 允许对程序存储器进行擦除操作, 擦除操作在下一条 WR 命令时启动。当 FREE 清零时, 则仅使能写操作。

当 WREN 位置 1 时, 允许将 WR 位置 1 并开始写操作。上电时, WREN 位被清零。WREN 必须在 WR 置 1 前由代码置 1。WREN 保持置 1 直到由代码清零为止。

WRERR 位在 WR 位置 1 时由硬件置 1, 在内部编程定时器超时、写操作结束时被清零。如果由于任何原因导致写操作中断, WRERR 位仍保持置 1。

注: 在正常工作期间, WRERR 读为 1。这表明写操作被复位提早终止或进行了不合法的写操作。

WR 控制位用于启动写操作。用软件只能将该位置 1 而无法清零。在写操作完成后, 由硬件将其清零。

注: 当写操作完成时, EEIF 中断标志位 (PIR2<4>) 被置 1。它必须用软件清零。

PIC18F2423/2523/4423/4523

寄存器 6-1: EECON1: EEPROM 控制寄存器 1

R/W-x	R/W-x	U-0	R/W-0	R/W-x	R/W-0	R/S-0	R/S-0
EEPGD	CFGS	—	FREE	WRERR ⁽¹⁾	WREN	WR	RD
bit 7							bit 0

图注:

S = 可设置位	U = 未实现位, 读为 0
R = 可读位	W = 可写位
-n = POR 值	1 = 置 1
	0 = 清零
	x = 未知

- bit 7 **EEPGD:** 闪存程序存储器或数据 EEPROM 存储器选择位
1 = 访问闪存程序存储器
0 = 访问数据 EEPROM 存储器
- bit 6 **CFGS:** 闪存程序存储器 / 数据 EEPROM 存储器或配置寄存器选择位
1 = 访问配置寄存器
0 = 访问闪存程序存储器或数据 EEPROM 存储器
- bit 5 **未实现:** 读为 0
- bit 4 **FREE:** 闪存行擦除使能位
1 = 在下一条 WR 命令时擦除 TBLPTR 指定的程序存储器行 (擦除操作完成后清零)
0 = 仅执行写操作
- bit 3 **WRERR:** 闪存程序存储器 / 数据 EEPROM 存储器错误标志位 ⁽¹⁾
1 = 写操作提早终止 (由于正常操作中自定时编程期间的任何复位, 或不合法的写操作)
0 = 写操作完成
- bit 2 **WREN:** 闪存程序存储器 / 数据 EEPROM 存储器写使能位
1 = 允许对闪存程序存储器 / 数据 EEPROM 存储器的写周期
0 = 禁止对闪存程序存储器 / 数据 EEPROM 存储器的写周期
- bit 1 **WR:** 写控制位
1 = 启动数据 EEPROM 擦写周期或程序存储器的擦写周期或写周期 (操作是自定时的, 一旦写操作完成, 该位即由硬件清零。用软件只能将 WR 位置 1, 但不能清零。)
0 = EEPROM 写周期完成
- bit 0 **RD:** 读控制位
1 = 启动 EEPROM 读操作 (读操作需要一个周期。RD 位由硬件清零。用软件只能将 RD 位置 1, 但不能清零。EEPGD = 1 或 CFGS = 1 时, RD 位无法置 1。)
0 = 不启动 EEPROM 读操作

注 1: 当发生 WRERR 时, EEGD 和 CFGS 位不会被清零。这样可以跟踪错误状况。

PIC18F2423/2523/4423/4523

6.2.2 TABLAT——表锁存寄存器

表锁存器 (TABLAT) 是映射到 SFR 空间的一个 8 位寄存器。表锁存器用于在程序存储器和数据 RAM 之间传输数据时保存 8 位数据。

6.2.3 TBLPTR——表指针寄存器

表指针 (TBLPTR) 寄存器在程序存储器中以字节为单位进行寻址。TBLPTR 由 3 个 SFR 寄存器组成：表指针最高字节、表指针高字节和表指针低字节 (TBLPTRU:TBLPTRH:TBLPTRL)。这 3 个寄存器合起来组成一个 22 位宽的指针。其中低 21 位允许器件寻址高达 2MB 程序存储器空间。第 22 位则允许访问器件 ID、用户 ID 和配置位。

TBLRD 和 TBLWT 指令要使用表指针寄存器 TBLPTR。这些指令可以基于表操作以 4 种方法之一更新 TBLPTR。表 6-1 列出了这些操作。这些操作只会影响 TBLPTR 的低 21 位。

6.2.4 表指针范围

TBLPTR 用于读、写和擦除闪存程序存储器。

当执行 TBLRD 时，TBLPTR 的所有 22 位决定将程序存储器的哪个字节读入 TABLAT。

当执行 TBLWT 时，表指针寄存器的低 5 位 (TBLPTR<4:0>) 决定要写入程序存储器的哪个保持寄存器 (共有 32 个)。当程序存储器的定时写入 (通过 WR 位) 开始时，TBLPTR 的高 17 位 (TBLPTR<21:5>) 将决定要写入哪个程序存储器块 (每块 32 字节)。更多详细信息，请参见第 6.5 节“写闪存程序存储器”。

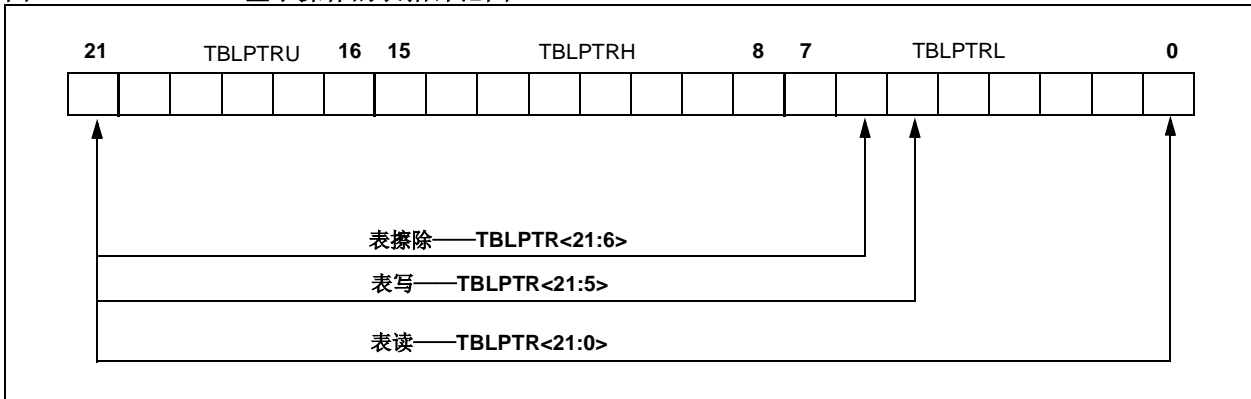
当执行擦除程序存储器时，表指针寄存器的高 16 位 (TBLPTR<21:6>) 指向将要擦除的 64 字节块。低有效位 (TBLPTR<5:0>) 被忽略。

图 6-3 说明了基于闪存程序存储器操作的 TBLPTR 相关范围。

表 6-1: 执行 TBLRD 和 TBLWT 指令的表指针操作

示例	表指针操作
TBLRD* TBLWT*	不修改 TBLPTR
TBLRD** TBLWT**	TBLPTR 在读 / 写后递增
TBLRD*- TBLWT*-	TBLPTR 在读 / 写后递减
TBLRD+* TBLWT+*	TBLPTR 在读 / 写前递增

图 6-3: 基于操作的表指针范围



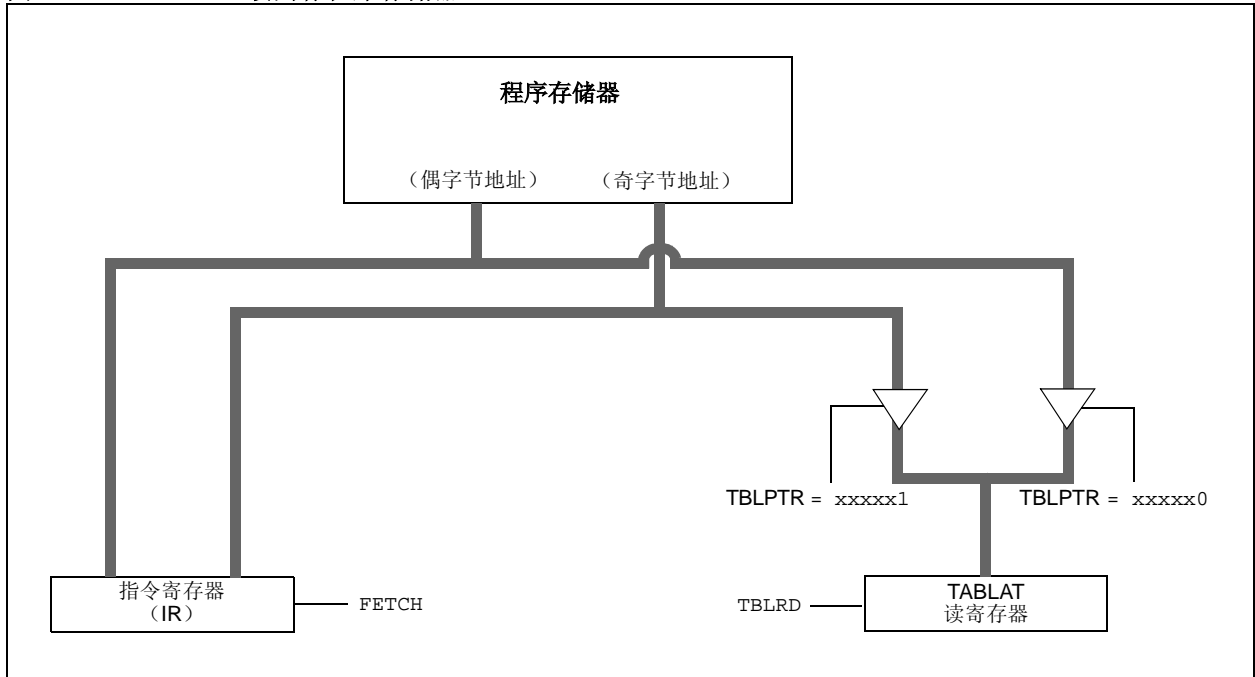
6.3 读闪存程序存储器

TBLRD 指令用于从程序存储器读取数据并放入数据 RAM。表读操作每次从程序存储器读取一个字节。

TBLPTR 指向程序存储空间的某个字节地址。执行 TBLRD 指令将把指向的字节装入 TABLAT。此外，还可以自动修改 TBLPTR 以进行下一次表读操作。

内部程序存储器通常以字为单位进行组织。由地址的最低有效位来选择字的高字节或者低字节。图 6-4 显示了内部程序存储器和 TABLAT 之间的接口。

图 6-4: 读闪存程序存储器



例 6-1: 读闪存程序存储器的一个字

```

MOVLW    CODE_ADDR_UPPER    ; Load TBLPTR with the base
MOVWF    TBLPTRU            ; address of the word
MOVLW    CODE_ADDR_HIGH
MOVWF    TBLPTRH
MOVLW    CODE_ADDR_LOW
MOVWF    TBLPTRL
READ_WORD
TBLRD*+  ; read into TABLAT and increment
MOVF    TABLAT, W          ; get data
MOVWF    WORD_EVEN
TBLRD*+  ; read into TABLAT and increment
MOVFW   TABLAT, W          ; get data
MOVF    WORD_ODD
    
```

PIC18F2423/2523/4423/4523

6.4 擦除闪存程序存储器

最小擦除块大小为 32 个字或 64 字节。只有通过使用外部编程器，或通过 ICSP™ 控制，才能够批量擦除更大的程序存储器块。闪存阵列不支持字擦除。

当单片机本身开始一个擦除过程时，会擦除一个 64 字节的程序存储器块。16 个最高有效位 TBLPTR<21:6> 指向要擦除的块。TBLPTR<5:0> 被忽略。

擦除操作由 EECON1 寄存器控制。必须将 EEPGD 位置 1 以指向闪存程序存储器。WREN 位必须被置 1 以启用写操作。FREE 位被置 1 以选择擦除操作。

为了安全起见，必须使用 EECON2 的写启动序列。

擦除内部闪存必须执行长写操作。在长写周期中，指令暂停执行。由内部编程定时器终止长写操作。

6.4.1 闪存程序存储器擦除序列

擦除内部程序存储器块的步骤如下：

1. 将要擦除的行地址装入表指针寄存器。
2. 设置 EECON1 寄存器来执行擦除操作：
 - 将 EEPGD 位置 1 以指向程序存储器；
 - 将 CFGS 位清零以访问程序存储器；
 - 将 WREN 位置 1 以启用写操作；
 - 将 FREE 位置 1 以启用擦除操作。
3. 禁止中断。
4. 向 EECON2 写入 55h。
5. 向 EECON2 写入 0AAh。
6. 将 WR 位置 1。这将开始行擦除周期。
7. CPU 在擦除期间将会暂停工作（使用内部定时器定时约 2 ms）。
8. 重新允许中断。

例 6-2: 擦除闪存程序存储器的一行

	MOVLW	CODE_ADDR_UPPER	; load TBLPTR with the base
	MOVWF	TBLPTRU	; address of the memory block
	MOVLW	CODE_ADDR_HIGH	
	MOVWF	TBLPTRH	
	MOVLW	CODE_ADDR_LOW	
	MOVWF	TBLPTRL	
ERASE_ROW	BSF	EECON1, EEPGD	; point to Flash program memory
	BCF	EECON1, CFGS	; access Flash program memory
	BSF	EECON1, WREN	; enable write to memory
	BSF	EECON1, FREE	; enable Row Erase operation
	BCF	INTCON, GIE	; disable interrupts
	MOVLW	55h	
	MOVWF	EECON2	; write 55h
必需的序列	MOVLW	0AAh	
	MOVWF	EECON2	; write 0AAh
	BSF	EECON1, WR	; start erase (CPU stall)
	BSF	INTCON, GIE	; re-enable interrupts

6.5 写闪存程序存储器

最小编程块大小为 16 个字或 32 字节。不支持字或字节编程。

在内部使用表写命令将需要写入闪存存储器的内容装入保持寄存器中。表写操作使用 32 个保持寄存器进行编程。

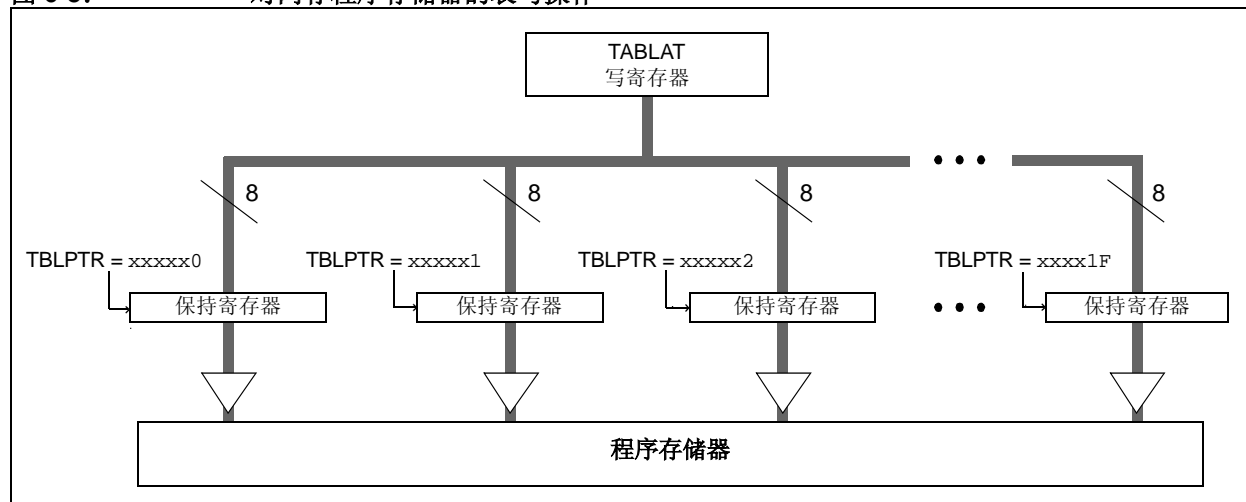
由于表锁寄存器 (TABLAT) 只是单字节寄存器, 所以对于每次编程操作, TBLWT 指令都必须执行 32 次。因为只写保持寄存器, 所以所有的表写操作实际上都是短写。更新 32 个保持寄存器后, 必须写 EECON1 寄存器, 以便启动长写周期开始编程操作。

对内部闪存编程要求使用长写操作。在长写周期中, 指令暂停执行。由内部编程定时器终止长写操作。

由 EEPROM 片上定时器控制写入的时间。写入 / 擦除电压由片上的电荷泵产生, 该电荷泵可以工作在器件的电压范围内。

注: 器件复位和写操作完成后保持寄存器的默认值为 FFh。将 FFh 写入保持寄存器不会修改其中的值。这意味着可以单独修改程序存储器的各字节 (假如不是想把任何位从 0 更改为 1)。当单独修改字节时, 无需在执行写操作前装入所有 32 个保持寄存器。

图 6-5: 对闪存程序存储器的表写操作



6.5.1 写入闪存程序存储器的过程

对内部程序存储单元的编程的过程为:

1. 将 64 字节读入 RAM。
2. 必要时更新 RAM 中的数据值。
3. 把要擦除的目标地址装入表指针寄存器。
4. 执行行擦除。
5. 将要写入的第一个字节的地址装入表指针寄存器。
6. 表指针递减 1。
7. 将 32 个字节写入保持寄存器 (预递增)。
8. 设置 EECON1 寄存器来执行写操作:
 - 将 EEPGD 位置 1 以指向程序存储器;
 - 将 CFGS 位清零以访问程序存储器;
 - 将 WREN 位置 1 以能使字节写操作。

9. 禁止中断。
10. 向 EECON2 写入 55h。
11. 向 EECON2 写入 0AAh。
12. 将 WR 位置 1。这将开始写周期。
13. CPU 在写入期间将会暂停工作 (使用内部定时器定时约 2 ms)。
14. 重新允许中断。
15. 重复从步骤 6 开始的操作写入剩余的 32 个字节。
16. 校验存储器 (表读)。

此过程需要大约 6 ms 以更新存储器的一行 64 字节。例 6-3 给出了所需代码的示例。

注: 在将 WR 位置 1 前, 表指针必须指向保持寄存器中的 32 个字节的地址范围内。

PIC18F2423/2523/4423/4523

例 6-3: 写闪存程序存储器

```
    MOVLW    D'64'                ; number of bytes in erase block
    MOVWF    COUNTER
    MOVLW    BUFFER_ADDR_HIGH     ; point to buffer
    MOVWF    FSR0H
    MOVLW    BUFFER_ADDR_LOW
    MOVWF    FSR0L
    MOVLW    CODE_ADDR_UPPER     ; Load TBLPTR with the base
    MOVWF    TBLPTRU             ; address of the memory block
    MOVLW    CODE_ADDR_HIGH
    MOVWF    TBLPTRH
    MOVLW    CODE_ADDR_LOW       ; 6 LSB = '0'
    MOVWF    TBLPTRL

READ_BLOCK
    TBLRD*+                       ; read into TABLAT, and inc
    MOVF     TABLAT, W            ; get data
    MOVWF    POSTINC0            ; store data
    DECFSZ   COUNTER, F          ; done?
    BRA     READ_BLOCK           ; repeat

MODIFY_WORD
    MOVLW    DATA_ADDR_HIGH     ; point to buffer
    MOVWF    FSR0H
    MOVLW    DATA_ADDR_LOW
    MOVWF    FSR0L
    MOVLW    NEW_DATA_LOW        ; update buffer word
    MOVWF    POSTINC0
    MOVLW    NEW_DATA_HIGH
    MOVWF    INDF0

ERASE_BLOCK
    MOVLW    CODE_ADDR_UPPER     ; load TBLPTR with the base
    MOVWF    TBLPTRU             ; address of the memory block
    MOVLW    CODE_ADDR_HIGH
    MOVWF    TBLPTRH
    MOVLW    CODE_ADDR_LOW
    MOVWF    TBLPTRL
    BSF     EECON1, EEPGD        ; point to Flash program memory
    BCF     EECON1, CFGS         ; access Flash program memory
    BSF     EECON1, WREN         ; enable write to memory
    BSF     EECON1, FREE         ; enable Row Erase operation
    BCF     INTCON, GIE          ; disable interrupts

    MOVLW    55h
    MOVWF    EECON2              ; write 55h
    MOVLW    0AAh
    MOVWF    EECON2              ; write 0AAh
    BSF     EECON1, WR           ; start erase (CPU stall)
    BSF     INTCON, GIE          ; re-enable interrupts
    TBLRD*-                       ; dummy read - decrement pointer
    MOVLW    BUFFER_ADDR_HIGH     ; point to buffer
    MOVWF    FSR0H
    MOVLW    BUFFER_ADDR_LOW
    MOVWF    FSR0L

WRITE_BUFFER_BACK1                ; write first 32 bytes to Flash
    MOVLW    D'32'                ; number of bytes in holding register
    MOVWF    COUNTER

WRITE_BYTE_TO_HREGS1
    MOVFF    POSTINC0, WREG        ; get low byte of buffer data
    MOVWF    TABLAT                ; present data to table latch
    TBLWT*+                       ; short write to holding
    ; register using pre-increment
    DECFSZ   COUNTER              ; loop until buffers are full
    BRA     WRITE_BYTE_TO_HREGS1
```

例 6-3: 写闪存程序存储器 (续)

```

PROGRAM_MEMORY1
    BSF    EECON1, EEPGD        ; point to Flash program memory
    BCF    EECON1, CFGS        ; access Flash program memory
    BSF    EECON1, WREN        ; enable write to memory
    BCF    INTCON, GIE         ; disable interrupts
    MOVLW  55h
    必需的 MOVWF  EECON2            ; write 55h
序列    MOVLW  0Aah
    MOVWF  EECON2            ; write 0AAh
    BSF    EECON1, WR         ; start program (CPU stall)
    BSF    INTCON, GIE        ; re-enable interrupts
    BCF    EECON1, WREN        ; disable write to memory
WRITE_BUFFER_BACK2
    MOVLW  D'32'              ; number of bytes in holding register
    MOVWF  COUNTER
WRITE_BYTE_TO_HREGS2
    MOVFF  POSTINC0, WREG     ; get low byte of buffer data
    MOVWF  TABLAT             ; present data to table latch
    TBLWT+*                   ; short write to holding
                                ; register using pre-increment
    DECFSZ COUNTER, F         ; loop until buffers are full
    BRA   WRITE_BYTE_TO_HREGS2
PROGRAM_MEMORY2
    BSF    EECON1, EEPGD        ; point to Flash program memory
    BCF    EECON1, CFGS        ; access Flash program memory
    BSF    EECON1, WREN        ; enable write to memory
    BCF    INTCON, GIE         ; disable interrupts
    MOVLW  55h
    必需的 MOVWF  EECON2            ; write 55h
序列    MOVLW  0AAh
    MOVWF  EECON2            ; write 0AAh
    BSF    EECON1, WR         ; start program (CPU stall)
    BSF    INTCON, GIE        ; re-enable interrupts
    BCF    EECON1, WREN        ; disable write to memory
    
```

6.5.2 写校验

根据具体应用，将写入存储器的值与原始值校验比对是一个很好的编程习惯。在应用中，如果某些位的写次数接近规定极限值，就应该采用写校验。

6.5.3 意外终止写操作

如果由于意外事件（如掉电或意外复位）终止了写操作，应该对刚刚编程的存储单元进行验证，如有必要，还要重新进行编程。当写操作在正常操作过程中因 MCLR 复位或 WDT 超时复位而中断时，用户可以检查 WRERR 位，并根据需要重写该存储单元。

6.5.4 防止误写操作的保护措施

为防止对闪存程序存储器意外误写操作，必须遵循写操作的启动序列。在例 6-3 中，“必需的序列”通过使用 5 条指令的特定序列来防止存储器被意外误写。必须正确执行所示序列，否则写操作不会发生。

6.6 代码保护期间闪存程序存储器的操作

其他保护措施可通过使用第 23.5 节“程序校验和代码保护”中描述的代码保护功能来实现。

PIC18F2423/2523/4423/4523

表 6-2: 与闪存程序存储器相关的寄存器

名称	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	复位值 所在页
TBLPTRU	—	—	bit 21	程序存储器表指针最高字节 (TBLPTR<20:16>)					49
TBPLTRH	程序存储器表指针高字节 (TBLPTR<15:8>)								49
TBLPTL	程序存储器表指针低字节 (TBLPTR<7:0>)								49
TABLAT	程序存储器表锁存器								49
INTCON	GIE/GIEH	PEIE/GIEL	TMR0IE	INT0IE	RBIE	TMR0IF	INT0IF	RBIF	49
EECON2	EEPROM 控制寄存器 2 (不是实际存在的寄存器)								51
EECON1	EEPGD	CFGS	—	FREE	WRERR	WREN	WR	RD	51
IPR2	OSCFIP	CMIP	—	EEIP	BCLIP	HLVDIP	TMR3IP	CCP2IP	52
PIR2	OSCFIF	CMIF	—	EEIF	BCLIF	HLVDIF	TMR3IF	CCP2IF	52
PIE2	OSCFIE	CMIE	—	EEIE	BCLIE	HLVDIE	TMR3IE	CCP2IE	52

图注: — = 未实现, 读为 0。闪存 /EEPROM 访问期间不使用阴影单元。

7.0 数据 EEPROM 存储器

数据 EEPROM 是非易失性的存储器阵列，独立于数据 RAM 和程序存储器，用于程序数据的长期存储。它并不直接映射到寄存器文件或程序存储空间，而是通过特殊功能寄存器（SFR）来间接寻址。在整个 VDD 范围内的正常运行期间，EEPROM 是可读写的。

有 5 个 SFR 用于读写数据 EEPROM 以及程序存储器，它们是：

- EECON1
- EECON2
- EEDATA
- EEADR

数据 EEPROM 允许以字节为单位读写。当与数据存储器接口时，EEDATA 存放 8 位读写数据，而 EEADR 寄存器存放被访问的 EEPROM 存储单元的地址。

EEPROM 数据存储器具有高耐擦写次数。字节写操作会自动擦除目标存储单元并写入新数据（在写入前擦除）。写入时间由片上定时器控制，其值根据电压、温度和不同的芯片而不同。具体的限制值，请参见 D122（第 26.0 节“电气特性”中的表 26-1）。

7.1 EEADR 寄存器

EEADR 寄存器用于寻址数据 EEPROM 以进行读写操作。8 位的寄存器可寻址 256 字节（00h 至 FFh）的存储器范围。

7.2 EECON1 和 EECON2 寄存器

对数据 EEPROM 的访问由 EECON1 和 EECON2 两个寄存器控制。它们也用来控制对程序存储器的访问，访问这两种存储器时对这两个寄存器的使用方法类似。

EECON1 寄存器（寄存器 7-1）是数据和程序存储器访问的控制寄存器。控制位 EEPGD 决定访问程序闪存存储器还是数据 EEPROM 存储器。清零时，操作将访问数据 EEPROM 存储器。置 1 时，则访问程序闪存存储器。

控制位 CFGS 决定访问配置寄存器还是程序闪存存储器 / 数据 EEPROM 存储器。置 1 时，后续操作会访问配置寄存器。而当 CFGS 清零时，则由 EEPGD 位来选择具体访问程序闪存存储器还是数据 EEPROM 存储器。

当 WREN 位置 1 时，允许进行写操作。上电时，WREN 位被清零。WRERR 位在 WR 位被置 1 时由硬件置 1，在内部编程定时器定时结束和写操作结束时被清零。

注： 在正常操作期间，WRERR 可能会读为 1。这表明写操作被复位提早终止或进行了不合法的写操作。

WR 控制位用于启动写操作。用软件只能将该位置 1 而无法清零。在写操作完成后，由硬件将其清零。

注： 当写操作完成时，EEIF 中断标志位（PIR2<4>）被置 1。它必须用软件清零。

控制位 RD 和 WR 分别启动读和擦写操作。这些位由硬件置 1，并在操作完成时由硬件清零。

当访问程序存储器（EEPGD = 1）时，RD 位无法置 1。程序存储器是通过表读指令读取的。关于表读的信息，请参见第 6.1 节“表读与表写”。

EECON2 寄存器不是实际存在的寄存器。它专用于存储器写和擦除过程。读 EECON2 将得到全 0。

PIC18F2423/2523/4423/4523

寄存器 7-1: EECON1: EEPROM 控制寄存器 1

R/W-x	R/W-x	U-0	R/W-0	R/W-x	R/W-0	R/S-0	R/S-0
EEPGD	CFGS	—	FREE	WRERR ⁽¹⁾	WREN	WR	RD
bit 7							bit 0

图注:	S = 可设置位						
R = 可读位	W = 可写位		U = 未实现位, 读为 0				
-n = POR 值	1 = 置 1		0 = 清零			x = 未知	

- bit 7 **EEPGD:** 闪存程序存储器或数据 EEPROM 存储器选择位
 1 = 访问闪存程序存储器
 0 = 访问数据 EEPROM 存储器
- bit 6 **CFGS:** 闪存程序存储器 / 数据 EEPROM 存储器或配置寄存器选择位
 1 = 访问配置寄存器
 0 = 访问闪存程序存储器或数据 EEPROM 存储器
- bit 5 **未实现:** 读为 0
- bit 4 **FREE:** 闪存行擦除使能位
 1 = 在下一条 WR 命令时擦除 TBLPTR 寻址的程序存储器行 (擦除操作完成后清零)
 0 = 仅执行写操作
- bit 3 **WRERR:** 闪存程序存储器 / 数据 EEPROM 存储器错误标志位 ⁽¹⁾
 1 = 写操作提早终止 (由于正常操作中自定时编程期间的任何复位, 或不合法的写操作)
 0 = 写操作完成
- bit 2 **WREN:** 闪存程序存储器 / 数据 EEPROM 存储器写使能位
 1 = 允许对闪存程序存储器 / 数据 EEPROM 存储器的写周期
 0 = 禁止对闪存程序存储器 / 数据 EEPROM 存储器的写周期
- bit 1 **WR:** 写控制位
 1 = 启动数据 EEPROM 擦写周期或程序存储器的擦除周期或写周期 (操作是自定时的, 一旦写操作完成, 该位即由硬件清零。用软件只能将 WR 位置 1, 但不能清零。)
 0 = EEPROM 写周期完成
- bit 0 **RD:** 读控制位
 1 = 启动 EEPROM 读操作 (读操作需要一个周期。RD 位由硬件清零。用软件只能将 RD 位置 1, 但不能清零。EEPGD = 1 或 CFGS = 1 时, RD 位无法置 1。)
 0 = 不启动 EEPROM 读操作

注 1: 当发生 WRERR 时, EEGD 和 CFGS 位不会清零。这样可以跟踪错误状况。

7.3 读数据 EEPROM 存储器

要读取数据存储单元，用户必须将地址写入 EEADR 寄存器，清零 EEPGD 控制位 (EECON1<7>)，然后将控制位 RD (EECON1<0>) 置 1。可在下一个指令周期访问该数据；因此，EEDATA 寄存器可由下一条指令读取。EEDATA 将把此值保存至下一次读取或用户向该存储单元写入数据时 (写操作) 为止。

基本过程如例 7-1 中所示。

7.4 写数据 EEPROM 存储器

要向 EEPROM 数据存储单元写入数据，必须首先将地址写入 EEADR 寄存器，并将数据写入 EEDATA 寄存器。必须遵循例 7-2 中的序列启动写周期。

如果没有完全遵循该指令序列 (即首先将 55h 写入 EECON2，随后将 0AAh 写入 EECON2，最后将 WR 位置 1) 写每个字节，将不会启动写操作。强烈建议在这个代码段执行期间禁止中断。

此外，必须将 EECON1 中的 WREN 位置 1 以启用写操作。这种机制可防止由于意外执行代码 (即程序失控) 导致误写数据 EEPROM。除了更新 EEPROM 时以外，WREN 位应始终保持清零。WREN 位不会被硬件清零。

一个写序列启动后，EECON1、EEADR 和 EEDATA 不能被修改。除非将 WREN 位置 1，否则将禁止 WR 位被置 1。WR 和 WREN 不能由同一指令置 1。

写周期完成后，WR 位由硬件清零并且 EEPROM 中断标志位 EEIF 被置 1。用户可以允许此中断或查询此位。EEIF 必须用软件清零。

7.5 写校验

根据具体应用，将写入存储器的值与原始值校验比对是一个很好的编程习惯。在应用中，如果某些位的写次数接近额定极限值，就应该采用写校验。

例 7-1: 读数据 EEPROM

MOVLW	DATA_EE_ADDR	;
MOVWF	EEADR	; Data Memory Address to read
BCF	EECON1, EEPGD	; Point to DATA memory
BCF	EECON1, CFGS	; Access EEPROM
BSF	EECON1, RD	; EEPROM Read
MOVF	EEDATA, W	; W = EEDATA

例 7-2: 写数据 EEPROM

	MOVLW	DATA_EE_ADDR	;
	MOVWF	EEADR	; Data Memory Address to write
	MOVLW	DATA_EE_DATA	;
	MOVWF	EEDATA	; Data Memory Value to write
	BCF	EECON1, EEPGD	; Point to DATA memory
	BCF	EECON1, CFGS	; Access EEPROM
	BSF	EECON1, WREN	; Enable writes
	BCF	INTCON, GIE	; Disable Interrupts
	MOVLW	55h	;
	MOVWF	EECON2	; Write 55h
	MOVLW	0AAh	;
必需的序列	MOVWF	EECON2	; Write 0AAh
	BSF	EECON1, WR	; Set WR bit to begin write
	BSF	INTCON, GIE	; Enable Interrupts
			; User code execution
	BCF	EECON1, WREN	; Disable writes on write complete (EEIF set)

PIC18F2423/2523/4423/4523

7.6 代码保护期间的操作

数据 EEPROM 存储器在配置字中有它自己的代码保护位。如果使能任一种代码保护机制，外部读写操作就被禁止。

单片机本身可以读写内部数据 EEPROM，与代码保护配置位的状态无关。更多信息，请参见第 23.0 节“CPU 的特殊功能”。

7.7 防止误写操作的保护措施

有些情况下，用户并不希望写入数据 EEPROM 存储器。为了防止 EEPROM 误写操作，器件实现了各种保护机制。上电时，WREN 位被清零。而且，上电延时定时期间（TPWRT，参数 33）也会阻止对 EEPROM 进行写操作。

在欠压、电源毛刺或软件故障期间，写操作的启动序列以及 WREN 位可共同防止意外写操作的发生。

7.8 使用数据 EEPROM

数据 EEPROM 是高耐用性可字节寻址的阵列，已将其优化以便存储频繁变动的信息（例如，程序变量或其他经常更新的数据）。频繁变动值的更新频率通常高于规范 D124 中的规定。如果情况并非如此，必须执行阵列刷新。因此，只是偶尔改变的变量（如常量、ID 和校准值等）应该存储在闪存程序存储器中。

简单的数据 EEPROM 刷新程序如例 7-3 中所示。

注： 如果数据 EEPROM 仅用于存储常量和 / 或很少改变的数据，没有必要执行阵列刷新。请参见规范 D124。

例 7-3: 数据 EEPROM 刷新程序

```
CLRF    EEADR           ; Start at address 0
BCF     EECON1, CFGS    ; Set for memory
BCF     EECON1, EEPGD   ; Set for Data EEPROM
BCF     INTCON, GIE     ; Disable interrupts
BSF     EECON1, WREN    ; Enable writes
Loop:   BSF     EECON1, RD ; Read current address
        MOVLW  55h      ;
        MOVWF  EECON2   ; Write 55h
        MOVLW  0AAh     ;
        MOVWF  EECON2   ; Write 0AAh
        BSF     EECON1, WR ; Set WR bit to begin write
        BTFSC  EECON1, WR ; Wait for write to complete
        BRA    $-2
        INCF   EEADR, F  ; Increment address
        BRA    LOOP     ; Not zero, do it again

        BCF     EECON1, WREN ; Disable writes
        BSF     INTCON, GIE  ; Enable interrupts
```


PIC18F2423/2523/4423/4523

表 7-1: 与数据 EEPROM 存储器相关的寄存器

名称	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	复位值所在页
INTCON	GIE/GIEH	PEIE/GIEL	TMR0IE	INT0IE	RBIE	TMR0IF	INT0IF	RBIF	49
EEADR	EEPROM 地址寄存器								51
EEDATA	EEPROM 数据寄存器								51
EECON2	EEPROM 控制寄存器 2 (不是实际存在的寄存器)								51
EECON1	EEPGD	CFGS	—	FREE	WRERR	WREN	WR	RD	51
IPR2	OSCFIP	CMIP	—	EEIP	BCLIP	HLVDIP	TMR3IP	CCP2IP	52
PIR2	OSCFIF	CMIF	—	EEIF	BCLIF	HLVDIF	TMR3IF	CCP2IF	52
PIE2	OSCFIE	CMIE	—	EEIE	BCLIE	HLVDIE	TMR3IE	CCP2IE	52

图注: — = 未实现, 读为 0。闪存 /EEPROM 访问时不使用阴影单元。

PIC18F2423/2523/4423/4523

注:

8.0 8 x 8 硬件乘法器

8.1 简介

所有 PIC18 器件均包含一个 8 x 8 硬件乘法器（是 ALU 的一部分）。该乘法器可执行无符号运算并产生一个 16 位运算结果，该结果存储在 一对乘积寄存器 PRODH:PRODL 中。该乘法器执行的运算不会影响 STATUS 寄存器中的任何标志。

通过硬件执行乘法运算只需要一个指令周期。硬件乘法器具有更高的计算吞吐量并减少了乘法算法的代码长度，从而可在许多先前仅能使用数字信号处理器的应用中使用 PIC18 器件。表 8-1 给出了硬件和软件乘法运算的比较，包括所需存储空间和执行时间。

8.2 工作原理

例 8-1 给出了一个 8 x 8 无符号乘法运算的指令序列。当已在 WREG 寄存器中装入了一个乘数时，实现该运算仅需一条指令。

例 8-2 给出了一个 8 x 8 有符号乘法运算的指令序列。要弄清参数的符号位，必须检查每个参数的最高有效位（MSb），并做相应的减法。

例 8-1: 8 x 8 无符号乘法程序

```
MOVWF ARG1, W ;
MULWF ARG2 ; ARG1 * ARG2 ->
; PRODH:PRODL
```

例 8-2: 8 x 8 有符号乘法程序

```
MOVWF ARG1, W
MULWF ARG2 ; ARG1 * ARG2 ->
; PRODH:PRODL
BTFSC ARG2, SB ; Test Sign Bit
SUBWF PRODH, F ; PRODH = PRODH
; - ARG1
MOVWF ARG2, W
BTFSC ARG1, SB ; Test Sign Bit
SUBWF PRODH, F ; PRODH = PRODH
; - ARG2
```

表 8-1: 各种乘法运算的性能比较

程序	乘法实现方法	程序存储器 (字)	周期数 (最多)	时间		
				32 MHz 时	10 MHz 时	4 MHz 时
8 x 8 无符号	非硬件乘法	13	69	8.63 μs	27.6 μs	69 μs
	硬件乘法	1	1	125 ns	400 ns	1 μs
8 x 8 有符号	非硬件乘法	33	91	11.4 μs	36.4 μs	91 μs
	硬件乘法	6	6	750 ns	2.4 μs	6 μs
16 x 16 无符号	非硬件乘法	21	242	30.3 μs	96.8 μs	242 μs
	硬件乘法	28	28	3.5 μs	11.2 μs	28 μs
16 x 16 有符号	非硬件乘法	52	254	31.8 μs	102.6 μs	254 μs
	硬件乘法	35	40	5.0 μs	16.0 μs	40 μs

PIC18F2423/2523/4423/4523

例 8-3 给出了一个 16 x 16 无符号乘法运算的指令序列。公式 8-1 为所使用的算法。32 位结果存储在 4 个寄存器 (RES3:RES0) 中。

公式 8-1: 16 x 16 无符号乘法算法

$$\begin{aligned} \text{RES3:RES0} &= \text{ARG1H:ARG1L} \cdot \text{ARG2H:ARG2L} \\ &= (\text{ARG1H} \cdot \text{ARG2H} \cdot 2^{16}) + \\ &\quad (\text{ARG1H} \cdot \text{ARG2L} \cdot 2^8) + \\ &\quad (\text{ARG1L} \cdot \text{ARG2H} \cdot 2^8) + \\ &\quad (\text{ARG1L} \cdot \text{ARG2L}) \end{aligned}$$

例 8-3: 16 x 16 无符号乘法程序

```

MOVF ARG1L, W
MULWF ARG2L          ; ARG1L * ARG2L->
                      ; PRODH:PRODL

MOVFF PRODH, RES1   ;
MOVFF PRODL, RES0   ;
;
MOVF ARG1H, W
MULWF ARG2H          ; ARG1H * ARG2H->
                      ; PRODH:PRODL

MOVFF PRODH, RES3   ;
MOVFF PRODL, RES2   ;
;
MOVF ARG1L, W
MULWF ARG2H          ; ARG1L * ARG2H->
                      ; PRODH:PRODL

MOVF PRODL, W
ADDWF RES1, F        ; Add cross
MOVF PRODH, W        ; products
ADDWFC RES2, F       ;
CLRF WREG            ;
ADDWFC RES3, F       ;
;
MOVF ARG1H, W
MULWF ARG2L          ; ARG1H * ARG2L->
                      ; PRODH:PRODL

MOVF PRODL, W
ADDWF RES1, F        ; Add cross
MOVF PRODH, W        ; products
ADDWFC RES2, F       ;
CLRF WREG            ;
ADDWFC RES3, F       ;

```

例 8-4 给出了 16 x 16 有符号乘法运算的指令序列。公式 8-2 为所使用的算法。32 位结果存储在 4 个寄存器 (RES3:RES0) 中。要弄清乘数的符号位，必须检查每个乘数的最高有效位 (MSb)，并做相应的减法。

公式 8-2: 16 x 16 有符号乘法算法

$$\begin{aligned} \text{RES3:RES0} &= \text{ARG1H:ARG1L} \cdot \text{ARG2H:ARG2L} \\ &= (\text{ARG1H} \cdot \text{ARG2H} \cdot 2^{16}) + \\ &\quad (\text{ARG1H} \cdot \text{ARG2L} \cdot 2^8) + \\ &\quad (\text{ARG1L} \cdot \text{ARG2H} \cdot 2^8) + \\ &\quad (\text{ARG1L} \cdot \text{ARG2L}) + \\ &\quad (-1 \cdot \text{ARG2H} < 7 > \cdot \text{ARG1H:ARG1L} \cdot 2^{16}) + \\ &\quad (-1 \cdot \text{ARG1H} < 7 > \cdot \text{ARG2H:ARG2L} \cdot 2^{16}) \end{aligned}$$

例 8-4: 16 x 16 有符号乘法程序

```

MOVF ARG1L, W
MULWF ARG2L          ; ARG1L * ARG2L ->
                      ; PRODH:PRODL

MOVFF PRODH, RES1   ;
MOVFF PRODL, RES0   ;
;
MOVF ARG1H, W
MULWF ARG2H          ; ARG1H * ARG2H ->
                      ; PRODH:PRODL

MOVFF PRODH, RES3   ;
MOVFF PRODL, RES2   ;
;
MOVF ARG1L, W
MULWF ARG2H          ; ARG1L * ARG2H ->
                      ; PRODH:PRODL

MOVF PRODL, W
ADDWF RES1, F        ; Add cross
MOVF PRODH, W        ; products
ADDWFC RES2, F       ;
CLRF WREG            ;
ADDWFC RES3, F       ;
;
MOVF ARG1H, W
MULWF ARG2L          ; ARG1H * ARG2L ->
                      ; PRODH:PRODL

MOVF PRODL, W
ADDWF RES1, F        ; Add cross
MOVF PRODH, W        ; products
ADDWFC RES2, F       ;
CLRF WREG            ;
ADDWFC RES3, F       ;
;
BTFS ARG2H, 7        ; ARG2H:ARG2L neg?
BRA SIGN_ARG1        ; no, check ARG1
MOVF ARG1L, W
SUBWF RES2           ;
MOVF ARG1H, W
SUBWFB RES3          ;
;
SIGN_ARG1
BTFS ARG1H, 7        ; ARG1H:ARG1L neg?
BRA CONT_CODE        ; no, done
MOVF ARG2L, W
SUBWF RES2           ;
MOVF ARG2H, W
SUBWFB RES3          ;
;
CONT_CODE
:

```

9.0 中断

PIC18F2423/2523/4423/4523 器件具有多个中断源及中断优先级功能，该功能可以给每个中断源分配高优先级或者低优先级。高优先级中断向量位于 0008h，低优先级中断向量位于 0018h。高优先级中断事件可以中断正在处理的低优先级中断。

有 10 个寄存器用于控制中断操作。这些寄存器是：

- RCON
- INTCON
- INTCON2
- INTCON3
- PIR1 和 PIR2
- PIE1 和 PIE2
- IPR1 和 IPR2

建议使用随 MPLAB® IDE 提供的 Microchip 头文件命名这些寄存器中的位。这使得汇编器 / 编译器能够自动识别指定寄存器内的这些位。

通常，中断源有 3 个位用于控制其操作。这些位的功能分别是：

- **标志位**表明发生了中断事件
- **允许位**允许程序跳转到中断向量地址处执行（当标志位置 1 时）
- **优先级位**用于选择高优先级还是低优先级

通过将 IPEN 位（RCON<7>）置 1，可使能中断优先级功能。当使能中断优先级时，有 2 个全局中断允许位。将 GIEH 位（INTCON<7>）置 1，可允许所有优先级位已置 1（高优先级）的中断。将 GIEL 位（INTCON<6>）置 1，可允许所有优先级位已清零（低优先级）的中断。当中断标志位、允许位及相应的全局中断允许位均被置 1 时，中断将根据优先级位的设置立即跳转到地址 0008h 或 0018h。也可以通过设置相应的中断允许位来禁止各个中断。

当 IPEN 位清零（默认状态）时，便会禁止中断优先级功能，此时中断是与 PIC® 中档系列器件兼容的。在兼容模式下，各个中断源的中断优先级位不起作用。INTCON<6> 是 PEIE 位，用于允许 / 禁止所有的外设中断源。INTCON<7> 是 GIE 位，用于允许 / 禁止所有中断源。在兼容模式下，所有中断均跳转到 0008h。

当响应中断时，全局中断允许位被清零以禁止其他中断。清零后的 IPEN 位就是 GIE 位。如果使用了中断优先级，这个位就是 GIEH 位或者 GIEL 位。高优先级中断源会中断低优先级中断。在处理高优先级中断时，低优先级中断将不被响应。

返回地址被压入堆栈，中断向量地址（0008h 或 0018h）被装入 PC。只要在中断服务程序中，就可以通过查询中断标志位来确定中断源。在重新允许中断前，必须用软件将中断标志位清零，以避免重复响应中断。

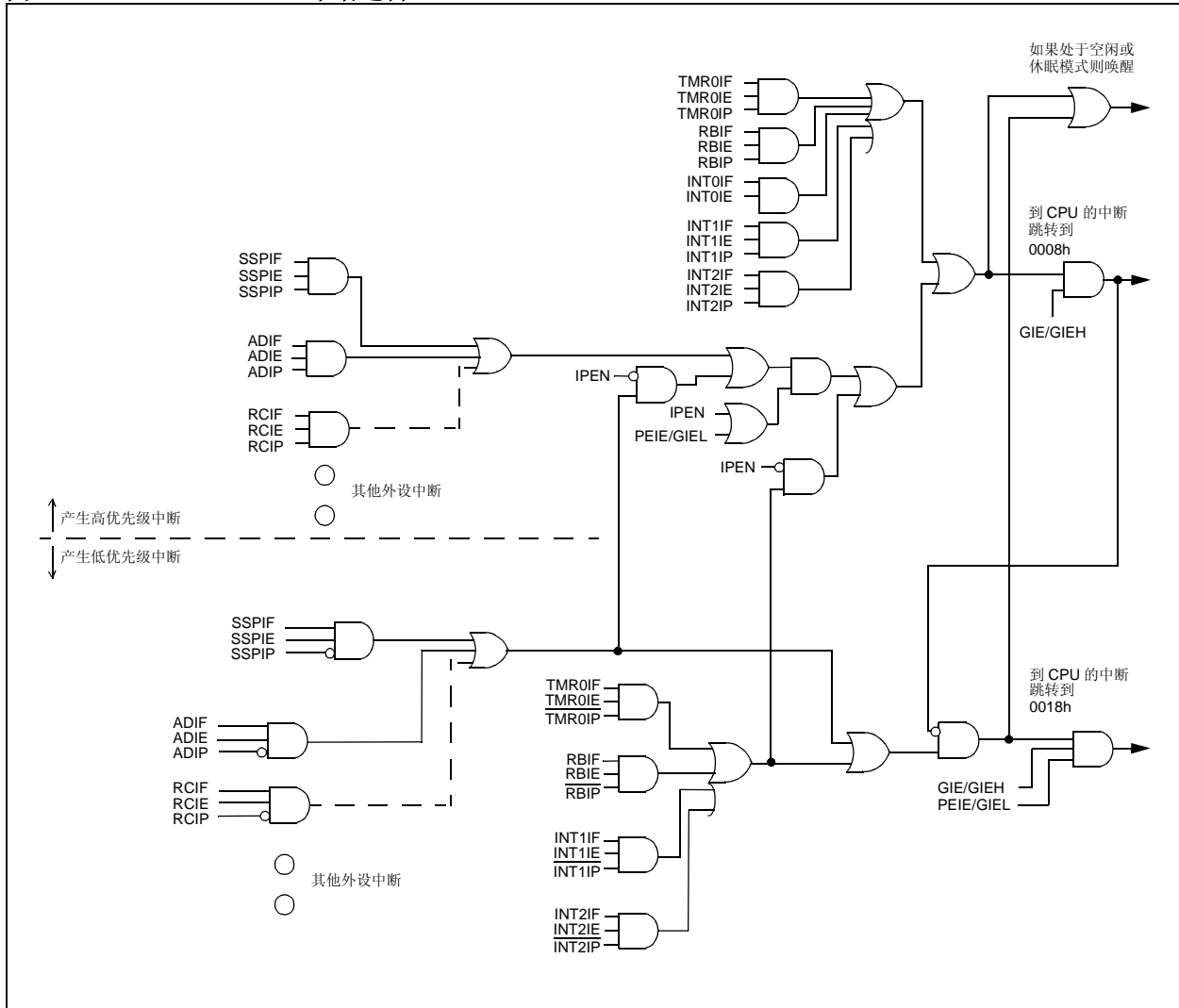
执行“从中断返回”指令 RETFIE 将退出中断程序，同时将 GIE 位（若使用中断优先级则为 GIEH 或 GIEL 位）置 1，从而重新允许中断。

对于外部中断事件，例如 INT 引脚中断或者 PORTB 输入电平变化中断，中断响应延时将会是 3 到 4 个指令周期。对于单周期或双周期指令，中断响应延时完全相同。各中断标志位的置 1 不受对应的中断允许位和 GIE 位状态的影响。

注：	当允许任何中断时，不要使用 MOVFF 指令修改中断控制寄存器。否则可能导致单片机操作出错。
-----------	--

PIC18F2423/2523/4423/4523

图 9-1: PIC18 中断逻辑



9.1 INTCON 寄存器

INTCON 寄存器是可读写的寄存器，包含各个中断允许位、优先级位和标志位。

注： 当中断条件产生时，不管相应的中断允许位或全局中断允许位的状态如何，中断标志位都将置 1。中断标志位可由软件查询。用户软件应在允许一个中断前，先将相应的中断标志位清零；否则只要允许了中断，就会产生中断。

寄存器 9-1: INTCON: 中断控制寄存器

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-x
GIE/GIEH	PEIE/GIEL	TMR0IE	INT0IE	RBIE	TMR0IF	INT0IF	RBIF ⁽¹⁾
bit 7							bit 0

图注：

R = 可读位	W = 可写位	U = 未实现位，读为 0
-n = POR 值	1 = 置 1	0 = 清零
		x = 未知

- bit 7 **GIE/GIEH:** 全局中断允许位
 当 IPEN = 0 时:
 1 = 允许所有未被屏蔽的中断
 0 = 禁止所有中断
 当 IPEN = 1 时:
 1 = 允许所有高优先级中断
 0 = 禁止所有中断
- bit 6 **PEIE/GIEL:** 外设中断允许位
 当 IPEN = 0 时:
 1 = 允许所有未被屏蔽的外设中断
 0 = 禁止所有外设中断
 当 IPEN = 1 时:
 1 = 允许所有低优先级的外设中断
 0 = 禁止所有低优先级的外设中断
- bit 5 **TMR0IE:** TMR0 溢出中断允许位
 1 = 允许 TMR0 溢出中断
 0 = 禁止 TMR0 溢出中断
- bit 4 **INT0IE:** INT0 外部中断允许位
 1 = 允许 INT0 外部中断
 0 = 禁止 INT0 外部中断
- bit 3 **RBIE:** RB 端口电平变化中断允许位
 1 = 允许 RB 端口电平变化中断
 0 = 禁止 RB 端口电平变化中断
- bit 2 **TMR0IF:** TMR0 溢出中断标志位
 1 = TMR0 寄存器已溢出 (必须用软件清零)
 0 = TMR0 寄存器未溢出
- bit 1 **INT0IF:** INT0 外部中断标志位
 1 = 发生了 INT0 外部中断 (必须用软件清零)
 0 = 未发生 INT0 外部中断
- bit 0 **RBIF:** RB 端口电平变化中断标志位 ⁽¹⁾
 1 = RB7:RB4 引脚中至少有一个引脚的电平状态发生了改变 (必须用软件清零)
 0 = RB7:RB4 引脚电平状态没有改变

注 1: 电平的不匹配会不断地将该位置 1。读取 PORTB 可以结束不匹配情况，并将该位清零。

PIC18F2423/2523/4423/4523

寄存器 9-2: INTCON2: 中断控制寄存器 2

R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	U-0	R/W-1	U-0	R/W-1
$\overline{\text{RBPU}}$	INTEDG0	INTEDG1	INTEDG2	—	TMR0IP	—	RBIP
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位 W = 可写位 U = 未实现位, 读为 0
-n = POR 值 1 = 置 1 0 = 清零 x = 未知

- bit 7 **$\overline{\text{RBPU}}$** : PORTB 上拉使能位
 1 = 禁止所有 PORTB 上拉
 0 = 根据各端口锁存值使能 PORTB 上拉
- bit 6 **INTEDG0**: 外部中断 0 边沿选择位
 1 = 上升沿触发中断
 0 = 下降沿触发中断
- bit 5 **INTEDG1**: 外部中断 1 边沿选择位
 1 = 上升沿触发中断
 0 = 下降沿触发中断
- bit 4 **INTEDG2**: 外部中断 2 边沿选择位
 1 = 上升沿触发中断
 0 = 下降沿触发中断
- bit 3 **未实现**: 读为 0
- bit 2 **TMR0IP**: TMR0 溢出中断优先级位
 1 = 高优先级
 0 = 低优先级
- bit 1 **未实现**: 读为 0
- bit 0 **RBIP**: RB 端口电平变化中断优先级位
 1 = 高优先级
 0 = 低优先级

注: 当中断条件产生时, 不管相应的中断允许位或全局中断允许位的状态如何, 中断标志位都将置 1。中断标志位可由软件查询。
用户软件应在允许一个中断前, 先将相应的中断标志位清零; 否则只要允许了中断, 就会产生中断。

PIC18F2423/2523/4423/4523

寄存器 9-3: INTCON3: 中断控制寄存器 3

R/W-1	R/W-1	U-0	R/W-0	R/W-0	U-0	R/W-0	R/W-0
INT2IP	INT1IP	—	INT2IE	INT1IE	—	INT2IF	INT1IF
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位 W = 可写位 U = 未实现位, 读为 0
 -n = POR 值 1 = 置 1 0 = 清零 x = 未知

- bit 7 **INT2IP:** INT2 外部中断优先级位
 1 = 高优先级
 0 = 低优先级
- bit 6 **INT1IP:** INT1 外部中断优先级位
 1 = 高优先级
 0 = 低优先级
- bit 5 **未实现:** 读为 0
- bit 4 **INT2IE:** INT2 外部中断允许位
 1 = 允许 INT2 外部中断
 0 = 禁止 INT2 外部中断
- bit 3 **INT1IE:** INT1 外部中断允许位
 1 = 允许 INT1 外部中断
 0 = 禁止 INT1 外部中断
- bit 2 **未实现:** 读为 0
- bit 1 **INT2IF:** INT2 外部中断标志位
 1 = 发生了 INT2 外部中断 (必须用软件清零)
 0 = 未发生 INT2 外部中断
- bit 0 **INT1IF:** INT1 外部中断标志位
 1 = 发生了 INT1 外部中断 (必须用软件清零)
 0 = 未发生 INT1 外部中断

注: 当中断条件产生时, 不管相应的中断允许位或全局中断允许位的状态如何, 中断标志位都将置 1。中断标志位可由软件查询。
 用户软件应在允许一个中断前, 先将相应的中断标志位清零; 否则只要允许了中断, 就会产生中断。

PIC18F2423/2523/4423/4523

9.2 PIR 寄存器

PIR 寄存器包含各外设中断的标志位。根据外设中断源的数量，有两个外设中断请求标志寄存器（PIR1 和 PIR2）。

注 1: 当中断条件产生时，不管相应的中断允许位或全局中断允许位 GIE（INTCON<7>）的状态如何，中断标志位都将置 1。

2: 用户软件应在允许中断前和处理完中断后，将相应的中断标志位清零。

寄存器 9-4: PIR1: 外设中断请求（标志）寄存器 1

R/W-0	R/W-0	R-0	R-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
PSPIF ⁽¹⁾	ADIF	RCIF	TXIF	SSPIF	CCP1IF	TMR2IF	TMR1IF
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位 W = 可写位 U = 未实现位，读为 0
-n = POR 值 1 = 置 1 0 = 清零 x = 未知

- bit 7 **PSPIF:** 并行从动端口读 / 写中断标志位 ⁽¹⁾
1 = 发生了读或写操作（必须用软件清零）
0 = 未发生读或写操作
- bit 6 **ADIF:** A/D 转换器中断标志位
1 = A/D 转换完成（必须用软件清零）
0 = A/D 转换未完成
- bit 5 **RCIF:** EUSART 接收中断标志位
1 = EUSART 接收缓冲器 RCREG 满（读取 RCREG 时清零）
0 = EUSART 接收缓冲器为空
- bit 4 **TXIF:** EUSART 发送中断标志位
1 = EUSART 发送缓冲器 TXREG 空（写入 TXREG 时清零）
0 = EUSART 发送缓冲器满
- bit 3 **SSPIF:** 主同步串行口中断标志位
1 = 发送 / 接收完成（必须用软件清零）
0 = 等待发送 / 接收
- bit 2 **CCP1IF:** CCP1 中断标志位
捕捉模式:
1 = 发生了 TMR1 寄存器捕捉（必须用软件清零）
0 = 未发生 TMR1 寄存器捕捉
比较模式:
1 = 发生了 TMR1 寄存器的比较匹配（必须用软件清零）
0 = 未发生 TMR1 寄存器的比较匹配
PWM 模式:
在此模式下未使用。
- bit 1 **TMR2IF:** TMR2 与 PR2 匹配中断标志位
1 = TMR2 与 PR2 匹配（必须用软件清零）
0 = TMR2 与 PR2 未发生匹配
- bit 0 **TMR1IF:** TMR1 溢出中断标志位
1 = TMR1 寄存器溢出（必须用软件清零）
0 = TMR1 寄存器未溢出

注 1: 该位在 28 引脚器件上未实现，读为 0。

PIC18F2423/2523/4423/4523

寄存器 9-5: PIR2: 外设中断请求 (标志) 寄存器 2

R/W-0	R/W-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
OSCFIF	CMIF	—	EEIF	BCLIF	HLVDIF	TMR3IF	CCP2IF
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位 W = 可写位 U = 未实现位, 读为 0
 -n = POR 值 1 = 置 1 0 = 清零 x = 未知

- bit 7 **OSCFIF:** 振荡器失效中断标志位
 1 = 系统振荡器失效, 改成由 INTOSC 作为时钟输入 (必须用软件清零)
 0 = 系统时钟正常运行
- bit 6 **CMIF:** 比较器中断标志位
 1 = 比较器输入已改变 (必须用软件清零)
 0 = 比较器输入未变化
- bit 5 **未实现:** 读为 0
- bit 4 **EEIF:** 数据 EEPROM/ 闪存写操作中断标志位
 1 = 写操作完成 (必须用软件清零)
 0 = 写操作未完成或尚未开始
- bit 3 **BCLIF:** 总线冲突中断标志位
 1 = 发生了总线冲突 (必须用软件清零)
 0 = 未发生总线冲突
- bit 2 **HLVDIF:** 高 / 低压检测中断标志位
 1 = 发生了高 / 低压条件 (方向由 VDIRMAG 位 HLVDCON<7> 决定)
 0 = 未发生高 / 低压条件
- bit 1 **TMR3IF:** TMR3 溢出中断标志位
 1 = TMR3 寄存器溢出 (必须用软件清零)
 0 = TMR3 寄存器未溢出
- bit 0 **CCP2IF:** CCP2 中断标志位
捕捉模式:
 1 = 发生了 TMR1 寄存器捕捉 (必须用软件清零)
 0 = 未发生 TMR1 寄存器捕捉
比较模式:
 1 = 发生了 TMR1 寄存器的比较匹配 (必须用软件清零)
 0 = 未发生 TMR1 寄存器的比较匹配
PWM 模式:
 在此模式下不使用。

PIC18F2423/2523/4423/4523

9.3 PIE 寄存器

PIE 寄存器包含各外设中断的允许位。根据外设中断源的数量，有两个外设中断允许寄存器（PIE1 和 PIE2）。当 IPEN = 0 时，要允许任一外设中断，必须将 PEIE 位置 1。

寄存器 9-6: **PIE1: 外设中断允许寄存器 1**

R/W-0	R/W-0	R-0	R-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
PSPIE ⁽¹⁾	ADIE	RCIE	TXIE	SSPIE	CCP1IE	TMR2IE	TMR1IE
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位	W = 可写位	U = 未实现位，读为 0	
-n = POR 值	1 = 置 1	0 = 清零	x = 未知

- bit 7 **PSPIE:** 并行从动端口读 / 写中断允许位 ⁽¹⁾
 - 1 = 允许 PSP 读 / 写中断
 - 0 = 禁止 PSP 读 / 写中断
- bit 6 **ADIE:** A/D 转换器中断允许位
 - 1 = 允许 A/D 中断
 - 0 = 禁止 A/D 中断
- bit 5 **RCIE:** EUSART 接收中断允许位
 - 1 = 允许 EUSART 接收中断
 - 0 = 禁止 EUSART 接收中断
- bit 4 **TXIE:** EUSART 发送中断允许位
 - 1 = 允许 EUSART 发送中断
 - 0 = 禁止 EUSART 发送中断
- bit 3 **SSPIE:** 主同步串行口中断允许位
 - 1 = 允许 MSSP 中断
 - 0 = 禁止 MSSP 中断
- bit 2 **CCP1IE:** CCP1 中断允许位
 - 1 = 允许 CCP1 中断
 - 0 = 禁止 CCP1 中断
- bit 1 **TMR2IE:** TMR2 与 PR2 匹配中断允许位
 - 1 = 允许 TMR2 与 PR2 匹配中断
 - 0 = 禁止 TMR2 与 PR2 匹配中断
- bit 0 **TMR1IE:** TMR1 溢出中断允许位
 - 1 = 允许 TMR1 溢出中断
 - 0 = 禁止 TMR1 溢出中断

注 1: 该位在 28 引脚器件上未实现，读为 0。

PIC18F2423/2523/4423/4523

寄存器 9-7: PIE2: 外设中断允许寄存器 2

R/W-0	R/W-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
OSCFIE	CMIE	—	EEIE	BCLIE	HLVDIE	TMR3IE	CCP2IE
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

- bit 7 **OSCFIE:** 振荡器失效中断允许位
1 = 允许
0 = 禁止
- bit 6 **CMIE:** 比较器中断允许位
1 = 允许
0 = 禁止
- bit 5 **未实现:** 读为 0
- bit 4 **EEIE:** 数据 EEPROM/ 闪存写操作中中断允许位
1 = 允许
0 = 禁止
- bit 3 **BCLIE:** 总线冲突中断允许位
1 = 允许
0 = 禁止
- bit 2 **HLVDIE:** 高 / 低压检测中断允许位
1 = 允许
0 = 禁止
- bit 1 **TMR3IE:** TMR3 溢出中断允许位
1 = 允许
0 = 禁止
- bit 0 **CCP2IE:** CCP2 中断允许位
1 = 允许
0 = 禁止

PIC18F2423/2523/4423/4523

9.4 IPR 寄存器

IPR 寄存器包含各外设中断的优先级位。根据外设中断源的数量，有两个外设中断优先级寄存器（IPR1 和 IPR2）。使用优先级位时，要求将中断优先级允许（IPEN）位置 1。

寄存器 9-8: IPR1: 外设中断优先级寄存器 1

R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1
PSP1P ⁽¹⁾	ADIP	RCIP	TXIP	SSPIP	CCP1IP	TMR2IP	TMR1IP
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位	W = 可写位	U = 未实现位，读为 0	
-n = POR 值	1 = 置 1	0 = 清零	x = 未知

- bit 7 **PSP1P:** 并行从动端口读 / 写中断优先级位 ⁽¹⁾
1 = 高优先级
0 = 低优先级
- bit 6 **ADIP:** A/D 转换器中断优先级位
1 = 高优先级
0 = 低优先级
- bit 5 **RCIP:** EUSART 接收中断优先级位
1 = 高优先级
0 = 低优先级
- bit 4 **TXIP:** EUSART 发送中断优先级位
1 = 高优先级
0 = 低优先级
- bit 3 **SSPIP:** 主同步串行口中断优先级位
1 = 高优先级
0 = 低优先级
- bit 2 **CCP1IP:** CCP1 中断优先级位
1 = 高优先级
0 = 低优先级
- bit 1 **TMR2IP:** TMR2 与 PR2 匹配中断优先级位
1 = 高优先级
0 = 低优先级
- bit 0 **TMR1IP:** TMR1 溢出中断优先级位
1 = 高优先级
0 = 低优先级

注 1: 该位在 28 引脚器件上未实现，读为 0。

PIC18F2423/2523/4423/4523

寄存器 9-9: IPR2: 外设中断优先级寄存器 2

R/W-1	R/W-1	U-0	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1
OSCFIP	CMIP	—	EEIP	BCLIP	HLVDIP	TMR3IP	CCP2IP
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

- bit 7 **OSCFIP:** 振荡器失效中断优先级位
1 = 高优先级
0 = 低优先级
- bit 6 **CMIP:** 比较器中断优先级位
1 = 高优先级
0 = 低优先级
- bit 5 **未实现:** 读为 0
- bit 4 **EEIP:** 数据 EEPROM/ 闪存写操作中断优先级位
1 = 高优先级
0 = 低优先级
- bit 3 **BCLIP:** 总线冲突中断优先级位
1 = 高优先级
0 = 低优先级
- bit 2 **HLVDIP:** 高 / 低压检测中断优先级位
1 = 高优先级
0 = 低优先级
- bit 1 **TMR3IP:** TMR3 溢出中断优先级位
1 = 高优先级
0 = 低优先级
- bit 0 **CCP2IP:** CCP2 中断优先级位
1 = 高优先级
0 = 低优先级

PIC18F2423/2523/4423/4523

9.5 RCON 寄存器

SBOREN 位和复位标志位的操作已在第 4.1 节“RCON 寄存器”中详细讨论。

RCON 寄存器中包含的标志位可用来确定器件上次复位或从空闲或休眠模式唤醒的原因。RCON 还包含一个可使能中断优先级的 IPEN 位。

寄存器 9-10: RCON: 复位控制寄存器

R/W-0	R/W-1 ⁽¹⁾	U-0	R/W-1	R-1	R-1	R/W-0 ⁽²⁾	R/W-0
IPEN	SBOREN	—	\overline{RI}	\overline{TO}	\overline{PD}	\overline{POR}	\overline{BOR}
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

- bit 7 **IPEN:** 中断优先级使能位
1 = 使能中断优先级
0 = 禁止中断优先级 (PIC16CXXX 兼容模式)
- bit 6 **SBOREN:** BOR 软件使能位 ⁽¹⁾
位操作的详细信息, 请参见寄存器 4-1。
- bit 5 **未实现:** 读为 0
- bit 4 **\overline{RI} :** RESET 指令标志位
位操作的详细信息, 请参见寄存器 4-1。
- bit 3 **\overline{TO} :** 看门狗超时标志位
位操作的详细信息, 请参见寄存器 4-1。
- bit 2 **\overline{PD} :** 掉电检测标志位
位操作的详细信息, 请参见寄存器 4-1。
- bit 1 **\overline{POR} :** 上电复位状态位 ⁽²⁾
位操作的详细信息, 请参见寄存器 4-1。
- bit 0 **\overline{BOR} :** 欠压复位状态位
位操作的详细信息, 请参见寄存器 4-1。

注 1: 如果使能了 SBOREN 位, 其复位状态为 1; 否则为 0。更多信息, 请参见寄存器 4-1。

注 2: \overline{POR} 的实际复位值由器件复位的类型决定。更多信息, 请参见寄存器 4-1。

9.6 INTn 引脚中断

RB0/INT0、RB1/INT1 和 RB2/INT2 引脚上的外部中断都是边沿触发的。如果 INTCON2 寄存器中相应的 INTEDGx 位被置 1 (= 1)，则为上升沿触发；如果该位被清零，则为下降沿触发。当 RBx/INTx 引脚上出现一个有效边沿时，相应的标志位 INTxIF 被置 1。通过清零相应的允许位 INTxIE，可禁止该中断。在重新允许该中断前，必须在中断服务程序中先用软件将中断标志位 INTxIF 清零。

如果 INTxIE 位在进入空闲或休眠模式前被置 1，则所有的外部中断 (INT0、INT1 和 INT2) 均能将处理器从空闲或休眠模式唤醒。如果全局中断允许位 GIE 被置 1，则处理器将在被唤醒之后转移到中断向量处执行程序。

INT1 和 INT2 的中断优先级由中断优先级位 INT1IP (INTCON3<6>) 和 INT2IP (INTCON3<7>) 的值决定。没有与 INT0 相关的优先级位。INT0 始终是一个高优先级的中断源。

9.7 TMR0 中断

在 8 位模式 (默认模式) 下，TMR0 寄存器的溢出 (FFh → 00h) 会使 TMR0IF 标志位置 1。在 16 位模式下，TMR0H:TMR0L 寄存器对的溢出 (FFFFh → 0000h) 会使 TMR0IF 标志位置 1。通过将允许位 TMR0IE (INTCON<5>) 置 1 或清零，可以允许或禁止该中断。Timer0 的中断优先级由中断优先级位 TMR0IP (INTCON2<2>) 的值决定。欲进一步了解 Timer0 模块的详细信息，请参见第 11.0 节“Timer0 模块”。

9.8 PORTB 电平变化中断

PORTB<7:4> 上的输入电平变化会将标志位 RBIF (INTCON<0>) 置 1。通过将中断允许位 RBIE (INTCON<3>) 置 1 或清零，可以允许或禁止该中断。PORTB 电平变化中断的优先级由中断优先级位 RBIP (INTCON2<0>) 的值决定。

9.9 中断的现场保护

在中断期间，PC 的返回地址被保存在堆栈中。另外，WREG、STATUS 和 BSR 寄存器的值被压入快速返回堆栈。如果未使用从中断快速返回功能 (见第 5.3 节“数据存储结构”)，那么用户可能需要在进入中断服务程序前时保存 WREG、STATUS 和 BSR 寄存器的值。根据用户的具体应用，还可能需要在保存其他寄存器的值。例 9-1 在执行中断服务程序期间，保存并恢复 WREG、STATUS 和 BSR 寄存器的值。

例 9-1: 将 STATUS、WREG 和 BSR 寄存器的值保存在 RAM 中

```
MOVWF    W_TEMP                ; W_TEMP is in virtual bank
MOVFF    STATUS, STATUS_TEMP    ; STATUS_TEMP located anywhere
MOVFF    BSR, BSR_TEMP          ; BSR_TEMP located anywhere
;
; USER ISR CODE
;
MOVFF    BSR_TEMP, BSR          ; Restore BSR
MOVF     W_TEMP, W              ; Restore WREG
MOVFF    STATUS_TEMP, STATUS    ; Restore STATUS
```

PIC18F2423/2523/4423/4523

注:

10.0 I/O 端口

根据选定的器件和使能的功能，最多有 5 个端口可供使用。I/O 端口的一些引脚与器件上外设功能复用。一般来说，当外设被使能时，其对应的引脚就不能被用作通用 I/O 引脚。

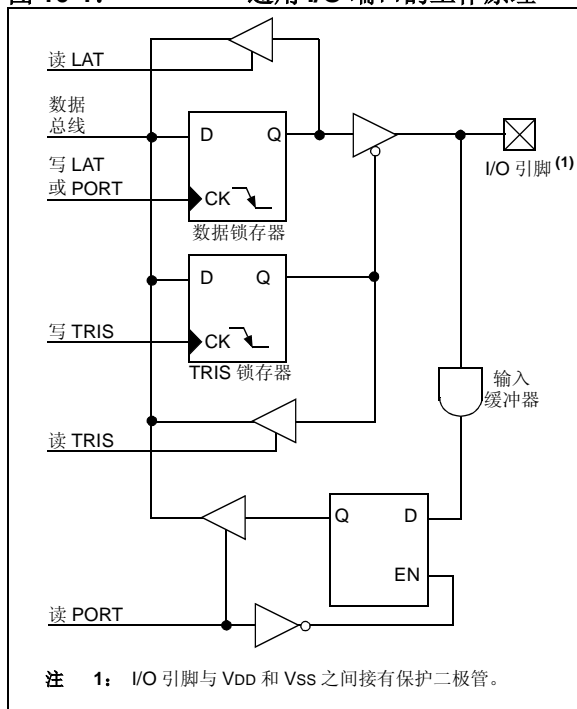
每个端口都有三个操作寄存器。这些寄存器是：

- TRIS 寄存器（数据方向寄存器）
- PORT 寄存器（读取器件引脚的电平）
- LAT 寄存器（输出锁存器）

在对 I/O 引脚驱动值进行读—修改—写时会用到数据锁存器（LAT 寄存器）。

图 10-1 给出了通用 I/O 端口的简化模型，没有给出与其他外设的接口。

图 10-1: 通用 I/O 端口的工作原理



10.1 PORTA、TRISA 和 LATA 寄存器

PORTA 是一个 8 位宽的双向端口，对应的数据方向寄存器是 TRISA。将 TRISA 某位置 1 (= 1) 时，会将 PORTA 的相应引脚设为输入（即，使相应的输出驱动器呈高阻状态）。将 TRISA 某位清零 (= 0) 时，会将 PORTA 的相应引脚设为输出（即，将输出锁存器中的内容输出到选中引脚）。

读 PORTA 寄存器将读出相应引脚的状态，而对其进行写操作则是将数据写入端口锁存器。

数据锁存寄存器（LATA）也是存储器映射的。对 LATA 寄存器执行读—修改—写操作将读写为 PORTA 锁存的输出值。

RA4 引脚与 Timer0 模块的时钟输入以及比较器输出之一复用，成为 RA4/T0CKI/C1OUT 引脚。RA6 和 RA7 引脚与主振荡器引脚复用，通过在配置寄存器（详细信息，请参见第 23.1 节“配置位”）中对主振荡器进行配置可将这两个引脚使能为振荡器或 I/O 引脚。当不被用作端口引脚时，RA6 和 RA7 及其相关的 TRIS 和 LAT 位均读为 0。

MSSP 模块也将 RA5/AN4/SS/HLVDIN/C2OUT 引脚用作数字输入。为此，必须在 ADCON1 中将引脚配置为数字，并且将 TRISA<5> 置 1。

其他 PORTA 引脚与模拟输入、模拟 VREF+ 和 VREF- 输入、比较器参考电压输出以及 HLVD 模拟输入复用。通过将 ADCON1 寄存器（A/D 控制寄存器 1）中的控制位清零或置 1，可将 RA3:RA0 和 RA5 引脚选作模拟输入引脚。

通过在 CMCON 寄存器中设置相应的位还可以将 RA0 到 RA5 引脚用作比较器输入或输出。要将 RA3:RA0 用作数字输入，还必须关闭比较器。

注： 在上电复位时，RA5 和 RA3:RA0 被配置为模拟输入并读为 0。RA4 则被配置为数字输入。

RA4/T0CKI/C1OUT 引脚为施密特触发器输入，所有其他 PORTA 引脚都为 TTL 电平输入和全 CMOS 输出驱动器。

TRISA 寄存器控制着 PORTA 引脚的方向，即使它们被用作模拟输入。当引脚用于模拟输入时，用户必须确保 TRISA 寄存器中相应的位保持置 1。

例 10-1: 初始化 PORTA

```

CLRF   PORTA   ; Initialize PORTA by
              ; clearing output
              ; data latches
CLRF   LATA    ; Alternate method
              ; to clear output
              ; data latches
MOVLW  07h    ; Configure A/D
MOVWF  ADCON1 ; for digital inputs
MOVWF  07h    ; Configure comparators
MOVWF  CMCON  ; for digital input
MOVLW  0CFh  ; Value used to
              ; initialize data
              ; direction
MOVWF  TRISA  ; Set RA<3:0> as inputs
              ; RA<5:4> as outputs
    
```

PIC18F2423/2523/4423/4523

表 10-1: PORTA I/O 汇总

引脚	功能	TRIS 设置	I/O	I/O 类型	说明
RA0/AN0	RA0	0	O	DIG	LATA<0> 数据输出; 不受模拟输入影响。
		1	I	TTL	PORTA<0> 数据输入; 当使能模拟输入时被禁止。
	AN0	1	I	ANA	A/D 输入通道 0 和比较器 C1- 输入。POR 时的默认输入配置; 不影响数字输出。
		0	O	DIG	LATA<1> 数据输出; 不受模拟输入影响。
RA1/AN1	RA1	1	I	TTL	PORTA<1> 数据输入; 当使能模拟输入时被禁止。
		1	I	ANA	A/D 输入通道 1 和比较器 C2- 输入。POR 时的默认输入配置; 不影响数字输出。
RA2/AN2/ VREF-/CVREF	RA2	0	O	DIG	LATA<2> 数据输出; 不受模拟输入影响。当使能 CVREF 输出时被禁止。
		1	I	TTL	PORTA<2> 数据输入。当使能模拟功能时被禁止; 当使能 CVREF 输出时被禁止。
	AN2	1	I	ANA	A/D 输入通道 2 和比较器 C2+ 输入。POR 时的默认输入配置; 不受模拟输出影响。
	VREF-	1	I	ANA	A/D 和比较器低参考电压输入。
	CVREF	x	O	ANA	比较器参考电压输出。使能该功能将禁止数字 I/O。
RA3/AN3/VREF+	RA3	0	O	DIG	LATA<3> 数据输出; 不受模拟输入影响。
		1	I	TTL	PORTA<3> 数据输入; 当使能模拟输入时被禁止。
	AN3	1	I	ANA	A/D 输入通道 3 和比较器 C1+ 输入。POR 时的默认输入配置。
	VREF+	1	I	ANA	A/D 和比较器高参考电压输入。
RA4/T0CKI/C1OUT	RA4	0	O	DIG	LATA<4> 数据输出。
		1	I	ST	PORTA<4> 数据输入; POR 时的默认配置。
	T0CKI	1	I	ST	Timer0 的时钟输入。
	C1OUT	0	O	DIG	比较器 1 的输出; 优先于端口数据。
RA5/AN4/SS/ HLVDIN/C2OUT	RA5	0	O	DIG	LATA<5> 数据输出; 不受模拟输入影响。
		1	I	TTL	PORTA<5> 数据输入; 当使能模拟输入时被禁止。
	AN4	1	I	ANA	A/D 输入通道 4。POR 时的默认配置。
	SS	1	I	TTL	MSSP 的从动选择输入 (MSSP 模块)。
	HLVDIN	1	I	ANA	高/低压检测外部跳变点输入。
	C2OUT	0	O	DIG	比较器 2 的输出; 优先于端口数据。
OSC2/CLKO/RA6	OSC2	x	O	ANA	主振荡器反馈输出连接 (XT、HS 和 LP 模式)。
	CLKO	x	O	DIG	RC、INTIO1 和 EC 振荡器模式下的系统周期时钟输出 (Fosc/4)。
	RA6	0	O	DIG	LATA<6> 数据输出。仅在 RCIO、INTIO2 和 ECIO 模式下使能。
		1	I	TTL	PORTA<6> 数据输入。仅在 RCIO、INTIO2 和 ECIO 模式下使能。
OSC1/CLKI/RA7	OSC1	x	I	ANA	主振荡器输入连接。
	CLKI	x	I	ANA	主时钟输入连接。
	RA7	0	O	DIG	LATA<7> 数据输出。在外部振荡器模式下被禁止。
		1	I	TTL	PORTA<7> 数据输入。在外部振荡器模式下被禁止。

图注: DIG = 数字电平输出; TTL = TTL 输入缓冲器; ST = 施密特触发器输入缓冲器; ANA = 模拟电平输入 / 输出;
x = 无关 (TRIS 位不影响端口方向或此时改写 TRIS 位的设置)。

PIC18F2423/2523/4423/4523

表 10-2: 与 PORTA 相关的寄存器汇总

名称	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	复位值所在页
PORTA	RA7 ⁽¹⁾	RA6 ⁽¹⁾	RA5	RA4	RA3	RA2	RA1	RA0	52
LATA	LATA7 ⁽¹⁾	LATA6 ⁽¹⁾	PORTA 数据锁存寄存器 (读和写数据锁存器)						52
TRISA	TRISA7 ⁽¹⁾	TRISA6 ⁽¹⁾	PORTA 数据方向控制寄存器						52
ADCON1	—	—	VCFG1	VCFG0	PCFG3	PCFG2	PCFG1	PCFG0	51
CMCON	C2OUT	C1OUT	C2INV	C1INV	CIS	CM2	CM1	CM0	51
CVRCON	CVREN	CVROE	CVRR	CVRSS	CVR3	CVR2	CVR1	CVR0	51

图注: — = 未实现, 读为 0。PORTA 不使用阴影单元。

注 1: RA7:RA6 及其相关的锁存器和数据方向位根据振荡器配置使能为 I/O 引脚; 否则, 它们将被读为 0。

PIC18F2423/2523/4423/4523

10.2 PORTB、TRISB 和 LATB 寄存器

PORTB 是一个 8 位宽的双向端口，对应的数据方向寄存器是 TRISB。将 TRISB 某位置 1 (= 1) 时，会将 PORTB 的相应引脚设为输入（即，使相应的输出驱动器呈高阻状态）。将 TRISB 某位清零 (= 0) 时，会将 PORTB 的相应引脚设为输出（即，将输出锁存器中的内容置于选中引脚）。

数据锁存器（LATB）也是存储器映射的。对 LATB 寄存器执行读—修改—写操作将读写为 PORTB 锁存的输出值。

例 10-2: 初始化 PORTB

```
CLRF    PORTB    ; Initialize PORTB by
                ; clearing output
                ; data latches
CLRF    LATB     ; Alternate method
                ; to clear output
                ; data latches
MOVLW   0Fh     ; Set RB<4:0> as
MOVWF   ADCON1  ; digital I/O pins
                ; (required if config bit
                ; PBDEN is set)
MOVLW   0CFh   ; Value used to
                ; initialize data
                ; direction
MOVWF   TRISB   ; Set RB<3:0> as inputs
                ; RB<5:4> as outputs
                ; RB<7:6> as inputs
```

每个 PORTB 引脚都具有内部弱上拉。一个控制位即可接通所有数字输入引脚的上拉。这是通过清零 RBPUL 位（INTCON2<7>）实现的。当端口引脚被配置为数字输出或模拟输入时，其弱上拉会自动关闭。上电复位会禁止弱上拉。

注： 上电复位时，默认情况下 RB4:RB0 被配置为模拟输入且读为 0；RB7:RB5 则被配置为数字输入。
通过对配置位 PBDEN 进行编程，RB4:RB0 可在 POR 时被配置为数字输入。

PORTB 的四个引脚（RB7:RB4）具有电平变化中断功能，也被称为“键盘中断”（KBI3:KBI0）。仅当将这些引脚配置为输入时，才具有此中断功能（即当 RB7:RB4 中的任何一个引脚被配置为输出时，该引脚将不再具有电平变化中断功能）。将引脚（RB7:RB4）上的输入电平与 PORTB 上次读入锁存器的旧值进行比较。对 RB7:RB4 上的“不匹配”输出进行或运算，产生 RB 端口电平变化中断，并将标志位 RBIF（INTCON<0>）置 1。

该中断可将器件从休眠模式或任何空闲模式唤醒。用户可用以下方式在中断服务程序中清除该中断：

- 读或写 PORTB（MOVFF（ANY）和 PORTB 指令除外）。
- 将标志位 RBIF 清零。

不匹配条件将继续把标志位 RBIF 置 1。读 PORTB 将结束不匹配条件并允许将标志位 RBIF 清零。

建议使用电平变化中断功能实现按键唤醒操作，以及那些仅使用 PORTB 的电平变化中断功能的操作。在使用电平变化中断功能时，建议不要查询 PORTB 的状态。

RB3 可由控制位 CCP2MX 配置为 CCP2 模块（CCP2MX = 0）的备用外设引脚。

在器件编程期间 RB7:RB5 被分别用作 PGD:PGC:PGM 引脚。更多详细信息，请参见第 23.7 节“在线串行编程”、第 23.8 节“在线调试器”和第 23.9 节“单电源 ICSP 编程”。

RB2:RB0 提供外部中断输入（分别为 INT2:INT0）。详细信息，请参见第 9.6 节“INTn 引脚中断”。

当 ECCP1 使用外部故障输入来将 PWM 输出关闭时，RB0 提供故障输入（FLT0）。更多信息，请参见第 16.4.7 节“增强型 PWM 自动关闭”。

PIC18F2423/2523/4423/4523

表 10-3: PORTB I/O 汇总

引脚	功能	TRIS 设置	I/O	I/O 类型	说明
RB0/INT0/FLT0/ AN12	RB0	0	O	DIG	LATB<0> 数据输出; 不受模拟输入影响。
		1	I	TTL	PORTB<0> 数据输入; 当 $\overline{\text{RBPU}}$ 位清零时启用弱上拉。当使能模拟输入时被禁止。(1)
	INT0	1	I	ST	外部中断 0 输入。
	FLT0	1	I	ST	增强型 PWM 故障输入 (ECCP1 模块); 通过软件使能。
	AN12	1	I	ANA	A/D 输入通道 12。(1)
RB1/INT1/AN10	RB1	0	O	DIG	LATB<1> 数据输出; 不受模拟输入影响。
		1	I	TTL	PORTB<1> 数据输入; 当 $\overline{\text{RBPU}}$ 位清零时启用弱上拉。当使能模拟输入时被禁止。(1)
	INT1	1	I	ST	外部中断 1 输入。
	AN10	1	I	ANA	A/D 输入通道 10。(1)
RB2/INT2/AN8	RB2	0	O	DIG	LATB<2> 数据输出; 不受模拟输入影响。
		1	I	TTL	PORTB<2> 数据输入; 当 $\overline{\text{RBPU}}$ 位清零时启用弱上拉。当使能模拟输入时被禁止。(1)
	INT2	1	I	ST	外部中断 2 输入。
	AN8	1	I	ANA	A/D 输入通道 8。(1)
RB3/AN9/CCP2	RB3	0	O	DIG	LATB<3> 数据输出; 不受模拟输入影响。
		1	I	TTL	PORTB<3> 数据输入; 当 $\overline{\text{RBPU}}$ 位清零时启用弱上拉。当使能模拟输入时被禁止。(1)
	AN9	1	I	ANA	A/D 输入通道 9。(1)
	CCP2(2)	0	O	DIG	CCP2 比较输出和 PWM 输出。
		1	I	ST	CCP2 捕捉输入。
RB4/KBI0/AN11	RB4	0	O	DIG	LATB<4> 数据输出; 不受模拟输入影响。
		1	I	TTL	PORTB<4> 数据输入; 当 $\overline{\text{RBPU}}$ 位清零时启用弱上拉。当使能模拟输入时被禁止。(1)
	KBI0	1	I	TTL	引脚电平变化中断。
	AN11	1	I	ANA	A/D 输入通道 11。(1)
RB5/KBI1/PGM	RB5	0	O	DIG	LATB<5> 数据输出。
		1	I	TTL	PORTB<5> 数据输入; 当 $\overline{\text{RBPU}}$ 位清零时启用弱上拉。
	KBI1	1	I	TTL	引脚电平变化中断。
	PGM	x	I	ST	单电源编程模式选择 (ICSP™)。由 LVP 配置位使能; 所有其他引脚功能被禁止。
RB6/KBI2/PGC	RB6	0	O	DIG	LATB<6> 数据输出。
		1	I	TTL	PORTB<6> 数据输入; 当 $\overline{\text{RBPU}}$ 位清零时启用弱上拉。
	KBI2	1	I	TTL	引脚电平变化中断。
	PGC	x	I	ST	供 ICSP 和 ICD 操作使用的串行执行 (ICSP™) 时钟输入。(3)
RB7/KBI3/PGD	RB7	0	O	DIG	LATB<7> 数据输出。
		1	I	TTL	PORTB<7> 数据输入; 当 $\overline{\text{RBPU}}$ 位清零时启用弱上拉。
	KBI3	1	I	TTL	引脚电平变化中断。
	PGD	x	O	DIG	供 ICSP 和 ICD 操作使用的串行执行数据输出。(3)
		x	I	ST	供 ICSP 和 ICD 操作使用的串行执行数据输入。(3)

图注: DIG = 数字电平输出; TTL = TTL 输入缓冲器; ST = 施密特触发器输入缓冲器; ANA = 模拟电平输入 / 输出; x = 无关 (TRIS 位不影响端口方向或此时改写 TRIS 位的设置)。

注 1: POR 时的配置由 PBadEN 配置位决定。默认情况下, 当 PBadEN 置 1 时, 引脚被配置为模拟输入; 当 PBadEN 清零时, 则被配置为数字输入。

2: 当 CCP2MX 配置位为 0 时 CCP2 的备用设置。默认设置为 RC1。

3: 当使能 ICSP 或 ICD 时, 禁止所有其他引脚的功能。

PIC18F2423/2523/4423/4523

表 10-4: 与 PORTB 相关的寄存器汇总

名称	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	复位值 所在页
PORTB	RB7	RB6	RB5	RB4	RB3	RB2	RB1	RB0	52
LATB	PORTB 数据锁存寄存器 (读和写数据锁存器)								52
TRISB	PORTB 数据方向控制寄存器								52
INTCON	GIE/GIEH	PEIE/GIEL	TMR0IE	INT0IE	RBIE	TMR0IF	INT0IF	RBIF	49
INTCON2	$\overline{\text{RBPU}}$	INTEDG0	INTEDG1	INTEDG2	—	TMR0IP	—	RBIP	49
INTCON3	INT2IP	INT1IP	—	INT2IE	INT1IE	—	INT2IF	INT1IF	49
ADCON1	—	—	VCFG1	VCFG0	PCFG3	PCFG2	PCFG1	PCFG0	51

图注: — = 未实现, 读为 0。PORTB 不使用阴影单元。

10.3 PORTC、TRISC 和 LATC 寄存器

PORTC 是一个 8 位宽的双向端口，对应的数据方向寄存器是 TRISC。将 TRISC 某位置 1 (= 1) 时，会将 PORTC 的相应引脚设为输入（即，使相应的输出驱动器呈高阻状态）。将 TRISC 某位清零 (= 0) 时，会将 PORTC 的相应引脚设为输出（即，将输出锁存器中的内容输出到选中引脚）。

数据锁存寄存器 (LATC) 也是存储器映射的。对 LATC 寄存器执行读-修改-写操作将读写为 PORTC 锁存的内容输出值。

PORTC 与几种外设功能复用（表 10-5）。这些引脚配有施密特触发器输入缓冲器。RC1 一般由配置位 CCP2MX 配置为 CCP2 模块的默认外设引脚（默认/擦除状态，CCP2MX = 1）。

RC7 和 RC6 由 EUSART 使用（第 18.0 节“增强型通用同步/异步收发器 (EUSART)”）。RC5、RC4 和 RC3 由 MSSP 使用（第 17.0 节“主同步串行口 (MSSP) 模块”）。RC2 由 ECCP1 使用（第 16.0 节“增强型捕捉/比较/PWM (ECCP) 模块”）。RC1 和 RC0 由 Timer1 振荡器使用（第 12.3 节“Timer1 振荡器”）。RC0 也可用作 Timer1 和 Timer3 的时钟输入（分别见第 12.0 节“Timer1 模块”和第 14.0 节“Timer3 模块”）。RC1 也可由 CCP2 使用（第 15.0 节“捕捉/比较/PWM (CCP) 模块”），取决于配置位 CCP2MX（寄存器 23-4，CONFIG3H）。

当使能外设功能时，应小心定义每个 PORTC 引脚的 TRIS 位。有些外设会改写 TRIS 位的设置，将引脚定义为输出引脚或输入引脚。用户应该查阅相应的外设章节来获取更多的信息。

注： 上电复位时，这些引脚被配置为数字输入。

外设对引脚的改写会影响 TRISC 寄存器的内容。尽管如此，读 TRISC 总是会返回其当前的内容。

例 10-3: 初始化 PORTC

```
CLRF    PORTC    ; Initialize PORTC by
           ; clearing output
           ; data latches
CLRF    LATC     ; Alternate method
           ; to clear output
           ; data latches
MOVLW  0CFh     ; Value used to
           ; initialize data
           ; direction
MOVWF  TRISC    ; Set RC<3:0> as inputs
           ; RC<5:4> as outputs
           ; RC<7:6> as inputs
```

PIC18F2423/2523/4423/4523

表 10-5: PORTC I/O 汇总

引脚	功能	TRIS 设置	I/O	I/O 类型	说明
RC0/T1OSO/ T13CKI	RC0	0	O	DIG	LATC<0> 数据输出。
		1	I	ST	PORTC<0> 数据输入。
	T1OSO	x	O	ANA	Timer1 振荡器输出；当使能 Timer1 振荡器时被使能。禁止数字 I/O。
	T13CKI	1	I	ST	Timer1/Timer3 计数器输入。
RC1/T1OSI/CCP2	RC1	0	O	DIG	LATC<1> 数据输出。
		1	I	ST	PORTC<1> 数据输入。
	T1OSI	x	I	ANA	Timer1 振荡器输入；当使能 Timer1 振荡器时被使能。禁止数字 I/O。
	CCP2 ⁽¹⁾	0	O	DIG	CCP2 比较输出和 PWM 输出；优先于端口数据。
1		I	ST	CCP2 捕捉输入。	
RC2/CCP1/P1A	RC2	0	O	DIG	LATC<2> 数据输出。
		1	I	ST	PORTC<2> 数据输入。
	CCP1	0	O	DIG	ECCP1 比较输出或 PWM 输出；优先于端口数据。
		1	I	ST	ECCP1 捕捉输入。
P1A ⁽²⁾	0	O	DIG	ECCP1 增强型 PWM 输出，通道 A。可以在增强型 PWM 关闭事件时被配置为三态。优先于端口数据。	
RC3/SCK/SCL	RC3	0	O	DIG	LATC<3> 数据输出。
		1	I	ST	PORTC<3> 数据输入。
	SCK	0	O	DIG	SPI 时钟输出（MSSP 模块）；优先于端口数据。
		1	I	ST	SPI 时钟输入（MSSP 模块）。
SCL	0	O	DIG	I ² C™ 时钟输出（MSSP 模块）；优先于端口数据。	
	1	I	I ² C/SMB	I ² C 时钟输入（MSSP 模块）；输入类型取决于模块设置。	
RC4/SDI/SDA	RC4	0	O	DIG	LATC<4> 数据输出。
		1	I	ST	PORTC<4> 数据输入。
	SDI	1	I	ST	SPI 数据输入（MSSP 模块）。
	SDA	1	O	DIG	I ² C 数据输出（MSSP 模块）；优先于端口数据。
1		I	I ² C/SMB	I ² C 数据输入（MSSP 模块）；输入类型取决于模块设置。	
RC5/SDO	RC5	0	O	DIG	LATC<5> 数据输出。
		1	I	ST	PORTC<5> 数据输入。
	SDO	0	O	DIG	SPI 数据输出（MSSP 模块）；优先于端口数据。
RC6/TX/CK	RC6	0	O	DIG	LATC<6> 数据输出。
		1	I	ST	PORTC<6> 数据输入。
	TX	1	O	DIG	异步串行发送数据输出（EUSART 模块）；优先于端口数据。用户必须将其配置为输出。
	CK	1	O	DIG	同步串行时钟输出（EUSART 模块）；优先于端口数据。
1		I	ST	同步串行时钟输入（EUSART 模块）。	
RC7/RX/DT	RC7	0	O	DIG	LATC<7> 数据输出。
		1	I	ST	PORTC<7> 数据输入。
	RX	1	I	ST	异步串行接收数据输入（EUSART 模块）。
	DT	1	O	DIG	同步串行数据输出（EUSART 模块）；优先于端口数据。
1		I	ST	同步串行数据输入（EUSART 模块）。用户必须将其配置为输入。	

图注： DIG = 数字电平输出； TTL = TTL 输入缓冲器； ST = 施密特触发器输入缓冲器； ANA = 模拟电平输入 / 输出； I²C/SMB = I²C/SMBus 输入缓冲器； x = 无关（TRIS 位不影响端口方向或此时改写 TRIS 位的设置）。

- 注 1: 当 CCP2MX 配置位置 1 时 CCP2 的默认分配。备用分配为 RB3。
 注 2: 增强型 PWM 输出仅在 PIC18F4523 器件上实现。

PIC18F2423/2523/4423/4523

表 10-6: 与 PORTC 相关的寄存器汇总

名称	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	复位值 所在页
PORTC	RC7	RC6	RC5	RC4	RC3	RC2	RC1	RC0	52
LATC	PORTC 数据锁存寄存器 (读和写数据锁存器)								52
TRISC	PORTC 数据方向控制寄存器								52

PIC18F2423/2523/4423/4523

10.4 PORTD、TRISD 和 LATD 寄存器

注： PORTD 仅在 40/44 引脚器件上实现。

PORTD 是一个 8 位宽的双向端口，对应的数据方向寄存器是 TRISD。将 TRISD 某位置 1 (= 1) 时，会将 PORTD 的相应引脚设为输入（即，使相应的输出驱动器呈高阻状态）。将 TRISD 某位清零 (= 0) 时，会将 PORTD 的相应引脚设为输出（即，将输出锁存器中的内容输出到选中引脚）。

数据锁存寄存器（LATD）也是存储器映射的。对 LATD 寄存器执行读—修改—写操作将读写为 PORTD 锁存的输出值。

PORTD 上的所有引脚都配有施密特触发器输入缓冲器。每个引脚都可被单独配置为输入或输出。

PORTD 的三个引脚与增强型 CCP 模块的 P1B、P1C 和 P1D 输出复用。这些额外的 PWM 输出引脚的操作在第 16.0 节“增强型捕捉 / 比较 / PWM (ECCP) 模块”中有更详细的阐述。

注： 上电复位时，这些引脚被配置为数字输入。

还可通过将控制位 PSPMODE (TRISE<4>) 置 1，将 PORTD 配置为 8 位宽的微处理器端口（并行从动端口）。在此模式下，输入缓冲器是 TTL。关于并行从动端口（PSP）的更多信息，请参见第 10.6 节“并行从动端口”。

注： 当增强型 PWM 模式使用双输出或四输出时，PORTD 的 PSP 功能被自动禁止。

例 10-4: 初始化 PORTD

```
CLRF    PORTD    ; Initialize PORTD by
                ; clearing output
                ; data latches
CLRF    LATD     ; Alternate method
                ; to clear output
                ; data latches
MOVLW  0CFh     ; Value used to
                ; initialize data
                ; direction
MOVWF  TRISD    ; Set RD<3:0> as inputs
                ; RD<5:4> as outputs
                ; RD<7:6> as inputs
```

PIC18F2423/2523/4423/4523

表 10-7: PORTD I/O 汇总⁽¹⁾

引脚	功能	TRIS 设置	I/O	I/O 类型	说明
RD0/PSP0	RD0	0	O	DIG	LATD<0> 数据输出。
		1	I	ST	PORTD<0> 数据输入。
	PSP0	x	O	DIG	PSP 读数据输出 (LATD<0>)；优先于端口数据。
		x	I	TTL	PSP 写数据输入。
RD1/PSP1	RD1	0	O	DIG	LATD<1> 数据输出。
		1	I	ST	PORTD<1> 数据输入。
	PSP1	x	O	DIG	PSP 读数据输出 (LATD<1>)；优先于端口数据。
		x	I	TTL	PSP 写数据输入。
RD2/PSP2	RD2	0	O	DIG	LATD<2> 数据输出。
		1	I	ST	PORTD<2> 数据输入。
	PSP2	x	O	DIG	PSP 读数据输出 (LATD<2>)；优先于端口数据。
		x	I	TTL	PSP 写数据输入。
RD3/PSP3	RD3	0	O	DIG	LATD<3> 数据输出。
		1	I	ST	PORTD<3> 数据输入。
	PSP3	x	O	DIG	PSP 读数据输出 (LATD<3>)；优先于端口数据。
		x	I	TTL	PSP 写数据输入。
RD4/PSP4	RD4	0	O	DIG	LATD<4> 数据输出。
		1	I	ST	PORTD<4> 数据输入。
	PSP4	x	O	DIG	PSP 读数据输出 (LATD<4>)；优先于端口数据。
		x	I	TTL	PSP 写数据输入。
RD5/PSP5/P1B	RD5	0	O	DIG	LATD<5> 数据输出。
		1	I	ST	PORTD<5> 数据输入。
	PSP5	x	O	DIG	PSP 读数据输出 (LATD<5>)；优先于端口数据。
		x	I	TTL	PSP 写数据输入。
	P1B	0	O	DIG	ECCP1 增强型 PWM 输出，通道 B；优先于端口和 PSP 数据。可以在增强型 PWM 关闭事件时被配置为三态。
RD6/PSP6/P1C	RD6	0	O	DIG	LATD<6> 数据输出。
		1	I	ST	PORTD<6> 数据输入。
	PSP6	x	O	DIG	PSP 读数据输出 (LATD<6>)；优先于端口数据。
		x	I	TTL	PSP 写数据输入。
	P1C	0	O	DIG	ECCP1 增强型 PWM 输出，通道 C；优先于端口和 PSP 数据。可以在增强型 PWM 关闭事件时被配置为三态。
RD7/PSP7/P1D	RD7	0	O	DIG	LATD<7> 数据输出。
		1	I	ST	PORTD<7> 数据输入。
	PSP7	x	O	DIG	PSP 读数据输出 (LATD<7>)；优先于端口数据。
		x	I	TTL	PSP 写数据输入。
	P1D	0	O	DIG	ECCP1 增强型 PWM 输出，通道 D；优先于端口和 PSP 数据。可以在增强型 PWM 关闭事件时被配置为三态。

图注: DIG = 数字电平输出；TTL = TTL 输入缓冲器；ST = 施密特触发器输入缓冲器；x = 无关 (TRIS 位不影响端口方向或此时改写 TRIS 位的设置)。

注 1: 这些寄存器和 / 或位在 28 引脚器件上未实现。

PIC18F2423/2523/4423/4523

表 10-8: 与 PORTD 相关的寄存器汇总 (1)

名称	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	复位值 所在页
PORTD	RD7	RD6	RD5	RD4	RD3	RD2	RD1	RD0	52
LATD	PORTD 数据锁存寄存器 (读和写数据锁存器)								52
TRISD	PORTD 数据方向控制寄存器								52
TRISE	IBF	OBF	IBOV	PSPMODE	—	TRISE2	TRISE1	TRISE0	52
CCP1CON	P1M1 ⁽¹⁾	P1M0 ⁽¹⁾	DC1B1	DC1B0	CCP1M3	CCP1M2	CCP1M1	CCP1M0	51

图注: — = 未实现, 读为 0。PORTD 不使用阴影单元。

注 1: 这些寄存器和 / 或位在 28 引脚器件上未实现。

10.5 PORTE、TRISE 和 LATE 寄存器

根据选定的特定 PIC18F2423/2523/4423/4523 器件，PORTE 可通过两种不同的方式实现。

对于 40/44 引脚器件，PORTE 是 4 位宽的端口。三个引脚（RE0/RD/AN5、RE1/WR/AN6 和 RE2/CS/AN7）可单独配置为输入或输出。这些引脚配有施密特触发器输入缓冲器。当被选为模拟输入时，这些引脚将读为 0。

对应的数据方向寄存器是 TRISE。将 TRISE 某位置 1（= 1）时，会将 PORTE 的相应引脚设为输入（即，使相应的输出驱动器呈高阻状态）。将 TRISE 某位清零（= 0）时，会将 PORTE 的相应引脚设为输出（即，将输出锁存器中的内容输出到选中引脚）。

TRISE 控制着 RE 引脚的方向，即使它们被用作模拟输入。用户在将这些引脚用作模拟输入时，必须确保将它们配置为输入。

注： 上电复位时，RE2:RE0 被配置为模拟输入。

TRISE 寄存器的高 4 位也控制着并行从动端口的操作。它们的操作在寄存器 10-1 中进行说明。

数据锁存寄存器（LATE）也是存储器映射的。对 LATE 寄存器执行读—修改—写操作将读写为 PORTE 锁存的输出值。

PORTE（MCLR/Vpp/RE3）的第 4 个引脚是仅输入引脚。其操作由 MCLRE 配置位控制。当被选为端口引脚时（MCLRE = 0），它用作仅数字输入引脚；这样，它不具备与操作相关的 TRIS 或 LAT 位。否则，它用作器件的主复位输入。在任何一种配置中，RE3 都用作编程期间的编程电压输入。

注： 上电复位时，仅当主复位功能禁止时，才能将 RE3 使能为数字输入。

例 10-5: 初始化 PORTE

```
CLRF    PORTE    ; Initialize PORTE by
                ; clearing output
                ; data latches
CLRF    LATE     ; Alternate method
                ; to clear output
                ; data latches
MOVLW  0Ah      ; Configure A/D
MOVWF  ADCON1   ; for digital inputs
MOVLW  03h      ; Value used to
                ; initialize data
                ; direction
MOVWF  TRISE    ; Set RE<0> as inputs
                ; RE<1> as outputs
                ; RE<2> as inputs
```

10.5.1 28 引脚器件上的 PORTE

对于 28 引脚器件，仅当主复位功能禁止时（MCLRE = 0），才能使用 PORTE。在这些情况下，PORTE 是一位仅由 RE3 组成的仅输入端口。引脚操作如前所述。

PIC18F2423/2523/4423/4523

寄存器 10-1: TRISE 寄存器 (仅 40/44 引脚器件)

R-0	R-0	R/W-0	R/W-0	U-0	R/W-1	R/W-1	R/W-1
IBF	OBF	IBOV	PSPMODE	—	TRISE2	TRISE1	TRISE0
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

- bit 7 **IBF:** 输入缓冲器满状态位
1 = 已接收一个字, 等待 CPU 读取
0 = 未接收到任何字
- bit 6 **OBF:** 输出缓冲器满状态位
1 = 输出缓冲器仍保存着之前写入的字
0 = 输出缓冲器已被读取
- bit 5 **IBOV:** 输入缓冲器溢出检测位 (处于微处理器模式下)
1 = 之前输入的字尚未被读取时发生写操作 (必须用软件清零)
0 = 未发生溢出
- bit 4 **PSPMODE:** 并行从动端口模式选择位
1 = 并行从动端口模式
0 = 通用 I/O 模式
- bit 3 **未实现:** 读为 0
- bit 2 **TRISE2:** RE2 方向控制位
1 = 输入
0 = 输出
- bit 1 **TRISE1:** RE1 方向控制位
1 = 输入
0 = 输出
- bit 0 **TRISE0:** RE0 方向控制位
1 = 输入
0 = 输出

PIC18F2423/2523/4423/4523

表 10-9: PORTE I/O 汇总

引脚	功能	TRIS 设置	I/O	I/O 类型	说明
RE0/ $\overline{\text{RD}}$ /AN5	RE0	0	O	DIG	LATE<0> 数据输出；不受模拟输入影响。
		1	I	ST	PORTE<0> 数据输入；当使能模拟输入时被禁止。
	$\overline{\text{RD}}$	1	I	TTL	PSP 读使能输入（PSP 被使能）。
	AN5	1	I	ANA	A/D 输入通道 5；POR 时的默认输入配置。
RE1/ $\overline{\text{WR}}$ /AN6	RE1	0	O	DIG	LATE<1> 数据输出；不受模拟输入影响。
		1	I	ST	PORTE<1> 数据输入；当使能模拟输入时被禁止。
	$\overline{\text{WR}}$	1	I	TTL	PSP 写使能输入（PSP 被使能）。
	AN6	1	I	ANA	A/D 输入通道 6；POR 时的默认输入配置。
RE2/ $\overline{\text{CS}}$ /AN7	RE2	0	O	DIG	LATE<2> 数据输出；不受模拟输入影响。
		1	I	ST	PORTE<2> 数据输入；当使能模拟输入时被禁止。
	$\overline{\text{CS}}$	1	I	TTL	PSP 写使能输入（PSP 被使能）。
	AN7	1	I	ANA	A/D 输入通道 7；POR 时的默认输入配置。
$\overline{\text{MCLR}}$ / $\overline{\text{VPP}}$ /RE3 ⁽¹⁾	$\overline{\text{MCLR}}$	—	I	ST	外部主复位输入；当 MCLRE 配置位置 1 时被使能。
	VPP	—	I	ANA	高电压检测；用于 ICSP™ 模式输入检测。始终可用，与引脚模式无关。
	RE3	— ⁽²⁾	I	ST	PORTE<3> 数据输入；当 MCLRE 配置位清零时被使能。

图注： DIG = 数字电平输出；TTL = TTL 输入缓冲器；ST = 施密特触发器输入缓冲器；ANA = 模拟电平输入 / 输出；x = 无关（TRIS 位不影响端口方向或此时改写 TRIS 位的设置）。

- 注 1：** RE3 在 28 引脚和 40/44 引脚器件上均存在。所有其他 PORTE 引脚只在 40/44 引脚器件上存在。
注 2： RE3 没有相应的 TRIS 位来控制数据方向。

表 10-10: 与 PORTE 相关的寄存器汇总

名称	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	复位值所在页
PORTE	—	—	—	—	RE3 ^(1,2)	RE2	RE1	RE0	52
LATE ⁽²⁾	—	—	—	—	—	PORTE 数据锁存寄存器 (读和写数据锁存器)			52
TRISE	IBF	OBF	IBOV	PSPMODE	—	TRISE2	TRISE1	TRISE0	52
ADCON1	—	—	VCFG1	VCFG0	PCFG3	PCFG2	PCFG1	PCFG0	51

图注： — = 未实现，读为 0。PORTE 不使用阴影单元。

- 注 1：** 仅当主复位功能被禁止时（MCLRE 配置位 = 0）可用。
注 2： RE3 是在 28 引脚和 40/44 引脚器件上均可使用的唯一 PORTE 位。所有其他位只能在实现 PORTE 时使用（即 40/44 引脚器件）。

PIC18F2423/2523/4423/4523

10.6 并行从动端口

注： 并行从动端口仅在40/44引脚器件上实现。

除了作为通用 I/O 端口，PORTD 还可用作一个 8 位宽的并行从动端口（PSP）或微处理器端口。PSP 操作由 TRISE 寄存器（寄存器 10-1）的高 4 位控制。只要增强型 CCP 模块不是工作在双输出或四输出 PWM 模式下，将控制位 PSPMODE（TRISE<4>）置 1 可使能 PSP 操作。在从动模式下，可从外部异步地读写端口。

PSP 可以直接与 8 位微处理器数据总线连接。外部微处理器可以读或写 PORTD 8 位锁存值。将控制位 PSPMODE 置 1 可使能 PORTE I/O 引脚，使之成为微处理器端口的控制输入。当置 1 时，端口引脚 RE0 为 RD 输入，RE1 为 WR 输入，RE2 为 CS（片选）输入。要实现此功能，TRISE 寄存器（TRISE<2:0>）中对应的数据方向位必须配置为输入（置 1）。A/D 端口配置位 PFCG3:PFCG0（ADCON1<3:0>）也必须设置为 1010 到 1111 范围内的值。

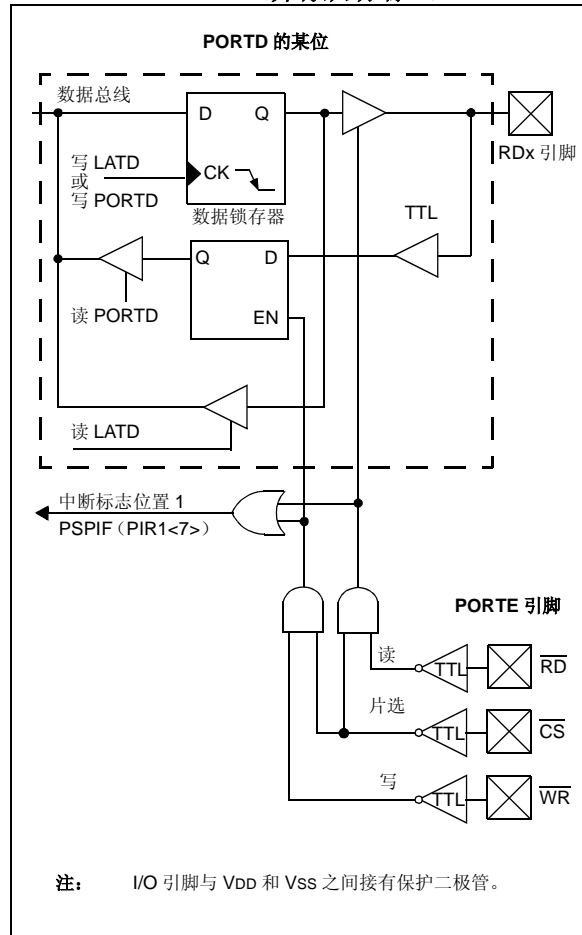
当第一次检测到 \overline{CS} 和 \overline{WR} 线均为低电平时发生对 PSP 的写操作，当检测到任何一根线为高电平时结束写操作。写操作结束后，PSPIF 和 IBF 标志位均置 1。

当第一次检测到 \overline{CS} 和 \overline{RD} 线均为低电平时发生对 PSP 的读操作。PORTD 中的数据被读出且 OBF 位被清零。如果用户将新数据写入 PORTD 希望将 OBF 置 1，该数据会立即被读出；但 OBF 位不会被置 1。

当 \overline{CS} 或 \overline{RD} 线被检测到高电平时，PORTD 引脚返回到输入状态且 PSPIF 位被置 1。用户应用程序应等到 PSPIF 被置 1 后才向 PSP 提供服务；这样，可查询 IBF 和 OBF 位并采取相应的操作。

写和读模式下控制信号的时序分别如图 10-3 和图 10-4 所示。

图 10-2: PORTD 和 PORTE 框图（并行从动端口）



PIC18F2423/2523/4423/4523

图 10-3: 并行从动端口写波形图

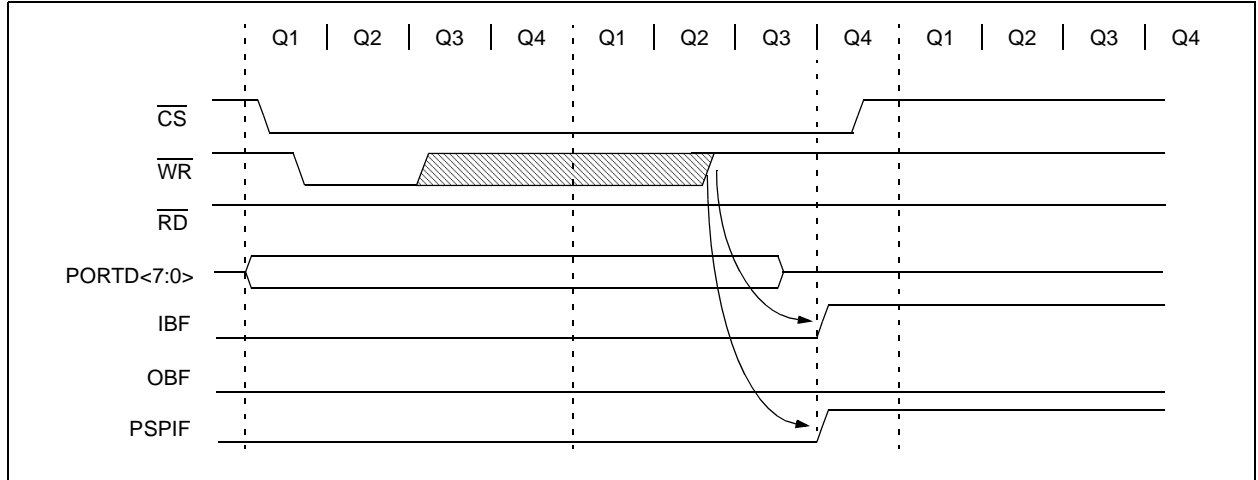


图 10-4: 并行从动端口读波形图

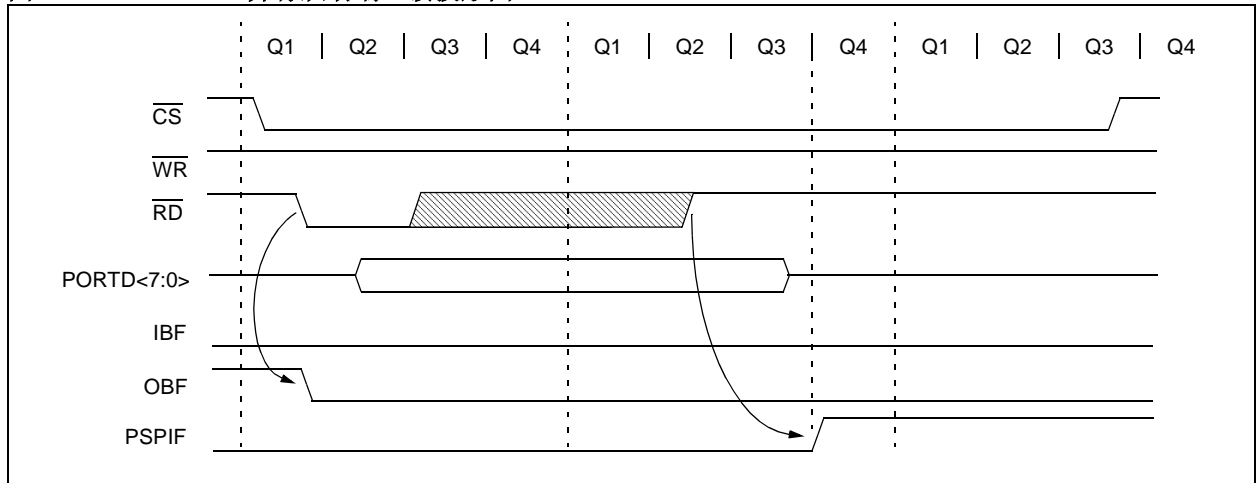


表 10-11: 与并行从动端口相关的寄存器

名称	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	复位值 所在页
PORTD	RD7	RD6	RD5	RD4	RD3	RD2	RD1	RD0	52
LATD	PORTD 数据锁存寄存器 (读和写数据锁存器)								52
TRISD	PORTD 数据方向控制寄存器								52
PORTE	—	—	—	—	RE3	RE2	RE1	RE0	52
LATE	—	—	—	—	—	PORTE 数据锁存寄存器 (读和写数据锁存器)			52
TRISE	IBF	OBF	IBOV	PSPMODE	—	TRISE2	TRISE1	TRISE0	52
INTCON	GIE/GIEH	PEIE/GIEL	TMR0IF	INT0IE	RBIE	TMR0IF	INT0IF	RBIF	49
PIR1	PSPIF	ADIF	RCIF	TXIF	SSPIF	CCP1IF	TMR2IF	TMR1IF	52
PIE1	PSPIE	ADIE	RCIE	TXIE	SSPIE	CCP1IE	TMR2IE	TMR1IE	52
IPR1	PSPIP	ADIP	RCIP	TXIP	SSPIP	CCP1IP	TMR2IP	TMR1IP	52
ADCON1	—	—	VCFG1	VCFG0	PCFG3	PCFG2	PCFG1	PCFG0	51

图注: — = 未实现, 读为 0。并行从动端口不使用阴影单元。

PIC18F2423/2523/4423/4523

注:

PIC18F2423/2523/4423/4523

11.0 TIMER0 模块

Timer0 模块具有以下特性:

- 可由软件选择作为 8 位或 16 位定时器 / 计数器
- 可读写寄存器
- 专用的 8 位软件可编程预分频器
- 可选的时钟源 (内部或外部)
- 外部时钟的边沿选择
- 溢出时产生中断

T0CON 寄存器 (寄存器 11-1) 控制该模块操作的所有方面, 包括预分频比的选择。它是可读写的。

图 11-1 给出了 8 位模式下 Timer0 模块的简化框图。图 11-2 给出了 16 位模式下 Timer0 模块的简化框图。

寄存器 11-1: T0CON: TIMER0 控制寄存器

R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1
TMR0ON	T08BIT	T0CS	T0SE	PSA	T0PS2	T0PS1	T0PS0
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

bit 7 **TMR0ON:** Timer0 开 / 关控制位

1 = 使能 Timer0

0 = 停止 Timer0

bit 6 **T08BIT:** Timer0 8 位 / 16 位控制位

1 = Timer0 被配置为 8 位定时器 / 计数器

0 = Timer0 被配置为 16 位定时器 / 计数器

bit 5 **T0CS:** Timer0 时钟源选择位

1 = T0CKI 引脚上的信号

0 = 内部指令周期时钟 (CLKO)

bit 4 **T0SE:** Timer0 时钟源边沿选择位

1 = 在 T0CKI 引脚上电平的下降沿递增

0 = 在 T0CKI 引脚上电平的上升沿递增

bit 3 **PSA:** Timer0 预分频器分配位

1 = 未分配 Timer0 预分频器。Timer0 时钟输入不经预分频器分频。

0 = 已分配 Timer0 预分频器。Timer0 时钟输入来自预分频器的输出。

bit 2-0 **T0PS2:T0PS0:** Timer0 预分频值选择位

111 = 1:256 预分频值

110 = 1:128 预分频值

101 = 1:64 预分频值

100 = 1:32 预分频值

011 = 1:16 预分频值

010 = 1:8 预分频值

001 = 1:4 预分频值

000 = 1:2 预分频值

PIC18F2423/2523/4423/4523

11.1 Timer0 工作原理

Timer0既可用作定时器也可用作计数器。可通过T0CS位 (T0CON<5>) 来选择模式。在定时器模式下 (T0CS = 0)，该模块在每个时钟周期计都会递增 (默认情况下)，除非选择了其他预分频值 (见第 11.3 节“预分频器”)。如果写入 TMR0 寄存器，那么在随后的两个指令周期内，都不再递增。用户可通过将调整值写入 TMR0 寄存器来避开这一问题。

通过将 T0CS 位置 1 (= 1) 选择计数器模式。在该模式下，Timer0 可在 RA4/T0CKI 引脚上信号的每个上升沿或下降沿递增。递增边沿由 Timer0 时钟源边沿选择位 T0SE (T0CON<4>) 决定。清零该位即选择上升沿。下面讨论外部时钟输入的限制条件。

可以使用外部时钟源来驱动 Timer0。但是，必须满足一定要求，以确保外部时钟和内部相位时钟 (Tosc) 保持同步。在同步之后，定时器 / 计数器需要一定的延时才开始递增。

11.2 16 位模式下 Timer0 的读写操作

TMR0H 并不是 16 位模式下 Timer0 的高字节，而是被缓存的 Timer0 高字节，不可以被直接读写 (见图 11-2)。在读 TMR0L 时使用 Timer0 高字节的内容更新 TMR0H。这样可以一次读取 Timer0 的全部 16 位，而无需验证读到的高字节和低字节的有效性 (在连续读取高字节和低字节时，由于可能存在进位，因此需要验证读到的高字节和低字节的有效性)。

同样，写入 Timer0 的高字节也是通过 TMR0H 缓冲寄存器来操作的。在写入 TMR0L 的同时，使用 TMR0H 的内容更新 Timer0 的高字节。这样一次就可以完成 Timer0 全部 16 位的更新。

图 11-1: TIMER0 框图 (8 位模式)

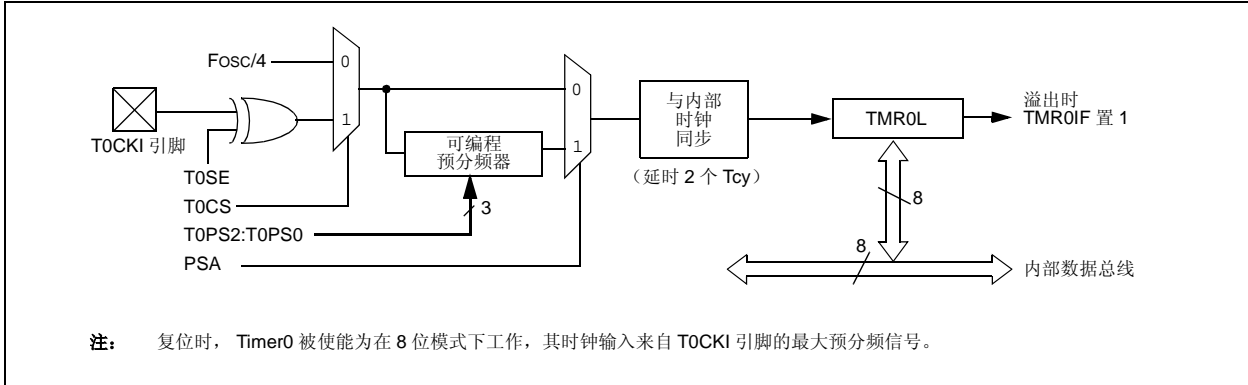
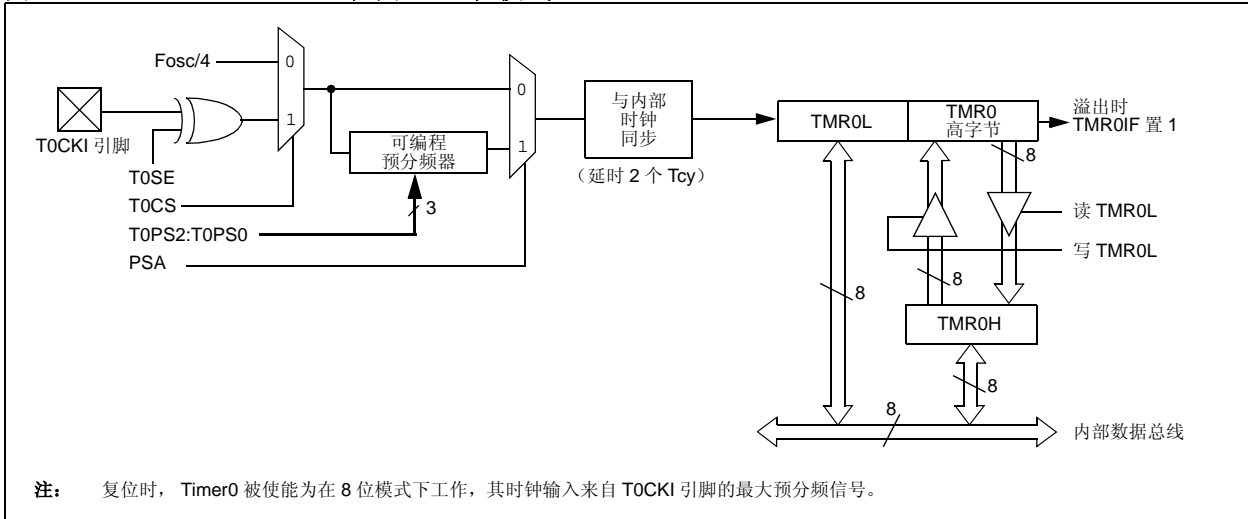


图 11-2: TIMER0 框图 (16 位模式)



11.3 预分频器

Timer0 模块的预分频器为一个 8 位计数器。该预分频器不可直接读写。通过 PSA 和 T0PS2:T0PS0 位 (T0CON<3:0>) 进行预分频器的分配和设定预分频比值。

将 PSA 位清零可将预分频器分配给 Timer0 模块。预分频值可以在 1:2 到 1:256 之间进行选择, 以 2 的整数次幂递增。

如果将预分频器分配给 Timer0 模块, 所有写入 TMR0 寄存器的指令 (例如, CLRF TMR0、MOVWF TMR0 和 BSF TMR0 等), 都会将预分频器的计数值清零。

注: 如果将预分频器分配给 Timer0, 写入 TMR0 会将预分频器的计数值清零, 但不会改变预分频器的分配。

11.3.1 切换预分频器的分配

预分频器的分配完全由软件控制, 并且在程序执行期间可以随时更改。

11.4 Timer0 中断

8 位模式下的 TMR0 寄存器从 FFh 溢出到 00h, 或 16 位模式下的 TMR0 从 FFFFh 溢出到 0000h 时, 将产生 TMR0 中断。这种溢出会使 TMR0IF 标志位置 1。可以通过清零 TMR0IE 位 (INTCON<5>) 来屏蔽该中断。在重新允许该中断前, 必须在中断服务程序中用软件清零 TMR0IF 位。

由于 Timer0 在休眠模式下是关闭的, 所以 TMR0 中断无法将处理器从休眠状态唤醒。

表 11-1: 与 TIMER0 相关的寄存器

名称	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	复位值所在页
TMR0L	Timer0 寄存器的低字节								50
TMR0H	Timer0 寄存器的高字节								50
INTCON	GIE/GIEH	PEIE/GIEL	TMR0IE	INT0IE	RBIE	TMR0IF	INT0IF	RBIF	49
T0CON	TMR0ON	T08BIT	T0CS	T0SE	PSA	T0PS2	T0PS1	T0PS0	50
TRISA	TRISA7 ⁽¹⁾	TRISA6 ⁽¹⁾	PORTA 数据方向控制寄存器						52

图注: Timer0 不使用阴影单元。

注 1: PORTA<7:6> 及其方向位根据不同的主振荡器模式被单独配置为端口引脚。当被禁止时, 这些位读为 0。

PIC18F2423/2523/4423/4523

注:

12.0 TIMER1 模块

Timer1 定时器 / 计数器模块具有以下特性:

- 可由软件选择作为 16 位定时器或计数器
- 可读写的 8 位寄存器 (TMR1H 和 TMR1L)
- 可选择器件时钟或 Timer1 内部振荡器作为时钟源 (内部或外部)
- 溢出时产生中断
- 可被 CCP 特殊事件触发信号复位
- 器件时钟状态标志位 (T1RUN)

图 12-1 给出了 Timer1 模块的简化框图。图 12-2 给出了此模块在读写模式下的工作原理框图。

此模块自身带有低功耗振荡器可提供额外的时钟选项。Timer1 振荡器也可作为单片机处于节能状态时的低功耗时钟源。

仅需极少量外部元件和代码开销, Timer1 可以用于提供实时时钟 (RTC)。

Timer1 由 T1CON 控制寄存器 (寄存器 12-1) 控制。该寄存器还包含 Timer1 振荡器使能位 (T1OSCEN)。可以通过将控制位 TMR1ON (T1CON<0>) 置 1 或清零来使能或禁止 Timer1。

寄存器 12-1: T1CON: TIMER1 控制寄存器

R/W-0	R-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
RD16	T1RUN	T1CKPS1	T1CKPS0	T1OSCEN	$\overline{T1SYNC}$	TMR1CS	TMR1ON
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位	W = 可写位	U = 未实现位, 读为 0
-n = POR 值	1 = 置 1	0 = 清零
		x = 未知

- bit 7 **RD16:** 16 位读 / 写模式使能位
 1 = 使能 Timer1 通过一次 16 位操作进行寄存器读 / 写
 0 = 使能 Timer1 通过两次 8 位操作进行寄存器读 / 写
- bit 6 **T1RUN:** Timer1 系统时钟状态位
 1 = 器件时钟由 Timer1 振荡器产生
 0 = 器件时钟由另一个时钟源产生
- bit 5-4 **T1CKPS1:T1CKPS0:** Timer1 输入时钟预分频值选择位
 11 = 1:8 预分频值
 10 = 1:4 预分频值
 01 = 1:2 预分频值
 00 = 1:1 预分频值
- bit 3 **T1OSCEN:** Timer1 振荡器使能位
 1 = 使能 Timer1 振荡器
 0 = 关闭 Timer1 振荡器
 关闭振荡器的反相器和反馈电阻以降低功耗。
- bit 2 **$\overline{T1SYNC}$:** Timer1 外部时钟输入同步选择位
当 TMR1CS = 1 时:
 1 = 不同步外部时钟输入
 0 = 同步外部时钟输入
当 TMR1CS = 0 时:
 该位为无关位。当 TMR1CS = 0 时, Timer1 使用内部时钟。
- bit 1 **TMR1CS:** Timer1 时钟源选择位
 1 = 使用 RC0/T1OSO/T13CKI 引脚上的外部时钟 (上升沿计数)
 0 = 内部时钟 (Fosc/4)
- bit 0 **TMR1ON:** Timer1 使能位
 1 = 使能 Timer1
 0 = 停止 Timer1

PIC18F2423/2523/4423/4523

12.1 Timer1 工作原理

Timer1 可在以下模式工作：

- 定时器
- 同步计数器
- 异步计数器

工作模式由时钟选择位 TMR1CS (T1CON<1>) 决定。当 TMR1CS 清零 (= 0) 时, Timer1 在每个内部指令周期 ($F_{osc}/4$) 递增。当该位置 1 时, Timer1 在 Timer1 外部时钟输入信号 (T13CKI) 或 Timer1 振荡器输出信号 (如果使能) 的每个上升沿递增。

当使能 Timer1 时, RC1/T1OSI 和 RC0/T1OSO/T13CKI 引脚变为输入引脚。这意味着 TRISC<1:0> 的值被忽略并且这些引脚将读为 0。

图 12-1: TIMER1 框图

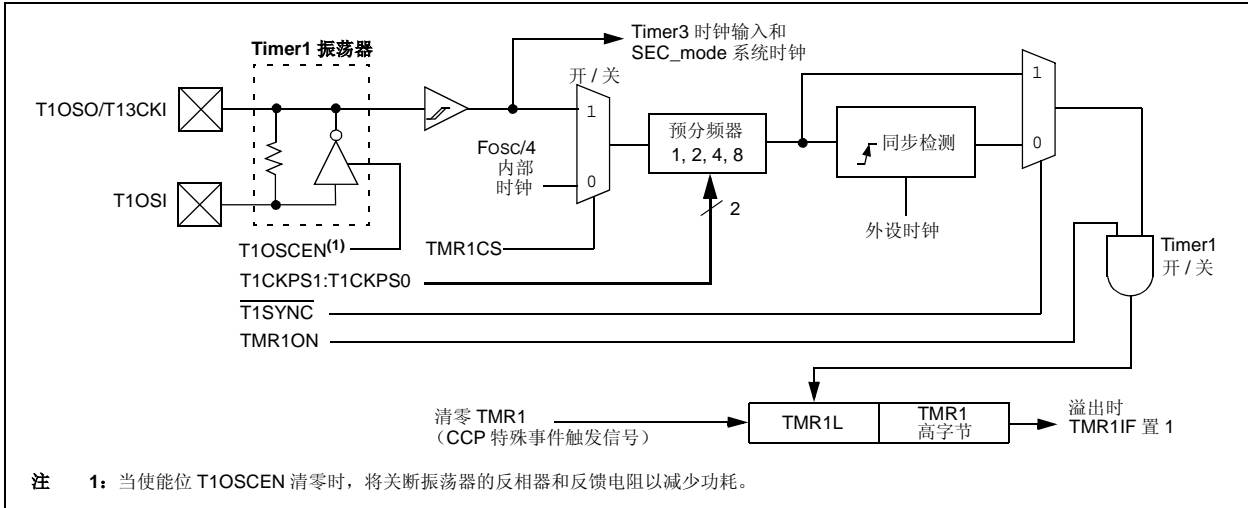
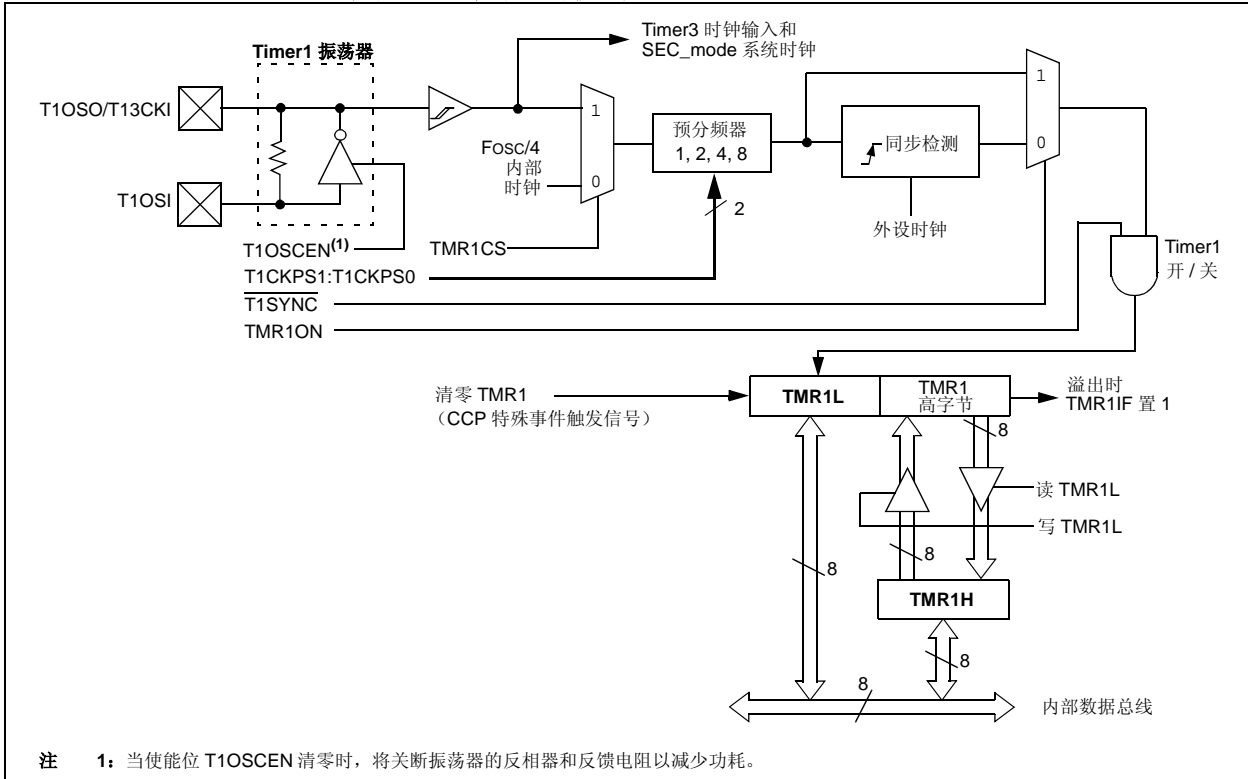


图 12-2: TIMER1 框图 (16 位读/写模式)



12.2 Timer1 的 16 位读 / 写模式

可将 Timer1 配置为 16 位读写模式（见图 12-2）。当 RD16 控制位（T1CON<7>）置 1 时，TMR1H 的地址被映射到 Timer1 的高字节缓冲寄存器。读 TMR1L 将把 Timer1 的高字节的内容装入 Timer1 高字节缓冲器。这种方式使用户可以精确地读取 Timer1 的全部 16 位，而不需要像先读高字节再读低字节那样，由于两次读取之间可能存在进位，而不得不验证读取的有效性。

写 Timer1 的高字节也必须通过 TMR1H 缓冲寄存器进行。在写入 TMR1L 的同时，使用 TMR1H 的内容更新 Timer1 的高字节。这样允许用户将 16 位值一次写入 Timer1 的高字节和低字节。

在该模式下不能直接读写 Timer1 的高字节。所有读写都必须通过 Timer1 高字节缓冲寄存器来进行。写入 TMR1H 不会清零 Timer1 预分频器。只有在写 TMR1L 时才会清零该预分频器。

12.3 Timer1 振荡器

片上晶体振荡器电路连接在 T1OSI（输入）引脚和 T1OSO（放大器输出）引脚之间。可以通过将 Timer1 振荡器使能位 T1OSCEN（T1CON<3>）置 1 来使能该振荡电路。该振荡电路是一种低功耗电路，它采用了额定振荡频率为 32 kHz 的音叉式晶振。在所有功耗管理模式下都可继续运行。图 12-3 所示是典型的 LP 振荡器电路。表 12-1 给出了供 Timer1 振荡器选择的电容值。

用户必须提供软件延时来确保 Timer1 振荡器的正常起振。

图 12-3: TIMER1 LP 振荡器的外部元件

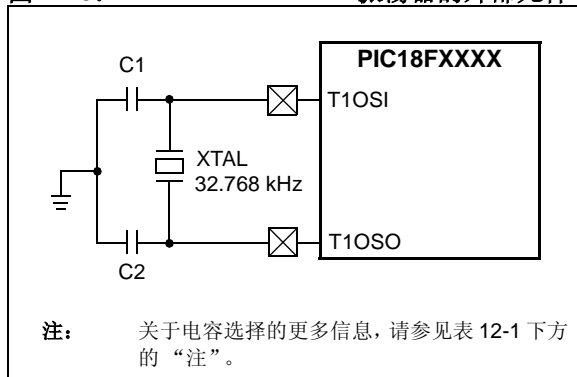


表 12-1: TIMER 振荡器的电容选择

振荡器类型	频率	C1	C2
LP (CL = 12.6 pF)	32 kHz	18 pF ⁽¹⁾	18 pF ⁽¹⁾
LP (CL = 6.0 pF)	32 kHz	6 pF ⁽¹⁾	6 pF ⁽¹⁾

- 注
- 1: Microchip 建议将该值作为验证振荡电路的起始点。
 - 2: 因为每种谐振器 / 晶振都有其自身特性，用户应当向谐振器 / 晶振制造厂商询问外部元件的适当值。
 - 3: 上述电容值仅供设计参考。

12.3.1 使用 TIMER1 作为时钟源

在功耗管理模式下也可以将 Timer1 振荡器用作时钟源。通过将时钟选择位 SCS1:SCS0（OSCCON<1:0>）设置为 01，器件可以切换到 SEC_RUN 模式，CPU 和外设都可以用 Timer1 振荡器作为时钟源。如果 IDLEN 位（OSCCON<7>）被清零并且执行了 SLEEP 指令，器件将进入 SEC_IDLE 模式。更多详细信息，请参见第 3.0 节“功耗管理模式”。

无论何时将 Timer1 振荡器用作时钟源，Timer1 系统时钟状态标志位 T1RUN（T1CON<6>）均会置 1。这可用于确定控制器的当前时钟模式。该位也可指示故障保护时钟监视器当前正使用的时钟源。如果使能了故障保护时钟监视器并且 Timer1 振荡器在提供时钟信号时发生了故障，查询 T1RUN 位可以确定时钟源是 Timer1 振荡器还是其他时钟源。

12.3.2 低功耗 TIMER1 选项

根据器件配置，Timer1 振荡器可以在两种不同的功耗级别下工作。当 LPT1OSC 配置位置 1 时，Timer1 振荡器在低功耗模式下工作。当 LPT1OSC 清零时，Timer1 在较高功耗模式下工作。不管器件工作在什么模式下，特定模式的功耗都是相对固定的。默认将 Timer1 配置为工作在功耗较高的模式下。

由于低功耗 Timer1 模式对干扰更加敏感，噪声环境可能会导致振荡器工作不稳定。因此低功耗选项最适合那些需要重点考虑节省功耗的低噪声应用。

PIC18F2423/2523/4423/4523

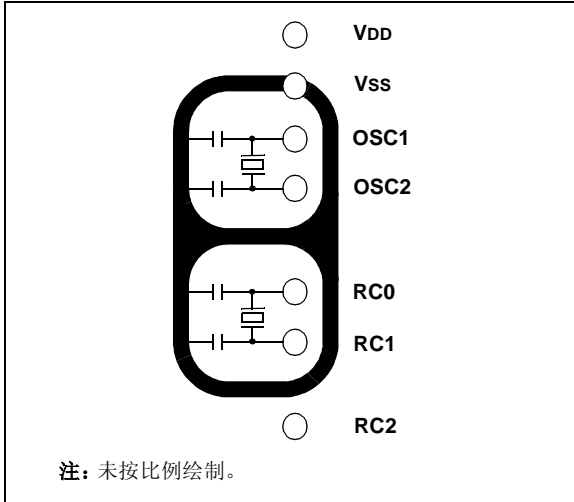
12.3.3 TIMER1 振荡器布线注意事项

Timer1 振荡器电路在工作期间仅消耗极少的电流。鉴于此振荡器的低功耗特性，它对附近变化较快的信号比较敏感。

如图 12-3 所示，振荡电路应该尽可能靠近单片机。除了 VSS 或 VDD 外，在该振荡电路边界内不应有其他电路通过。

对于单面 PCB，如果必须要在该振荡器附近布高速电路（如输出比较模式或 PWM 模式的 CCP1 引脚，或使用 OSC2 引脚的主振荡器），那么在该振荡电路周围布接地保护环（如图 12-4 所示）或再加一个地平面可能会有帮助。

图 12-4: 带有接地保护环的振荡电路



12.4 Timer1 中断

TMR1 寄存器对 (TMR1H:TMR1L) 从 0000h 递增到 FFFFh，然后溢出返回到 0000h 重新开始计数。如果允许了 Timer1 中断，则溢出时会产生 Timer1 中断，锁存到中断标志位 TMR1IF (PIR1<0>) 中。可以通过对 Timer1 中断允许位 TMR1IE (PIE1<0>) 置 1 或清零来允许或禁止该中断。

12.5 使用 CCP 特殊事件触发信号复位 Timer1

如果 CCP 模块配置为使用 Timer1 以及在比较模式下产生特殊事件触发信号 (CCP1M3:CCP1M0 或 CCP2M3:CCP2M0 = 1011)，该信号将复位 Timer1。如果使能了 A/D 模块，来自 CCP2 的触发信号还将启动 A/D 转换（更多信息，请参见第 15.3.4 节“特殊事件触发器”）。

要使用这一功能，必须将模块配置为定时器或同步计数器。在这种情况下，CCPRH:CCPRL 寄存器对实际上变成了 Timer1 的周期寄存器。

如果 Timer1 在异步计数器模式下运行，复位操作可能不起作用。

如果对 Timer1 的写操作和特殊事件触发信号同时发生，则写操作优先。

注：CCP 模块产生的特殊事件触发信号不会将 TMR1IF 中断标志位 (PIR1<0>) 置 1。

12.6 使用 Timer1 作为实时时钟

为 Timer1 外接一个 LP 振荡器（如第 12.3 节“Timer1 振荡器”中所述），可以允许用户在他们中的应用中包括 RTC 功能。只需通过一个提供精确时基的廉价时钟晶振以及几行计算时间的应用程序代码就可实现这一功能。当器件在休眠模式下工作并使用电池或超大容量电容作为电源时，可省去另外的 RTC 器件和备用电池。

应用代码程序 RTCISR（如例 12-1 所示），演示了使用中断服务程序以 1 秒的间隔递增计数器的简单方法。将 TMR1 寄存器对的值递增至溢出将触发中断并调用中断服务程序，该程序会使秒计数器递增 1，其他的分钟和小时计数器则会在前面的计数器溢出时递增 1。

由于该寄存器对为 16 位宽，因此使用 32.768 kHz 时钟，将其计数到溢出需要 2 秒。要强制在所需的 1 秒时间间隔溢出，必须预先加载它；最简单的方法是用 BSF 指令将 TMR1H 的最高有效位置 1。请注意决不要预先加载或改变 TMR1L 寄存器，这样做可能会引起多个周期的累积错误。

要使此方法精确，Timer1 必须工作于异步模式且必须允许 Timer1 溢出中断 (PIE1<0> = 1)，如程序 RTCINIT 中所示。同时 Timer1 振荡器也必须被使能并始终运行。

PIC18F2423/2523/4423/4523

例 12-1: 使用 TIMER1 中断服务实现实时时钟

```

RTCinit
    MOVLW    80h                ; Preload TMR1 register pair
    MOVWF   TMR1H              ; for 1 second overflow
    CLRF    TMR1L
    MOVLW   b'00001111'        ; Configure for external clock,
    MOVWF   T1CON              ; Asynchronous operation, external oscillator
    CLRF    secs               ; Initialize timekeeping registers
    CLRF    mins               ;
    MOVLW   .12
    MOVWF   hours
    BSF     PIE1, TMR1IE       ; Enable Timer1 interrupt
    RETURN

RTCisr
    BSF     TMR1H, 7           ; Preload for 1 sec overflow
    BCF     PIR1, TMR1IF      ; Clear interrupt flag
    INCF    secs, F           ; Increment seconds
    MOVLW   .59               ; 60 seconds elapsed?
    CPFSGT  secs
    RETURN                        ; No, done
    CLRF    secs              ; Clear seconds
    INCF    mins, F          ; Increment minutes
    MOVLW   .59               ; 60 minutes elapsed?
    CPFSGT  mins
    RETURN                        ; No, done
    CLRF    mins              ; clear minutes
    INCF    hours, F         ; Increment hours
    MOVLW   .23               ; 24 hours elapsed?
    CPFSGT  hours
    RETURN                        ; No, done
    CLRF    hours            ; Reset hours
    RETURN                        ; Done
    
```

表 12-2: 与 TIMER1 作为定时器 / 计数器相关的寄存器

名称	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	复位值所在页
INTCON	GIE/GIEH	PEIE/GIEL	TMR0IE	INT0IE	RBIE	TMR0IF	INT0IF	RBIF	49
PIR1	PSPIF ⁽¹⁾	ADIF	RCIF	TXIF	SSPIF	CCP1IF	TMR2IF	TMR1IF	52
PIE1	PSPIE ⁽¹⁾	ADIE	RCIE	TXIE	SSPIE	CCP1IE	TMR2IE	TMR1IE	52
IPR1	PSPIP ⁽¹⁾	ADIP	RCIP	TXIP	SSPIP	CCP1IP	TMR2IP	TMR1IP	52
TMR1L	Timer1 寄存器的低字节								50
TMR1H	Timer1 寄存器的高字节								50
T1CON	RD16	T1RUN	T1CKPS1	T1CKPS0	T1OSCEN	T1SYNC	TMR1CS	TMR1ON	50

图注: Timer1 模块不使用阴影单元。

注 1: 这些位在 28 引脚器件上未实现; 始终保持这些位清零。

PIC18F2423/2523/4423/4523

注:

13.0 TIMER2 模块

Timer2 模块定时器具有以下特性：

- 8 位定时器和周期寄存器（分别为 TMR2 和 PR2）
- 可读写（以上两个寄存器）
- 可软件编程的预分频器（分频比为 1:1、1:4 和 1:16）
- 可软件编程的后分频器（分频比为 1:1 到 1:16）
- TMR2 与 PR2 匹配时中断
- 作为 MSSP 模块的可选移位时钟

此模块由 T2CON 寄存器（寄存器 13-1）控制，此寄存器使能或禁止定时器并配置预分频器和后分频器。可以通过清零控制位 TMR2ON (T2CON<2>) 关闭 Timer2，以实现功耗最小。

图 13-1 给出了此模块的简化框图。

13.1 Timer2 工作原理

在正常工作模式下，TMR2 从 00h 开始，每个时钟周期 (Fosc/4) 递增 1。4 位计数器 / 预分频器提供了对时钟输入不分频、4 分频和 16 分频三种预分频选项，并可通过预分频比控制位 T2CKPS1:T2CKPS0 (T2CON<1:0>) 进行选择。在每个时钟周期，TMR2 的值都会与周期寄存器 PR2 中的值进行比较。当两个值匹配时，由比较器产生匹配信号作为定时器的输出。此信号也会使 TMR2 的值在下一个周期复位到 00h，并驱动输出计数器 / 后分频器（见第 13.2 节“Timer2 中断”）。

TMR2 和 PR2 寄存器均可直接读写。在任何器件复位时，TMR2 寄存器都会清零，而 PR2 寄存器则初始化为 FFh。预分频和后分频计数器均会在发生以下事件时清零：

- 对 TMR2 寄存器进行写操作
- 对 T2CON 寄存器进行写操作
- 任何器件复位（上电复位、MCLR 复位、看门狗定时器复位或欠压复位）

写 T2CON 时 TMR2 不会清零。

寄存器 13-1: T2CON: TIMER2 控制寄存器

U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
—	T2OUTPS3	T2OUTPS2	T2OUTPS1	T2OUTPS0	TMR2ON	T2CKPS1	T2CKPS0
bit 7							bit 0

图注：

R = 可读位	W = 可写位	U = 未实现位，读为 0
-n = POR 值	1 = 置 1	0 = 清零
		x = 未知

bit 7	未实现：读为 0
bit 6-3	T2OUTPS3:T2OUTPS0: Timer2 输出后分频比选择位 0000 = 1:1 后分频比 0001 = 1:2 后分频比 • • • 1111 = 1:16 后分频比
bit 2	TMR2ON: Timer2 使能位 1 = 使能 Timer2 0 = 关闭 Timer2
bit 1-0	T2CKPS1:T2CKPS0: Timer2 时钟预分频值选择位 00 = 预分频值为 1 01 = 预分频值为 4 1x = 预分频值为 16

PIC18F2423/2523/4423/4523

13.2 Timer2 中断

Timer2 也可以产生可选的器件中断。Timer2 输出信号 (TMR2 与 PR2 匹配时) 为 4 位输出计数器 / 后分频器提供输入。此计数器产生的 TMR2 匹配中断标志位为 TMR2IF (PIR1<1>)。可以通过将 TMR2 匹配中断允许位 TMR2IE (PIE1<1>) 置 1 来允许此中断。

可以通过后分频比控制位 T2OUTPS3:T2OUTPS0 (T2CON<6:3>) 在 16 个后分频比选项 (从 1:1 到 1:16) 中选择其一。

13.3 Timer2 输出

TMR2 不经分频的输出主要用于 CCP 模块, 它用作 CCP 模块在 PWM 模式下工作时的时基。

还可选择将 Timer2 用作 MSSP 模块在 SPI 模式下工作时的移位时钟源。第 17.0 节“主同步串行口 (MSSP) 模块”中提供了更多信息。

图 13-1: TIMER2 框图

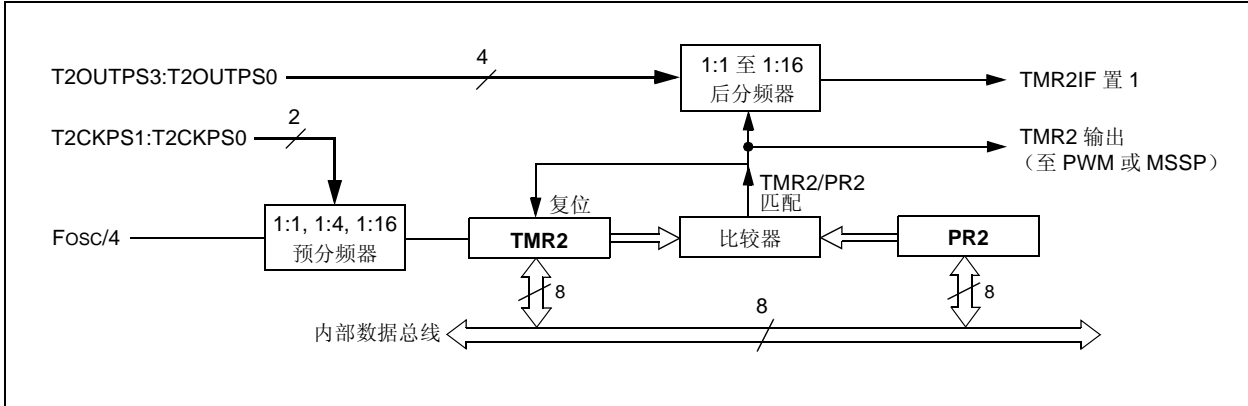


表 13-1: 与 TIMER2 作为定时器 / 计数器相关的寄存器

名称	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	复位值所在页
INTCON	GIE/GIEH	PEIE/GIEL	TMR0IE	INT0IE	RBIE	TMR0IF	INT0IF	RBIF	49
PIR1	PSPIF ⁽¹⁾	ADIF	RCIF	TXIF	SSPIF	CCP1IF	TMR2IF	TMR1IF	52
PIE1	PSPIE ⁽¹⁾	ADIE	RCIE	TXIE	SSPIE	CCP1IE	TMR2IE	TMR1IE	52
IPR1	PSPIP ⁽¹⁾	ADIP	RCIP	TXIP	SSPIP	CCP1IP	TMR2IP	TMR1IP	52
TMR2	Timer2 寄存器								50
T2CON	—	T2OUTPS3	T2OUTPS2	T2OUTPS1	T2OUTPS0	TMR2ON	T2CKPS1	T2CKPS0	50
PR2	Timer2 周期寄存器								50

图注: — = 未实现, 读为 0。Timer2 模块不使用阴影单元。

注 1: 这些位在 28 引脚器件上未实现; 始终保持这些位清零。

14.0 TIMER3 模块

Timer3 模块定时器 / 计数器具有以下特性:

- 可由软件选择作为 16 位定时器或计数器
- 可读写的 8 位寄存器 (TMR3H 和 TMR3L)
- 可选择器件时钟或 Timer1 内部振荡器作为时钟源 (内部或外部)
- 溢出时产生中断
- 可被 CCP 特殊事件触发信号复位

图 14-1 给出了 Timer3 模块的简化框图。图 14-2 给出了此模块在读写模式下的工作原理框图。

Timer3 模块是通过 T3CON 寄存器 (寄存器 14-1) 来控制的。该寄存器还可以为 CCP 模块选择时钟源 (更多信息, 请参见第 15.1.1 节“CCP 模块和定时器资源”)。

寄存器 14-1: T3CON: TIMER3 控制寄存器

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
RD16	T3CCP2	T3CKPS1	T3CKPS0	T3CCP1	$\overline{T3SYNC}$	TMR3CS	TMR3ON
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位	W = 可写位	U = 未实现位, 读为 0
-n = POR 值	1 = 置 1	0 = 清零
		x = 未知

- bit 7 **RD16:** 16 位读 / 写模式使能位
 1 = 使能 Timer3 通过一次 16 位操作进行寄存器读 / 写
 0 = 使能 Timer3 通过两次 8 位操作进行寄存器读 / 写
- bit 6,3 **T3CCP2:T3CCP1:** CCPx 的时钟源 (是 Timer3 还是 Timer1) 使能位
 1x = Timer3 是 CCP 模块的捕捉 / 比较时钟源
 01 = Timer3 是 CCP2 的捕捉 / 比较时钟源;
 Timer1 是 CCP1 的捕捉 / 比较时钟源
 00 = Timer1 是 CCP 模块的捕捉 / 比较时钟源
- bit 5-4 **T3CKPS1:T3CKPS0:** Timer3 输入时钟预分频值选择位
 11 = 1:8 预分频值
 10 = 1:4 预分频值
 01 = 1:2 预分频值
 00 = 1:1 预分频值
- bit 2 **T3SYNC:** Timer3 外部时钟输入同步控制位 (不适用于器件时钟来自 Timer1/Timer3 的场合。)
当 TMR3CS = 1 时:
 1 = 不与外部时钟输入同步
 0 = 与外部时钟输入同步
当 TMR3CS = 0 时:
 该位为无关位。当 TMR3CS = 0 时, Timer3 使用内部时钟。
- bit 1 **TMR3CS:** Timer3 时钟源选择位
 1 = 使用 Timer1 振荡器或 T13CKI 引脚信号作为外部时钟输入 (在第一个下降沿之后的上升沿开始计数)
 0 = 内部时钟 (Fosc/4)
- bit 0 **TMR3ON:** Timer3 使能位
 1 = 使能 Timer3
 0 = 停止 Timer3

PIC18F2423/2523/4423/4523

14.1 Timer3 工作原理

Timer3 可工作在以下三种模式之一：

- 定时器
- 同步计数器
- 异步计数器

工作模式由时钟选择位 TMR3CS (T3CON<1>) 决定。当 TMR3CS 清零 (= 0) 时, Timer3 在每个内部指令周期 ($F_{osc}/4$) 递增。当该位置 1 时, Timer3 在 T13CKI 时钟输入引脚或 Timer1 振荡器输出信号 (如果使能) 的每个上升沿递增。

当使能 Timer1 时, RC1/T1OSI 和 RC0/T1OSO/T13CKI 引脚变为输入引脚。这意味着 TRISC<1:0> 的值被忽略并且这些引脚将读为 0。

图 14-1: TIMER3 框图

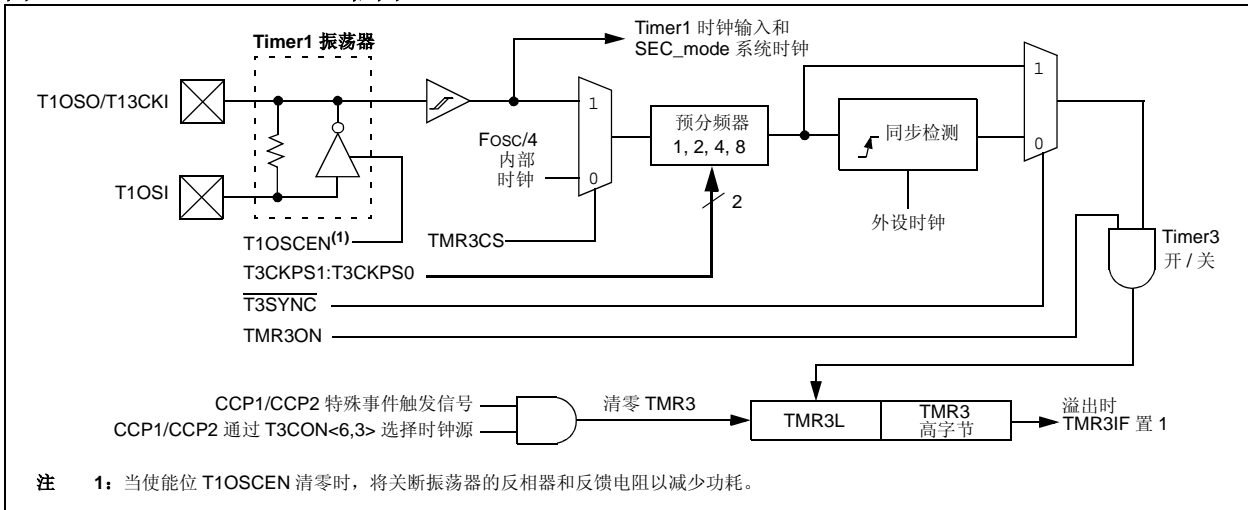
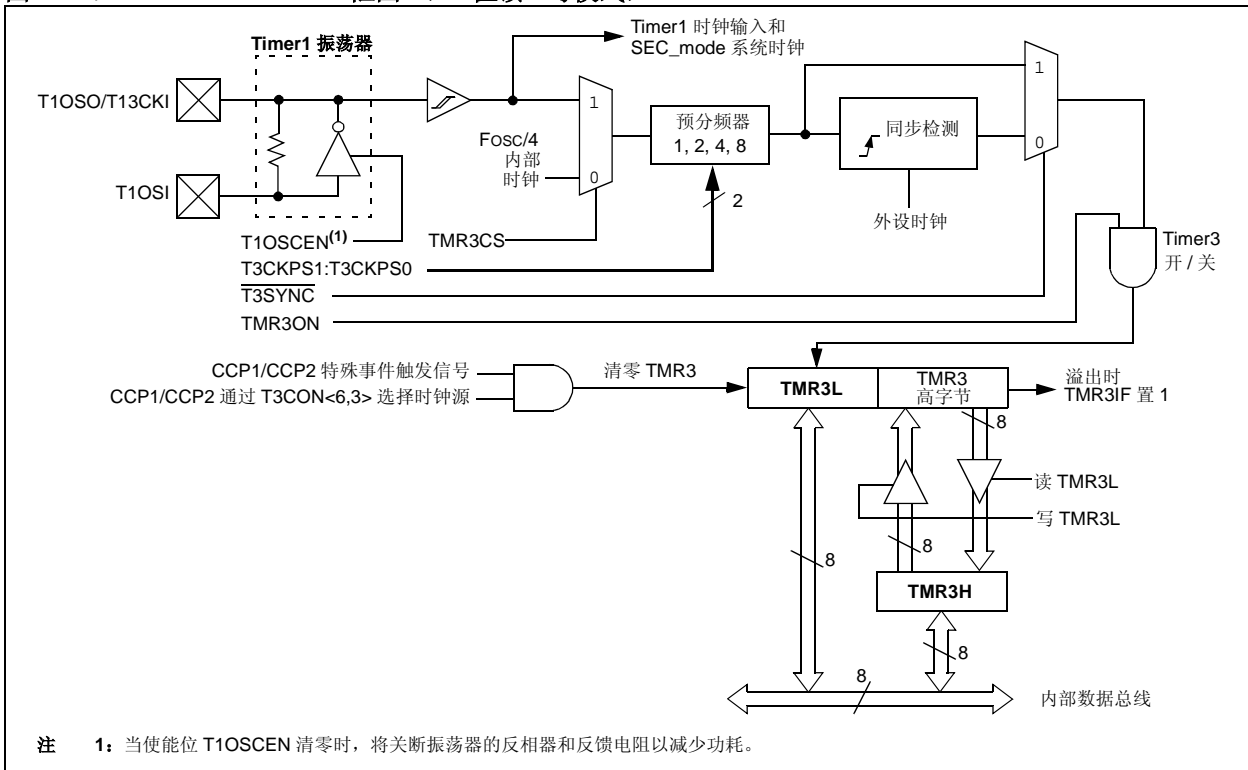


图 14-2: TIMER3 框图 (16 位读 / 写模式)



14.2 Timer3 16 位读 / 写模式

可将 Timer3 配置为 16 位读写模式（见图 14-2）。当 RD16 控制位（T3CON<7>）置 1 时，TMR3H 的地址被映射到 Timer3 的高字节缓冲寄存器。读 TMR3L 将把 Timer3 的高字节的内容装入 Timer3 高字节缓冲寄存器。这种方式使用户可以精确地读取 Timer3 的全部 16 位，而不需要像先读高字节再读低字节那样由于两次读取之间可能存在进位，而不得不验证读取的有效性。

写 Timer3 的高字节也必须通过 TMR3H 缓冲寄存器进行。在写入 TMR3L 的同时，使用 TMR3H 的内容更新 Timer3 的高字节。这样允许用户将 16 位值一次写入 Timer3 的高字节和低字节。

在该模式下不能直接读写 Timer3 的高字节。所有读写都必须通过 Timer3 高字节缓冲寄存器来进行。

写入 TMR3H 不会清零 Timer3 预分频器。只有在写 TMR3L 时才会清零该预分频器。

14.3 使用 Timer1 振荡器作为 Timer3 的时钟源

Timer1 内部振荡器可用作 Timer3 的时钟源。通过将 T1OSCN（T1CON<3>）位置 1，可启用 Timer1 振荡器。要将它用作 Timer3 的时钟源，还必须将 TMR3CS 位置 1。如前文所述，这样做也会将 Timer3 配置为在振荡器的每个上升沿递增。

对 Timer1 振荡器的描述，请参见第 12.3 节“Timer1 振荡器”。

14.4 Timer3 中断

TMR3 寄存器对（TMR3H:TMR3L）从 0000h 递增至 FFFFh，然后溢出返回到 0000h 重新开始计数。如果允许了 Timer3 中断，则溢出时会产生 Timer3 中断，锁存到中断标志位 TMR3IF（PIR2<1>）。可以通过对 Timer3 中断允许位 TMR3IE（PIE2<1>）置 1 或清零来允许或禁止该中断。

14.5 使用 CCP 特殊事件触发信号复位 Timer3

如果 CCP 模块配置为使用 Timer3 以及在比较模式下产生特殊事件触发信号（CCP1M3:CCP1M0 或 CCP2M3:CCP2M0 = 1011），该信号将复位 Timer3。如果使能了 A/D 模块，CCP2 特殊事件触发信号还将启动 A/D 转换（更多信息，请参见第 15.3.4 节“特殊事件触发器”）。

要使用这一功能，必须将模块配置为定时器或同步计数器。在这种情况下，CCPR2H:CCPR2L 寄存器对实际上变成了 Timer3 的周期寄存器。

如果 Timer3 在异步计数器模式下运行，复位操作可能不起作用。

如果对 Timer3 的写操作和 CCP 模块特殊事件触发信号同时发生，则写操作优先。

注： CCP 模块的特殊事件触发信号不会将 TMR3IF 中断标志位（PIR2<1>）置 1。

表 14-1: 与 TIMER3 作为定时器 / 计数器相关的寄存器

名称	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	复位值所在页
INTCON	GIE/GIEH	PEIE/GIEL	TMR0IE	INT0IE	RBIE	TMR0IF	INT0IF	RBIF	49
PIR2	OSCFIF	CMIF	—	EEIF	BCLIF	HLVDIF	TMR3IF	CCP2IF	52
PIE2	OSCFIE	CMIE	—	EEIE	BCLIE	HLVDIE	TMR3IE	CCP2IE	52
IPR2	OSCFIP	CMIP	—	EEIP	BCLIP	HLVDIP	TMR3IP	CCP2IP	52
TMR3L	Timer3 寄存器的低字节								51
TMR3H	Timer3 寄存器的高字节								51
T1CON	RD16	T1RUN	T1CKPS1	T1CKPS0	T1OSCN	T1SYN \bar{C}	TMR1CS	TMR1ON	50
T3CON	RD16	T3CCP2	T3CKPS1	T3CKPS0	T3CCP1	T3SYN \bar{C}	TMR3CS	TMR3ON	51

图注： — = 未实现，读为 0。Timer3 模块不使用阴影单元。

PIC18F2423/2523/4423/4523

注:

15.0 捕捉 / 比较 / PWM (CCP) 模块

PIC18F2423/2523/4423/4523 器件都有两个 CCP (捕捉 / 比较 / PWM) 模块。每个模块包含一个 16 位寄存器, 可用作 16 位捕捉寄存器、16 位比较寄存器或 PWM 主 / 从占空比寄存器。

在 28 引脚器件中, 两个标准的 CCP 模块 (CCP1 和 CCP2) 如本章中所述进行工作。在 40/44 引脚器件中, CCP1 实现为增强型 CCP 模块, 具有标准捕捉和比较模式以及增强型 PWM 模式。ECCP 实现在第 16.0 节“增强型捕捉 / 比较 / PWM (ECCP) 模块”中进行讨论。

本章中描述的捕捉和比较操作适用于所有标准和增强型 CCP 模块。

注: 在本节和第 16.0 节“增强型捕捉 / 比较 / PWM (ECCP) 模块”中, 在提到与 CCP 模块相关的寄存器和位名称时, 一般会使用“x”或“y”代替特定的模块编号。因此, “CCPxCON”可能指 CCP1、CCP2 或 ECCP1 的控制寄存器。“CCPxCON”在这些章节中用来指代模块控制寄存器, 与 CCP 模块是标准还是增强型实现无关。

寄存器 15-1: CCPxCON 寄存器 (CCP2 模块和 28 引脚器件中的 CCP1 模块)

U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
—	—	DCxB1	DCxB0	CCPxM3	CCPxM2	CCPxM1	CCPxM0
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位	W = 可写位	U = 未实现位, 读为 0
-n = POR 值	1 = 置 1	0 = 清零
		x = 未知

bit 7-6 **未实现:** 读为 0

bit 5-4 **DCxB1:DCxB0:** CCPx 模块的 PWM 占空比 bit 1 和 bit 0

捕捉模式:

未使用。

比较模式:

未使用。

PWM 模式:

这两位是 10 位 PWM 占空比的两个最低位 (bit 1 和 bit 0)。占空比的高 8 位 (DCx9:DCx2) 在 CCPRxL 中。

bit 3-0 **CCPxM3:CCPxM0:** CCPx 模块模式选择位

0000 = 禁止捕捉 / 比较 / PWM (复位 CCPx 模块)

0001 = 保留

0010 = 比较模式: 匹配时输出电平翻转 (CCPxIF 位置 1)

0011 = 保留

0100 = 捕捉模式: 每个下降沿

0101 = 捕捉模式: 每个上升沿

0110 = 捕捉模式: 每 4 个上升沿

0111 = 捕捉模式: 每 16 个上升沿

1000 = 比较模式: 初始化 CCPx 引脚为低电平, 比较匹配时强制 CCPx 引脚为高电平 (CCPxIF 位置 1)

1001 = 比较模式: 初始化 CCPx 引脚为高电平, 比较匹配时强制 CCPx 引脚为低电平 (CCPxIF 位置 1)

1010 = 比较模式: 比较匹配时产生软件中断 (CCPxIF 位置 1, CCPx 引脚反映 I/O 状态)

1011 = 比较模式: 当 CCP2 发生匹配时触发特殊事件、复位定时器或启动 A/D 转换 (CCPxIF 位置 1)

11xx = PWM 模式

PIC18F2423/2523/4423/4523

15.1 CCP 模块配置

每个捕捉 / 比较 / PWM 模块均有一个控制寄存器（通常为 CCPxCON）和一个数据寄存器（CCPRx）与之相关联。数据寄存器由两个 8 位寄存器组成：CCPRxL（低字节）和 CCPRxH（高字节）。所有寄存器在捕捉和比较模式下都是可读写的。CCPR1H 在 PWM 模式下是只读的。

15.1.1 CCP 模块和定时器资源

CCPx 模块根据选定的模式使用 Timer1、Timer2 或 Timer3。该模块在捕捉或比较模式下使用 Timer1 和 Timer3，而在 PWM 模式下使用 Timer2。

表 15-1: CCP 模式——定时器资源

CCP/ECCP 模式	定时器资源
捕捉 比较 PWM	Timer1 或 Timer3 Timer1 或 Timer3 Timer2

要将某个特定的定时器分配给某个 CCP 模块由 T3CON 寄存器（寄存器 14-1）中的“定时器—CCP”使能位决定。如果将两个 CCP 模块配置为同时工作在相同的模式（捕捉 / 比较或 PWM）下，那么这两个模块可在任何时候被激活并可共享相同的定时器资源。图 15-1 和图 15-2 总结了这两个模块间的相互关系。如果选定的定时器工作于异步计数器模式下，捕捉操作将无法进行。

15.1.2 CCP2 引脚分配

可根据器件配置改变 CCP2（捕捉输入、比较和 PWM 输出）的引脚分配。CCP2MX 配置位决定哪个引脚与 CCP2 复用。默认情况下，分配给 RC1（CCP2MX = 1）。如果清零该配置位，CCP2 将与 RB3 复用。

改变 CCP2 的引脚分配并不会自动改变对端口引脚配置的要求。无论其引脚的分配如何，用户必须始终确保为 CCP2 操作正确配置对应的 TRIS 寄存器。

表 15-2: CCP1 和 CCP2 在使用定时器资源方面的相互关系

CCP1 模式	CCP2 模式	相互关系
捕捉	捕捉	每个模块都可用 TMR1 或 TMR3 作为时基。每个 CCP 的时基也可以各不相同。
捕捉	比较	可将 CCP2 配置为特殊事件触发器用以复位 TMR1 或 TMR3（取决于所使用的时基）。CCP2 特殊事件触发器也可用于启动 A/D 转换。如果 CCP1 使用与 CCP2 相同的定时器作为时基，上述操作可能会对 CCP1 产生影响。
比较	捕捉	可将 CCP1 配置为特殊事件触发器用以复位 TMR1 或 TMR3（取决于所使用的时基）。如果 CCP2 使用与 CCP1 相同的定时器作为时基，上述操作可能会对 CCP2 产生影响。
比较	比较	每个模块均可配置为特殊事件触发器用以复位时基。CCP2 特殊事件触发器也可用于启动 A/D 转换。如果两个模块使用相同的时基，可能会发生冲突。
捕捉	PWM ⁽¹⁾	无
比较	PWM ⁽¹⁾	无
PWM ⁽¹⁾	捕捉	无
PWM ⁽¹⁾	比较	无
PWM ⁽¹⁾	PWM	两个 PWM 具有相同的频率和更新速率（TMR2 中断）。

注 1: 包括标准和增强型 PWM 操作。

15.2 捕捉模式

在捕捉模式下，当相应的 CCPx 引脚发生以下事件时，CCPRxH:CCPRxL 寄存器对捕捉 TMR1 或 TMR3 寄存器的 16 位值。

- 每个下降沿
- 每个上升沿
- 每 4 个上升沿
- 每 16 个上升沿

事件由模式选择位 CCPxM3:CCPxM0 (CCPxCON<3:0>) 选择。当完成一次捕捉时，中断请求标志位 CCPxIF 置 1；它必须用软件清零。如果在读取寄存器 CCPRx 值之前发生了另一次捕捉，那么原来的捕捉值会被新的捕捉值覆盖。

15.2.1 CCP 引脚配置

在捕捉模式下，应通过将相应的 TRIS 方向位置 1 将 CCPx 引脚配置为输入。

注： 如果 CCP 引脚被配置为输出且 CCP 模块处于捕捉模式下，对该引脚的写操作可能产生 CCP 捕捉。

15.2.2 TIMER1/TIMER3 模式选择

用于捕捉功能的定时器 (Timer1 和 / 或 Timer3) 必须在定时器模式或同步计数器模式下。在异步计数器模式下，无法进行捕捉操作。可在 T3CON 寄存器中选择用于 CCPx 模块的定时器 (见第 15.1.1 节“CCP 模块和定时器资源”)。

15.2.3 软件中断

当捕捉模式改变时，可能会产生错误的捕捉中断。用户在改变 CCP 模式时应该保持 CCPxIE 中断允许位清零以避免错误中断。应在工作模式改变后清零中断标志位 CCPxIF。

15.2.4 CCP 预分频器

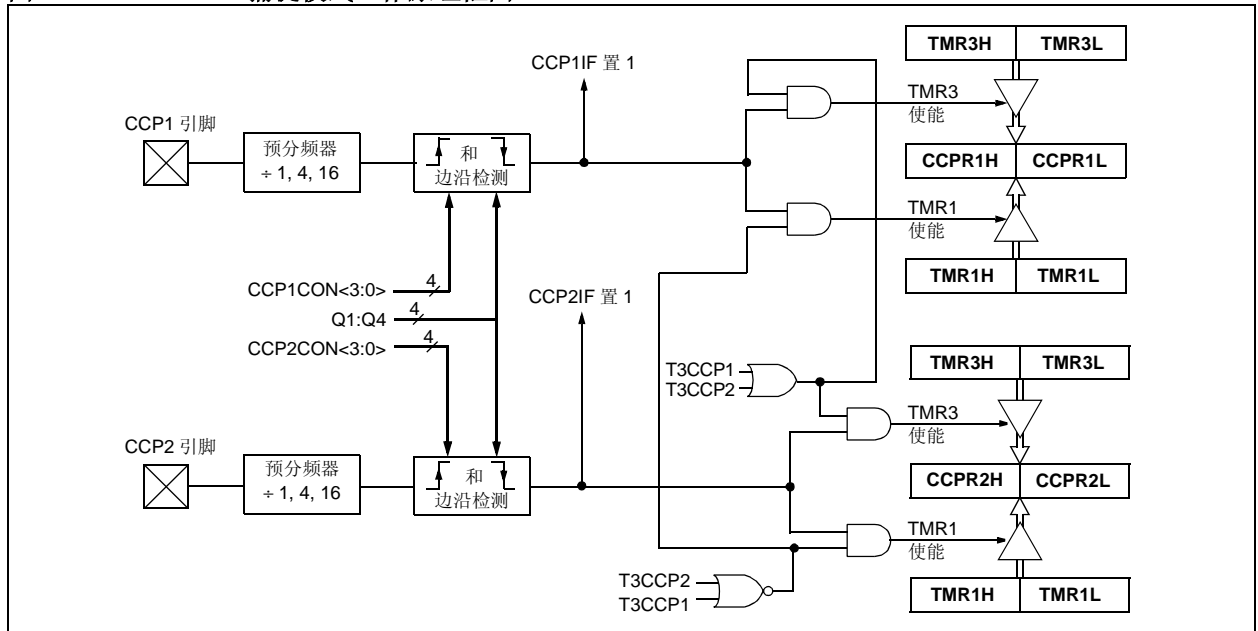
在捕捉模式下有 4 种预分频比设置；它们作为工作模式的一部分由模式选择位 (CCPxM3:CCPxM0) 选择。只要关闭 CCPx 模块或禁止捕捉模式，预分频计数器就会被清零。这意味着任何复位都会将预分频计数器清零。

在两个预分频比之间切换会产生中断。而且，预分频计数器不会被清零；因此第一次捕捉可能来自于一个非零的预分频比。例 15-1 给出了切换捕捉预分频比时建议采用的方法。这个示例使预分频计数器清零且不会产生错误中断。

例 15-1: 改变捕捉预分频比 (以 CCP2 为例)

```
CLRF   CCP2CON      ; Turn CCP module off
MOVLW  NEW_CAPT_PS ; Load WREG with the
                    ; new prescaler
                    ; value and CCP ON
MOVWF  CCP2CON      ; Load CCP2CON with
                    ; this value
```

图 15-1: 捕捉模式工作原理框图



PIC18F2423/2523/4423/4523

15.3 比较模式

在比较模式下，16 位 CCPRx 寄存器的值不断与 TMR1 或 TMR3 寄存器对的值作比较。当两者匹配时，CCPx 引脚将会：

- 驱动为高电平
- 驱动为低电平
- 电平翻转（高电平变为低电平或低电平变为高电平）
- 保持不变（即反映 I/O 锁存器的状态）

引脚动作取决于模式选择位（CCPxM3:CCPxM0）的值。同时，中断标志位 CCPxIF 置 1。

15.3.1 CCP 引脚配置

用户必须通过将相应的 TRIS 位清零，将 CCPx 引脚配置为输出。

注： 清零 CCPxCON 寄存器会将相应的 CCP 引脚输出比较锁存器强制为默认的低电平。这不是引脚输出数据锁存器。

15.3.2 TIMER1/TIMER3 模式选择

如果 CCPx 模块使用比较功能，则 Timer1 和/或 Timer3 必须运行在定时器模式或同步计数器模式下。在异步计数器模式下，可能无法进行比较操作。

15.3.3 软件中断模式

当选择了“生成软件中断模式”时（CCPxM3:CCPxM0 = 1010），相应的 CCPx 引脚不受影响。将仅产生 CCP 中断（如果允许）并将 CCPxIE 位置 1。

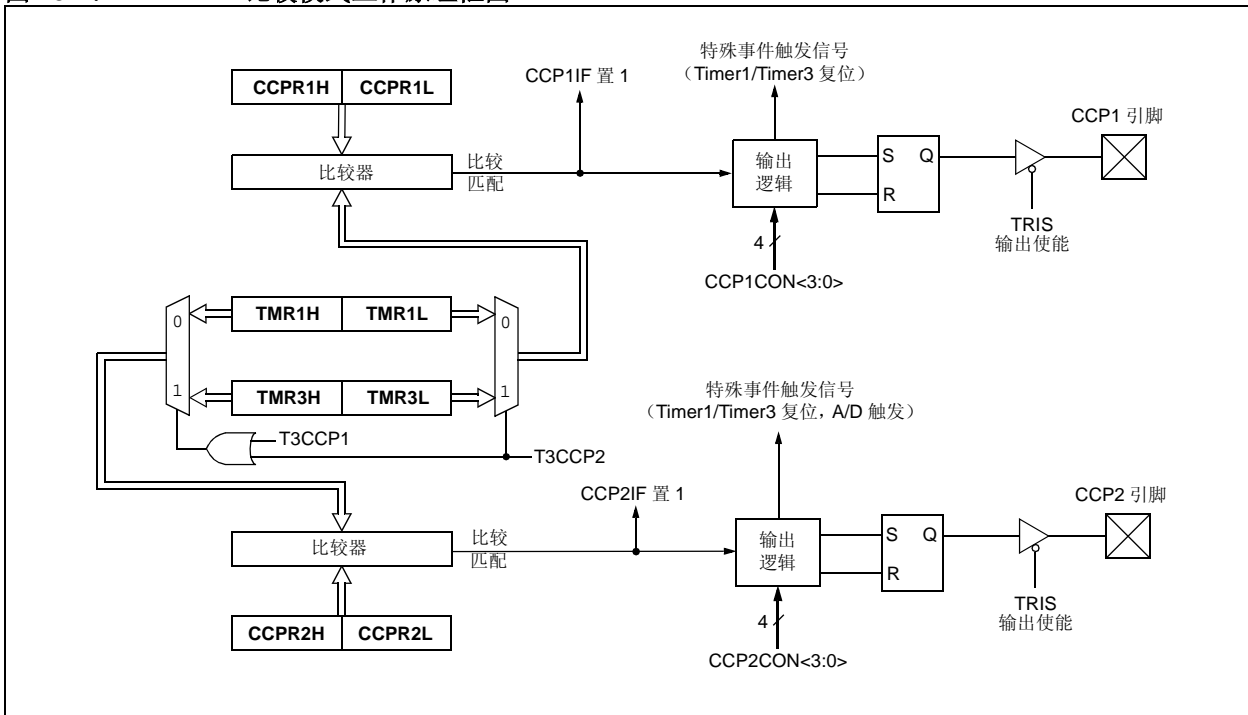
15.3.4 特殊事件触发器

两个 CCP 模块均配备了一个特殊事件触发器。在比较模式下可产生内部硬件信号以触发其他模块动作。通过选择比较特殊事件触发模式（CCPxM3:CCPxM0 = 1011），使能特殊事件触发器。

对于任何一个 CCP 模块，无论当前使用哪个定时器资源作为模块的时基，特殊事件触发器将把对应的定时寄存器对复位。这样 CCPRx 寄存器可用作两个定时器的可编程周期寄存器。

CCP2 的特殊事件触发器还能启动 A/D 转换。要实现此功能，必须首先使能 A/D 转换器。

图 15-2: 比较模式工作原理框图



PIC18F2423/2523/4423/4523

表 15-3: 与捕捉、比较、TIMER1 和 TIMER3 相关的寄存器

名称	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	复位值所在页
INTCON	GIE/GIEH	PEIE/GIEL	TMR0IE	INT0IE	RBIE	TMR0IF	INT0IF	RBIF	49
RCON	IPEN	SBOREN ⁽²⁾	—	\overline{RI}	\overline{TO}	\overline{PD}	\overline{POR}	\overline{BOR}	48
PIR1	PSPIF ⁽¹⁾	ADIF	RCIF	TXIF	SSPIF	CCP1IF	TMR2IF	TMR1IF	52
PIE1	PSPIE ⁽¹⁾	ADIE	RCIE	TXIE	SSPIE	CCP1IE	TMR2IE	TMR1IE	52
IPR1	PSPIP ⁽¹⁾	ADIP	RCIP	TXIP	SSPIP	CCP1IP	TMR2IP	TMR1IP	52
PIR2	OSCFIF	CMIF	—	EEIF	BCLIF	HLVDIF	TMR3IF	CCP2IF	52
PIE2	OSCFIE	CMIE	—	EEIE	BCLIE	HLVDIE	TMR3IE	CCP2IE	52
IPR2	OSCFIP	CMIP	—	EEIP	BCLIP	HLVDIP	TMR3IP	CCP2IP	52
TRISB	PORTB 数据方向控制寄存器								52
TRISC	PORTC 数据方向控制寄存器								52
TMR1L	Timer1 寄存器的低字节								50
TMR1H	Timer1 寄存器的高字节								50
T1CON	RD16	T1RUN	T1CKPS1	T1CKPS0	T1OSCEN	$\overline{T1SYNC}$	TMR1CS	TMR1ON	50
TMR3H	Timer3 寄存器的高字节								51
TMR3L	Timer3 寄存器的低字节								51
T3CON	RD16	T3CCP2	T3CKPS1	T3CKPS0	T3CCP1	$\overline{T3SYNC}$	TMR3CS	TMR3ON	51
CCPR1L	捕捉 / 比较 / PWM 寄存器 1 的低字节								51
CCPR1H	捕捉 / 比较 / PWM 寄存器 1 的高字节								51
CCP1CON	P1M1 ⁽¹⁾	P1M0 ⁽¹⁾	DC1B1	DC1B0	CCP1M3	CCP1M2	CCP1M1	CCP1M0	51
CCPR2L	捕捉 / 比较 / PWM 寄存器 2 的低字节								51
CCPR2H	捕捉 / 比较 / PWM 寄存器 2 的高字节								51
CCP2CON	—	—	DC2B1	DC2B0	CCP2M3	CCP2M2	CCP2M1	CCP2M0	51

图注: — = 未实现, 读为 0。捕捉 / 比较、Timer1 或 Timer3 不使用阴影单元。

注 1: 这些位在 28 引脚器件上未实现; 始终保持这些位清零。

注 2: SBOREN 位仅在 BOREN1:BOREN0 配置位 = 01 时可用; 否则, 它被禁止且读为 0。请参见第 4.4 节“欠压复位 (BOR)”。

CCPRxH 寄存器和一个 2 位的内部锁存器用于给 PWM 占空比提供双重缓冲。这种双重缓冲结构非常重要，它可以避免在 PWM 操作中产生毛刺。

当 CCPRxH 和 2 位锁存值与 TMR2（以及内部 2 位 Q 时钟或 TMR2 预分频值的 2 位）匹配时，CCPx 引脚被清零。

在给定 PWM 频率的情况下，最大的 PWM 分辨率（位）由以下公式给出：

公式 15-3:

$$\text{PWM 分辨率 (最大)} = \frac{\log\left(\frac{F_{\text{OSC}}}{F_{\text{PWM}} * \text{TMR2 预分频值}}\right)}{\log(2)} \text{ 位}$$

注： 如果 PWM 占空比的值大于 PWM 周期，则 CCP2 引脚将不会被清零。

表 15-4: 40 MHz 时 PWM 频率和分辨率示例

PWM 频率	2.44 kHz	9.77 kHz	39.06 kHz	156.25 kHz	312.50 kHz	416.67 kHz
定时器预分频值（1、4 和 16）	16	4	1	1	1	1
PR2 值	FFh	FFh	FFh	3Fh	1Fh	17h
最大分辨率（位）	10	10	10	8	7	6.58

15.4.3 PWM 自动关闭（仅限 CCP1）

28 引脚器件中的 CCP1 模块也具有增强型 CCP 模块的 PWM 自动关闭功能。该功能的操作在第 16.4.7 节“增强型 PWM 自动关闭”中详细讨论。

CCP2 不具备自动关闭功能。

15.4.4 设置 PWM 操作

当配置 CCPx 模块的 PWM 操作时，应遵循以下步骤：

1. 通过写 PR2 寄存器设置 PWM 周期。
2. 通过写 CCPRxL 寄存器和 CCPxCON<5:4> 位设置 PWM 占空比。
3. 通过清零相应的 TRIS 位将 CCPx 引脚设为输出引脚。
4. 通过写 T2CON 设置 TMR2 预分频值并随后使能 Timer2。
5. 配置 CCPx 模块使之工作于 PWM 模式。

PIC18F2423/2523/4423/4523

表 15-5: 与 PWM 和 TIMER2 相关的寄存器

名称	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	复位值 所在页
INTCON	GIE/GIEH	PEIE/GIEL	TMR0IE	INT0IE	RBIE	TMR0IF	INT0IF	RBIF	49
RCON	IPEN	SBOREN ⁽²⁾	—	\overline{RI}	\overline{TO}	\overline{PD}	\overline{POR}	\overline{BOR}	48
PIR1	PSPIF ⁽¹⁾	ADIF	RCIF	TXIF	SSPIF	CCP1IF	TMR2IF	TMR1IF	52
PIE1	PSPIE ⁽¹⁾	ADIE	RCIE	TXIE	SSPIE	CCP1IE	TMR2IE	TMR1IE	52
IPR1	PSPIP ⁽¹⁾	ADIP	RCIP	TXIP	SSPIP	CCP1IP	TMR2IP	TMR1IP	52
TRISB	PORTB 数据方向控制寄存器								52
TRISC	PORTC 数据方向控制寄存器								52
TMR2	Timer2 寄存器								50
PR2	Timer2 周期寄存器								50
T2CON	—	T2OUTPS3	T2OUTPS2	T2OUTPS1	T2OUTPS0	TMR2ON	T2CKPS1	T2CKPS0	50
CCPR1L	捕捉 / 比较 / PWM 寄存器 1 的低字节								51
CCPR1H	捕捉 / 比较 / PWM 寄存器 1 的高字节								51
CCP1CON	P1M1 ⁽¹⁾	P1M0 ⁽¹⁾	DC1B1	DC1B0	CCP1M3	CCP1M2	CCP1M1	CCP1M0	51
CCPR2L	捕捉 / 比较 / PWM 寄存器 2 的低字节								51
CCPR2H	捕捉 / 比较 / PWM 寄存器 2 的高字节								51
CCP2CON	—	—	DC2B1	DC2B0	CCP2M3	CCP2M2	CCP2M1	CCP2M0	51
ECCP1AS	ECCPASE	ECCPAS2	ECCPAS1	ECCPAS0	PSSAC1	PSSAC0	PSSBD1 ⁽¹⁾	PSSBD0 ⁽¹⁾	51
ECCP1DEL	PRSEN	PDC6 ⁽¹⁾	PDC5 ⁽¹⁾	PDC4 ⁽¹⁾	PDC3 ⁽¹⁾	PDC2 ⁽¹⁾	PDC1 ⁽¹⁾	PDC0 ⁽¹⁾	51

图注: — = 未实现, 读为 0。PWM 或 Timer2 不使用阴影单元。

注 1: 这些位在 28 引脚器件上未实现; 始终保持这些位清零。

注 2: SBOREN 位仅在 BOREN1:BORENO 配置位 = 01 时可用; 否则, 它被禁止且读为 0。请参见第 4.4 节“欠压复位 (BOR)”。

16.0 增强型捕捉 / 比较 / PWM (ECCP) 模块

注: ECCP 模块仅在 40/44 引脚器件中实现。

在 PIC18F4423/4523 器件中, CCP1 实现为具有增强型 PWM 功能的标准 CCP 模块。这些功能包括 2 或 4 路输出通道、用户可选极性、死区控制和自动关闭与重

启。第 16.4 节“增强型 PWM 模式”将详细讨论增强功能。ECCP 模块的捕捉、比较和单输出 PWM 功能与标准 CCP 模块的相同。

增强型 CCP 模块的控制寄存器如寄存器 16-1 所示。它与 PIC18F2423/2523 器件中的 CCPxCON 寄存器的不同之处在于,实现了两个最高有效位来控制 PWM 功能。

寄存器 16-1: CCP1CON 寄存器 (ECCP1 模块, 40/44 引脚器件)

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
P1M1	P1M0	DC1B1	DC1B0	CCP1M3	CCP1M2	CCP1M1	CCP1M0
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位 W = 可写位 U = 未实现位, 读为 0
 -n = POR 值 1 = 置 1 0 = 清零 x = 未知

bit 7-6 **P1M1:P1M0:** 增强型 PWM 输出配置位
 如果 CCP1M3:CCP1M2 = 00、01 和 10:
 xx = P1A 配置为捕捉 / 比较输入 / 输出; P1B、P1C 和 P1D 配置为端口引脚
 如果 CCP1M3:CCP1M2 = 11:
 00 = 单输出: P1A 被调制; P1B、P1C 和 P1D 配置为端口引脚
 01 = 全桥正向输出: P1D 被调制; P1A 有效; P1B 和 P1C 无效
 10 = 半桥输出: P1A 和 P1B 被调制, 带有死区控制; P1C 和 P1D 配置为端口引脚
 11 = 全桥反向输出: P1B 被调制; P1C 有效; P1A 和 P1D 无效

bit 5-4 **DC1B1:DC1B0:** PWM 占空比 bit 1 和 bit 0
捕捉模式:
 未使用。
比较模式:
 未使用。
PWM 模式:
 这些位是 10 位 PWM 占空比的低 2 位。占空比的高 8 位在 CCPR1L 中。

bit 3-0 **CCP1M3:CCP1M0:** 增强型 CCP 模式选择位
 0000 = 捕捉 / 比较 / PWM 关闭 (复位 ECCP 模块)
 0001 = 保留
 0010 = 比较模式: 匹配时翻转输出
 0011 = 捕捉模式
 0100 = 捕捉模式: 每个下降沿
 0101 = 捕捉模式: 每个上升沿
 0110 = 捕捉模式: 每 4 个上升沿
 0111 = 捕捉模式: 每 16 个上升沿
 1000 = 比较模式: 初始化 CCP1 引脚为低电平, 比较匹配时输出置 1 (CCP1IF 置 1)
 1001 = 比较模式: 初始化 CCP1 引脚为高电平, 比较匹配时输出清零 (CCP1IF 置 1)
 1010 = 比较模式: 仅产生软件中断, CCP1 引脚恢复到 I/O 状态
 1011 = 比较模式: 特殊事件触发器 (ECCP 复位 TMR1 或 TMR3, CC1IF 位置 1)
 1100 = PWM 模式: P1A 和 P1C 高电平有效; P1B 和 P1D 高电平有效
 1101 = PWM 模式: P1A 和 P1C 高电平有效; P1B 和 P1D 低电平有效
 1110 = PWM 模式: P1A 和 P1C 低电平有效; P1B 和 P1D 高电平有效
 1111 = PWM 模式: P1A 和 P1C 低电平有效; P1B 和 P1D 低电平有效

PIC18F2423/2523/4423/4523

除了可使用 CCP1CON 寄存器和 ECCP1AS 寄存器提供的扩展模式外，ECCP 模块还有一个与增强型 PWM 操作和自动关闭功能相关的寄存器，它是：

- ECCP1DEL（死区延时）

16.1 ECCP 输出和配置

取决于所选定的工作模式，增强型 CCP 模块最多有四路 PWM 输出。这些指定为 P1A 到 P1D 的输出，可以与 PORTC 和 PORTD 的 I/O 引脚复用。输出是否有效取决于选定的 CCP 工作模式。表 16-1 中总结了引脚分配。

若要将 I/O 引脚配置为 PWM 输出，必须通过设置 P1M1:P1M0 和 CCP1M3:CCP1M0 位来选择适当的 PWM 模式。端口引脚的相应 TRISC 和 TRISD 方向位也必须设置为输出。

16.1.1 ECCP 模块和定时器资源

像标准的 CCP 模块一样，ECCP 模块根据选定的模式使用 Timer1、Timer2 或 Timer3。该模块在捕捉或比较模式下使用 Timer1 和 Timer3，而在 PWM 模式下使用 Timer2。标准和增强型 CCP 模块在使用定时器资源方面的相互关系与标准 CCP 模块之间的相同。第 15.1.1 节“CCP 模块和定时器资源”给出了定时器资源的更多详细信息。

16.2 捕捉和比较模式

除了下面讨论的特殊事件触发器的操作，ECCP 模块的捕捉和比较模式与 CCP2 的操作是相同的。这些将在第 15.2 节“捕捉模式”和第 15.3 节“比较模式”中详细讨论。当在 28 引脚和 40/44 引脚器件之间移植时不需要任何更改。

16.2.1 特殊事件触发器

ECCP1 的特殊事件触发器输出会复位 TMR1 或 TMR3 寄存器对，具体复位哪一对寄存器，视当前选定的定时器资源而定。这使得 CCPR1 寄存器可有效地成为 Timer1 或 Timer3 的 16 位可编程周期寄存器。

16.3 标准 PWM 模式

当配置为单输出模式时，ECCP 模块的功能与 PWM 模式下的标准 CCP 模块相同，如第 15.4 节“PWM 模式”中所述。有时也称为“兼容的 CCP”模式，如表 16-1 所示。

注： 当设置单输出 PWM 操作时，用户可自由使用第 15.4.4 节“设置 PWM 操作”或第 16.4.9 节“设置 PWM 操作”中所述的任一过程。后者更为通用，并可用于单输出或多输出 PWM。

表 16-1: 各种 ECCP1 模式的引脚分配

ECCP 模式	CCP1CON 配置	RC2	RD5	RD6	RD7
所有 40/44 引脚器件:					
兼容的 CCP	00xx 11xx	CCP1	RD5/PSP5	RD6/PSP6	RD7/PSP7
双 PWM	10xx 11xx	P1A	P1B	RD6/PSP6	RD7/PSP7
四 PWM	x1xx 11xx	P1A	P1B	P1C	P1D

图注： x = 无关位。阴影单元表示在给定模式下 ECCP1 不使用的引脚分配。

16.4 增强型 PWM 模式

增强型 PWM 模式为更大范围的控制应用提供了更多的 PWM 输出选项。该模块是标准 CCP 模块的向后兼容版本，可提供最多四路输出，指定为 P1A 到 P1D。用户还可以选择信号的极性（高电平有效或低电平有效）。模块的输出模式和极性可通过设置 CCP1CON 寄存器的 P1M1:P1M0 和 CCP1M3:CCP1M0 位来进行配置。

图 16-1 给出了 PWM 工作原理的简化框图。所有控制寄存器都是双重缓冲的，且在新的 PWM 周期（Timer2 复位时的周期边界）开始时装入，以防止任何输出出现毛刺。PWM 延时寄存器 ECCP1DEL 是个例外，它在占空比边界或者周期边界装入（取决于哪一个先出现）。由于缓冲作用，模块会一直等到指定的定时器复位，而不是立即开始。这意味着增强型 PWM 波形与标准 PWM 波形并不完全一致，而是偏移一个指令周期（4 T_{osc}）。像以前一样，用户必须手动将相应的 TRIS 位设置为输出。

16.4.1 PWM 周期

PWM 周期可通过写 PR2 寄存器来指定。PWM 周期可由以下公式计算。

公式 16-1:

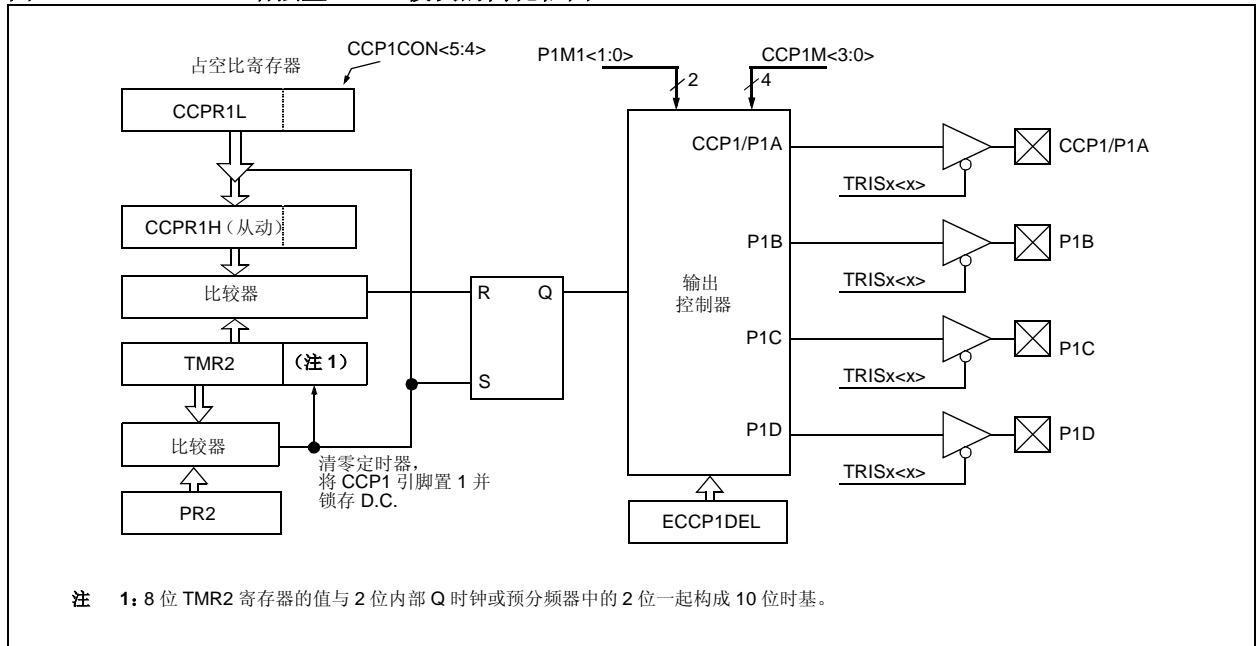
$$\text{PWM 周期} = \frac{[(PR2) + 1] \cdot 4 \cdot T_{osc}}{(\text{TMR2 预分频值})}$$

PWM 频率定义为 1/[PWM 周期]。当 TMR2 中的值与 PR2 中的值相等时，在下一个递增周期将发生以下 3 个事件：

- TMR2 被清零
- CCP1 引脚置 1（如果 PWM 占空比 = 0%，CCP1 引脚不会被置 1）
- PWM 占空比从 CCPR1L 复制到 CCPR1H

注： 在确定 PWM 频率时不会用到 Timer2 后分频器（见第 13.0 节“Timer2 模块”）。通过后分频器，可以不同于 PWM 输出频率的速率进行数据更新。

图 16-1: 增强型 PWM 模块的简化框图



PIC18F2423/2523/4423/4523

16.4.2 PWM 占空比

通过写入 CCPR1L 寄存器和 CCP1CON<5:4> 位来指定 PWM 占空比。分辨率最高可达 10 位。CCPR1L 包含高 8 位而 CCP1CON<5:4> 包含低 2 位。该 10 位值由 CCPR1L:CCP1CON<5:4> 表示。PWM 占空比可由以下公式计算。

公式 16-2:

$$\text{PWM 占空比} = \frac{(\text{CCPR1L:CCP1CON<5:4>}) \cdot T_{\text{osc}}}{T_{\text{osc}} \cdot (\text{TMR2 预分频值})}$$

可以在任何时候写入 CCPR1L 和 CCP1CON<5:4>, 但是在 PR2 和 TMR2 发生匹配 (即周期结束) 前占空比值不会被复制到 CCPR1H 中。在 PWM 模式下, CCPR1H 是只读寄存器。

CCPR1H 寄存器和一个 2 位的内部锁存器用于给 PWM 占空比提供双重缓冲。这种双重缓冲结构非常重要, 它可以避免在 PWM 操作中产生毛刺。当 CCPR1H 和 2 位锁存值与 TMR2, 及内部 2 位 Q 时钟或 2 位 TMR2 预分频器值相匹配时, CCP1 引脚被清零。在给定 PWM 频率的情况下, 最大的 PWM 分辨率 (位) 由以下公式给出。

公式 16-3:

$$\text{PWM 分辨率 (最大)} = \frac{\log\left(\frac{F_{\text{OSC}}}{F_{\text{PWM}} \cdot \text{TMR2 预分频值}}\right)}{\log(2)} \text{ 位}$$

注: 如果 PWM 占空比的值比 PWM 周期长, 则 CCP1 引脚将不会被清零。

16.4.3 PWM 输出配置

CCP1CON 寄存器的 P1M1:P1M0 位可用于设置以下 4 种配置之一:

- 单输出
- 半桥输出
- 全桥输出, 正向模式
- 全桥输出, 反向模式

单输出模式也就是在第 16.4 节“增强型 PWM 模式”中讨论的标准 PWM 模式。半桥和全桥输出模式在接下来的章节中详细讨论。

表 16-2: 40 MHz 时 PWM 频率和分辨率示例

PWM 频率	2.44 kHz	9.77 kHz	39.06 kHz	156.25 kHz	312.50 kHz	416.67 kHz
定时器预分频值 (1、4 和 16)	16	4	1	1	1	1
PR2 值	FFh	FFh	FFh	3Fh	1Fh	17h
最大分辨率 (位)	10	10	10	8	7	6.58

图 16-2: PWM 输出关系 (高电平有效状态)

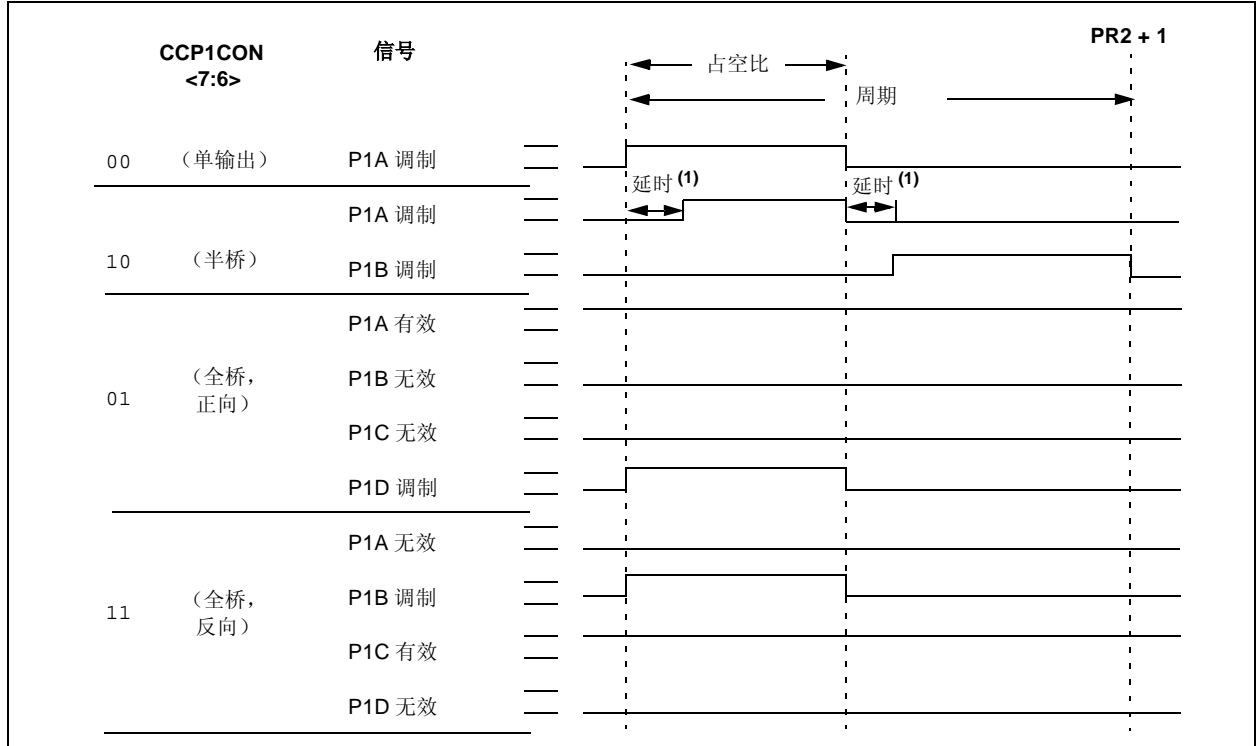
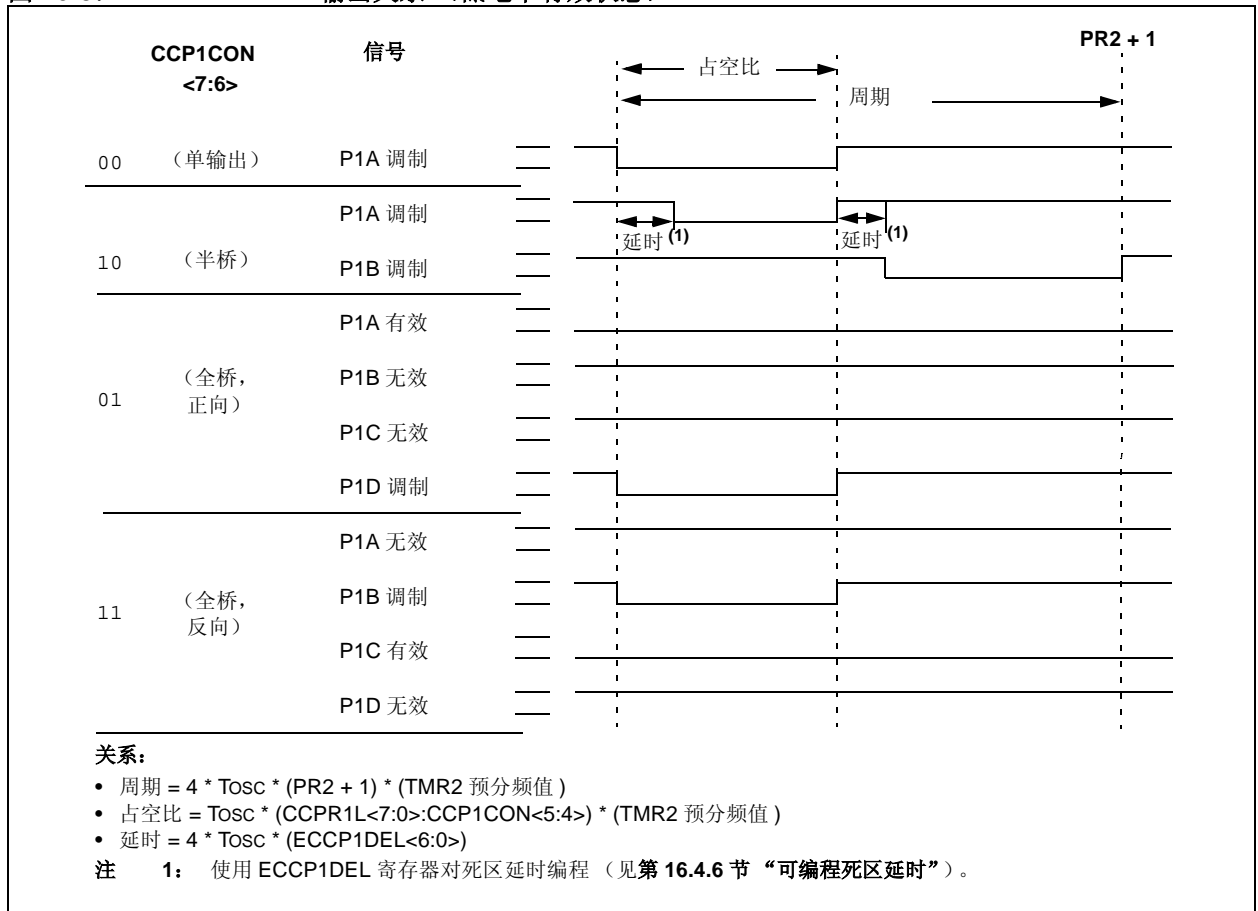


图 16-3: PWM 输出关系 (低电平有效状态)



PIC18F2423/2523/4423/4523

16.4.4 半桥模式

在半桥输出模式下，有两个引脚用作输出驱动推挽式负载。P1A 引脚输出 PWM 输出信号，P1B 引脚输出互补的 PWM 输出信号（图 16-4）。这种模式可用于半桥应用（如图 16-5 所示），或者用于全桥应用——这种情况下使用两个 PWM 信号调制 4 个功率开关。

在半桥输出模式下，可编程死区延时可用于防止半桥功率器件中流过直通（Shoot-through）电流。PDC6:PDC0 位的值设置在输出被驱动为有效之前的指令周期数。如果这个值比占空比大，则在整个周期中相应的输出保持为无效。关于死区延时操作的详细信息，请参见第 16.4.6 节“可编程死区延时”。

由于 P1A 和 P1B 输出与 PORTC<2> 和 PORTD<5> 数据锁存器是复用的，TRISC<2> 和 TRISD<5> 位必须清零，从而将 P1A 和 P1B 配置为输出。

图 16-4: 半桥 PWM 输出

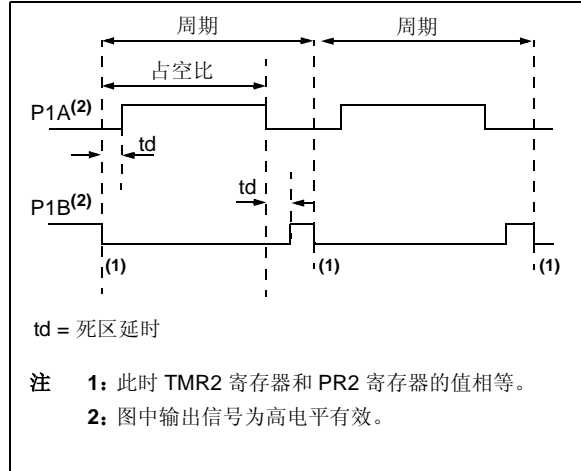
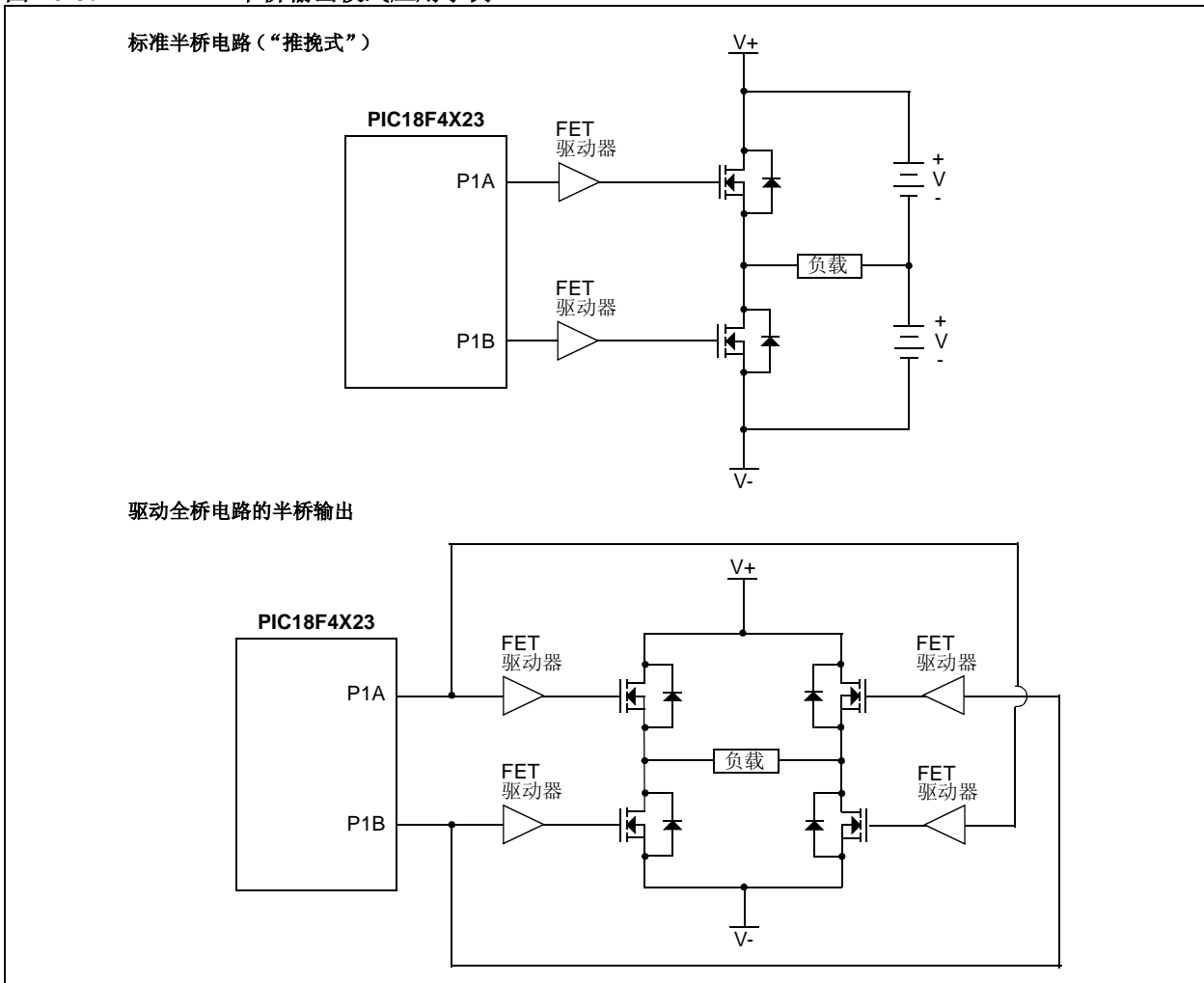


图 16-5: 半桥输出模式应用示例

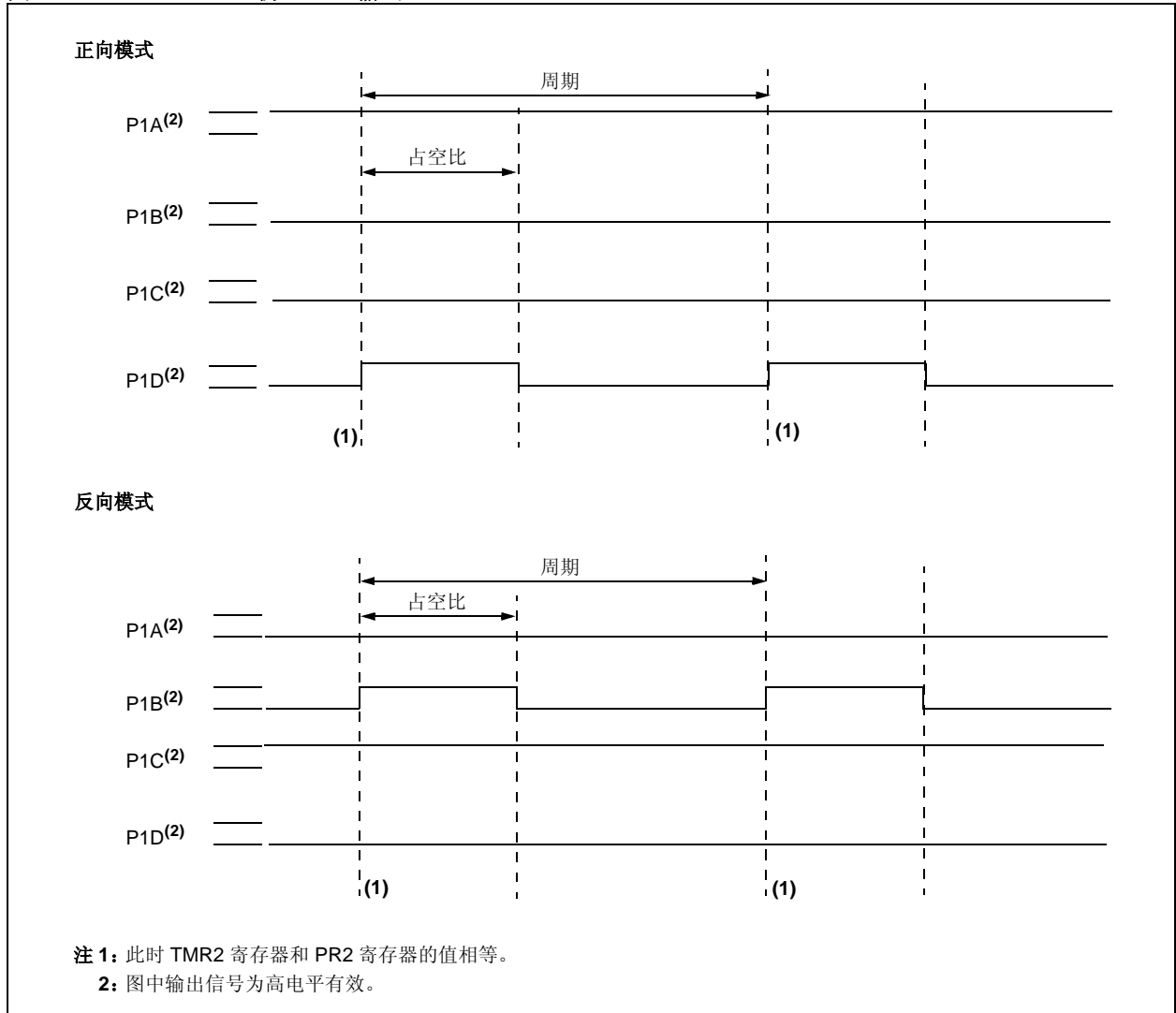


16.4.5 全桥模式

在全桥输出模式下，四个引脚都用作输出；但是，同一时间只有两个输出同时有效。在正向模式下，引脚 P1A 持续有效，引脚 P1D 被调制。在反向模式下，引脚 P1C 持续有效，引脚 P1B 被调制。如图 16-6 所示。

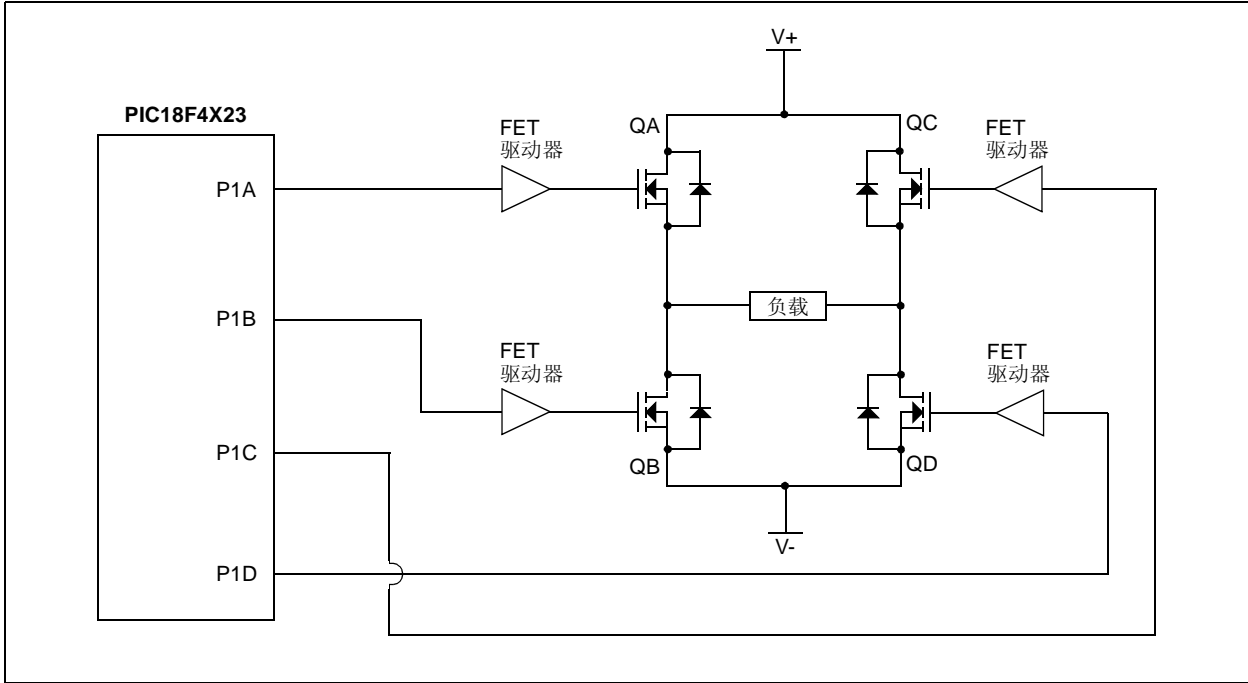
P1A、P1B、P1C 和 P1D 输出与 PORTC<2> 和 PORTD<7:5> 数据锁存器复用。TRISC<2> 和 TRISD<7:5> 位必须清零，从而将 P1A、P1B、P1C 和 P1D 引脚配置为输出。

图 16-6: 全桥 PWM 输出



PIC18F2423/2523/4423/4523

图 16-7: 全桥应用示例



16.4.5.1 全桥模式中的方向改变

在全桥输出模式下，CCP1CON 寄存器中的 P1M1 位允许用户控制正 / 反方向。当应用软件改变这个方向控制位时，模块将在下一个 PWM 周期改用新的方向。

在当前 PWM 周期结束之前，调制输出（P1B 和 P1D）进入无效状态，而未调制输出（P1A 和 P1C）切换到以相反的方向驱动。这发生在下一个 PWM 周期开始之前的 $4 T_{osc} * (\text{Timer2 预分频值})$ 时间间隔内。Timer2 预分频值可以是 1、4 或 16，这取决于 T2CKPS1:T2CKPS0 位（T2CON<1:0>）的值。从切换未调制输出驱动方向到下一个周期开始这一段时间内，调制输出（P1B 和 P1D）保持无效。这种关系如图 16-8 所示。

注意在全桥输出模式下，CCP1 模块不提供任何死区延时。通常，因为始终只有一个输出被调制，所以不需要死区延时。然而，有一种情况将需要死区延时。这一情况发生在以下两个条件同时满足时：

1. 当输出的占空比达到或者接近 100% 时，PWM 输出方向改变。
2. 功率开关（包括功率器件和驱动电路）的关断时间比导通时间要长。

在图 16-9 所示的例子中，在占空比接近 100% 时，PWM 方向从正向改变到反向。在时间 t_1 ，输出 P1A 和 P1D 变为无效，而输出 P1C 变为有效。在这个示例中，因为功率器件的关断时间比导通时间要长，在“t”时间内，功率器件 QC 和 QD 中可能流过直通电流（见图 16-7）。当 PWM 方向从反向改变到正向时，功率器件 QA 和 QB 也将出现相同的现象。

如果应用中需要在高占空比时改变 PWM 方向，必须满足以下要求之一：

1. 在改变方向之前的一个 PWM 周期降低 PWM 占空比。
2. 使用开关驱动电路，使开关管的关断时间比导通时间短。

也可能存在其他避免直通电流的方案。

图 16-8: PWM 方向改变

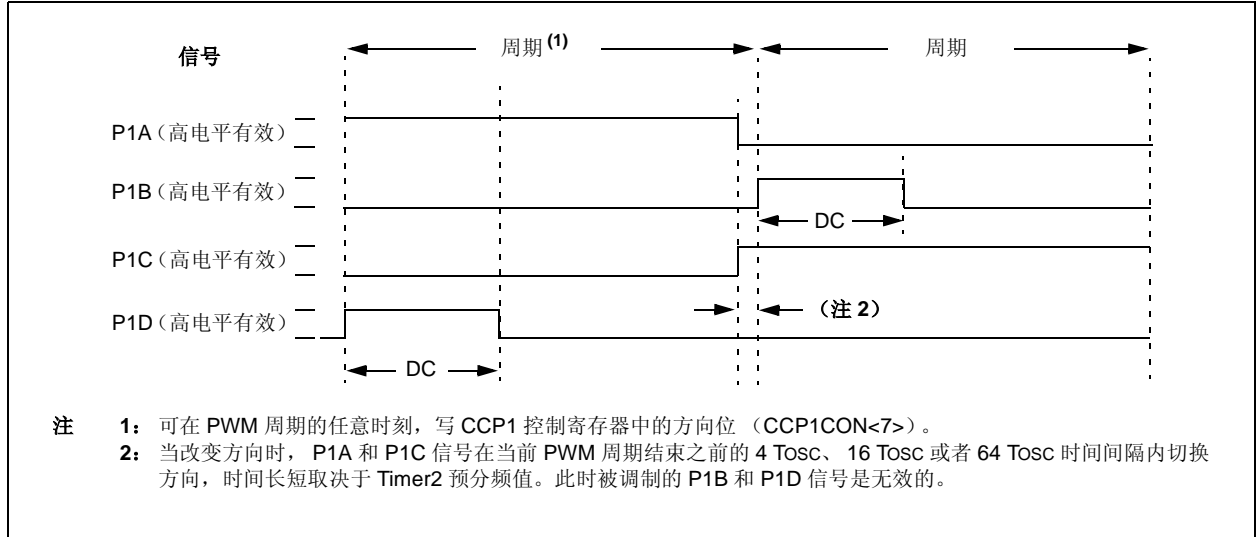
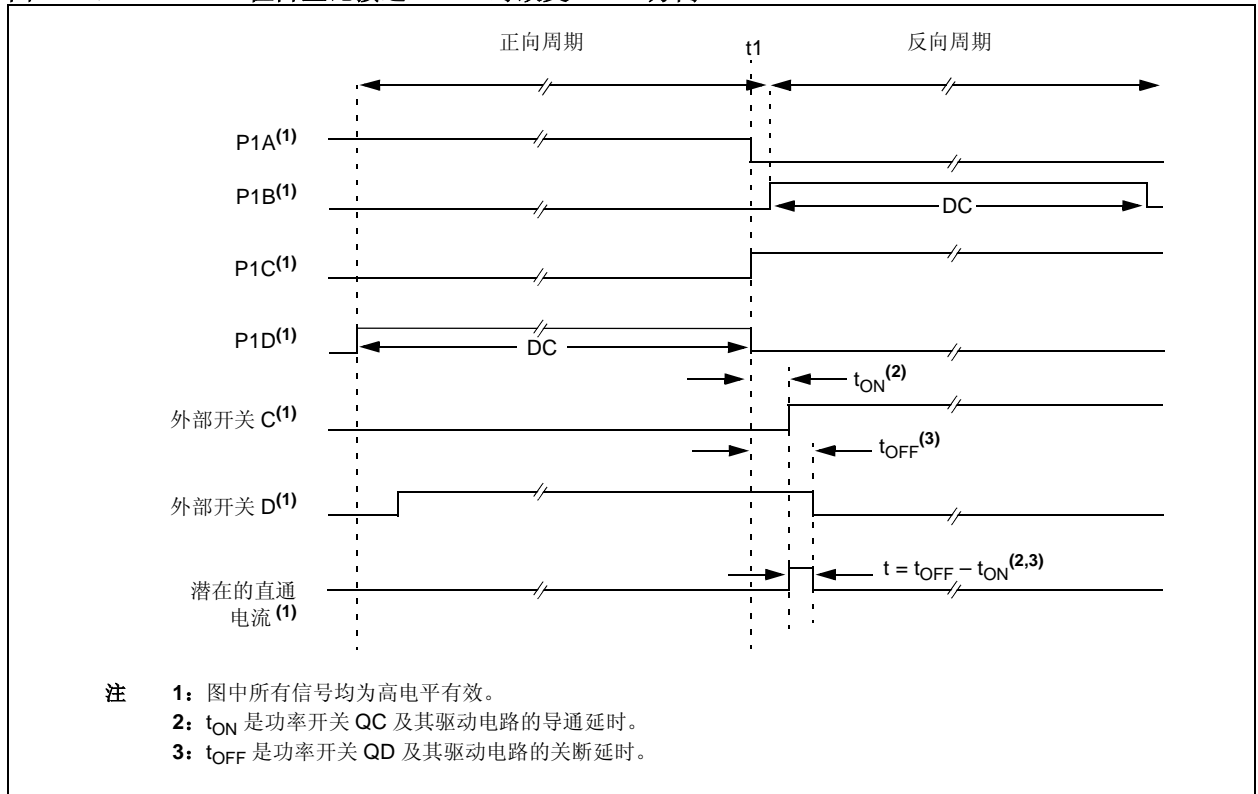


图 16-9: 在占空比接近 100% 时改变 PWM 方向



PIC18F2423/2523/4423/4523

16.4.6 可编程死区延时

注： 可编程死区延时在带有标准 CCP 模块的 28 引脚器件上未实现。

在所有功率开关管都以 PWM 频率调制的半桥应用中，功率开关管关断通常比导通需要更多的时间。如果上下两个功率开关管在同一时间开关（一个导通，另一个关断），那么在一段很短的时间里，两个开关管可能同时导通，直到一个开关管完全关断为止。在这短暂的时间里，两个功率开关管中可能流过较高的电流（*直通电流*），将逆变桥的电源与地短路。为避免开关过程中可能会出现破坏性直通电流，通常需要延迟功率开关管的导通，保证在另一个开关管完全关断之后，再导通相应的功率开关管。

在半桥输出模式下，可采用数字可编程死区延时来避免出现损坏逆变桥功率开关管的直通电流。在信号从无效状态切换到有效状态时增加延时。请参见图 16-4。ECCP1DEL 寄存器（寄存器 16-2）的 PDC6:PDC0 位以单片机指令周期（ T_{CY} 或 $4 T_{OSC}$ ）为单位设置延时。这些位在 28 引脚器件上不存在，这是因为标准 CCP 模块不支持半桥操作。

16.4.7 增强型 PWM 自动关闭

当 CCP1 编程设置为任一种增强型 PWM 模式时，有效输出引脚可配置为自动关闭。当关闭事件发生时，可立即把增强型 PWM 输出引脚置为定义的关闭状态。

自动关闭事件可由两个比较器模块之一、故障输入引脚（FLT0）上的低电平或这三者的任意组合引起。比较器可用于监控与桥电路中被监控电流成比例的电压输入。如果电压超过门限值，比较器将切换状态并触发关闭。或者，也可以由 FLT0 引脚上的低电平数字信号来触发关闭。不选择任何自动关闭源可以禁止自动关闭功能。使用的自动关闭源由 ECCPAS2:ECCPAS0 位（ECCP1AS<6:4> 位）选择。

当关闭发生时，输出引脚被异步置为其关闭状态，关闭状态由 PSSAC1:PSSAC0 和 PSSBD1:PSSBD0 位（ECCP1AS3:ECCP1AS0）指定。每对引脚（P1A/P1C 和 P1B/P1D）可以设置为驱动高电平、驱动低电平或者三态（不驱动）。ECCPASE 位（ECCP1AS<7>）也被置 1，以保持增强型 PWM 输出为关闭状态。

当关闭事件发生时，ECCPASE 位由硬件置 1。如果自动重启功能没有使能，当关闭条件被清除时，ECCPASE 位由固件清零。如果自动重启被使能，当自动关闭条件被清除时，ECCPASE 位自动清零。

如果 ECCPASE 位在 PWM 周期开始时被置 1，则 PWM 输出在整个 PWM 周期保持关闭状态。当 ECCPASE 位被清零时，PWM 输出将在下一个 PWM 周期开始时恢复正常操作。

注： 当关闭条件有效时，禁止写 ECCPASE 位。

PIC18F2423/2523/4423/4523

寄存器 16-2: ECCP1DEL: 死区延时寄存器

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
PRSEN	PDC6 ⁽¹⁾	PDC5 ⁽¹⁾	PDC4 ⁽¹⁾	PDC3 ⁽¹⁾	PDC2 ⁽¹⁾	PDC1 ⁽¹⁾	PDC0 ⁽¹⁾
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位 W = 可写位 U = 未实现位, 读为 0
 -n = POR 值 1 = 置 1 0 = 清零 x = 未知

bit 7 **PRSEN:** PWM 重启使能位
 1 = 自动关闭时, 一旦关闭事件消失, ECCPASE 位自动清零; PWM 自动重启
 0 = 自动关闭时, ECCPASE 必须用软件清零以重启 PWM

bit 6-0 **PDC6:PDC0:** PWM 延时时数位 ⁽¹⁾
 延时时间, 指的是 PWM 信号转换为有效的预定时间和实际时间之间的时间差, 单位为 Fosc/4 (4 * Tosc) 周期。

注 1: 在 28 引脚器件上保留; 保持这些位清零。

寄存器 16-3: ECCP1AS: 增强型捕捉 / 比较 / PWM 自动关闭控制寄存器

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
ECCPASE	ECCPAS2	ECCPAS1	ECCPAS0	PSSAC1	PSSAC0	PSSBD1 ⁽¹⁾	PSSBD0 ⁽¹⁾
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位 W = 可写位 U = 未实现位, 读为 0
 -n = POR 值 1 = 置 1 0 = 清零 x = 未知

bit 7 **ECCPASE:** ECCP 自动关闭事件状态位
 1 = 发生了关闭事件; ECCP 输出为关闭状态
 0 = ECCP 输出正常工作

bit 6-4 **ECCPAS2:ECCPAS0:** ECCP 自动关闭源选择位
 111 = FLT0 或比较器 1 或比较器 2
 110 = FLT0 或比较器 2
 101 = FLT0 或比较器 1
 100 = FLT0
 011 = 比较器 1 或比较器 2
 010 = 比较器 2 的输出
 001 = 比较器 1 的输出
 000 = 禁止自动关闭

bit 3-2 **PSSAC1:PSSAC0:** 引脚 A 和 C 关闭状态控制位
 1x = 引脚 A 和 C 为三态 (40/44 引脚器件)
 01 = 驱动引脚 A 和 C 为 1
 00 = 驱动引脚 A 和 C 为 0

bit 1-0 **PSSBD1:PSSBD0:** 引脚 B 和 D 关闭状态控制位 ⁽¹⁾
 1x = 引脚 B 和 D 为三态
 01 = 驱动引脚 B 和 D 为 1
 00 = 驱动引脚 B 和 D 为 0

注 1: 在 28 引脚器件上保留; 保持这些位清零。

PIC18F2423/2523/4423/4523

16.4.7.1 自动关闭和自动重启

自动关闭功能可以配置为允许在关闭事件后自动重启模块。这可通过将 ECCP1DEL 寄存器的 PRSEN 位 (ECCP1DEL<7>) 置 1 使能。

在关闭模式下, 如果 PRSEN = 1 (图 16-10), 只要导致关闭的条件持续不变, ECCPASE 位将保持置 1。当关闭条件清除时, ECCPASE 位清零。如果 PRSEN = 0 (图 16-11), 一旦关闭条件发生, ECCPASE 位将保持置 1 直到被固件清零。一旦 ECCPASE 位被清零, 增强型 PWM 将在下一个 PWM 周期的开始重新工作。

注: 当关闭条件有效时, 禁止写 ECCPASE 位。

如果自动关闭源为比较器之一, 关闭条件是一个电平值, 这与 PRSEN 位的设置无关。只要关闭的条件一直持续, ECCPASE 位就不能被清零。

可以通过写 1 到 ECCPASE 位, 强制进入自动关闭模式。

16.4.8 启动注意事项

当 ECCP 模块工作在 PWM 模式时, 必须在 PWM 输出引脚上外接适当的上拉和 / 或下拉电阻。当单片机退出复位状态时, 所有 I/O 引脚呈高阻状态。外部电路必须保持功率开关器件处于截止状态, 直到单片机将 I/O 引脚驱动为适当的信号电平, 或者激活 PWM 输出为止。

CCP1M1:CCP1M0 位 (CCP1CON<1:0>) 允许用户为每一对 PWM 输出引脚 (P1A/P1C 和 P1B/P1D) 选择 PWM 输出信号为高电平有效或低电平有效。PWM 输出极性必须在 PWM 引脚配置为输出之前选择。建议不要在 PWM 引脚被配置为输出时改变极性配置, 因为这可能导致应用电路损坏。

当 PWM 模块初始化时, P1A、P1B、P1C 和 P1D 输出锁存器可能不在正确的状态。这样在配置 ECCP 模块的同时使能 PWM 引脚为输出, 可能损坏应用电路。应首先将 ECCP 模块配置为正确的输出模式并经过一个完整的 PWM 周期之后, 再将 PWM 引脚配置为输出。当第二个 PWM 周期开始时, TMR2IF 位置 1 表明一个完整的 PWM 周期结束了。

图 16-10: PWM 自动关闭 (PRSEN = 1, 使能自动重启)

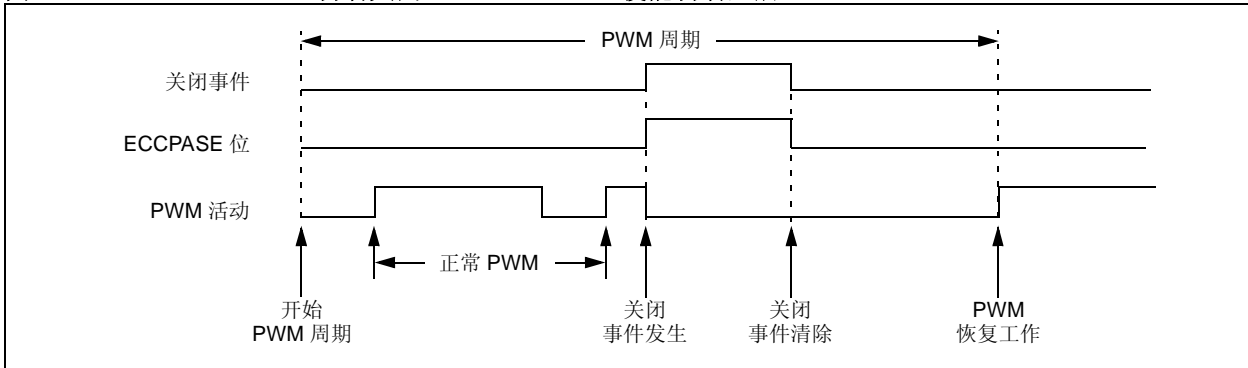
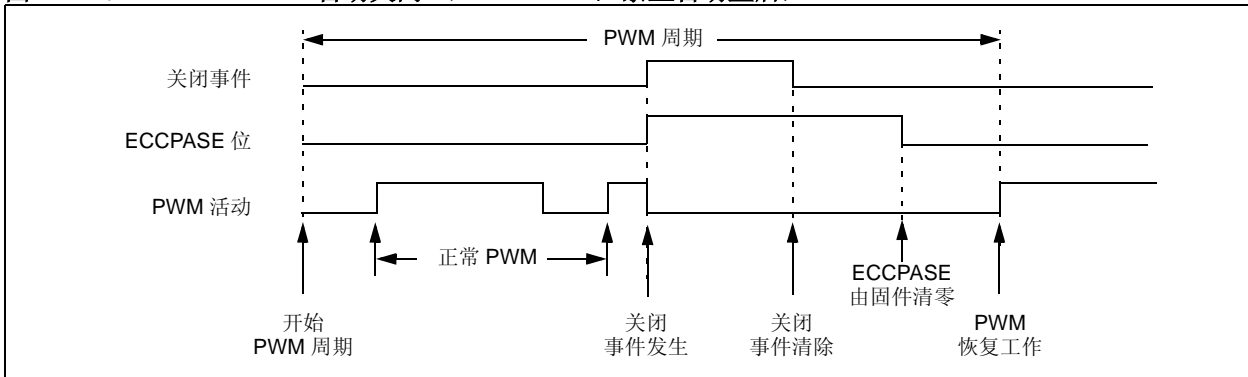


图 16-11: PWM 自动关闭 (PRSEN = 0, 禁止自动重启)



16.4.9 设置 PWM 操作

要配置 ECCP 模块的 PWM 操作，可采用以下步骤：

1. 通过将相应的 TRIS 位置 1，配置 PWM 引脚 P1A 和 P1B（以及 P1C 和 P1D，如果使用）为输入。
2. 通过装载 PR2 寄存器设置 PWM 周期。
3. 如果需要自动关闭：
 - 禁止自动关闭（ECCPASE = 0）
 - 配置源（FLT0、比较器 1 或比较器 2）
 - 等待非关闭条件
4. 通过装载恰当的值到 CCP1CON 寄存器将 ECCP 模块设置为需要的 PWM 模式和配置：
 - 用 P1M1:P1M0 位选择输出配置和方向。
 - 用 CCP1M3:CCP1M0 位选择 PWM 输出信号的极性。
5. 通过装载 CCPR1L 寄存器和 CCP1CON<5:4> 位设置 PWM 占空比。
6. 对于半桥输出模式，通过装载恰当的值到 ECCP1DEL<6:0> 设置死区延时。
7. 如果需要自动关闭操作，装载 ECCP1AS 寄存器：
 - 使用 ECCPAS2:ECCPAS0 位选择自动关闭源。
 - 使用 PSSAC1:PSSAC0 和 PSSBD1:PSSBD0 位选择 PWM 输出引脚在关闭时的状态。
 - 将 ECCPASE 位（ECCP1AS<7>）置 1。
 - 使用 CMCON 寄存器配置比较器。
 - 将比较器输出配置为模拟输入。
8. 如果需要自动重启，将 PRSEN 位（ECCP1DEL<7>）置 1。
9. 配置及启动 TMR2：
 - 通过清零 TMR2IF 位（PIR1<1>）清零 TMR2 中断标志位。
 - 通过装载 T2CKPS<1:0> 位（T2CON<1:0>）设置 TMR2 预分频值。
 - 通过将 TMR2ON 位（T2CON<2>）置 1 使能 Timer2。
10. 在新的 PWM 周期开始后使能 PWM 输出：
 - 等待直到 TMRn 溢出（TMRnIF 位置 1）。
 - 通过清零相应的 TRIS 位，使能 CCP1/P1A、P1B、P1C 和 / 或 P1D 引脚为输出。
 - 清零 ECCPASE 位（ECCP1AS<7>）。

16.4.10 功耗管理模式下的操作

在休眠模式下，所有时钟源都被禁止。Timer2 不再递增，模块的状态也不会改变。如果 ECCP 引脚正在驱动一个值，则该驱动值保持不变。当器件被唤醒时，将从该状态继续。如果使能了双速启动，来自 INTOSC 和后分频器的初始启动频率可能不会立即稳定。

在 PRI_IDLE 模式下，主时钟将继续作为 ECCP 模块的时钟源，保持不变。在所有其他功耗管理模式下，选定的功耗管理模式时钟将作为 Timer2 的时钟源。功耗管理模式时钟很可能与主时钟频率不同。

16.4.10.1 使用故障保护时钟监视器操作

如果使能故障保护时钟监视器，时钟故障将强制器件进入功耗管理 RC_RUN 模式，并将 OSCFIF 位（PIR2<7>）置 1。ECCP 将从内部振荡器时钟源获取时钟信号，可能与主时钟的时钟频率不同。

更多详细信息，请参见前面的章节。

16.4.11 复位的影响

上电复位及后续的复位都将强制所有端口为输入模式，并强制 CCP 寄存器为复位状态。

这将强制增强型 CCP 模块复位到与标准 CCP 模块兼容的状态。

PIC18F2423/2523/4423/4523

表 16-3: 与 ECCP1 模块和 TIMER1 到 TIMER3 相关的寄存器

名称	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	复位值 所在页
INTCON	GIE/GIEH	PEIE/GIEL	TMR0IE	INT0IE	RBIE	TMR0IF	INT0IF	RBIF	49
RCON	IPEN	SBOREN ⁽¹⁾	—	\overline{RI}	\overline{TO}	\overline{PD}	\overline{POR}	\overline{BOR}	48
PIR1	PSPIF	ADIF	RCIF	TXIF	SSPIF	CCP1IF	TMR2IF	TMR1IF	52
PIE1	PSPIE	ADIE	RCIE	TXIE	SSPIE	CCP1IE	TMR2IE	TMR1IE	52
IPR1	PSPIP	ADIP	RCIP	TXIP	SSPIP	CCP1IP	TMR2IP	TMR1IP	52
PIR2	OSCFIF	CMIF	—	EEIF	BCLIF	HLVDIF	TMR3IF	CCP2IF	52
PIE2	OSCFIE	CMIE	—	EEIE	BCLIE	HLVDIE	TMR3IE	CCP2IE	52
IPR2	OSCFIP	CMIP	—	EEIP	BCLIP	HLVDIP	TMR3IP	CCP2IP	52
TRISB	PORTB 数据方向控制寄存器								52
TRISC	PORTC 数据方向控制寄存器								52
TRISD	PORTD 数据方向控制寄存器								52
TMR1L	Timer1 寄存器的低字节								50
TMR1H	Timer1 寄存器的高字节								50
T1CON	RD16	T1RUN	T1CKPS1	T1CKPS0	T1OSCEN	$\overline{T1SYN\overline{C}}$	TMR1CS	TMR1ON	50
TMR2	Timer2 寄存器								50
T2CON	—	T2OUTPS3	T2OUTPS2	T2OUTPS1	T2OUTPS0	TMR2ON	T2CKPS1	T2CKPS0	50
PR2	Timer2 周期寄存器								50
TMR3L	Timer3 寄存器的低字节								51
TMR3H	Timer3 寄存器的高字节								51
T3CON	RD16	T3CCP2	T3CKPS1	T3CKPS0	T3CCP1	$\overline{T3SYN\overline{C}}$	TMR3CS	TMR3ON	51
CCPR1L	捕捉 / 比较 / PWM 寄存器 1 的低字节								51
CCPR1H	捕捉 / 比较 / PWM 寄存器 1 的高字节								51
CCP1CON	P1M1 ⁽²⁾	P1M0 ⁽²⁾	DC1B1	DC1B0	CCP1M3	CCP1M2	CCP1M1	CCP1M0	51
ECCP1AS	ECCPASE	ECCPAS2	ECCPAS1	ECCPAS0	PSSAC1	PSSAC0	PSSBD1 ⁽²⁾	PSSBD0 ⁽²⁾	51
ECCP1DEL	PRSEN	PDC6 ⁽²⁾	PDC5 ⁽²⁾	PDC4 ⁽²⁾	PDC3 ⁽²⁾	PDC2 ⁽²⁾	PDC1 ⁽²⁾	PDC0 ⁽²⁾	51

图注: — = 未实现, 读为 0。ECCP 操作期间不使用阴影单元。

注 1: SBOREN 位仅在 BOREN1:BOREN0 配置位 = 01 时可用; 否则, 它被禁止且读为 0。请参见第 4.4 节“欠压复位 (BOR)”。

注 2: 这些位在 28 引脚器件上未实现; 始终保持这些位清零。

17.0 主同步串行口 (MSSP) 模块

17.1 主 SSP (MSSP) 模块概述

主同步串行口 (MSSP) 模块是用于同其他外设或单片机器件进行通信的串行接口。这些外设器件可以是串行 EEPROM、移位寄存器、显示驱动器和 A/D 转换器等。MSSP 模块有下列两种工作模式：

- 串行外设接口 (Serial Peripheral Interface, SPI)
- I²C
 - 全主控模式
 - 从动模式 (支持广播地址呼叫)

I²C 接口硬件上支持下列模式：

- 主控模式
- 多主机模式
- 从动模式 (具有用于 10 位和 7 位寻址的地址屏蔽功能)

17.2 控制寄存器

MSSP 模块有三个相关的寄存器，包括一个状态寄存器 (SSPSTAT) 和两个控制寄存器 (SSPCON1 和 SSPCON2)。根据 MSSP 模块是在 SPI 模式还是 I²C 模式下工作，这些寄存器的用途及它们各自的配置位将完全不同。

下面各节会提供更多详细信息。

17.3 SPI 模式

SPI 模式允许同时同步发送和接收 8 位数据。器件支持 SPI 的所有四种模式。通常使用以下三个引脚来实现通信：

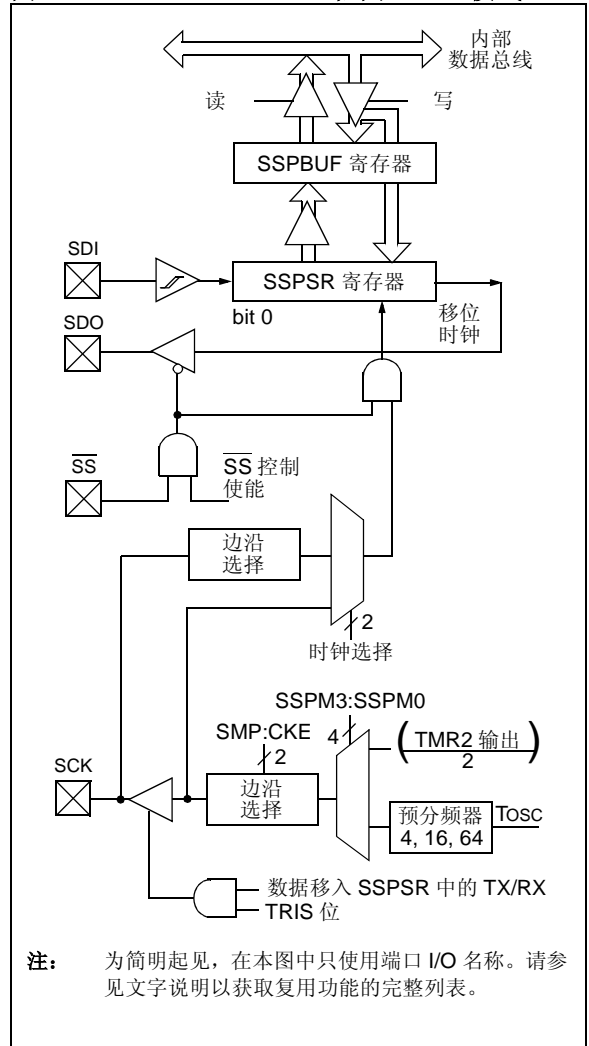
- 串行数据输出 (Serial Data Out, SDO) —— RC5/SDO
- 串行数据输入 (Serial Data In, SDI) —— RC4/SDI/SDA
- 串行时钟 (Serial Clock, SCK) —— RC3/SCK/SCL

此外，当处于从动工作模式时要使用第 4 个引脚：

- 从动选择 (\overline{SS}) —— RA5/AN4/ \overline{SS} /HLVDIN/C2OUT

图 17-1 给出了 MSSP 模块在 SPI 模式下的工作原理框图。

图 17-1: MSSP 框图 (SPI 模式)



PIC18F2423/2523/4423/4523

17.3.1 寄存器

MSSP 模块有四个寄存器用于 SPI 工作模式。这些寄存器包括：

- MSSP 控制寄存器 1 (SSPCON1)
- MSSP 状态寄存器 (SSPSTAT)
- 串行接收 / 发送缓冲寄存器 (SSPBUF)
- MSSP 移位寄存器 (SSPSR) ——不可直接访问

SSPCON1 和 SSPSTAT 是 SPI 模式下的控制寄存器和状态寄存器。SSPCON1 寄存器是可读写的。SSPSTAT 的低 6 位是只读的，而高 2 位是可读写的。

SSPSR 是用来将数据移入或移出的移位寄存器。SSPBUF 是缓冲寄存器，可用于数据字节的写入或读出。

接收数据时，SSPSR 和 SSPBUF 共同构成一个双重缓冲接收器。当 SSPSR 接收到一个完整的字节之后，该字节会被送入 SSPBUF，同时将中断标志位 SSPIF 置 1。

在数据发送过程中，SSPBUF 不是双重缓冲的，对 SSPBUF 的写操作将同时写入 SSPBUF 和 SSPSR。

寄存器 17-1: SSPSTAT: MSSP 状态寄存器 (SPI 模式)

R/W-0	R/W-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0
SMP	CKE ⁽¹⁾	D/A	P	S	R/W	UA	BF
bit 7							bit 0

图注：

R = 可读位	W = 可写位	U = 未实现位，读为 0
-n = POR 值	1 = 置 1	0 = 清零
		x = 未知

- bit 7 **SMP:** 采样位
SPI 主控模式:
1 = 在数据输出时间的末端采样输入数据
0 = 在数据输出时间的中间采样输入数据
SPI 从动模式:
当 SPI 工作在从动模式时，必须将 SMP 清零。
- bit 6 **CKE:** SPI 时钟选择位 ⁽¹⁾
1 = 时钟状态从有效转换到空闲时发送
0 = 时钟状态从空闲转换到有效时发送
- bit 5 **D/A:** 数据 / 地址位
只在 I²C 模式下使用。
- bit 4 **P:** 停止位
只在 I²C 模式下使用。当禁止 MSSP 模块 (SSPEN 清零) 时，该位被清零。
- bit 3 **S:** 起始位
只在 I²C 模式下使用。
- bit 2 **R/W:** 读 / 写信息位
只在 I²C 模式下使用。
- bit 1 **UA:** 更新地址位
只在 I²C 模式下使用。
- bit 0 **BF:** 缓冲器满状态位 (仅用于接收模式)
1 = 接收完成, SSPBUF 满
0 = 接收未完成, SSPBUF 空

注 1: 时钟状态的极性由 CKP 位 (SSPCON1<4>) 设置。

PIC18F2423/2523/4423/4523

17.3.2 工作原理

当初始化 SPI 时，需要指定几个选项。可以通过编程相应的控制位（SSPCON1<5:0> 和 SSPSTAT<7:6>）来指定。这些控制位用于指定以下选项：

- 主控模式（SCK 作为时钟输出）
- 从动模式（SCK 作为时钟输入）
- 时钟极性（SCK 的空闲状态）
- 数据输入采样相位（数据输出时间的中间或末尾）
- 时钟边沿（在 SCK 的上升沿 / 下降沿输出数据）
- 时钟速率（仅用于主控模式）
- 从动选择模式（仅用于从动模式）

MSSP 模块由一个发送 / 接收移位寄存器（SSPSR）和一个缓冲寄存器（SSPBUF）组成。SSPSR 将数据移入 / 移出器件，最高有效位在前。在新数据接收完毕前，SSPBUF 保存上次写入 SSPSR 的数据。一旦 8 位数据接收完毕，该字节就被移入 SSPBUF 寄存器。然后，缓冲器满检测位 BF（SSPSTAT<0>）和中断标志位 SSPIF 被置 1。这种双重缓冲数据接收方式（SSPBUF），允许在 CPU

读取刚接收的数据之前，就开始接收下一个字节。在数据发送 / 接收期间，任何试图写 SSPBUF 寄存器的操作都无效，并且写冲突检测位 WCOL（SSPCON1<7>）将被置 1。用户必须用软件将 WCOL 位清零才能判断以后对 SSPBUF 寄存器的写入是否成功。

为确保应用软件能有效地接收数据，在下一个要发送的数据字节写入 SSPBUF 之前，读取 SSPBUF 中现有的数据。缓冲器满位 BF（SSPSTAT<0>）用于表示何时 SSPBUF 装入了接收到的数据（发送完成）。当 SSPBUF 中的数据被读取后，BF 位即被清零。如果 SPI 仅仅作为一个发送器，则不必理会该数据。通常，可用 MSSP 中断来判断发送 / 接收是否已完成。必须读取和 / 或写入 SSPBUF。如果不打算使用中断，用软件查询的方法同样可确保不会发生写冲突。例 17-1 举例说明了装载 SSPBUF（SSPSR）进行数据发送的过程。

不能直接读写 SSPSR 寄存器，只能通过寻址 SSPBUF 寄存器来访问。此外，MSSP 状态寄存器（SSPSTAT）用于指示各种状态。

例 17-1: 装载 SSPBUF（SSPSR）寄存器

LOOP	BTFSS	SSPSTAT, BF	;Has data been received (transmit complete)?
	BRA	LOOP	;No
	MOVF	SSPBUF, W	;WREG reg = contents of SSPBUF
	MOVWF	RXDATA	;Save in user RAM, if data is meaningful
	MOVF	TXDATA, W	;W reg = contents of TXDATA
	MOVWF	SSPBUF	;New data to xmit

17.3.3 使能 SPI I/O

要使能串口，MSSP 使能位 SSPEN (SSPCON1<5>) 必须置 1。要复位或重新配置 SPI 模式，要先将 SSPEN 位清零，重新初始化 SSPCON 寄存器，然后将 SSPEN 位置 1。这将把 SDI、SDO、SCK 和 SS 引脚配置为串口引脚。要将上述引脚用于串口功能，必须正确设置引脚的数据方向位（在 TRIS 寄存器中）：

- SDI 由 SPI 模块自动控制
- SDO 必须将 TRISC<5> 位清零
- SCK（主控模式）必须将 TRISC<3> 位清零
- SCK（从动模式）必须将 TRISC<3> 位置 1
- SS 必须将 TRISA<5> 位置 1

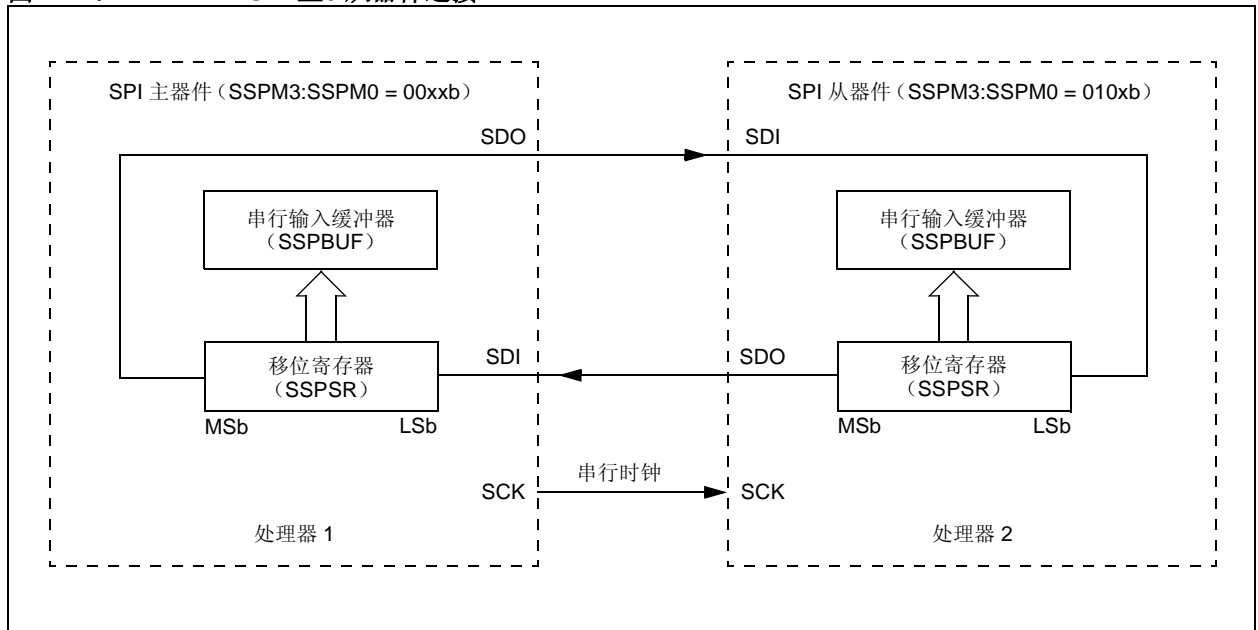
对于不需要的串口功能，可通过将对应的数据方向寄存器（TRIS）设置为相反值来屏蔽。

17.3.4 典型连接

图 17-2 给出了两个单片机之间的典型连接。主器件（处理器 1）通过发送 SCK 信号来启动数据传输。数据在编程设定的时钟边沿被移出两个处理器的移位寄存器。并在相反的时钟边沿被锁存。必须将两个处理器的时钟极性（CKP）设置为相同，这样就可以同时收发数据。数据是否有效，取决于应用软件。这就导致以下三种数据传输情形：

- 主器件发送数据——从器件发送无效（dummy）数据
- 主器件发送数据——从器件发送数据
- 主器件发送无效数据——从器件发送数据

图 17-2: SPI 主 / 从器件连接



PIC18F2423/2523/4423/4523

17.3.5 主控模式

因为由主器件控制 SCK 信号，所以它可以在任意时刻启动数据传输。主器件根据软件协议确定从器件（图 17-2 中的处理器 2）应在何时广播数据。

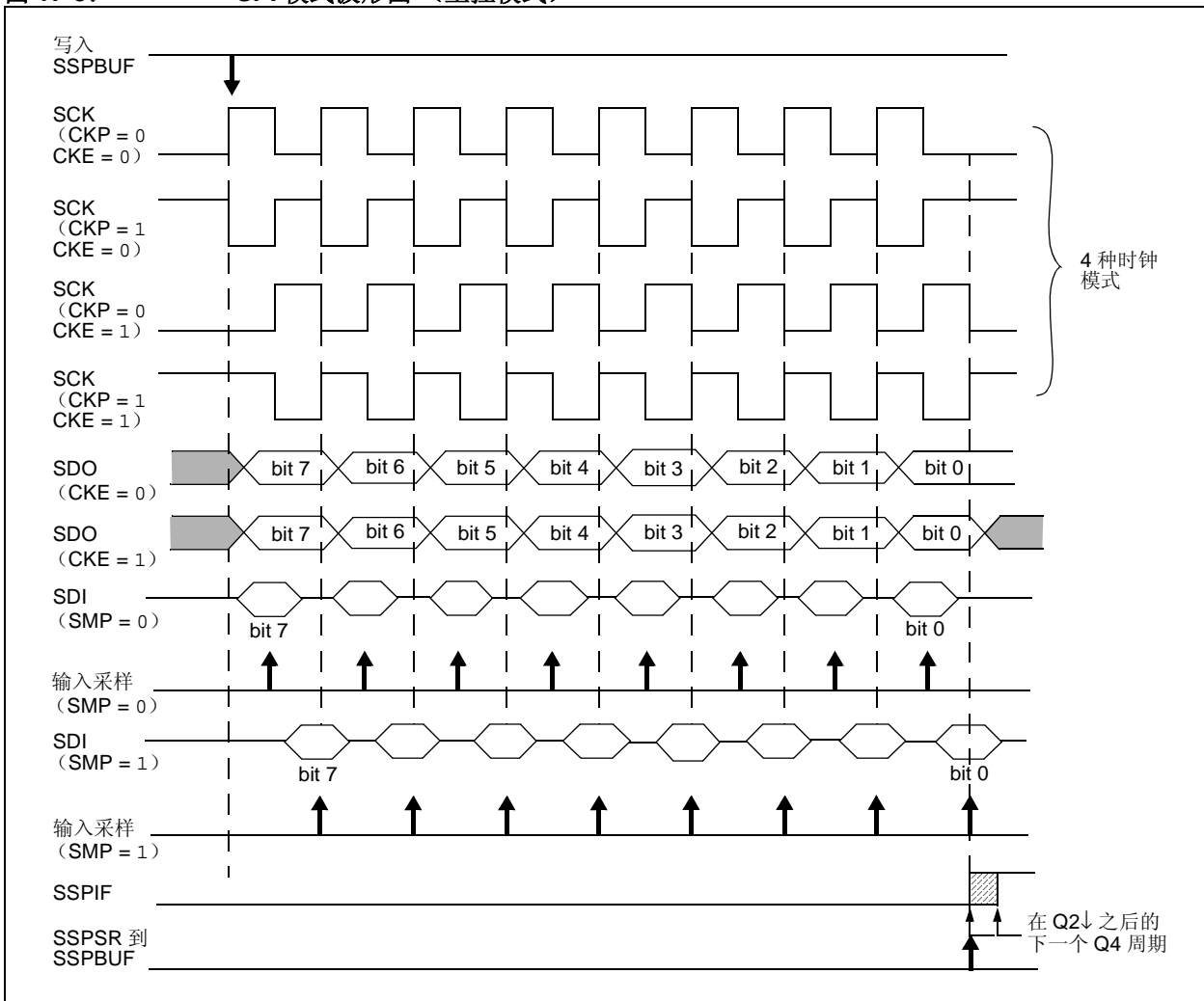
在主控模式下，数据一旦写入 SSPBUF 寄存器就开始发送或接收。如果只打算将 SPI 作为接收器，则可以禁止 SDO 输出（将其编程设置为输入）。SSPSR 寄存器按设置的时钟速率，连续移入 SDI 引脚上的信号。每收到一个字节，就将其装入 SSPBUF 寄存器，就像接收到普通字节一样（中断和状态位相应置 1）。这在以“线路活动监控”（Line Activity Monitor）方式工作的接收器应用中很有用。

可通过对 CKP 位（SSPCON1<4>）进行适当的编程来选择时钟极性。图 17-3、图 17-5 和图 17-6 将给出 SPI 通信的波形图，其中最先发送的是最高有效位。在主控模式下，SPI 时钟速率（位速率）可由用户编程设定为下面几种之一：

- Fosc/4（或 Tcy）
- Fosc/16（或 4 • Tcy）
- Fosc/64（或 16 • Tcy）
- Timer2 输出 /2

图 17-3 给出了主控模式的波形图。当 CKE 位置 1 时，SDO 数据在 SCK 出现时钟边沿前一直有效。图中所示的输入采样的变化由 SMP 位的状态反映。图中给出了将接收到的数据装入 SSPBUF 的时间。

图 17-3: SPI 模式波形图（主控模式）



17.3.6 从动模式

在从动模式下，当 SCK 引脚上有外部时钟脉冲时发送和接收数据。当最后一位数据被锁存后，中断标志位 SSPIF 置 1。

在 SPI 从动模式下使能该模块前，时钟线必须与适当的空闲状态相匹配。时钟线可通过读 SCK 引脚来查看。空闲状态由 CKP 位 (SSPCON1<4>) 决定。

在从动模式下，外部时钟由 SCK 引脚上的外部时钟源提供。外部时钟必须满足电气规范中规定的高电平和低电平的最短时间要求。

在休眠模式下，从器件仍可发送 / 接收数据。当接收到一个字节时，器件从休眠状态中唤醒。

17.3.7 从动选择同步

SS 引脚允许同步从动模式。SPI 必须处于从动模式，并使能 SS 引脚控制 (SSPCON1<3:0> = 04h)。要使 SS 引脚作为输入，不得将该引脚驱动为低电平。数据锁存

器必须为高电平。当 SS 引脚为低电平时，使能数据的发送和接收，同时 SDO 引脚被驱动。当 SS 引脚变为高电平时，即使是在字节的发送过程中，也不再驱动 SDO 引脚，而是将其变成悬空输出状态。根据应用需要，可在 SDO 引脚上外接上拉 / 下拉电阻。

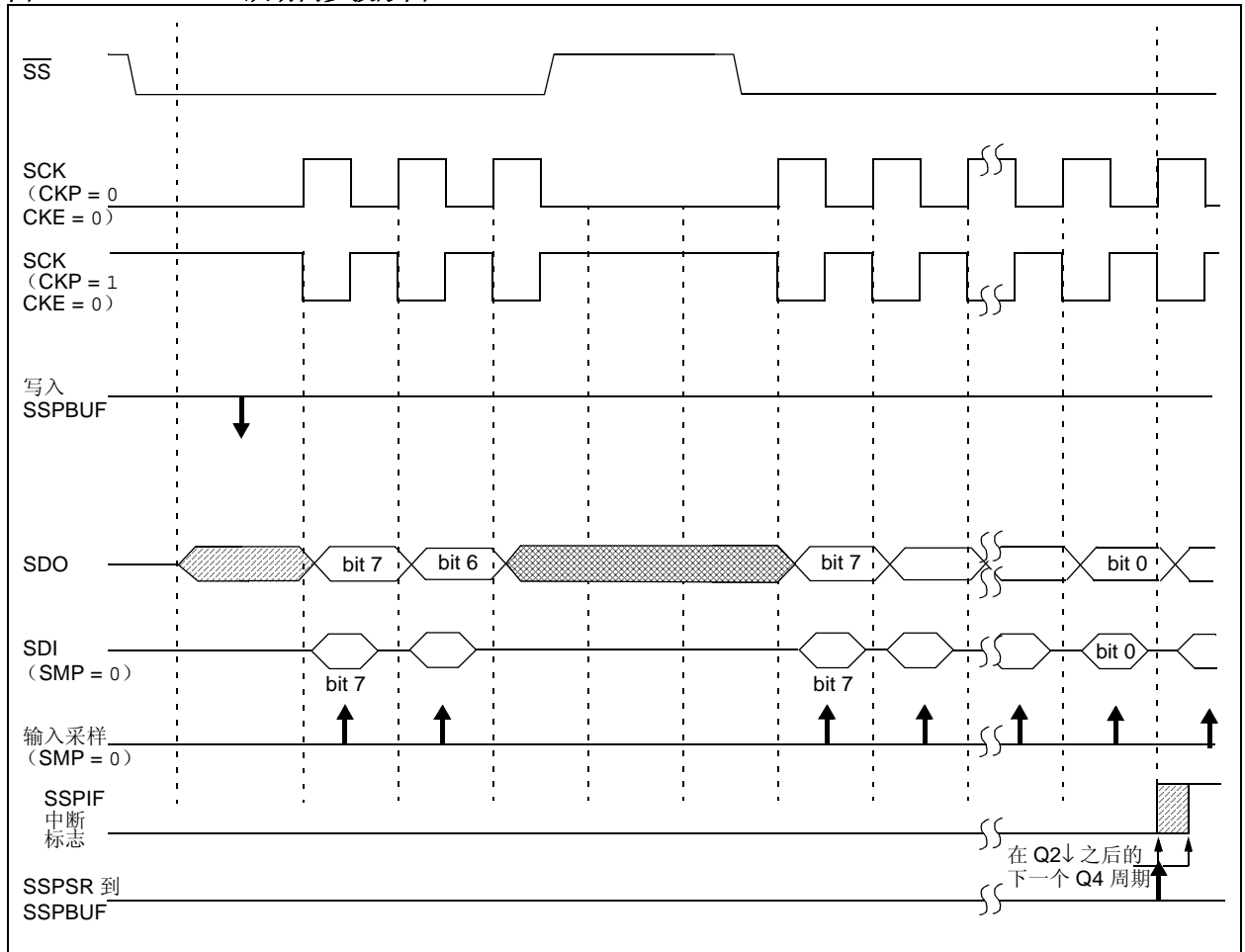
注 1: 当 SPI 处于从动模式，并且使能 SS 引脚控制 (SSPCON1<3:0> = 0100) 时，如果 SS 引脚设置为 VDD 电平将使 SPI 模块复位。

2: 如果 SPI 用于从动模式并且 CKE 置 1，则必须使能 SS 引脚控制。

当 SPI 模块复位后，位计数器被强制为 0。这是通过强制将 SS 引脚拉为高电平或将 SSPEN 位清零来实现的。

将 SDO 引脚和 SDI 引脚相连，可以仿真二线制通信。当 SPI 需要作为接收器工作时，SDO 引脚可以被配置为输入端。这样就禁止了从 SDO 发送数据。因为 SDI 不会引起总线冲突，所以可以一直将其保持为输入 (SDI 功能)。

图 17-4: 从动同步波形图



PIC18F2423/2523/4423/4523

图 17-5: SPI 模式波形图 (从动模式, $CKE = 0$)

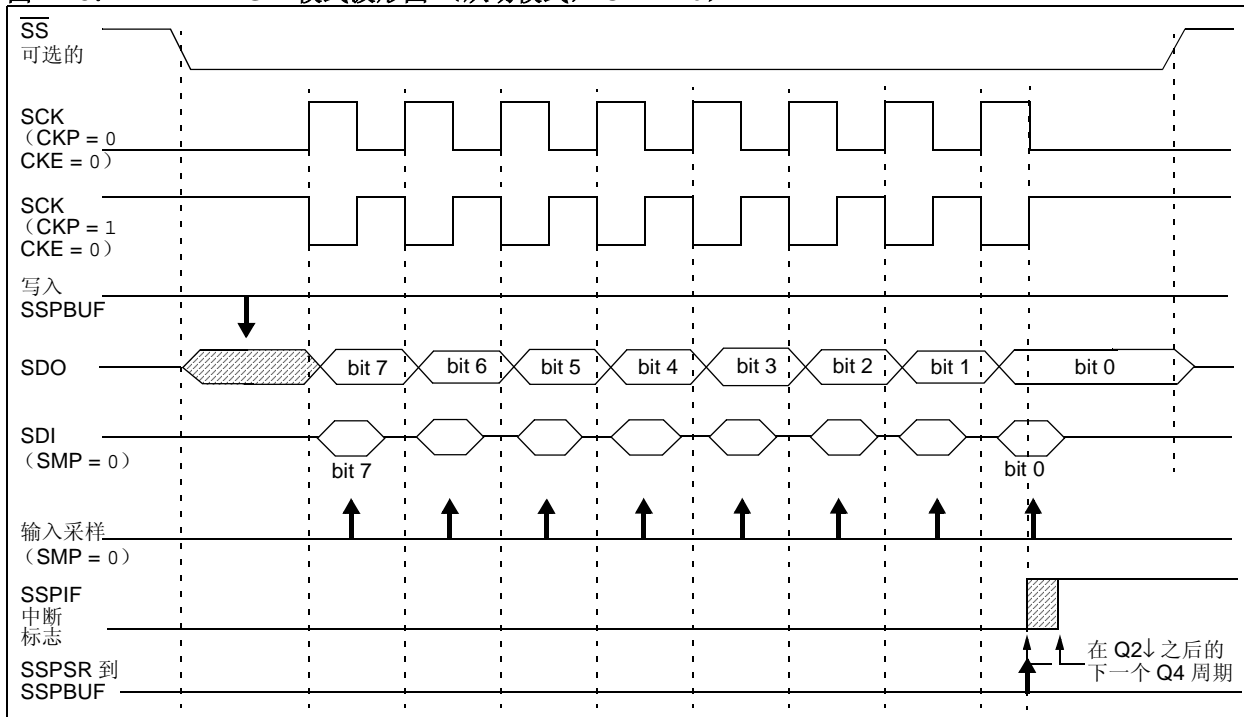
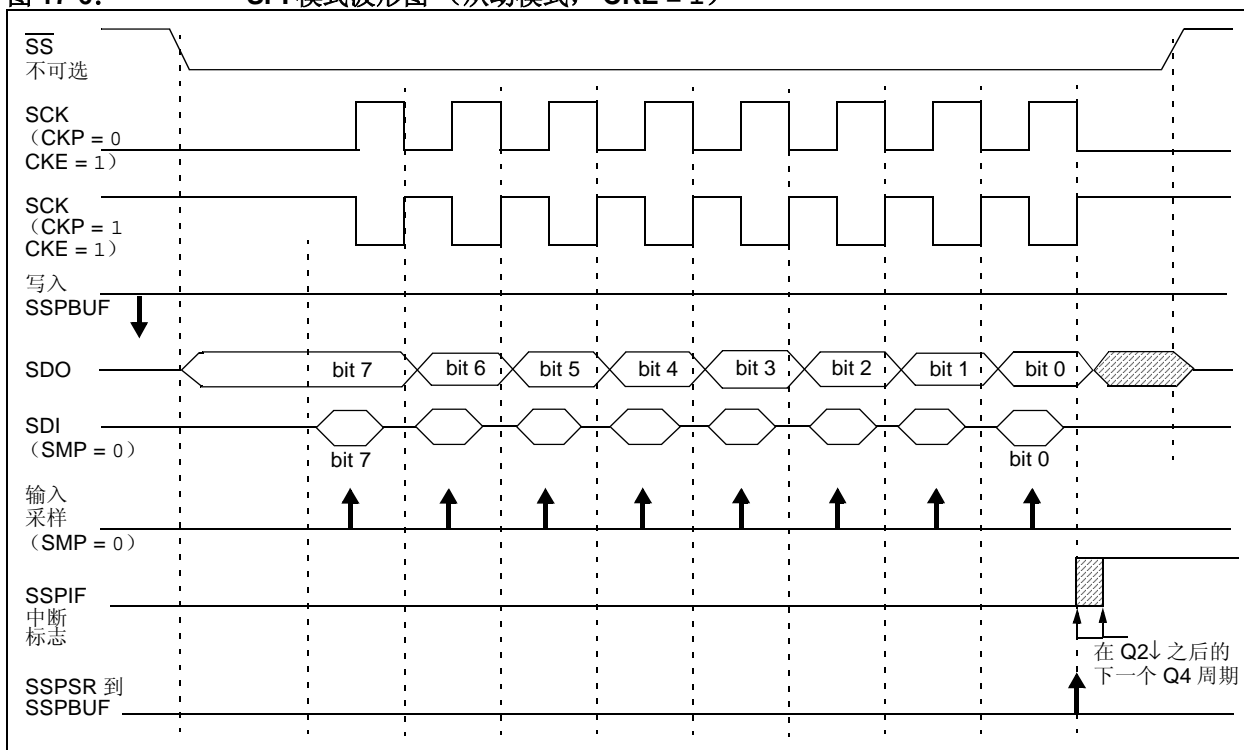


图 17-6: SPI 模式波形图 (从动模式, $CKE = 1$)



17.3.8 在功耗管理模式下的操作

在 SPI 主控模式下，模块时钟速度与全功耗模式下的不同；处于休眠模式时，所有时钟都停止。

在空闲模式下，需要为外设提供一个时钟。该时钟来自于主时钟源、辅助时钟源（32.768 kHz 的 Timer1 振荡器）或 INTOSC 时钟源。更多信息，请参见第 2.7 节“时钟源与振荡器切换”。

在大多数情况下，主器件为 SPI 数据提供的时钟速度并不重要；但是，每个系统都应该评估此因素。

如果允许了 MSSP 中断，那么当主器件发送完数据时这些中断可以将控制器从休眠模式或某种空闲模式唤醒。如果不想从休眠或空闲模式退出，应该禁止 MSSP 中断。

如果选择了休眠模式，所有模块的时钟都将停止，并且在器件被唤醒前，发送 / 接收将保持此停滞状态。当器件返回到运行模式后，该模块将恢复发送和接收数据。

在 SPI 从动模式下，SPI 发送 / 接收移位寄存器与器件异步工作。这可以使器件处于任何功耗管理模式下，而且数据仍可被移入 SPI 发送 / 接收移位寄存器。当 8 位数据全部接收到后，MSSP 中断标志位将置 1，并且如果允许中断的话，器件被唤醒。

17.3.9 复位的影响

复位操作会禁止 MSSP 模块并终止当前的数据传输。

17.3.10 总线模式兼容性

表 17-1 中所示是标准 SPI 模式与 CKP 和 CKE 控制位状态的对应关系。

表 17-1: SPI 总线模式

标准 SPI 模式术语	控制位状态	
	CKP	CKE
0, 0	0	1
0, 1	0	0
1, 0	1	1
1, 1	1	0

还有一个 SMP 位用来控制数据何时被采样。

表 17-2: 与 SPI 操作相关的寄存器

名称	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	复位值所在页
INTCON	GIE/GIEH	PEIE/GIEL	TMR0IE	INT0IE	RBIE	TMR0IF	INT0IF	RBIF	49
PIR1	PSPIF ⁽¹⁾	ADIF	RCIF	TXIF	SSPIF	CCP1IF	TMR2IF	TMR1IF	52
PIE1	PSPIE ⁽¹⁾	ADIE	RCIE	TXIE	SSPIE	CCP1IE	TMR2IE	TMR1IE	52
IPR1	PSPIP ⁽¹⁾	ADIP	RCIP	TXIP	SSPIP	CCP1IP	TMR2IP	TMR1IP	52
TRISA	TRISA7 ⁽²⁾	TRISA6 ⁽²⁾	PORTA 数据方向控制寄存器						52
TRISC	PORTC 数据方向控制寄存器								52
SSPBUF	MSSP 接收缓冲器 / 发送寄存器								50
SSPCON1	WCOL	SSPOV	SSPEN	CKP	SSPM3	SSPM2	SSPM1	SSPM0	50
SSPSTAT	SMP	CKE	D/A	P	S	R/W	UA	BF	50

图注： SPI 模式下的 MSSP 不使用阴影单元。

注 1： 这些位在 28 引脚器件上未实现；始终保持这些位清零。

注 2： PORTA<7:6> 及其方向位根据不同的主振荡器模式被单独配置为端口引脚。当被禁止时，这些位读为 0。

PIC18F2423/2523/4423/4523

17.4 I²C 模式

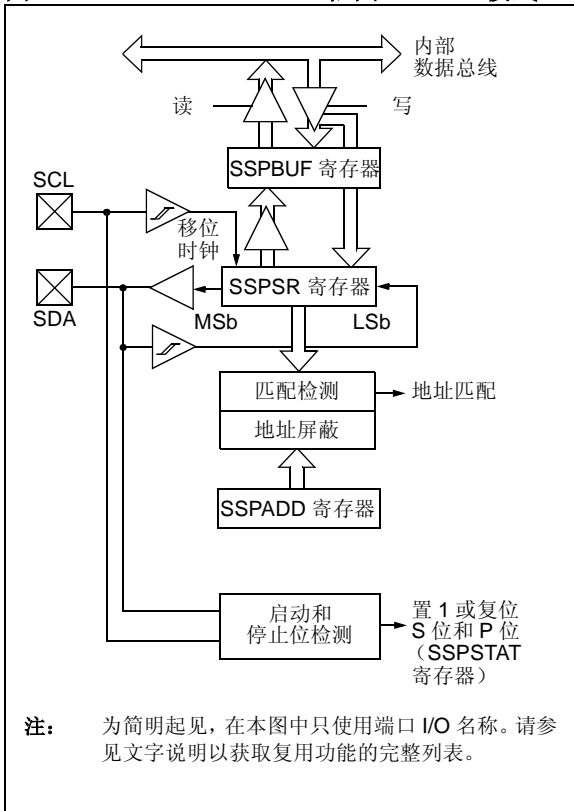
MSSP 模块工作在 I²C 模式时，可以实现所有的主控和从动功能（包括广播呼叫支持），并且硬件上提供起始位和停止位的中断来判断总线何时空闲（多主机功能）。MSSP 模块实现了标准模式规范以及 7 位和 10 位寻址。

有两个引脚用于数据传输：

- 串行时钟（SCL）——RC3/SCK/SCL
- 串行数据（SDA）——RC4/SDI/SDA

用户必须通过将 TRISC<4:3> 位置 1 将上述引脚配置为输入或输出引脚。

图 17-7: MSSP 框图 (I²C™ 模式)



17.4.1 寄存器

MSSP 模块有 6 个寄存器用于 I²C 操作。这些寄存器包括：

- MSSP 控制寄存器 1 (SSPCON1)
- MSSP 控制寄存器 2 (SSPCON2)
- MSSP 状态寄存器 (SSPSTAT)
- 串行接收 / 发送缓冲寄存器 (SSPBUF)
- MSSP 移位寄存器 (SSPSR) ——不可直接访问
- MSSP 地址寄存器 (SSPADD)

SSPCON1、SSPCON2 和 SSPSTAT 是在 I²C 模式下的控制寄存器和状态寄存器。SSPCON1 和 SSPCON2 寄存器是可读写的。SSPSTAT 的低 6 位是只读的，而高 2 位是可读写的。

SSPSR 是用来将数据移入或移出的移位寄存器。SSPBUF 是缓冲寄存器，可用于缓存读写的数据字节。

当 MSSP 被配置为工作在 I²C 从动模式下时，SSPADD 寄存器将保存从器件的地址。当 MSSP 工作在主控模式下时，SSPADD 的低 7 位用作波特率发生器的重载值。

接收数据时，SSPSR 和 SSPBUF 共同构成一个双重缓冲接收器。当 SSPSR 接收到一个完整的字节之后，该字节会被送入 SSPBUF，同时将中断标志位 SSPIF 置 1。

在数据发送过程中，SSPBUF 不是双重缓冲的，对 SSPBUF 的写操作将同时写入 SSPBUF 和 SSPSR。

PIC18F2423/2523/4423/4523

寄存器 17-3: **SSPSTAT: MSSP 状态寄存器 (I²C™ 模式)**

R/W-0	R/W-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0
SMP	CKE	D/A	P ⁽¹⁾	S ⁽¹⁾	R/W ^(2,3)	UA	BF
bit 7						bit 0	

图注:

R = 可读位 W = 可写位 U = 未实现位, 读为 0
 -n = POR 值 1 = 置 1 0 = 清零 x = 未知

- bit 7 **SMP:** 斜率控制位
在 主控或从动模式下:
 1 = 标准速度模式下禁止斜率控制 (100 kHz 和 1 MHz)
 0 = 高速模式下使能斜率控制 (400 KHz)
- bit 6 **CKE:** SMBus 选择位
在 主控或从动模式下:
 1 = 使能 SMBus 特定输入
 0 = 禁止 SMBus 特定输入
- bit 5 **D/A:** 数据 / 地址位
在 主控模式下:
 保留。
在 从动模式下:
 1 = 表示上一个接收或发送的字节是数据
 0 = 表示上一个接收或发送的字节是地址
- bit 4 **P:** 停止位 ⁽¹⁾
 1 = 表示上一次检测到停止位
 0 = 上一次未检测到停止位
- bit 3 **S:** 起始位 ⁽¹⁾
 1 = 表示上一次检测到起始位
 0 = 上一次未检测到起始位
- bit 2 **R/W:** 读 / 写信息位 ^(2,3)
在 从动模式下:
 1 = 读
 0 = 写
在 主控模式下:
 1 = 正在进行发送
 0 = 不在进行发送
- bit 1 **UA:** 更新地址位 (仅用于 10 位从动模式)
 1 = 表示用户需要更新 SSPADD 寄存器中的地址
 0 = 不需要更新地址
- bit 0 **BF:** 缓冲器满状态位
在 发送模式下:
 1 = SSPBUF 已满
 0 = SSPBUF 为空
在 接收模式下:
 1 = SSPBUF 已满 (不包括 $\overline{\text{ACK}}$ 和停止位)
 0 = SSPBUF 为空 (不包括 $\overline{\text{ACK}}$ 和停止位)

- 注**
- 1: 该位在复位及 SSPEN 清零时被清零。
 - 2: 该位保存最后一个地址匹配后的 R/W 位信息。该位仅在从地址匹配到下一个起始位、停止位或非 $\overline{\text{ACK}}$ 位之间有效。
 - 3: 将该位与 SEN、RSEN、PEN、RCEN 或 ACKEN 进行或运算将指示 MSSP 是否处于有效模式。

PIC18F2423/2523/4423/4523

寄存器 17-4: SSPCON1: MSSP 控制寄存器 1 (I²C™ 模式)

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
WCOL	SSPOV	SSPEN	CKP	SSPM3	SSPM2	SSPM1	SSPM0
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

bit 7

WCOL: 写冲突检测位

在主控发送模式下:

1 = 当 I²C 不满足启动发送数据的条件时, 试图向 SSPBUF 寄存器写入数据 (必须用软件清零)

0 = 未发生冲突

在从动发送模式下:

1 = 正在发送前一个字时, 又有数据写入 SSPBUF 寄存器 (必须用软件清零)

0 = 未发生冲突

在接收模式 (主控或从动模式) 下:

该位是无关位。

bit 6

SSPOV: 接收溢出指示位

在接收模式下:

1 = SSPBUF 寄存器仍保存前一字节时, 接收到一个新的字节 (必须用软件清零)

0 = 无溢出

在发送模式下:

在发送模式下, 该位是无关位。

bit 5

SSPEN: 主同步串口使能位

1 = 使能串口并将 SDA 和 SCL 引脚配置为串口引脚⁽¹⁾

0 = 禁止串口并将上述引脚配置为 I/O 端口引脚⁽¹⁾

bit 4

CKP: SCK 释放控制位

在从动模式下:

1 = 释放时钟

0 = 保持时钟低电平 (时钟延长), 用来确保数据建立时间

在主控模式下:

在此模式下未使用。

bit 3-0

SSPM3:SSPM0: 主同步串口模式选择位

1111 = I²C 从动模式, 10 位地址, 并允许起始位和停止位中断

1110 = I²C 从动模式, 7 位地址, 并允许起始位和停止位中断

1011 = I²C 由固件控制的主控模式 (从器件空闲)

1000 = I²C 主控模式, 时钟 = Fosc/(4 * (SSPADD + 1))

0111 = I²C 从动模式, 10 位地址

0110 = I²C 从动模式, 7 位地址

此处未列出的位组合被保留或只用于 SPI 模式。

注 1: 当该位被使能时, 必须将 SDA 和 SCL 引脚正确配置为输入或输出引脚。

PIC18F2423/2523/4423/4523

寄存器 17-5: **SSPCON2: MSSP 控制寄存器 2 (I²C™ 模式)**

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
GCEN	ACKSTAT	ACKDT/ ADMSK5	ACKEN ⁽¹⁾ / ADMSK4	RCEN ⁽¹⁾ / ADMSK3	PEN ⁽¹⁾ / ADMSK2	RSEN ⁽¹⁾ / ADMSK1	SEN ⁽¹⁾
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位 W = 可写位 U = 未实现位, 读为 0
 -n = POR 值 1 = 置 1 0 = 清零 x = 未知

- bit 7 **GCEN:** 广播呼叫使能位 (仅用于从动模式)
 1 = 当 SSPSR 接收到广播呼叫地址 (0000h) 时允许中断
 0 = 禁止广播呼叫地址
- bit 6 **ACKSTAT:** 应答状态位 (仅用于主控发送模式)
 1 = 未收到来自从器件的应答
 0 = 收到来自从器件的应答
- bit 5 **ACKDT/ADMSK5:** 应答数据位
在主控接收模式下: (2)
 1 = 无应答
 0 = 应答
在从动模式下:
 1 = 使能 ADD5 的地址屏蔽
 0 = 禁止 ADD5 的地址屏蔽
- bit 4 **ACKEN/ADMSK4:** 应答序列使能位
在主控接收模式下: (1)
 1 = 在 SDA 和 SCL 引脚上发起应答序列, 并发送 ACKDT 数据位。由硬件自动清零。
 0 = 应答序列空闲
在从动模式下:
 1 = 使能 ADD4 的地址屏蔽
 0 = 禁止 ADD4 的地址屏蔽
- bit 3 **RCEN/ADMSK3:** 接收使能位
在主控接收模式下: (1)
 1 = 使能 I²C 接收模式
 0 = 接收空闲
在从动模式下:
 1 = 使能 ADD3 的地址屏蔽
 0 = 禁止 ADD3 的地址屏蔽
- bit 2 **PEN/ADMSK2:** 停止条件使能位
在主控模式下: (1)
 1 = 在 SDA 和 SCL 引脚上发起停止条件。由硬件自动清零。
 0 = 停止条件空闲
在从动模式下:
 1 = 使能 ADD2 的地址屏蔽
 0 = 禁止 ADD2 的地址屏蔽

注 1: 对于 ACKEN、RCEN、PEN、RSEN 和 SEN 位: 如果 I²C 模块处于激活状态, 这些位不能被置 1 (不支持多任务处理), 并且也不能写入 SSPBUF (或禁止写 SSPBUF)。
 2: 当用户在接收结束发起一个应答序列时发送该值。

PIC18F2423/2523/4423/4523

寄存器 17-5: SSPCON2: MSSP 控制寄存器 2 (I²C™ 模式) (续)

- bit 1 **RSEN/ADMSK1:** 重复启动条件使能位
在主控模式下: (1)
1 = 在 SDA 和 SCL 引脚上发起重复启动条件。由硬件自动清零。
0 = 重复启动条件空闲
在从动模式下 (7 位地址模式):
1 = 使能 ADD1 的地址屏蔽
0 = 禁止 ADD1 的地址屏蔽
在从动模式下 (10 位地址模式):
1 = 使能 ADD1 和 ADD0 的地址屏蔽
0 = 禁止 ADD1 和 ADD0 的地址屏蔽
- bit 0 **SEN:** 启动条件使能 / 延长使能位 (1)
在主控模式下:
1 = 在 SDA 和 SCL 引脚上发起启动条件。由硬件自动清零。
0 = 启动条件空闲
在从动模式下:
1 = 为从动发送和从动接收使能时钟延长
0 = 时钟延长被禁止

- 注 1: 对于 ACKEN、RCEN、PEN、RSEN 和 SEN 位: 如果 I²C 模块处于激活状态, 这些位不能被置 1 (不支持多任务处理), 并且也不能写入 SSPBUF (或禁止写 SSPBUF)。
2: 当用户在接收结束发起一个应答序列时发送该值。

寄存器 17-6: SSPADD: MSSP 地址寄存器 (1)

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
ADD7	ADD6	ADD5	ADD4	ADD3	ADD2	ADD1	ADD0
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位 W = 可写位 U = 未实现位, 读为 0
-n = POR 值 1 = 置 1 0 = 清零 x = 未知

bit 7-0 **ADD<7:0>:** MSSP 地址位

- 注 1: I²C™ 从动模式下的 MSSP 地址寄存器。I²C 主控模式下的 MSSP 波特率寄存器。

17.4.2 工作原理

通过将 MSSP 使能位 SSPEN (SSPCON<5>) 置 1, 可使能 MSSP 模块。

SSPCON1 寄存器用于控制 I²C 工作。可通过设置模式选择位 (SSPCON<3:0>) 选择以下 I²C 模式之一:

- I²C 主控模式, 时钟 = (Fosc/4) x (SSPAD + 1)
- I²C 从动模式 (7 位地址)
- I²C 从动模式 (10 位地址)
- I²C 从动模式 (7 位地址), 允许起始位和停止位中断
- I²C 从动模式 (10 位地址), 允许起始位和停止位中断
- I²C 固件控制的主控模式, 从器件空闲

如果通过将相应的 TRISC 位置 1 将 SCL 和 SDA 引脚编程为输入引脚, 那么在 SSPEN 位置 1 时选择任何 I²C 模式, 将强制这两个引脚漏极开路。要确保此模块正常工作, 必须为 SCL 和 SDA 引脚外接上拉电阻。

17.4.3 从动模式

在从动模式下, SCL 引脚和 SDA 引脚必须被配置为输入 (TRISC<4:3> 置 1)。必要时 MSSP 模块将使用输出数据改写输入状态 (从发送器)。

I²C 从动模式硬件总是在地址匹配时产生中断。地址屏蔽功能可使硬件在多个地址发生匹配时 (7 位寻址模式下多达 31 个, 10 位寻址模式下多达 63 个) 产生中断。用户也可以通过模式选择位, 选择使用起始位或停止位中断。

当地址匹配或在地址匹配后发送的数据被接收时, 硬件会自动产生一个应答 (ACK) 脉冲, 并把当前 SSPSR 寄存器中接收到的值装入 SSPBUF 寄存器。

只要满足下列条件之一, MSSP 模块就不会产生此 ACK 脉冲:

- 在接收到数据前, 缓冲器满位 BF (SSPSTAT<0>) 被置 1。
- 在接收到数据前, 溢出位 SSPOV (SSPCON1<6>) 被置 1。

在上述情况下, SSPSR 寄存器的值不会载入 SSPBUF, 但是 SSPIF (PIR1<3>) 会置 1。BF 位是通过读取 SSPBUF 寄存器清零的, 而 SSPOV 位是通过软件清零的。

为确保正常工作, SCL 时钟输入必须满足最小高电平和最小低电平时间要求。在时序参数 100 和参数 101 中显示了 I²C 规范的高低电平时间和对 MSSP 模块的具体要求。

17.4.3.1 寻址

一旦 MSSP 模块被使能, 它就会等待启动条件出现。启动条件出现后, 8 位数据被移入 SSPSR 寄存器。在时钟 (SCL) 线的上升沿采样所有的输入位。寄存器 SSPSR<7:1> 的值和 SSPADD 寄存器的值比较, 该比较是在第 8 个时钟 (SCL) 脉冲下降沿进行的。如果地址匹配, 并且 BF 位和 SSPOV 位都被清零, 会发生下列事件:

1. SSPSR 寄存器值被装入 SSPBUF 寄存器。
2. 将缓冲器满标志位 BF 置 1。
3. 产生 ACK 脉冲。
4. 在第 9 个 SCL 脉冲的下降沿, MSSP 中断标志位 SSPIF (PIR1<3>) 置 1 (如果允许中断, 则产生中断)。

在 10 位地址模式下, 从器件需要接收两个地址字节。第一个地址字节的高 5 位将指定这是否是一个 10 位地址。R/W 位 (SSPSTAT<2>) 必须指定写操作, 这样从器件才能接收到第二个地址字节。对于 10 位地址, 第一个字节应该是 “11110 A9 A8 0”, 其中 “A9” 和 “A8” 是该地址的两个最高有效位。10 位地址模式的操作步骤如下, 其中 7-9 步是针对从发送器而言的。

1. 接收地址的第一个 (高) 字节 (SSPIF 位、BF 位和 UA 位 (SSPSTAT<1>) 置 1)。
2. 用地址的第二个 (低) 字节更新 SSPADD 寄存器 (UA 位清零并释放 SCL 时钟线)。
3. 读 SSPBUF 寄存器 (BF 位清零) 并将标志位 SSPIF 清零。
4. 接收地址的第二个 (低) 字节 (SSPIF 位、BF 位和 UA 位置 1)。
5. 使用地址的第一个 (高) 字节更新 SSPADD 寄存器。如果匹配的话就释放 SCL 时钟线, 这将清零 UA 位。
6. 读 SSPBUF 寄存器 (BF 位清零) 并将标志位 SSPIF 清零。
7. 接收重复启动条件。
8. 接收地址的第一个 (高) 字节 (SSPIF 位和 BF 位置 1)。
9. 读 SSPBUF 寄存器 (BF 位清零) 并将标志位 SSPIF 清零。

PIC18F2423/2523/4423/4523

17.4.3.2 地址屏蔽

将地址的某一位屏蔽意味着该位可为任意值，此时会响应两个地址并产生一个中断。由于同一时刻可以有多个地址位被屏蔽，所以在 7 位模式下可响应多达 31 个地址，而在 10 位模式下则可响应多达 63 个地址（见例 17-2）。

不管是否使用地址屏蔽，I²C 从器件的工作方式保持不变。但当使用地址屏蔽时，I²C 从器件能够应答多个地址并产生中断，此时需要通过查询 SSPBUF 来判断是哪一个地址引起的中断。

• 7 位地址模式

地址屏蔽位 ADMSK<5:1> 可用来屏蔽 SSPADD 寄存器中对应的地址位。如果 ADMSK 的某位是有效的（ADMSK<n> = 1），则对应的地址位可以被忽略（ADD<n> = x）。对于发出地址应答的模块来讲，只要与没被屏蔽的地址位匹配就可以了。

• 10 位地址模式

地址屏蔽位 ADMSK<5:2> 可用来屏蔽 SSPADD 寄存器中对应的地址位，而 ADMSK<1> 可以同时屏蔽地址的低 2 位 ADD<1:0>。如果 ADMSK 的某位是有效的（ADMSK<n> = 1），则对应的地址位可以被忽略（ADD<n> = x）。需要注意的是，尽管在 10 位寻址模式下，地址的高 2 位也要用到 SSPADD 寄存器中的某些位，但地址屏蔽位对这两个位不起作用，地址屏蔽位只会影响地址低字节中的位。

- | |
|----------------------------------|
| 注 1: ADMSK<1> 屏蔽地址的低 2 位。 |
| 2: 地址屏蔽不会对地址的高 2 位起作用。 |

例 17-2: 地址屏蔽

7 位寻址模式:

SSPxADD<7:1> = 1010 0000

ADMSK<5:1> = 00 111

可被应答的地址 = 0xA0, 0xA2, 0xA4, 0xA6
0xA8, 0xAA, 0xAC, 0xAE

10 位寻址模式:

SSPxADD<7:0> = 1010 0000（此例中地址高 2 位被忽略，因为它们不受影响。）

ADMSK<5:1> = 00 111

可被应答的地址 = 0xA0, 0xA1, 0xA2, 0xA3
0xA4, 0xA5, 0xA6, 0xA7
0xA8, 0xA9, 0xAA, 0xAB
0xAC, 0xAD, 0xAE, 0xAF

地址高 2 位不受地址屏蔽的影响。

17.4.3.3 接收

当地址字节的 $\overline{R/\overline{W}}$ 位清零并发生地址匹配时，SSPSTAT 寄存器的 $\overline{R/\overline{W}}$ 位清零。接收的地址被装入 SSPBUF 寄存器，且 SDA 线保持低电平（ACK）。

当发生地址字节溢出时，则不会产生应答脉冲（ACK）。溢出条件是指 BF 位（SSPSTAT<0>）置 1，或者 SSPOV 位（SSPCON1<6>）置 1。

每个数据传输字节都会产生一个 MSSP 中断。标志位 SSPIF（PIR1<3>）必须用软件清零。通过 SSPSTAT 寄存器可以确定该字节的状态。

如果 SEN 被使能（SSPCON2<0> = 1），RC3/SCK/SCL 将在每个数据传输之后保持为低电平（时钟延长）。必须通过将 CKP 位（SSPCON1<4>）置 1 才能释放时钟。更多详细信息，请参见第 17.4.4 节“时钟延长”。

17.4.3.4 发送

当输入的地址字节的 $\overline{R/\overline{W}}$ 位置 1 并发生地址匹配时，SSPSTAT 寄存器的 $\overline{R/\overline{W}}$ 位置 1。接收到的地址被装入 SSPBUF 寄存器。ACK 脉冲在第 9 位时发送，同时不管 SEN 的值如何，RC3/SCK/SCL 引脚保持低电平（更多详细信息，请参见第 17.4.4 节“时钟延长”）。通过延长时钟，主器件只有在从器件准备好发送数据时，才发出另一个时钟脉冲。发送的数据必须被装入 SSPBUF 寄存器，同时也被装入 SSPSR 寄存器。然后，应该通过将 CKP（SSPCON1<4>）置 1 来使能 RC3/SCK/SCL 引脚。8 个数据位在 SCL 输入的下降沿被移出。这可确保在 SCL 为高电平期间 SDA 信号是有效的（图 17-10）。

来自接收器的 \overline{ACK} 脉冲将在第 9 个 SCL 输入脉冲的上升沿锁存。如果 SDA 信号为高电平（无 ACK 应答信号），那么表示数据传输已完成。在这种情况下，如果从器件锁存了 \overline{ACK} ，将复位从动逻辑（复位 SSPSTAT 寄存器），同时从器件监视下一个起始位的出现。如果 SDA 线为低电平（ACK），则必须将下一个要发送的数据装入 SSPBUF 寄存器。同样，必须通过将 CKP 位置 1 来使能 RC3/SCK/SCL 引脚。

每传输一个数据字节都会产生一个 MSSP 中断。SSPIF 位必须用软件清零，SSPSTAT 寄存器用于确定字节的状态。SSPIF 位在第 9 个时钟脉冲的下降沿被置 1。

PIC18F2423/2523/4423/4523

图 17-8: I²C™ 从动模式接收时序 (SEN = 0, 7 位地址)

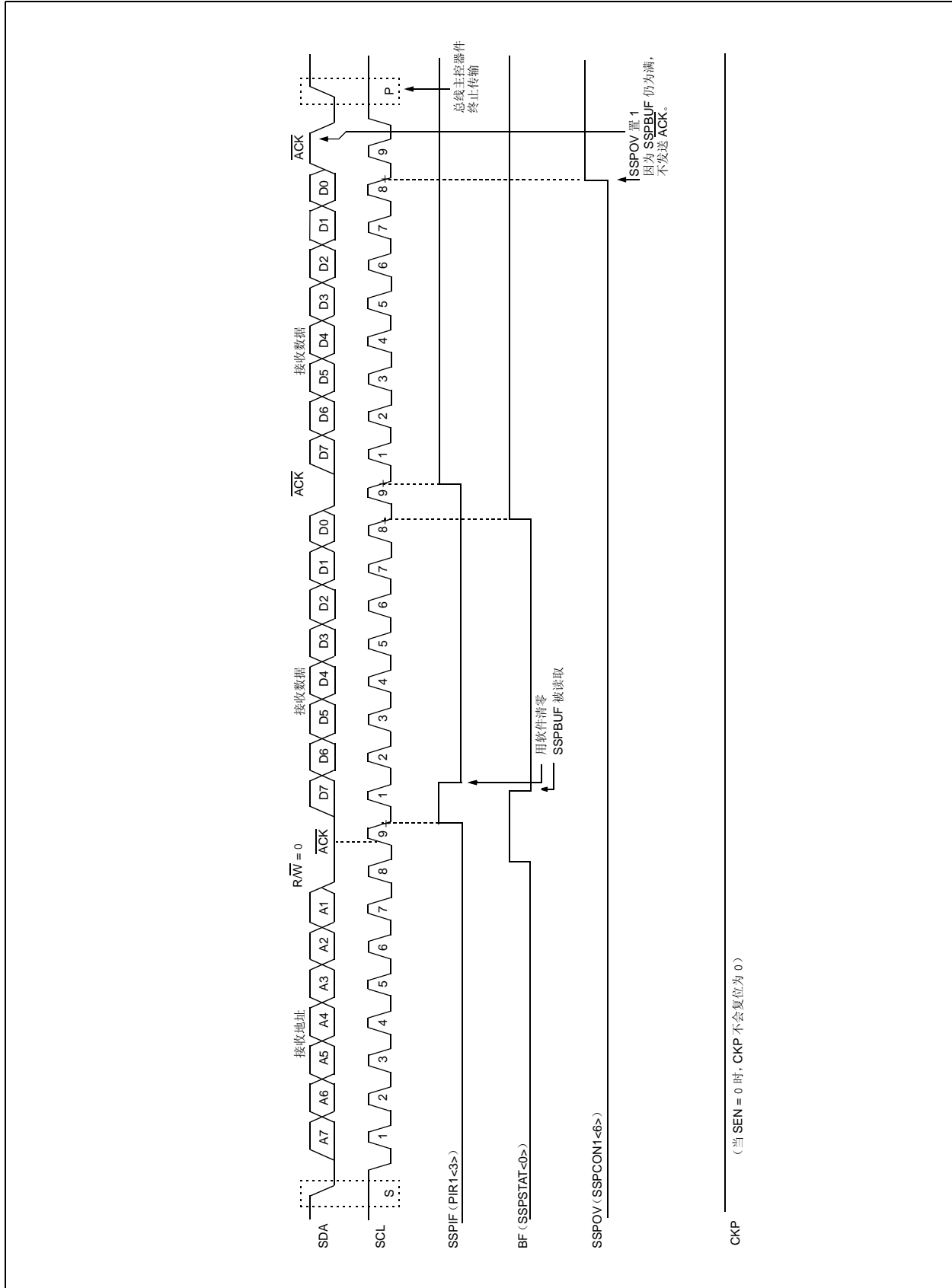
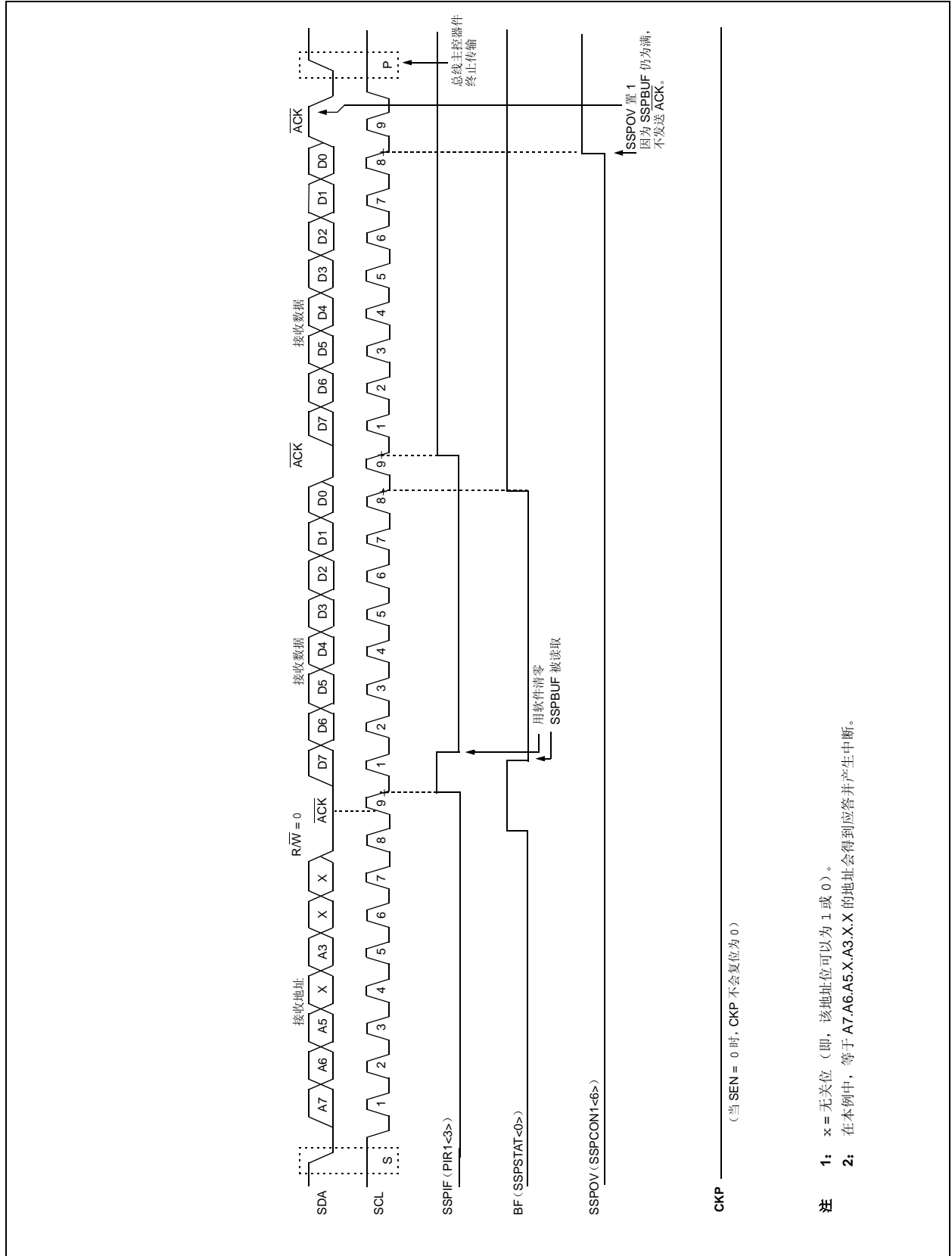


图 17-9: I²C™ 从动模式接收时序 (SEN = 0 且 ADMSK<5:1> = 01011, 7 位地址)



PIC18F2423/2523/4423/4523

图 17-10: I²C™ 从动模式发送时序 (7 位地址)

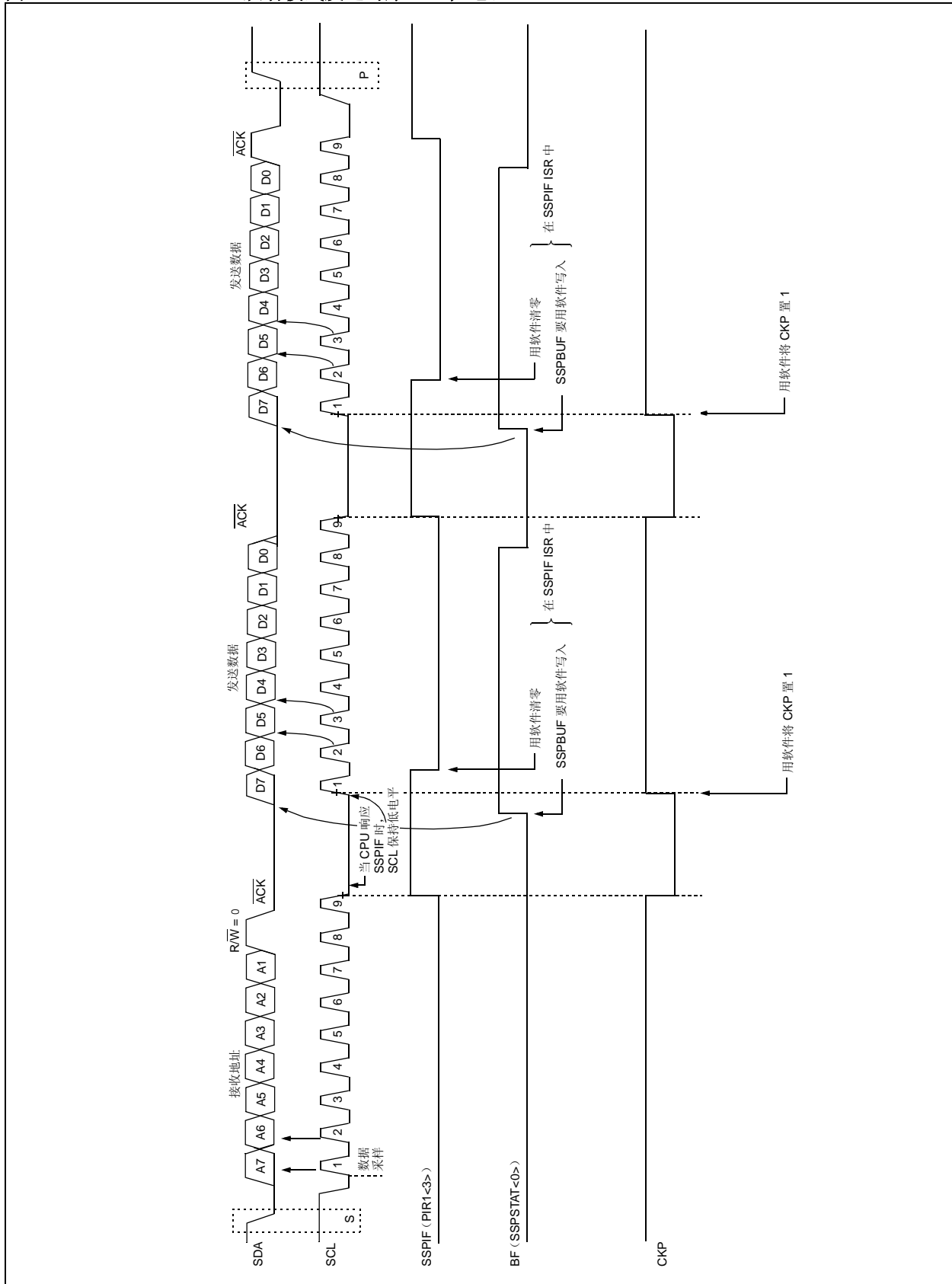
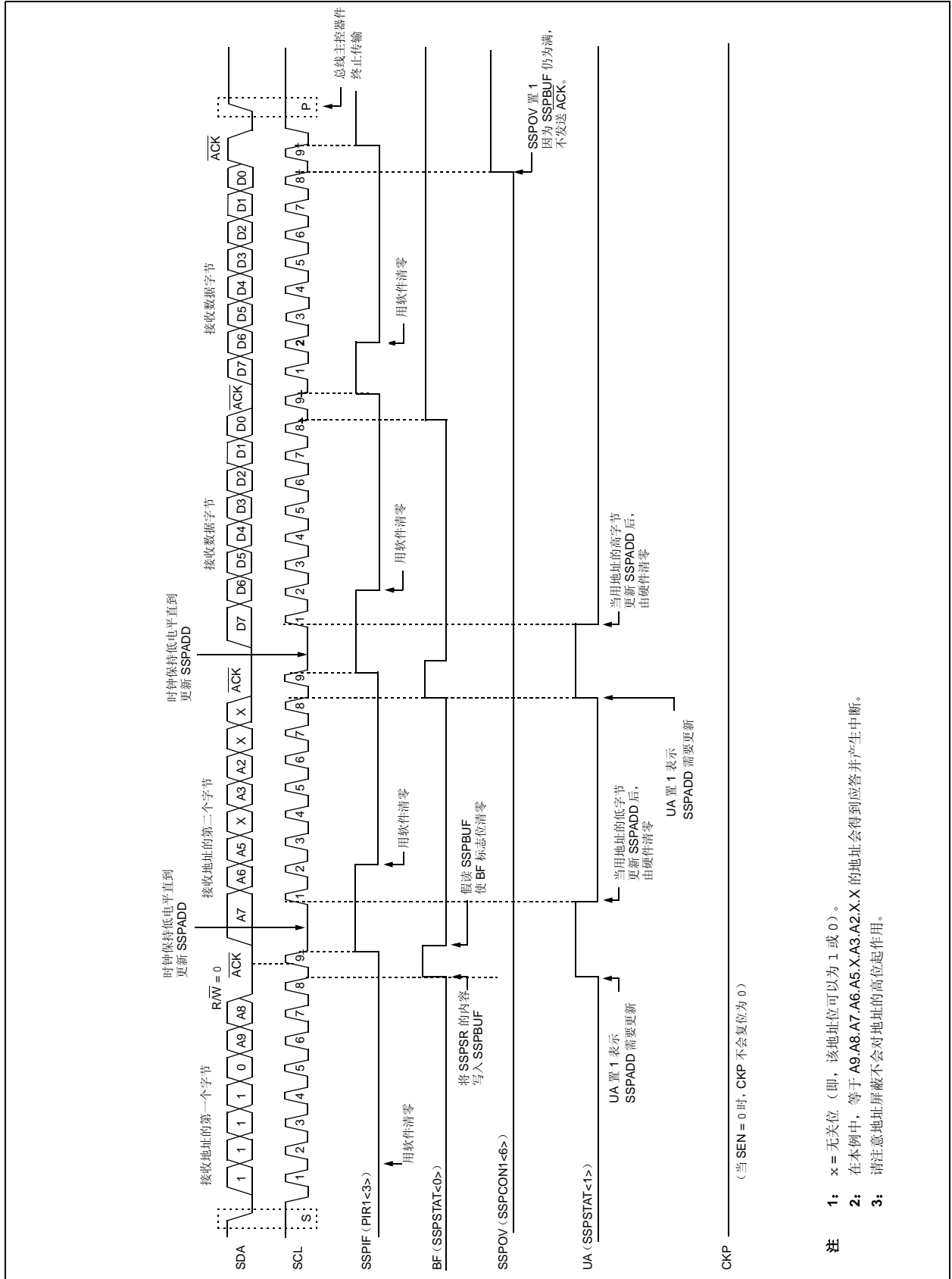


图 17-11: I²C™ 从动模式接收时序 (SEN = 0 且 ADMSK<5:1> = 01001, 10 位地址)



PIC18F2423/2523/4423/4523

图 17-12: I²C™ 从动模式接收时序 (SEN = 0, 10 位地址)

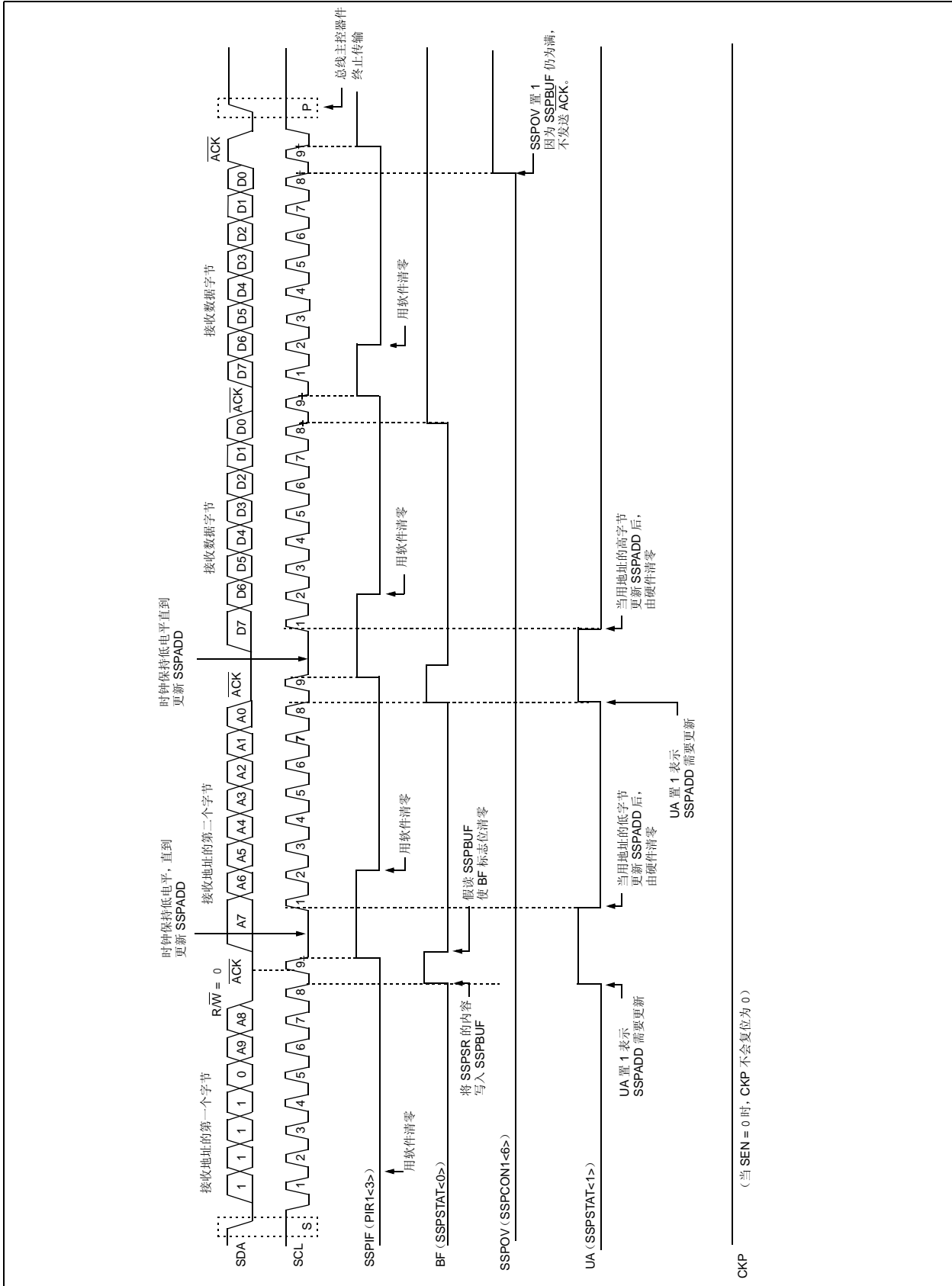
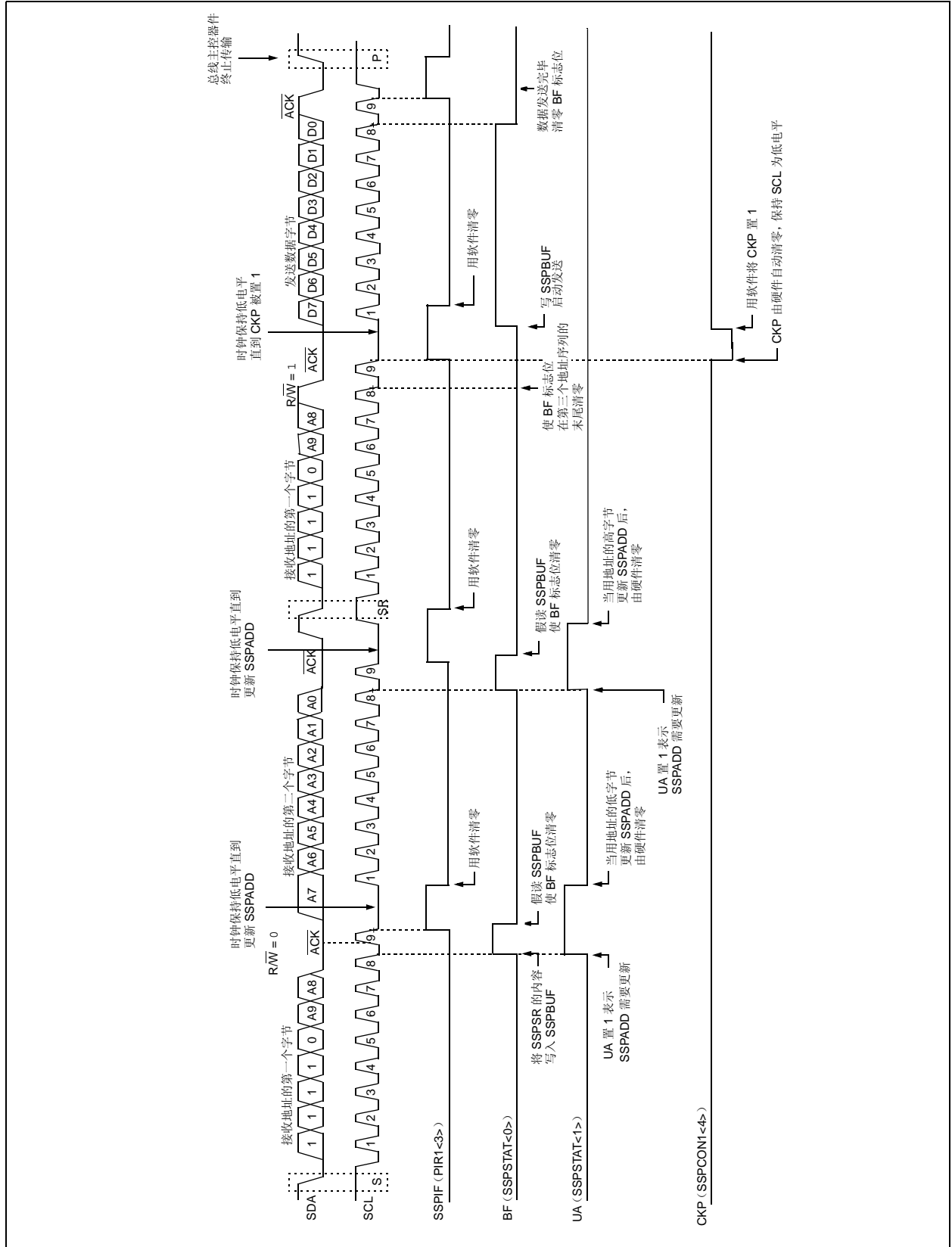


图 17-13: I²C™ 从动模式发送时序 (10 位地址)



PIC18F2423/2523/4423/4523

17.4.4 时钟延长

7位和10位从动模式均能在发送序列期间实现自动时钟延长。

SEN 位 (SSPCON2<0>) 允许在接收期间使能时钟延长。将 SEN 置 1 将使 SCL 引脚在每个数据接收序列的末尾保持低电平。

17.4.4.1 7 位从动接收模式 (SEN = 1) 的时钟延长

在 7 位从动接收模式下, 如果在 $\overline{\text{ACK}}$ 序列末的第 9 个时钟的下降沿将 BF 位置 1, 则 SSPCON1 寄存器中的 CKP 位就会自动清零, 强制 SCL 输出保持在低电平。CKP 被清零会将 SCL 线拉为低电平。在允许继续接收之前, 必须在用户的中断服务程序中将 CKP 位置 1。保持 SCL 信号为低电平, 用户可以在主器件发起另一个接收序列之前, 有时间处理中断服务程序并读取 SSPBUF 的内容。这将防止发生缓冲器溢出 (见图 17-15)。

- 注 1:** 如果用户在第 9 个时钟的下降沿到来之前读取了 SSPBUF 的内容, 使得 BF 位被清零, 那么 CKP 位就不会被清零, 也不会发生时钟延长。
- 2:** 不管 BF 位的状态如何, CKP 位都可以用软件置 1。为避免溢出, 在下一个接收序列开始之前, 用户要注意在中断服务程序中清零 BF 位。

17.4.4.2 10 位从动接收模式 (SEN = 1) 的时钟延长

在 10 位从动接收模式下, 在地址序列中会自动发生时钟延长, 但是 CKP 位不会被清零。在这期间, 如果 UA 位在第 9 个时钟之后置 1, 将启动时钟延长。UA 位在接收到 10 位地址的高字节后被置 1, 然后接收 10 位地址的第二个字节并清零 R/W 位。在更新 SSPADD 的时候释放时钟线。如同 7 位模式一样, 在每个数据接收序列中会发生时钟延长。

- 注:** 如果用户在第 9 个时钟的下降沿出现之前查询 UA 位, 并通过更新 SSPADD 寄存器清零 UA 位, 而且在此之前用户没有读取 SSPBUF 寄存器使 BF 位清零, 则 CKP 位的电平仍然不会被拉低。基于 BF 位状态的时钟延长仅在数据序列中出现, 不会出现在地址序列中。

17.4.4.3 7 位从动发送模式的时钟延长

如果 BF 位被清零, 7 位从动发送模式将通过在第 9 个时钟的下降沿出现后清零 CKP 位, 以实现时钟延长。上述情形与 SEN 位的状态无关。

用户的中断服务程序必须先将 CKP 位置 1 才可以继续发送。在保持 SCL 信号为低电平期间, 用户在主器件发起另一个发送序列之前, 将有时处理中断服务程序并装入 SSPBUF 的内容 (见图 17-10)。

- 注 1:** 如果用户在第 9 个时钟的下降沿之前就装入 SSPBUF 的内容, 使得 BF 位置 1, 那么 CKP 位就不会被清零, 也不会发生时钟延长。
- 2:** 不管 BF 位的状态如何, CKP 位都可以用软件置 1。

17.4.4.4 10 位从动发送模式的时钟延长

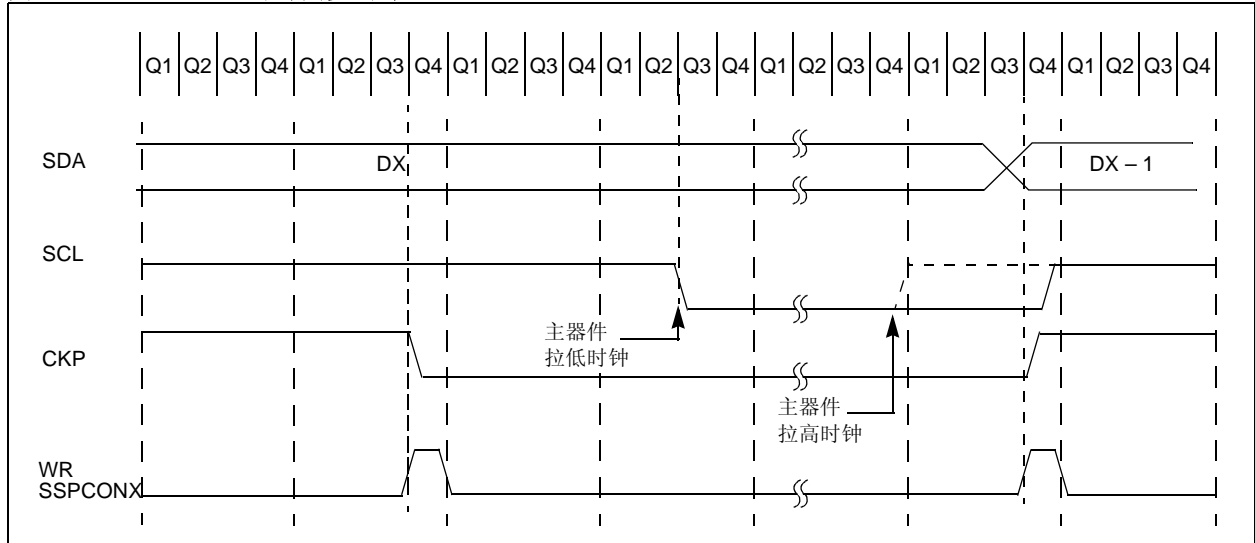
在 10 位从动发送模式下, 在前两个地址序列中由 UA 位的状态来控制时钟延长, 正如同 10 位从动接收模式一样。头两个地址后跟着第三个地址序列, 该地址序列包含 10 位地址的高位和被置为 1 的 R/W 位。在执行完第三个地址序列后, UA 位不置 1, 此时模块配置为发送模式, 由 BF 标志位控制时钟延长, 正如 7 位从动发送模式一样 (见图 17-13)。

17.4.4.5 时钟同步和 CKP 位

当 CKP 位被清零时，SCL 输出被强制为 0。然而，将 CKP 位清零不会将 SCL 输出拉为低电平，除非已经采样到 SCL 输出为低电平。因此，CKP 位不会将 SCL 信号拉为低电平，除非外部 I²C 主器件将 SCL 线拉低。

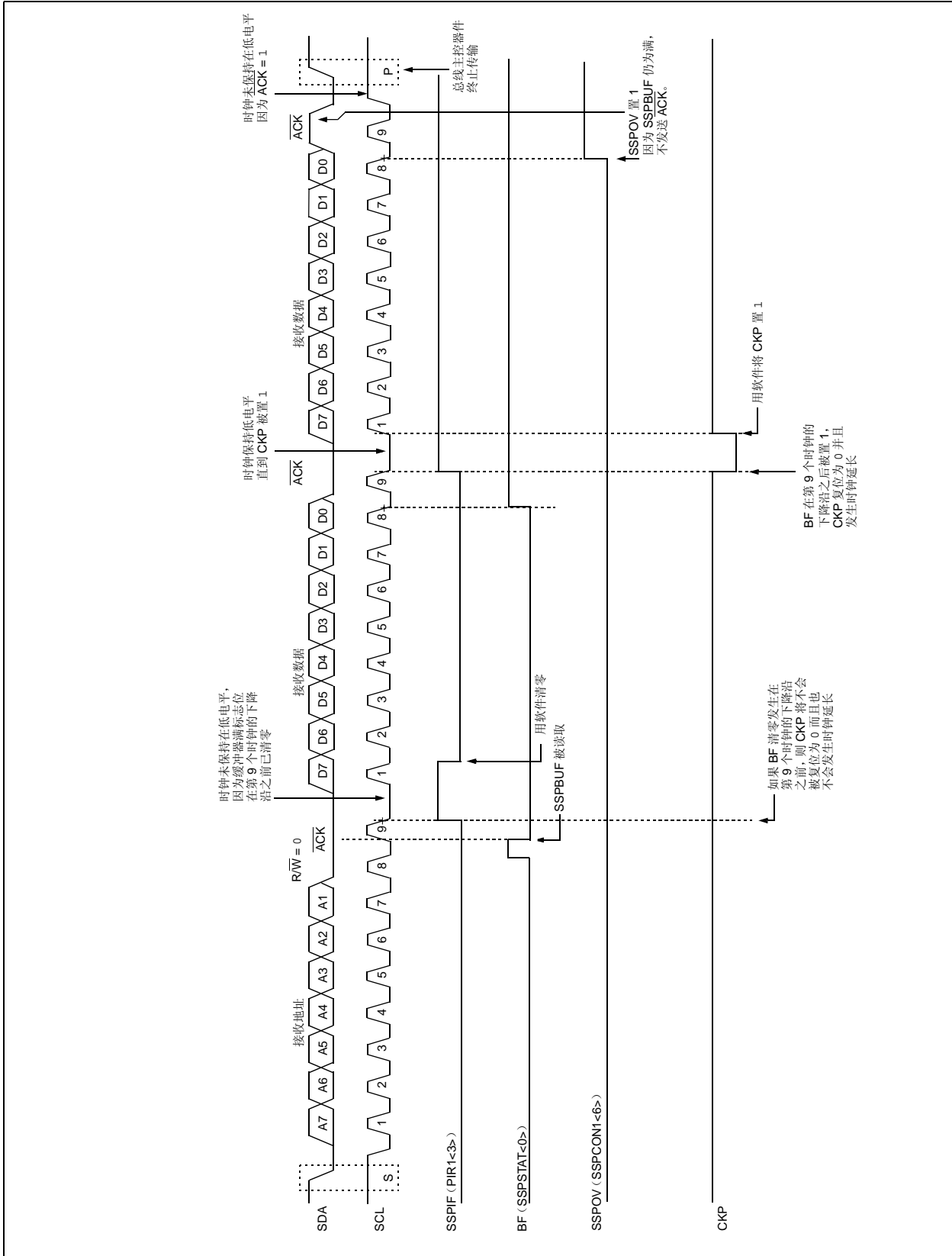
SCL 输出将保持低电平，直到 CKP 位置 1 且 I²C 总线上的其他器件将 SCL 电平拉高为止。这可以确保对 CKP 位的写操作不会违反 SCL 的最小高电平时间要求（见图 17-14）。

图 17-14: 时钟同步时序



PIC18F2423/2523/4423/4523

图 17-15: I²C™ 从动模式接收时序 (SEN = 1, 7 位地址)



PIC18F2423/2523/4423/4523

17.4.5 支持广播呼叫地址

在 I²C 总线的寻址过程中，通常由启动条件后的第一个字节决定主器件将寻址哪个从器件。但广播呼叫地址例外，它能寻址所有器件。当使用这个地址时，理论上所有的器件都应该发送一个应答信号来响应。

广播呼叫地址是由 I²C 协议为特定目的保留的 8 个地址之一。它由全 0 组成，且 R/W = 0。

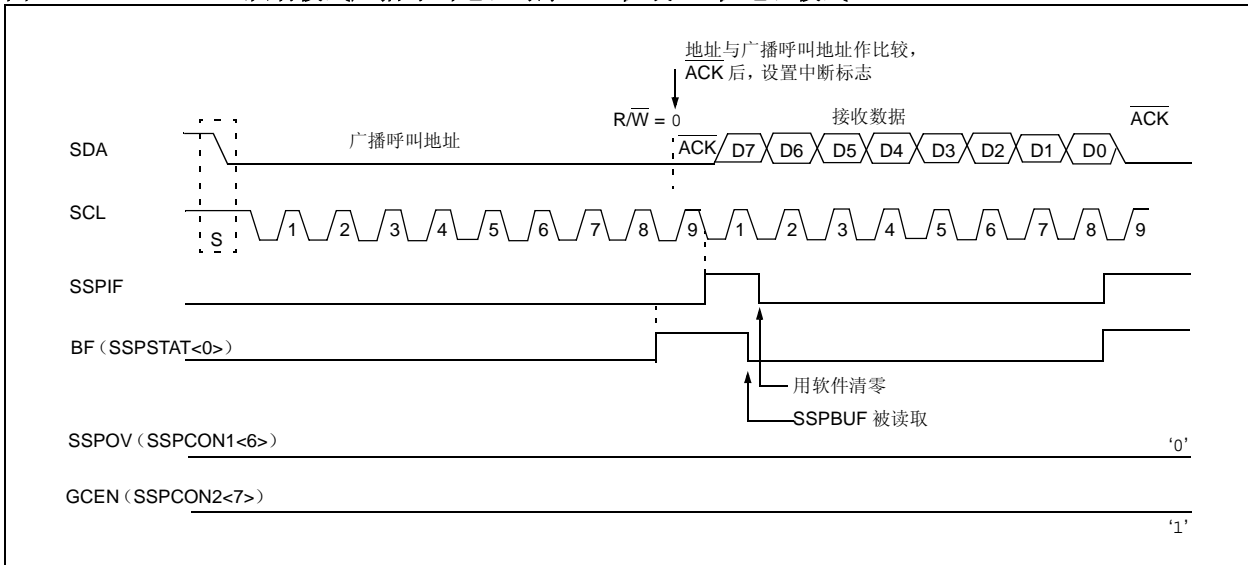
当使能广播呼叫使能位 (GCEN) (SSPCON2<7> 置 1) 时，即可识别广播呼叫地址。检测到起始位后，8 位数据会被移入 SSPSR，同时将该地址与 SSPADD 进行比较。它还会与硬件中固定的广播呼叫地址进行比较。

如果与广播呼叫地址匹配，SSPSR 的值将被传输到 SSPBUF，BF 标志位 (第 8 位) 置 1，并且 SSPIF 中断标志位在第 9 位 (ACK 位) 的下降沿置 1。

当中断得到响应时，可以通过读取 SSPBUF 的内容来检查中断源。该值可用于判断是特定器件的地址还是一个广播呼叫地址。

在 10 位模式下，需要更新 SSPADD 来匹配地址的后半部分，同时 UA 位置 1 (SSPSTAT<1>)。如果 GCEN 位置 1 时采样到广播呼叫地址，同时从器件被配置为 10 位地址模式，则不再需要地址的后半部分，也不会将 UA 位置 1，从器件将在应答后开始接收数据 (图 17-17)。

图 17-17: 从动模式广播呼叫地址时序 (7 位或 10 位地址模式)



17.4.6 主控模式

通过将 SSPCON1 中的相应 SSPM 位置 1 和清零，同时将 SSPEN 位置 1，可以使能主控模式。在 主控模式下，SCL 和 SDA 信号线由 MSSP 硬件控制。

主控模式通过在检测到启动和停止条件时产生中断来工作。停止 (P) 位和启动 (S) 位在复位或禁止 MSSP 模块时清零。当 P 位置 1 时，可以获得 I²C 总线的控制权；否则，P 位和 S 位都清零，总线处于空闲状态。

在固件控制的主控模式下，用户代码根据启动和停止位条件执行所有的 I²C 总线操作。

一旦使能主控模式，用户即可选择以下 6 项操作：

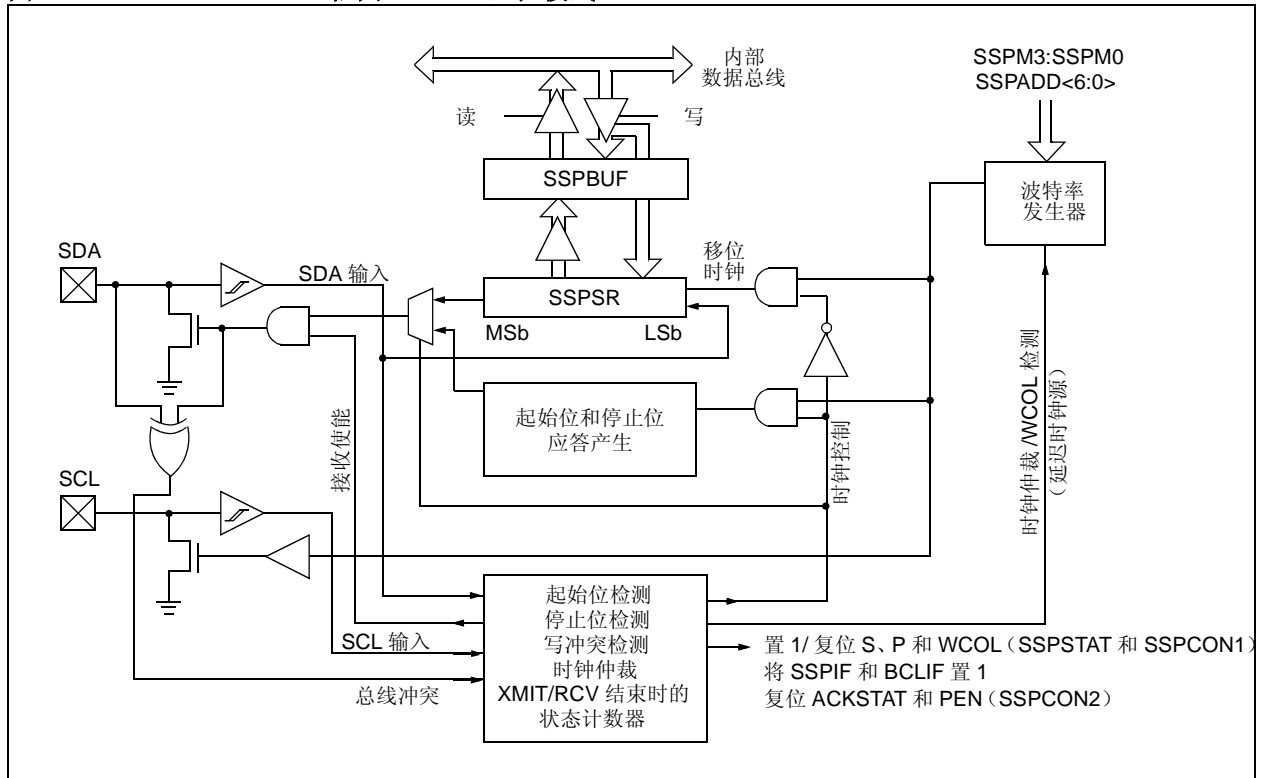
1. 在 SDA 和 SCL 上发出一个启动条件。
2. 在 SDA 和 SCL 上发出一个重复启动条件。
3. 写入 SSPBUF 寄存器，启动数据 / 地址的发送。
4. 配置 I²C 端口以接收数据。
5. 在接收数据字节末尾产生应答信号。
6. 在 SDA 和 SCL 上产生停止条件。

注： 当配置为 I²C 主控模式时，MSSP 模块不允许事件排队。例如，在启动条件结束前，不允许用户立即写 SSPBUF 寄存器以启动传输。在这种情况下，将不会执行写 SSPBUF，WCOL 位将被置 1，这表明没有发生对 SSPBUF 的写操作。

下列事件会使 MSSP 中断标志位 SSPIF 置 1（如果允许 MSSP 中断，则产生中断）

- 启动条件
- 停止条件
- 数据字节发送 / 接收
- 应答发送
- 重复启动

图 17-18: MSSP 框图 (I²C™ 主控模式)



17.4.6.1 I²C 主控模式工作原理

主器件产生所有串行时钟脉冲和启动 / 停止条件。以停止条件或重复启动条件结束传输过程。因为重复启动条件也是下一次串行传输的开始，因此 I²C 总线一直保持不被释放的状态。

在主控发送器模式下，串行数据通过 SDA 输出，而串行时钟由 SCL 输出。发送的第一个字节包括作为接收方的从器件地址（7 位）和读 / 写（R/W）位。在这种情况下，R/W 位将是逻辑 0。一次发送 8 位串行数据。每发送一个字节，会收到一个应答位。输出启动和停止条件，表明串行传输的开始和结束。

在主控接收模式下，发送的第一个字节包括作为发送方的从器件地址（7 位）和 R/W 位。在这种情况下，R/W 将是逻辑 1。因此，发送的第一个字节是一个 7 位从器件地址，后面跟 1 表示接收。串行数据通过 SDA 接收，而串行时钟由 SCL 输出。每次接收 8 位串行数据。每接收到一个字节，都会发送一个应答位。启动和停止条件分别代表发送的开始和结束。

在 I²C 模式下，将使用 SPI 模式中使用的波特率发生器将 SCL 时钟频率设置为 100 kHz、400 kHz 或 1 MHz。更多详细信息，请参见第 17.4.7 节“波特率”。

下面是一个典型的发送过程：

1. 用户通过将启动使能位 SEN（SSPCON2<0>）置 1，产生启动条件。
2. SSPIF 置 1。在进行下一步操作前，MSSP 模块将等待所需的启动时间。
3. 用户将从器件地址装入 SSPBUF 进行发送。
4. 器件地址从 SDA 引脚移出，直到发送完所有 8 位地址数据。
5. MSSP 模块移入来自从器件的 ACK 位，并将它的值写入 SSPCON2 寄存器（SSPCON2<6>）。
6. MSSP 模块在第 9 个时钟周期的末尾将 SSPIF 置 1，产生一个中断。
7. 用户将 8 位数据装入 SSPBUF。
8. 数据从 SDA 引脚移出，直到发送完所有 8 位数据。
9. MSSP 模块移入来自从器件的 ACK 位，并将它的值写入 SSPCON2 寄存器（SSPCON2<6>）。
10. MSSP 模块在第 9 个时钟周期的末尾将 SSPIF 置 1，产生一个中断。
11. 用户通过将停止使能位 PEN（SSPCON2<2>）置 1 产生停止条件。
12. 一旦停止条件完成，将产生一个中断。

17.4.7 波特率

在 I²C 主控模式下，波特率发生器（Baud Rate Generator, BRG）的重载值位于 SSPADD 寄存器的低 7 位（图 17-19）。当发生对 SSPBUF 的写操作时，波特率发生器将自动开始计数。BRG 会递减计数至 0，然后停止直到再次发生重载。BRG 计数器会在每个指令周期（T_{cy}）中的 Q2 和 Q4 时钟周期上进行两次递减计数。在 I²C 主控模式下，会自动重载 BRG。

如果指定操作完成（即，在传输的最后一个数据位后面跟着 ACK），内部时钟将自动停止计数，SCL 引脚将保持在其最后的状态。

表 17-3 给出了不同的指令周期下的时钟频率以及装入 SSPADD 的 BRG 值。

图 17-19: 波特率发生器框图

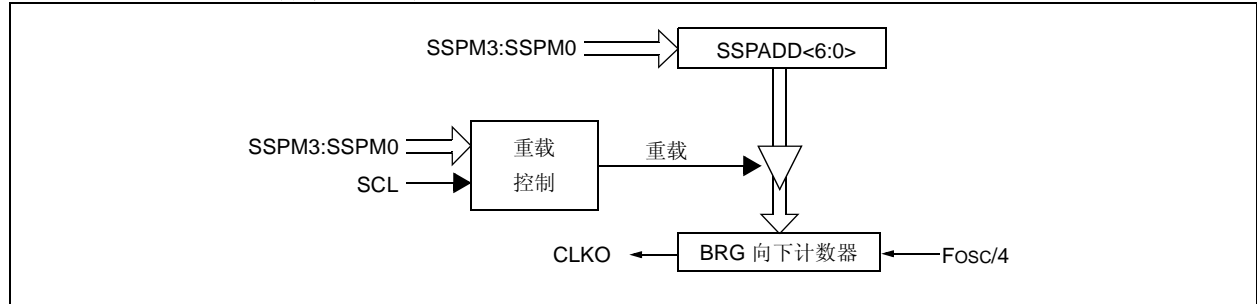


表 17-3: 使用 BRG 的 I²C™ 时钟频率

F _{cy}	F _{cy} *2	BRG 值	F _{SCL} (两次 BRG 计满返回)
10 MHz	20 MHz	18h	400 kHz ⁽¹⁾
10 MHz	20 MHz	1Fh	312.5 kHz
10 MHz	20 MHz	63h	100 kHz
4 MHz	8 MHz	09h	400 kHz ⁽¹⁾
4 MHz	8 MHz	0Ch	308 kHz
4 MHz	8 MHz	27h	100 kHz
1 MHz	2 MHz	02h	333 kHz ⁽¹⁾
1 MHz	2 MHz	09h	100 kHz
1 MHz	2 MHz	00h	1 MHz ⁽¹⁾

注 1: 虽然 I²C 接口各方面都不符合 400 kHz I²C 规范（该规范适用于大于 100 kHz 的频率），但在需要较高频率的应用场合可以慎重使用。

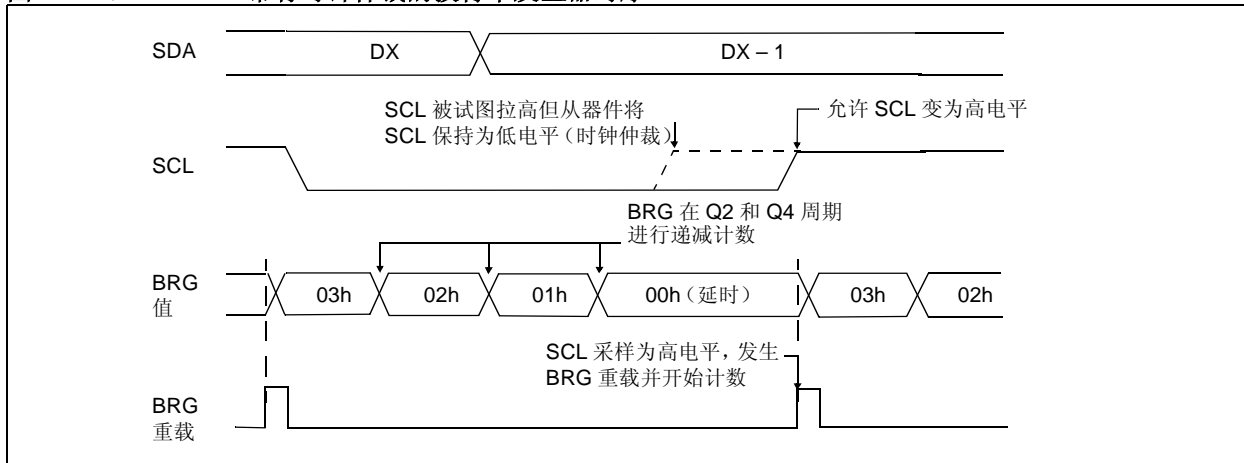
PIC18F2423/2523/4423/4523

17.4.7.1 时钟仲裁

如果在任何接收、发送或重复启动 / 停止条件过程中，主器件拉高了 SCL 引脚（允许 SCL 引脚悬空为高电平），就会发生时钟仲裁。如果允许 SCL 引脚悬空为高电平，波特率发生器（BRG）将暂停计数直到实际采样

到 SCL 引脚为高电平为止，然后波特率发生器将被重新装入 SSPADD<6:0> 的值并开始计数。这可以保证当外部器件将时钟拉低时，SCL 在至少一个 BRG 周期内保持高电平（图 17-20）。

图 17-20: 带有时钟仲裁的波特率发生器时序



17.4.8 I²C 主控模式启动条件时序

要产生启动条件，用户应将启动条件使能位 SEN (SSPCON2<0>) 置 1。当 SDA 和 SCL 引脚采样为高电平时，波特率发生器重新装入 SSPADD<6:0> 的内容并开始计数。如果波特率发生器发生超时 (TBRG) 时，SCL 和 SDA 都采样为高电平，则 SDA 引脚被驱动为低电平。当 SCL 为高电平时，将 SDA 驱动为低电平将产生启动条件，并使 S 位 (SSPSTAT<3>) 置 1。随后波特率发生器重新装入 SSPADD<6:0> 的内容并恢复计数。当波特率发生器再次超时 (TBRG) 时，SEN 位 (SSPCON2<0>) 将自动被硬件清零，波特率发生器暂停工作，SDA 保持低电平，启动条件结束。

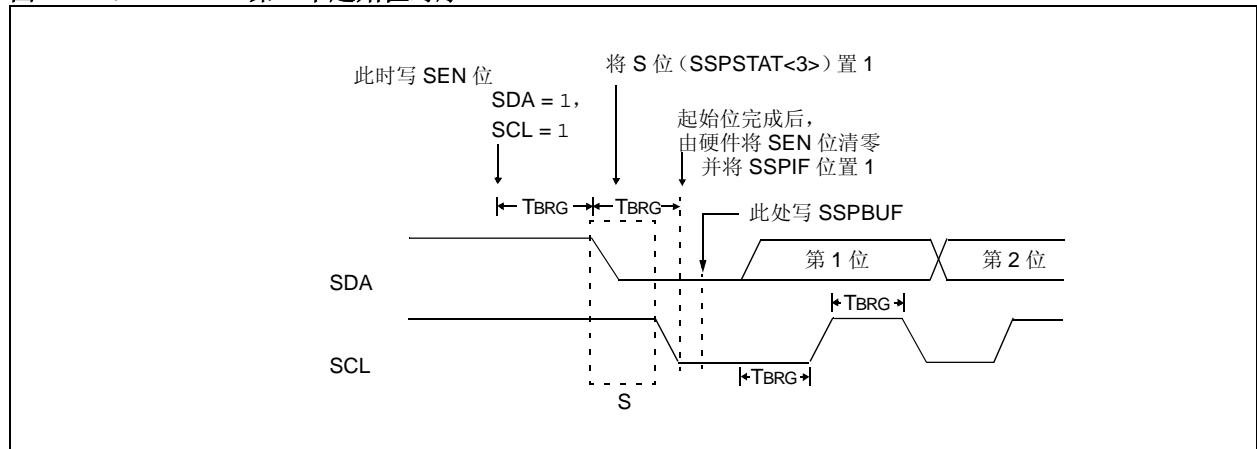
注： 如果在启动条件开始时，SDA 和 SCL 引脚已经采样为低电平，或者在启动条件期间，SCL 在 SDA 线被驱动为低电平之前已经采样为低电平，则会发生总线冲突。总线冲突中断标志位 BCLIF 置 1，启动条件中止，I²C 模块复位到空闲状态。

17.4.8.1 WCOL 状态标志

如果用户在启动序列进行过程中试图写 SSPBUF，则 WCOL 将置 1，缓冲器的内容不会改变 (写操作无效)。

注： 由于不允许事件排队，在启动条件结束之前，不能写 SSPCON2 的低 5 位。

图 17-21: 第一个起始位时序



PIC18F2423/2523/4423/4523

17.4.9 I²C 主控模式重复启动条件时序

将 RSEN 位 (SSPCON2<1>) 编程为高电平, 并且 I²C 逻辑模块处于空闲状态时, 就会产生重复启动条件。当 RSEN 位置 1 时, SCL 引脚被拉为低电平。当 SCL 引脚采样为低电平时, 波特率发生器装入 SSPADD<5:0> 的值, 并开始计数。在该波特率发生器计数周期 (TBRG) 内 SDA 引脚被释放 (其引脚电平被拉高)。当波特率发生器超时, 如果 SDA 采样为高电平, SCL 引脚将被拉高。当 SCL 被采样为高电平时, 波特率发生器重新装入 SSPADD<6:0> 的值并开始计数。SDA 和 SCL 必须在一个计数周期 TBRG 内采样为高电平。接下来, 在一个 TBRG 中, 将 SDA 引脚驱动为低电平 (SDA = 0), 同时 SCL 保持高电平。然后 RSEN 位 (SSPCON2<1>) 将自动清零, 这次波特率发生器不会重载, SDA 引脚保持低电平。一旦在 SDA 和 SCL 引脚上检测到启动条件, S 位 (SSPSTAT<3>) 将被置 1。直到波特率发生器发生超时后, SSPIF 位才会置 1。

- 注 1:** 有其他事件在进行时, 编程设置对 RSEN 无效。
- 注 2:** 在重复启动条件期间, 下列事件将会导致总线冲突:
- 当 SCL 由低电平变为高电平时, SDA 采样为低电平。
 - 在 SDA 被拉低之前, SCL 变为低电平。这表明另一个主器件正试图发送一个数据 1。

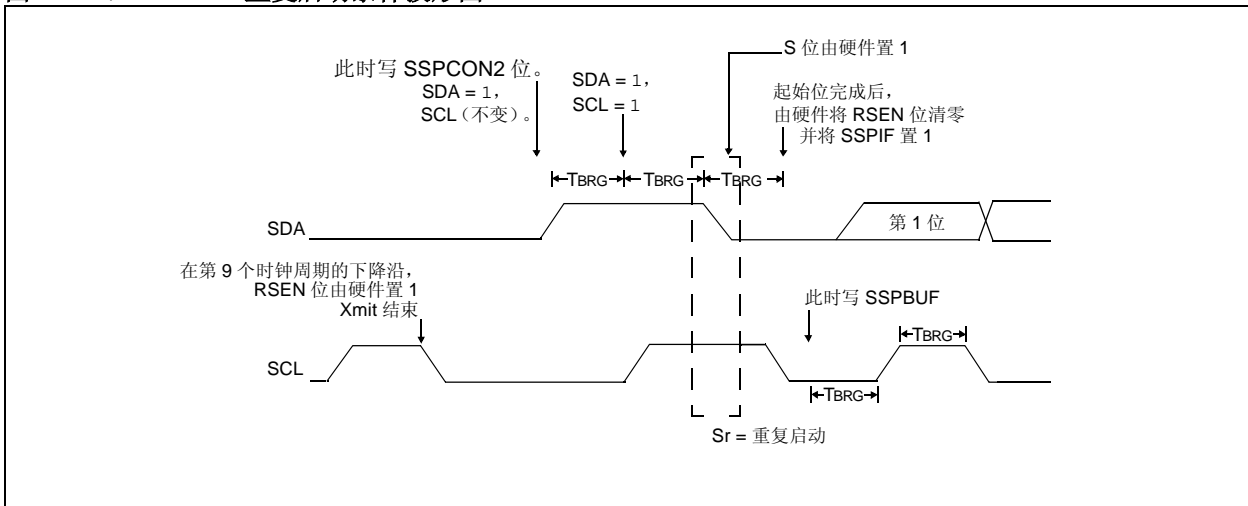
一旦 SSPIF 位被置 1, 用户便可以在 7 位地址模式下将 7 位地址, 或者在 10 位地址模式下将默认的第一个地址字节写入 SSPBUF。当发送完第一个 8 位数据并接收到一个 ACK 后, 用户可以发送另外 8 位地址 (10 位地址模式) 或 8 位数据 (7 位地址模式)。

17.4.9.1 WCOL 状态标志

如果用户在重复启动序列进行过程中试图写 SSPBUF, 则 WCOL 将置 1, 缓冲器的内容不会改变 (写操作无效)。

- 注:** 由于不允许事件排队, 在重复启动条件结束之前, 不能写 SSPCON2 的低 5 位。

图 17-22: 重复启动条件波形图



17.4.10 I²C 主控模式下的发送

发送一个数据字节、一个 7 位地址或一个 10 位地址的一半，都是通过写一个值到 SSPBUF 寄存器来实现的。该操作将使缓冲器满标志位 BF 置 1，波特率发生器开始计数，同时开始下一次发送。在 SCL 的下降沿有效后（见数据保持时间规范参数 106），地址 / 数据的每一位被移出至 SDA 引脚。在一个波特率发生器计满返回周期（TBRG）内，SCL 保持低电平。数据应该在 SCL 释放为高电平前保持有效（见数据建立时间规范参数 107）。当 SCL 引脚释放为高电平时，它将在一个 TBRG 内保持高电平状态。在此期间以及 SCL 的下一个下降沿之后的一段时间内，SDA 引脚上的数据必须保持稳定。在第 8 位数据被移出（第 8 个时钟周期的下降沿）之后，BF 标志位被清零，同时主器件释放 SDA。此时如果发生地址匹配或是数据被正确接收，被寻址的从器件将在第 9 个位时间发出一个 ACK 位作为响应。ACK 的状态在第 9 个时钟周期的下降沿写入 ACKDT 位。主器件接收到应答之后，应答状态位 ACKSTAT 会被清零。如果未收到应答，则该位被置 1。第 9 个时钟周期之后，SSPIF 位置 1，主控时钟（波特率发生器）暂停，直到下一个数据字节装入 SSPBUF，SCL 引脚保持低电平，SDA 保持不变（图 17-23）。

在写 SSPBUF 之后，地址的每一位在 SCL 的下降沿被移出，直至所有 7 位地址位和 R/W 位都被移出。在第 8 个时钟的下降沿，主器件将 SDA 引脚拉为高电平，以允许从器件发出一个应答响应。在第 9 个时钟的下降沿，主器件通过采样 SDA 引脚来判断地址是否被从器件识别。ACK 位的状态被装入 ACKSTAT 状态位（SSPCON2<6>）。在发送地址的第 9 个时钟下降沿之后，SSPIF 置 1，BF 标志位清零，波特率发生器关闭直到下一次写 SSPBUF，且 SCL 引脚保持低电平，允许 SDA 引脚悬空。

17.4.10.1 BF 状态标志

在发送模式下，BF 位（SSPSTAT<0>）在 CPU 写 SSPBUF 时置 1，在所有 8 位数据移出后清零。

17.4.10.2 WCOL 状态标志

如果用户在发送进行过程中试图写 SSPBUF（即，SSPSR 仍在移出数据字节），则 WCOL 将置 1，缓冲器的内容不会改变（写操作无效）。

WCOL 必须用软件清零。

17.4.10.3 ACKSTAT 状态标志

在发送模式下，当从器件发送应答响应（ACK = 0）时，ACKSTAT 位（SSPCON2<6>）清零；当从器件没有应答（ACK = 1）时，该位置 1。从器件在识别出其地址（包括广播呼叫地址）或正确接收数据后，会发出一个应答。

17.4.11 I²C 主控模式接收

通过编程接收使能位 RCEN（SSPCON2<3>）使能主控模式接收。

注： 将 RCEN 位置 1 前，MSSP 必须处于空闲状态，否则对 RCEN 位置 1 将无效。

波特率发生器开始计数，每次计满返回时，SCL 引脚的状态发生改变（由高变低或由低变高），数据被移入 SSPSR。第 8 个时钟的下降沿之后，接收使能标志位自动清零，SSPSR 的内容装入 SSPBUF，BF 标志位置 1，SSPIF 标志位置 1，波特率发生器暂停计数，且 SCL 保持为低电平。此时 MSSP 处于空闲状态，等待下一条命令。当 CPU 读缓冲器时，BF 标志位将自动清零。通过将应答序列使能位 ACKEN（SSPCON2<4>）置 1，用户可以在接收结束后发送应答位。

17.4.11.1 BF 状态标志

接收数据过程中，把地址或数据字节从 SSPSR 装入 SSPBUF 时，BF 位置 1。在读 SSPBUF 寄存器时将其清零。

17.4.11.2 SSPOV 状态标志

接收数据过程中，当 SSPSR 接收到 8 位数据时，SSPOV 位置 1，BF 标志位已经在上一次接收时置 1。

17.4.11.3 WCOL 状态标志

如果用户在接收进行过程中试图写 SSPBUF（即，SSPSR 仍在移入数据字节），则 WCOL 将置 1，缓冲器的内容不会改变（写操作无效）。

PIC18F2423/2523/4423/4523

图 17-23: I²C™ 主控模式发送波形图 (7 位或 10 位地址)

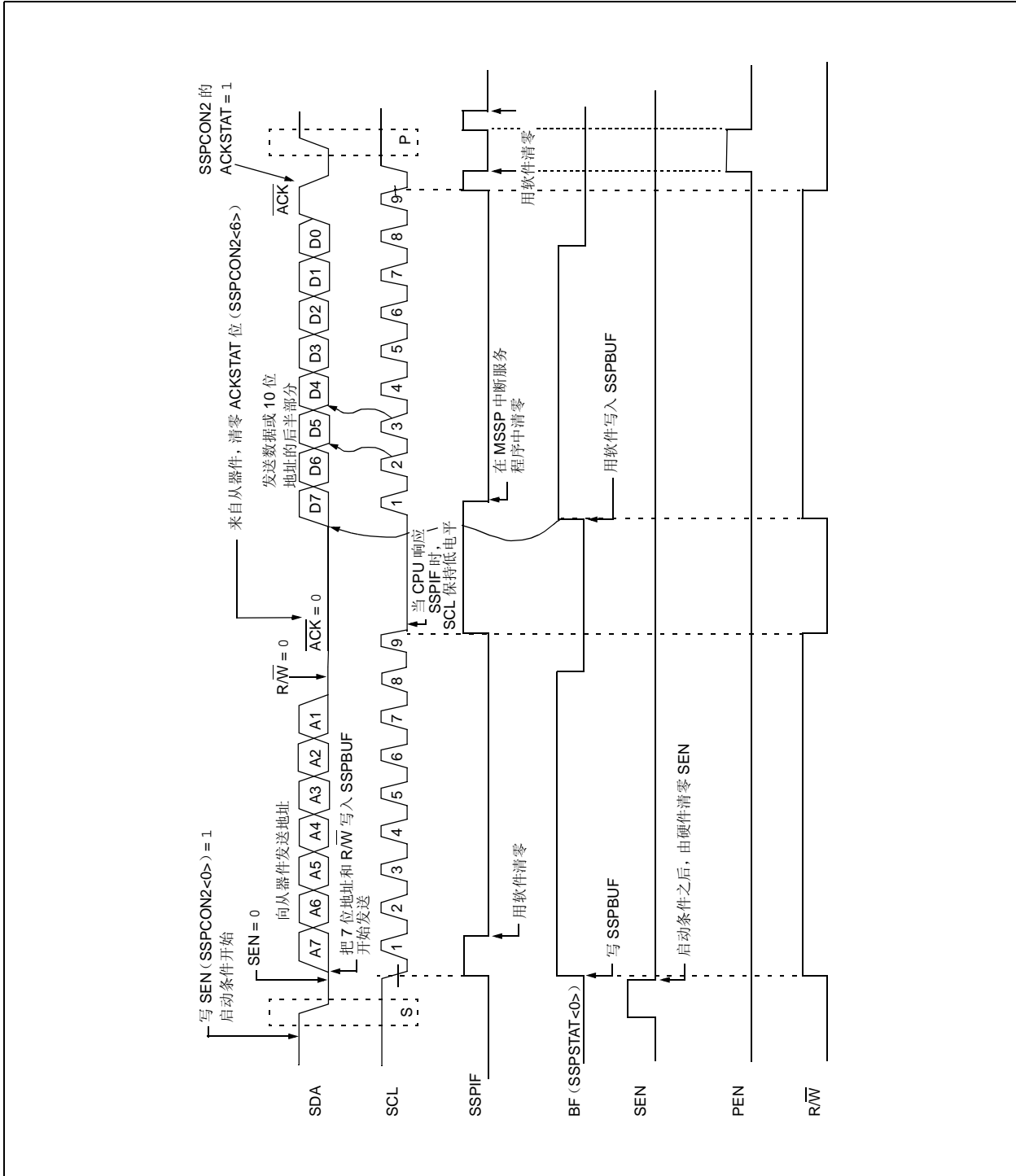
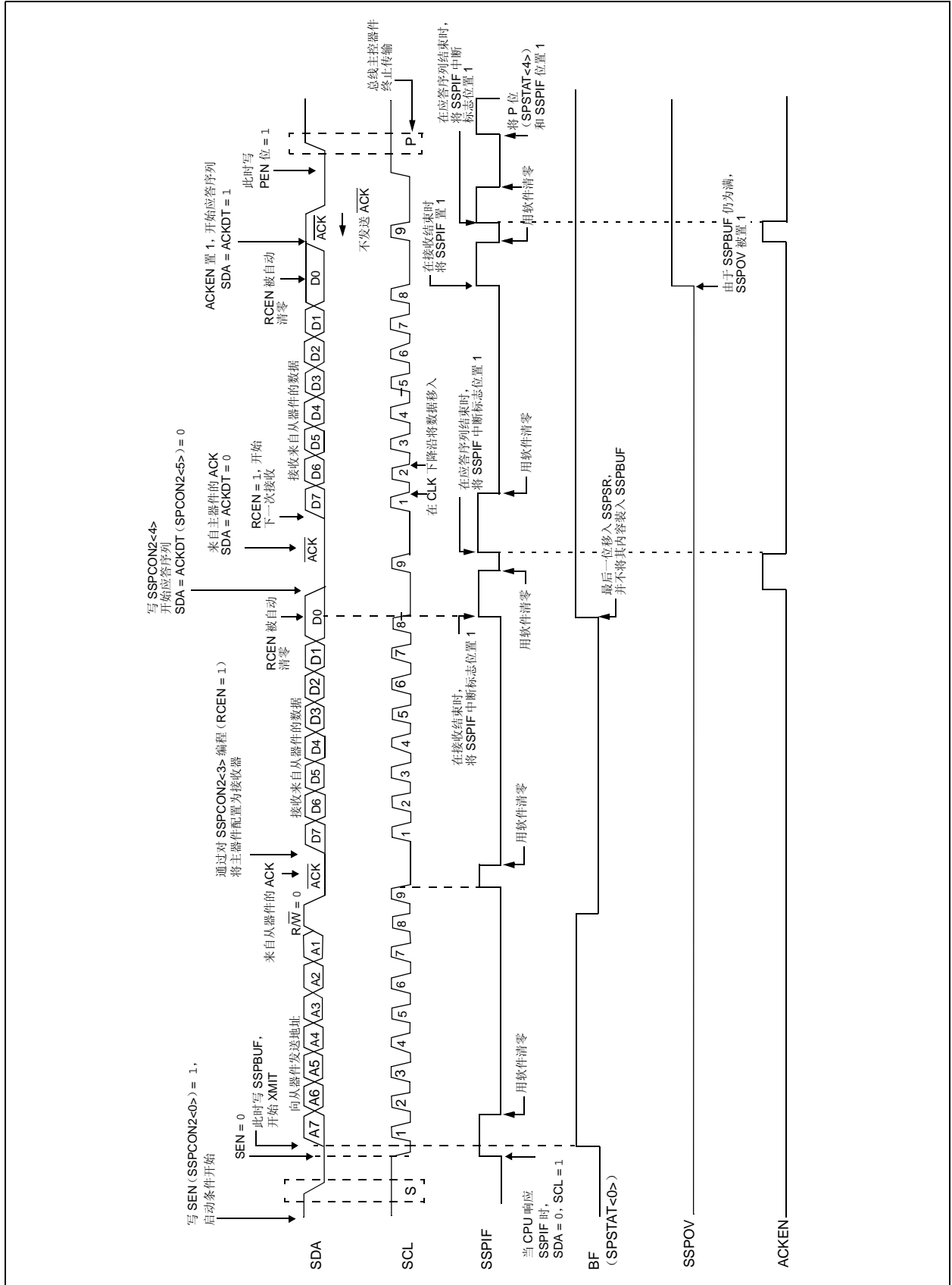


图 17-24: I²C™ 主控模式接收波形图 (7 位地址)



PIC18F2423/2523/4423/4523

17.4.12 应答序列时序

将应答序列使能位 $ACKEN$ ($SSPCON2<4>$) 置 1 即可使能应答序列。当该位被置 1 时, SCL 引脚被拉低, 应答数据位的内容输出到 SDA 引脚上。如果用户希望产生一个应答, 则应该将 $ACKDT$ 位清零。否则, 用户要在应答序列开始前将 $ACKDT$ 位置 1。然后波特率发生器进行一个周期 ($TBRG$) 的计数, 随后 SCL 引脚电平被拉高。当 SCL 引脚采样为高电平时 (时钟仲裁), 波特率发生器再进行一个 $TBRG$ 周期的计数。然后 SCL 引脚被拉低。在这之后, $ACKEN$ 位自动清零, 波特率发生器关闭, $MSSP$ 模块进入空闲模式 (图 17-25)。

17.4.12.1 WCOL 状态标志

如果用户在应答序列进行过程中试图写 $SSPBUF$, 则 $WCOL$ 将置 1, 缓冲器的内容不会改变 (写操作无效)。

17.4.13 停止条件时序

如果将停止序列使能位 PEN ($SSPCON2<2>$) 置 1, 则在接收 / 发送结束后, SDA 引脚上将产生停止位。在接收 / 发送结束时, SCL 引脚在第 9 个时钟的下降沿后保持低电平。当 PEN 位置 1 时, 主器件将 SDA 线置为低电平。当 SDA 线采样为低电平时, 波特率发生器被重载并递减计数至 0。当波特率发生器发生超时, SCL 引脚被拉为高电平, 在一个 $TBRG$ (波特率发生器计满返回周期) 之后, SDA 引脚将被拉高。当 SDA 引脚采样为高电平且 SCL 也是高电平时, P 位 ($SSPSTAT<4>$) 置 1。另一个 $TBRG$ 之后, PEN 位被清零, 同时 $SSPIF$ 位被置 1 (图 17-26)。

17.4.13.1 WCOL 状态标志

如果用户在停止序列进行过程中试图写 $SSPBUF$, 则 $WCOL$ 位将置 1, 缓冲器的内容不会改变 (写操作无效)。

图 17-25: 应答序列波形图

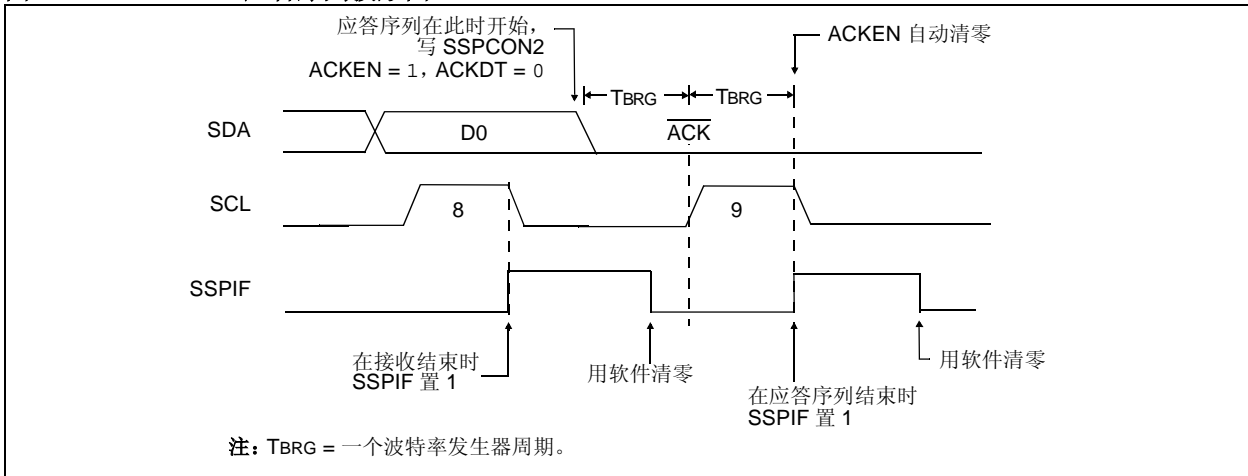
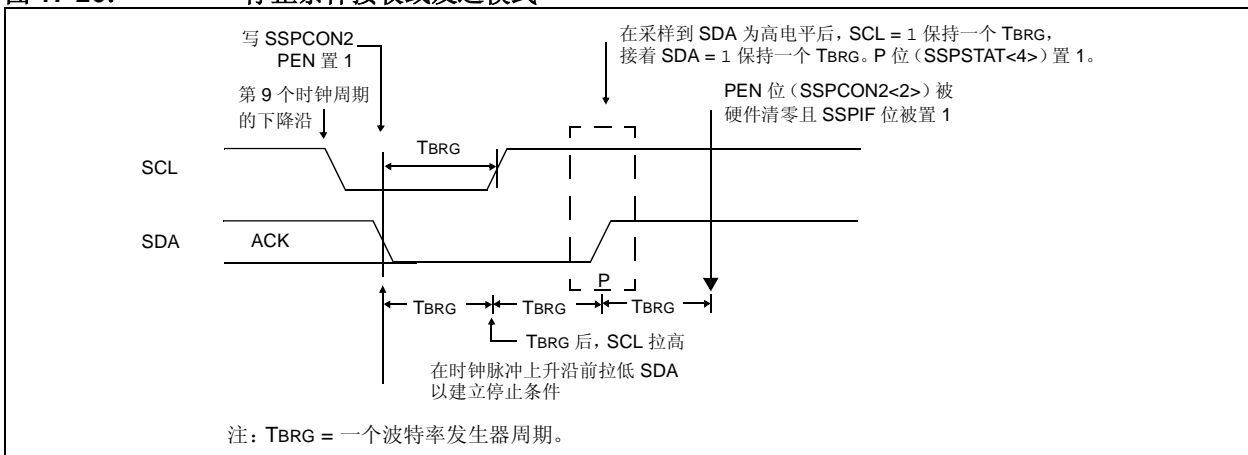


图 17-26: 停止条件接收或发送模式



17.4.14 休眠模式下的操作

在休眠模式下，I²C 模块能够接收地址或数据。并且在地址匹配或字节传输完成后，如果允许 MSSP 中断，将唤醒处理器。

17.4.15 复位的影响

复位会禁止 MSSP 模块并终止当前的数据传输。

17.4.16 多主机模式

在多主机模式下，在检测到启动和停止条件时将产生中断，这可以用于判断总线是否空闲。停止 (P) 位和启动 (S) 位在复位或禁止 MSSP 模块时清零。当 P 位 (SSPSTAT<4>) 置 1 时，可以取得 I²C 总线的控制权；否则，P 位和 S 位都清零，总线处于空闲状态。当总线忙时，一旦出现停止条件，将产生 MSSP 中断。

在多主机模式下，必须一直监视 SDA 线来进行仲裁，查看信号电平是否为期望的输出电平。此操作由硬件实现，其结果保存在 BCLIF 位中。

可能导致仲裁失败的情况是：

- 地址传输
- 数据传输
- 启动条件
- 重复启动条件
- 应答条件

17.4.17 多主机通信、总线冲突与总线仲裁

多主机模式是通过总线仲裁来支持的。当主器件将地址/数据位输出到 SDA 引脚时，如果一个主器件在 SDA 上输出 1 (将 SDA 引脚悬空为高电平)，而另一个主器件输出 0，就会发生总线仲裁。如果 SDA 引脚上期望的数据是 1，而实际采样到的数据是 0，则发生了总线冲突。主器件将把总线冲突中断标志位 BCLIF 置 1，并将 I²C 端口复位到空闲状态 (图 17-27)。

如果在发送过程中发生总线冲突，则发送操作停止，BF 标志位被清零，SDA 和 SCL 线被拉高，并且可写入 SSPBUF。当执行完总线冲突中断服务程序后，如果 I²C 总线空闲，用户可通过发出启动条件恢复通信。

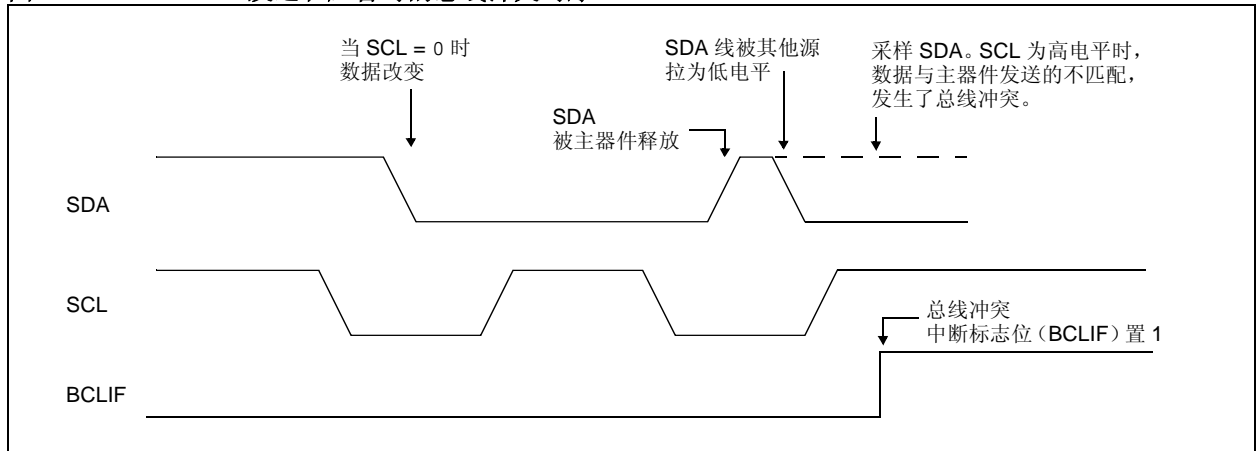
如果在启动、重复启动、停止或应答信号的进行过程中发生总线冲突，则这种状态被中止，SDA 和 SCL 线被拉高，SSPCON2 寄存器中的对应控制位清零。当执行完总线冲突中断服务程序后，如果 I²C 总线空闲，用户可通过发出启动条件恢复通信。

主器件将继续监视 SDA 和 SCL 引脚。一旦出现停止条件，SSPIF 位将被置 1。

发生总线冲突时无论发送的进度如何，写入 SSPBUF 都会从第一个数据位开始发送数据。

在多主机模式下，通过在检测到启动和停止条件时产生中断可以确定总线何时空闲。SSPSTAT 寄存器中的 P 位置 1 时，可以获取 I²C 总线的控制权；否则，P 位和 S 位都清零，总线处于空闲状态。

图 17-27: 发送和应答时的总线冲突时序



PIC18F2423/2523/4423/4523

17.4.17.1 启动条件期间的总线冲突

启动条件期间，以下事件将导致总线冲突：

- 在启动条件开始时，SDA 或 SCL 被采样为低电平（图 17-28）。
- SDA 被拉低之前，SCL 采样为低电平（图 17-29）。

在启动条件期间，SDA 和 SCL 引脚都会被监视。

如果 SDA 引脚已经是低电平，或 SCL 引脚已经是低电平，则：

- 中止启动条件，
- BCLIF 标志位置 1，
- MSSP 模块复位为空闲状态（图 17-28）。

启动条件从 SDA 和 SCL 引脚被拉高开始。当 SDA 引脚采样为高电平时，波特率发生器装入 SSPADD<6:0> 的值并递减计数至 0。如果在 SDA 为高电平时，SCL 引脚采样为低电平，则发生了总线冲突，因为这表示另一个主器件在启动条件期间试图发送一个数据 1。

如果 SDA 引脚在该计数周期内采样为低电平，则 BRG 复位，同时 SDA 线保持原值（图 17-30）。但是，如果 SDA 引脚采样为 1，则在 BRG 计数结束时该引脚将被置为低电平。接着，波特率发生器被重载并递减计数至 0，在此期间，如果 SCL 引脚采样到 0，则不会发生总线冲突。在 BRG 计数结束时，SCL 引脚被拉为低电平。

注： 在启动条件期间不太可能发生总线冲突，因为两个总线主控器件不可能精确地在同一时刻发出启动条件。因此一个主器件将总是先于另一个主器件将 SDA 拉低。但是上述情况不会引起总线冲突，因为两个主器件一定会对启动条件后的第一个地址进行仲裁。如果地址是相同的，必须继续对数据部分、重复启动条件或停止条件进行仲裁。

图 17-28: 启动条件期间的总线冲突（仅 SDA）

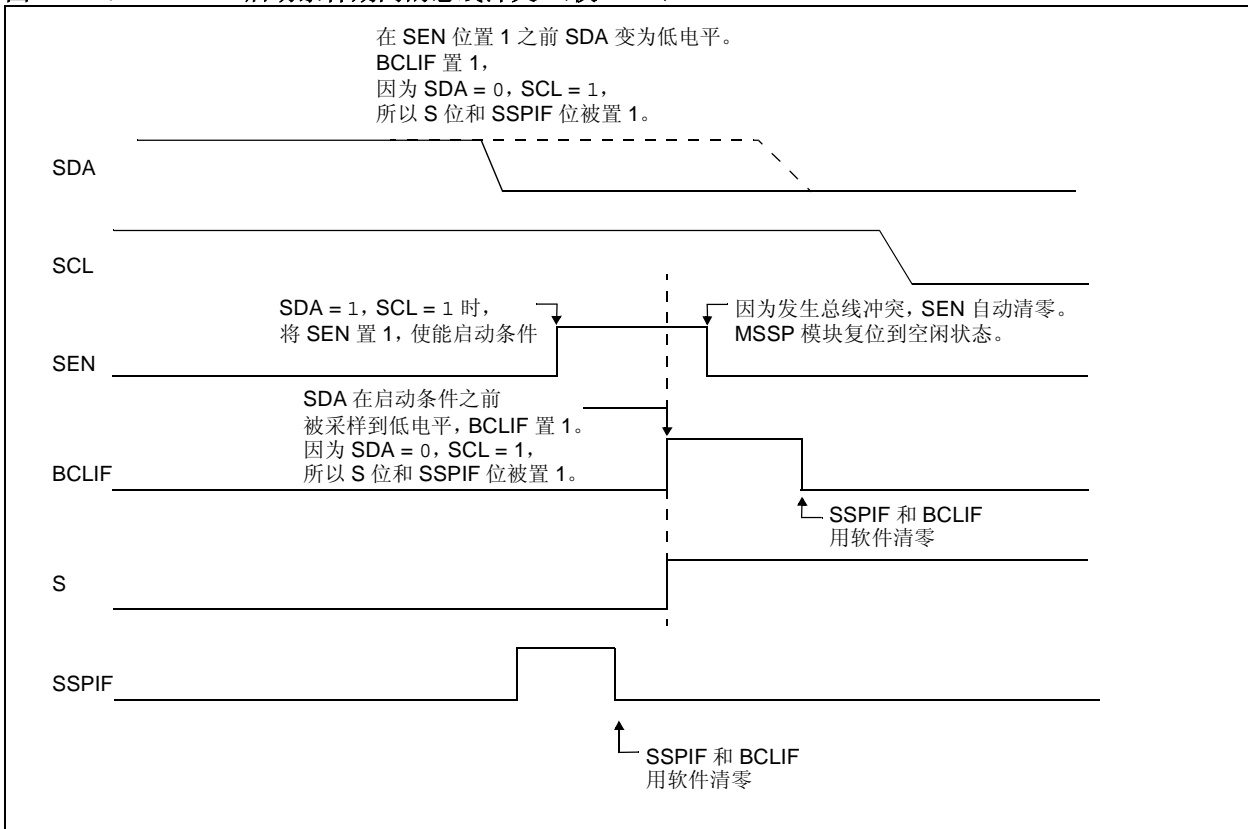


图 17-29: 启动条件期间的总线冲突 (SCL = 0)

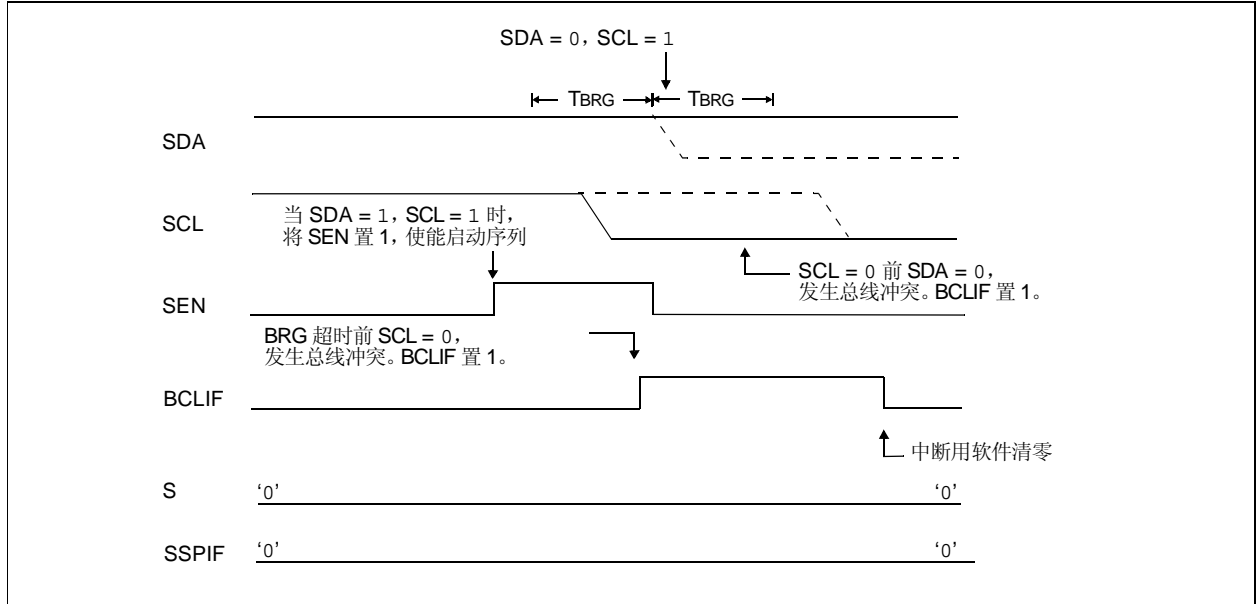
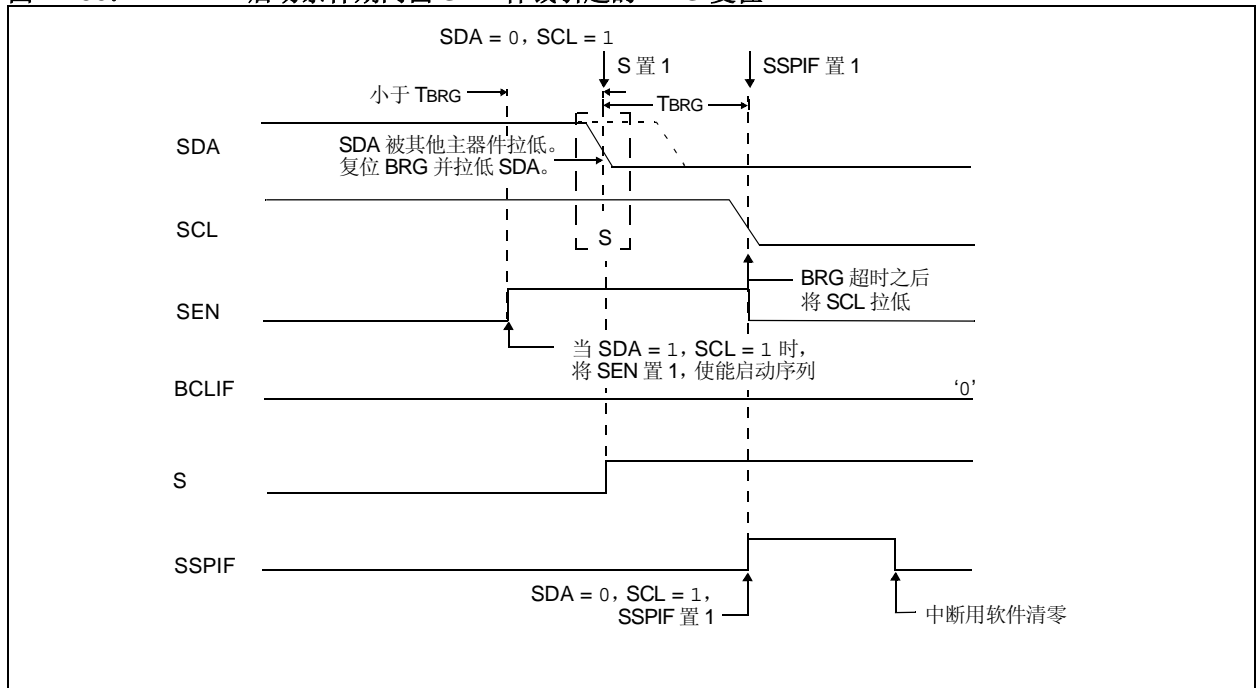


图 17-30: 启动条件期间由 SDA 仲裁引起的 BRG 复位



PIC18F2423/2523/4423/4523

17.4.17.2 重复启动条件期间的总线冲突

在下列情况中，重复启动条件期间会发生总线冲突：

- a) 在 SCL 由低电平变为高电平期间，在 SDA 上采样到低电平。
- b) 在 SDA 被拉为低电平之前，SCL 变为低电平，表示另一个主器件正试图发送一个数据 1。

当用户拉高 SDA 并允许该引脚悬空为高电平时，BRG 装入 SSPADD<6:0> 中的值并递减计数至 0，接着 SCL 引脚被拉高，当 SCL 引脚采样到高电平时，对 SDA 引脚进行采样。

如果 SDA 为低电平，则已发生了总线冲突（即，另一个主器件正试图发送一个数据 0，见图 17-31）。如果 SDA 被采样到高电平，则 BRG 被重新装入值并开始计数。如果 SDA 在 BRG 超时之前从高电平变为低电平，则不会发生总线冲突，因为两个主器件不可能精确地在同一时刻将 SDA 拉低。

如果 SCL 在 BRG 超时之前从高电平变为低电平，且 SDA 尚未被拉低，那么将发生总线冲突。在此情况下，另一个主器件在重复启动条件期间正试图发送一个数据 1（见图 17-32）。

如果在 BRG 超时结束时 SCL 和 SDA 都仍然是高电平，则 SDA 引脚被拉低，BRG 重新装入值并开始计数。在计数结束时，不管 SCL 引脚的状态如何，SCL 引脚都被拉低，重复启动条件结束。

图 17-31: 重复启动条件期间的总线冲突（情形 1）

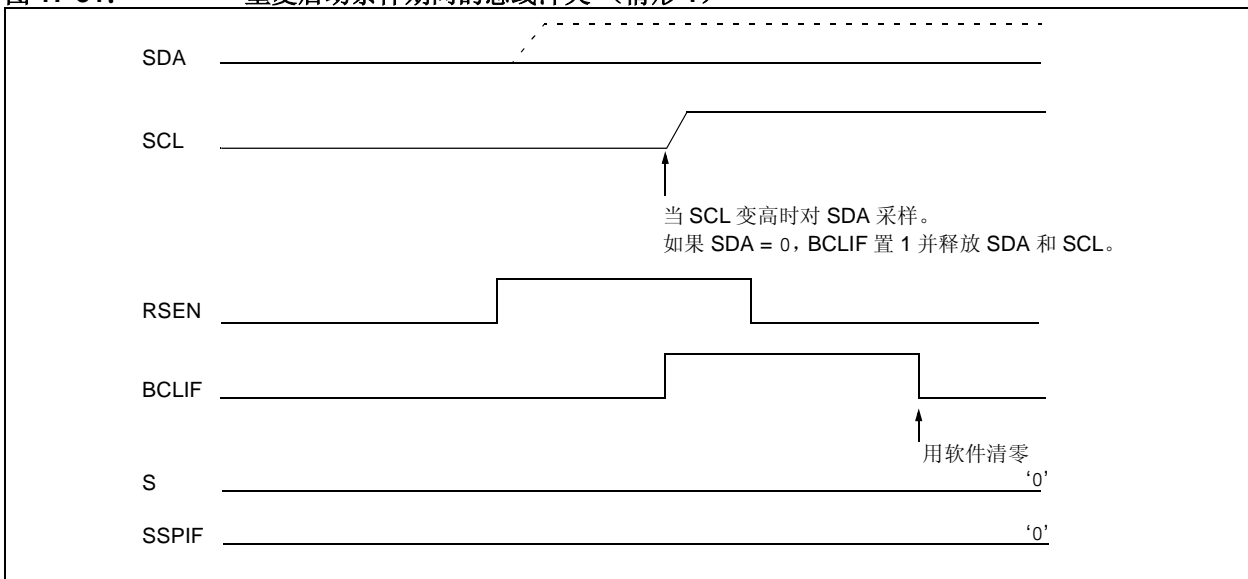
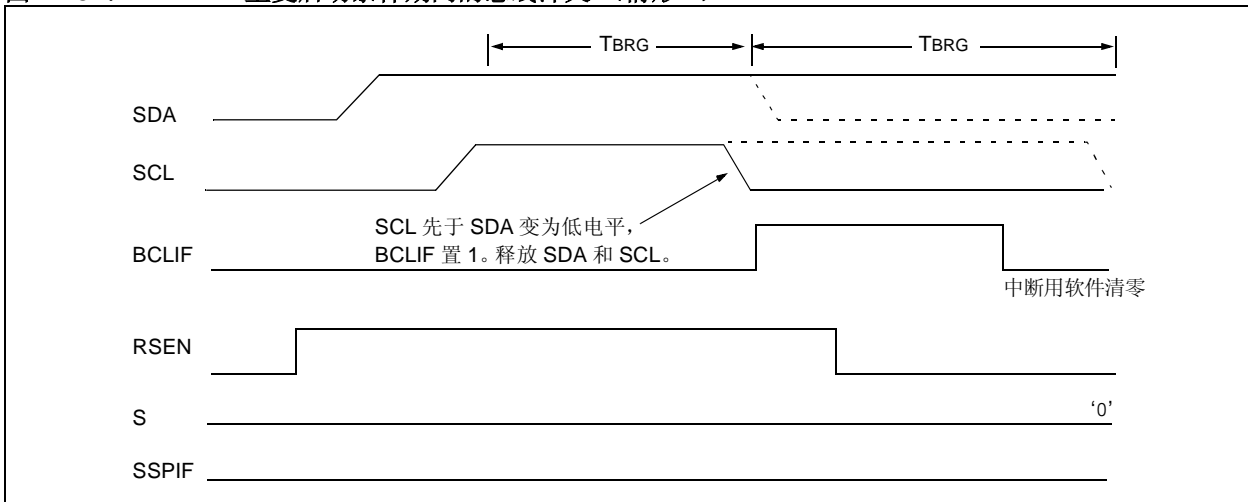


图 17-32: 重复启动条件期间的总线冲突（情形 2）



17.4.17.3 停止条件期间的总线冲突

以下事件会导致停止条件期间发生总线冲突：

- a) SDA 已被拉高并允许悬空为高电平之后，SDA 在 BRG 超时后被采样到低电平。
- b) SCL 引脚被拉高之后，SCL 在 SDA 变成高电平之前被采样到低电平。

停止条件从 SDA 被置成低电平开始。当 SDA 采样为低电平时，SCL 引脚被允许悬空。当 SDA 被采样到高电平时（时钟仲裁），波特率发生器装入 SSPADD<6:0> 的值并递减计数至 0。BRG 超时后，SDA 被采样。如果 SDA 采样为低电平，则已发生总线冲突。这是因为另一个主器件正试图发送一个数据 0（图 17-33）。如果 SCL 引脚在允许 SDA 悬空为高电平前被采样到低电平，也会发生总线冲突。这是另一个主器件正试图发送一个数据 0 的另外一种情况（图 17-34）。

图 17-33: 停止条件期间的总线冲突（情形 1）

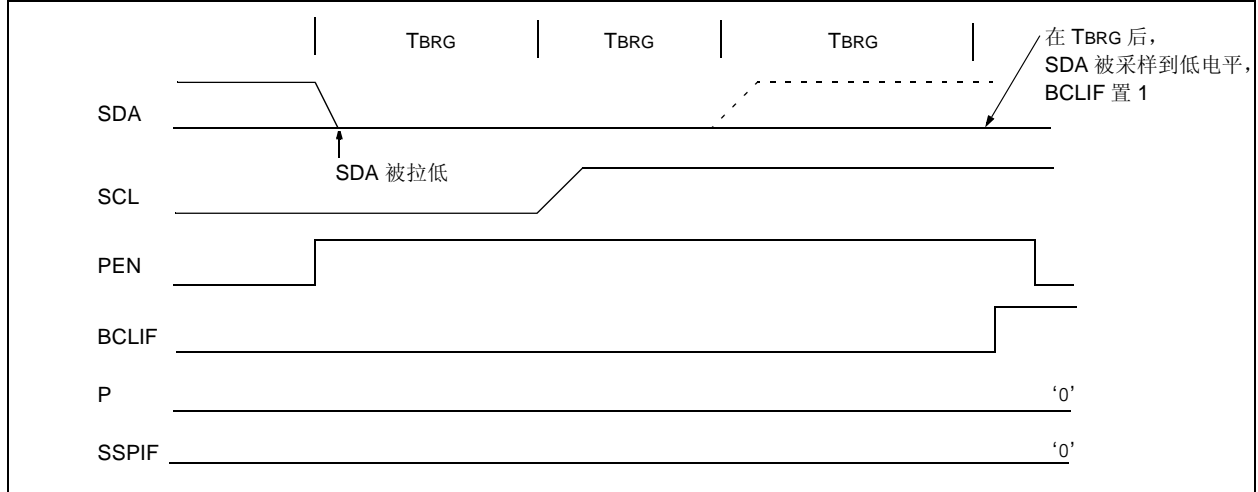
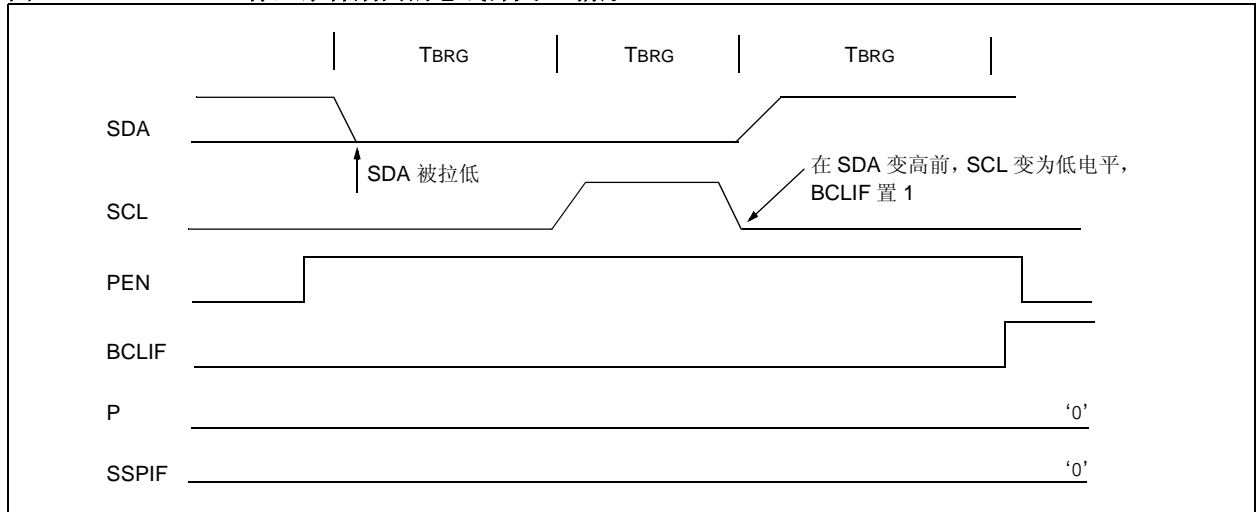


图 17-34: 停止条件期间的总线冲突（情形 2）



PIC18F2423/2523/4423/4523

注:

18.0 增强型通用同步 / 异步收发器 (EUSART)

增强型通用同步 / 异步收发器 (Enhanced Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter, EUSART) 模块是两个串行 I/O 模块之一。(通常 USART 也称为“串行通信接口”或 SCI。) 可以将 EUSART 配置为能与 CRT 终端和个人计算机等外设通信的全双工异步系统, 也可以将它配置成能够与 A/D 或 D/A 集成电路、串行 EEPROM 等外设通信的半双工同步系统。

增强型 USART 模块还实现了其他功能, 包括自动波特率检测和校准、接收到同步间隔字符时的自动唤醒和 12 位间隔字符发送。因为具有这些功能, 所以用在局域互连网络 (Local Interconnect Network, LIN) 总线系统中非常理想。

EUSART 可配置为以下几种工作模式:

- 带有以下功能的异步模式 (全双工):
 - 接收到字符时自动唤醒
 - 自动波特率校准
 - 12 位间隔字符发送
- 同步——主控 (半双工) 模式, 时钟极性可选
- 同步——从动 (半双工) 模式, 时钟极性可选

增强型 USART 的引脚与 PORTC 复用。要把 RC6/TX/CK 和 RC7/RX/DT 引脚配置为 EUSART:

- SPEN (RCSTA<7>) 位必须置 1 (= 1)
- TRISC<7> 位必须置 1 (= 1)
- TRISC<6> 位必须置 1 (= 1)

注: EUSART 控制逻辑在需要时会自动将引脚从输入重新配置为输出。

增强型 USART 模块的操作是由以下 3 个寄存器控制的:

- 发送状态和控制寄存器 (TXSTA)
- 接收状态和控制寄存器 (RXSTA)
- 波特率控制寄存器 (BAUDCON)

这些寄存器将在寄存器 18-1、寄存器 18-2 和寄存器 18-3 中分别详细介绍。

PIC18F2423/2523/4423/4523

寄存器 18-1: TXSTA: 发送状态和控制寄存器

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R-1	R/W-0
CSRC	TX9	TXEN ⁽¹⁾	SYNC	SENDB	BRGH	TRMT	TX9D
bit 7						bit 0	

图注:

R = 可读位	W = 可写位	U = 未实现位, 读为 0
-n = POR 值	1 = 置 1	0 = 清零
		x = 未知

bit 7	<p>CSRC: 时钟源选择位</p> <p><u>异步模式:</u> 无关位。</p> <p><u>同步模式:</u> 1 = 主控模式 (时钟来自内部 BRG) 0 = 从动模式 (时钟来自外部时钟源)</p>
bit 6	<p>TX9: 9 位发送使能位</p> <p>1 = 选择 9 位发送 0 = 选择 8 位发送</p>
bit 5	<p>TXEN: 发送使能位 ⁽¹⁾</p> <p>1 = 使能发送 0 = 禁止发送</p>
bit 4	<p>SYNC: EUSART 模式选择位</p> <p>1 = 同步模式 0 = 异步模式</p>
bit 3	<p>SENDB: 发送间隔字符位</p> <p><u>异步模式:</u> 1 = 在下次发送时发送“同步间隔”字符 (在完成时由硬件清零) 0 = “同步间隔”字符发送完成</p> <p><u>同步模式:</u> 无关位。</p>
bit 2	<p>BRGH: 高波特率选择位</p> <p><u>异步模式:</u> 1 = 高速 0 = 低速</p> <p><u>同步模式:</u> 在此模式下未使用。</p>
bit 1	<p>TRMT: 发送移位寄存器状态位</p> <p>1 = TSR 空 0 = TSR 满</p>
bit 0	<p>TX9D: 发送数据的第 9 位</p> <p>可以是地址 / 数据位或奇偶校验位。</p>

注 1: 在同步模式下, SREN/CREN 的优先级高于 TXEN。

PIC18F2423/2523/4423/4523

寄存器 18-3: BAUDCON: 波特率控制寄存器

R/W-0	R-1	U-0	R/W-0	R/W-0	U-0	R/W-0	R/W-0
ABDOVF	RCIDL	—	SCKP	BRG16	—	WUE	ABDEN
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位 W = 可写位 U = 未实现位, 读为 0
 -n = POR 值 1 = 置 1 0 = 清零 x = 未知

- bit 7 **ABDOVF:** 自动波特率采样计满返回状态位
 1 = 在自动波特率检测模式下出现了 BRG 计满返回 (必须用软件清零)
 0 = 没有发生 BRG 计满返回
- bit 6 **RCIDL:** 接收操作空闲状态位
 1 = 接收操作处于空闲状态
 0 = 接收操作处于活动状态
- bit 5 **未实现:** 读为 0
- bit 4 **SCKP:** 同步时钟极性选择位
异步模式:
 在此模式下未使用。
同步模式:
 1 = 空闲状态时钟 (CK) 为高电平
 0 = 空闲状态时钟 (CK) 为低电平
- bit 3 **BRG16:** 16 位波特率寄存器使能位
 1 = 16 位波特率发生器——SPBRGH 和 SPBRG
 0 = 8 位波特率发生器——仅 SPBRG, 忽略 SPBRGH 的值 (兼容模式)
- bit 2 **未实现:** 读为 0
- bit 1 **WUE:** 唤醒使能位
异步模式:
 1 = EUSART 将继续采样 RX 引脚——中断在下降沿产生, 在下一个上升沿由硬件清零该位
 0 = 未监测 RX 引脚或检测到了上升沿
同步模式:
 在此模式下未使用。
- bit 0 **ABDEN:** 自动波特率检测使能位
异步模式:
 1 = 在下一个字符使能波特率检测。需要收到“同步”字段 (55h), 完成时由硬件清零
 0 = 禁止波特率检测或检测已完成
同步模式:
 在此模式下未使用。

18.1 波特率发生器 (BRG)

BRG 是一个专用的 8 位或 16 位发生器，支持 EUSART 的异步和同步模式。默认情况下，BRG 工作在 8 位模式下，通过将 BRG16 位 (BAUDCON<3>) 置 1 可以选择 16 位模式。

SPBRGH:SPBRG 寄存器对控制自由运行的定时器周期。在异步模式下，BRGH (TXSTA<2>) 和 BRG16 (BAUDCON<3>) 位也用于控制波特率。在同步模式下，BRGH 位会被忽略。表 18-1 所示为不同 EUSART 模式的波特率计算公式，但仅适用于主控模式 (由内部产生时钟信号)。

给出期望的波特率和 Fosc 值，就可以使用表 18-1 中的公式计算 SPBRGH:SPBRG 寄存器的最近似整数值。这样就可以判断波特率误差。例 18-1 给出了计算示例。表 18-2 中给出了不同异步模式下典型的波特率和误差

值。使用高波特率 (BRGH = 1) 或 16 位 BRG 有利于减小波特率误差，或者在快速振荡频率条件下实现低波特率。

向 SPBRGH:SPBRG 寄存器写入新值会使 BRG 定时器复位 (或清零)。这可以确保 BRG 无需等待定时器溢出就可以输出新的波特率。

18.1.1 在功耗管理模式下的操作

器件时钟用于产生所需的波特率。当进入一种功耗管理模式时，新时钟源可能会工作在一个不同的频率下。这可能需要调整 SPBRG 寄存器对中的值。

18.1.2 采样

检测电路对 RX 引脚采样三次，以判定 RX 引脚上出现的是高电平还是低电平。

表 18-1: 波特率公式

配置位			BRG/EUSART 模式	波特率计算公式
SYNC	BRG16	BRGH		
0	0	0	8 位 / 异步	$F_{osc}/[64(n+1)]$
0	0	1	8 位 / 异步	$F_{osc}/[16(n+1)]$
0	1	0	16 位 / 异步	
0	1	1	16 位 / 异步	$F_{osc}/[4(n+1)]$
1	0	x	8 位 / 同步	
1	1	x	16 位 / 同步	

图注: x = 无关位, n = SPBRGH:SPBRG 寄存器对的值

PIC18F2423/2523/4423/4523

例 18-1: 计算波特率误差

器件工作在 $F_{osc} = 16 \text{ MHz}$ ，目标波特率 = 9600，异步模式，8 位 BRG:

$$\text{目标波特率} = F_{osc} / (64 ([SPBRGH:SPBRG] + 1))$$

求解 SPBRGH:SPBRG:

$$X = ((F_{osc} / \text{目标波特率}) / 64) - 1$$

$$= ((16000000 / 9600) / 64) - 1$$

$$= [25.042] = 25$$

$$\text{计算波特率} = 16000000 / (64 (25 + 1))$$

$$= 9615$$

$$\text{误差} = (\text{计算波特率} - \text{目标波特率}) / \text{目标波特率}$$

$$= (9615 - 9600) / 9600 = 0.16\%$$

表 18-2: 与波特率发生器相关的寄存器

名称	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	复位值所在页
TXSTA	CSRC	TX9	TXEN	SYNC	SENDB	BRGH	TRMT	TX9D	51
RCSTA	SPEN	RX9	SREN	CREN	ADDEN	FERR	OERR	RX9D	51
BAUDCON	ABDOVF	RCIDL	—	SCKP	BRG16	—	WUE	ABDEN	51
SPBRGH	EUSART 波特率发生器寄存器的高字节								51
SPBRG	EUSART 波特率发生器寄存器的低字节								51

图注: — = 未实现，读为 0。BRG 不使用阴影单元。

PIC18F2423/2523/4423/4523

表 18-3: 异步模式下的波特率

波特率 (K)	SYNC = 0, BRGH = 0, BRG16 = 0											
	Fosc = 32.000 MHz			Fosc = 20.000 MHz			Fosc = 10.000 MHz			Fosc = 8.000 MHz		
	实际波特率 (K)	% 误差	SPBRG 值 (十进制)	实际波特率 (K)	% 误差	SPBRG 值 (十进制)	实际波特率 (K)	% 误差	SPBRG 值 (十进制)	实际波特率 (K)	% 误差	SPBRG 值 (十进制)
0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.2	—	—	—	1.221	1.73	255	1.202	0.16	129	1.201	-0.16	103
2.4	2.404	0.16	207	2.404	0.16	129	2.404	0.16	64	2.403	-0.16	51
9.6	9.615	0.16	51	9.766	1.73	31	9.766	1.73	15	9.615	-0.16	12
19.2	19.231	0.16	25	19.531	1.73	15	19.531	1.73	7	—	—	—
57.6	55.555	-3.55	8	62.500	8.51	4	52.083	-9.58	2	—	—	—
115.2	125.000	8.51	3	104.167	-9.58	2	78.125	-32.18	1	—	—	—

波特率 (K)	SYNC = 0, BRGH = 0, BRG16 = 0								
	Fosc = 4.000 MHz			Fosc = 2.000 MHz			Fosc = 1.000 MHz		
	实际波特率 (K)	% 误差	SPBRG 值 (十进制)	实际波特率 (K)	% 误差	SPBRG 值 (十进制)	实际波特率 (K)	% 误差	SPBRG 值 (十进制)
0.3	0.300	0.16	207	0.300	-0.16	103	0.300	-0.16	51
1.2	1.202	0.16	51	1.201	-0.16	25	1.201	-0.16	12
2.4	2.404	0.16	25	2.403	-0.16	12	—	—	—
9.6	8.929	-6.99	6	—	—	—	—	—	—
19.2	20.833	8.51	2	—	—	—	—	—	—
57.6	62.500	8.51	0	—	—	—	—	—	—
115.2	62.500	-45.75	0	—	—	—	—	—	—

波特率 (K)	SYNC = 0, BRGH = 1, BRG16 = 0											
	Fosc = 32.000 MHz			Fosc = 20.000 MHz			Fosc = 10.000 MHz			Fosc = 8.000 MHz		
	实际波特率 (K)	% 误差	SPBRG 值 (十进制)	实际波特率 (K)	% 误差	SPBRG 值 (十进制)	实际波特率 (K)	% 误差	SPBRG 值 (十进制)	实际波特率 (K)	% 误差	SPBRG 值 (十进制)
0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.4	—	—	—	—	—	—	2.441	1.73	255	2.403	-0.16	207
9.6	9.615	0.16	207	9.615	0.16	129	9.615	0.16	64	9.615	-0.16	51
19.2	19.231	0.16	103	19.231	0.16	64	19.531	1.73	31	19.230	-0.16	25
57.6	57.143	-0.79	34	56.818	-1.36	21	56.818	-1.36	10	55.555	3.55	8
115.2	117.647	2.12	16	113.636	-1.36	10	125.000	8.51	4	—	—	—

波特率 (K)	SYNC = 0, BRGH = 1, BRG16 = 0								
	Fosc = 4.000 MHz			Fosc = 2.000 MHz			Fosc = 1.000 MHz		
	实际波特率 (K)	% 误差	SPBRG 值 (十进制)	实际波特率 (K)	% 误差	SPBRG 值 (十进制)	实际波特率 (K)	% 误差	SPBRG 值 (十进制)
0.3	—	—	—	—	—	—	0.300	-0.16	207
1.2	1.202	0.16	207	1.201	-0.16	103	1.201	-0.16	51
2.4	2.404	0.16	103	2.403	-0.16	51	2.403	-0.16	25
9.6	9.615	0.16	25	9.615	-0.16	12	—	—	—
19.2	19.231	0.16	12	—	—	—	—	—	—
57.6	62.500	8.51	3	—	—	—	—	—	—
115.2	125.000	8.51	1	—	—	—	—	—	—

PIC18F2423/2523/4423/4523

表 18-3: 异步模式下的波特率 (续)

波特率 (K)	SYNC = 0, BRGH = 0, BRG16 = 1											
	Fosc = 32.000 MHz			Fosc = 20.000 MHz			Fosc = 10.000 MHz			Fosc = 8.000 MHz		
	实际波特率 (K)	% 误差	SPBRG 值 (十进制)	实际波特率 (K)	% 误差	SPBRG 值 (十进制)	实际波特率 (K)	% 误差	SPBRG 值 (十进制)	实际波特率 (K)	% 误差	SPBRG 值 (十进制)
0.3	0.300	0.01	6666	0.300	0.02	4165	0.300	0.02	2082	0.300	-0.04	1665
1.2	1.200	-0.02	1666	1.200	-0.03	1041	1.200	-0.03	520	1.201	-0.16	415
2.4	2.401	0.04	832	2.399	-0.03	520	2.404	0.16	259	2.403	-0.16	207
9.6	9.615	0.16	207	9.615	0.16	129	9.615	0.16	64	9.615	-0.16	51
19.2	19.231	0.16	103	19.231	0.16	64	19.531	1.73	31	19.230	-0.16	25
57.6	57.142	-0.79	34	56.818	-1.36	21	56.818	-1.36	10	55.555	3.55	8
115.2	117.647	2.12	16	113.636	-1.36	10	125.000	8.51	4	—	—	—

波特率 (K)	SYNC = 0, BRGH = 0, BRG16 = 1								
	Fosc = 4.000 MHz			Fosc = 2.000 MHz			Fosc = 1.000 MHz		
	实际波特率 (K)	% 误差	SPBRG 值 (十进制)	实际波特率 (K)	% 误差	SPBRG 值 (十进制)	实际波特率 (K)	% 误差	SPBRG 值 (十进制)
0.3	0.300	0.04	832	0.300	-0.16	415	0.300	-0.16	207
1.2	1.202	0.16	207	1.201	-0.16	103	1.201	-0.16	51
2.4	2.404	0.16	103	2.403	-0.16	51	2.403	-0.16	25
9.6	9.615	0.16	25	9.615	-0.16	12	—	—	—
19.2	19.231	0.16	12	—	—	—	—	—	—
57.6	62.500	8.51	3	—	—	—	—	—	—
115.2	125.000	8.51	1	—	—	—	—	—	—

波特率 (K)	SYNC = 0, BRGH = 1, BRG16 = 1 或 SYNC = 1, BRG16 = 1											
	Fosc = 32.000 MHz			Fosc = 20.000 MHz			Fosc = 10.000 MHz			Fosc = 8.000 MHz		
	实际波特率 (K)	% 误差	SPBRG 值 (十进制)	实际波特率 (K)	% 误差	SPBRG 值 (十进制)	实际波特率 (K)	% 误差	SPBRG 值 (十进制)	实际波特率 (K)	% 误差	SPBRG 值 (十进制)
0.3	0.300	0.00	26666	0.300	0.00	16665	0.300	0.00	8332	0.300	-0.01	6665
1.2	1.200	0.00	6666	1.200	0.02	4165	1.200	0.02	2082	1.200	-0.04	1665
2.4	2.400	0.01	3332	2.400	0.02	2082	2.402	0.06	1040	2.400	-0.04	832
9.6	9.603	0.04	832	9.596	-0.03	520	9.615	0.16	259	9.615	-0.16	207
19.2	19.185	-0.07	416	19.231	0.16	259	19.231	0.16	129	19.230	-0.16	103
57.6	57.553	-0.07	138	57.471	-0.22	86	58.140	0.94	42	57.142	0.79	34
115.2	115.942	0.64	68	116.279	0.94	42	113.636	-1.36	21	117.647	-2.12	16

波特率 (K)	SYNC = 0, BRGH = 1, BRG16 = 1 或 SYNC = 1, BRG16 = 1								
	Fosc = 4.000 MHz			Fosc = 2.000 MHz			Fosc = 1.000 MHz		
	实际波特率 (K)	% 误差	SPBRG 值 (十进制)	实际波特率 (K)	% 误差	SPBRG 值 (十进制)	实际波特率 (K)	% 误差	SPBRG 值 (十进制)
0.3	0.300	0.01	3332	0.300	-0.04	1665	0.300	-0.04	832
1.2	1.200	0.04	832	1.201	-0.16	415	1.201	-0.16	207
2.4	2.404	0.16	415	2.403	-0.16	207	2.403	-0.16	103
9.6	9.615	0.16	103	9.615	-0.16	51	9.615	-0.16	25
19.2	19.231	0.16	51	19.230	-0.16	25	19.230	-0.16	12
57.6	58.824	2.12	16	55.555	3.55	8	—	—	—
115.2	111.111	-3.55	8	—	—	—	—	—	—

18.1.3 自动波特率检测

增强型 USART 模块支持波特率自动检测和校准。此功能仅在异步模式下当 WUE 位清零时有效。

只要接收到起始位并且 ABDEN 位已置 1，就会开始自动波特率检测（图 18-1）。波特率计算采用自平均的方式。

在自动波特率检测（Auto-Baud Rate Detect, ABD）模式下，BRG 的时钟是反向的。不是由 BRG 为进入的 RX 信号提供时钟信号，而是由 RX 信号为 BRG 定时。在 ABD 模式下，内部波特率发生器被用作计数器来计算输入的串行字节流的位间隔时间。

一旦 ABDEN 位置 1，状态机就会将 BRG 清零并寻找起始位。为了正确计算比特率，自动波特率检测必须接收到一个值为 55h（ASCII 字符 U，也是 LIN 总线的同步字符）的字节。为了尽量减少输入信号不对称造成的影响，在接收低位和高位的时间内都要进行测量。在起始位后，SPBRG 使用预先选择的时钟源在 RX 的第一个上升沿开始计数。在 RX 引脚传输了 8 个位，或在检测到第 5 个上升沿后，会将相应 BRG 周期内的累加值保存在 SPBRGH:SPBRG 寄存器对中。当第 5 个时钟周期出现时（应与停止位对应），ABDEN 位会自动清零。

如果发生了 BRG 计满返回（从 FFFFh 溢出到 0000h），会在 ABDOVF 状态位（BAUDCON<7>）有所反映。该位可在 BRG 溢出时由硬件置 1，也可以由用户通过软件置 1 或清零。在发生计满返回事件后，ABD 模式继续有效，ABDEN 位保持置 1（图 18-2）。

在校准波特率周期时，BRG 寄存器时钟频率为预配置时钟频率的 1/8。请注意 BRG 时钟将由 BRG16 和 BRGH 位配置。不管 BRG16 如何设置，SPBRG 和 SPBRGH 都将被用作 16 位计数器。用户通过检查 SPBRGH 寄存器的值是否为 00h，可以验证 8 位模式下是否发生了进位。表 18-4 所示为 BRG 计数器的时钟速率。

当发生 ABD 序列时，EUSART 状态机保持在空闲状态。一旦在 RX 上检测到第 5 个上升沿，中断标志位 RCIF 就会置 1。需要读取 RCREG 中的值，来清除中断标志位 RC1IF。应丢弃 RCREG 的值。

- 注 1:** 如果 WUE 位与 ABDEN 位同时置 1，自动波特率检测会在间隔字符之后的字节开始。
- 2:** 需要由用户来判断进入字符波特率是否处于所选 BRG 时钟源范围内。由于位误差率的原因，某些振荡频率和 EUSART 波特率的组合无法实现。使用自动波特率检测功能时，必须综合考虑系统总的时序和通信波特率。

表 18-4: BRG 计数器时钟速率

BRG16	BRGH	BRG 计数器时钟
0	0	Fosc/512
0	1	Fosc/128
1	0	Fosc/128
1	1	Fosc/32

注: 在 ABD 序列期间，不管 BRG16 如何设置，SPBRG 和 SPBRGH 都被用作 16 位计数器。

18.1.3.1 ABD 和 EUSART 发送

由于 ABD 采样期间 BRG 时钟是反向的，因此在 ABD 期间不能使用 EUSART 发送器。这意味着只要 ABDEN 位置 1，就不能写入 TXREG。用户还应确保在发送期间 ABDEN 不能为置 1 状态，否则可能会导致无法预料的 EUSART 操作。

PIC18F2423/2523/4423/4523

图 18-1: 自动波特率计算

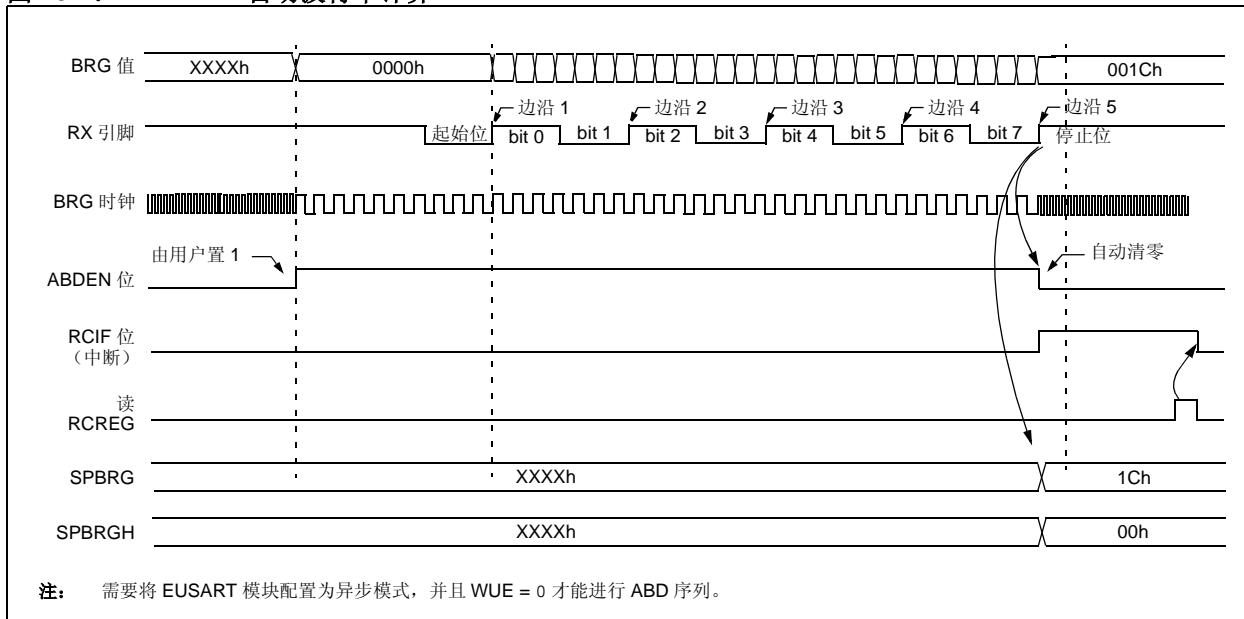
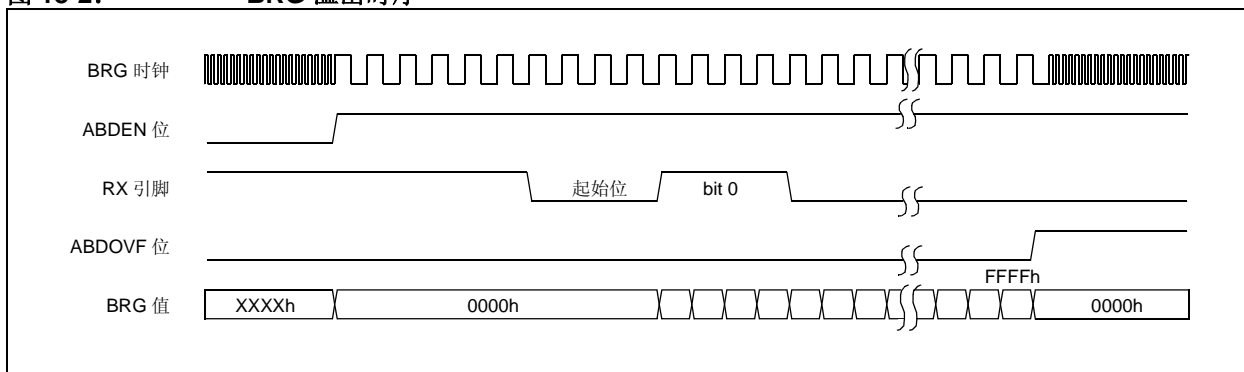


图 18-2: BRG 溢出时序



18.2 EUSART 异步模式

通过将 SYNC 位 (TXSTA<4>) 清零可选择异步工作模式。在此模式下, EUSART 使用标准的不归零 (Non-Return-to-Zero, NRZ) 格式 (1 个起始位、8 个或 9 个数据位和 1 个停止位)。最常用的格式是含有 8 个数据位。片上专用 8 位/16 位波特率发生器可借助于振荡器产生标准波特率频率。

EUSART 首先发送和接收 LSb。EUSART 的发送器和接收器在功能上是独立的, 但采用相同的数据格式和波特率。根据 BRGH 位和 BRG16 位 (TXSTA<2>和 BAUDCON<3>) 的设置值, 波特率发生器可以产生两种不同的波特率时钟, 频率分别为位速率的 16 倍或 64 倍。硬件不支持奇偶校验, 但可以用软件实现, 校验值保存在第 9 个数据位中。

当工作在异步模式下时, EUSART 模块包括以下重要组成部分:

- 波特率发生器
- 采样电路
- 异步发送器
- 异步接收器
- 同步间隔字符自动唤醒
- 12 位间隔字符发送
- 自动波特率检测

18.2.1 EUSART 异步发送器

图 18-3 给出了 EUSART 发送器框图。发送器的核心是发送 (串行) 移位寄存器 (Transmit Shift Register, TSR)。移位寄存器从读/写发送缓冲寄存器 TXREG 中获取数据。TXREG 寄存器中的数据由软件写入。在前一次装入数据的停止位发送前, 不会向 TSR 寄存器装入新数据。一旦停止位发送完毕, TXREG 寄存器中的新数据 (如果有) 就会被装入 TSR。

一旦 TXREG 寄存器向 TSR 寄存器传输了数据 (在 1 个 Tcy 内发生), TXREG 寄存器就为空, 同时标志位 TXIF (PIR1<4>) 置 1。可以通过将中断允许位 TXIE (PIE1<4>) 置 1 或清零来允许或禁止该中断。不管 TXIE 的状态如何, 只要中断发生, TXIF 就会置 1 并且不能用软件清零。TXIF 不会在 TXREG 装入新数据时立即被清零, 而是在装入指令后的第二个指令周期被清零。因此在 TXREG 装入新数据后立即查询 TXIF, 会得到无效结果。

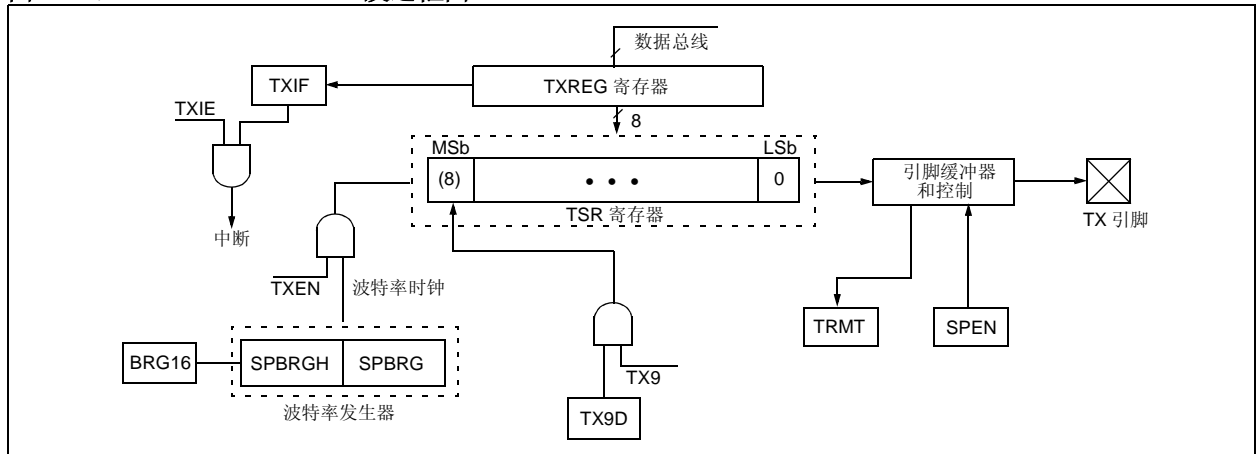
TXIF 指示的是 TXREG 寄存器的状态, 而另一个位 TRMT (TXSTA<1>) 则指示 TSR 寄存器的状态。TRMT 是只读位, 它在 TSR 寄存器为空时被置 1。TRMT 位与任何中断逻辑均无关联, 因此要确定 TSR 寄存器是否为空, 用户只能对此位进行查询。

注 1: TSR 寄存器并未映射到数据存储器中, 因此用户不能直接访问它。
注 2: 当使能位 TXEN 置 1 时, 标志位 TXIF 置 1。

设置异步发送操作的步骤如下:

1. 对 SPBRGH:SPBRG 寄存器进行初始化, 设置合适的波特率。按需要将 BRGH 和 BRG16 位置 1 或清零, 以获得所需的波特率。
2. 通过将 SYNC 位清零并将 SPEN 位置 1, 使能异步串口。
3. 如果需要中断, 将允许位 TXIE 置 1。
4. 如果需要 9 位发送, 将发送位 TX9 置 1。可以作为地址/数据位使用。
5. 通过将 TXEN 位置 1 使能发送, 此操作同时也会将 TXIF 位置 1。
6. 如果选择了 9 位发送, 将第 9 位装入 TX9D 位。
7. 将数据装入 TXREG 寄存器 (开始发送)。
8. 如果使用中断, 应确保 INTCON 寄存器中的 GIE 和 PEIE 位 (INTCON<7:6>) 置 1。

图 18-3: EUSART 发送框图



PIC18F2423/2523/4423/4523

图 18-4: 异步发送

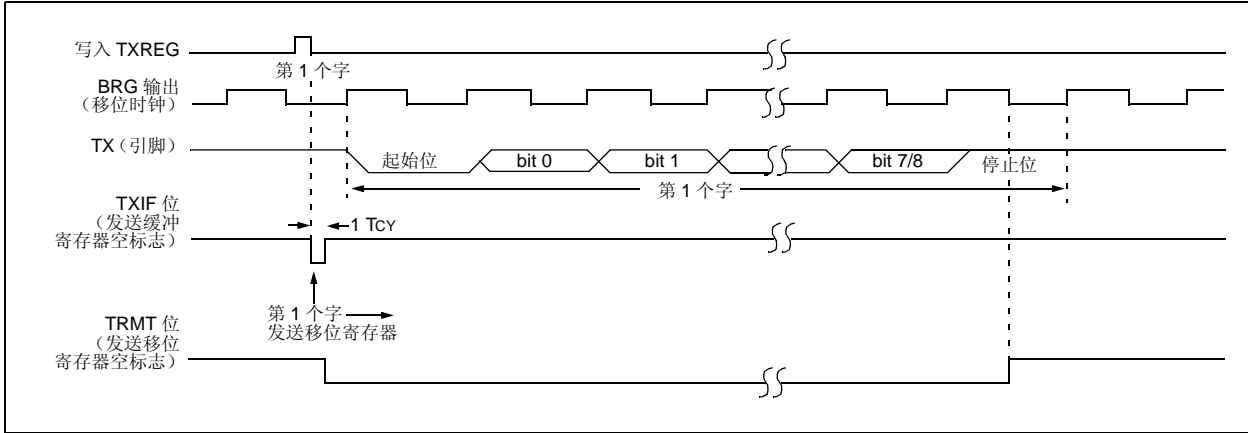


图 18-5: 异步发送（背对背）

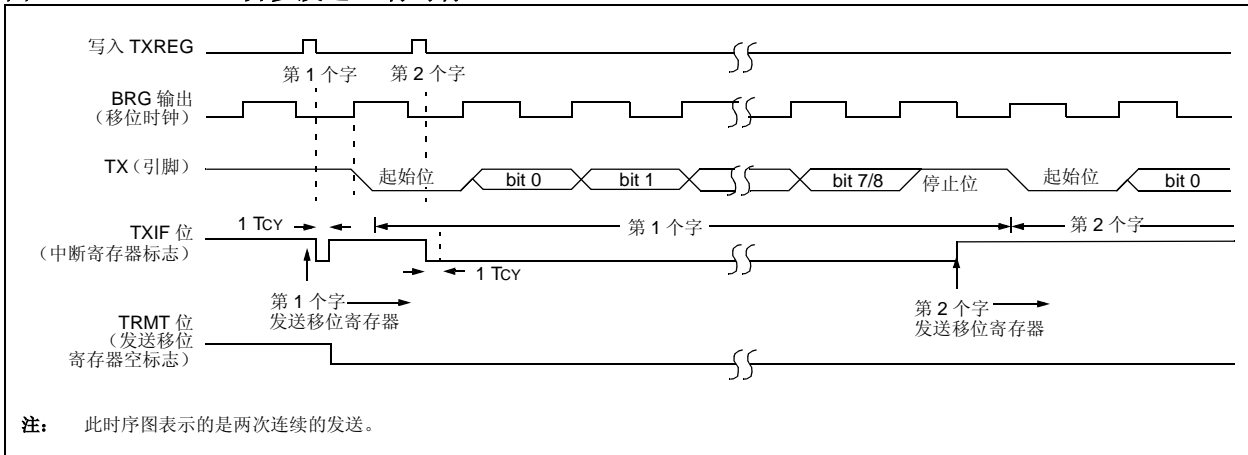


表 18-5: 与异步发送相关的寄存器

名称	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	复位值所在页
INTCON	GIE/GIEH	PEIE/GIEL	TMR0IE	INT0IE	RBIE	TMR0IF	INT0IF	RBIF	49
PIR1	PSPIF ⁽¹⁾	ADIF	RCIF	TXIF	SSPIF	CCP1IF	TMR2IF	TMR1IF	52
PIE1	PSPIE ⁽¹⁾	ADIE	RCIE	TXIE	SSPIE	CCP1IE	TMR2IE	TMR1IE	52
IPR1	PSPIP ⁽¹⁾	ADIP	RCIP	TXIP	SSPIP	CCP1IP	TMR2IP	TMR1IP	52
RCSTA	SPEN	RX9	SREN	CREN	ADDEN	FERR	OERR	RX9D	51
TXREG	EUSART 发送寄存器								51
TXSTA	CSRC	TX9	TXEN	SYNC	SENDB	BRGH	TRMT	TX9D	51
BAUDCON	ABDOVF	RCIDL	—	SCKP	BRG16	—	WUE	ABDEN	51
SPBRGH	EUSART 波特率发生器寄存器的高字节								51
SPBRG	EUSART 波特率发生器寄存器的低字节								51

图注：— = 未实现单元，读为 0。异步发送不使用阴影单元。

注 1：在 28 引脚器件中保留；始终保持这些位清零。

18.2.2 EUSART 异步接收器

图 18-6 给出了接收器框图。在 RX 引脚上接收数据，并驱动数据恢复模块。数据恢复模块实际上是一个工作频率为 16 倍波特率的高速移位器，而主接收串行移位器的工作频率等于位速率或 F_{osc} 。此模式通常用于 RS-232 系统。

设置异步接收操作的步骤如下：

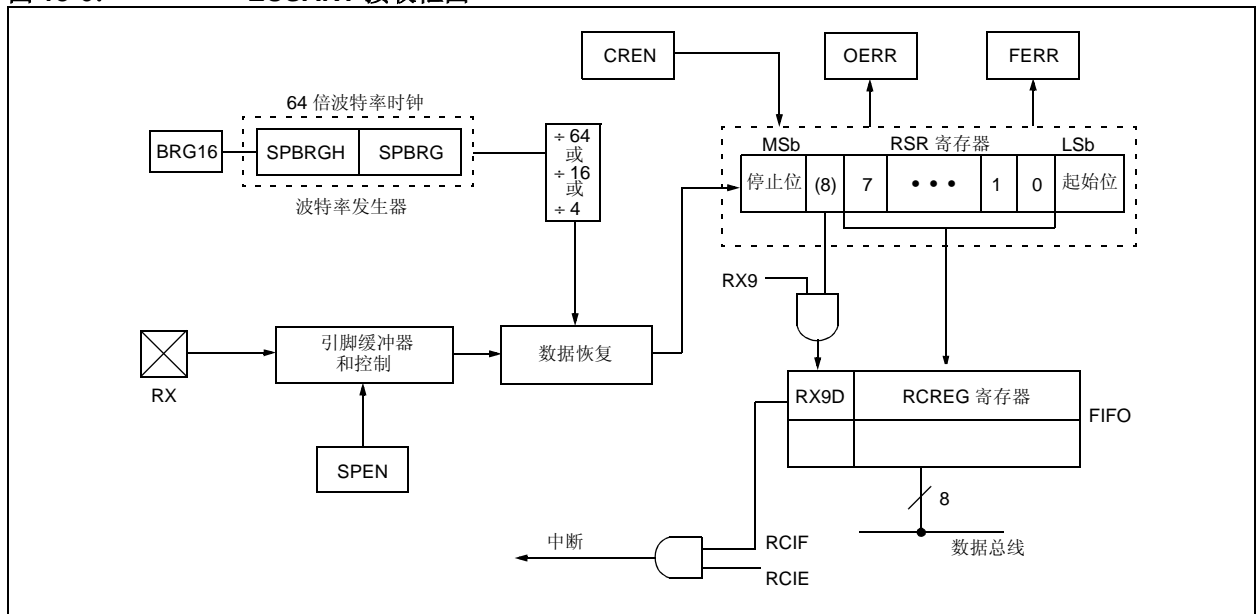
1. 对 SPBRGH:SPBRG 寄存器进行初始化，设置合适的波特率。按需要将 BRGH 和 BRG16 位置 1 或清零，以获得所需的波特率。
2. 通过将 SYNC 位清零并将 SPEN 位置 1，使能异步串口。
3. 如果需要中断，将允许位 RCIE 置 1。
4. 如果需要接收 9 位数据，将 RX9 位置 1。
5. 通过将 CREN 位置 1 使能接收。
6. 当接收完成时标志位 RCIF 将被置 1，此时如果中断允许位 RCIE 已置 1，则还将产生一个中断。
7. 读 RCSTA 寄存器获取第 9 位数据（如果已使能），并判断在接收过程中是否发生了错误。
8. 读 RCREG 寄存器来读取接收到的 8 位数据。
9. 如果发生错误，通过将使能位 CREN 清零来清除错误。
10. 如果使用中断，应确保 INTCON 寄存器中的 GIE 和 PEIE 位（INTCON<7:6>）置 1。

18.2.3 设置带有地址检测功能的 9 位模式

此模式通常用于 RS-485 系统。按如下步骤设置带有地址检测功能的异步接收操作：

1. 对 SPBRGH:SPBRG 寄存器进行初始化，设置合适的波特率。按需要将 BRGH 和 BRG16 位置 1 或清零，以获得所需的波特率。
2. 通过将 SYNC 位清零并将 SPEN 位置 1，使能异步串口。
3. 如果需要中断，将 RCEN 位置 1 并用 RCIP 位选择所需的优先级别。
4. 将 RX9 位置 1，使能 9 位接收。
5. 将 ADDEN 位置 1，使能地址检测。
6. 将 CREN 位置 1，使能接收。
7. 当接收完成时 RCIF 位将被置 1。此时如果 RCIE 和 GIE 位已置 1，还将响应中断。
8. 读 RCSTA 寄存器判断在接收时是否发生了错误，同时读取第 9 位数据（如果适用）。
9. 读 RCREG 判断是否正在对器件进行寻址。
10. 如果发生错误，将 CREN 位清零。
11. 如果已寻址到器件，将 ADDEN 位清零，允许所有的接收数据进入接收缓冲器并中断 CPU。

图 18-6: EUSART 接收框图



PIC18F2423/2523/4423/4523

图 18-7: 异步接收

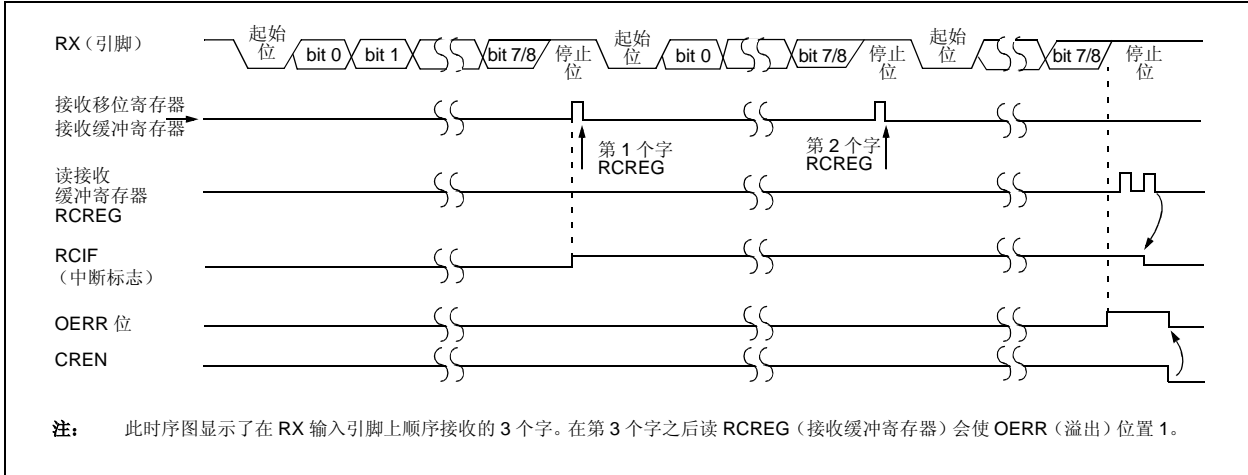


表 18-6: 与异步接收相关的寄存器

名称	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	复位值所在页
INTCON	GIE/GIEH	PEIE/GIEL	TMR0IE	INT0IE	RBIE	TMR0IF	INT0IF	RBIF	49
PIR1	PSPIF ⁽¹⁾	ADIF	RCIF	TXIF	SSPIF	CCP1IF	TMR2IF	TMR1IF	52
PIE1	PSPIE ⁽¹⁾	ADIE	RCIE	TXIE	SSPIE	CCP1IE	TMR2IE	TMR1IE	52
IPR1	PSPIP ⁽¹⁾	ADIP	RCIP	TXIP	SSPIP	CCP1IP	TMR2IP	TMR1IP	52
RCSTA	SPEN	RX9	SREN	CREN	ADDEN	FERR	OERR	RX9D	51
RCREG	EUSART 接收寄存器								51
TXSTA	CSRC	TX9	TXEN	SYNC	SENDB	BRGH	TRMT	TX9D	51
BAUDCON	ABDOVF	RCIDL	—	SCKP	BRG16	—	WUE	ABDEN	51
SPBRGH	EUSART 波特率发生器寄存器的高字节								51
SPBRG	EUSART 波特率发生器寄存器的低字节								51

图注： — = 未实现单元，读为 0。异步接收不使用阴影单元。

注 1： 在 28 引脚器件中保留；始终保持这些位清零。

18.2.4 同步间隔字符自动唤醒

在休眠模式下，EUSART 的所有时钟都会暂停。因此，波特率发生器处于非激活状态，且无法进行正确的数据接收。自动唤醒功能允许当 RX/DT 线上有事件发生时唤醒控制器，该功能需要 EUSART 工作在异步模式下。

通过将 WUE 位（BAUDCON<1>）置 1，使能自动唤醒功能。该功能启用后，将禁止 RX/DT 上的典型接收操作，且 EUSART 保持在空闲状态并监视唤醒事件（不管 CPU 运行模式如何）。唤醒事件是指 RX/DT 线上发生高电平到低电平的转换。（这刚好与“同步间隔”字符或 LIN 协议唤醒信号字符的启动条件一致。）

唤醒事件后，模块产生一个 RCIF 中断。在正常工作模式下，中断会与 Q 时钟同步产生（图 18-8）；如果器件处于休眠模式，则两者是不同步的（图 18-9）。通过读 RCREG 寄存器可清除中断条件。

唤醒事件后，当 RX 线上出现由低向高的电平转换时，WUE 位自动清零。此时，EUSART 模块将从空闲状态返回正常工作模式，由此用户可知“同步间隔”事件已经结束。

18.2.4.1 使用自动唤醒功能的特别注意事项

因为自动唤醒功能是通过检测RX/DT上的上升沿跳变实现的，所以在停止位前该引脚上任何的状态改变都可能产生错误的结束字符并导致数据或帧错误。因此，为了确保正常的传输，必须首先发送全0字符。对于标准的RS-232器件，该字符是00h（8位），而对于LIN总线器件则是000h（12位）。

另外还必须考虑振荡器起振时间，尤其在采用起振时间较长的振荡器（即，XT或HS模式）应用中更要注意这一点。“同步间隔”（或唤醒信号）字符必须足够长，并且跟有足够长的时间间隔，以便使选定振荡器有充足的时间起振来保证EUSART正确初始化。

18.2.4.2 使用WUE位的特别注意事项

使用WUE和RCIF事件的时序来判断接收数据的有效性时，有可能会引起一些混淆。如前所述，将WUE位置1会使EUSART进入空闲状态。唤醒事件会通过将RCIF位置1产生一个接收中断。此后当RX/DT出现上升沿时，WUE位被清零。然后通过读RCREG寄存器清除中断条件。一般情况下，RCREG中的数据是无效数据，应该丢弃。

WUE位清零（或仍然置1）同时RCIF标志位置1并不能表明RCREG中接收的数据是完整的。用户应该考虑在固件中同时验证是否完整地接收了数据。

要确保没有丢失有效数据，应检查RCIDL位来验证是否还在接收数据。如果不在接收数据，则可将WUE位置1，使器件立即进入休眠模式。

图 18-8: 正常工作模式下的自动唤醒位（WUE）时序

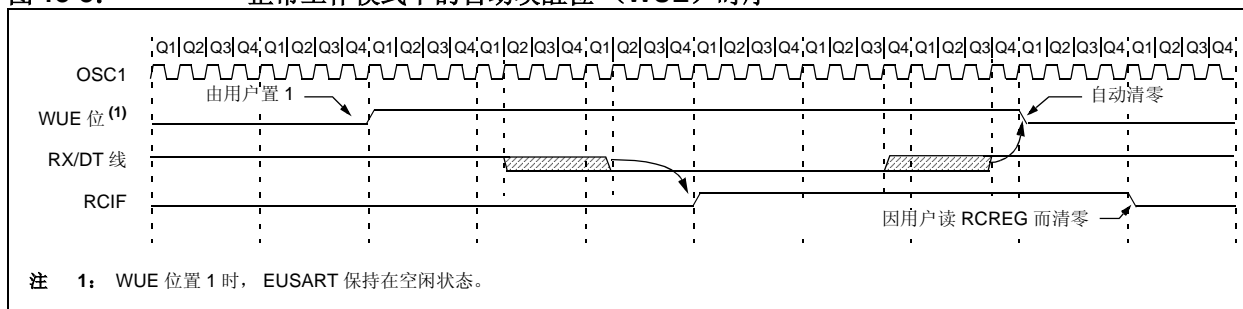
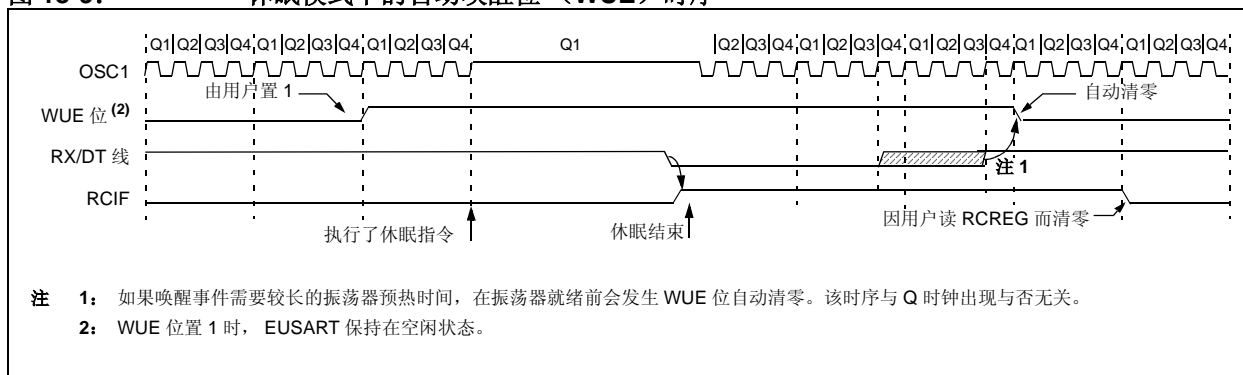


图 18-9: 休眠模式下的自动唤醒位（WUE）时序



PIC18F2423/2523/4423/4523

18.2.5 间隔字符序列

EUSART 模块能够发送符合 LIN 总线标准的特殊间隔字符序列。发送的间隔字符包括 1 个起始位，后面跟有 12 个 0 位和 1 个停止位。当发送移位寄存器装有数据时，只要 SENDB 和 TXEN 位 (TXSTA<3> 和 TXSTA<5>) 置 1，就会发送帧间隔字符。请注意写入 TXREG 的数据值会被忽略，并会发送全 0。

在发送了相应的停止位后，硬件会自动将 SENDB 位复位。这样用户可以在间隔字符（在 LIN 规范中通常是同步字符）后预先将下一个要发送字节装入发送 FIFO。

请注意在发送间隔字符时写入 TXREG 的数据值会被忽略。写入仅仅是为了启动正确的序列。

正如其在正常发送操作中一样，TRMT 位表明发送正在进行还是处于空闲状态。关于发送间隔字符的时序，请参见图 18-10。

18.2.5.1 间隔和同步发送序列

下述序列会发送一个报文帧头，包括一个间隔字符和其后的自动波特率同步字节。此序列适用于典型的 LIN 总线主器件。

1. 将 EUSART 配置为所需的模式。
2. 将 TXEN 和 SENDB 位置 1，以设置间隔字符。

3. 将无效字符装入 TXREG，启动发送（该值会被忽略）。
4. 将 55h 写入 TXREG，以便把同步字符装入 FIFO 缓冲器。
5. 间隔字符发送后，硬件会将 SENDB 位复位。此时，同步字符会以预先配置的模式发送。

当 TXREG 为空时（由 TXIF 指示），下一个数据字节会写入 TXREG。

18.2.6 接收间隔字符

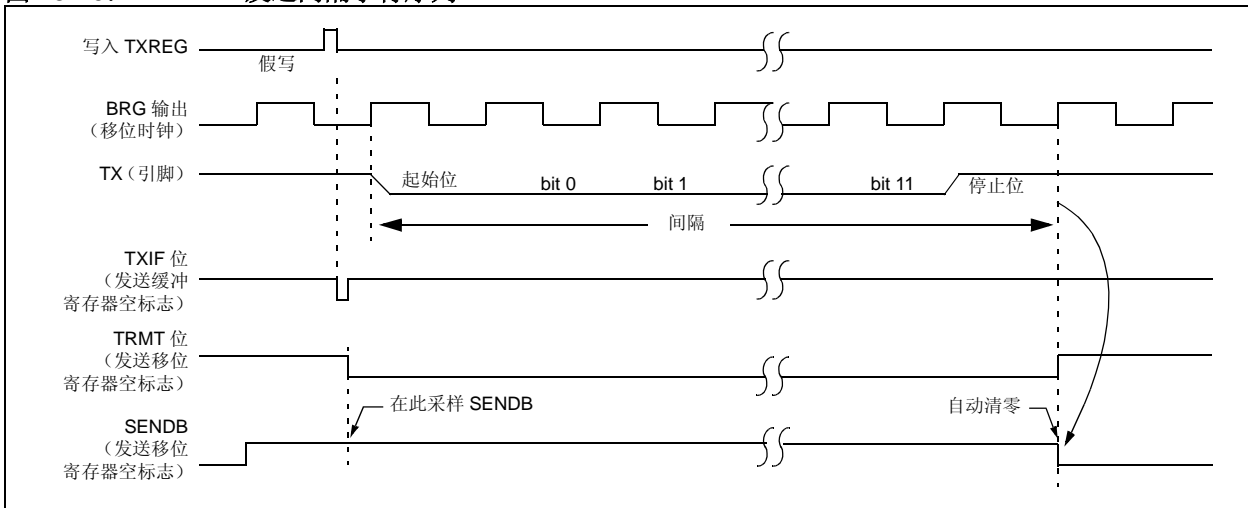
增强型 USART 模块接收间隔字符有两种方法。

第一种方法是强制将波特率配置为典型速率的 9/13。这可以使停止位在正确的采样点（对于间隔字符为起始位之后的 13 位，对于典型数据则是 8 个数据位）产生。

第二种方法是使用第 18.2.4 节“同步间隔字符自动唤醒”中描述的自动唤醒功能。通过使能此功能，EUSART 将采样 RX/DT 上电平的下两次跳变，产生一个 RCIF 中断，接收下一个数据字节，并在随后产生另一个中断。

请注意在间隔字符后，用户通常希望使能自动波特率检测功能。无论使用哪种方法，用户都可以在检测到 TXIF 中断时马上将 ABD 位置 1。

图 18-10: 发送间隔字符序列



18.3 EUSART 同步主控模式

将 CSRC 位 (TXSTA<7>) 置 1 可以进入同步主控模式。在此模式下, 数据以半双工方式发送 (即发送和接收不能同时进行)。发送数据时禁止接收, 反之亦然。将 SYNC 位 (TXSTA<4>) 置 1 可以进入同步模式。此外, 应将使能位 SPEN (RCSTA<7>) 置 1, 分别把 TX 和 RX 引脚配置为 CK (时钟) 和 DT (数据) 线。

主控模式意味着处理器在 CK 时钟线上发送主控时钟信号。时钟极性是通过 SCKP 位 (BAUDCON<4>) 选择的。将 SCKP 置 1 是将空闲状态时的 CK 设为高电平, 将该位清零则将空闲状态时的 CK 设为低电平。此选项支持将本模块与 Microwire 器件配合使用。

18.3.1 EUSART 同步主控发送

图 18-3 给出了 EUSART 发送器框图。发送器的核心是发送 (串行) 移位寄存器 (TSR)。移位寄存器从读 / 写发送缓冲寄存器 TXREG 中获取数据。TXREG 寄存器中的数据由软件装入。在前一次装入数据的最后一位发送完成后, 才向 TSR 寄存器装入新数据。一旦最后一位发送完成, 就会将 TXREG 寄存器的新数据 (如果有) 装入 TSR。

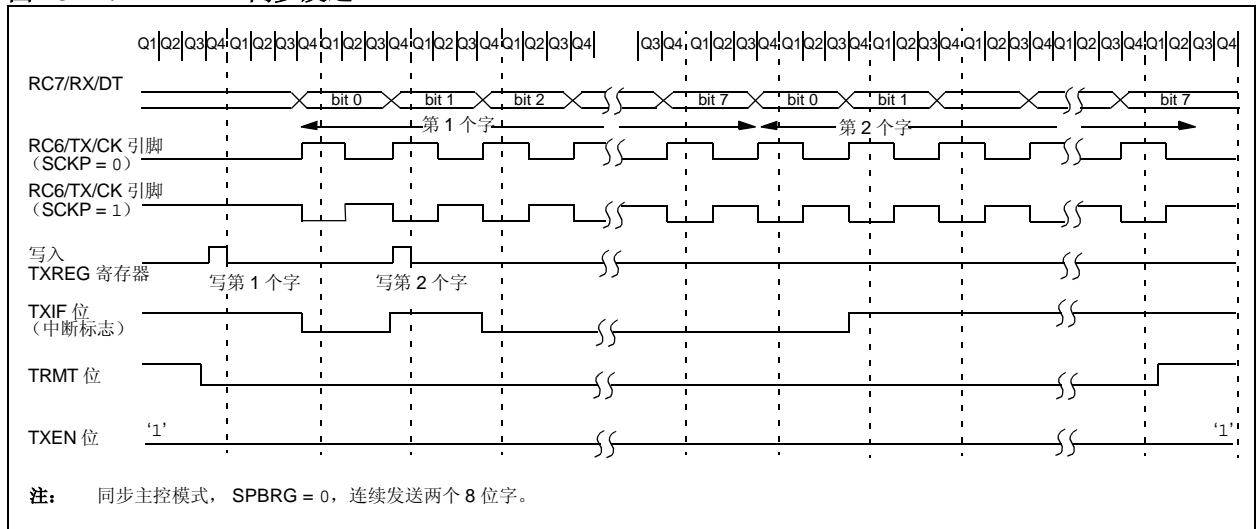
一旦 TXREG 寄存器向 TSR 寄存器传输了数据 (在 1 个 T_{cy} 内发生), TXREG 寄存器就为空, 同时标志位 TXIF (PIR1<4>) 被置 1。可以通过将中断允许位 TXIE (PIE1<4>) 置 1 或清零来允许或禁止该中断。TXIF 被置 1 不受 TXIE 状态的影响, 且不能用软件清零。只有在新数据装入 TXREG 寄存器时, TXIF 才会复位。

TXIF 表示的是 TXREG 寄存器的状态, 而另一个标志位 TRMT (TXSTA<1>) 则表示 TSR 寄存器的状态。TRMT 位是一个只读位, 当 TSR 为空时, TRMT 被置 1。TRMT 位与任何中断逻辑均无关联, 因此要确定 TSR 寄存器是否为空, 用户只能对此位进行查询。TSR 并未映射到数据存储寄存器中, 所以用户不能直接访问它。

设置同步主控发送操作的步骤如下:

1. 对 SPBRGH:SPBRG 寄存器进行初始化, 设置合适的波特率。按需要将 BRG16 位置 1 或清零, 以获得所需的波特率。
2. 通过将 SYNC、SPEN 和 CSRC 位置 1, 使能同步主控串口。
3. 如果需要中断, 将允许位 TXIE 置 1。
4. 如果需要 9 位发送, 将 TX9 位置 1。
5. 将 TXEN 位置 1, 使能发送。
6. 如果选择了 9 位发送, 将第 9 位装入 TX9D 位。
7. 将数据装入 TXREG 寄存器, 启动发送。
8. 如果使用中断, 应确保 INTCON 寄存器中的 GIE 和 PEIE 位 (INTCON<7:6>) 置 1。

图 18-11: 同步发送



PIC18F2423/2523/4423/4523

图 18-12: 同步发送 (由 TXEN 位控制)

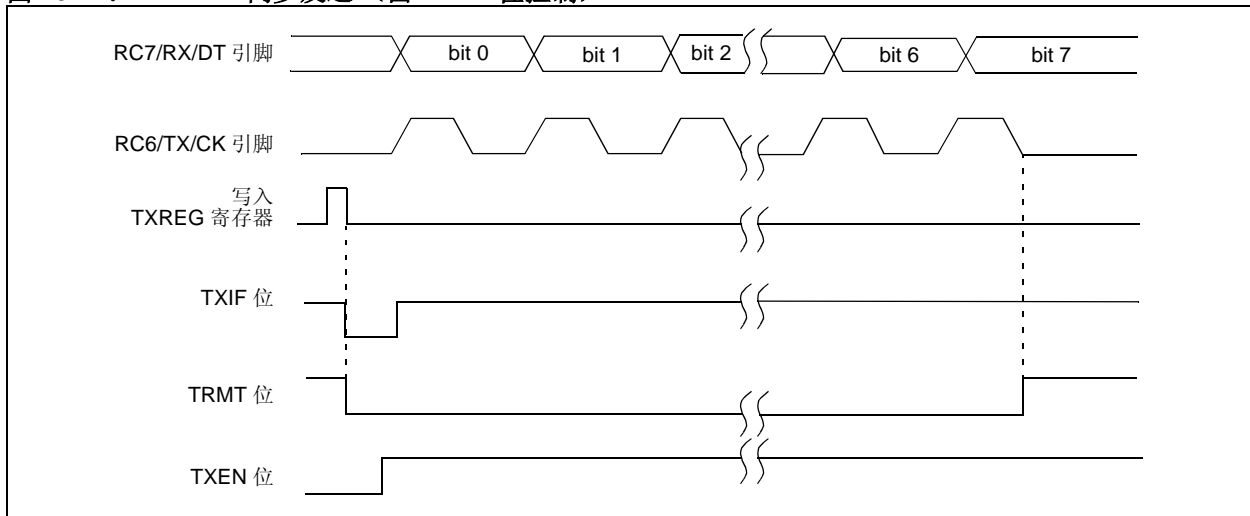


表 18-7: 与同步主控发送相关的寄存器

名称	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	复位值 所在页
INTCON	GIE/GIEH	PEIE/GIEL	TMR0IE	INT0IE	RBIE	TMR0IF	INT0IF	RBIF	49
PIR1	PSPIF ⁽¹⁾	ADIF	RCIF	TXIF	SSPIF	CCP1IF	TMR2IF	TMR1IF	52
PIE1	PSPIE ⁽¹⁾	ADIE	RCIE	TXIE	SSPIE	CCP1IE	TMR2IE	TMR1IE	52
IPR1	PSPIP ⁽¹⁾	ADIP	RCIP	TXIP	SSPIP	CCP1IP	TMR2IP	TMR1IP	52
RCSTA	SPEN	RX9	SREN	CREN	ADDEN	FERR	OERR	RX9D	51
TXREG	EUSART 发送寄存器								51
TXSTA	CSRC	TX9	TXEN	SYNC	SENDB	BRGH	TRMT	TX9D	51
BAUDCON	ABDOVF	RCIDL	—	SCKP	BRG16	—	WUE	ABDEN	51
SPBRGH	EUSART 波特率发生器寄存器的高字节								51
SPBRG	EUSART 波特率发生器寄存器的低字节								51

图注: — = 未实现, 读为 0。同步主控发送不使用阴影单元。

注 1: 在 28 引脚器件中保留; 始终保持这些位清零。

18.3.2 EAUSART 同步主控接收

一旦选择了同步模式，只要将单字节接收使能位 SREN (RCSTA<5>) 或连续接收使能位 CREN (RCSTA<4>) 置 1，即可使能接收。在时钟的下降沿采样 RX 引脚上的数据。

如果使能位 SREN 置 1，则只接收单个字。如果将使能位 CREN 置 1，则会连续接收数据，直到将 CREN 位清零。如果两个位均被置 1，则 CREN 优先。

设置同步主控接收操作的步骤如下：

1. 对 SPBRGH:SPBRG 寄存器进行初始化，设置合适的波特率。按需要将 BRG16 位置 1 或清零，以获得所需的波特率。
2. 通过将 SYNC、SPEN 和 CSRC 位置 1，使能同步主控串口。

3. 确保将 CREN 和 SREN 位清零。
4. 如果需要中断，将允许位 RCIE 置 1。
5. 如果需要接收 9 位数据，将 RX9 位置 1。
6. 如果需要单字接收，将 SREN 位置 1。如果需要连续接收，将 CREN 位置 1。
7. 当接收完成时中断标志位 RCIF 将置 1，此时如果中断允许位 RCIE 已置 1，则还将产生一个中断。
8. 读 RCSTA 寄存器获取第 9 位数据（如果已使能），并判断在接收过程中是否发生了错误。
9. 读 RCREG 寄存器来读取接收到的 8 位数据。
10. 如果发生错误，将 CREN 位清零以清除错误。
11. 如果使用中断，应确保 INTCON 寄存器中的 GIE 和 PEIE 位 (INTCON<7:6>) 置 1。

图 18-13: 同步接收（主控模式，SREN）

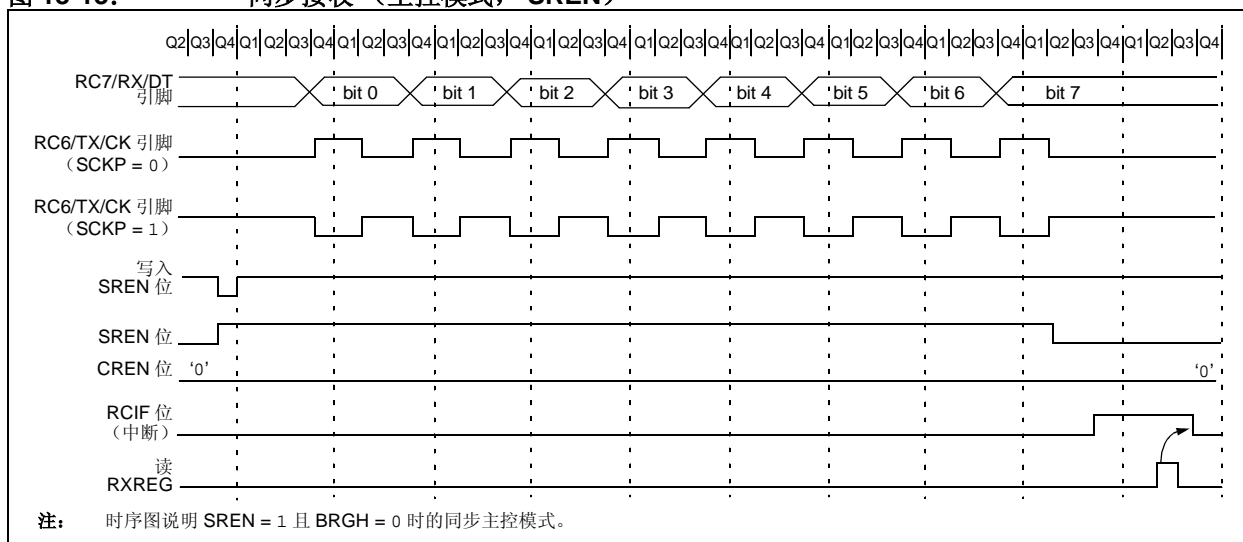


表 18-8: 与同步主控接收相关的寄存器

名称	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	复位值所在页
INTCON	GIE/GIEH	PEIE/GIEL	TMR0IE	INT0IE	RBIE	TMR0IF	INT0IF	RBIF	49
PIR1	PSPIF ⁽¹⁾	ADIF	RCIF	TXIF	SSPIF	CCP1IF	TMR2IF	TMR1IF	52
PIE1	PSPIE ⁽¹⁾	ADIE	RCIE	TXIE	SSPIE	CCP1IE	TMR2IE	TMR1IE	52
IPR1	PSPIP ⁽¹⁾	ADIP	RCIP	TXIP	SSPIP	CCP1IP	TMR2IP	TMR1IP	52
RCSTA	SPEN	RX9	SREN	CREN	ADDEN	FERR	OERR	RX9D	51
RCREG	EUSART 接收寄存器								51
TXSTA	CSRC	TX9	TXEN	SYNC	SENDB	BRGH	TRMT	TX9D	51
BAUDCON	ABDOVF	RCIDL	—	SCKP	BRG16	—	WUE	ABDEN	51
SPBRGH	EUSART 波特率发生器寄存器的高字节								51
SPBRG	EUSART 波特率发生器寄存器的低字节								51

图注：— = 未实现，读为 0。同步主控接收不使用阴影单元。

注 1：在 28 引脚器件中保留；始终保持这些位清零。

PIC18F2423/2523/4423/4523

18.4 EUSART 同步从动模式

将 CSRC (TXSTA<7>) 清零可进入同步从动模式。此模式与同步主控模式的区别在于移位时钟由 CK 引脚上的外部时钟提供 (主控模式中由内部时钟提供)。这使得器件能在任何低功耗模式下发送或接收数据。

18.4.1 EUSART 同步从动发送

除了休眠模式以外, 同步主控模式和从动模式的工作方式是相同的。

如果向 TXREG 写 2 个字, 然后执行 SLEEP 指令, 则会发生以下事件:

- a) 第一个字立即传送到 TSR 寄存器进行发送。
- b) 第二个字仍保留在 TXREG 寄存器中。
- c) 不会将标志位 TXIF 置 1。
- d) 当第一个字移出 TSR 后, TXREG 寄存器将把第二个字传送给 TSR, 同时将标志位 TXIF 置 1。
- e) 如果中断允许位 TXIE 置 1, 中断将把器件从休眠状态唤醒。如果允许了全局中断, 程序则会跳转到中断向量处执行。

设置同步从动发送的步骤如下:

1. 通过将 SYNC 和 SPEN 位置 1 并将 CSRC 位清零, 使能同步从动串口。
2. 将 CREN 和 SREN 位清零。
3. 如果需要中断, 将允许位 TXIE 置 1。
4. 如果需要 9 位发送, 将 TX9 位置 1。
5. 将使能位 TXEN 置 1 以使能发送。
6. 如果选择了 9 位发送, 将第 9 位装入 TX9D 位。
7. 将数据装入 TXREGx 寄存器, 启动发送。
8. 如果使用中断, 应确保 INTCON 寄存器中的 GIE 和 PEIE 位 (INTCON<7:6>) 置 1。

表 18-9: 与同步从动发送相关的寄存器

名称	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	复位值 所在页
INTCON	GIE/GIEH	PEIE/GIEL	TMR0IE	INT0IE	RBIE	TMR0IF	INT0IF	RBIF	49
PIR1	PSPIF ⁽¹⁾	ADIF	RCIF	TXIF	SSPIF	CCP1IF	TMR2IF	TMR1IF	52
PIE1	PSPIE ⁽¹⁾	ADIE	RCIE	TXIE	SSPIE	CCP1IE	TMR2IE	TMR1IE	52
IPR1	PSPIP ⁽¹⁾	ADIP	RCIP	TXIP	SSPIP	CCP1IP	TMR2IP	TMR1IP	52
RCSTA	SPEN	RX9	SREN	CREN	ADDEN	FERR	OERR	RX9D	51
TXREG	EUSART 发送寄存器								51
TXSTA	CSRC	TX9	TXEN	SYNC	SENDB	BRGH	TRMT	TX9D	51
BAUDCON	ABDOVF	RCIDL	—	SCKP	BRG16	—	WUE	ABDEN	51
SPBRGH	EUSART 波特率发生器寄存器的高字节								51
SPBRG	EUSART 波特率发生器寄存器的低字节								51

图注: — = 未实现, 读为 0。同步从动发送不使用阴影单元。

注 1: 在 28 引脚器件中保留; 始终保持这些位清零。

18.4.2 EUSART 同步从动接收

除了休眠模式、空闲模式以及在从动模式下忽略 SREN 位以外，同步主控和从动模式的工作方式完全相同。

如果在进入休眠或空闲模式前将 CREN 位置 1 使能接收，那么在低功耗模式下可以接收到一个数据字。接收到该字后，RSR 寄存器将把数据发送到 RCREG 寄存器。如果中断允许位 RCIE 已置 1，产生的中断将把芯片从低功耗模式唤醒。如果允许了全局中断，程序则会跳转到中断向量处执行。

设置同步从动接收操作的步骤如下：

1. 通过将 SYNC 和 SPEN 位置 1 并将 CSRC 位清零，使能同步从动串口。
2. 如果需要中断，将允许位 RCIE 置 1。
3. 如果需要接收 9 位数据，将 RX9 位置 1。
4. 将使能位 CREN 置 1 以使能接收。
5. 当接收完成时，RCIF 位将被置 1。如果中断允许位 RCIE 已置 1，则还将产生一个中断。
6. 读 RCSTA 寄存器获取第 9 位数据（如果已使能），并判断在接收过程中是否发生了错误。
7. 读 RCREG 寄存器来读取接收到的 8 位数据。
8. 如果发生错误，将 CREN 位清零以清除错误。
9. 如果使用中断，应确保 INTCON 寄存器中的 GIE 和 PEIE 位（INTCON<7:6>）置 1。

表 18-10: 与同步从动接收相关的寄存器

名称	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	复位值所在页
INTCON	GIE/GIEH	PEIE/GIEL	TMR0IE	INT0IE	RBIE	TMR0IF	INT0IF	RBIF	49
PIR1	PSPIF ⁽¹⁾	ADIF	RCIF	TXIF	SSPIF	CCP1IF	TMR2IF	TMR1IF	52
PIE1	PSPIE ⁽¹⁾	ADIE	RCIE	TXIE	SSPIE	CCP1IE	TMR2IE	TMR1IE	52
IPR1	PSPIP ⁽¹⁾	ADIP	RCIP	TXIP	SSPIP	CCP1IP	TMR2IP	TMR1IP	52
RCSTA	SPEN	RX9	SREN	CREN	ADDEN	FERR	OERR	RX9D	51
RCREG	EUSART 接收寄存器								51
TXSTA	CSRC	TX9	TXEN	SYNC	SENDB	BRGH	TRMT	TX9D	51
BAUDCON	ABDOVF	RCIDL	—	SCKP	BRG16	—	WUE	ABDEN	51
SPBRGH	EUSART 波特率发生器寄存器的高字节								51
SPBRG	EUSART 波特率发生器寄存器的低字节								51

图注： — = 未实现，读为 0。同步从动接收不使用阴影单元。

注 1： 在 28 引脚器件中保留；始终保持这些位清零。

PIC18F2423/2523/4423/4523

注:

19.0 12位模数转换器 (A/D) 模块

28 引脚器件的模数 (Analog-to-Digital, A/D) 转换器模块有 10 路输入, 40/44 引脚器件有 13 路输入。此模块能将一个模拟输入信号转换成相应的 12 位数字信号。

此模块有五个寄存器:

- A/D 转换结果高位寄存器 (ADRESH)
- A/D 转换结果低位寄存器 (ADRESL)
- A/D 转换控制寄存器 0 (ADCON0)
- A/D 转换控制寄存器 1 (ADCON1)
- A/D 转换控制寄存器 2 (ADCON2)

ADCON0 寄存器 (如寄存器 19-1 所示) 控制 A/D 模块的工作。ADCON1 寄存器 (如寄存器 19-2 所示) 配置端口引脚功能。ADCON2 寄存器 (如寄存器 19-3 所示) 配置 A/D 时钟源、可编程采样时间和输出结果的对齐方式。

寄存器 19-1: ADCON0: A/D 控制寄存器 0

U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
—	—	CHS3	CHS2	CHS1	CHS0	GO/DONE	ADON
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位	W = 可写位	U = 未实现位, 读为 0
-n = POR 值	1 = 置 1	0 = 清零
		x = 未知

- bit 7-6 **未实现:** 读为 0
- bit 5-2 **CHS3:CHS0:** 模拟通道选择位
 - 0000 = 通道 0 (AN0)
 - 0001 = 通道 1 (AN1)
 - 0010 = 通道 2 (AN2)
 - 0011 = 通道 3 (AN3)
 - 0100 = 通道 4 (AN4)
 - 0101 = 通道 5 (AN5) ^(1,2)
 - 0110 = 通道 6 (AN6) ^(1,2)
 - 0111 = 通道 7 (AN7) ^(1,2)
 - 1000 = 通道 8 (AN8)
 - 1001 = 通道 9 (AN9)
 - 1010 = 通道 10 (AN10)
 - 1011 = 通道 11 (AN11)
 - 1100 = 通道 12 (AN12)
 - 1101 = 未实现 ⁽²⁾
 - 1110 = 未实现 ⁽²⁾
 - 1111 = 未实现 ⁽²⁾
- bit 1 **GO/DONE:** A/D 转换状态位
 - 当 ADON = 1 时:
 - 1 = A/D 转换正在进行
 - 0 = A/D 空闲
- bit 0 **ADON:** A/D 模块使能位
 - 1 = 使能 A/D 转换器模块
 - 0 = 禁止 A/D 转换器模块

- 注**
- 1: 这些通道在 28 引脚器件上未实现。
 - 2: 对未实现通道执行转换会返回悬空输入的测量值。

PIC18F2423/2523/4423/4523

寄存器 19-2: ADCON1: A/D 控制寄存器 1

U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0 ⁽¹⁾	R/W ⁽¹⁾	R/W ⁽¹⁾	R/W ⁽¹⁾
—	—	VCFG1	VCFG0	PCFG3	PCFG2	PCFG1	PCFG0
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

bit 7-6 **未实现:** 读为 0

bit 5 **VCFG1:** 参考电压配置位 (VREF- 电压源)

1 = VREF- (AN2)

0 = VSS

bit 4 **VCFG0:** 参考电压配置位 (VREF+ 电压源)

1 = VREF+ (AN3)

0 = VDD

bit 3-0 **PCFG3:PCFG0:** A/D 端口配置控制位:

PCFG3: PCFG0	AN12	AN11	AN10	AN9	AN8	AN7 ⁽²⁾	AN6 ⁽²⁾	AN5 ⁽²⁾	AN4	AN3	AN2	AN1	AN0
0000 ⁽¹⁾	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
0001	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
0010	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
0011	D	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
0100	D	D	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
0101	D	D	D	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
0110	D	D	D	D	A	A	A	A	A	A	A	A	A
0111 ⁽¹⁾	D	D	D	D	D	A	A	A	A	A	A	A	A
1000	D	D	D	D	D	D	A	A	A	A	A	A	A
1001	D	D	D	D	D	D	D	A	A	A	A	A	A
1010	D	D	D	D	D	D	D	D	A	A	A	A	A
1011	D	D	D	D	D	D	D	D	D	A	A	A	A
1100	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	A	A	A
1101	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	A	A
1110	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	A
1111	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D

A = 模拟输入

D = 数字 I/O

注 1: PCFG 位的 POR 值取决于 PBADEN 配置位的值。当 PBADEN = 1 时, PCFG<3:0> = 0000; 当 PBADEN = 0 时, PCFG<3:0> = 0111。

2: AN5 到 AN7 仅在 40/44 引脚器件上可用。

PIC18F2423/2523/4423/4523

寄存器 19-3: **ADCON2: A/D 控制寄存器 2**

R/W-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
ADFM	—	ACQT2	ACQT1	ACQT0	ADCS2	ADCS1	ADCS0
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

bit 7 **ADFM:** A/D 结果格式选择位

1 = 右对齐

0 = 左对齐

bit 6 **未实现:** 读为 0

bit 5-3 **ACQT2:ACQT0:** A/D 采集时间选择位

111 = 20 个 TAD

110 = 16 个 TAD

101 = 12 个 TAD

100 = 8 个 TAD

011 = 6 个 TAD

010 = 4 个 TAD

001 = 2 个 TAD

000 = 0 个 TAD⁽¹⁾

bit 2-0 **ADCS2:ADCS0:** A/D 转换时钟选择位

111 = FRC (时钟来自 A/D 模块 RC 振荡器) ⁽¹⁾

110 = FOSC/64

101 = FOSC/16

100 = FOSC/4

011 = FRC (时钟来自 A/D 模块 RC 振荡器) ⁽¹⁾

010 = FOSC/32

001 = FOSC/8

000 = FOSC/2

注 1: 如果选择了 FRC 时钟源, 在 A/D 时钟启动之前会加上一个 T_{cy} (指令周期) 的延时。这可以保证在开始转换之前执行 SLEEP 指令。

PIC18F2423/2523/4423/4523

可通过软件选择器件的正负电源电压（VDD 和 VSS）或 RA3/AN3/VREF+ 和 RA2/AN2/VREF-/CVREF 引脚上的电压作为 A/D 转换的模拟参考电压。

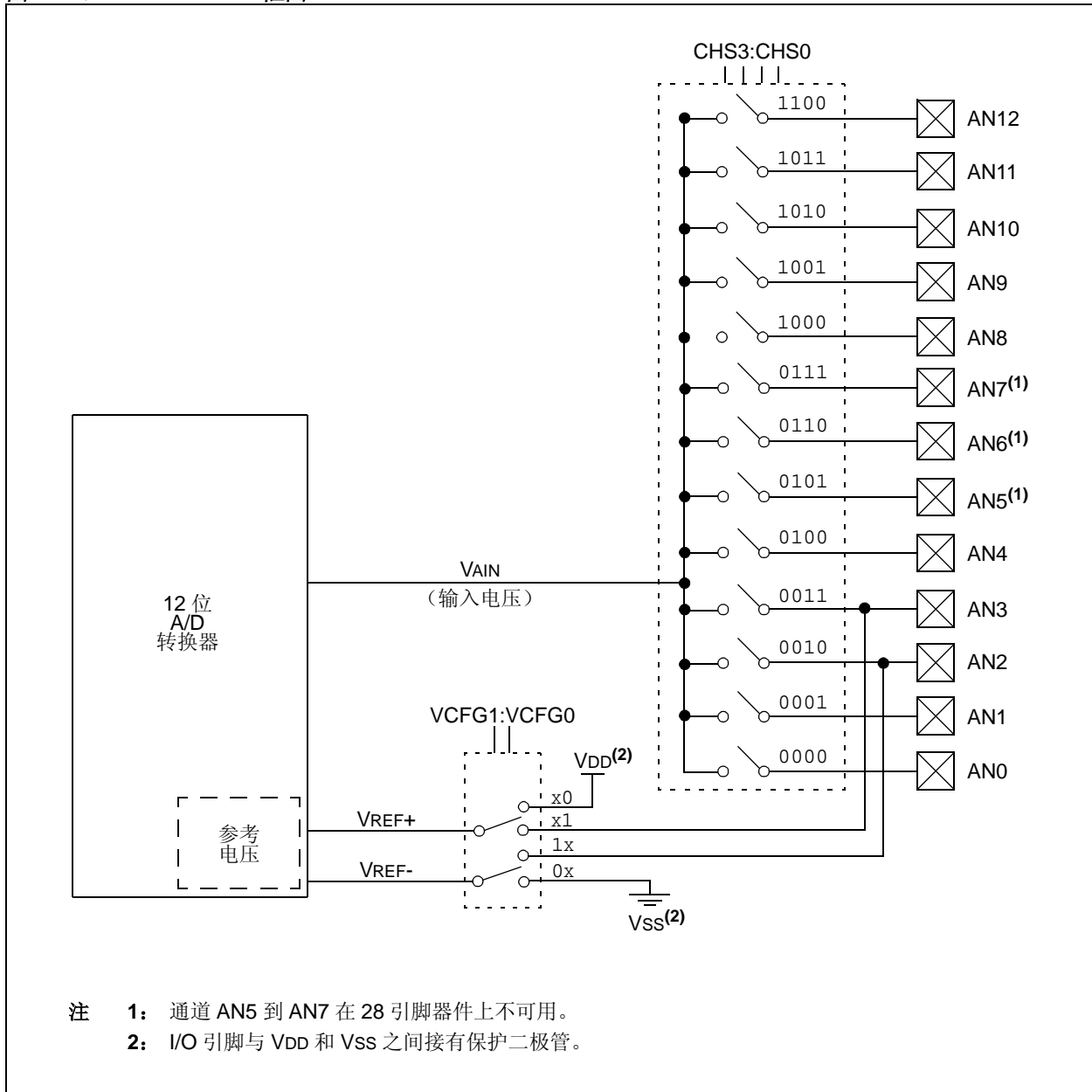
A/D 转换器具有可在休眠状态下工作的特性。要使 A/D 转换器在休眠状态下工作，其时钟必须来自于 A/D 模块内部的 RC 振荡器。

采样保持电路的输出是转换器的输入，A/D 转换器采用逐次逼近法得到转换结果。

器件复位将强制所有寄存器进入复位状态。这将迫使 A/D 模块关闭并中止正在进行的转换。

与 A/D 转换器相关的每个端口引脚都可以被配置为模拟输入或数字 I/O。ADRESH 和 ADRESL 寄存器保存 A/D 转换的结果。当 A/D 转换完成时，结果被装入 ADRESH:ADRESL 寄存器，GO/DONE 位（在 ADCON0 寄存器中）被清零且 A/D 中断标志位 ADIF 被置 1。图 19-1 给出了 A/D 模块的框图。

图 19-1: A/D 框图



- 注 1: 通道 AN5 到 AN7 在 28 引脚器件上不可用。
 注 2: I/O 引脚与 VDD 和 VSS 之间接有保护二极管。

POR 和 BOR 复位后, ADRESH:ADRESL 寄存器的值不确定, 并且不受任何其他复位的影响。

按要求配置好 A/D 模块后, 在开始转换之前必须采集选定的通道。模拟输入通道的相应 TRIS 位必须设置为输入。采集时间的确定, 请参见第 19.1 节 “A/D 采集要求”。在采集完成之后, 即可启动 A/D 转换。采集时间可以被编程置于 GO/DONE 位置 1 和实际启动转换之间。

在执行 A/D 转换时应该遵循以下步骤:

1. 配置 A/D 模块:
 - 配置模拟引脚、参考电压和数字 I/O (通过 ADCON1 寄存器)
 - 选择 A/D 输入通道 (通过 ADCON0 寄存器)
 - 选择 A/D 采集时间 (通过 ADCON2 寄存器)
 - 选择 A/D 转换时钟 (通过 ADCON2 寄存器)
 - 使能 A/D 模块 (通过 ADCON0 寄存器)
2. 需要时, 配置 A/D 中断:
 - ADIF 位清零
 - ADIE 位置 1
 - GIE 位置 1
3. 需要时, 等待所需的采样时间。
4. 启动转换:
 - 将 GO/DONE 位置 1 (通过 ADCON0 寄存器)

5. 等待 A/D 转换完成, 可通过以下两种方法之一来判断转换是否完成:
 - 查询 GO/DONE 位是否被清零
 或
 - 等待 A/D 中断
6. 读取 A/D 结果寄存器 (ADRESH:ADRESL), 需要时将 ADIF 位清零。
7. 如需进行下一次 A/D 转换, 返回步骤 1 或步骤 2。每位的 A/D 转换时间定义为 T_{AD} 。在下次采集开始前需要等待至少 $2 T_{AD}$ 的时间。

图 19-2: A/D 传递函数

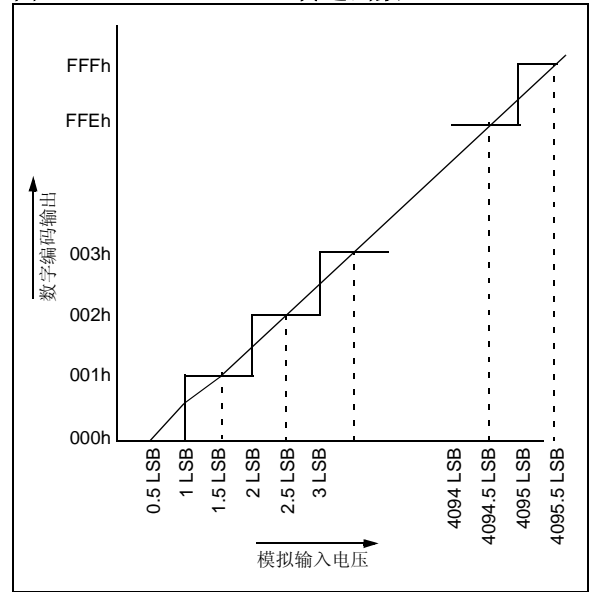
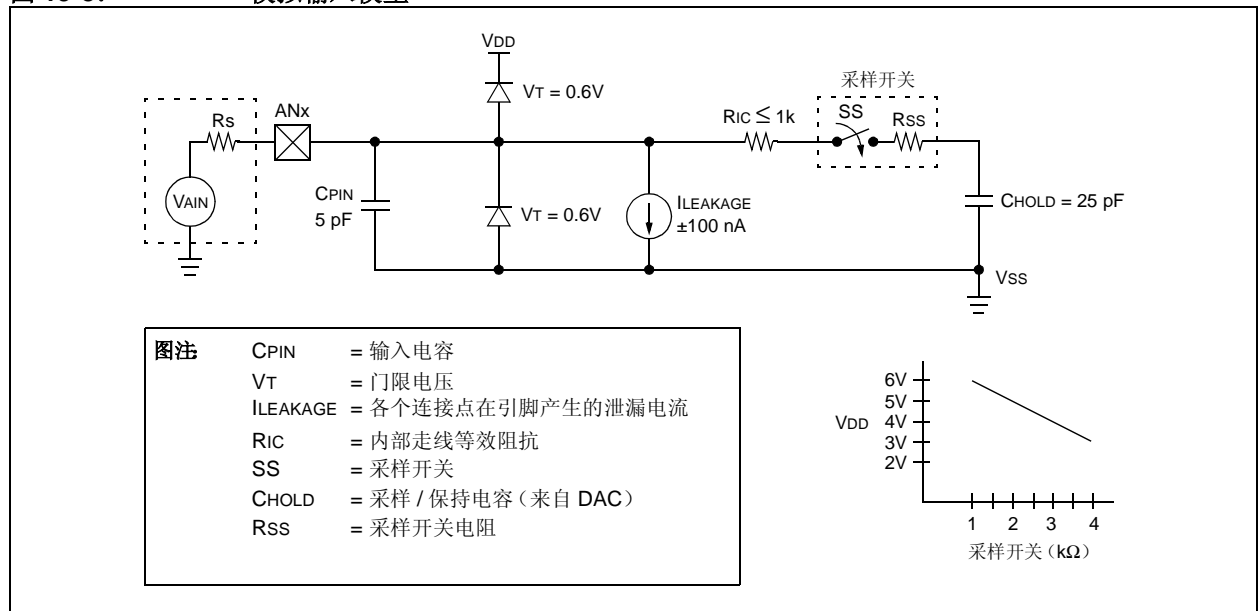


图 19-3: 模拟输入模型



PIC18F2423/2523/4423/4523

19.1 A/D 采集要求

为了使 A/D 转换器达到规定的精度，必须使充电保持电容（CHOLD）充满至输入通道的电压值。模拟输入模型见图 19-3。信号源阻抗（Rs）和内部采样开关阻抗（Rss）直接影响给电容 CHOLD 充电所需要的时间。采样开关阻抗（Rss）值随器件电压（VDD）变化而改变。信号源阻抗影响模拟输入的失调电压（由于引脚泄漏电流的原因）。**模拟信号源的最大阻抗推荐值为 2.5 kΩ。**选择（改变）模拟输入通道后，必须对通道进行采样才能启动转换，采集时间必须大于最小采集时间。

注： 当开始转换时，将保持电容与输入引脚断开。

可以使用公式 19-1 来计算最小采集时间。该公式假设误差为 1/2 LSB（A/D 转换需要 4096 步）。1/2 LSB 误差是 A/D 达到规定分辨率所允许的最大误差。

例 19-3 显示了所需的最小采集时间 TACQ 的计算过程。计算结果基于以下对应用系统的假设：

CHOLD	=	25 pF
Rs	=	2.5 kΩ
转换误差	≤	1/2 LSB
VDD	=	3V → Rss = 4 kΩ
温度	=	85°C（系统最大值）

公式 19-1: 采集时间

$$\begin{aligned} TACQ &= \text{放大器稳定时间} + \text{保持电容充电时间} + \text{温度系数} \\ &= TAMP + TC + TCOFF \end{aligned}$$

公式 19-2: A/D 最小充电时间

$$\begin{aligned} V_{HOLD} &= (V_{REF} - (V_{REF}/4096)) \cdot (1 - e^{-(Tc/CHOLD)(RIC + R_{SS} + R_s)}) \\ \text{或} \\ Tc &= -(CHOLD)(RIC + R_{SS} + R_s) \ln(1/4096) \end{aligned}$$

公式 19-3: 计算所需要的最小采集时间

$$\begin{aligned} TACQ &= TAMP + Tc + TCOFF \\ TAMP &= 0.2 \mu s \\ TCOFF &= (Temp - 25^\circ C)(0.02 \mu s/^\circ C) \\ &= (85^\circ C - 25^\circ C)(0.02 \mu s/^\circ C) \\ &= 1.2 \mu s \end{aligned}$$

只有在温度 > 25°C 时才需要温度系数。当温度低于 25°C 时，TCOFF = 0 ms。

$$\begin{aligned} Tc &= -(CHOLD)(RIC + R_{SS} + R_s) \ln(1/4096) \mu s \\ &= -(25 \text{ pF})(1 \text{ k}\Omega + 4 \text{ k}\Omega + 2.5 \text{ k}\Omega) \ln(0.0004883) \mu s \\ &= 1.56 \mu s \\ TACQ &= 0.2 \mu s + 1.56 \mu s + 1.2 \mu s \\ &= 2.96 \mu s \end{aligned}$$

19.2 选择和配置采集时间

用户可以利用 `ADCON2` 寄存器选择采集时间，采集时间发生在每次 `GO/DONE` 位置 1 之后。用户也可以使用自动确定的采集时间。

采集时间可由 `ACQT2:ACQT0` 位 (`ADCON2<5:3>`) 设置，它提供了 2 到 20 T_{AD} 范围。当 `GO/DONE` 位被置 1 时，A/D 模块会继续在选定采集时间内采样输入通道，然后自动开始转换。由于采集时间是已被编程的，因此没有必要在选择通道和将 `GO/DONE` 位置 1 之间另外等待一个采集时间。

当 `ACQT2:ACQT0 = 000` 时选择手动采集。当 `GO/DONE` 位被置 1 时，采样停止并开始转换。用户必须确保在选择所需输入通道和将 `GO/DONE` 位置 1 之间已插入了所需的采集时间。此选项也是 `ACQT2:ACQT0` 位的默认复位状态，并且与不提供可编程采集时间的器件相兼容。

在这两种情况下，当转换完成时，`GO/DONE` 位均被清零，`ADIF` 标志位均被置 1 并且 A/D 开始对当前选择的通道进行采样。如果采集时间已经被编程，那么将不会有任何标志指示采集时间是否结束，或转换是否开始。

19.3 选择 A/D 转换时钟

每位的 A/D 转换时间定义为 T_{AD} 。每完成一次 12 位 A/D 转换需要 13 个 T_{AD} 。可用软件选择 A/D 转换的时钟源。 T_{AD} 可有以下 7 种选择：

- 2 Tosc
- 4 Tosc
- 8 Tosc
- 16 Tosc
- 32 Tosc
- 64 Tosc
- 内部 RC 振荡器

为了实现正确的 A/D 转换，A/D 转换时钟 (T_{AD}) 必须尽可能得小，但它必须大于最小 T_{AD} （更多信息，请参见参数 130）。

表 19-1 显示了器件在不同的工作频率下和选择不同的 A/D 时钟源时得到的 T_{AD} 。

表 19-1: 不同器件工作频率下的 T_{AD}

A/D 时钟源 (T_{AD})		假设 T_{AD} 最小值 = 0.8 μ s
工作模式	ADCS2:ADCS0	最大 Fosc
2 Tosc	000	2.50 MHz
4 Tosc	100	5.00 MHz
8 Tosc	001	10.00 MHz
16 Tosc	101	20.00 MHz
32 Tosc	010	40.00 MHz
64 Tosc	110	40.00 MHz
RC ⁽²⁾	x11	1.00 MHz ⁽¹⁾

注 1: RC 时钟源的典型 T_{AD} 时间为 2.5 μ s。

注 2: 当器件工作频率高于 1 MHz 时，整个转换过程必须在休眠模式下进行，或者使用 Fosc 分频器。否则，A/D 转换精度可能超出规范允许的范围。

PIC18F2423/2523/4423/4523

19.4 在功耗管理模式下的操作

在功耗管理模式下，自动采集时间和 A/D 转换时钟的选择一定程度上可由时钟源和频率决定。

如果希望器件处于功耗管理模式时进行 A/D 采集转换，就应该根据使用的时钟源对 ADCON2 中的 ADCS2:ADCS0 位进行更新。ACQT2:ACQT0 位不需要像 ADCS2:ADCS0 位那样调整 TAD 时间以获得新的时钟速度。在进入功耗管理模式之后，就可以开始 A/D 采集或转换。采集或转换开始以后，器件应继续使用相同的时钟源直到转换完成。

如果需要，在转换期间也可以将器件置于相应的空闲模式。如果器件的时钟频率小于 1 MHz，就应该选择 A/D 模块的 RC 时钟源。

在休眠模式下工作需要选择 A/D 模块的 FRC 时钟。如果将 ACQT2:ACQT0 设置为 000 并启动 A/D 转换，转换将延时一个指令周期以允许执行 SLEEP 指令并进入休眠模式。IDLEN 位 (OSCCON<7>) 必须在转换开始之前被清零。

19.5 配置模拟端口引脚

ADCON1、TRISA、TRISB 和 TRISE 寄存器均可用于配置 A/D 端口引脚。如果希望端口引脚为模拟输入，则必须将相应的 TRIS 位置 1 (输入)。如果将 TRIS 位清零 (输出)，则数字输出电平 (VOH 或 VOL) 将被转换。

A/D 转换与 CHS3:CHS0 位及 TRIS 位的状态无关。

- 注**
- 1: 读取端口寄存器时，所有配置为模拟输入通道的引脚均读为 0 (低电平)。配置为数字输入的引脚，也可以进行模拟量转换。引脚上的电压将被精确转换。
 - 2: 定义为数字输入引脚上的模拟电平可能会导致数字输入缓冲器消耗的电流超出器件规范。
 - 3: 通过控制 ADCON1 中的 PCFG3:PCFG0 位的复位方式，配置寄存器 3H 中的 PBDEN 位可将 PORTB 引脚配置成复位时为模拟或数字引脚。

19.6 A/D 转换

图 19-4 显示了在 $\overline{\text{GO/DONE}}$ 位置 1 且 ACQT2:ACQTO 位被清零后 A/D 转换器的工作状态。转换在下一条指令执行之后开始，以允许器件在转换开始之前进入休眠模式。

图 19-5 显示了在 $\overline{\text{GO/DONE}}$ 位置 1, ACQT2:ACQTO 位被设置为 010, 且在转换开始之前选择 4 TAD 采集时间后 A/D 转换器的工作状态。

在转换期间将 $\overline{\text{GO/DONE}}$ 位清零将中止当前的 A/D 转换。不会用部分完成的 A/D 转换结果更新 A/D 结果寄存器对。这意味着 ADRESH:ADRESL 寄存器仍将保持上一次转换的结果（或上一次写入 ADRESH:ADRESL 寄存器的值）。

在 A/D 转换完成或停止以后，需要等待 2 个 T_{CY} 才能开始下一次采集。等待时间一到，将自动开始对所选通道进行采集。

注： 不应在启动 A/D 转换的指令中将 $\overline{\text{GO/DONE}}$ 位置 1。在使能 A/D 转换后代码应等待至少 3 个 TAD，才能开始采集和转换周期。

19.7 放电

放电过程用于对保持电容的值进行初始化。在每次采样之前都会对电容阵列放电。这一特性有助于优化单位增益放大器，因为电路总是需要为电容阵列充电，而不是根据以前测量的值进行充放电。

图 19-4: A/D 转换 TAD 周期 ($\text{ACQT}\langle 2:0 \rangle = 000$, $T_{ACQ} = 0$)

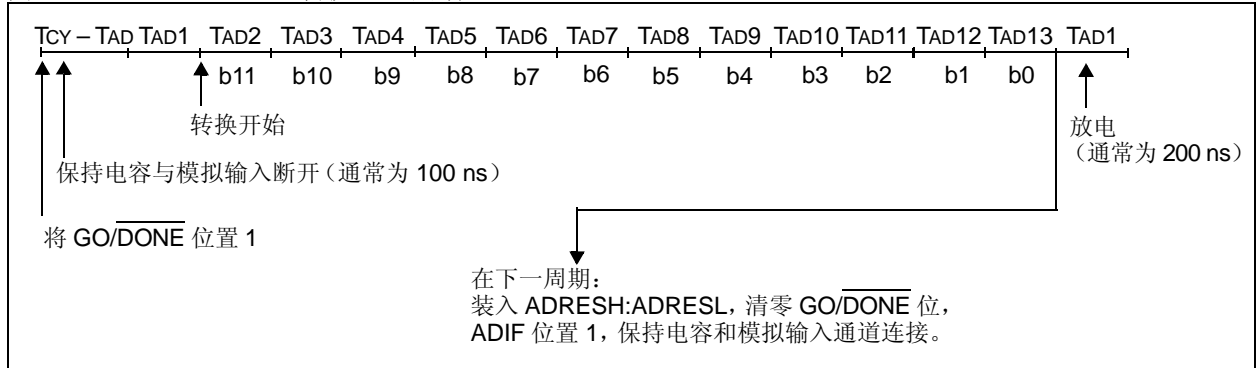
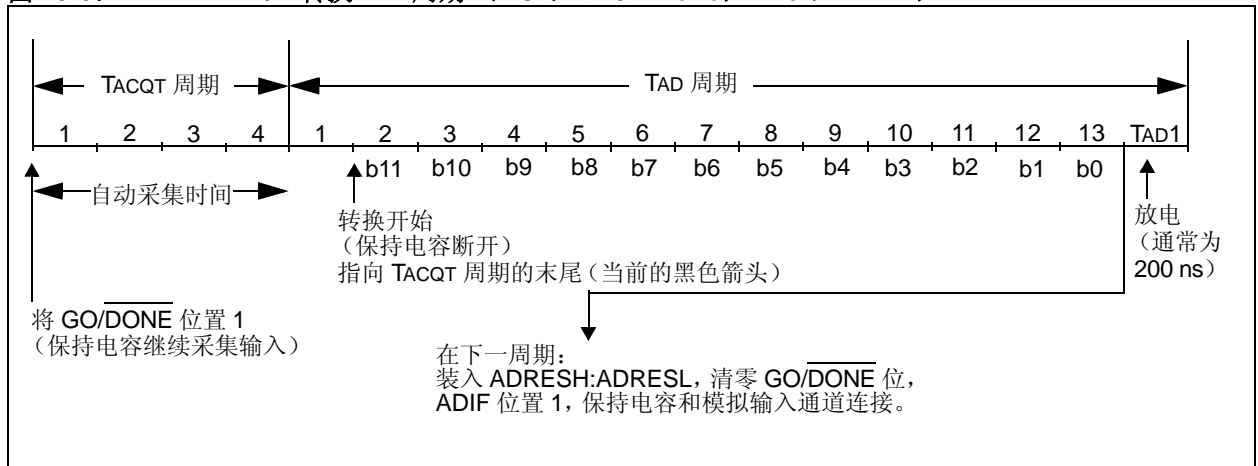


图 19-5: A/D 转换 TAD 周期 ($\text{ACQT}\langle 2:0 \rangle = 010$, $T_{ACQ} = 4 \text{ TAD}$)



PIC18F2423/2523/4423/4523

19.8 CCP2 触发器的使用

CCP2 模块的特殊事件触发信号可以启动 A/D 转换。这需要将 CCP2M3:CCP2M0 位 (CCP2CON<3:0>) 设置为 1011, 且使能 A/D 模块 (ADON 位置 1)。发生触发事件时, GO/DONE 位被置 1, 启动 A/D 采集和转换并将 Timer1 (或 Timer3) 计数器复位为 0。复位 Timer1 (或 Timer3) 可自动重复 A/D 采集周期, 最大限度地降低了软件开销 (将 ADRESH:ADRESL 内容传

送到所需存储单元)。特殊事件触发信号将 GO/DONE 位置 1 (启动转换) 之前, 用户必须选择正确的模拟输入通道和最小采集周期, 最小采集周期由用户设定或通过选择合适的 TAcq 时间来设定。

如果未使能 A/D 模块 (ADON 清零), 则特殊事件触发信号将被 A/D 模块忽略, 但它仍会将 Timer1 (或 Timer3) 计数器复位。

表 19-2: 与 A/D 操作相关的寄存器

名称	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	复位值所在页
INTCON	GIE/GIEH	PEIE/GIEL	TMR0IE	INT0IE	RBIE	TMR0IF	INT0IF	RBIF	49
PIR1	PSPIF ⁽¹⁾	ADIF	RCIF	TXIF	SSPIF	CCP1IF	TMR2IF	TMR1IF	52
PIE1	PSPIE ⁽¹⁾	ADIE	RCIE	TXIE	SSPIE	CCP1IE	TMR2IE	TMR1IE	52
IPR1	PSPIP ⁽¹⁾	ADIP	RCIP	TXIP	SSPIP	CCP1IP	TMR2IP	TMR1IP	52
PIR2	OSCFIF	CMIF	—	EEIF	BCLIF	HLVDIF	TMR3IF	CCP2IF	52
PIE2	OSCFIE	CMIE	—	EEIE	BCLIE	HLVDIE	TMR3IE	CCP2IE	52
IPR2	OSCFIP	CMIP	—	EEIP	BCLIP	HLVDIP	TMR3IP	CCP2IP	52
ADRESH	A/D 结果寄存器的高字节								51
ADRESL	A/D 结果寄存器的低字节								51
ADCON0	—	—	CHS3	CHS2	CHS1	CHS0	GO/DONE	ADON	51
ADCON1	—	—	VCFG1	VCFG0	PCFG3	PCFG2	PCFG1	PCFG0	51
ADCON2	ADFM	—	ACQT2	ACQT1	ACQT0	ADCS2	ADCS1	ADCS0	51
PORTA	RA7 ⁽²⁾	RA6 ⁽²⁾	RA5	RA4	RA3	RA2	RA1	RA0	52
TRISA	TRISA7 ⁽²⁾	TRISA6 ⁽²⁾	PORTA 数据方向控制寄存器						52
PORTB	RB7	RB6	RB5	RB4	RB3	RB2	RB1	RB0	52
TRISB	PORTB 数据方向控制寄存器								52
LATB	PORTB 数据锁存寄存器 (读和写数据锁存器)								52
PORTE ⁽¹⁾	—	—	—	—	RE3 ⁽³⁾	RE2	RE1	RE0	52
TRISE ⁽¹⁾	IBF	OBF	IBOV	PSPMODE	—	TRISE2	TRISE1	TRISE0	52
LATE ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	PORTE 数据锁存寄存器			52

图注: — = 未实现, 读为 0。A/D 转换不使用阴影单元。

注 1: 这些寄存器和 / 或位在 28 引脚器件上未实现, 读为 0。

注 2: PORTA<7:6> 及其方向位根据不同的主振荡器模式被分别配置为端口引脚。当被禁止时, 这些位读为 0。

注 3: RE3 端口位在 MCLRE 配置位为 0 时仅可用作输入引脚。

20.0 比较器模块

模拟比较器模块包含两个比较器，可以用多种方式对它们进行配置。比较器的输入可以是与 RA0 到 RA5 引脚复用的模拟输入，也可以为片上参考电压（见第 21.0 节“比较器参考电压模块”）。数字输出（正常或翻转的）可从引脚电平读取，也可通过控制寄存器读取。

CMCON 寄存器（寄存器 20-1）选择比较器的输入和输出配置。图 20-1 给出了各种比较器配置的框图。

寄存器 20-1: **CMCON: 比较器控制寄存器**

R-0	R-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-1	R/W-1	R/W-1
C2OUT	C1OUT	C2INV	C1INV	CIS	CM2	CM1	CM0
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位	W = 可写位	U = 未实现位, 读为 0
-n = POR 值	1 = 置 1	0 = 清零
		x = 未知

- bit 7 **C2OUT:** 比较器 2 输出位
 当 C2INV = 0 时:
 1 = C2 VIN+ > C2 VIN-
 0 = C2 VIN+ < C2 VIN-
 当 C2INV = 1 时:
 1 = C2 VIN+ < C2 VIN-
 0 = C2 VIN+ > C2 VIN-
- bit 6 **C1OUT:** 比较器 1 输出位
 当 C1INV = 0 时:
 1 = C1 VIN+ > C1 VIN-
 0 = C1 VIN+ < C1 VIN-
 当 C1INV = 1 时:
 1 = C1 VIN+ < C1 VIN-
 0 = C1 VIN+ > C1 VIN-
- bit 5 **C2INV:** 比较器 2 输出翻转位
 1 = C2 输出翻转
 0 = C2 输出不翻转
- bit 4 **C1INV:** 比较器 1 输出翻转位
 1 = C1 输出翻转
 0 = C1 输出不翻转
- bit 3 **CIS:** 比较器输入切换位
 当 CM2:CM0 = 110 时:
 1 = C1 VIN- 连接到 RA3/AN3/VREF+
 C2 VIN- 连接到 RA2/AN2/VREF-/CVREF
 0 = C1 VIN- 连接到 RA0/AN0
 C2 VIN- 连接到 RA1/AN1
- bit 2-0 **CM2:CM0:** 比较器模式位
 图 20-1 给出了比较器的几种模式以及相应 CM2:CM0 位的设置。

PIC18F2423/2523/4423/4523

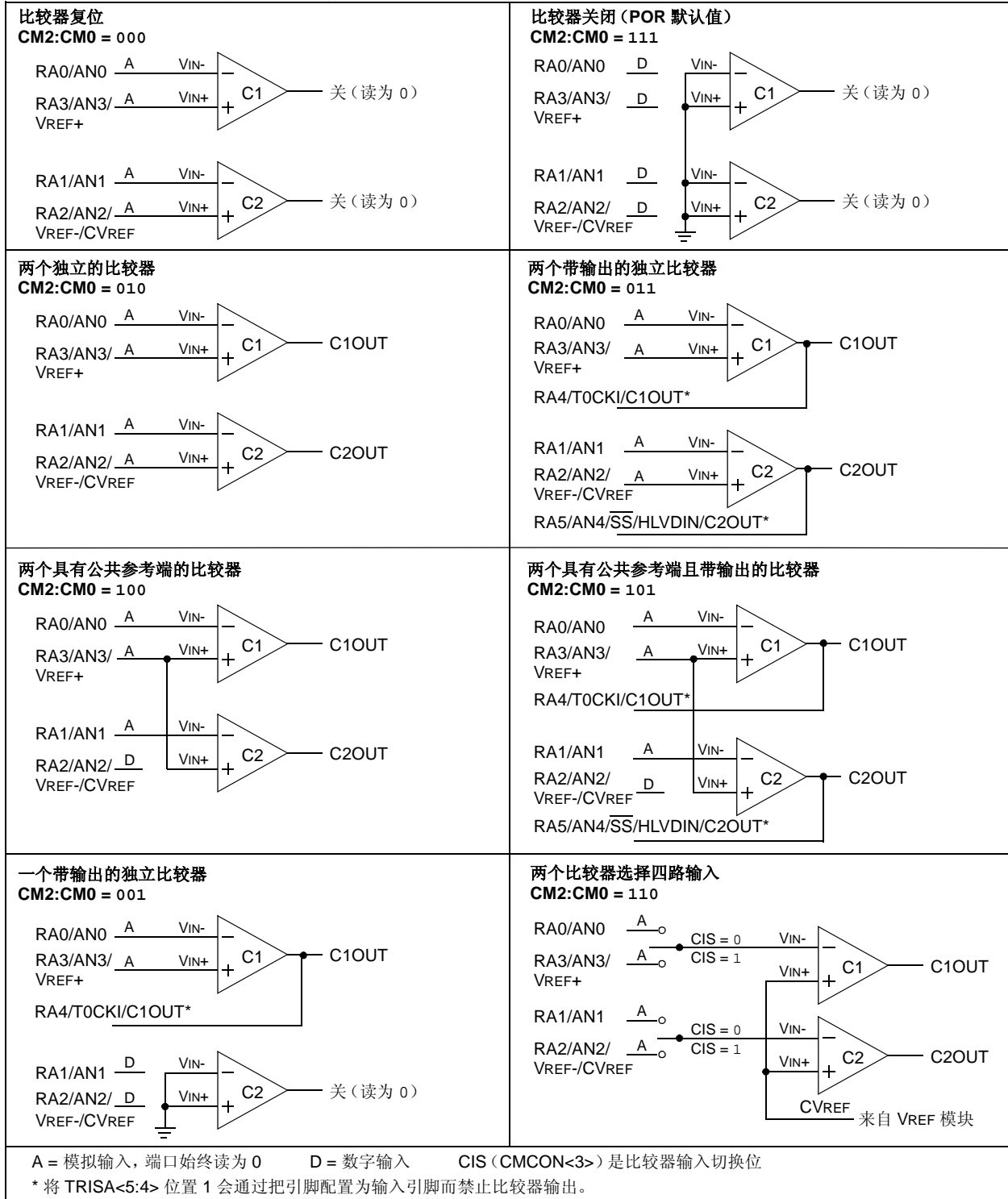
20.1 比较器配置

图 20-1 给出了比较器的 8 种工作模式。CMCON 寄存器的 CM2:CM0 位用于选择模式。TRISA 寄存器控制每种模式下比较器引脚的数据方向。如果改变比较器模

式，由于存在特定的模式改变延时（如第 26.0 节“电气特性”所示），比较器的输出电平可能会在此延时期间无效。

注： 改变比较器模式期间应禁止比较器中断；否则会产生错误的中断。

图 20-1: 比较器 I/O 工作模式



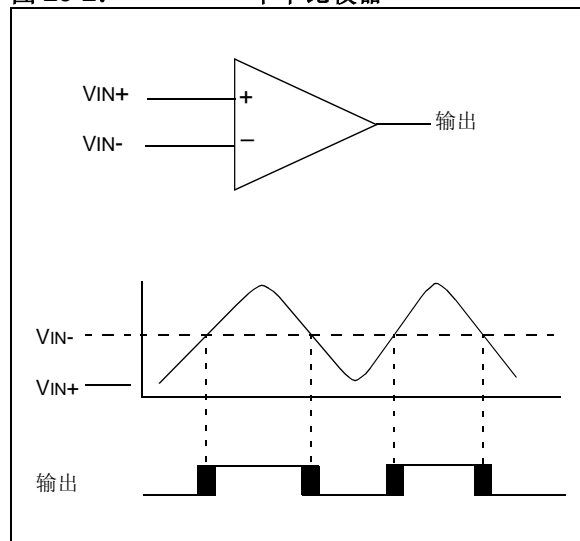
20.2 比较器工作原理

图 20-2 显示了单个比较器，以及其模拟输入电平和数字输出之间的关系。当 VIN+ 上的模拟输入电平值小于 VIN- 上的模拟输入值时，比较器输出数字低电平。当 VIN+ 上的模拟输入电平值大于 VIN- 上的模拟输入值时，比较器输出数字高电平。图 20-2 中比较器输出的阴影部分表示因输入失调电压和响应时间所造成的输出不确定区域。

20.3 比较器参考电压

根据不同的比较器工作模式，可选择使用外部或内部参考电压。将 VIN- 上的模拟信号与 VIN+ 上的信号作比较，并相应地调整比较器的数字输出（图 20-2）。

图 20-2: 单个比较器



20.3.1 外部参考电压信号

当使用外部参考电压时，可将比较器模块中的两个比较器配置为使用同一个参考源或使用不同的参考源。但是，门限检测电路可能要求使用同一个参考源。参考信号可被施加到比较器的任一引脚上（见表 26-2）。

20.3.2 内部参考电压信号

比较器模块也可以选择使用内部比较器参考电压模块产生的参考电压。在第 21.0 节“比较器参考电压模块”中详细介绍了该模块。

只有在两个比较器选择四路输入的模式（CM2:CM0 = 110）中才可使用内部参考电压。在该模式下，内部参考电压被施加到两个比较器的 VIN+ 引脚上。

20.4 比较器响应时间

响应时间是指从选定一个新的参考电压或输入源到比较器输出达到一个有效电平的最短时间。如果内部参考电压改变了，在使用比较器输出时，必须考虑内部参考电压的最大延时。否则，应使用比较器的最大延时（见表 26-2）。

20.5 比较器输出

通过 CMCON 寄存器可读取比较器输出。这些位是只读的。比较器输出也可以直接输出到 RA4 和 RA5 I/O 引脚。当被使能时，RA4 和 RA5 引脚输出路径上的多路开关会发生切换，并且每个引脚的输出与比较器输出是不同步的。每个比较器输出的不确定区域的大小与规范中给出的输入失调电压和响应时间有关。图 20-3 给出了比较器的输出框图。

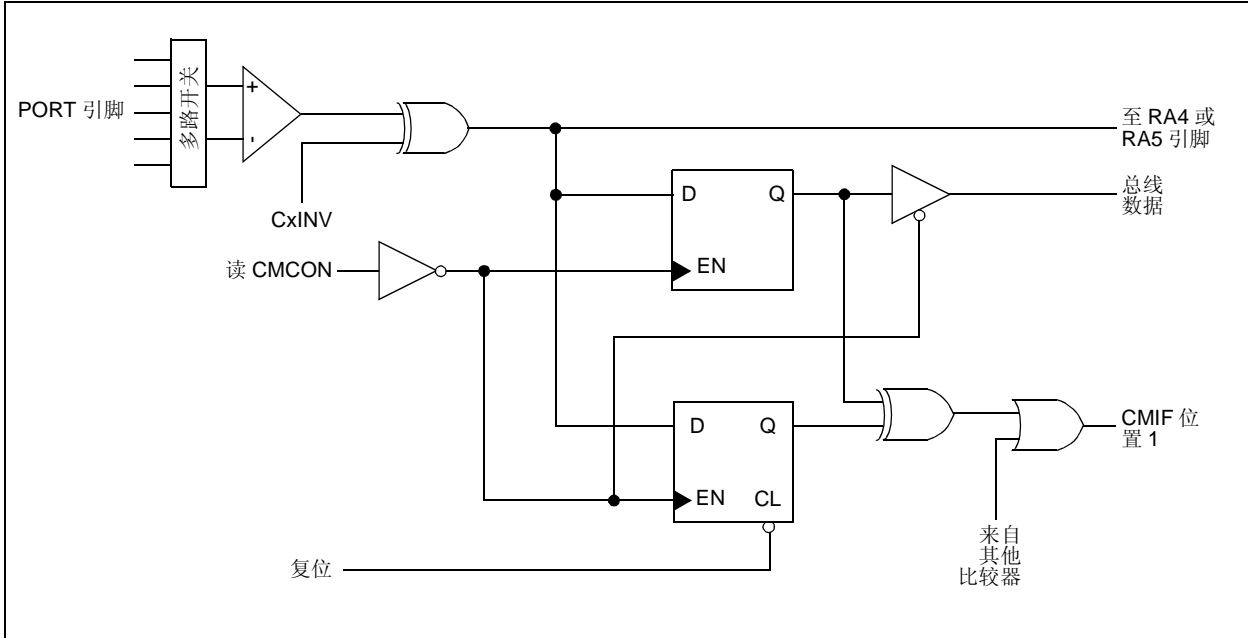
在该模式下，TRISA 仍作为 RA4 和 RA5 引脚的输出使能/禁止位。

使用 C2INV 和 C1INV 位（CMCON<5:4>）可改变比较器输出的极性。

- 注**
- 1: 读端口寄存器时，所有配置为模拟输入的引脚将读为 0。配置为数字输入的引脚将根据施密特触发器输入规范，对模拟输入进行相应转换。
 - 2: 定义为数字输入引脚上的模拟电平可能会使输入缓冲器的电流消耗超过规定值。

PIC18F2423/2523/4423/4523

图 20-3: 比较器输出框图



20.6 比较器中断

任一比较器的输出值发生变化，都会将该比较器的中断标志位置 1。需要用软件保存输出位的状态信息（从 CMCON<7:6> 读取），以确定实际发生的变化。CMIF 位（PIR2<6>）是比较器中断标志位，且必须通过清零复位。由于可以向该寄存器写入 1，因此可以产生模拟中断。

必须将 CMIE 位（PIE2<6>）和 PEIE 位（INTCON<6>）置 1 以允许中断。此外，还必须将 GIE 位（INTCON<7>）置 1。如果这些位中的任何一个被清零，将无法允许中断，尽管中断条件发生时仍会将 CMIF 位置 1。

注： 当执行读操作时（Q2 周期开始），如果 CMCON 寄存器（C1OUT 或 C2OUT）的值发生变化，那么 CMIF（PIR2<6>）中断标志位可能不会被置 1。

用户可用以下方式在中断服务程序中清除该中断：

- 任何对 CMCON 的读或写都将结束不匹配条件。
- 将标志位 CMIF 清零。

不匹配条件将继续把标志位 CMIF 置 1。读 CMCON 将结束不匹配条件并允许将标志位 CMIF 清零。

20.7 休眠期间的比较器操作

当比较器处于激活状态而器件处于休眠模式时，比较器仍保持激活状态并可产生中断（如果中断被允许）。中断会把器件从休眠模式唤醒。每个处于工作状态中的比较器都会消耗额外的电流，如比较器规范中所示。若要将休眠模式下的功耗减到最低，可在进入休眠模式前关闭比较器（CM2:CM0 = 111）。如果器件从休眠状态唤醒，CMCON 寄存器的内容不受影响。

20.8 复位的影响

器件复位强制 CMCON 寄存器进入复位状态，从而使比较器模块进入关闭模式（CM2:CM0 = 111）。但是，器件复位时输入引脚（RA0 到 RA3）被默认配置为模拟输入。这些引脚的 I/O 配置由 PCFG3:PCFG0 位（ADCON1<3:0>）的设置决定。因此，当复位时引脚呈现模拟输入状态，将使得器件电流降至最小。

20.9 模拟输入连接注意事项

模拟输入的简化电路如图20-4所示。由于模拟引脚被连接到数字输出端，它们与VDD和VSS之间连有反向偏置的二极管。因此，模拟输入必须在VSS和VDD之间。如果输入电压在任一方向超出该范围0.6V以上，就可

能发生一个二极管正向偏置而使输入电压箝位。模拟信号源的最大阻抗推荐值为10kΩ。任何连接到模拟输入引脚的外部元件（如电容或齐纳二极管），要保证其泄漏电流极小。

图 20-4: 比较器模拟输入模型

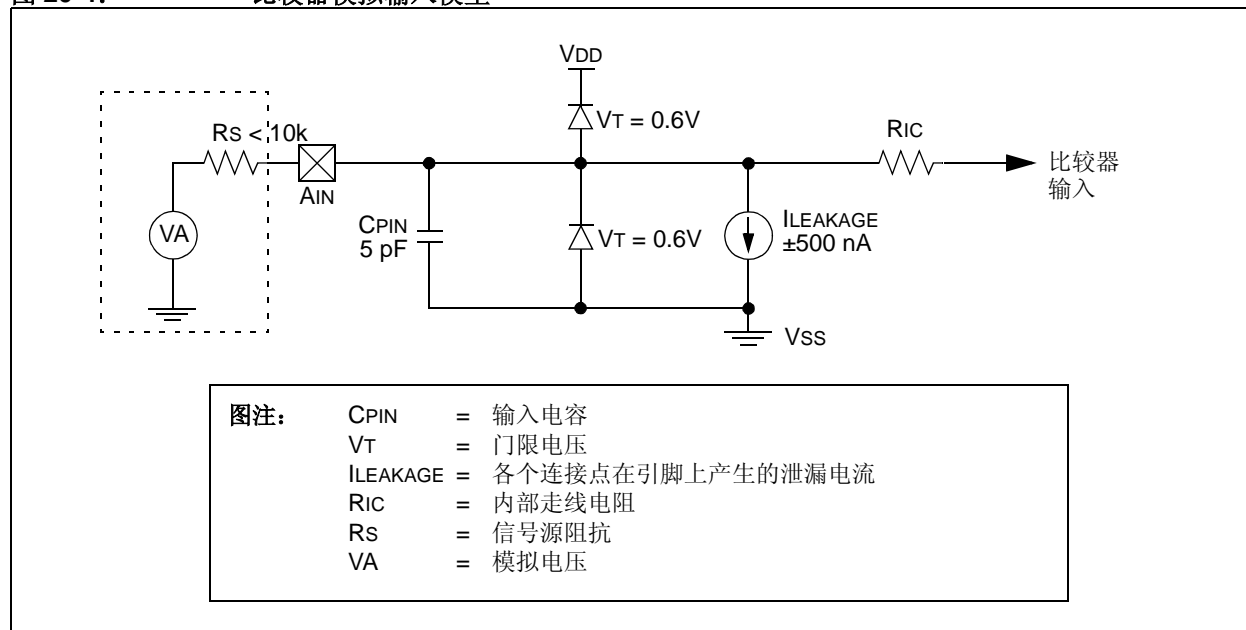


表 20-1: 与比较器模块相关的寄存器

名称	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	复位值所在页
CMCON	C2OUT	C1OUT	C2INV	C1INV	CIS	CM2	CM1	CM0	51
CVRCON	CVREN	CVROE	CVRR	CVRSS	CVR3	CVR2	CVR1	CVR0	51
INTCON	GIE/GIEH	PEIE/GIEL	TMR0IE	INT0IE	RBIE	TMR0IF	INT0IF	RBIF	52
PIR2	OSCFIF	CMIF	—	EEIF	BCLIF	HLVDIF	TMR3IF	CCP2IF	52
PIE2	OSCFIE	CMIE	—	EEIE	BCLIE	HLVDIE	TMR3IE	CCP2IE	52
IPR2	OSCFIP	CMIP	—	EEIP	BCLIP	HLVDIP	TMR3IP	CCP2IP	52
PORTA	RA7 ⁽¹⁾	RA6 ⁽¹⁾	RA5	RA4	RA3	RA2	RA1	RA0	52
LATA	LATA7 ⁽¹⁾	LATA6 ⁽¹⁾	PORTA 数据锁存寄存器（读和写数据锁存器）						52
TRISA	TRISA7 ⁽¹⁾	TRISA6 ⁽¹⁾	PORTA 数据方向控制寄存器						52

图注: — = 未实现，读为 0。比较器模块不使用阴影单元。

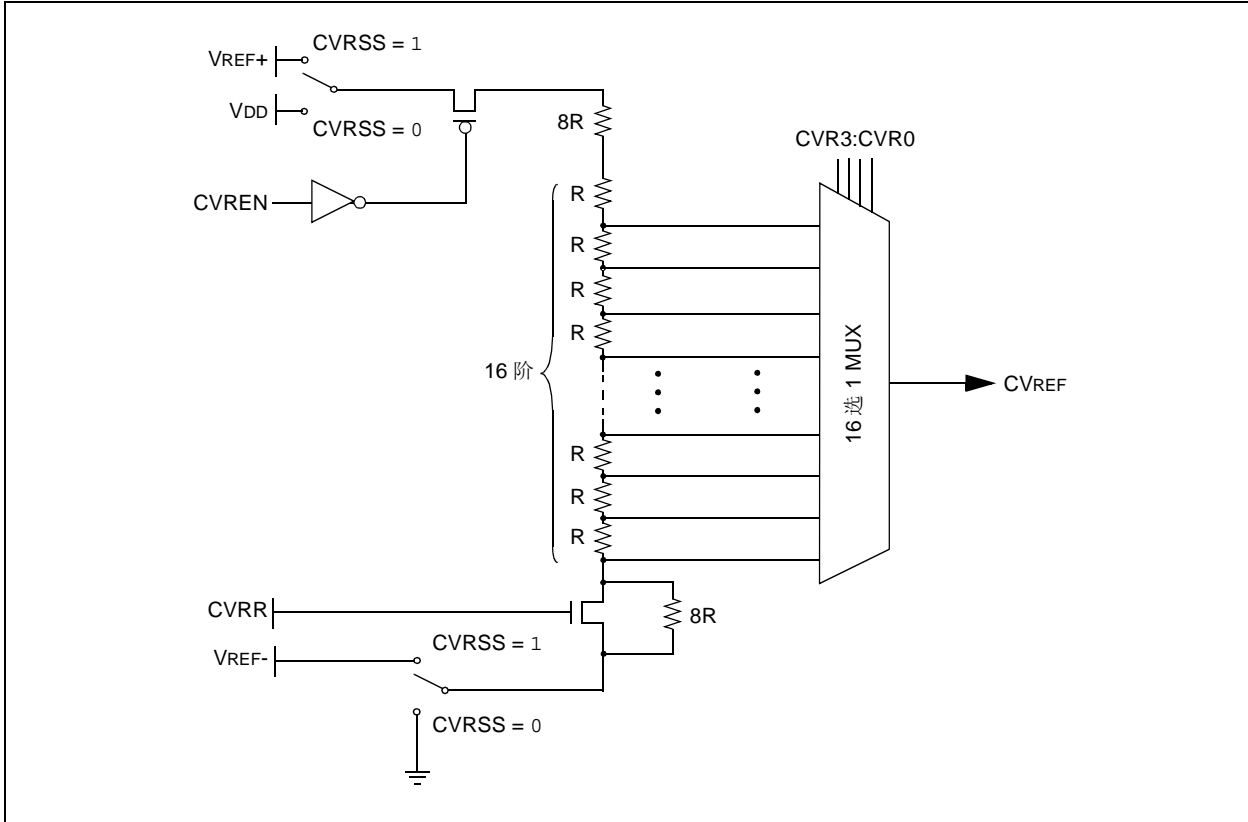
注 1: PORTA<7:6> 及其方向和锁存器位根据不同的主振荡器模式被分别配置为端口引脚。当被禁止时，这些位读为 0。

PIC18F2423/2523/4423/4523

注:

PIC18F2423/2523/4423/4523

图 21-1: 比较器参考电压模块框图



21.2 参考电压精度 / 误差

由于模块结构的限制，并不能实现整个参考电压范围。梯形电阻网络顶部和底部的晶体管（图 21-1）使 CVREF 值不能达到参考电压源的满幅值。参考电压是由参考电压源分压而来的，因此 CVREF 输出随参考电压源的波动而变化。经过测试的参考电压的绝对精度，请参见第 26.0 节“电气特性”。

21.3 休眠期间的操作

如果因中断或看门狗定时器超时将器件从休眠模式唤醒，CVRCON 寄存器的内容将不受影响。为了降低休眠模式下的电流消耗，应禁止参考电压模块。

21.4 复位的影响

器件复位时，CVREN 位（CVRCON<7>）将被清零从而禁止参考电压模块。复位还将 CVROE 位（CVRCON<6>）清零，使参考电压与 RA2 引脚断开；同时通过将 CVRR 位（CVRCON<5>）清零选择高电压范围。CVR 值选择位也将清零。

21.5 连接注意事项

参考电压模块的工作独立于比较器模块。如果 CVROE 位被置 1，那么参考电压发生器的输出可能与 RA2 引脚相连。当 RA2 被配置为数字输入引脚时，将参考电压输出连接到 RA2 引脚，将会增加电流消耗。使能 CVROE 时，将 RA2 配置为数字输出引脚也将增加电流消耗。

RA2 引脚可被用作简单的 D/A 输出，但是其驱动能力有限。要提高电流驱动能力，VREF 参考电压输出端必须外接缓冲器。图 21-2 举例说明了这一缓冲技术。

图 21-2: 参考电压输出缓冲示例

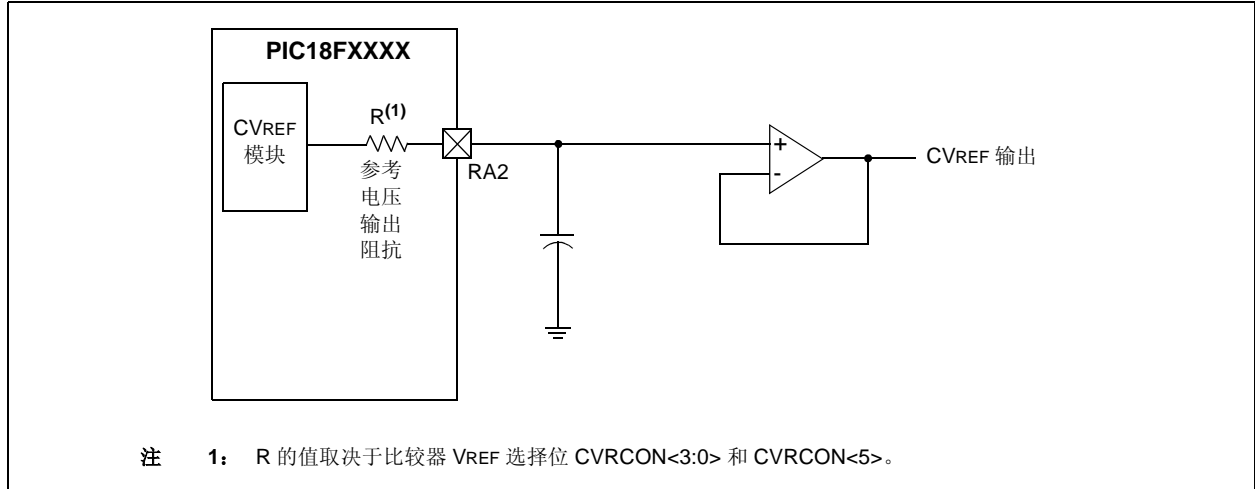


表 21-1: 与比较器参考电压模块相关的寄存器

名称	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	复位值所在页
CVRCON	CVREN	CVROE	CVRR	CVRSS	CVR3	CVR2	CVR1	CVR0	51
CMCON	C2OUT	C1OUT	C2INV	C1INV	CIS	CM2	CM1	CM0	51
TRISA	TRISA7 ⁽¹⁾	TRISA6 ⁽¹⁾	PORTA 数据方向控制寄存器						52

图注: 比较器参考电压模块不使用阴影单元。

注 1: PORTA 引脚根据振荡器配置情况使能。

PIC18F2423/2523/4423/4523

注:

22.0 高 / 低压检测 (HLVD)

PIC18F2423/2523/4423/4523 器件配有一个高 / 低压检测模块 (HLVD)。该模块是一个可编程的电路, 它允许用户指定器件的电压跳变点和变化方向。如果器件电压按照指定的方向相对于电压跳变点发生了偏离, 就会将中断标志位置 1。如果允许了中断, 程序将跳转到中断向量地址处执行, 由软件响应该中断。

高 / 低压检测控制寄存器 (寄存器 22-1) 完全控制 HLVD 模块的工作。用户可通过软件控制该寄存器将电路 “关闭”, 从而使器件的电流消耗降至最低。

图 22-1 给出了 HLVD 模块的框图。

寄存器 22-1: HLVDCON: 高 / 低压检测控制寄存器

R/W-0	U-0	R-0	R/W-0	R/W-0	R/W-1	R/W-0	R/W-1
VDIRMAG	—	IRVST	HLVDEN	HLVDL3 ⁽¹⁾	HLVDL2 ⁽¹⁾	HLVDL1 ⁽¹⁾	HLVDL0 ⁽¹⁾
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位	W = 可写位	U = 未实现位, 读为 0
-n = POR 值	1 = 置 1	0 = 清零
		x = 未知

- bit 7 **VDIRMAG:** 电压方向选择位
1 = 当电压等于或超过跳变点 (HLVDL3:HLVDL0) 时, 事件发生
0 = 当电压等于或低于跳变点 (HLVDL3:HLVDL0) 时, 事件发生
- bit 6 **未实现:** 读为 0
- bit 5 **IRVST:** 内部参考电压稳定标志位
1 = 表示电压检测逻辑在指定的电压范围产生中断标志
0 = 表示电压检测逻辑在指定的电压范围不产生中断标志, 并且不应允许 HLVD 中断
- bit 4 **HLVDEN:** 高 / 低压检测模块使能位
1 = 使能 HLVD
0 = 禁止 HLVD
- bit 3-0 **HLVDL3:HLVDL0:** 电压检测门限值⁽¹⁾
1111 = 使用外部模拟输入 (输入来自于 HLVDIN 引脚)
1110 = 最大设置
·
·
·
0000 = 最小设置

注 1: 具体规范, 请参见表 26-4。

PIC18F2423/2523/4423/4523

通过将 HLVDEN 位置 1 使能该模块。每次使能 HLVD 模块时，电路需要一定时间才能稳定下来。IRVST 位是一个只读位，用来表明电路是否稳定。仅当电路稳定且 IRVST 位置 1 后，该模块才能产生中断。

VDIRMAG 位决定该模块的整体工作状态。当 VDIRMAG 清零时，模块监视 VDD 看它是否跌落到预先确定的设置点以下。当该位置 1 时，模块监视 VDD 看它是否上升到设置点以上。

22.1 工作原理

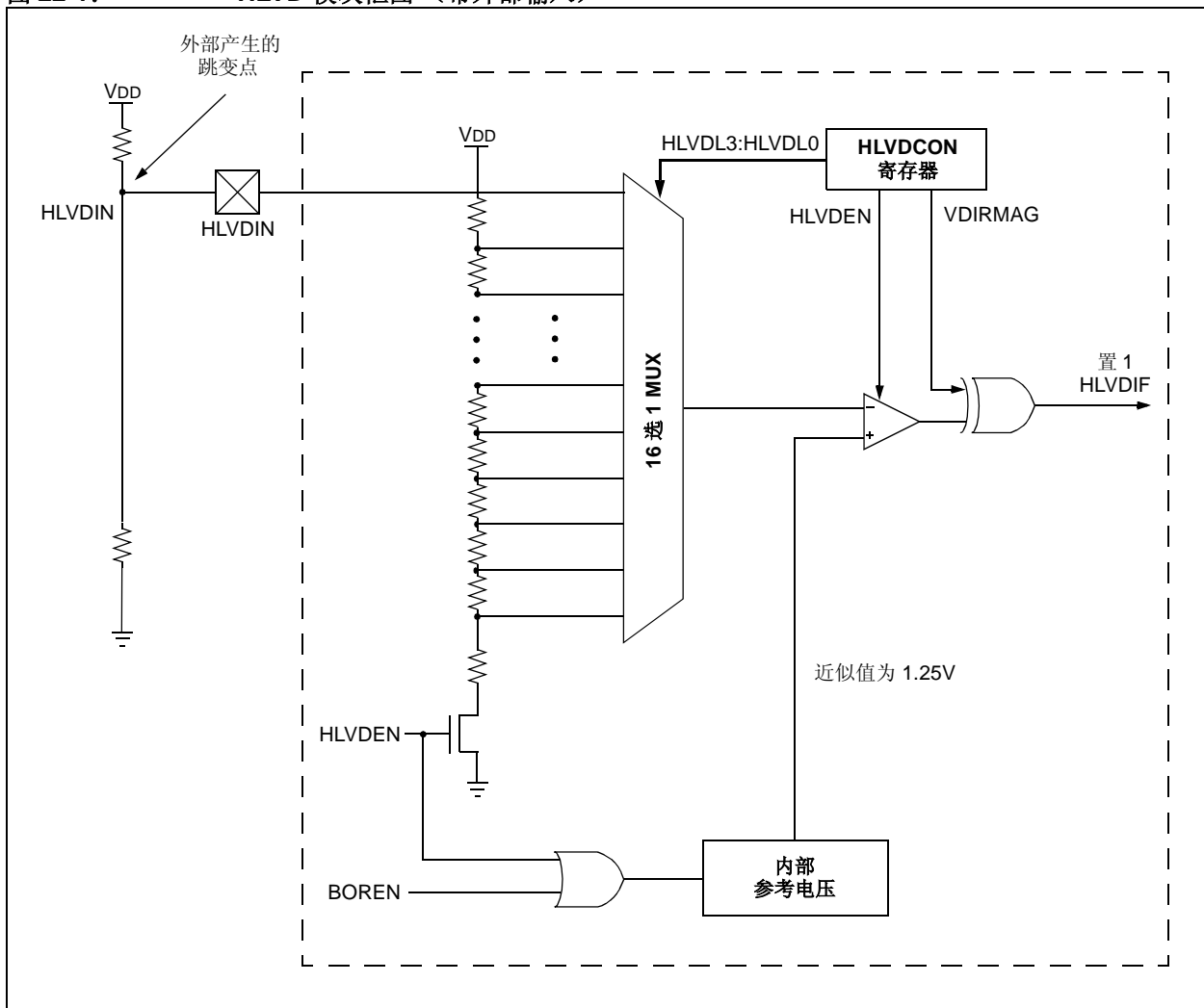
当使能了 HLVD 模块时，比较器使用内部产生的参考电压作为设置点。将设置点的电压与跳变点电压作比较，其中电阻分压器中的每个节点均代表一个电压跳变点。“跳变点”电压是被检测到高压或低压事件时的电压

值，它取决于该模块的配置。当供电电压等于跳变点电压时，电阻阵列的节点电压输出值等于由参考电压源模块产生的内部参考电压（近似值为 1.25V）。然后比较器通过将 HLVDIF 位置 1 产生一个中断信号。

可用软件编程指定跳变点电压为 15 个值中的任何一个或外部电压输入。通过对 HLVDL3:HLVDL0 位（HLVDCON<3:0>）进行编程可以选择跳变点。

HLVD 模块还有一个额外的功能，允许用户通过外部电压源向模块提供跳变电压。当 HLVDL3:HLVDL0 位被设置为 1111 时，使能此模式。在此状态下，比较器输入与外部输入引脚 HLVDIN 复用。因此用户可以灵活地配置高 / 低压检测中断，使之可以在有效工作范围内的任何电压点上产生。

图 22-1: HLVD 模块框图（带外部输入）



22.2 HLVD 设置

要设置 HLVD 模块，需要遵循以下步骤：

1. 将值写入 HLVDL3:HLVDL0，选择所需的 HLVD 跳变点。
2. 将 VDIRMAG 位设置为检测高压 (VDIRMAG = 1) 或低压 (VDIRMAG = 0)。
3. 通过将 HLVDEN 位置 1，使能 HLVD 模块。
4. 清零 HLVD 中断标志位 (PIR2<2>)，该位可能被上次中断置 1。
5. 如果需要中断，将 HLVDIE 和 GIE 位 (PIE2<2> 和 INTCON<7>) 置 1 允许 HLVD 中断。直到 IRVST 位也置 1 时才会发生中断。

22.3 电流消耗

使能了该模块就使能了 HLVD 比较器和分压器，并将消耗静态电流。电气规范中的参数 D022B 给出了使能该模块时的电流总消耗。

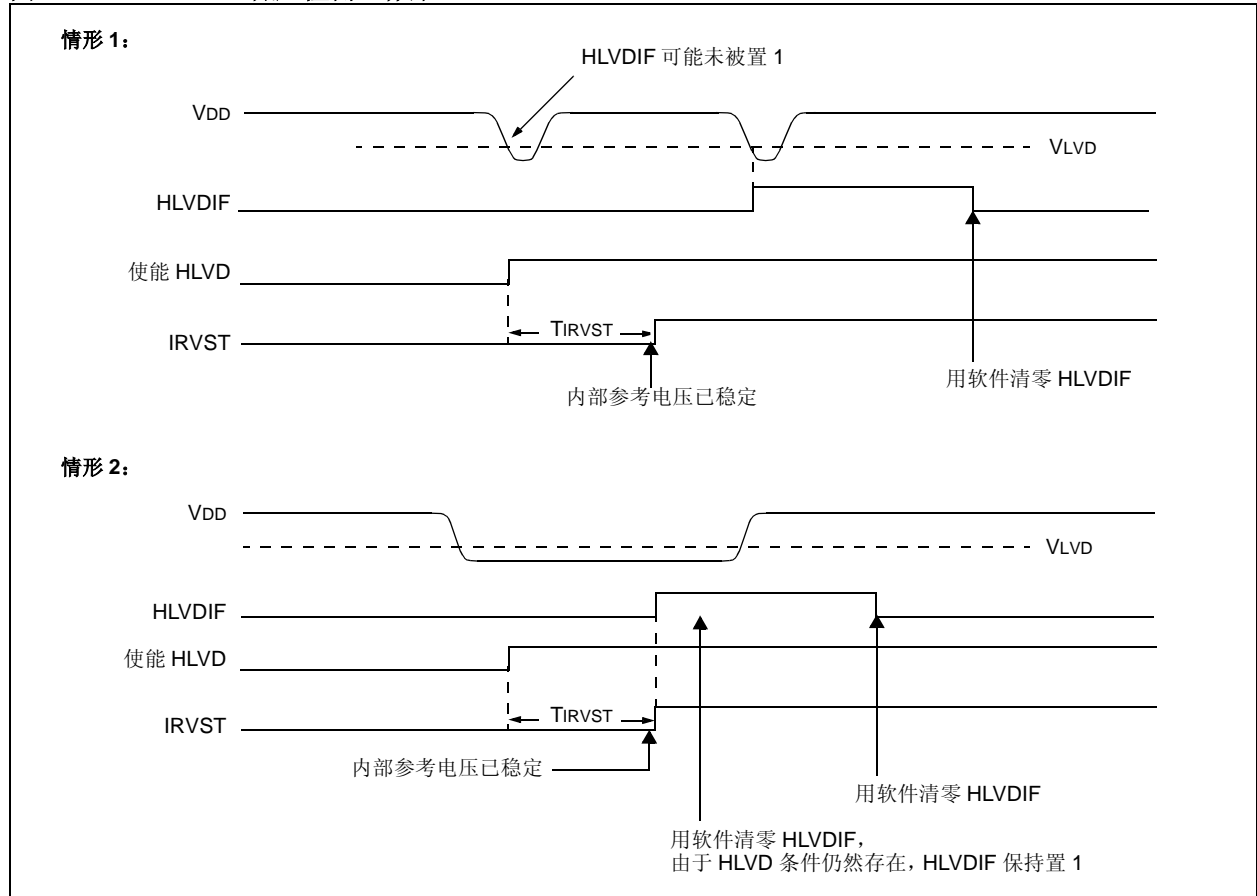
HLVD 模块无需一直工作，工作与否取决于具体的应用。要降低电流消耗，只需要在检测电压时，短时间地使能 HLVD 电路，在检测完成之后马上禁止 HLVD 模块。

22.4 HLVD 启动时间

电气规范中的参数 D420 规定了 HLVD 模块的内部参考电压，该参考电压也可供其他内部电路（如可编程欠压复位电路）使用。如果禁止了 HLVD 或其他使用参考电压的电路以降低器件的电流消耗，则参考电压电路将需要一段时间稳定下来以后才能可靠地检测低压或高压条件。HLVD 启动时间 T_{IRVST} 与器件时钟速度无关。它由电气规范中的参数 36 规定。

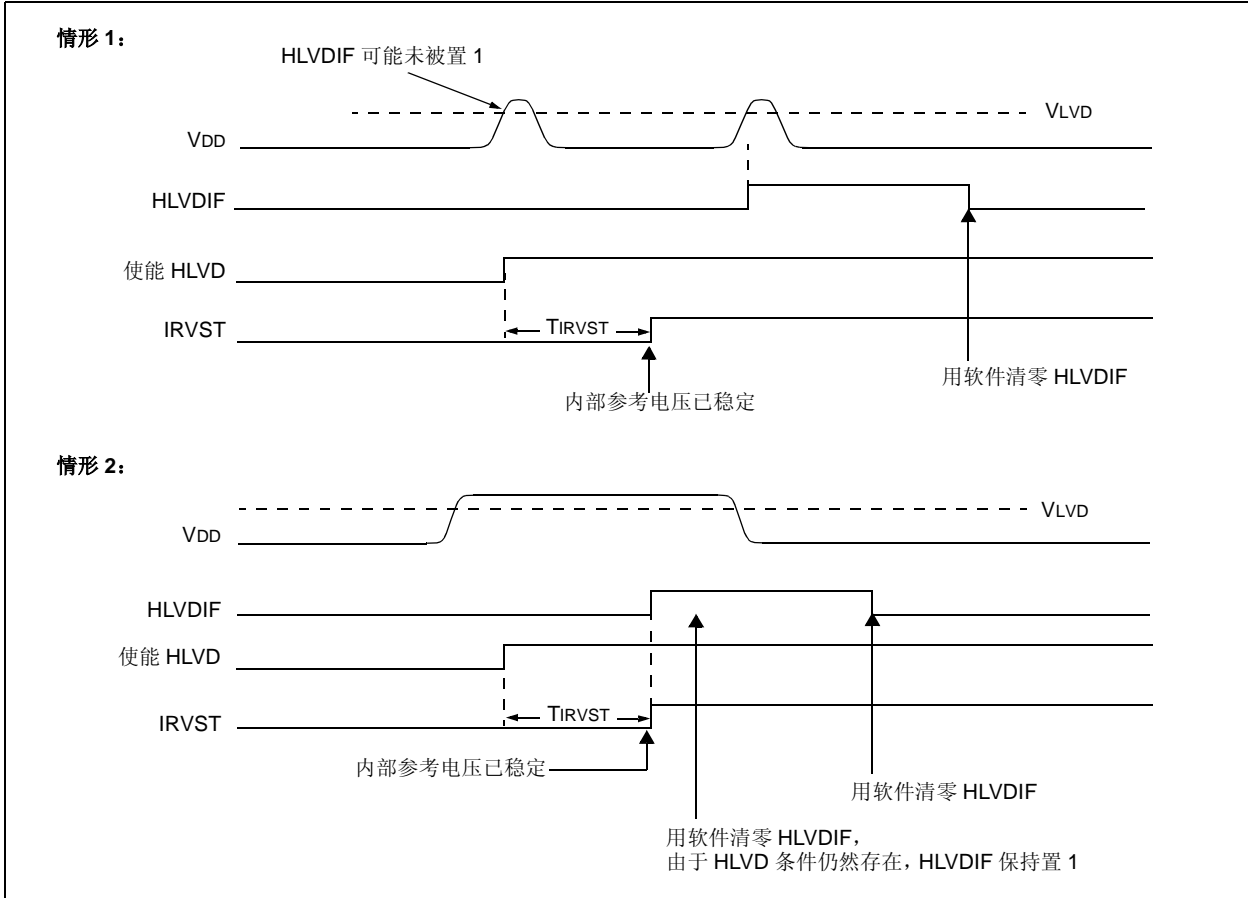
直到 T_{IRVST} 结束并且参考电压达到稳定后才会允许 HLVD 中断标志。基于此原因，在此时间间隔期间，超出设置点的偏离可能不会被检测到。请参见图 22-2 或图 22-3。

图 22-2: 低压检测工作原理 (VDIRMAG = 0)



PIC18F2423/2523/4423/4523

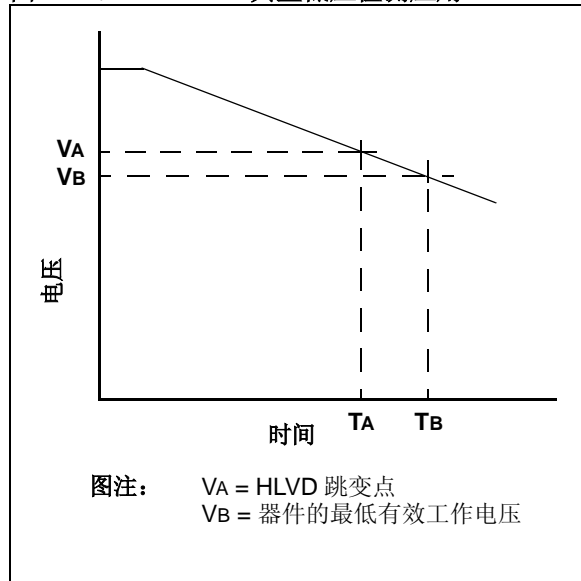
图 22-3: 高压检测工作原理 (VDIRMAG = 1)



22.5 应用

在许多应用中，当电压低于或高于某个门限值时，系统希望可以检测到该事件。对于一般的电池应用，图 22-4 给出了一个近似的电压曲线。器件电压会随时间逐渐下降。当器件电压达到电压 V_A 时，HLVD 逻辑电路会在时间 T_A 产生中断。该中断将导致执行中断服务子程序，从而使应用程序能在器件电压退出有效工作范围（对应的时间为 T_B ）之前执行“日常任务”，并安全关闭。因此，HLVD 将会提供一个时间窗（表示为 T_A 和 T_B 的时间差）使应用程序能安全地退出。

图 22-4: 典型低压检测应用



22.6 休眠期间的操作

当被使能时，HLVD 电路在休眠期间将继续工作。如果器件电压越过了跳变点，HLVDIF 位将会被置 1 并且器件将从休眠状态中被唤醒。如果已经允许了全局中断，程序将跳转到中断向量地址处继续执行。

22.7 复位的影响

器件复位将强制所有寄存器进入复位状态。这会强制关闭 HLVD 模块。

表 22-1: 与高 / 低压检测模块相关的寄存器

名称	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	复位值 所在页
HLVDCON	VDIRMAG	—	IRVST	HLVDEN	HLVDL3	HLVDL2	HLVDL1	HLVDL0	50
INTCON	GIE/GIEH	PEIE/GIEL	TMR0IE	INT0IE	RBIE	TMR0IF	INT0IF	RBIF	49
PIR2	OSCFIF	CMIF	—	EEIF	BCLIF	HLVDIF	TMR3IF	CCP2IF	52
PIE2	OCSFIE	CMIE	—	EEIE	BCLIE	HLVDIE	TMR3IE	CCP2IE	52
IPR2	OSCFIP	CMIP	—	EEIP	BCLIP	HLVDIP	TMR3IP	CCP2IP	52

图注: — = 未实现，读为 0。HLVD 模块不使用阴影单元。

PIC18F2423/2523/4423/4523

注:

23.0 CPU 的特殊功能

PIC18F2423/2523/4423/4523 器件具有几项特殊的功能，旨在最大限度地提高系统可靠性，并通过减少外部元件的使用将成本降至最低。这些功能包括：

- 振荡器选择
- 复位：
 - 上电复位（POR）
 - 上电延时定时器（PWRT）
 - 振荡器起振定时器（OST）
 - 欠压复位（BOR）
- 中断
- 看门狗定时器（WDT）
- 故障保护时钟监视器
- 双速启动
- 代码保护
- ID 存储单元
- 在线串行编程

要根据具体应用对频率、功耗、精度和成本的要求来选择振荡器。在第 2.0 节“振荡器配置”中详细讨论了所有的选项。

在本数据手册的前面几章中已完整地讨论了器件的复位和中断。

除了为复位提供了上电延时定时器和振荡器起振定时器之外，PIC18F2423/2523/4423/4523 器件还提供了一个看门狗定时器，该定时器可通过配置位永久使能或用软件控制（如果配置为禁止）。

器件自带的内部 RC 振荡器还提供了故障保护时钟监视器（FSCM）和双速启动这两个额外的功能。FSCM 对外设时钟进行后台监视，并在外设时钟发生故障时自动切换时钟源。双速启动使得几乎可在启动发生那一刻立即执行代码，同时主时钟源继续其起振延时。

通过设置相应的配置寄存器位可以使能和配置所有这些功能。

23.1 配置位

可以通过对配置位编程（读为 0）或不编程（读为 1）来选择不同的器件配置。这些配置位被映射到程序存储器以 300000h 开始的单元中。

用户会注意到地址 300000h 超出了用户程序存储空间范围。事实上，它属于配置存储空间（300000h-3FFFFh），这一空间仅能通过表读和表写进行访问。

对配置寄存器进行编程的方式与对闪存存储器进行编程的方式类似。EECON1 寄存器中的 WR 位启动自定时写入配置寄存器。在正常操作模式下，带有指向配置寄存器的 TBLPTR 的 TBLWT 指令设置写配置寄存器要用到的地址和数据。将 WR 位置 1 启动对配置寄存器的长写操作。配置寄存器一次被写入一个字节。TBLWT 指令可以将 1 或 0 写入单元来改写配置单元的内容。关于闪存编程的更多详细信息，请参见第 6.5 节“写闪存程序存储器”。

表 23-1: 配置位和器件 ID

寄存器名称		Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	默认 / 未编程值
300001h	CONFIG1H	IESO	FCMEN	—	—	FOSC3	FOSC2	FOSC1	FOSC0	00-- 0111
300002h	CONFIG2L	—	—	—	BORV1	BORV0	BOREN1	BOREN0	PWRTEN	---1 1111
300003h	CONFIG2H	—	—	—	WDTPS3	WDTPS2	WDTPS1	WDTPS0	WDTEN	---1 1111
300005h	CONFIG3H	MCLRRE	—	—	—	—	LPT1OSC	PBADEN	CCP2MX	1--- -011
300006h	CONFIG4L	DEBUG	XINST	—	—	—	LVP	—	STVREN	10-- -1-1
300008h	CONFIG5L	—	—	—	—	CP3 ⁽¹⁾	CP2 ⁽¹⁾	CP1	CP0	---- 1111
300009h	CONFIG5H	CPD	CPB	—	—	—	—	—	—	11-- ----
30000Ah	CONFIG6L	—	—	—	—	WRT3 ⁽¹⁾	WRT2 ⁽¹⁾	WRT1	WRT0	---- 1111
30000Bh	CONFIG6H	WRTD	WRTB	WRTC	—	—	—	—	—	111- ----
30000Ch	CONFIG7L	—	—	—	—	EBTR3 ⁽¹⁾	EBTR2 ⁽¹⁾	EBTR1	EBTR0	---- 1111
30000Dh	CONFIG7H	—	EBTRB	—	—	—	—	—	—	-1-- ----
3FFFFEh	DEVID1 ⁽²⁾	DEV3	DEV2	DEV1	DEV0	REV3	REV2	REV1	REV0	xxxx xxxx ⁽²⁾
3FFFFFh	DEVID2 ⁽²⁾	DEV11	DEV10	DEV9	DEV8	DEV7	DEV6	DEV5	DEV4	xxxx xxxx ⁽²⁾

图注： x = 未知， u = 不变， — = 未实现。阴影单元未实现，读为 0。

注 1： 在 PIC18F2423/4423 器件中未实现；保持该位置 1。

注 2： 关于 DEVID1 和 DEVID2 的值，请参见寄存器 23-12 和寄存器 23-13。DEVID 寄存器为只读寄存器，用户不能对其进行编程。

PIC18F2423/2523/4423/4523

寄存器 23-1: CONFIG1H: 配置寄存器 1 的高字节 (字节地址为 300001h)

R/P-0	R/P-0	U-0	U-0	R/P-0	R/P-1	R/P-1	R/P-1
IESO	FCMEN	—	—	FOSC3	FOSC2	FOSC1	FOSC0
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位

P = 可编程位

U = 未实现位, 读为 0

-n = 未对器件编程时的值

u = 编程后状态不变

bit 7 **IESO:** 内部 / 外部振荡器切换位

1 = 使能振荡器切换模式

0 = 禁止振荡器切换模式

bit 6 **FCMEN:** 故障保护时钟监视器使能位

1 = 使能故障保护时钟监视器

0 = 禁止故障保护时钟监视器

bit 5-4 **未实现:** 读为 0

bit 3-0 **FOSC3:FOSC0:** 振荡器选择位

11xx = 外部 RC 振荡器, RA6 用作 CLKO 引脚

101x = 外部 RC 振荡器, RA6 用作 CLKO 引脚

1001 = 内部振荡器模块, RA6 用作 CLKO 引脚, RA7 用作端口引脚

1000 = 内部振荡器模块, RA6 和 RA7 均用作端口引脚

0111 = 外部 RC 振荡器, RA6 用作端口引脚

0110 = 使能 PLL 的 HS 振荡器 (时钟频率 = 4 x FOSC1)

0101 = EC 振荡器, RA6 用作端口引脚

0100 = EC 振荡器, RA6 用作 CLKO 引脚

0011 = 外部 RC 振荡器, RA6 用作 CLKO 引脚

0010 = HS 振荡器

0001 = XT 振荡器

0000 = LP 振荡器

PIC18F2423/2523/4423/4523

寄存器 23-2: **CONFIG2L: 配置寄存器 2 的低字节** (字节地址为 30002h)

U-0	U-0	U-0	R/P-1	R/P-1	R/P-1	R/P-1	R/P-1
—	—	—	BORV1 ⁽¹⁾	BORV0 ⁽¹⁾	BOREN1 ⁽²⁾	BOREN0 ⁽²⁾	PWRTEN ⁽²⁾
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位

P = 可编程位

U = 未实现位, 读为 0

-n = 未对器件编程时的值

u = 编程后状态不变

bit 7-5 **未实现:** 读为 0

bit 4-3 **BORV1:BORV0:** 欠压复位电压位 ⁽¹⁾

11 = 最小设置

·

·

·

00 = 最大设置

bit 2-1 **BOREN1:BOREN0:** 欠压复位使能位 ⁽²⁾

11 = 仅由硬件使能欠压复位 (禁止 SBOREN)

10 = 仅由硬件使能欠压复位, 休眠模式下被禁止 (禁止 SBOREN)

01 = 由软件使能和控制欠压复位 (使能 SBOREN)

00 = 禁止使用硬件或软件使能欠压复位

bit 0 **PWRTEN:** 上电延时定时器 (PWRT) 使能位 ⁽²⁾

1 = 禁止 PWRT

0 = 使能 PWRT

注 1: 请参见第 26.1 节“直流特性: 供电电压”获取规范信息。

注 2: 上电延时定时器与欠压复位是相互独立的, 可以分别控制两者的操作。

PIC18F2423/2523/4423/4523

寄存器 23-3: **CONFIG2H: 配置寄存器 2 的高字节** (字节地址为 300003h)

U-0	U-0	U-0	R/P-1	R/P-1	R/P-1	R/P-1	R/P-1
—	—	—	WDTPS3	WDTPS2	WDTPS1	WDTPS0	WDTEN
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位 P = 可编程位 U = 未实现位, 读为 0
 -n = 未对器件编程时的值 u = 编程后状态不变

- bit 7-5 **未实现:** 读为 0
- bit 4-1 **WDTPS3:WDTPS0:** 看门狗定时器后分频比选择位
 - 1111 = 1:32,768
 - 1110 = 1:16,384
 - 1101 = 1:8,192
 - 1100 = 1:4,096
 - 1011 = 1:2,048
 - 1010 = 1:1,024
 - 1001 = 1:512
 - 1000 = 1:256
 - 0111 = 1:128
 - 0110 = 1:64
 - 0101 = 1:32
 - 0100 = 1:16
 - 0011 = 1:8
 - 0010 = 1:4
 - 0001 = 1:2
 - 0000 = 1:1
- bit 0 **WDTEN:** 看门狗定时器使能位
 - 1 = 使能 WDT
 - 0 = 禁止 WDT (由 SWDTEN 位控制)

PIC18F2423/2523/4423/4523

寄存器 23-6: CONFIG5L: 配置寄存器 5 的低字节 (字节地址为 300008h)

U-0	U-0	U-0	U-0	R/C-1	R/C-1	R/C-1	R/C-1
—	—	—	—	CP3 ⁽¹⁾	CP2 ⁽¹⁾	CP1	CP0
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位 C = 可清零位 U = 未实现位, 读为 0
 -n = 未对器件编程时的值 u = 编程后状态不变

- bit 7-4 **未实现:** 读为 0
- bit 3 **CP3:** 代码保护位 ⁽¹⁾
 1 = Block 3 (006000-007FFFh) 不受代码保护
 0 = Block 3 (006000-007FFFh) 受代码保护
- bit 2 **CP2:** 代码保护位 ⁽¹⁾
 1 = Block 2 (004000-005FFFh) 不受代码保护
 0 = Block 2 (004000-005FFFh) 受代码保护
- bit 1 **CP1:** 代码保护位
 1 = Block 1 (002000-003FFFh) 不受代码保护
 0 = Block 1 (002000-003FFFh) 受代码保护
- bit 0 **CP0:** 代码保护位
 1 = Block 0 (000800-001FFFh) 不受代码保护
 0 = Block 0 (000800-001FFFh) 受代码保护

注 1: 在 PIC18F2423/4423 器件中未实现: 保持该位置 1。

寄存器 23-7: CONFIG5H: 配置寄存器 5 的高字节 (字节地址为 300009h)

R/C-1	R/C-1	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0
CPD	CPB	—	—	—	—	—	—
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位 C = 可清零位 U = 未实现位, 读为 0
 -n = 未对器件编程时的值 u = 编程后状态不变

- bit 7 **CPD:** 数据 EEPROM 代码保护位
 1 = 数据 EEPROM 不受代码保护
 0 = 数据 EEPROM 受代码保护
- bit 6 **CPB:** 引导块代码保护位
 1 = 引导块 (000000-0007FFh) 不受代码保护
 0 = 引导块 (000000-0007FFh) 受代码保护
- bit 5-0 **未实现:** 读为 0

PIC18F2423/2523/4423/4523

寄存器 23-8: CONFIG6L: 配置寄存器 6 的低字节 (字节地址为 3000Ah)

U-0	U-0	U-0	U-0	R/C-1	R/C-1	R/C-1	R/C-1
—	—	—	—	WRT3 ⁽¹⁾	WRT2 ⁽¹⁾	WRT1	WRT0
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位 C = 可清零位 U = 未实现位, 读为 0
 -n = 未对器件编程时的值 u = 编程后状态不变

- bit 7-4 **未实现:** 读为 0
- bit 3 **WRT3:** 写保护位 ⁽¹⁾
 1 = Block 3 (006000-007FFFh) 不受写保护
 0 = Block 3 (006000-007FFFh) 受写保护
- bit 2 **WRT2:** 写保护位 ⁽¹⁾
 1 = Block 2 (004000-005FFFh) 不受写保护
 0 = Block 2 (004000-005FFFh) 受写保护
- bit 1 **WRT1:** 写保护位
 1 = Block 1 (002000-003FFFh) 不受写保护
 0 = Block 1 (002000-003FFFh) 受写保护
- bit 0 **WRT0:** 写保护位
 1 = Block 0 (000800-001FFFh) 不受写保护
 0 = Block 0 (000800-001FFFh) 受写保护

注 1: 在 PIC18F2423/4423 器件中未实现; 保持该位置 1。

寄存器 23-9: CONFIG6H: 配置寄存器 6 的高字节 (字节地址为 3000Bh)

R/C-1	R/C-1	R-1	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0
WRTD	WRTB	WRTC ⁽¹⁾	—	—	—	—	—
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位 C = 可清零位 U = 未实现位, 读为 0
 -n = 未对器件编程时的值 u = 编程后状态不变

- bit 7 **WRTD:** 数据 EEPROM 写保护位
 1 = 数据 EEPROM 不受写保护
 0 = 数据 EEPROM 受写保护
- bit 6 **WRTB:** 引导块写保护位
 1 = 引导块 (000000-0007FFFh) 不受写保护
 0 = 引导块 (000000-0007FFFh) 受写保护
- bit 5 **WRTC:** 配置寄存器写保护位 ⁽¹⁾
 1 = 配置寄存器 (300000-3000FFFh) 不受写保护
 0 = 配置寄存器 (300000-3000FFFh) 受写保护
- bit 4-0 **未实现:** 读为 0

注 1: 在正常执行模式下, 该位是只读的; 该位仅在编程模式下可写入。

PIC18F2423/2523/4423/4523

寄存器 23-10: **CONFIG7L: 配置寄存器 7 的低字节** (字节地址为 30000Ch)

U-0	U-0	U-0	U-0	R/C-1	R/C-1	R/C-1	R/C-1
—	—	—	—	EBTR3 ⁽¹⁾	EBTR2 ⁽¹⁾	EBTR1	EBTR0
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位 C = 可清零位 U = 未实现位, 读为 0
 -n = 未对器件编程时的值 u = 编程后状态不变

- bit 7-4 **未实现:** 读为 0
- bit 3 **EBTR3:** 表读保护位 ⁽¹⁾
 1 = 其他块可对 Block 3 (006000-007FFFh) 执行表读操作
 0 = 禁止其他块对 Block 3 (006000-007FFFh) 执行表读操作
- bit 2 **EBTR2:** 表读保护位 ⁽¹⁾
 1 = 其他块可对 Block 2 (004000-005FFFh) 执行表读操作
 0 = 禁止其他块对 Block 2 (004000-005FFFh) 执行表读操作
- bit 1 **EBTR1:** 表读保护位
 1 = 其他块可对 Block 1 (002000-003FFFh) 执行表读操作
 0 = 禁止其他块对 Block 1 (002000-003FFFh) 执行表读操作
- bit 0 **EBTR0:** 表读保护位
 1 = 其他块可对 Block 0 (000800-001FFFh) 执行表读操作
 0 = 禁止其他块对 Block 0 (000800-001FFFh) 执行表读操作

注 1: 在 PIC18F2423/4423 器件中未实现; 保持该位置 1。

寄存器 23-11: **CONFIG7H: 配置寄存器 7 的高字节** (字节地址为 30000Dh)

U-0	R/C-1	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0
—	EBTRB	—	—	—	—	—	—
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位 C = 可清零位 U = 未实现位, 读为 0
 -n = 未对器件编程时的值 u = 编程后状态不变

- bit 7 **未实现:** 读为 0
- bit 6 **EBTRB:** 引导块表读保护位
 1 = 其他块可对引导块 (000000-0007FFFh) 执行表读操作
 0 = 禁止其他块对引导块 (000000-0007FFFh) 执行表读操作
- bit 5-0 **未实现:** 读为 0

PIC18F2423/2523/4423/4523

寄存器 23-12: DEVID1: PIC18F2423/2523/4423/4523 器件的器件 ID 寄存器 1

R	R	R	R	R	R	R	R
DEV3	DEV2	DEV1	DEV0	REV3	REV2	REV1	REV0
bit 7							bit 0

图注:

R = 只读位 P = 可编程位 U = 未实现位, 读为 0
-n = 未对器件编程时的值 u = 编程后状态不变

bit 7-4 **DEV3:DEV0:** 器件 ID 位
1101 = PIC18F4423
1001 = PIC18F4523
0101 = PIC18F2423
0001 = PIC18F2523

bit 3-0 **REV3:REV0:** 版本 ID 位
这些位用于表明器件版本。

寄存器 23-13: DEVID2: PIC18F2423/2523/4423/4523 器件的器件 ID 寄存器 2

R	R	R	R	R	R	R	R
DEV11 ⁽¹⁾	DEV10 ⁽¹⁾	DEV9 ⁽¹⁾	DEV8 ⁽¹⁾	DEV7 ⁽¹⁾	DEV6 ⁽¹⁾	DEV5 ⁽¹⁾	DEV4 ⁽¹⁾
bit 7							bit 0

图注:

R = 只读位 P = 可编程位 U = 未实现位, 读为 0
-n = 未对器件编程时的值 u = 编程后状态不变

bit 7-0 **DEV11:DEV4:** 器件 ID 位 ⁽¹⁾
这些位与器件 ID 寄存器 1 中的 DEV3:DEV0 一起用于标识器件型号。
0001 0001 = PIC18F2423/2523 器件
0001 0000 = PIC18F4423/4523 器件

注 1: DEV11:DEV4 的值可能会被其他器件共用。特定器件是通过使用整个 DEV11:DEV0 位序列来标识的。

PIC18F2423/2523/4423/4523

23.2 看门狗定时器 (WDT)

PIC18F2423/2523/4423/4523 器件的 WDT 是由 INTRC 时钟源驱动的。当使能 WDT 时, 时钟源也将同时使能。WDT 超时溢出周期的标称值为 4 ms, 其稳定性与 INTRC 振荡器相同。

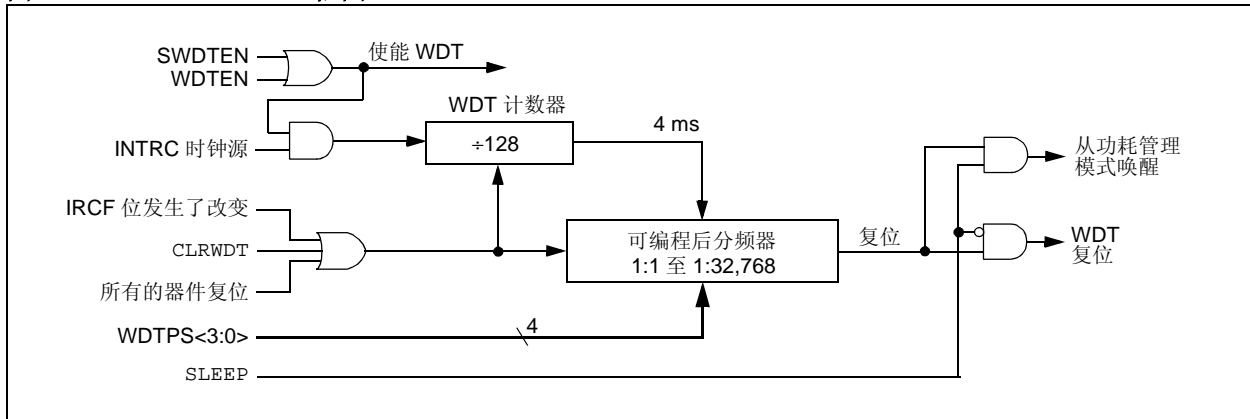
4 ms 的 WDT 超时溢出周期将与 16 位后分频器的分频值相乘来得到更长的时间周期。通过配置寄存器 2H 来控制一个多路开关以对 WDT 后分频器的输出进行选择。因此可获得的超时溢出周期范围为 4 ms 至 131.072 秒 (2.18 分钟)。当发生以下任一事件时, WDT 和后分频器将被清零, 这些事件包括: 执行 SLEEP 或 CLRWDT 指令、IRCF 位 (OSCCON<6:4>) 发生了改变或发生时钟故障。

- 注
- 1: 当执行 CLRWDT 和 SLEEP 指令时, WDT 和后分频器的计数值将被清零。
 - 2: 更改 IRCF 位 (OSCCON<6:4>) 的设置会清零 WDT 和后分频器的计数值。
 - 3: 当执行 CLRWDT 指令时, 后分频器的计数值将被清零。
 - 4: 当 FSCM 检测到时钟故障并切换时钟源时, WDT 和后分频器的计数值将被清零。

23.2.1 控制寄存器

寄存器 23-14 表示 WDTCON 寄存器。它是一个可读写的寄存器并包含一个控制位, 该控制位允许使用软件来改写 WDT 使能配置位 (仅当配置位已禁止 WDT 时)。

图 23-1: WDT 框图



PIC18F2423/2523/4423/4523

寄存器 23-14: WDTCON: 看门狗定时器控制寄存器

U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	R/W-0
—	—	—	—	—	—	—	SWDTEN ⁽¹⁾
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位 W = 可写位 U = 未实现位, 读为 0
 -n = POR 值 1 = 置 1 0 = 清零 x = 未知

bit 7-1 **未实现:** 读为 0
 bit 0 **SWDTEN:** 由软件控制的看门狗定时器使能位 ⁽¹⁾
 1 = 打开看门狗定时器
 0 = 关闭看门狗定时器

注 1: 当使能 WDTEN 配置位时该位不起作用。

表 23-2: 看门狗定时器寄存器汇总

名称	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	复位值所在页
RCON	IPEN	SBOREN ⁽¹⁾	—	\overline{RI}	\overline{TO}	\overline{PD}	\overline{POR}	\overline{BOR}	48
WDTCON	—	—	—	—	—	—	—	SWDTEN	50

图注: — = 未实现, 读为 0。看门狗定时器不使用阴影单元。

注 1: SBOREN 位仅在 BOREN1:BOREN0 配置位 = 01 时可用; 否则, 它被禁止且读为 0。请参见第 4.4 节“欠压复位 (BOR)”。

PIC18F2423/2523/4423/4523

23.3 双速启动

双速启动功能允许单片机在主时钟源稳定之前使用 INTOSC 振荡器作为时钟源，从而帮助器件最大限度地缩短从振荡器起振到代码执行之间的延时。通过将 IESO 配置位置 1 可使能该功能。

仅当主振荡器模式为 LP、XT、HS 或 HSPLL（基于晶振的模式）时才可使用双速启动。其他时钟源不需要 OST 起振延时；对于这些时钟源，应禁止双速启动。

一旦使能双速启动，当器件复位或从休眠模式中被唤醒时，在上电延时定时器发生超时后，器件将被配置成使用内部振荡器模块作为时钟源。这使得在主振荡器起振、OST 运行的同时，代码开始执行。一旦 OST 超时，器件就自动切换到 PRI_RUN 模式。

为了在将器件从休眠模式唤醒或 FSCM 事件发生时使用超过 1 MHz 的时钟速度，通过在复位后立即修改 IRCF2:IRCF0 位，可以预设 INTOSC 时钟源以提供该时钟速度。

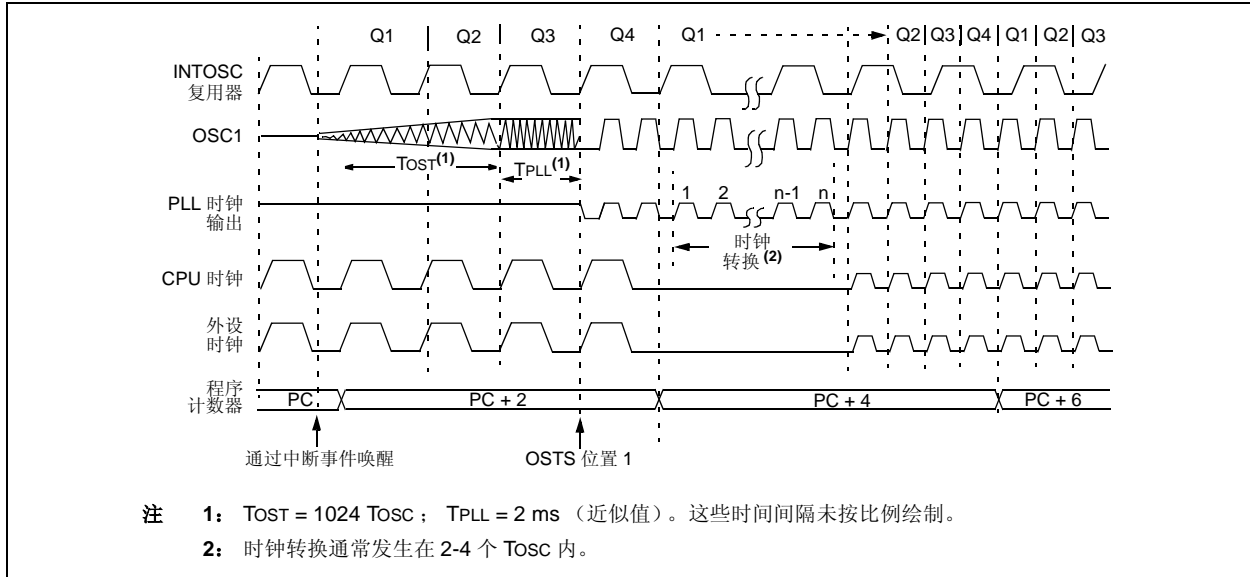
在其他功耗管理模式下，不使用双速启动。器件将使用当前选定的时钟源直到主时钟源可用为止。IESO 位的设置被忽略。

23.3.1 使用双速启动时的注意事项

当在双速启动模式中使用 INTOSC 振荡器时，器件仍将遵守进入功耗管理模式的正常指令顺序，包括执行多条 SLEEP 指令（见第 3.1.4 节“多条 SLEEP 命令”）。实际上，这意味着在 OST 超时前用户代码可以改变 SCS1:SCS0 位的设置或执行 SLEEP 指令。这就使应用程序能短暂地唤醒器件，执行“日常事务”，并在器件开始使用主时钟源前返回休眠状态。

用户代码还能通过检查 OST 位（OSCCON<3>）的状态来确定主时钟源是否正在为系统提供时钟。如果该位置 1，则表示主振荡器正在为系统提供时钟。否则，表示当器件复位或从休眠模式被唤醒期间由内部振荡器模块为系统提供时钟。

图 23-2: 双速启动时钟转换的时序图（从 INTOSC 切换到 HSPLL）

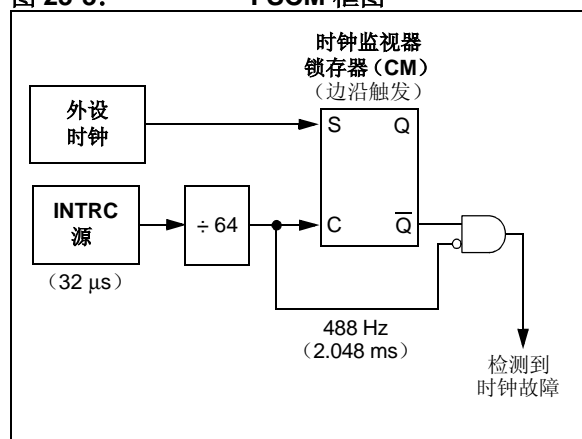


23.4 故障保护时钟监视器

故障保护时钟监视器（FSCM）可使单片机在外部时钟发生故障时，自动将系统时钟切换到内部振荡器模块以保证器件能继续运行。将 FCMEN 配置位置 1 可使能 FSCM 功能。

当使能 FSCM 时，INTRC 振荡器将一直保持运行以监视外设时钟，并且在外设时钟发生故障时作为备用时钟。时钟监视（如图 23-3 所示）通过创建一个采样时钟信号实现，该信号为 INTRC 输出的 64 分频。这样就使得 FSCM 采样时钟脉冲之间有充足的时间间隔，从而保证在此期间至少有一个外设时钟沿出现。外设时钟和采样时钟作为时钟监视锁存器（CM）的输入。CM 在系统时钟源的下降沿被置 1，在采样时钟的上升沿被清零。

图 23-3: FSCM 框图



在采样时钟的下降沿检测外部时钟故障。如果在出现采样时钟的下降沿时，CM 仍置 1，就表示检测到外部时钟故障（图 23-4）。这将引发以下事件：

- 通过将 OSCFIF (PIR2<7>) 置 1，由 FSCM 产生振荡器故障中断；
- 器件时钟源切换到内部振荡器模块（OSCCON 不会被更新，因此无法显示当前时钟源——这就是故障保护状态）；并且
- WDT 复位。

对于时序要求较高的应用，内部振荡器模块的频率可能不够稳定。在这些情况下，最好选择另一种时钟配置并进入其他功耗管理模式。可以尝试部分恢复或执行安全关闭。更多详细信息，请参见第 3.1.4 节“多条 SLEEP 命令”和第 23.3.1 节“使用双速启动时的注意事项”。

为了在将器件从休眠模式唤醒或 FSCM 事件发生时使用超过 1 MHz 的时钟速度，通过在复位后立即修改 IRCF2:IRCF0 位，可以预设 INTOSC 时钟源以提供该时钟速度。

FSCM 只能检测出主时钟源或辅助时钟源的故障。如果内部振荡器模块发生故障，将不会被检测到，当然也不可能采取任何措施。

23.4.1 FSCM 和看门狗定时器

FSCM 和 WDT 均以 INTRC 振荡器作为时钟源。由于 WDT 使用独立的分频器和计数器，使能 FSCM 时，禁止 WDT 对 INTRC 振荡器的运行没有任何影响。

如前所述，当发生时钟故障时，时钟源将切换到 INTOSC 时钟源。根据由 IRCF2:IRCF0 位选择的频率的不同，代码执行速度也会相应发生很大的变化。如果使能 WDT 的时候使用的是小预分频值，时钟速度的下降将引起 WDT 超时，随后使器件复位。由于这个原因，故障保护时钟监视器事件也会使 WDT 和后分频器复位，使 WDT 从执行速度发生变化那一刻起开始重新计数，从而避免发生错误超时。

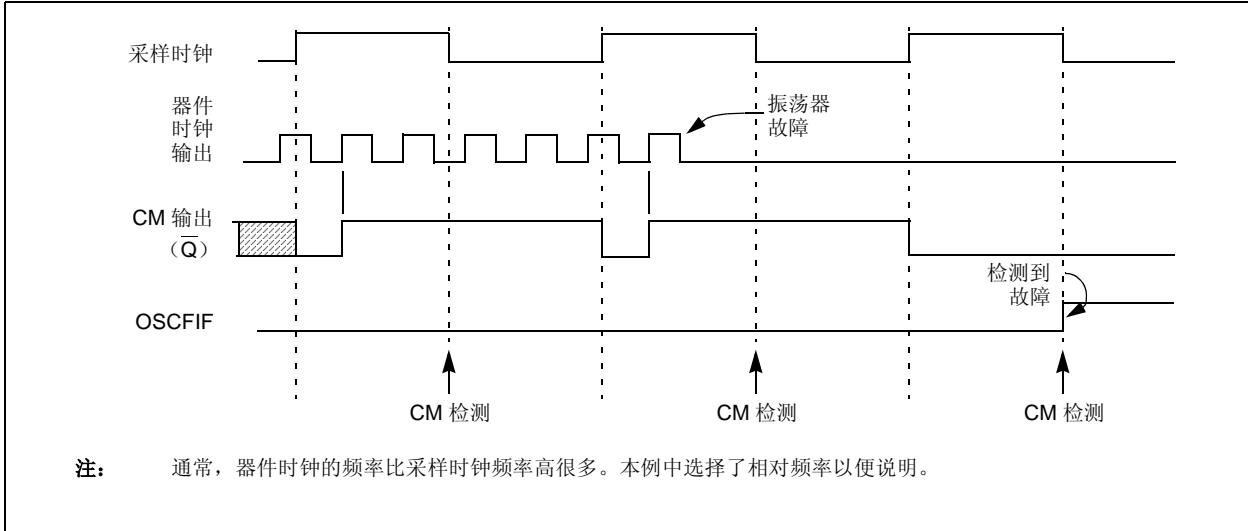
23.4.2 退出故障保护运行模式

器件复位或进入功耗管理模式均可结束故障保护状态。发生复位时，控制器启动在配置寄存器 1H 中指定的主时钟源（具有如 OST 或 PLL 定时器所需的起振延时）。INTOSC 多路开关将在主时钟源就绪之前提供系统时钟（类似于双速启动）。当主时钟源可用时，系统时钟源将切换为主时钟（OSCCON 寄存器中的 OST 位将置 1，表明当前使用的是主时钟源）。然后，故障保护时钟监视器恢复对外设时钟的监视。

在启动期间，主时钟源可能永远不能就绪。在这种情况下，器件运行将以 INTOSC 多路开关作为时钟源。OSCCON 寄存器将保持复位状态直到进入功耗管理模式为止。

PIC18F2423/2523/4423/4523

图 23-4: FSCM 时序图



23.4.3 功耗管理模式下的 FSCM 中断

进入功耗管理模式时, 时钟多路开关选择由 `OSCCON` 寄存器选定的时钟源。在该模式下将恢复对功耗管理时钟源的故障保护监视。

如果在功耗管理运行模式下发生了振荡器故障, 接下来的操作取决于是否允许了振荡器故障中断。如果允许了 (`OSCFIF = 1`), 代码执行将以 `INTOSC` 多路开关的输出作为时钟源, 并且不会自动转换回发生故障的时钟源。

如果禁止了该中断, 处于空闲模式时产生的中断将使 CPU 开始执行指令, 同时以 `INTOSC` 源作为系统时钟源。

23.4.4 POR 或从休眠中唤醒

FSCM 设计为用来在主时钟启动后的任何时候检测振荡器故障。当主时钟为 `EC` 或 `RC` 模式时, 监视会在这些事件发生后立即开始。

当振荡器模式使用了晶振或谐振器时 (如 `HS`、`HSPLL`、`LP` 或 `XT`), 情况会有些不同。由于这类振荡器需要的起振时间可能比 FSCM 采样时钟的周期长很多, 因此可能会检测到假的时钟故障。为了避免这种情况, 在此类模式中, 内部振荡器模块会被自动配置为器件时钟并一直工作到主时钟稳定下来为止 (`OST` 和 `PLL` 定时器发生超时)。这与双速启动模式相同。一旦主时钟稳定下来, `INTRC` 就将重新作为 FSCM 时钟源。

注: 用于防止在 POR 或从休眠状态唤醒时发生错误中断的逻辑, 同样也将阻止随后对振荡器故障的检测。通过监视 `OSTS` 位, 并使用定时程序来确定振荡器起振时间是否过长, 可避免这个问题。即使如此, 在检测到振荡器故障时也不会将振荡器故障中断标志位置 1。

正如第 23.3.1 节 “使用双速启动时的注意事项” 中所述, 在等待主时钟稳定的过程中, 可以选择另一种时钟配置和另一种功耗管理模式。当选择了新的功耗管理模式时, 主时钟将被禁止。

PIC18F2423/2523/4423/4523

23.5 程序校验和代码保护

PIC18闪存器件的整个代码保护结构与以往的PIC® MCU器件截然不同。

用户程序存储器被分成了五个存储块。其中一个存储块是 2 KB 的引导块。存储器的其余部分按二进制边界被分成四个存储块。

这五个存储块均有与其关联的三个代码保护位。它们是：

- 代码保护位 (CPn)
- 写保护位 (WRTn)
- 外部块表读位 (EBTRn)

图 23-5 给出了 16 KB 和 32 KB 器件的程序存储器构成以及与每个存储区关联的特定代码保护位。表 23-3 中总结了这些位的实际地址。

图 23-5: PIC18F2423/2523/4423/4523 受代码保护的程序存储区

存储容量 / 器件		地址范围	存储块的代码保护受控于:
16 KB (PIC18F2423/4423)	32 KB (PIC18F2523/4523)		
引导块	引导块	000000h 0007FFh	CPB, WRTB, EBTRB
Block 0	Block 0	000800h 001FFFh	CP0, WRT0, EBTR0
Block 1	Block 1	002000h 003FFFh	CP1, WRT1, EBTR1
未实现 读为 0	Block 2	004000h 005FFFh	CP2, WRT2, EBTR2
	Block 3	006000h 007FFFh	CP3, WRT3, EBTR3
	未实现 读为 0		(未实现的存储空间)
		1FFFFFFh	

表 23-3: 代码保护寄存器汇总

寄存器名称		Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
300008h	CONFIG5L	—	—	—	—	CP3 ⁽¹⁾	CP2 ⁽¹⁾	CP1	CP0
300009h	CONFIG5H	CPD	CPB	—	—	—	—	—	—
30000Ah	CONFIG6L	—	—	—	—	WRT3 ⁽¹⁾	WRT2 ⁽¹⁾	WRT1	WRT0
30000Bh	CONFIG6H	WRD	WRTB	WRTC	—	—	—	—	—
30000Ch	CONFIG7L	—	—	—	—	EBTR3 ⁽¹⁾	EBTR2 ⁽¹⁾	EBTR1	EBTR0
30000Dh	CONFIG7H	—	EBTRB	—	—	—	—	—	—

图注: 未实现阴影单元。

注 1: 在 PIC18F2423/4423 器件中未实现; 保持该位置 1。

PIC18F2423/2523/4423/4523

23.5.1 程序存储器代码保护

可使用表读和表写指令读写任何程序存储单元。器件 ID 可以通过表读指令进行读取。配置寄存器可以通过表读和表写指令进行读写操作。

在正常执行模式下，CPn 位不起任何作用。CPn 位禁止外部读写。如果 WRTn 配置位为 0，则用户存储块可被保护不受表写指令的影响。EBTRn 位控制表读操作。对于 EBTRn 位设置为 0 的用户存储块，允许在该块内执

行表读操作。不允许从存储块以外的存储单元执行表读指令，将导致读为 0。图 23-6 到 23-8 例举了表写和表读保护。

注： 代码保护位只能从 1 写为 0 状态。不可能将处于 0 状态的位写为 1。只有通过整片擦除或块擦除功能才能将代码保护位设置为 1。整片擦除和块擦除功能只能通过 ICSP 或外部编程器启动。

图 23-6: 不允许表写 (WRTn)

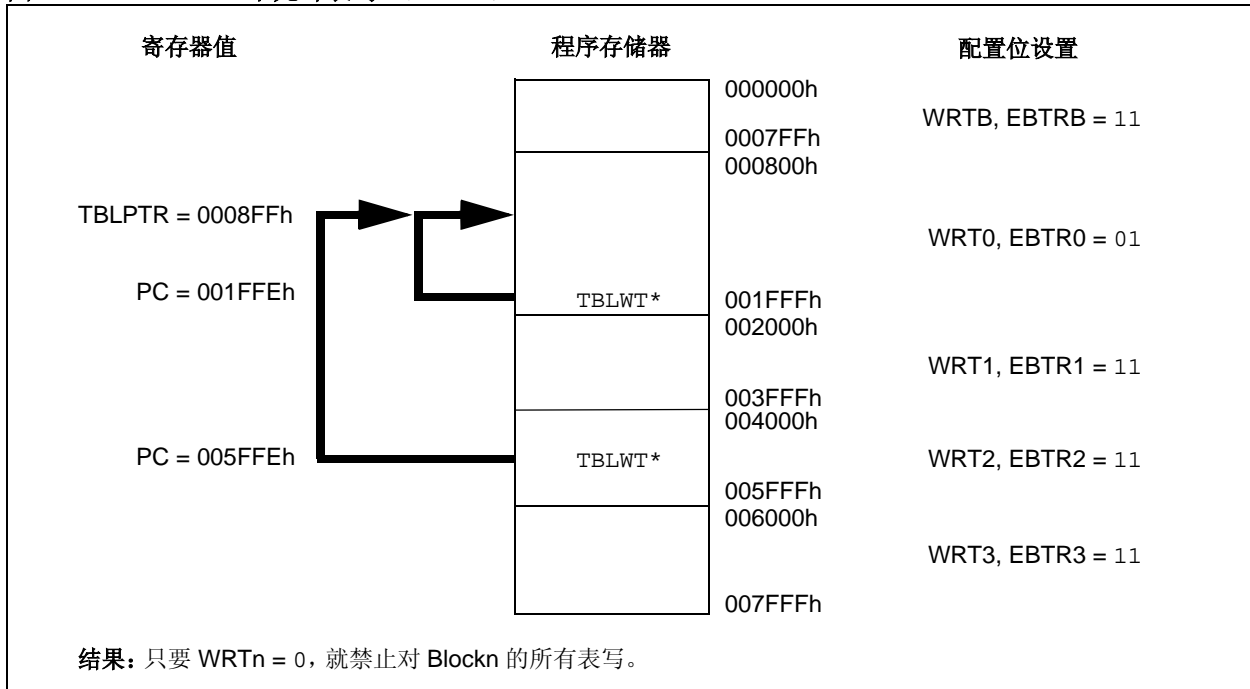


图 23-7: 不允许从外部存储块进行表读 (EBTRn)

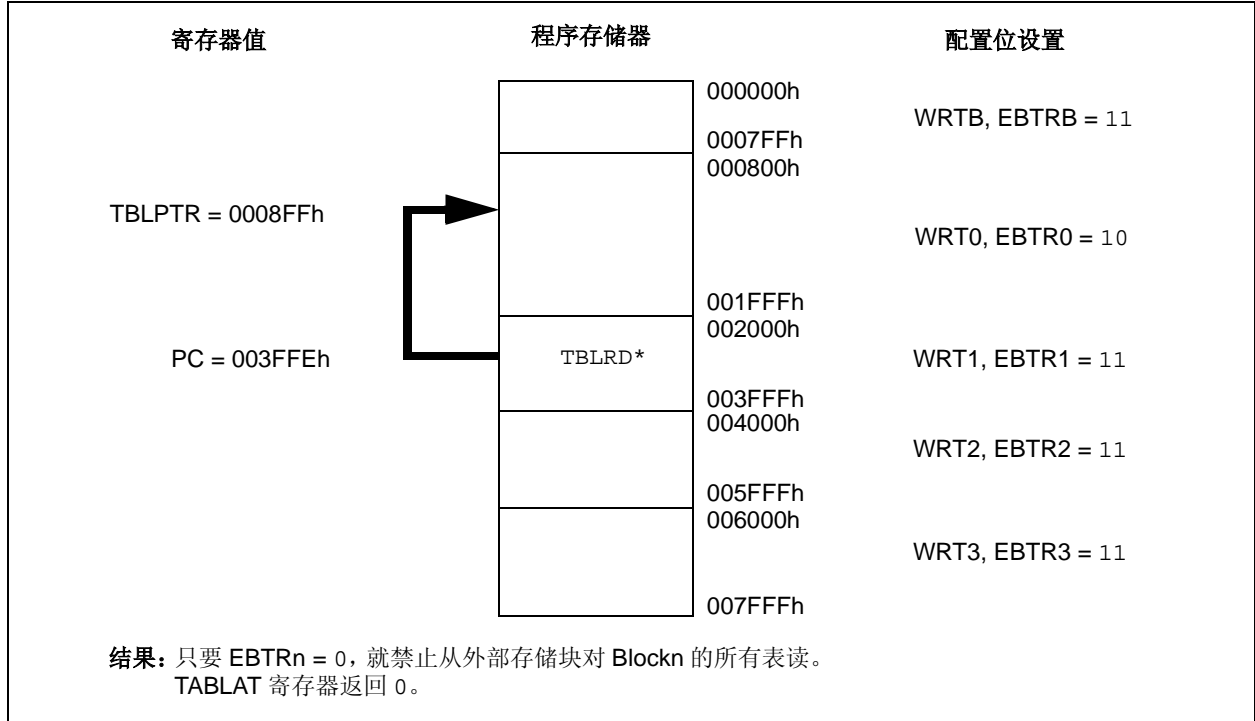
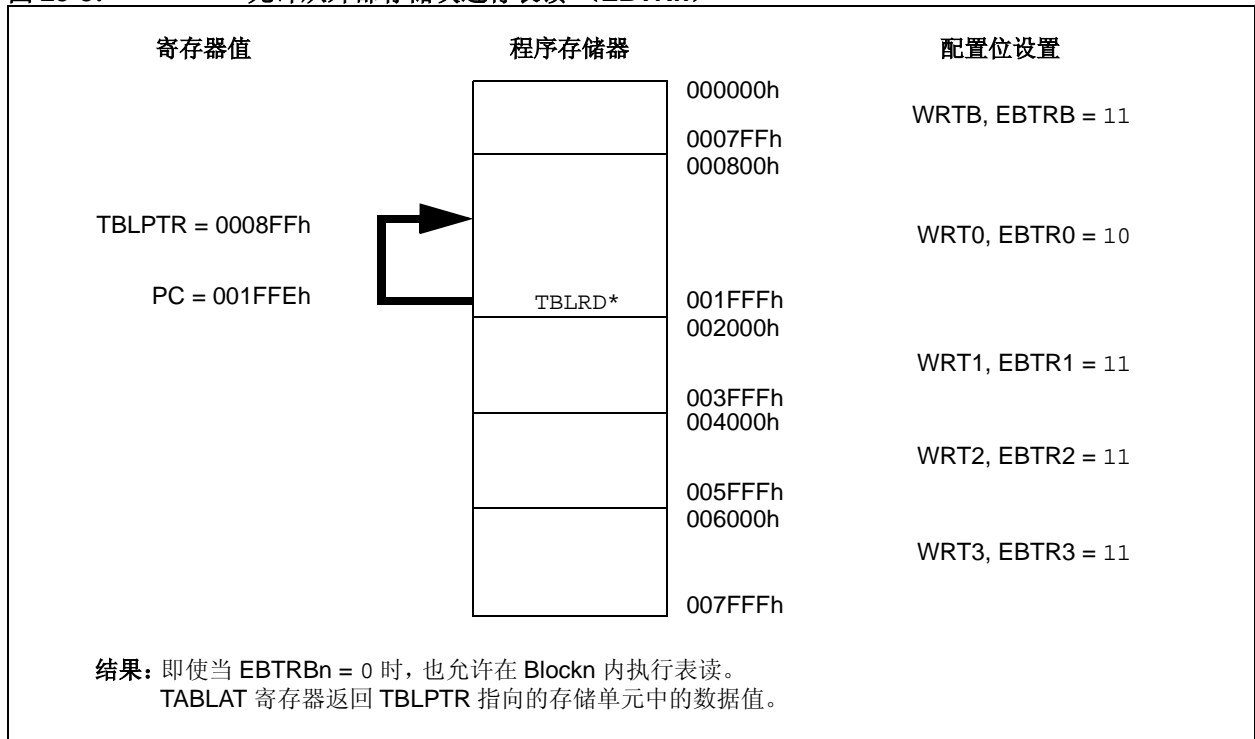


图 23-8: 允许从外部存储块进行表读 (EBTRn)



PIC18F2423/2523/4423/4523

23.5.2 数据 EEPROM 代码保护

整个数据 EEPROM 受外部读写的保护，这通过 CPD 和 WRD 两个位来实现。CPD 禁止数据 EEPROM 的外部读写。WRD 禁止从内部和外部写数据 EEPROM。在正常操作下，CPU 可以始终读数据 EEPROM，与保护位的设置无关。

23.5.3 配置寄存器保护

配置寄存器可被写保护。WRTC 位控制配置寄存器的保护。在正常执行模式下，WRTC 位是只读的。WRTC 只能通过 ICSP 或外部编程器写入。

23.6 ID 存储单元

有 8 个存储单元（200000h-200007h）被指定为 ID 存储单元，供用户存储校验和其他代码标识。在正常执行时可通过 TBLRD 和 TBLWT 指令读写这些存储单元；在编程 / 验证时，也可读写这些存储单元。当器件被代码保护时，也可读取 ID 存储单元。

23.7 在线串行编程

可以在最终的应用电路中对 PIC18F2423/2523/4423/4523 器件进行串行编程。只需要 5 根线即可实现这一操作，其中时钟线、数据线各一根，其余 3 根分别是电源线、接地线和编程电压线。这允许用户在生产电路板时使用未编程器件，仅在产品交付之前才对单片机进行编程，从而可以使用最新版本的固件或者定制固件进行编程。VDD 为 3.0V 到 5.5V 时可使能块操作或批量操作。

23.8 在线调试器

将 DEBUG 配置位编程为 0，可启用在线调试器功能。该功能允许使用 MPLAB® IDE 进行一些简单的调试。当使能了单片机的这项功能时，有些资源就不再是通用的了。表 23-4 给出了后台调试器所需的资源。

表 23-4: 调试器资源

I/O 引脚:	RB6 和 RB7
堆栈:	2 级深度
程序存储器:	512 字节
数据存储器:	10 字节

要使用单片机的在线调试器功能，在设计时必须对 MCLR/VPP/RE3、VDD、VSS、RB7 和 RB6 进行在线串行编程连接，从而与 Microchip 或第三方开发工具公司提供的在线调试器模块接口。

23.9 单电源 ICSP 编程

LVP 配置位使能单电源 ICSP 编程（原来称为低电压 ICSP 编程或 LVP）。当使能单电源编程时，单片机可以在无需对 MCLR/VPP/RE3 引脚施加高电压的情况下进行编程，但 RB5/KBI1/PGM 引脚专用于控制程序模式选择，不能再用作通用 I/O 引脚。

使用单电源编程时，VDD 被施加到 MCLR/VPP/RE3 引脚，如同在正常执行模式下一样。要进入编程模式，VDD 被施加到 PGM 引脚。

- | | |
|----------|--|
| 注 | 1: 通过将 VIH 施加到 MCLR 引脚，就可以进行高电压编程，与 LVP 位或 PGM 引脚的状态无关。 |
| | 2: 默认情况下，未编程器件（如 Microchip 提供的）和已擦除器件均使能了单电源 ICSP 编程。 |
| | 3: 当使能单电源编程时，RB5 引脚不能再用作通用 I/O 引脚。 |
| | 4: 当使能 LVP 时，从外部将 PGM 引脚拉至 VSS 可以允许正常程序执行。 |

如果不再使用单电源 ICSP 编程模式，则 LVP 位可以被清零。RB5/KBI1/PGM 随后可作为数字 I/O 引脚 RB5。LVP 位仅在使用标准高电压编程时可被置 1 或清零（VIH 被施加到 MCLR/VPP/RE3 引脚）。一旦 LVP 被禁止，只能使用标准高电压编程来对器件进行编程。

不受代码保护的存储区可以使用块擦除或逐行擦除进行擦除，然后在任何指定的 VDD 下进行写入。如果要擦除受代码保护的存储区，需要进行块擦除。如果在使用低电压编程时执行块擦除，则器件的 VDD 必须为 3.0V 到 5.5V。

24.0 指令集汇总

PIC18F2423/2523/4423/4523 器件具有一个包含 75 条 PIC18 核心指令的标准指令集，和一个包含用于优化递归或使用软件堆栈的代码的 8 条新指令的扩展指令集。本章后面的部分将讨论扩展指令集。

24.1 标准指令集

标准的 PIC18 指令集与以前的 PIC[®]MCU 指令集相比，添加了很多增强功能，并保持了易于从其他 PIC 指令集移植的特点。大部分指令为单程序存储字（16 位），只有 4 条指令需要两个程序存储单元。

每个单字指令都是一个 16 位字，由操作码（指明指令类型）和一个或多个操作数（指定指令操作）组成。

整个指令集具有高度的正交性，可以分为以下 4 种基本类型：

- 字节操作类指令
- 位操作类指令
- 立即数操作类指令
- 控制操作类指令

表 24-2 为 PIC18 指令集汇总，列出了上述四类指令。表 24-1 给出了操作码字段的说明。

大部分字节操作类的指令都含有三个操作数：

1. 文件寄存器（由“f”指定）
2. 保存结果的目标寄存器（由“d”指定）
3. 被访问存储器（由“a”指定）

文件寄存器标识符“f”指定了指令将会使用哪一个文件寄存器。目标寄存器标识符“d”指定了操作结果的存放位置。如果“d”为 0，操作结果存入 WREG 寄存器中。如果“d”为 1，操作结果存入指令指定的文件寄存器中。

所有位操作类指令都含有三个操作数：

1. 文件寄存器（由“f”指定）
2. 文件寄存器中的位（由“b”指定）
3. 被访问存储器（由“a”指定）

位域标识符“b”选择操作所影响的位的编号，而文件寄存器标识符“f”则代表这些位所在的寄存器编号。

立即数操作类指令使用以下操作数：

- 要装入文件寄存器中的立即数（由“k”指定）
- 要装入立即数的 FSR 寄存器（由“f”指定）
- 不需要操作数（由“—”指定）

控制类指令可能使用以下操作数：

- 程序存储器地址（由“n”指定）
- CALL 或 RETURN 指令的模式（由“s”指定）
- 表读和表写指令的模式（由“m”指定）
- 不需要操作数（由“—”指定）

除了 4 条双字指令外，所有的指令都是单字指令。双字指令将所需的信息保存在 32 位中。第二个字的高 4 位都是 1。如果第二个字作为一条指令执行，它会执行为 NOP 指令。

除非条件测试结果为真或者指令执行改变了程序计数器的值，否则执行所有的单字指令都只需要一个指令周期。对于上述两种特殊情况，指令执行需要两个指令周期，在第二个指令周期中执行一条 NOP 指令。

执行双字指令需要两个指令周期。

每个指令周期由 4 个振荡器周期组成。因此，如果振荡器频率为 4 MHz，正常的指令执行时间为 1 μs。如果条件测试结果为真或指令执行改变了程序计数器的值，则指令的执行时间为 2 μs。双字跳转指令（如果为真）的执行则需要 3 μs。

图 24-1 给出了指令的几种通用格式。所有示例均使用“nnh”来表示十六进制数。

指令集汇总（见表 24-2）列出了可被 Microchip MPASM[™] 汇编器识别的标准指令。

第 24.1.1 节“标准指令集”中对每条指令进行了介绍。

PIC18F2423/2523/4423/4523

表 24-1: 操作码字段说明

字段	说明
a	快速操作 RAM 位 a = 0: 快速操作 RAM 内的 RAM 存储单元 (BSR 寄存器被忽略) a = 1: 由 BSR 寄存器指定 RAM 存储区
bbb	8 位文件寄存器内的位地址 (0 到 7)。
BSR	存储区选择寄存器。用于选择当前的 RAM 存储区。
C、DC、Z、OV 和 N	ALU 状态位: 进位、半进位、全零、溢出和负标志位。
d	目标寄存器选择位 d = 0: 结果保存至 WREG 寄存器 d = 1: 结果保存至文件寄存器 f
dest	目标寄存器: 可以是 WREG 寄存器或指定的文件寄存器地址。
f	8 位文件寄存器地址 (00h 到 FFh), 或 2 位 FSR 标识符 (0h 到 3h)。
f _s	12 位文件寄存器地址 (000h 到 FFFh)。这是源地址。
f _d	12 位文件寄存器地址 (000h 到 FFFh)。这是目标地址。
GIE	全局中断允许位。
k	立即数、常数或者标号 (可能是 8 位、12 位或 20 位的值)。
Label	标号名称。
mm	表读和表写指令的 TBLPTR 寄存器模式。 只用于表读和表写指令:
*	不改变寄存器 (如用于表读和表写的 TBLPTR)
*+	后递增寄存器 (如用于表读和表写的 TBLPTR)
*-	后递减寄存器 (如用于表读和表写的 TBLPTR)
++	预递增寄存器 (如用于表读和表写的 TBLPTR)
n	相对跳转指令的相对地址 (二进制补码), 或 Call/Branch 和 Return 指令的直接地址。
PC	程序计数器。
PCL	程序计数器低字节。
PCH	程序计数器高字节。
PCLATH	程序计数器高字节锁存器。
PCLATU	程序计数器最高字节锁存器。
\overline{PD}	掉电位。
PRODH	乘积的高字节。
PRODL	乘积的低字节。
s	快速调用 / 返回模式选择位 s = 0: 不对影子寄存器进行更新, 也不用影子寄存器的内容更新主寄存器 s = 1: 将主寄存器的值存入影子寄存器或把影子寄存器中的值载入主寄存器 (快速模式)
TBLPTR	21 位表指针 (指向程序存储器地址)。
TABLAT	8 位表锁存器。
\overline{TO}	超时溢出位。
TOS	栈顶。
u	未使用或未改变。
WDT	看门狗定时器。
WREG	工作寄存器 (累加器)。
x	无关位 (0 或 1)。编译器将产生 x = 0 的代码。为了与所有的 Microchip 软件工具兼容, 建议使用这种形式。
z _s	对 (源) 文件寄存器进行间接寻址的 7 位偏移量。
z _d	对 (目标) 文件寄存器进行间接寻址的 7 位偏移量。
{ }	可选参数。
[text]	表示变址地址。
(text)	text 的内容。
[expr]<n>	表示由指针 expr 指定的寄存器中的位 n。
→	赋值。
< >	寄存器位域。
∈	表示属于某个集合。
斜体文字	用户定义项 (字体为 Courier New)。

PIC18F2423/2523/4423/4523

表 24-2: PIC18FXXXX 指令集

助记符, 操作数	说明	周期	16 位指令字		受影响 的状态位	注	
			MSb	LSb			
针对字节的操作类指令							
ADDWF	f, d, a	WREG 与 f 相加	1	0010	01da0 ffff ffff	C, DC, Z, OV, N	1, 2
ADDWFC	f, d, a	WREG 与 f 带进位相加	1	0010	0da ffff ffff	C, DC, Z, OV, N	1, 2
ANDWF	f, d, a	WREG 和 f 作逻辑与运算	1	0001	01da ffff ffff	Z, N	1, 2
CLRF	f, a	将 f 清零	1	0110	101a ffff ffff	Z	2
COMF	f, d, a	对 f 取反	1	0001	11da ffff ffff	Z, N	1, 2
CPFSEQ	f, a	将 f 与 WREG 作比较, 相等则跳过	1 (2 或 3)	0110	001a ffff ffff	无	4
CPFSGT	f, a	将 f 与 WREG 作比较, 大于则跳过	1 (2 或 3)	0110	010a ffff ffff	无	4
CPFSLT	f, a	将 f 与 WREG 作比较, 小于则跳过	1 (2 或 3)	0110	000a ffff ffff	无	1, 2
DECF	f, d, a	f 递减 1	1	0000	01da ffff ffff	C, DC, Z, OV, N	1, 2, 3, 4
DECFSZ	f, d, a	f 递减 1, 为 0 则跳过	1 (2 或 3)	0010	11da ffff ffff	无	1, 2, 3, 4
DCFSNZ	f, d, a	f 递减 1, 非 0 则跳过	1 (2 或 3)	0100	11da ffff ffff	无	1, 2
INCF	f, d, a	f 递增 1	1	0010	10da ffff ffff	C, DC, Z, OV, N	1, 2, 3, 4
INCFSZ	f, d, a	f 递增 1, 为 0 则跳过	1 (2 或 3)	0011	11da ffff ffff	无	4
INFSNZ	f, d, a	f 递增 1, 非 0 则跳过	1 (2 或 3)	0100	10da ffff ffff	无	1, 2
IORWF	f, d, a	WREG 和 f 作逻辑或运算	1	0001	00da ffff ffff	Z, N	1, 2
MOVF	f, d, a	传送 f	1	0101	00da ffff ffff	Z, N	1
MOVFF	f _s , f _d	将 f _s (源) 内容传送到 f _d (目标)	第一个字 第二个字	2	1100 ffff ffff ffff	无	
MOVWF	f, a	将 WREG 内容传送到 f	1	0110	111a ffff ffff	无	
MULWF	f, a	WREG 与 f 相乘	1	0000	001a ffff ffff	无	1, 2
NEGF	f, a	对 f 取补	1	0110	110a ffff ffff	C, DC, Z, OV, N	
RLCF	f, d, a	f 带进位循环左移	1	0011	01da ffff ffff	C, Z, N	1, 2
RLNCF	f, d, a	f 循环左移 (不带进位)	1	0100	01da ffff ffff	Z, N	
RRCF	f, d, a	f 带进位循环右移	1	0011	00da ffff ffff	C, Z, N	
RRNCF	f, d, a	f 循环右移 (不带进位)	1	0100	00da ffff ffff	Z, N	
SETF	f, a	将 f 的内容置为全 1	1	0110	100a ffff ffff	无	1, 2
SUBFWB	f, d, a	WREG 减去 f (带借位)	1	0101	01da ffff ffff	C, DC, Z, OV, N	
SUBWF	f, d, a	f 减去 WREG	1	0101	11da ffff ffff	C, DC, Z, OV, N	1, 2
SUBWFB	f, d, a	f 减去 WREG (带借位)	1	0101	10da ffff ffff	C, DC, Z, OV, N	
SWAPF	f, d, a	将 f 中的两个半字节进行交换	1	0011	10da ffff ffff	无	4
TSTFSZ	f, a	测试 f, 为 0 则跳过	1 (2 或 3)	0110	011a ffff ffff	无	1, 2
XORWF	f, d, a	WREG 和 f 作逻辑异或运算	1	0001	10da ffff ffff	Z, N	

- 注 1: 当端口寄存器修改自身时 (例如, MOVF PORTB, 1, 0), 使用的值是引脚上的当前值。例如, 如果将一引脚配置为输入, 且对应数据锁存器中的值为 1, 但此时若有外部器件将该引脚驱动为低电平, 则被写回数据锁存器的数据值将是 0。
- 2: 当对 TMR0 寄存器执行该指令 (并且 d = 1) 时, 如果已为其分配了预分频器, 则将该预分频器清零。
- 3: 如果程序计数器 (PC) 被修改或者条件测试为真, 则该指令需要两个周期。第二个周期执行一条 NOP 指令。
- 4: 某些指令是双字指令。这些指令的第二个字将作为 NOP 指令执行, 除非指令的第一个字获取这 16 位中包含的信息。这将确保所有程序存储单元内存储的都是合法的指令。

PIC18F2423/2523/4423/4523

表 24-2: PIC18FXXXX 指令集 (续)

助记符, 操作数	说明	周期	16 位指令字				受影响的状态位	注	
			MSb	LSb					
针对位的操作类指令									
BCF	f, b, a	将 f 寄存器中的某位清零	1	1001	bbba	ffff	ffff	无	1, 2
BSF	f, b, a	将 f 寄存器中的某位置 1	1	1000	bbba	ffff	ffff	无	1, 2
BTFSC	f, b, a	测试 f 中的某位, 为 0 则跳过	1 (2 或 3)	1011	bbba	ffff	ffff	无	3, 4
BTFSS	f, b, a	测试 f 中的某位, 为 1 则跳过	1 (2 或 3)	1010	bbba	ffff	ffff	无	3, 4
BTG	f, d, a	将 f 中的某位取反	1	0111	bbba	ffff	ffff	无	1, 2
控制类指令									
BC	n	进位则跳转	1 (2)	1110	0010	nnnn	nnnn	无	4
BN	n	为负则跳转	1 (2)	1110	0110	nnnn	nnnn	无	
BNC	n	无进位则跳转	1 (2)	1110	0011	nnnn	nnnn	无	
BNN	n	不为负则跳转	1 (2)	1110	0111	nnnn	nnnn	无	
BNOV	n	不溢出则跳转	1 (2)	1110	0101	nnnn	nnnn	无	
BNZ	n	不为零则跳转	1 (2)	1110	0001	nnnn	nnnn	无	
BOV	n	溢出则跳转	1 (2)	1110	0100	nnnn	nnnn	无	
BRA	n	无条件跳转	2	1101	0nnn	nnnn	nnnn	无	
BZ	n	为零则跳转	1 (2)	1110	0000	nnnn	nnnn	无	
CALL	n, s	调用子程序 第一个字 第二个字	2	1110	110s	kkkk	kkkk	无	
CLRWDT	—	将看门狗定时器清零	1	0000	0000	0000	0100	$\overline{TO}, \overline{PD}$	
DAW	—	对 WREG 进行十进制调整	1	0000	0000	0000	0111	C	
GOTO	n	跳转到地址 第一个字 第二个字	2	1110	1111	kkkk	kkkk	无	
NOP	—	空操作	1	0000	0000	0000	0000	无	
NOP	—	空操作	1	1111	xxxx	xxxx	xxxx	无	
POP	—	弹出返回堆栈栈项 (TOS)	1	0000	0000	0000	0110	无	
PUSH	—	压入返回堆栈栈项 (TOS)	1	0000	0000	0000	0101	无	
RCALL	n	相对调用	2	1101	lnnn	nnnn	nnnn	无	
RESET	—	用软件使器件复位	1	0000	0000	1111	1111	全部	
RETFIE	s	从中断返回	2	0000	0000	0001	000s	GIE/GIEH, PEIE/GIEL	
RETLW	k	返回并将立即数送入 WREG	2	0000	1100	kkkk	kkkk	无	
RETURN	s	从子程序返回	2	0000	0000	0001	001s	无	
SLEEP	—	进入待机模式	1	0000	0000	0000	0011	$\overline{TO}, \overline{PD}$	

- 注
- 1: 当端口寄存器修改自身时 (例如, MOVF PORTB, 1, 0), 使用的值是引脚上的当前值。例如, 如果将一引脚配置为输入, 且对应数据锁存器中的值为 1, 但此时若有外部器件将该引脚驱动为低电平, 则被写回数据锁存器的数据值将是 0。
 - 2: 当对 TMR0 寄存器执行该指令 (并且 d = 1) 时, 如果已为其分配了预分频器, 则将该预分频器清零。
 - 3: 如果程序计数器 (PC) 被修改或者条件测试为真, 则该指令需要两个周期。第二个周期执行一条 NOP 指令。
 - 4: 某些指令是双字指令。这些指令的第二个字将作为 NOP 指令执行, 除非指令的第一个字获取这 16 位中包含的信息。这将确保所有程序存储单元内存储的都是合法的指令。

PIC18F2423/2523/4423/4523

表 24-2: PIC18FXXXX 指令集 (续)

助记符, 操作数	说明	周期	16 位指令字				受影响 的状态位	注	
			MSb			LSb			
立即数操作类指令									
ADDLW	k	WREG 与立即数相加	1	0000	1111	kkkk	kkkk	C, DC, Z, OV, N	
ANDLW	k	WREG 和立即数进行逻辑与运算	1	0000	1011	kkkk	kkkk	Z, N	
IORLW	k	WREG 和立即数进行逻辑或运算	1	0000	1001	kkkk	kkkk	Z, N	
LFSR	f, k	传送立即数 (12位) 第一个字 到 FSR (f) 第二个字	2	1110	1110	00ff	kkkk	无	
MOVLB	k		1	1111	0000	kkkk	kkkk	无	
MOVLW	k	将立即数传送到 BSR<3:0>	1	0000	1110	kkkk	kkkk	无	
MULLW	k	将立即数传送到 WREG	1	0000	1101	kkkk	kkkk	无	
RETLW	k	WREG 和立即数相乘	2	0000	1100	kkkk	kkkk	无	
SUBLW	k	返回并将立即数送入 WREG	1	0000	1000	kkkk	kkkk	C, DC, Z, OV, N	
XORLW	k	立即数减去 WREG WREG 和立即数进行逻辑异或运算	1	0000	1010	kkkk	kkkk	Z, N	
数据存储器 ↔ 程序存储器操作									
TBLRD*		表读	2	0000	0000	0000	1000	无	
TBLRD*+		后递增表读		0000	0000	0000	1001	无	
TBLRD*-		后递减表读		0000	0000	0000	1010	无	
TBLRD+*		预递增表读		0000	0000	0000	1011	无	
TBLWT*		表写	2	0000	0000	0000	1100	无	
TBLWT*+		后递增表写		0000	0000	0000	1101	无	
TBLWT*-		后递减表写		0000	0000	0000	1110	无	
TBLWT+*		预递增表写		0000	0000	0000	1111	无	

- 注 1: 当端口寄存器修改自身时 (例如, MOVF PORTB, 1, 0), 使用的值是引脚上的当前值。例如, 如果将一引脚配置为输入, 且对应数据锁存器中的值为 1, 但此时若有外部器件将该引脚驱动为低电平, 则被写回数据锁存器的数据值将是 0。
- 2: 当对 TMR0 寄存器执行该指令 (并且 d = 1) 时, 如果已为其分配了预分频器, 则将该预分频器清零。
- 3: 如果程序计数器 (PC) 被修改或者条件测试为真, 则该指令需要两个周期。第二个周期执行一条 NOP 指令。
- 4: 某些指令是双字指令。这些指令的第二个字将作为 NOP 指令执行, 除非指令的第一个字获取这 16 位中包含的信息。这确保所有程序存储单元内存储的都是合法的指令。

PIC18F2423/2523/4423/4523

24.1.1 标准指令集

ADDLW W 与立即数相加

语法: ADDLW k

操作数: $0 \leq k \leq 255$

操作: $(W) + k \rightarrow W$

受影响的状态位: N、OV、C、DC 和 Z

机器码:

0000	1111	kkkk	kkkk
------	------	------	------

说明: 将 W 寄存器的内容与 8 位立即数 k 相加, 结果存储在 W 寄存器中。

指令字数: 1

指令周期数: 1

Q 周期操作:

Q1	Q2	Q3	Q4
译码	读立即数 k	处理数据	写入 W

示例: ADDLW 15h

执行指令前
W = 10h

执行指令后
W = 25h

ADDWF W 与 f 寄存器相加

语法: ADDWF f{,d{,a}}

操作数: $0 \leq f \leq 255$
 $d \in [0,1]$
 $a \in [0,1]$

操作: $(W) + (f) \rightarrow \text{dest}$

受影响的状态位: N、OV、C、DC 和 Z

机器码:

0010	01da	ffff	ffff
------	------	------	------

说明: 将 W 的内容与 f 寄存器的内容相加。如果 d 为 0, 结果存储在 W 中。如果 d 为 1, 结果存回寄存器 f (默认)。如果 a 为 0, 选择快速操作存储区。如果 a 为 1, 使用 BSR 选择 GPR 存储区 (默认)。如果 a 为 0 且使能了扩展指令集, 只要 $f \leq 95$ (5Fh), 指令就将以立即数变址寻址模式进行操作。详细信息, 请参见第 24.2.3 节“立即数变址寻址模式下针对字节和针对位的指令”。

指令字数: 1

指令周期数: 1

Q 周期操作:

Q1	Q2	Q3	Q4
译码	读寄存器 f	处理数据	写入目标寄存器

示例: ADDWF REG, 0, 0

执行指令前
W = 17h
REG = 0C2h

执行指令后
W = 0D9h
REG = 0C2h

注: 所有的 PIC18 指令都可能在其指令助记符之前使用可选的标号参数, 用于符号寻址。如果使用了标号, 那么指令语法将变为: {label} 指令参数。

PIC18F2423/2523/4423/4523

ADDWFC

W 与 f 带进位相加

语法: ADDWFC f {,d {,a}}

操作数: $0 \leq f \leq 255$
 $d \in [0,1]$
 $a \in [0,1]$

操作: $(W) + (f) + (C) \rightarrow \text{dest}$

受影响的状态位: N、OV、C、DC 和 Z

0010	00da	ffff	ffff
------	------	------	------

说明: 将 W 的内容、进位标志位与数据存储器单元 f 的内容相加。如果 d 为 0，结果存储在 W 中。如果 d 为 1，结果存储在数据存储器单元 f 中。

如果 a 为 0，选择快速操作存储区。如果 a 为 1，使用 BSR 选择 GPR 存储区（默认）。

如果 a 为 0 且使能了扩展指令集，只要 $f \leq 95$ (5Fh)，指令就将以立即数变址寻址模式进行操作。详细信息，请参见第 24.2.3 节“立即数变址寻址模式下针对字节和针对位的指令”。

指令字数: 1

指令周期数: 1

Q 周期操作:

Q1	Q2	Q3	Q4
译码	读寄存器 f	处理数据	写入目标寄存器

示例: ADDWFC REG, 0, 1

执行指令前

进位标志位 = 1
 REG = 02h
 W = 4Dh

执行指令后

进位标志位 = 0
 REG = 02h
 W = 50h

ANDLW

立即数和 W 寄存器作逻辑与运算

语法: ANDLW k

操作数: $0 \leq k \leq 255$

操作: $(W) .\text{AND. } k \rightarrow W$

受影响的状态位: N 和 Z

0000	1011	kkkk	kkkk
------	------	------	------

说明: 将 W 的内容与 8 位立即数 k 进行逻辑与运算。结果存储在 W 寄存器中。

指令字数: 1

指令周期数: 1

Q 周期操作:

Q1	Q2	Q3	Q4
译码	读立即数 k	处理数据	写入 W

示例: ANDLW 05Fh

执行指令前

W = A3h

执行指令后

W = 03h

PIC18F2423/2523/4423/4523

ANDWF 将 W 和 f 作逻辑与运算

语法: ANDWF f{,d{,a}}

操作数: $0 \leq f \leq 255$
 $d \in [0,1]$
 $a \in [0,1]$

操作: $(W) .AND.(f) \rightarrow dest$

受影响的状态位: N 和 Z

机器码:

0001	01da	ffff	ffff
------	------	------	------

说明: 将 W 的内容与寄存器 f 的内容进行逻辑与运算。如果 d 为 0, 结果存储在 W 中。如果 d 为 1, 结果存回寄存器 f (默认)。
 如果 a 为 0, 选择快速操作存储区。如果 a 为 1, 使用 BSR 选择 GPR 存储区 (默认)。
 如果 a 为 0 且使能了扩展指令集, 只要 $f \leq 95$ (5Fh), 指令就将以立即数变址寻址模式进行操作。详细信息, 请参见第 24.2.3 节“立即数变址寻址模式下针对字节和针对位的指令”。

指令字数: 1

指令周期数: 1

Q 周期操作:

Q1	Q2	Q3	Q4
译码	读寄存器 f	处理数据	写入目标寄存器

示例: ANDWF REG, 0, 0

执行指令前

W = 17h
 REG = C2h

执行指令后

W = 02h
 REG = C2h

BC 进位则跳转

语法: BC n

操作数: $-128 \leq n \leq 127$

操作: 如果进位标志位为 1
 $(PC) + 2 + 2n \rightarrow PC$

受影响的状态位: 无

机器码:

1110	0010	nnnn	nnnn
------	------	------	------

说明: 如果进位标志位为 1, 程序将跳转。“2n” (以二进制补码表示) 加到 PC。由于 PC 将递增以便取出下一条指令, 所以新地址将为 $PC + 2 + 2n$ 。该指令为一条双周期指令。

指令字数: 1

指令周期数: 1 (2)

Q 周期操作:

如果跳转:

Q1	Q2	Q3	Q4
译码	读立即数 n	处理数据	写入 PC
空操作	空操作	空操作	空操作

如果不跳转:

Q1	Q2	Q3	Q4
译码	读立即数 n	处理数据	空操作

示例: HERE BC 5

执行指令前

PC = 地址 (HERE)

执行指令后

如果进位标志位 = 1;
 PC = 地址 (HERE + 12)
 如果进位标志位 = 0;
 PC = 地址 (HERE + 2)

PIC18F2423/2523/4423/4523

BCF 将 f 寄存器中的某位清零

语法: BCF f, b {,a}

操作数: $0 \leq f \leq 255$
 $0 \leq b \leq 7$
 $a \in [0,1]$

操作: $0 \rightarrow f < b >$

受影响的状态位: 无

机器码:

1001	bbba	ffff	ffff
------	------	------	------

说明: 将寄存器 f 中的位 b 清零。
 如果 a 为 0, 选择快速操作存储区。如果 a 为 1, 使用 BSR 选择 GPR 存储区 (默认)。
 如果 a 为 0 且使能了扩展指令集, 只要 $f \leq 95$ (5Fh), 指令就将以立即数变址寻址模式进行操作。详细信息, 请参见第 24.2.3 节“立即数变址寻址模式下针对字节和针对位的指令”。

指令字数: 1

指令周期数: 1

Q 周期操作:

Q1	Q2	Q3	Q4
译码	读寄存器 f	处理数据	写寄存器 f

示例: BCF FLAG_REG, 7, 0

执行指令前
 FLAG_REG = C7h

执行指令后
 FLAG_REG = 47h

BN 为负则跳转

语法: BN n

操作数: $-128 \leq n \leq 127$

操作: 如果负标志位为 1
 $(PC) + 2 + 2n \rightarrow PC$

受影响的状态位: 无

机器码:

1110	0110	nnnn	nnnn
------	------	------	------

说明: 如果负标志位为 1, 程序将跳转。“2n” (以二进制补码表示) 加到 PC。由于 PC 将递增以便取出下一条指令, 所以新地址将为 $PC + 2 + 2n$ 。该指令为一条双周期指令。

指令字数: 1

指令周期数: 1 (2)

Q 周期操作:

如果跳转:

Q1	Q2	Q3	Q4
译码	读立即数 n	处理数据	写入 PC
空操作	空操作	空操作	空操作

如果不跳转:

Q1	Q2	Q3	Q4
译码	读立即数 n	处理数据	空操作

示例: HERE BN Jump

执行指令前
 PC = 地址 (HERE)

执行指令后
 如果负标志位 = 1;
 PC = 地址 (Jump)
 如果负标志位 = 0;
 PC = 地址 (HERE + 2)

PIC18F2423/2523/4423/4523

BNC 无进位则跳转

语法: BNC n
 操作数: $-128 \leq n \leq 127$
 操作: 如果进位标志位为 0
 $(PC) + 2 + 2n \rightarrow PC$

受影响的状态位: 无

机器码:

1110	0011	nnnn	nnnn
------	------	------	------

说明: 如果进位标志位为 0, 程序将跳转。
 “2n” (以二进制补码表示) 加到 PC。
 由于 PC 将递增以便取出下一条指令,
 所以新地址将为 $PC + 2 + 2n$ 。该指令为
 一条双周期指令。

指令字数: 1
 指令周期数: 1 (2)

Q 周期操作:
 如果跳转:

Q1	Q2	Q3	Q4
译码	读立即数 n	处理数据	写入 PC
空操作	空操作	空操作	空操作

如果不跳转:

Q1	Q2	Q3	Q4
译码	读立即数 n	处理数据	空操作

示例: HERE BNC Jump

执行指令前
 PC = 地址 (HERE)
 执行指令后
 如果进位标志位 = 0;
 PC = 地址 (Jump)
 如果进位标志位 = 1;
 PC = 地址 (HERE + 2)

BNN 不为负则跳转

语法: BNN n
 操作数: $-128 \leq n \leq 127$
 操作: 如果负标志位为 0
 $(PC) + 2 + 2n \rightarrow PC$

受影响的状态位: 无

机器码:

1110	0111	nnnn	nnnn
------	------	------	------

说明: 如果负标志位为 0, 程序将跳转。
 “2n” (以二进制补码表示) 加到 PC。
 由于 PC 将递增以便取出下一条指令,
 所以新地址将为 $PC + 2 + 2n$ 。该指令为
 一条双周期指令。

指令字数: 1
 指令周期数: 1 (2)

Q 周期操作:
 如果跳转:

Q1	Q2	Q3	Q4
译码	读立即数 n	处理数据	写入 PC
空操作	空操作	空操作	空操作

如果不跳转:

Q1	Q2	Q3	Q4
译码	读立即数 n	处理数据	空操作

示例: HERE BNN Jump

执行指令前
 PC = 地址 (HERE)
 执行指令后
 如果负标志位 = 0;
 PC = 地址 (Jump)
 如果负标志位 = 1;
 PC = 地址 (HERE + 2)

PIC18F2423/2523/4423/4523

BNOV 不溢出则跳转

语法: BNOV n
 操作数: $-128 \leq n \leq 127$
 操作: 如果溢出标志位为 0
 (PC) + 2 + 2n → PC

受影响的状态位: 无
 机器码:

1110	0101	nnnn	nnnn
------	------	------	------

说明: 如果溢出标志位为 0, 程序将跳转。
 “2n” (以二进制补码表示) 加到 PC。
 由于 PC 将递增以便取出下一条指令,
 所以新地址将为 PC + 2 + 2n。该指令为
 一条双周期指令。

指令字数: 1
 指令周期数: 1 (2)

Q 周期操作:
 如果跳转:

Q1	Q2	Q3	Q4
译码	读立即数 n	处理数据	写入 PC
空操作	空操作	空操作	空操作

如果不跳转:

Q1	Q2	Q3	Q4
译码	读立即数 n	处理数据	空操作

示例: HERE BNOV Jump

执行指令前
 PC = 地址 (HERE)
 执行指令后
 如果溢出标志位= 0;
 PC = 地址 (Jump)
 如果溢出标志位= 1;
 PC = 地址 (HERE + 2)

BNZ 不为零则跳转

语法: BNZ n
 操作数: $-128 \leq n \leq 127$
 操作: 如果全零标志位为 0
 (PC) + 2 + 2n → PC

受影响的状态位: 无
 机器码:

1110	0001	nnnn	nnnn
------	------	------	------

说明: 如果全零标志位为 0, 程序将跳转。
 “2n” (以二进制补码表示) 加到 PC。
 由于 PC 将递增以便取出下一条指令,
 所以新地址将为 PC + 2 + 2n。该指令为
 一条双周期指令。

指令字数: 1
 指令周期数: 1 (2)

Q 周期操作:
 如果跳转:

Q1	Q2	Q3	Q4
译码	读立即数 n	处理数据	写入 PC
空操作	空操作	空操作	空操作

如果不跳转:

Q1	Q2	Q3	Q4
译码	读立即数 n	处理数据	空操作

示例: HERE BNZ Jump

执行指令前
 PC = 地址 (HERE)
 执行指令后
 如果全零标志位= 0;
 PC = 地址 (Jump)
 如果全零标志位= 1;
 PC = 地址 (HERE + 2)

PIC18F2423/2523/4423/4523

BRA 无条件跳转

语法: BRA n
 操作数: $-1024 \leq n \leq 1023$
 操作: (PC) + 2 + 2n → PC
 受影响的状态位: 无

机器码:

1101	0nnn	nnnn	nnnn
------	------	------	------

 说明: “2n” (以二进制补码表示) 加到 PC。因为 PC 要先递增才能取下一条指令, 所以新地址将为 PC + 2 + 2n。该指令为一条双周期指令。

指令字数: 1
 指令周期数: 2

Q 周期操作:

Q1	Q2	Q3	Q4
译码	读立即数 n	处理数据	写入 PC
空操作	空操作	空操作	空操作

示例: HERE BRA Jump

执行指令前
 PC = 地址 (HERE)
 执行指令后
 PC = 地址 (Jump)

BSF 将 f 寄存器中的某位置 1

语法: BSF f, b {,a}
 操作数: $0 \leq f \leq 255$
 $0 \leq b \leq 7$
 $a \in [0,1]$
 操作: $1 \rightarrow f$

受影响的状态位: 无
 机器码:

1000	bbba	ffff	ffff
------	------	------	------

 说明: 将寄存器 f 的位 b 置 1。如果 a 为 0, 选择快速操作存储区。如果 a 为 1, 使用 BSR 选择 GPR 存储区 (默认)。如果 a 为 0 且使能了扩展指令集, 只要 $f \leq 95$ (5Fh), 指令就将以立即数变址寻址模式进行操作。详细信息, 请参见第 24.2.3 节“立即数变址寻址模式下针对字节和针对位的指令”。

指令字数: 1
 指令周期数: 1

Q 周期操作:

Q1	Q2	Q3	Q4
译码	读寄存器 f	处理数据	写寄存器 f

示例: BSF FLAG_REG, 7, 1

执行指令前
 FLAG_REG = 0Ah
 执行指令后
 FLAG_REG = 8Ah

PIC18F2423/2523/4423/4523

BTFSC 测试文件寄存器中的某位，为 0 则跳过

语法: BTFSC f, b {,a}

操作数: $0 \leq f \leq 255$
 $0 \leq b \leq 7$
 $a \in [0,1]$

操作: 如果 $(f < b) = 0$, 则跳过

受影响的状态位: 无

机器码:

1011	bbba	ffff	ffff
------	------	------	------

说明: 如果寄存器 f 的位 b 为 0, 则跳过下一条指令。即在 b 位为 0 时, 丢弃下一条指令 (执行当前指令期间取的指令) 转而执行一条 NOP 指令, 使该指令变成双周期指令。
 如果 a 为 0, 选择快速操作存储区。如果 a 为 1, 使用 BSR 选择 GPR 存储区 (默认)。
 如果 a 为 0 且使能了扩展指令集, 只要 $f \leq 95$ (5Fh), 指令就将以立即数变址寻址模式进行操作。详细信息, 请参见第 24.2.3 节 “立即数变址寻址模式下针对字节和针对位的指令”。

指令字数: 1

指令周期数: 1 (2)
注: 如果跳过且该指令后面跟有 2 字指令, 则执行 BTFSC 需要 3 个周期。

Q 周期操作:

Q1	Q2	Q3	Q4
译码	读寄存器 f	处理数据	空操作

如果跳过:

Q1	Q2	Q3	Q4
空操作	空操作	空操作	空操作

如果跳过且该指令后面跟有 2 字指令:

Q1	Q2	Q3	Q4
空操作	空操作	空操作	空操作
空操作	空操作	空操作	空操作

示例:

```
HERE   BTFSC   FLAG, 1, 0
FALSE  :
TRUE   :
```

执行指令前
 PC = 地址 (HERE)

执行指令后
 如果 $FLAG < 1 = 0$;
 PC = 地址 (TRUE)
 如果 $FLAG < 1 = 1$;
 PC = 地址 (FALSE)

BTFSS 测试文件寄存器中的某位，为 1 则跳过

语法: BTFSS f, b {,a}

操作数: $0 \leq f \leq 255$
 $0 \leq b < 7$
 $a \in [0,1]$

操作: 如果 $(f < b) = 1$, 则跳过

受影响的状态位: 无

机器码:

1010	bbba	ffff	ffff
------	------	------	------

说明: 如果寄存器 f 的位 b 为 1, 则跳过下一条指令。即在 b 位为 1 时, 丢弃下一条指令 (执行当前指令期间取的指令) 转而执行一条 NOP 指令, 使该指令变成双周期指令。
 如果 a 为 0, 选择快速操作存储区。如果 a 为 1, 使用 BSR 选择 GPR 存储区 (默认)。
 如果 a 为 0 且使能了扩展指令集, 只要 $f \leq 95$ (5Fh), 指令就将以立即数变址寻址模式进行操作。详细信息, 请参见第 24.2.3 节 “立即数变址寻址模式下针对字节和针对位的指令”。

指令字数: 1

指令周期数: 1 (2)
注: 如果跳过且该指令后面跟有 2 字指令, 则执行 BTFSS 需要 3 个周期。

Q 周期操作:

Q1	Q2	Q3	Q4
译码	读寄存器 f	处理数据	空操作

如果跳过:

Q1	Q2	Q3	Q4
空操作	空操作	空操作	空操作

如果跳过且该指令后面跟有 2 字指令:

Q1	Q2	Q3	Q4
空操作	空操作	空操作	空操作
空操作	空操作	空操作	空操作

示例:

```
HERE   BTFSS   FLAG, 1, 0
FALSE  :
TRUE   :
```

执行指令前
 PC = 地址 (HERE)

执行指令后
 如果 $FLAG < 1 = 0$;
 PC = 地址 (FALSE)
 如果 $FLAG < 1 = 1$;
 PC = 地址 (TRUE)

PIC18F2423/2523/4423/4523

BTG 将 f 中的某位取反

语法: BTG f, b {,a}
 操作数: $0 \leq f \leq 255$
 $0 \leq b < 7$
 $a \in [0,1]$
 操作: $(f \ll b) \rightarrow f \ll b$
 受影响的状态位: 无
 机器码:

0111	bbba	ffff	ffff
------	------	------	------

说明: 将数据存储单元 f 中的位 b 取反。
 如果 a 为 0, 选择快速操作存储区。如果 a 为 1, 使用 BSR 选择 GPR 存储区 (默认)。
 如果 a 为 0 且使能了扩展指令集, 只要 $f \leq 95$ (5Fh), 指令就将以立即数变址寻址模式进行操作。详细信息, 请参见第 24.2.3 节“立即数变址寻址模式下针对字节和针对位的指令”。

指令字数: 1
 指令周期数: 1
 Q 周期操作:

Q1	Q2	Q3	Q4
译码	读寄存器 f	处理数据	写寄存器 f

示例: BTG PORTC, 4, 0

执行指令前:
 PORTC = 0111 0101 [75h]
 执行指令后:
 PORTC = 0110 0101 [65h]

BOV 溢出则跳转

语法: BOV n
 操作数: $-128 \leq n \leq 127$
 操作: 如果溢出标志位为 1
 $(PC) + 2 + 2n \rightarrow PC$
 受影响的状态位: 无
 机器码:

1110	0100	nnnn	nnnn
------	------	------	------

说明: 如果溢出标志位为 1, 程序将跳转。“2n” (以二进制补码表示) 加到 PC。由于 PC 将递增以便取出下一条指令, 所以新地址将为 $PC + 2 + 2n$ 。该指令为一条双周期指令。

指令字数: 1
 指令周期数: 1 (2)

Q 周期操作:
 如果跳转:

Q1	Q2	Q3	Q4
译码	读立即数 n	处理数据	写入 PC
空操作	空操作	空操作	空操作

如果不跳转:

Q1	Q2	Q3	Q4
译码	读立即数 n	处理数据	空操作

示例: HERE BOV Jump

执行指令前
 PC = 地址 (HERE)
 执行指令后
 如果溢出标志位 = 1;
 PC = 地址 (Jump)
 如果溢出标志位 = 0;
 PC = 地址 (HERE + 2)

PIC18F2423/2523/4423/4523

BZ 为零则跳转

语法: BZ n
 操作数: $-128 \leq n \leq 127$
 操作: 如果全零标志位为 1
 (PC) + 2 + 2n → PC
 受影响的状态位: 无
 机器码:

1110	0000	nnnn	nnnn
------	------	------	------

说明: 如果全零标志位为 1, 程序将跳转。
 “2n” (以二进制补码表示) 加到 PC。
 由于 PC 将递增以便取出下一条指令,
 所以新地址将为 PC + 2 + 2n。该指令为
 一条双周期指令。
 指令字数: 1
 指令周期数: 1 (2)
 Q 周期操作:
 如果跳转:

Q1	Q2	Q3	Q4
译码	读立即数 n	处理数据	写入 PC
空操作	空操作	空操作	空操作

如果不跳转:

Q1	Q2	Q3	Q4
译码	读立即数 n	处理数据	空操作

示例: HERE BZ Jump

执行指令前
 PC = 地址 (HERE)
 执行指令后
 如果全零标志位 = 1;
 PC = 地址 (Jump)
 如果全零标志位 = 0;
 PC = 地址 (HERE + 2)

CALL 调用子程序

语法: CALL k {,s}
 操作数: $0 \leq k \leq 1048575$
 $s \in [0,1]$
 操作: (PC) + 4 → TOS,
 k → PC<20:1>
 如果 s = 1
 (W) → WS,
 (STATUS) → STATUSs,
 (BSR) → BSRS
 受影响的状态位: 无
 机器码:

1110	110s	k ₇ kkk	kkkk ₀
1111	k ₁₉ kkk	kkkk	kkkk ₈

第一个字 (k<7:0>)
 第二个字 (k<19:8>)
 说明: 在整个 2MB 的存储器范围内进行子程序
 调用。首先, 将返回地址 (PC + 4) 压
 入返回堆栈。如果 s = 1, 还会将 W、
 STATUS 和 BSR 寄存器的内容压入它们
 各自的影子寄存器 WS、STATUSs 和
 BSRS。如果 s = 0, 将不会进行任何更
 新 (默认)。然后, 将 20 位的值 k 装
 入 PC<20:1>。CALL 是一条双周期指
 令。
 指令字数: 2
 指令周期数: 2
 Q 周期操作:

Q1	Q2	Q3	Q4
译码	读立即数 k<7:0>	将 PC 压入 堆栈	读立即数 k<19:8>, 写入 PC
空操作	空操作	空操作	空操作

示例: HERE CALL THERE, 1

执行指令前
 PC = 地址 (HERE)
 执行指令后
 PC = 地址 (THERE)
 TOS = 地址 (HERE + 4)
 WS = W
 BSRS = BSR
 STATUSs = STATUS

PIC18F2423/2523/4423/4523

CLRF 将 f 清零

语法: CLRF f{,a}
 操作数: $0 \leq f \leq 255$
 $a \in [0,1]$
 操作: $000h \rightarrow f$
 $1 \rightarrow Z$

受影响的状态位: Z
 机器码:

0110	101a	ffff	ffff
------	------	------	------

说明: 清零指定寄存器的内容。
 如果 a 为 0, 选择快速操作存储区。如果 a 为 1, 使用 BSR 选择 GPR 存储区 (默认)。
 如果 a 为 0 且使能了扩展指令集, 只要 $f \leq 95$ (5Fh), 指令就将以立即数变址寻址模式进行操作。详细信息, 请参见第 24.2.3 节“立即数变址寻址模式下针对字节和针对位的指令”。

指令字数: 1
 指令周期数: 1
 Q 周期操作:

Q1	Q2	Q3	Q4
译码	读寄存器 f	处理数据	写寄存器 f

示例: CLRF FLAG_REG, 1
 执行指令前
 FLAG_REG = 5Ah
 执行指令后
 FLAG_REG = 00h

CLRWDT 将看门狗定时器清零

语法: CLRWDT
 操作数: 无
 操作: $000h \rightarrow WDT$,
 $000h \rightarrow WDT$ 后分频器,
 $1 \rightarrow \overline{TO}$,
 $1 \rightarrow \overline{PD}$

受影响的状态位: \overline{TO} 和 \overline{PD}
 机器码:

0000	0000	0000	0100
------	------	------	------

说明: CLRWDT 指令复位看门狗定时器及其后分频器。状态位 \overline{TO} 和 \overline{PD} 置 1。
 指令字数: 1
 指令周期数: 1
 Q 周期操作:

Q1	Q2	Q3	Q4
译码	空操作	处理数据	空操作

示例: CLRWDT
 执行指令前
 WDT 计数器 = ?
 执行指令后
 WDT 计数器 = 00h
 WDT 后分频器 = 0
 \overline{TO} = 1
 \overline{PD} = 1

PIC18F2423/2523/4423/4523

COMF 对 f 取反

语法: COMF f{,d{,a}}

操作数: $0 \leq f \leq 255$
 $d \in [0,1]$
 $a \in [0,1]$

操作: $(\bar{f}) \rightarrow \text{dest}$

受影响的状态位: N 和 Z

机器码:

0001	11da	ffff	ffff
------	------	------	------

说明: 将寄存器 f 的内容取反。如果 d 为 0, 结果存储在 W 中。如果 d 为 1, 结果存回寄存器 f (默认)。
 如果 a 为 0, 选择快速操作存储区。如果 a 为 1, 使用 BSR 选择 GPR 存储区 (默认)。
 如果 a 为 0 且使能了扩展指令集, 只要 $f \leq 95$ (5Fh), 指令就将以立即数变址寻址模式进行操作。详细信息, 请参见第 24.2.3 节“立即数变址寻址模式下针对字节和针对位的指令”。

指令字数: 1

指令周期数: 1

Q 周期操作:

Q1	Q2	Q3	Q4
译码	读寄存器 f	处理数据	写入目标寄存器

示例: COMF REG, 0, 0

执行指令前
 REG = 13h

执行指令后
 REG = 13h
 W = ECh

CPFSEQ 比较 f 和 W, 如果 f = W 则跳过

语法: CPFSEQ f{,a}

操作数: $0 \leq f \leq 255$
 $a \in [0,1]$

操作: (f) - (W), 如果 (f) = (W), 则跳过 (无符号比较)

受影响的状态位: 无

机器码:

0110	001a	ffff	ffff
------	------	------	------

说明: 通过执行无符号的减法, 将数据存储单元 f 的内容与 W 的内容作比较。
 如果 $f = W$, 则所取的指令被丢弃并执行一条 NOP 指令, 使该指令成为双周期指令。
 如果 a 为 0, 选择快速操作存储区。如果 a 为 1, 使用 BSR 选择 GPR 存储区 (默认)。
 如果 a 为 0 且使能了扩展指令集, 只要 $f \leq 95$ (5Fh), 指令就将以立即数变址寻址模式进行操作。详细信息, 请参见第 24.2.3 节“立即数变址寻址模式下针对字节和针对位的指令”。

指令字数: 1

指令周期数: 1 (2)

注: 如果跳过且该指令后面跟有 2 字指令, 则执行 CPFSEQ 需要 3 个周期。

Q 周期操作:

Q1	Q2	Q3	Q4
译码	读寄存器 f	处理数据	空操作

如果跳过:

Q1	Q2	Q3	Q4
空操作	空操作	空操作	空操作

如果跳过且该指令后面跟有 2 字指令:

Q1	Q2	Q3	Q4
空操作	空操作	空操作	空操作
空操作	空操作	空操作	空操作

示例: HERE CPFSEQ REG, 0
 NEQUAL :
 EQUAL :

执行指令前
 PC 地址 = HERE
 W = ?
 REG = ?

执行指令后
 如果 REG = W ;
 PC = 地址 (EQUAL)

如果 REG \neq W ;
 PC = 地址 (NEQUAL)

PIC18F2423/2523/4423/4523

CPFSGT 比较 f 和 W, 如果 f > W 则跳过

语法: CPFSGT f{,a}
 操作数: $0 \leq f \leq 255$
 $a \in [0,1]$
 操作: (f) - (W), 如果 (f) > (W), 则跳过 (无符号比较)
 受影响的状态位: 无
 机器码:

0110	010a	ffff	ffff
------	------	------	------

说明: 通过执行无符号的减法, 将数据存储单元 f 的内容与 W 的内容作比较。如果 f > W, 则所取的指令被丢弃并执行一条 NOP 指令, 使该指令成为双周期指令。
 如果 a 为 0, 选择快速操作存储区。如果 a 为 1, 使用 BSR 选择 GPR 存储区 (默认)。
 如果 a 为 0 且使能了扩展指令集, 只要 $f \leq 95$ (5Fh), 指令就将以立即数变址寻址模式进行操作。详细信息, 请参见第 24.2.3 节“立即数变址寻址模式下针对字节和针对位的指令”。

指令字数: 1
 指令周期数: 1 (2)
注: 如果跳过且该指令后面跟有 2 字指令, 则执行 CPFSGT 需要 3 个周期。

Q 周期操作:

Q1	Q2	Q3	Q4
译码	读寄存器 f	处理数据	空操作

如果跳过:

Q1	Q2	Q3	Q4
空操作	空操作	空操作	空操作

如果跳过且该指令后面跟有 2 字指令:

Q1	Q2	Q3	Q4
空操作	空操作	空操作	空操作
空操作	空操作	空操作	空操作

示例:

```
HERE    CPFSGT REG, 0
NGREATER :
GREATER  :
```

执行指令前
 PC = 地址 (HERE)
 W = ?
 执行指令后
 如果 REG > W;
 PC = 地址 (GREATER)
 如果 REG ≤ W;
 PC = 地址 (NGREATER)

CPFSLT 比较 f 和 W, 如果 f < W 则跳过

语法: CPFSLT f{,a}
 操作数: $0 \leq f \leq 255$
 $a \in [0,1]$
 操作: (f) - (W), 如果 (f) < (W), 则跳过 (无符号比较)
 受影响的状态位: 无
 机器码:

0110	000a	ffff	ffff
------	------	------	------

说明: 通过执行无符号的减法, 将数据存储单元 f 的内容与 W 的内容作比较。如果 f < W, 则所取的指令被丢弃并执行一条 NOP 指令, 使该指令成为双周期指令。
 如果 a 为 0, 选择快速操作存储区。如果 a 为 1, 使用 BSR 选择 GPR 存储区 (默认)。

指令字数: 1
 指令周期数: 1 (2)
注: 如果跳过且该指令后面跟有 2 字指令, 则执行 CPFSLT 需要 3 个周期。

Q 周期操作:

Q1	Q2	Q3	Q4
译码	读寄存器 f	处理数据	空操作

如果跳过:

Q1	Q2	Q3	Q4
空操作	空操作	空操作	空操作

如果跳过且该指令后面跟有 2 字指令:

Q1	Q2	Q3	Q4
空操作	空操作	空操作	空操作
空操作	空操作	空操作	空操作

示例:

```
HERE    CPFSLT REG, 1
NLESS   :
LESS    :
```

执行指令前
 PC = 地址 (HERE)
 W = ?
 执行指令后
 如果 REG < W;
 PC = 地址 (LESS)
 如果 REG ≥ W;
 PC = 地址 (NLESS)

PIC18F2423/2523/4423/4523

DAW 对 W 寄存器进行十进制调整

语法: DAW
 操作数: 无
 操作: 如果 $[W<3:0> > 9]$ 或 $[DC = 1]$, 则
 $(W<3:0>) + 6 \rightarrow W<3:0>$;
 否则
 $(W<3:0>) \rightarrow W<3:0>$;

如果 $[W<7:4> + DC > 9]$ 或 $[C = 1]$, 则
 $(W<7:4>) + 6 + DC \rightarrow W<7:4>$;
 否则
 $(W<7:4>) + DC \rightarrow W<7:4>$

受影响的状态位: C
 机器码:

0000	0000	0000	0111
------	------	------	------

 说明: DAW 指令调整 W 寄存器内的 8 位值, 即先前两个 BCD 格式变量相加得到的结果, 产生一个正确的 BCD 结果。

指令字数: 1
 指令周期数: 1
 Q 周期操作:

Q1	Q2	Q3	Q4
译码	读寄存器 W	处理数据	写 W

例 1:

	DAW	
执行指令前		
W	=	A5h
C	=	0
DC	=	0
执行指令后		
W	=	05h
C	=	1
DC	=	0

例 2:

	DAW	
执行指令前		
W	=	CEh
C	=	0
DC	=	0
执行指令后		
W	=	34h
C	=	1
DC	=	0

DECF f 递减 1

语法: `DECF f {,d {,a}}`
 操作数: $0 \leq f \leq 255$
 $d \in [0,1]$
 $a \in [0,1]$
 操作: $(f) - 1 \rightarrow \text{dest}$
 受影响的状态位: C、DC、N、OV 和 Z
 机器码:

0000	01da	ffff	ffff
------	------	------	------

 说明: 将寄存器 f 的内容递减 1。如果 d 为 0, 结果存储在 W 中。如果 d 为 1, 结果存回寄存器 f (默认)。

如果 a 为 0, 选择快速操作存储区。如果 a 为 1, 使用 BSR 选择 GPR 存储区 (默认)。
 如果 a 为 0 且使能了扩展指令集, 只要 $f \leq 95$ (5Fh), 指令就将以立即数变址寻址模式进行操作。详细信息, 请参见第 24.2.3 节“立即数变址寻址模式下针对字节和针对位的指令”。

指令字数: 1
 指令周期数: 1
 Q 周期操作:

Q1	Q2	Q3	Q4
译码	读寄存器 f	处理数据	写入目标寄存器

示例:

	DECF	CNT,	1,	0
执行指令前				
CNT	=	01h		
Z	=	0		
执行指令后				
CNT	=	00h		
Z	=	1		

PIC18F2423/2523/4423/4523

DECFSZ f 递减 1, 为 0 则跳过

语法: DECFSZ f {,d {,a}}

操作数: $0 \leq f \leq 255$
 $d \in [0,1]$
 $a \in [0,1]$

操作: $(f) - 1 \rightarrow \text{dest}$, 如果结果 = 0 则跳过

受影响的状态位: 无

机器码:

0010	11da	ffff	ffff
------	------	------	------

说明: 将寄存器 f 的内容递减 1。如果 d 为 0, 结果存储在 W 中。如果 d 为 1, 结果存回寄存器 f (默认)。
 如果结果为 0, 则丢弃已取的指令转而执行一条 NOP 指令, 使该指令成为双周期指令。
 如果 a 为 0, 选择快速操作存储区。如果 a 为 1, 使用 BSR 选择 GPR 存储区 (默认)。
 如果 a 为 0 且使能了扩展指令集, 只要 $f \leq 95$ (5Fh), 指令就将以立即数变址寻址模式进行操作。详细信息, 请参见第 24.2.3 节“立即数变址寻址模式下针对字节和针对位的指令”。

指令字数: 1

指令周期数: 1 (2)
注: 如果跳过且该指令后面跟有 2 字指令, 则执行 DECFSZ 需要 3 个周期。

Q 周期操作:

Q1	Q2	Q3	Q4
译码	读寄存器 f	处理数据	写入目标寄存器

如果跳过:

Q1	Q2	Q3	Q4
空操作	空操作	空操作	空操作

如果跳过且该指令后面跟有 2 字指令:

Q1	Q2	Q3	Q4
空操作	空操作	空操作	空操作
空操作	空操作	空操作	空操作

示例: HERE DECFSZ CNT, 1, 1
 GOTO LOOP
 CONTINUE

执行指令前
 PC = 地址 (HERE)

执行指令后
 CNT = CNT - 1
 如果 CNT = 0;
 PC = 地址 (CONTINUE)
 如果 CNT ≠ 0;
 PC = 地址 (HERE + 2)

DCFSNZ f 递减 1, 非 0 则跳过

语法: DCFSNZ f {,d {,a}}

操作数: $0 \leq f \leq 255$
 $d \in [0,1]$
 $a \in [0,1]$

操作: $(f) - 1 \rightarrow \text{dest}$, 如果结果 ≠ 0 则跳过

受影响的状态位: 无

机器码:

0100	11da	ffff	ffff
------	------	------	------

说明: 将寄存器 f 的内容递减 1。如果 d 为 0, 结果存储在 W 中。如果 d 为 1, 结果存回寄存器 f (默认)。
 如果结果不为 0, 则丢弃已取的指令转而执行一条 NOP 指令, 使该指令成为双周期指令。
 如果 a 为 0, 选择快速操作存储区。如果 a 为 1, 使用 BSR 选择 GPR 存储区 (默认)。
 如果 a 为 0 且使能了扩展指令集, 只要 $f \leq 95$ (5Fh), 指令就将以立即数变址寻址模式进行操作。详细信息, 请参见第 24.2.3 节“立即数变址寻址模式下针对字节和针对位的指令”。

指令字数: 1

指令周期数: 1 (2)
注: 如果跳过且该指令后面跟有 2 字指令, 则执行 DCFSNZ 需要 3 个周期。

Q 周期操作:

Q1	Q2	Q3	Q4
译码	读寄存器 f	处理数据	写入目标寄存器

如果跳过:

Q1	Q2	Q3	Q4
空操作	空操作	空操作	空操作

如果跳过且该指令后面跟有 2 字指令:

Q1	Q2	Q3	Q4
空操作	空操作	空操作	空操作
空操作	空操作	空操作	空操作

示例: HERE DCFSNZ TEMP, 1, 0
 ZERO :
 NZERO :

执行指令前
 TEMP = ?

执行指令后
 TEMP = TEMP - 1,
 如果 TEMP = 0;
 PC = 地址 (ZERO)
 如果 TEMP ≠ 0;
 PC = 地址 (NZERO)

PIC18F2423/2523/4423/4523

GOTO 无条件跳转

语法: GOTO k
 操作数: $0 \leq k \leq 1048575$
 操作: $k \rightarrow PC<20:1>$

受影响的状态位: 无

机器码:

第一个字 (k<7:0>)	1110	1111	k ₇ kkk	kkkk ₀
第二个字 (k<19:8>)	1111	k ₁₉ kkk	kkkk	kkkk ₈

说明: GOTO 指令允许无条件跳转到整个 2 MB 存储器范围中的任何位置。将 20 位值 k 装入 PC<20:1>。GOTO 始终为双周期指令。

指令字数: 2
 指令周期数: 2

Q 周期操作:

Q1	Q2	Q3	Q4
译码	读立即数 k<7:0>	空操作	读立即数 k<19:8>, 写入 PC
空操作	空操作	空操作	空操作

示例: GOTO THERE
 执行指令后
 PC = 地址 (THERE)

INCF f 递增 1

语法: INCF f {,d {,a}}
 操作数: $0 \leq f \leq 255$
 $d \in [0,1]$
 $a \in [0,1]$

操作: $(f) + 1 \rightarrow dest$

受影响的状态位: C、DC、N、OV 和 Z

机器码:

0010	10da	ffff	ffff
------	------	------	------

说明: 将寄存器 f 的内容递增 1。如果 d 为 0，结果存储在 W 中。如果 d 为 1，结果存回寄存器 f (默认)。如果 a 为 0，选择快速操作存储区。如果 a 为 1，使用 BSR 选择 GPR 存储区 (默认)。如果 a 为 0 且使能了扩展指令集，只要 $f \leq 95$ (5Fh)，指令就将以立即数变址寻址模式进行操作。详细信息，请参见第 24.2.3 节“立即数变址寻址模式下针对字节和针对位的指令”。

指令字数: 1
 指令周期数: 1

Q 周期操作:

Q1	Q2	Q3	Q4
译码	读寄存器 f	处理数据	写入 目标寄存器

示例: INCF CNT, 1, 0

执行指令前
 CNT = FFh
 Z = 0
 C = ?
 DC = ?
 执行指令后
 CNT = 00h
 Z = 1
 C = 1
 DC = 1

PIC18F2423/2523/4423/4523

INCFSZ f 递增 1, 为 0 则跳过

语法: INCFSZ f {,d {,a}}

操作数: $0 \leq f \leq 255$
 $d \in [0,1]$
 $a \in [0,1]$

操作: $(f) + 1 \rightarrow \text{dest}$,
 如果结果 = 0 则跳过

受影响的状态位: 无

机器码:

0011	11da	ffff	ffff
------	------	------	------

说明: 将寄存器 f 的内容递增 1。如果 d 为 0, 结果存储在 W 中。如果 d 为 1, 结果存回寄存器 f (默认)。
 如果结果为 0, 则丢弃已取的指令转而执行一条 NOP 指令, 使该指令成为双周期指令。
 如果 a 为 0, 选择快速操作存储区。如果 a 为 1, 使用 BSR 选择 GPR 存储区 (默认)。
 如果 a 为 0 且使能了扩展指令集, 只要 $f \leq 95$ (5Fh), 指令就将以立即数变址寻址模式进行操作。详细信息, 请参见第 24.2.3 节“立即数变址寻址模式下针对字节和针对位的指令”。

指令字数: 1

指令周期数: 1 (2)
注: 如果跳过且该指令后面跟有 2 字指令, 则执行 INCFSZ 需要 3 个周期。

Q 周期操作:

Q1	Q2	Q3	Q4
译码	读寄存器 f	处理数据	写入目标寄存器

如果跳过:

Q1	Q2	Q3	Q4
空操作	空操作	空操作	空操作

如果跳过且该指令后面跟有 2 字指令:

Q1	Q2	Q3	Q4
空操作	空操作	空操作	空操作
空操作	空操作	空操作	空操作

示例: HERE INCFSZ CNT, 1, 0
 ZERO :
 ZERO :

执行指令前
 PC = 地址 (HERE)

执行指令后
 CNT = CNT + 1
 如果 CNT = 0;
 PC = 地址 (ZERO)
 如果 CNT ≠ 0;
 PC = 地址 (NZERO)

INFSNZ f 递增 1, 非 0 则跳过

语法: INFSNZ f {,d {,a}}

操作数: $0 \leq f \leq 255$
 $d \in [0,1]$
 $a \in [0,1]$

操作: $(f) + 1 \rightarrow \text{dest}$, 如果结果 ≠ 0 则跳过

受影响的状态位: 无

机器码:

0100	10da	ffff	ffff
------	------	------	------

说明: 将寄存器 f 的内容递增 1。如果 d 为 0, 结果存储在 W 中。如果 d 为 1, 结果存回寄存器 f (默认)。
 如果结果不为 0, 则丢弃已取的指令转而执行一条 NOP 指令, 使该指令成为双周期指令。
 如果 a 为 0, 选择快速操作存储区。如果 a 为 1, 使用 BSR 选择 GPR 存储区 (默认)。
 如果 a 为 0 且使能了扩展指令集, 只要 $f \leq 95$ (5Fh), 指令就将以立即数变址寻址模式进行操作。详细信息, 请参见第 24.2.3 节“立即数变址寻址模式下针对字节和针对位的指令”。

指令字数: 1

指令周期数: 1 (2)
注: 如果跳过且该指令后面跟有 2 字指令, 则执行 INFSNZ 需要 3 个周期。

Q 周期操作:

Q1	Q2	Q3	Q4
译码	读寄存器 f	处理数据	写入目标寄存器

如果跳过:

Q1	Q2	Q3	Q4
空操作	空操作	空操作	空操作

如果跳过且该指令后面跟有 2 字指令:

Q1	Q2	Q3	Q4
空操作	空操作	空操作	空操作
空操作	空操作	空操作	空操作

示例: HERE INFSNZ REG, 1, 0
 ZERO
 NZERO

执行指令前
 PC = 地址 (HERE)

执行指令后
 REG = REG + 1
 如果 REG ≠ 0;
 PC = 地址 (NZERO)
 如果 REG = 0;
 PC = 地址 (ZERO)

PIC18F2423/2523/4423/4523

IORLW 将立即数与 W 作逻辑或运算

语法: IORLW k
 操作数: $0 \leq k \leq 255$
 操作: $(W) .OR. k \rightarrow W$
 受影响的状态位: N 和 Z
 机器码:

0000	1001	kkkk	kkkk
------	------	------	------

 说明: 将 W 的内容与 8 位立即数 k 进行逻辑或运算。结果存储在 W 寄存器中。
 指令字数: 1
 指令周期数: 1
 Q 周期操作:

Q1	Q2	Q3	Q4
译码	读立即数 k	处理数据	写入 W

示例: IORLW 35h
 执行指令前
 W = 9Ah
 执行指令后
 W = BFh

IORWF 将 W 与 f 作逻辑或运算

语法: IORWF f {,d {,a}}
 操作数: $0 \leq f \leq 255$
 $d \in [0,1]$
 $a \in [0,1]$
 操作: $(W) .OR.(f) \rightarrow dest$
 受影响的状态位: N 和 Z

机器码:

0001	00da	ffff	ffff
------	------	------	------

说明: 将 W 的内容与寄存器 f 的内容进行逻辑或运算。如果 d 为 0, 结果存储在 W 中。如果 d 为 1, 结果存回寄存器 f (默认)。
 如果 a 为 0, 选择快速操作存储区。如果 a 为 1, 使用 BSR 选择 GPR 存储区 (默认)。
 如果 a 为 0 且使能了扩展指令集, 只要 $f \leq 95$ (5Fh), 指令就将以立即数变址寻址模式进行操作。详细信息, 请参见第 24.2.3 节“立即数变址寻址模式下针对字节和针对位的指令”。
 指令字数: 1
 指令周期数: 1

Q 周期操作:

Q1	Q2	Q3	Q4
译码	读寄存器 f	处理数据	写入目标寄存器

示例: IORWF RESULT, 0, 1
 执行指令前
 RESULT = 13h
 W = 91h
 执行指令后
 RESULT = 13h
 W = 93h

PIC18F2423/2523/4423/4523

LFSR

装入 FSR

语法: LFSR f, k

操作数: $0 \leq f \leq 2$
 $0 \leq k \leq 4095$

操作: $k \rightarrow \text{FSRf}$

受影响的状态位: 无

机器码:	1110 1111	1110 0000	00ff k ₇ kkk	k ₁₁ kkk kkkk
------	--------------	--------------	----------------------------	-----------------------------

说明: 将 12 位立即数 k 装入 f 所指向的文件选择寄存器。

指令字数: 2

指令周期数: 2

Q 周期操作:

Q1	Q2	Q3	Q4
译码	读立即数 k 的 MSB	处理数据	将立即数 k 的 MSB 写入 FSRfH
译码	读立即数 k 的 LSB	处理数据	将立即数 k 的 LSB 写入 FSRfL

示例: LFSR 2, 3ABh

执行指令后
 FSR2H = 03h
 FSR2L = ABh

MOVF

传送 f

语法: MOVF f{,d{,a}}

操作数: $0 \leq f \leq 255$
 $d \in [0,1]$
 $a \in [0,1]$

操作: $f \rightarrow \text{dest}$

受影响的状态位: N 和 Z

机器码:	0101	00da	ffff	ffff
------	------	------	------	------

说明: 根据 d 的状态, 将寄存器 f 的内容传送到目标寄存器。如果 d 为 0, 结果存储在 W 中。如果 d 为 1, 结果存回寄存器 f (默认)。f 可以为 256 字节存储区中的任何存储单元。
 如果 a 为 0, 选择快速操作存储区。如果 a 为 1, 使用 BSR 选择 GPR 存储区 (默认)。
 如果 a 为 0 且使能了扩展指令集, 只要 $f \leq 95$ (5Fh), 指令就将以立即数变址寻址模式进行操作。详细信息, 请参见第 24.2.3 节“立即数变址寻址模式下针对字节和针对位的指令”。

指令字数: 1

指令周期数: 1

Q 周期操作:

Q1	Q2	Q3	Q4
译码	读寄存器 f	处理数据	写 W

示例: MOVF REG, 0, 0

执行指令前
 REG = 22h
 W = FFh
 执行指令后
 REG = 22h
 W = 22h

PIC18F2423/2523/4423/4523

MOVFF 将源寄存器的内容传送到目标寄存器

语法: MOVFF f_s, f_d

操作数: $0 \leq f_s \leq 4095$
 $0 \leq f_d \leq 4095$

操作: $(f_s) \rightarrow f_d$

受影响的状态位: 无

机器码:

第一个字 (源)	1100	ffff	ffff	ffff _s
第二个字 (目标)	1111	ffff	ffff	ffff _d

说明: 将源寄存器 f_s 的内容传送到目标寄存器 f_d 。
 源寄存器 f_s 可以是 4096 字节数据空间 (000h 到 FFFh) 中的任何存储单元, 目标寄存器 f_d 也可以是 000h 到 FFFh 中的任何存储单元。
 源或目标寄存器都可以是 W (这是个有用的特例)。
 MOVFF 指令对于将数据存储单元中的内容传输到外设寄存器 (如发送缓冲器或 I/O 端口) 的场合非常有用。
 MOVFF 指令不能使用 PCL、TOSU、TOSH 或 TOSL 作为目标寄存器。

指令字数: 2

指令周期数: 2 (3)

Q 周期操作:

Q1	Q2	Q3	Q4
译码	读寄存器 f (源寄存器)	处理数据	空操作
译码	空操作 无假读	空操作	写寄存器 f (目标寄存器)

示例: MOVFF REG1, REG2

执行指令前
 REG1 = 33h
 REG2 = 11h

执行指令后
 REG1 = 33h
 REG2 = 33h

MOVLB 将立即数传送到 BSR 的低半字节

语法: MOVLW k

操作数: $0 \leq k \leq 255$

操作: $k \rightarrow \text{BSR}$

受影响的状态位: 无

机器码:

0000	0001	kkkk	kkkk
------	------	------	------

说明: 将 8 位立即数 k 装入存储区选择寄存器 (BSR)。不管 $k_7:k_4$ 的值如何, $\text{BSR} \langle 7:4 \rangle$ 的值将始终保持为 0。

指令字数: 1

指令周期数: 1

Q 周期操作:

Q1	Q2	Q3	Q4
译码	读立即数 k	处理数据	将立即数 k 写入 BSR

示例: MOVLB 5

执行指令前
 BSR 寄存器 = 02h

执行指令后
 BSR 寄存器 = 05h

PIC18F2423/2523/4423/4523

MOVLW 将立即数传送到 W

语法: MOVLW k

操作数: $0 \leq k \leq 255$

操作: $k \rightarrow W$

受影响的状态位: 无

机器码:

0000	1110	kkkk	kkkk
------	------	------	------

说明: 将 8 位立即数 k 装入 W。

指令字数: 1

指令周期数: 1

Q 周期操作:

Q1	Q2	Q3	Q4
译码	读立即数 k	处理数据	写入 W

示例: MOVLW 5Ah

执行指令后
W = 5Ah

MOVWF 将 W 的内容传送到 f

语法: MOVWF f{,a}

操作数: $0 \leq f \leq 255$

$a \in [0,1]$

操作: $(W) \rightarrow f$

受影响的状态位: 无

机器码:

0110	111a	ffff	ffff
------	------	------	------

说明: 将 W 寄存器中的数据传送到寄存器 f。f 可以是 256 字节存储区中的任何存储单元。

如果 a 为 0, 选择快速操作存储区。如果 a 为 1, 使用 BSR 选择 GPR 存储区 (默认)。

如果 a 为 0 且使能了扩展指令集, 只要 $f \leq 95$ (5Fh), 指令就将以立即数变址寻址模式进行操作。详细信息, 请参见第 24.2.3 节“立即数变址寻址模式下针对字节和针对位的指令”。

指令字数: 1

指令周期数: 1

Q 周期操作:

Q1	Q2	Q3	Q4
译码	读寄存器 f	处理数据	写寄存器 f

示例: MOVWF REG, 0

执行指令前

W = 4Fh
REG = FFh

执行指令后

W = 4Fh
REG = 4Fh

PIC18F2423/2523/4423/4523

MULLW 将立即数与 W 中的内容相乘

语法: MULLW k
 操作数: $0 \leq k \leq 255$
 操作: $(W) \times k \rightarrow \text{PRODH:PRODL}$
 受影响的状态位: 无
 机器码:

0000	1101	kkkk	kkkk
------	------	------	------

 说明: 将 W 的内容与 8 位立即数 k 进行无符号的乘法运算。16 位的结果存储在 PRODH:PRODL 寄存器对中, 其中 PRODH 用于存储高字节。W 的内容不改变。所有状态标志位都不受影响。请注意此操作不可能发生溢出或进位。结果有可能为零, 但不会被检测到。
 指令字数: 1
 指令周期数: 1
 Q 周期操作:

Q1	Q2	Q3	Q4
译码	读立即数 k	处理数据	写寄存器 PRODH: PRODL

示例: MULLW 0C4h

执行指令前

W = E2h
 PRODH = ?
 PRODL = ?

执行指令后

W = E2h
 PRODH = ADh
 PRODL = 08h

MULWF 将 W 与 f 的内容相乘

语法: MULWF f {,a}
 操作数: $0 \leq f \leq 255$
 $a \in [0,1]$
 操作: $(W) \times (f) \rightarrow \text{PRODH:PRODL}$
 受影响的状态位: 无
 机器码:

0000	001a	ffff	ffff
------	------	------	------

 说明: 将 W 的内容与寄存器单元 f 的内容执行无符号的乘法运算。运算的 16 位结果保存在 PRODH:PRODL 寄存器对中, 其中 PRODH 用于存储高字节。W 和 f 的内容都不改变。所有状态标志位都不受影响。请注意此操作不可能发生溢出或进位。结果有可能为零, 但不会被检测到。如果 a 为 0, 选择快速操作存储区。如果 a 为 1, 使用 BSR 选择 GPR 存储区 (默认)。如果 a 为 0 且使能了扩展指令集, 只要 $f \leq 95$ (5Fh), 指令就将以立即数变址寻址模式进行操作。详细信息, 请参见第 24.2.3 节“立即数变址寻址模式下针对字节和针对位的指令”。
 指令字数: 1
 指令周期数: 1
 Q 周期操作:

Q1	Q2	Q3	Q4
译码	读寄存器 f	处理数据	写寄存器 PRODH: PRODL

示例: MULWF REG, 1

执行指令前

W = C4h
 REG = B5h
 PRODH = ?
 PRODL = ?

执行指令后

W = C4h
 REG = B5h
 PRODH = 8Ah
 PRODL = 94h

PIC18F2423/2523/4423/4523

NEGF	对 f 取补								
语法:	NEGF f {,a}								
操作数:	0 ≤ f ≤ 255 a ∈ [0,1]								
操作:	$(\bar{f}) + 1 \rightarrow f$								
受影响的状态位:	N、OV、C、DC 和 Z								
机器码:	<table border="1"> <tr> <td>0110</td> <td>110a</td> <td>ffff</td> <td>ffff</td> </tr> </table>	0110	110a	ffff	ffff				
0110	110a	ffff	ffff						
说明:	<p>用二进制补码对存储单元 f 内容取补，结果存储在数据存储单元 f 中。</p> <p>如果 a 为 0，选择快速操作存储区。如果 a 为 1，使用 BSR 选择 GPR 存储区（默认）。</p> <p>如果 a 为 0 且使能了扩展指令集，只要 f ≤ 95 (5Fh)，指令就将以立即数变址寻址模式进行操作。详细信息，请参见第 24.2.3 节“立即数变址寻址模式下针对字节和针对位的指令”。</p>								
指令字数:	1								
指令周期数:	1								
Q 周期操作:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Q1</th> <th>Q2</th> <th>Q3</th> <th>Q4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>译码</td> <td>读寄存器 f</td> <td>处理数据</td> <td>写寄存器 f</td> </tr> </tbody> </table>	Q1	Q2	Q3	Q4	译码	读寄存器 f	处理数据	写寄存器 f
Q1	Q2	Q3	Q4						
译码	读寄存器 f	处理数据	写寄存器 f						

示例:

```

NEGF REG, 1
执行指令前
REG = 0011 1010 [3Ah]
执行指令后
REG = 1100 0110 [C6h]
    
```

NOP	空操作								
语法:	NOP								
操作数:	无								
操作:	空操作								
受影响的状态位:	无								
机器码:	<table border="1"> <tr> <td>0000</td> <td>0000</td> <td>0000</td> <td>0000</td> </tr> <tr> <td>1111</td> <td>xxxx</td> <td>xxxx</td> <td>xxxx</td> </tr> </table>	0000	0000	0000	0000	1111	xxxx	xxxx	xxxx
0000	0000	0000	0000						
1111	xxxx	xxxx	xxxx						
说明:	不执行任何操作。								
指令字数:	1								
指令周期数:	1								
Q 周期操作:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Q1</th> <th>Q2</th> <th>Q3</th> <th>Q4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>译码</td> <td>空操作</td> <td>空操作</td> <td>空操作</td> </tr> </tbody> </table>	Q1	Q2	Q3	Q4	译码	空操作	空操作	空操作
Q1	Q2	Q3	Q4						
译码	空操作	空操作	空操作						

示例:
无。

PIC18F2423/2523/4423/4523

POP 弹出返回堆栈栈顶的内容

语法: POP
 操作数: 无
 操作: (TOS) → 丢弃
 受影响的状态位: 无
 机器码:

0000	0000	0000	0110
------	------	------	------

 说明: 从返回堆栈弹出 TOS 值并丢弃。然后, 前一个压入返回堆栈的值成为 TOS 值。此指令可以让用户正确管理返回堆栈, 从而实现软件堆栈。

指令字数: 1
 指令周期数: 1
 Q 周期操作:

Q1	Q2	Q3	Q4
译码	空操作	弹出 TOS 值	空操作

示例: POP GOTO NEW

执行指令前
 TOS = 0031A2h
 堆栈 (下一级) = 014332h

执行指令后
 TOS = 014332h
 PC = NEW

PUSH 压入返回堆栈栈顶

语法: PUSH
 操作数: 无
 操作: (PC + 2) → TOS
 受影响的状态位: 无
 机器码:

0000	0000	0000	0101
------	------	------	------

 说明: PC + 2 的值被压入返回堆栈的栈顶。原先的 TOS 值被压入堆栈的下一级。此指令允许通过修改 TOS 并将其压入返回堆栈来实现软件堆栈。

指令字数: 1
 指令周期数: 1
 Q 周期操作:

Q1	Q2	Q3	Q4
译码	将 PC + 2 压入返回堆栈	空操作	空操作

示例: PUSH

执行指令前
 TOS = 345Ah
 PC = 0124h

执行指令后
 PC = 0126h
 TOS = 0126h
 堆栈 (下一级) = 345Ah

PIC18F2423/2523/4423/4523

RCALL 相对调用

语法: RCALL n
 操作数: $-1024 \leq n \leq 1023$
 操作: (PC) + 2 → TOS,
 (PC) + 2 + 2n → PC

受影响的状态位: 无

机器码:

1101	1nnn	nnnn	nnnn
------	------	------	------

说明: 从当前地址跳转 (最多 1K) 来调用子程序。首先, 将返回地址 (PC + 2) 压入堆栈。然后, 将 “2n” (以二进制补码表示) 加到 PC。因为 PC 要先递增才能取下一条指令, 因此新地址将为 PC + 2 + 2n。该指令为一条双周期指令。

指令字数: 1

指令周期数: 2

Q 周期操作:

Q1	Q2	Q3	Q4
译码	读立即数 n 将 PC 压入堆栈	处理数据	写入 PC
空操作	空操作	空操作	空操作

示例: HERE RCALL Jump

执行指令前

PC = 地址 (HERE)

执行指令后

PC = 地址 (Jump)

TOS = 地址 (HERE + 2)

RESET 复位

语法: RESET

操作数: 无

操作: 将所有受 MCLR 复位影响的寄存器和标志位复位。

受影响的状态位: 全部

机器码:

0000	0000	1111	1111
------	------	------	------

说明: 此指令可实现用软件执行 MCLR 复位。

指令字数: 1

指令周期数: 1

Q 周期操作:

Q1	Q2	Q3	Q4
译码	开始复位	空操作	空操作

示例: RESET

执行指令后

寄存器 = 复位值

标志位 * = 复位值

PIC18F2423/2523/4423/4523

RETFIE 从中断返回

语法: RETFIE {s}
 操作数: $s \in [0,1]$
 操作: (TOS) → PC,
 1 → GIE/GIEH 或 PEIE/GIEL
 如果 $s = 1$
 (WS) → W,
 (STATUS) → STATUS,
 (BSRS) → BSR,
 PCLATU 和 PCLATH 保持不变

受影响的状态位: GIE/GIEH 和 PEIE/GIEL
 机器码:

0000	0000	0001	000s
------	------	------	------

说明: 从中断返回。执行出栈操作, 将栈顶 (TOS) 的内容装入 PC。通过将高或低优先级全局中断允许位置 1, 来允许中断。如果 $s = 1$, 则影子寄存器 WS、STATUS 和 BSRS 的内容将被装入对应的寄存器 W、STATUS 和 BSR。如果 $s = 0$, 则不更新这些寄存器 (默认)。

指令字数: 1
 指令周期数: 2

Q 周期操作:

Q1	Q2	Q3	Q4
译码	空操作	空操作	从堆栈弹出 PC 值, 将 GIEH 或 GIEL 置 1
空操作	空操作	空操作	空操作

示例: `RETFIE 1`

中断后

PC	=	TOS
W	=	WS
BSR	=	BSRS
STATUS	=	STATUSS
GIE/GIEH, PEIE/GIEL	=	1

RETLW 将立即数返回给 W

语法: RETLW k
 操作数: $0 \leq k \leq 255$
 操作: $k \rightarrow W$,
 (TOS) → PC,
 PCLATU 和 PCLATH 保持不变

受影响的状态位: 无
 机器码:

0000	1100	kkkk	kkkk
------	------	------	------

说明: 将 8 位立即数 k 装入 W。将栈顶内容 (返回地址) 装入程序计数器。高位地址锁存器 (PCLATH) 内容保持不变。

指令字数: 1
 指令周期数: 2

Q 周期操作:

Q1	Q2	Q3	Q4
译码	读立即数 k	处理数据	从堆栈弹出 PC 值, 写入 W
空操作	空操作	空操作	空操作

示例:

```
CALL TABLE ; W contains table
                ; offset value
                ; W now has
                ; table value
:
TABLE
    ADDWF PCL ; W = offset
    RETLW k0 ; Begin table
    RETLW k1 ;
:
    RETLW kn ; End of table
```

执行指令前
 W = 07h
 执行指令后
 W = kn 的值

PIC18F2423/2523/4423/4523

RETURN 从子程序返回

语法: RETURN {s}

操作数: $s \in [0,1]$

操作: (TOS) → PC
如果 $s = 1$
(WS) → W,
(STATUS) → STATUS,
(BSRS) → BSR,
PCLATU 和 PCLATH 保持不变

受影响的状态位: 无

机器码:

0000	0000	0001	001s
------	------	------	------

说明: 从子程序返回。执行出栈操作, 将栈顶 (TOS) 内容装入程序计数器。如果 $s = 1$, 将影子寄存器 WS、STATUS 和 BSRS 的内容装入相应的 W、STATUS 和 BSR 寄存器。如果 $s = 0$, 则不更新这些寄存器 (默认)。

指令字数: 1

指令周期数: 2

Q 周期操作:

Q1	Q2	Q3	Q4
译码	空操作	处理数据	从堆栈弹出 PC 值
空操作	空操作	空操作	空操作

示例: RETURN

执行指令后:
PC = TOS

RLCF f 带进位循环左移

语法: RLCF f {,d {,a}}

操作数: $0 \leq f \leq 255$
 $d \in [0,1]$
 $a \in [0,1]$

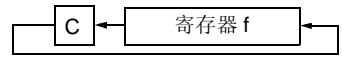
操作: (f<n>) → dest<n + 1>,
(f<7>) → C,
(C) → dest<0>

受影响的状态位: C、N 和 Z

机器码:

0011	01da	ffff	ffff
------	------	------	------

说明: 将寄存器 f 的内容连同进位标志位一起循环左移 1 位。如果 d 为 0, 结果存储在 W 中。如果 d 为 1, 结果存回寄存器 f (默认)。
如果 a 为 0, 选择快速操作存储区。如果 a 为 1, 使用 BSR 选择 GPR 存储区 (默认)。
如果 a 为 0 且使能了扩展指令集, 只要 $f \leq 95$ (5Fh), 指令就将以立即数变址寻址模式进行操作。详细信息, 请参见第 24.2.3 节“立即数变址寻址模式下针对字节和针对位的指令”。



指令字数: 1

指令周期数: 1

Q 周期操作:

Q1	Q2	Q3	Q4
译码	读寄存器 f	处理数据	写入目标寄存器

示例: RLCF REG, 0, 0

执行指令前
REG = 1110 0110
C = 0

执行指令后
REG = 1110 0110
W = 1100 1100
C = 1

PIC18F2423/2523/4423/4523

RLNCF **f** 循环左移（不带进位）

语法: RLNCF **f**{,d{,a}}

操作数: $0 \leq f \leq 255$
 $d \in [0,1]$
 $a \in [0,1]$

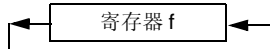
操作: ($f < n$) \rightarrow dest<n + 1>,
 ($f < 7$) \rightarrow dest<0>

受影响的状态位: N 和 Z

机器码:

0100	01da	ffff	ffff
------	------	------	------

说明: 将寄存器 **f** 的内容循环左移 1 位。如果 **d** 为 0, 结果存储在 **W** 中。如果 **d** 为 1, 结果存回寄存器 **f** (默认)。
 如果 **a** 为 0, 选择快速操作存储区。如果 **a** 为 1, 使用 **BSR** 选择 **GPR** 存储区 (默认)。
 如果 **a** 为 0 且使能了扩展指令集, 只要 $f \leq 95$ (5Fh), 指令就将以立即数变址寻址模式进行操作。详细信息, 请参见第 24.2.3 节“立即数变址寻址模式下针对字节和针对位的指令”。



指令字数: 1
 指令周期数: 1
 Q 周期操作:

Q1	Q2	Q3	Q4
译码	读寄存器 f	处理数据	写入目标寄存器

示例: RLNCF REG, 1, 0

执行指令前
REG = 1010 1011
 执行指令后
REG = 0101 0111

RRCF **f** 带进位循环右移

语法: RRCF **f**{,d{,a}}

操作数: $0 \leq f \leq 255$
 $d \in [0,1]$
 $a \in [0,1]$

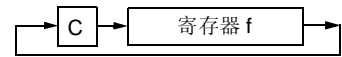
操作: ($f < n$) \rightarrow dest<n - 1>,
 ($f < 0$) \rightarrow C,
 (C) \rightarrow dest<7>

受影响的状态位: C、N 和 Z

机器码:

0011	00da	ffff	ffff
------	------	------	------

说明: 将寄存器 **f** 的内容连同进位标志位一起循环右移 1 位。如果 **d** 为 0, 结果存储在 **W** 中。如果 **d** 为 1, 结果存回寄存器 **f** (默认)。
 如果 **a** 为 0, 选择快速操作存储区。如果 **a** 为 1, 使用 **BSR** 选择 **GPR** 存储区 (默认)。
 如果 **a** 为 0 且使能了扩展指令集, 只要 $f \leq 95$ (5Fh), 指令就将以立即数变址寻址模式进行操作。详细信息, 请参见第 24.2.3 节“立即数变址寻址模式下针对字节和针对位的指令”。



指令字数: 1
 指令周期数: 1
 Q 周期操作:

Q1	Q2	Q3	Q4
译码	读寄存器 f	处理数据	写入目标寄存器

示例: RRCF REG, 0, 0

执行指令前
REG = 1110 0110
C = 0
 执行指令后
REG = 1110 0110
W = 0111 0011
C = 0

PIC18F2423/2523/4423/4523

RRNCF f 循环右移（不带进位）

语法: RRNCF f{,d{,a}}

操作数: $0 \leq f \leq 255$
 $d \in [0,1]$
 $a \in [0,1]$

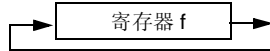
操作: $(f < n) \rightarrow \text{dest} < n - 1 >$,
 $(f < 0) \rightarrow \text{dest} < 7 >$

受影响的状态位: N 和 Z

机器码:

0100	00da	ffff	ffff
------	------	------	------

说明: 将寄存器 f 的内容循环右移 1 位。如果 d 为 0, 结果存储在 W 中。如果 d 为 1, 结果存回寄存器 f (默认)。
 如果 a 为 0, 选择快速操作存储区, 忽略 BSR 的值。如果 a 为 1, 使用 BSR 选择 GPR 存储区 (默认)。
 如果 a 为 0 且使能了扩展指令集, 只要 $f \leq 95$ (5Fh), 指令就将以立即数变址寻址模式进行操作。详细信息, 请参见第 24.2.3 节“立即数变址寻址模式下针对字节和针对位的指令”。



指令字数: 1

指令周期数: 1

Q 周期操作:

Q1	Q2	Q3	Q4
译码	读寄存器 f	处理数据	写入 目标寄存器

例 1: RRNCF REG, 1, 0

执行指令前
REG = 1101 0111

执行指令后
REG = 1110 1011

例 2: RRNCF REG, 0, 0

执行指令前
W = ?
REG = 1101 0111

执行指令后
W = 1110 1011
REG = 1101 0111

SETF 将 f 的内容置为全 1

语法: SETF f{,a}

操作数: $0 \leq f \leq 255$
 $a \in [0,1]$

操作: FFh \rightarrow f

受影响的状态位: 无

机器码:

0110	100a	ffff	ffff
------	------	------	------

说明: 将指定寄存器的内容置为 FFh。如果 a 为 0, 选择快速操作存储区。如果 a 为 1, 使用 BSR 选择 GPR 存储区 (默认)。
 如果 a 为 0 且使能了扩展指令集, 只要 $f \leq 95$ (5Fh), 指令就将以立即数变址寻址模式进行操作。详细信息, 请参见第 24.2.3 节“立即数变址寻址模式下针对字节和针对位的指令”。

指令字数: 1

指令周期数: 1

Q 周期操作:

Q1	Q2	Q3	Q4
译码	读寄存器 f	处理数据	写寄存器 f

示例: SETF REG, 1

执行指令前
REG = 5Ah

执行指令后
REG = FFh

PIC18F2423/2523/4423/4523

SLEEP 进入休眠模式

语法: SLEEP

操作数: 无

操作: 00h → WDT,
0 → WDT 后分频器,
1 → \overline{TO} ,
0 → PD

受影响的状态位: \overline{TO} 和 \overline{PD}

机器码:

0000	0000	0000	0011
------	------	------	------

说明: 掉电状态位 (\overline{PD}) 清零。超时状态位 (\overline{TO}) 置 1。看门狗定时器及其后分频器清零。振荡器停振, 处理器进入休眠模式。

指令字数: 1

指令周期数: 1

Q 周期操作:

Q1	Q2	Q3	Q4
译码	空操作	处理数据	进入休眠模式

示例: SLEEP

执行指令前
 \overline{TO} = ?
 \overline{PD} = ?

执行指令后
 \overline{TO} = 1 †
 \overline{PD} = 0

† 如果由 WDT 引起唤醒, 则此位将被清零。

SUBFWB W 减去 f (带借位)

语法: SUBFWB f {,d {,a}}

操作数: $0 \leq f \leq 255$
 $d \in [0,1]$
 $a \in [0,1]$

操作: $(W) - (f) - (\overline{C}) \rightarrow \text{dest}$

受影响的状态位: N、OV、C、DC 和 Z

机器码:

0101	01da	ffff	ffff
------	------	------	------

说明: 将 W 的内容减去 f 寄存器的内容和进位 (借位) (通过二进制补码方式进行运算)。如果 d 为 0, 结果存储在 W 中。如果 d 为 1, 结果存回寄存器 f (默认)。
如果 a 为 0, 选择快速操作存储区。
如果 a 为 1, 使用 BSR 选择 GPR 存储区 (默认)。
如果 a 为 0 且使能了扩展指令集, 只要 $f \leq 95$ (5Fh), 指令就将以立即数变址寻址模式进行操作。详细信息, 请参见第 24.2.3 节“立即数变址寻址模式下针对字节和针对位的指令”。

指令字数: 1

指令周期数: 1

Q 周期操作:

Q1	Q2	Q3	Q4
译码	读寄存器 f	处理数据	写入目标寄存器

例 1: SUBFWB REG, 1, 0

执行指令前
REG = 3
W = 2
C = 1

执行指令后
REG = FF
W = 2
C = 0
Z = 0
N = 1 ; 结果为负

例 2: SUBFWB REG, 0, 0

执行指令前
REG = 2
W = 5
C = 1

执行指令后
REG = 2
W = 3
C = 1
Z = 0
N = 0 ; 结果为正

例 3: SUBFWB REG, 1, 0

执行指令前
REG = 1
W = 2
C = 0

执行指令后
REG = 0
W = 2
C = 1
Z = 1
N = 0 ; 结果为零

PIC18F2423/2523/4423/4523

SUBLW 立即数减去 W 的内容

语法: `SUBLW k`

操作数: $0 \leq k \leq 255$

操作: $k - (W) \rightarrow W$

受影响的状态位: N、OV、C、DC 和 Z

机器码:

0000	1000	kkkk	kkkk
------	------	------	------

说明: 用 8 位立即数 k 减去 W。结果存储在 W 寄存器中。

指令字数: 1

指令周期数: 1

Q 周期操作:

Q1	Q2	Q3	Q4
译码	读立即数 k	处理数据	写入 W

例 1: `SUBLW 02h`

执行指令前

W = 01h

C = ?

执行指令后

W = 01h

C = 1 ; 结果为正

Z = 0

N = 0

例 2: `SUBLW 02h`

执行指令前

W = 02h

C = ?

执行指令后

W = 00h

C = 1 ; 结果为零

Z = 1

N = 0

例 3: `SUBLW 02h`

执行指令前

W = 03h

C = ?

执行指令后

W = FFh ; (二进制补码)

C = 0 ; 结果为负

Z = 0

N = 1

SUBWF f 减去 W

语法: `SUBWF f{,d{,a}}`

操作数: $0 \leq f \leq 255$
 $d \in [0,1]$
 $a \in [0,1]$

操作: $(f) - (W) \rightarrow \text{dest}$

受影响的状态位: N、OV、C、DC 和 Z

机器码:

0101	11da	ffff	ffff
------	------	------	------

说明: 用寄存器 f 中的内容减去 W 寄存器的内容 (通过二进制补码方式进行运算)。如果 d 为 0, 结果存储在 W 中。如果 d 为 1, 结果存回寄存器 f (默认)。

如果 a 为 0, 选择快速操作存储区。如果 a 为 1, 使用 BSR 选择 GPR 存储区 (默认)。

如果 a 为 0 且使能了扩展指令集, 只要 $f \leq 95$ (5Fh), 指令就将以立即数变址寻址模式进行操作。详细信息, 请参见第 24.2.3 节“立即数变址寻址模式下针对字节和针对位的指令”。

指令字数: 1

指令周期数: 1

Q 周期操作:

Q1	Q2	Q3	Q4
译码	读寄存器 f	处理数据	写入目标寄存器

例 1: `SUBWF REG, 1, 0`

执行指令前

REG = 3

W = 2

C = ?

执行指令后

REG = 1

W = 2

C = 1 ; 结果为正

Z = 0

N = 0

例 2: `SUBWF REG, 0, 0`

执行指令前

REG = 2

W = 2

C = ?

执行指令后

REG = 2

W = 0

C = 1 ; 结果为零

Z = 1

N = 0

例 3: `SUBWF REG, 1, 0`

执行指令前

REG = 1

W = 2

C = ?

执行指令后

REG = FFh ; (二进制补码)

W = 2

C = 0 ; 结果为负

Z = 0

N = 1

PIC18F2423/2523/4423/4523

SUBWFB f 减去 W (带借位)

语法: SUBWFB f{,d{,a}}

操作数: $0 \leq f \leq 255$
 $d \in [0,1]$
 $a \in [0,1]$

操作: $(f) - (W) - (\overline{C}) \rightarrow \text{dest}$

受影响的状态位: N、OV、C、DC 和 Z

机器码:

0101	10da	ffff	ffff
------	------	------	------

说明: 用 f 寄存器的内容减去 W 的内容和进位 (借位) (通过二进制补码方式进行运算)。如果 d 为 0, 结果存储在 W 中。如果 d 为 1, 结果存回寄存器 f (默认)。
 如果 a 为 0, 选择快速操作存储区。如果 a 为 1, 使用 BSR 选择 GPR 存储区 (默认)。
 如果 a 为 0 且使能了扩展指令集, 只要 $f \leq 95$ (5Fh), 指令就将以立即数变址寻址模式进行操作。详细信息, 请参见第 24.2.3 节“立即数变址寻址模式下针对字节和针对位的指令”。

指令字数: 1

指令周期数: 1

Q 周期操作:

Q1	Q2	Q3	Q4
译码	读寄存器 f	处理数据	写入目标寄存器

例 1: SUBWFB REG, 1, 0

执行指令前

REG	=	19h	(0001 1001)
W	=	0Dh	(0000 1101)
C	=	1	

执行指令后

REG	=	0Ch	(0000 1011)
W	=	0Dh	(0000 1101)
C	=	1	
Z	=	0	
N	=	0	; 结果为正

例 2: SUBWFB REG, 0, 0

执行指令前

REG	=	1Bh	(0001 1011)
W	=	1Ah	(0001 1010)
C	=	0	

执行指令后

REG	=	1Bh	(0001 1011)
W	=	00h	
C	=	1	
Z	=	1	; 结果为零
N	=	0	

例 3: SUBWFB REG, 1, 0

执行指令前

REG	=	03h	(0000 0011)
W	=	0Eh	(0000 1101)
C	=	1	

执行指令后

REG	=	F5h	(1111 0100) ; [二进制补码]
W	=	0Eh	(0000 1101)
C	=	0	
Z	=	0	
N	=	1	; 结果为负

SWAPF 将 f 的高半字节和低半字节交换

语法: SWAPF f{,d{,a}}

操作数: $0 \leq f \leq 255$
 $d \in [0,1]$
 $a \in [0,1]$

操作: $(f<3:0>) \rightarrow \text{dest}<7:4>$,
 $(f<7:4>) \rightarrow \text{dest}<3:0>$

受影响的状态位: 无

机器码:

0011	10da	ffff	ffff
------	------	------	------

说明: f 寄存器的高半字节和低半字节相互交换。如果 d 为 0, 结果存储在 W 中。如果 d 为 1, 结果存回寄存器 f (默认)。
 如果 a 为 0, 选择快速操作存储区。如果 a 为 1, 使用 BSR 选择 GPR 存储区 (默认)。
 如果 a 为 0 且使能了扩展指令集, 只要 $f \leq 95$ (5Fh), 指令就将以立即数变址寻址模式进行操作。详细信息, 请参见第 24.2.3 节“立即数变址寻址模式下针对字节和针对位的指令”。

指令字数: 1

指令周期数: 1

Q 周期操作:

Q1	Q2	Q3	Q4
译码	读寄存器 f	处理数据	写入目标寄存器

示例: SWAPF REG, 1, 0

执行指令前

REG	=	53h
-----	---	-----

执行指令后

REG	=	35h
-----	---	-----

PIC18F2423/2523/4423/4523

TBLRD 表读

语法: TBLRD (*; *+; *-; +*)

操作数: 无

操作: 如果执行 TBLRD *,
(程序存储器 (TBLPTR)) → TABLAT ;
TBLPTR 不改变;
如果执行 TBLRD *+,
(程序存储器 (TBLPTR)) → TABLAT ;
(TBLPTR) + 1 → TBLPTR ;
如果执行 TBLRD *-,
(程序存储器 (TBLPTR)) → TABLAT ;
(TBLPTR) - 1 → TBLPTR ;
如果执行 TBLRD +*,
(TBLPTR) + 1 → TBLPTR ;
(程序存储器 (TBLPTR)) → TABLAT

受影响的状态位: 无

0000	0000	0000	10nn nn=0 * =1 *+ =2 *- =3 +*
------	------	------	---

说明: 该指令用于读取程序存储器 (P.M.) 的内容。使用表指针 (TBLPTR) 对程序存储器进行寻址。

TBLPTR (一个 21 位指针) 指向程序存储器中的每个字节。TBLPTR 的寻址范围为 2MB。

TBLPTR<0> = 0: 程序存储字的低字节

TBLPTR<0> = 1: 程序存储字的高字节

TBLRD 指令可用如下方法修改 TBLPTR 的值:

- 不变
- 后递增
- 后递减
- 预递增

指令字数: 1

指令周期数: 2

Q 周期操作:

Q1	Q2	Q3	Q4
译码	空操作	空操作	空操作
空操作	空操作 (读程序存储器)	空操作	空操作 (写 TABLAT)

TBLRD 表读 (续)

例 1: TBLRD ** ;

执行指令前

TABLAT	=	55h
TBLPTR	=	00A356h
存储单元 (00A356h)	=	34h

执行指令后

TABLAT	=	34h
TBLPTR	=	00A357h

例 2: TBLRD ** ;

执行指令前

TABLAT	=	AAh
TBLPTR	=	01A357h
存储单元 (01A357h)	=	12h
存储单元 (01A358h)	=	34h

执行指令后

TABLAT	=	34h
TBLPTR	=	01A358h

PIC18F2423/2523/4423/4523

TBLWT 表写

语法: TBLWT (*; *+; *-; +*)

操作数: 无

操作: 如果执行 TBLWT*,
(TABLAT) → 保持寄存器;
TBLPTR 不改变;
如果执行 TBLWT*+,
(TABLAT) → 保持寄存器;
(TBLPTR) + 1 → TBLPTR ;
如果执行 TBLWT*-,
(TABLAT) → 保持寄存器;
(TBLPTR) - 1 → TBLPTR ;
如果执行 TBLWT+*,
(TBLPTR) + 1 → TBLPTR ;
(TABLAT) → 保持寄存器

受影响的状态位: 无

机器码:

0000	0000	0000	11nn nn=0 * =1 *+ =2 *- =3 +*
------	------	------	---

说明: 此指令使用 TBLPTR 的低 5 位来确定要将 TABLAT 中的内容写入 32 个保持寄存器中的哪一个。该保持寄存器用于对程序存储器 (P.M.) 的内容编程。(关于对闪存程序存储器编程的更多详细信息, 请参见第 6.0 节“闪存程序存储器”。)

TBLPTR (一个 21 位指针) 指向程序存储器中的每个字节。TBLPTR 的寻址范围为 2MB。TBLPTR 的 LSb 选择要访问程序存储单元的哪个字节。

TBLPTR[0] = 0: 程序存储字的低字节

TBLPTR[0] = 1: 程序存储字的高字节

TBLWT 指令可用如下方法修改 TBLPTR 的值:

- 不变
- 后递增
- 后递减
- 预递增

指令字数: 1

指令周期数: 2

Q 周期操作:

Q1	Q2	Q3	Q4
译码	空操作	空操作	空操作
空操作	空操作 (读 TABLAT)	空操作	空操作 (写保持寄 存器)

TBLWT 表写 (续)

例 1: TBLWT *+;

执行指令前

TABLAT	=	55h
TBLPTR	=	00A356h
保持寄存器 (00A356h)	=	FFh

执行指令后 (表写操作完成)

TABLAT	=	55h
TBLPTR	=	00A357h
保持寄存器 (00A356h)	=	55h

例 2: TBLWT +*;

执行指令前

TABLAT	=	34h
TBLPTR	=	01389Ah
保持寄存器 (01389Ah)	=	FFh
保持寄存器 (01389Bh)	=	FFh

执行指令后 (表写操作完成)

TABLAT	=	34h
TBLPTR	=	01389Bh
保持寄存器 (01389Ah)	=	FFh
保持寄存器 (01389Bh)	=	34h

PIC18F2423/2523/4423/4523

TSTFSZ 测试 f, 为 0 则跳过

语法: TSTFSZ f {,a}

操作数: $0 \leq f \leq 255$
 $a \in [0,1]$

操作: f 为 0 则跳过

受影响的状态位: 无

机器码:

0110	011a	ffff	ffff
------	------	------	------

说明: 如果 f = 0, 丢弃执行当前指令过程中已取的下一条指令并执行一条 NOP 指令, 使该指令成为双周期指令。
 如果 a 为 0, 选择快速操作存储区。如果 a 为 1, 使用 BSR 选择 GPR 存储区 (默认)。
 如果 a 为 0 且使能了扩展指令集, 只要 $f \leq 95$ (5Fh), 指令就将以立即数变址寻址模式进行操作。详细信息, 请参见第 24.2.3 节“立即数变址寻址模式下针对字节和针对位的指令”。

指令字数: 1

指令周期数: 1 (2)

注: 如果跳过且该指令后面跟有 2 字指令, 则执行 TSTFSZ 需要 3 个周期。

Q 周期操作:

Q1	Q2	Q3	Q4
译码	读寄存器 f	处理数据	空操作

如果跳过:

Q1	Q2	Q3	Q4
空操作	空操作	空操作	空操作

如果跳过且该指令后面跟有 2 字指令:

Q1	Q2	Q3	Q4
空操作	空操作	空操作	空操作
空操作	空操作	空操作	空操作

示例:

```
HERE    TSTFSZ CNT, 1
NZERO   :
ZERO    :
```

执行指令前
 PC = 地址 (HERE)

执行指令后
 如果 CNT = 00h,
 PC = 地址 (ZERO)
 如果 CNT ≠ 00h,
 PC = 地址 (NZERO)

XORLW 将立即数与 W 作逻辑异或运算

语法: XORLW k

操作数: $0 \leq k \leq 255$

操作: (W) .XOR. k → W

受影响的状态位: N 和 Z

机器码:

0000	1010	kkkk	kkkk
------	------	------	------

说明: 将 W 的内容与 8 位立即数 k 进行逻辑异或运算。结果存储在 W 寄存器中。

指令字数: 1

指令周期数: 1

Q 周期操作:

Q1	Q2	Q3	Q4
译码	读立即数 k	处理数据	写入 W

示例: XORLW 0AFh

执行指令前
 W = B5h

执行指令后
 W = 1Ah

PIC18F2423/2523/4423/4523

XORWF 将 W 与 f 作逻辑异或运算

语法: XORWF f{,d{,a}}

操作数: $0 \leq f \leq 255$
 $d \in [0,1]$
 $a \in [0,1]$

操作: (W) .XOR.(f) → dest

受影响的状态位: N 和 Z

机器码:

0001	10da	ffff	ffff
------	------	------	------

说明: 将 W 的内容与寄存器 f 的内容进行逻辑异或运算。如果 d 为 0, 结果存储在 W 中。如果 d 为 1, 结果存回寄存器 f (默认)。
如果 a 为 0, 选择快速操作存储区。如果 a 为 1, 使用 BSR 选择 GPR 存储区 (默认)。
如果 a 为 0 且使能了扩展指令集, 只要 $f \leq 95$ (5Fh), 指令就将以立即数变址寻址模式进行操作。详细信息, 请参见第 24.2.3 节“立即数变址寻址模式下针对字节和针对位的指令”。

指令字数: 1

指令周期数: 1

Q 周期操作:

Q1	Q2	Q3	Q4
译码	读寄存器 f	处理数据	写入目标寄存器

示例: XORWF REG, 1, 0

执行指令前
REG = AFh
W = B5h

执行指令后
REG = 1Ah
W = B5h

24.2 扩展指令集

除了 PIC18 指令集的 75 条标准指令之外，PIC18F2423/2523/4423/4523 器件还提供了针对内核 CPU 功能的可选扩展指令。这些新增的功能包括 8 条额外的指令，它们可以实现间接和变址寻址操作，并使得许多标准 PIC18 指令可以实现立即数变址寻址。

扩展指令集的额外功能在默认情况下是禁止的。用户必须通过将 XINST 配置位置 1，才能使用它们。

扩展指令集中的指令可以全部被归为立即数操作类指令，它们既可以操作文件选择寄存器，也可以使用这些寄存器进行变址寻址。还为其中两条指令 ADDFSR 和 SUBFSR 提供了使用 FSR2 的特例形式，即 ADDLNLK 和 SUBLNLK，这两条指令允许在执行后自动返回。

这些扩展的指令专门用于优化用高级语言特别是 C 语言编写的可重入程序代码（也就是递归或使用软件堆栈的代码）。此外，它们使用户能更高效地用高级语言对数据结构执行特定的操作。这些操作包括：

- 在进入和退出子程序时对软件堆栈空间进行动态分配和释放
- 函数指针调用
- 对软件堆栈指针进行操作
- 对软件堆栈中的变量进行操作

表 24-3 提供了扩展指令集中的指令汇总。第 24.2.2 节“扩展指令集”对这些指令进行了详细说明。第 272 页的表 24-1 提供了适用于标准和扩展的 PIC18 指令集的操作码字段说明。

注： 扩展指令集和立即数变址寻址模式是专为优化用 C 语言编写的应用程序而设计的，用户可能不会在汇编器中直接使用这些指令。对于那些需要查看编译器生成代码的用户，这些命令的语法可作为参考。

24.2.1 扩展指令的语法

大部分扩展指令都使用变址参数，同时使用一个文件选择寄存器和某一偏移量来指定源寄存器或目标寄存器。当指令的参数作为变址寻址的一部分时，会用方括号（“[]”）把它括起来。这时表示此参数用作变址地址或偏移量。如果 MPASM™ 汇编器发现一个变址地址或偏移量没有被括起来，它就会给出错误消息。

当使能扩展指令集时，括号也用于表示针对字节和针对位的指令中的变址参数。这是对指令语法的额外更改。更多详细信息，请参见第 24.2.3.1 节“标准 PIC18 命令的扩展指令语法”。

注： 以前，在 PIC18 和早期的指令集中使用方括号来表示可选参数。在此文本和以后的文本中，可选参数将用大括号（“{}”）表示。

表 24-3: PIC18 指令集的扩展

助记符, 操作数	说明	周期	16 位指令字		受影响的状态位
			MSb	LSb	
ADDFSR f, k	将立即数加到 FSR	1	1110	1000 f f k k k k k k	无
ADDLNLK k	将立即数加到 FSR2 并返回	2	1110	1000 11 k k k k k k	无
CALLW	使用 WREG 调用子程序	2	0000	0000 0001 0100	无
MOVSF z _s , f _d	将 z _s (源) 传送到 f _d (目标)	2	1110	1011 0 z z z z z z z z	无
MOVSS z _s , z _d	将 z _s (源) 传送到 z _d (目标)	2	1110	1011 1 z z z z z z z z	无
PUSHL k	将立即数保存到 FSR2, FSR2 递减 1	1	1110	1010 k k k k k k k k	无
SUBFSR f, k	FSR 减去立即数	1	1110	1001 f f k k k k k k	无
SUBLNLK k	FSR2 减去立即数并返回	2	1110	1001 11 k k k k k k	无

PIC18F2423/2523/4423/4523

24.2.2 扩展指令集

ADDFSR	将立即数加到 FSR								
语法:	ADDFSR f, k								
操作数:	0 ≤ k ≤ 63 f ∈ [0, 1, 2]								
操作:	FSR(f) + k → FSR(f)								
受影响的状态位:	无								
机器码:	<table border="1"> <tr> <td>1110</td> <td>1000</td> <td>ffkk</td> <td>kkkk</td> </tr> </table>	1110	1000	ffkk	kkkk				
1110	1000	ffkk	kkkk						
说明:	将 6 位立即数 k 加到由 f 指定的 FSR 的内容。								
指令字数:	1								
指令周期数:	1								
Q 周期操作:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Q1</th> <th>Q2</th> <th>Q3</th> <th>Q4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>译码</td> <td>读立即数 k</td> <td>处理数据</td> <td>写入 FSR</td> </tr> </tbody> </table>	Q1	Q2	Q3	Q4	译码	读立即数 k	处理数据	写入 FSR
Q1	Q2	Q3	Q4						
译码	读立即数 k	处理数据	写入 FSR						

示例: ADDFSR 2, 23h

执行指令前
FSR2 = 03FFh
执行指令后
FSR2 = 0422h

ADDULNK	将立即数加到 FSR2 并返回				
语法:	ADDULNK k				
操作数:	0 ≤ k ≤ 63				
操作:	FSR2 + k → FSR2, (TOS) → PC				
受影响的状态位:	无				
机器码:	<table border="1"> <tr> <td>1110</td> <td>1000</td> <td>11kk</td> <td>kkkk</td> </tr> </table>	1110	1000	11kk	kkkk
1110	1000	11kk	kkkk		
说明:	将 6 位立即数 k 加到 FSR2 的内容。然后通过将 TOS 的值装入 PC, 执行一条 RETURN 指令。执行该指令需要两个周期: 在第二个周期执行一条 NOP 指令。该指令可以被认为是 ADDFSR 指令的特例, 其中 f = 3 (二进制 “11”), 它仅对 FSR2 进行操作。				
指令字数:	1				
指令周期数:	2				

Q 周期操作:

Q1	Q2	Q3	Q4
译码	读立即数 k	处理数据	写入 FSR
空操作	空操作	空操作	空操作

示例: ADDULNK 23h

执行指令前
FSR2 = 03FFh
PC = 0100h
执行指令后
FSR2 = 0422h
PC = (TOS)

注: 所有的 PIC18 指令都可能在其指令助记符之前使用可选的标号参数, 用于符号寻址。如果使用了标号, 那么指令语法将变为: {label} 指令参数。

PIC18F2423/2523/4423/4523

CALLW 使用 WREG 调用子程序

语法:	CALLW				
操作数:	无				
操作:	(PC + 2) → TOS, (W) → PCL, (PCLATH) → PCH, (PCLATU) → PCU				
受影响的状态位:	无				
机器码:	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">0000</td> <td style="padding: 2px;">0000</td> <td style="padding: 2px;">0001</td> <td style="padding: 2px;">0100</td> </tr> </table>	0000	0000	0001	0100
0000	0000	0001	0100		

说明
首先，返回地址 (PC + 2) 被压入返回堆栈。接下来，将 W 寄存器的内容写入 PCL，PCL 现有的值被丢弃。然后，PCLATH 和 PCLATU 的内容被分别锁存到 PCH 和 PCU。第二个周期执行一条 NOP 指令，并同时取下一条指令。和 CALL 不一样，该指令没有更新 W、STATUS 或 BSR 寄存器的选项。

指令字数: 1
指令周期数: 2

Q 周期操作:

Q1	Q2	Q3	Q4
译码	读 WREG	将 PC 压入堆栈	空操作
空操作	空操作	空操作	空操作

示例: HERE CALLW

执行指令前

PC = 地址 (HERE)
PCLATH = 10h
PCLATU = 00h
W = 06h

执行指令后

PC = 001006h
TOS = 地址 (HERE + 2)
PCLATH = 10h
PCLATU = 00h
W = 06h

MOVSF 将变址寻址单元内容传送到 f

语法:	MOVSF [z _s], f _d								
操作数:	0 ≤ z _s ≤ 127 0 ≤ f _d ≤ 4095								
操作:	((FSR2) + z _s) → f _d								
受影响的状态位:	无								
机器码:	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">1110</td> <td style="padding: 2px;">1011</td> <td style="padding: 2px;">0zzz</td> <td style="padding: 2px;">zzzz_s</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">1111</td> <td style="padding: 2px;">ffff</td> <td style="padding: 2px;">ffff</td> <td style="padding: 2px;">ffff_d</td> </tr> </table>	1110	1011	0zzz	zzzz _s	1111	ffff	ffff	ffff _d
1110	1011	0zzz	zzzz _s						
1111	ffff	ffff	ffff _d						

说明
将源寄存器的内容传送到目标寄存器 f_d。通过将第一个字中的 7 位立即数偏移量 z_s 与 FSR2 的值相加来确定源寄存器的实际地址。第二个字中的 12 位立即数 f_d 指定目标寄存器的地址。两个地址均可以是 4096 字节的数据空间 (000h 到 FFFh) 中的任何存储单元。MOVSF 指令中的目标寄存器不能是 PCL、TOSU、TOSH 或 TOSL。如果计算得到的源地址指向间接寻址寄存器，将返回 00h。

指令字数: 2
指令周期数: 2

Q 周期操作:

Q1	Q2	Q3	Q4
译码	确定源地址	确定源地址	读源寄存器
译码	空操作 无假读	空操作	写寄存器 f (目标寄存器)

示例: MOVSF [05h], REG2

执行指令前

FSR2 = 80h
85h 单元的内容 = 33h
REG2 = 11h

执行指令后

FSR2 = 80h
85h 单元的内容 = 33h
REG2 = 33h

PIC18F2423/2523/4423/4523

MOVSS 在变址寻址单元之间传送数据

语法: MOVSS [z_s], [z_d]
 操作数: 0 ≤ z_s ≤ 127
 0 ≤ z_d ≤ 127
 操作: ((FSR2) + z_s) → ((FSR2) + z_d)

受影响的状态位: 无

机器码:

第一个字 (源)	1110	1011	1zzz	zzzz _s
第二个字 (目标)	1111	xxxx	xzzz	zzzz _d

说明
 将源寄存器的内容传送到目标寄存器。通过将 FSR2 中的值分别加上 7 位立即数偏移量 z_s 和 z_d 来确定源寄存器和目标寄存器的地址。两个寄存器都可以是 4096 字节数据存储单元空间 (000h 到 FFFh) 中的任意存储单元。
 MOVSS 指令不能使用 PCL、TOSU、TOSH 或 TOSL 作为目标寄存器。如果计算得到的源地址指向间接寻址寄存器，将返回 00h。如果计算得到的目标地址指向间接寻址寄存器，将执行一条 NOP 指令。

指令字数: 2
 指令周期数: 2
 Q 周期操作:

Q1	Q2	Q3	Q4
译码	确定源地址	确定源地址	读源寄存器
译码	确定目标地址	确定目标地址	写目标寄存器

示例: MOVSS [05h], [06h]

执行指令前
 FSR2 = 80h
 85h 单元的内容 = 33h
 86h 单元的内容 = 11h
 执行指令后
 FSR2 = 80h
 85h 单元的内容 = 33h
 86h 单元的内容 = 33h

PUSHL 将立即数保存到 FSR2，FSR2 递减 1

语法: PUSHL k
 操作数: 0 ≤ k ≤ 255
 操作: k → (FSR2),
 FSR2 - 1 → FSR2

受影响的状态位: 无

机器码:

1111	1010	kkkk	kkkk
------	------	------	------

说明: 8 位立即数 k 被写入由 FSR2 指定的数据存储单元。操作完后 FSR2 递减 1。此指令允许用户将值压入软件堆栈。

指令字数: 1
 指令周期数: 1

Q 周期操作:

Q1	Q2	Q3	Q4
译码	读取 k	处理数据	写入目标寄存器

示例: PUSHL 08h

执行指令前
 FSR2H:FSR2L = 01ECh
 存储单元 (01ECh) = 00h
 执行指令后
 FSR2H:FSR2L = 01EBh
 存储单元 (01ECh) = 08h

PIC18F2423/2523/4423/4523

SUBFSR FSR 减去立即数

语法: SUBFSR f, k

操作数: $0 \leq k \leq 63$

$f \in [0, 1, 2]$

操作: $FSR(f) - k \rightarrow FSRf$

受影响的状态位: 无

机器码:

1110	1001	ffkk	kkkk
------	------	------	------

说明: 用 f 指定的 FSR 的内容减去 6 位立即数 k。

指令字数: 1

指令周期数: 1

Q 周期操作:

Q1	Q2	Q3	Q4
译码	读寄存器 f	处理数据	写入 目标寄存器

示例: SUBFSR 2, 23h

执行指令前
FSR2 = 03FFh

执行指令后
FSR2 = 03DCh

SUBULNK FSR2 减去立即数并返回

语法: SUBULNK k

操作数: $0 \leq k \leq 63$

操作: $FSR2 - k \rightarrow FSR2$

$(TOS) \rightarrow PC$

受影响的状态位: 无

机器码:

1110	1001	1lkk	kkkk
------	------	------	------

说明: 用 FSR2 的内容减去 6 位立即数 k, 然后通过将 TOS 的值装入 PC, 执行一条 RETURN 指令。

执行该指令需要两个指令周期, 第二个指令周期执行一条 NOP 指令。

该指令可以被看作是 SUBFSR 指令的特例, 其中 $f = 3$ (二进制数“11”); 它只对 FSR2 进行操作。

指令字数: 1

指令周期数: 2

Q 周期操作:

Q1	Q2	Q3	Q4
译码	读寄存器 f	处理数据	写入 目标寄存器
空操作	空操作	空操作	空操作

示例: SUBULNK 23h

执行指令前
FSR2 = 03FFh
PC = 0100h

执行指令后
FSR2 = 03DCh
PC = (TOS)

PIC18F2423/2523/4423/4523

24.2.3 立即数变址寻址模式下针对字节和针对位的指令

注： 使能 PIC18 扩展指令集可能导致常规应用程序运行不正常或完全失败。

一旦使能扩展指令集，除了可以使用扩展指令集中的 8 条新命令之外，还将使能立即数变址寻址模式（第 5.5.1 节“使用立即数偏移量进行变址寻址”）。这将导致标准 PIC18 指令集中大部分指令的地址解析方法有很大变化。

当禁止扩展指令集时，包含在操作码中的地址被视为立即数存储单元：可以是快速操作存储区中的存储单元（ $a = 0$ ），或由 BSR 指定的 GPR 存储区中的存储单元（ $a = 1$ ）。当使能扩展指令集且 $a = 0$ 时，地址为 5Fh 或以下的文件寄存器参数被解析为 FSR2 中的指针值的偏移量，而不是一个立即数地址。对于实际应用来说，这意味着所有使用快速操作 RAM 位作为参数的指令，即所有针对字节或针对位的指令，或者几乎半数的 PIC18 核心指令，在使能了扩展指令集时操作都会有所不同。

当 FSR2 的内容为 00h 时，快速操作 RAM 的边界会被重新映射到它们的原始值。这对于编写向后兼容的代码很有用处。如果使用此技术，有必要在 C 程序调用汇编子程序时保存 FSR2 的值并在返回时将它恢复，这样做的目的是保护堆栈指针。用户还必须记住扩展指令集的语法要求（见第 24.2.3.1 节“标准 PIC18 命令的扩展指令语法”）。

虽然立即数变址寻址模式对于动态堆栈和指针操作很有用处，但是如果不小心对错误的寄存器进行了简单的算术运算也会非常麻烦。已经习惯使用 PIC18 编程的用户必须记住，在使能了扩展指令集后，地址小于或等于 5Fh 的寄存器用于立即数变址寻址。

下一页提供了在立即数变址寻址模式下，一些针对字节和位的典型指令的代表示例，通过这些示例可以看出指令执行如何受到影响。实例中的操作数条件适用于所有这些类型的指令。

24.2.3.1 标准 PIC18 命令的扩展指令语法

当使能了扩展指令集时，立即数偏移量“k”被用来替换标准的针对字节和位的命令中的文件寄存器参数“f”。如前所述，只有在“f”小于或等于 5Fh 时才会发生这种情况。当使用偏移量时，偏移量必须用方括号“[]”标出。因为在扩展指令集中，编译器将括号中的值解析为变址地址或偏移量。省略括号，或在括号内使用大于 5Fh 的值会在 MPASM 汇编器中产生错误。

如果变址参数已被正确加上了括号，那么就不再指定快速操作 RAM 参数；此参数自动被假定为 0。这与标准操作（禁止扩展指令集时）刚好相反，在标准操作中，a 基于目标地址被置 1。在变址寻址模式中，声明快速操作 RAM 位也将在 MPASM 汇编器中产生错误。

目标参数“d”的操作和以前一样。

在 MPASM 汇编器的最新版本中，必须明确调用对扩展指令集的语言支持。可以通过命令行选项 /Y 或在源代码中加入 PE 伪指令进行调用。

24.2.4 使能扩展指令集时的注意事项

需要注意的是，指令集的扩展并非对所有用户都有益。尤其是那些不编写使用软件堆栈的代码的用户不需要使用扩展指令集。

此外，立即数变址寻址模式可能会给写入 PIC18 汇编器的常规应用程序带来问题。这是因为常规模式的指令会尝试寻址快速操作存储区中地址低于 5Fh 的寄存器。当使能了扩展指令集时，这些地址被解析为相对于 FSR2 的立即数偏移量，所以应用程序会读或写错误的地址。

将应用程序移植到 PIC18F2423/2523/4423/4523 器件时，考虑代码的类型是非常重要的。在使用扩展指令集时，用 C 语言编写的代码较长的可重入应用程序会得益于高效编译而运行得很好，而大量使用快速操作存储区的常规应用程序不会获得任何益处。

PIC18F2423/2523/4423/4523

ADDWF 将 W 与变址寻址单元的内容相加 (立即数变址寻址模式)

语法: ADDWF [k],d

操作数: $0 \leq k \leq 95$
 $d \in [0,1]$

操作: $(W) + ((FSR2) + k) \rightarrow dest$

受影响的状态位: N、OV、C、DC 和 Z

机器码:

0010	01d0	kkkk	kkkk
------	------	------	------

说明: 将 W 的内容与由 FSR2 加上偏移量 k 指定的寄存器的内容相加。
如果 d 为 0, 结果存储在 W 中。如果 d 为 1, 结果存回寄存器 f (默认)。

指令字数: 1

指令周期数: 1

Q 周期操作:

Q1	Q2	Q3	Q4
译码	读取 k	处理数据	写入 目标寄存器

示例: ADDWF [OFST], 0

执行指令前

W	=	17h
OFST	=	2Ch
FSR2	=	0A00h
0A2Ch 单元的内容	=	20h

执行指令后

W	=	37h
0A2Ch 单元的内容	=	20h

BSF 将变址寻址单元相应位置 1 (立即数变址寻址模式)

语法: BSF [k], b

操作数: $0 \leq f \leq 95$
 $0 \leq b \leq 7$

操作: $1 \rightarrow ((FSR2) + k) $

受影响的状态位: 无

机器码:

1000	bbb0	kkkk	kkkk
------	------	------	------

说明: 将由 FSR2 加上偏移量 k 指定的寄存器中的 bit b 置 1。

指令字数: 1

指令周期数: 1

Q 周期操作:

Q1	Q2	Q3	Q4
译码	读寄存器 f	处理数据	写入 目标寄存器

示例: BSF [FLAG_OFST], 7

执行指令前

FLAG_OFST	=	0Ah
FSR2	=	0A00h
0A0Ah 单元的内容	=	55h

执行指令后

0A0Ah 单元的内容	=	D5h
-------------	---	-----

SETF 将变址寻址单元置全 1 (立即数变址寻址模式)

语法: SETF [k]

操作数: $0 \leq k \leq 95$

操作: $FFh \rightarrow ((FSR2) + k)$

受影响的状态位: 无

机器码:

0110	1000	kkkk	kkkk
------	------	------	------

说明: 将由 FSR2 加上偏移量 k 指定的寄存器的内容置为 FFh。

指令字数: 1

指令周期数: 1

Q 周期操作:

Q1	Q2	Q3	Q4
译码	读取 k	处理数据	写寄存器

示例: SETF [OFST]

执行指令前

OFST	=	2Ch
FSR2	=	0A00h
0A2Ch 单元的内容	=	00h

执行指令后

0A2Ch 单元的内容	=	FFh
-------------	---	-----

PIC18F2423/2523/4423/4523

24.2.5 使用 MICROCHIP MPLAB® IDE 工具的注意事项

最新版本的 Microchip 软件工具完全支持 PIC18F2423/2523/4423/4523 系列器件的扩展指令集。包括 MPLAB C18 C 语言编译器、MPASM 汇编语言和 MPLAB 集成开发环境 (IDE)。

当选择了目标器件进行软件开发时，MPLAB IDE 将自动按默认模式设置该器件的配置位。XINST 配置位的默认设置是 0，禁止扩展指令集和立即数变址寻址模式。在编程过程中必须将 XINST 位置 1 才能确保使用扩展指令集开发的应用程序能够正确执行。

要使用扩展指令集开发软件，用户必须在他们的语言工具中使能对扩展指令和变址寻址模式的支持。根据所使用的环境，可以通过以下几种方法来进行：

- 开发环境中的菜单选项或对话框，允许用户配置项目的语言工具及其设置
- 命令行选项
- 源代码中的伪指令

这些选项在不同的编译器、汇编器和开发环境中将有所不同。建议用户在其开发系统所附带的文档中查询相应的信息。

25.0 开发支持

一系列硬件及软件开发工具对 PIC[®] 单片机提供支持：

- 集成开发环境
 - MPLAB[®] IDE 软件
- 汇编器 / 编译器 / 链接器
 - MPASM[™] 汇编器
 - MPLAB C18 和 MPLAB C30 C 编译器
 - MPLINK[™] 目标链接器 / MPLIB[™] 目标库管理器
 - MPLAB ASM30 汇编器 / 链接器 / 库
- 模拟器
 - MPLAB SIM 软件模拟器
- 仿真器
 - MPLAB ICE 2000 在线仿真器
 - MPLAB REAL ICE[™] 在线仿真器
- 在线调试器
 - MPLAB ICD 2
- 器件编程器
 - PICSTART[®] Plus 开发编程器
 - MPLAB PM3 器件编程器
 - PICKit[™] 2 开发编程器
- 低成本演示和开发板及评估工具包

25.1 MPLAB 集成开发环境软件

MPLAB IDE 软件为 8/16 位单片机市场提供了前所未有的易于使用的软件开发平台。MPLAB IDE 是基于 Windows[®] 操作系统的应用软件，包括：

- 一个包含所有调试工具的图形界面
 - 模拟器
 - 编程器（单独销售）
 - 仿真器（单独销售）
 - 在线调试器（单独销售）
- 具有彩色上下文代码显示的全功能编辑器
- 多项目管理器
- 内容可直接编辑的可定制式数据窗口
- 高级源代码调试
- 可视化器件初始化程序，便于进行寄存器的初始化
- 鼠标停留在变量上进行查看的功能
- 通过拖放把变量从源代码窗口拉到观察窗口
- 丰富的在线帮助
- 集成了可选的第三方工具，如 HI-TECH 软件 C 编译器和 IAR C 编译器

MPLAB IDE 可以让您：

- 编辑源文件（汇编语言或 C 语言）
- 点击一次即可完成汇编（或编译）并将代码下载到 PIC MCU 仿真器和模拟器工具中（自动更新所有项目信息）
- 可使用如下各项进行调试：
 - 源文件（汇编语言或 C 语言）
 - 混合汇编语言和 C 语言
 - 机器码

MPLAB IDE 在单个开发范例中支持使用多种调试工具，包括从成本效益高的模拟器到低成本的在线调试器，再到全功能的仿真器。这样缩短了用户升级到更加灵活而功能更强大的工具时的学习时间。

PIC18F2423/2523/4423/4523

25.2 MPASM 汇编器

MPASM 汇编器是全功能通用宏汇编器，适用于所有的 PIC MCU。

MPASM 汇编器可生成用于 MPLINK 目标链接器的可重定位目标文件、Intel® 标准 HEX 文件、详细描述存储器使用状况和符号参考的 MAP 文件、包含源代码行及生成机器码的绝对 LST 文件以及用于调试的 COFF 文件。

MPASM 汇编器具有如下特征：

- 集成在 MPLAB IDE 项目中
- 用户定义的宏可简化汇编代码
- 对多用途源文件进行条件汇编
- 允许完全控制汇编过程的指令

25.3 MPLAB C18 和 MPLAB C30 C 编译器

MPLAB C18 和 MPLAB C30 代码开发系统是完全的 ANSI C 编译器，分别适用于 Microchip 的 PIC18 和 PIC24 系列单片机及 dsPIC30F 和 dsPIC33 系列数字信号控制器。这些编译器可提供其他编译器并不具备的强大的集成功能和出众的代码优化能力，且使用方便。

为便于源代码调试，编译器提供了针对 MPLAB IDE 调试器的优化符号信息。

25.4 MPLINK 目标链接器 / MPLIB 目标库管理器

MPLINK 目标链接器包含了由 MPASM 汇编器、MPLAB C18 C 编译器产生的可重定位目标。通过使用链接器脚本中的指令，它还可链接预编译库中的可重定位目标。

MPLIB 目标库管理器管理预编译代码库文件的创建和修改。当从源文件调用库中的一段子程序时，只有包含此子程序的模块被链接到应用中。这样可使大型库在许多不同应用中被高效地利用。

目标链接器 / 库管理器具有如下特征：

- 高效地连接单个的库而不是许多小文件
- 通过将相关的模块组合在一起增强代码的可维护性
- 只要列出、替换、删除和抽取模块，便可灵活地创建库

25.5 MPLAB ASM30 汇编器、链接器和库管理器

MPLAB ASM30 汇编器为 dsPIC30F 器件提供转换自符号汇编语言的可重定位机器码。MPLAB C30 C 编译器使用该汇编器生成目标文件。汇编器产生可重定位目标文件之后，可将这些目标文件存档，或其他可重定位目标文件和存档链接以生成可执行文件。该汇编器有如下显著特征：

- 支持整个 dsPIC30F 指令集
- 支持定点数据和浮点数据
- 命令行界面
- 丰富的指令集
- 灵活的宏语言
- MPLAB IDE 兼容性

25.6 MPLAB SIM 软件模拟器

MPLAB SIM 软件模拟器在指令级对 PIC MCU 和 dsPIC® DSC 进行模拟，使得用户可以在 PC 主机的环境下进行代码开发。对于任何给定的指令，用户均可对数据区进行检查或修改，并通过各种触发机制来产生激励。可以将各寄存器的情况记录在文件中，以便进行进一步地运行时分析。跟踪缓冲器和逻辑分析器的显示使模拟器还能记录和跟踪程序的执行、I/O 的动作、大部分的外设及内部寄存器的状况。

MPLAB SIM 软件模拟器完全支持使用 MPLAB C18 和 MPLAB C30 C 编译器以及 MPASM 和 MPLAB ASM30 汇编器的符号调试。该软件模拟器可用于在硬件实验室环境外灵活地开发和调试代码，是一款完美且经济的软件开发工具。

25.7 MPLAB ICE 2000 高性能在线仿真器

MPLAB ICE 2000 在线仿真器旨在为产品开发工程师提供一整套用于 PIC 单片机的设计工具。MPLAB ICE 2000 在线仿真器的软件控制由 MPLAB 集成开发环境平台提供，它允许在单一环境下进行编辑、编译、下载以及源代码调试。

MPLAB ICE 2000 是全功能仿真器系统，它具有增强的跟踪、触发和数据监控功能。处理器模块可插拔，使系统可轻松进行重新配置以适应各种不同处理器的仿真需要。MPLAB ICE 2000 在线仿真器的架构允许对其进行扩展以支持新的 PIC 单片机。

MPLAB ICE 2000 在线仿真器系统设计为一款实时仿真系统，该仿真系统具备通常只有昂贵的开发工具中才有的高级功能。选择 PC 平台和 Microsoft® Windows® 32 位操作系统可使这些功能在一个简单而统一的应用中得到很好的利用。

25.8 MPLAB REAL ICE 在线仿真器系统

MPLAB REAL ICE 在线仿真器系统是 Microchip 针对其闪存 DSC® 和 MCU 器件而推出的新一代高速仿真器。结合 MPLAB 集成开发环境 (IDE) 所具有的易于使用且功能强大的图形用户界面，该仿真器可对 PIC® 和 dsPIC® 闪存单片机进行调试和编程。IDE 是随每个工具包一起提供的。

MPLAB REAL ICE 探针通过高速 USB 2.0 接口与设计工程师的 PC 相连，并利用与常用 MPLAB ICD 2 系统兼容的连接器 (RJ11) 或新型抗噪声、高速低压差分信号 (LVDS) 互连电缆 (CAT5) 与目标板相连。

可通过 MPLAB IDE 下载将来版本的固件，对 MPLAB REAL ICE 进行现场升级。在即将推出的 MPLAB IDE 版本中，会支持许多新器件，还将增加一些新特性，如软件断点和汇编代码跟踪等。在同类仿真器中，MPLAB REAL ICE 的优势十分明显：低成本、高速仿真、实时变量监视、跟踪分析、复杂断点、耐用的探针接口及较长 (长达 3 米) 的互连电缆。

25.9 MPLAB ICD 2 在线调试器

Microchip 的在线调试器 MPLAB ICD 2 是一款功能强大而成本低廉的运行时开发工具，通过 RS-232 或高速 USB 接口与 PC 主机相连。该工具基于闪存 PIC MCU，可用于开发本系列及其他 PIC MCU 和 dsPIC DSC。MPLAB ICD 2 使用了闪存器件中内建的在线调试功能。该功能结合 Microchip 的在线串行编程 (In-Circuit Serial Programming™, ICSP™) 协议，可在 MPLAB 集成开发环境的图形用户界面上提供成本效益很高的在线闪存调试。这使设计人员可通过设置断点、单步运行以及对变量、CPU 状态以及外设寄存器进行监视的方法实现源代码的开发和调试。其全速运行特性可对硬件和应用进行实时测试。MPLAB ICD 2 还可用作某些 PIC 器件的开发编程器。

25.10 MPLAB PM3 器件编程器

MPLAB PM3 器件编程器是一款通用的、符合 CE 规范的器件编程器，其可编程电压设置在 VDDMIN 和 VDDMAX 之间时可靠性最高。它有一个用来显示菜单和错误信息的大 LCD 显示器 (128 x 64)，以及一个支持各种封装类型的可拆卸模块化插槽装置。编程器标准配置中带有一根 ICSP™ 电缆。在单机模式下，MPLAB PM3 器件编程器不必与 PC 相连即可对 PIC 器件进行读取、验证和编程。在该模式下它还可设置代码保护。MPLAB PM3 通过 RS-232 或 USB 电缆连接到 PC 主机上。MPLAB PM3 具备高速通信能力以及优化算法，可对存储器很大的器件进行快速编程，它还采用 SD/MMC 卡用作文件存储及数据安全应用。

PIC18F2423/2523/4423/4523

25.11 PICSTART Plus 开发编程器

PICSTART Plus 开发编程器是一款易于使用而成本低廉的原型编程器。它通过 COM (RS-232) 端口与 PC 相连。MPLAB 集成开发环境软件使得该编程器的使用简便、高效。PICSTART Plus 开发编程器支持采用 DIP 封装的大部分 PIC 器件，其引脚数最多可达 40 个。引脚数更多的器件，如 PIC16C92X 和 PIC17C76X，可通过连接一个转接插槽来获得支持。PICSTART Plus 开发编程器符合 CE 规范。

25.12 PICkit 2 开发编程器

PICkit™ 2 开发编程器是一个低成本编程器；对于某些选定闪存器件，它也是一个调试器，通过其易于使用的接口可对众多 Microchip 的低档、中档和 PIC18F 系列闪存单片机进行编程。PICkit 2 入门工具包中包含一个有实验布线区的开发板、十二堂系列课程、软件和 HI-TECH 的 PICC™ Lite C 编译器，有助于用户快速掌握 PIC® 单片机的使用。这一工具包为使用 Microchip 功能强大的中档闪存系列单片机进行编程、评估和应用开发，提供了所需的一切。

25.13 演示、开发和评估板

有许多演示、开发和评估板可用于各种 PIC MCU 和 dsPIC DSC，实现对全功能系统的快速应用开发。大多数的演示、开发和评估板都有实验布线区，供用户添加定制电路；还有应用固件和源代码，用于测试和修改。

这些板支持多种功能部件，包括 LED、温度传感器、开关、扬声器、RS-232 接口、LCD 显示器、电位计和附加 EEPROM 存储器。

演示和开发板可用于教学环境，在实验布线区设计定制电路，从而掌握各种单片机应用。

除了 PICDEM™ 和 dsPICDEM™ 演示 / 开发板系列电路外，Microchip 还有一系列评估工具包和演示软件，适用于模拟滤波器设计、KEELOQ® 数据安全产品 IC、CAN、IrDA®、PowerSmart® 电池管理、SEEVAL® 评估系统、 Σ - Δ ADC、流速传感器，等等。

有关演示、开发和评估工具包的完整列表，请查阅 Microchip 公司网页 (www.microchip.com) 以及最新的 “*Product Selector Guide (产品选型指南)*” (DS00148)。

26.0 电气特性

绝对最大额定值 (†)

环境温度.....	-40°C 至 +125°C
储存温度.....	-65°C 至 +150°C
任一引脚（除 VDD、 $\overline{\text{MCLR}}$ 和 RA4 外）相对于 VSS 的电压.....	-0.3V 至 (VDD + 0.3V)
VDD 引脚相对于 VSS 的电压.....	-0.3V 至 +7.5V
$\overline{\text{MCLR}}$ 引脚相对于 VSS 的电压（注 2）.....	0V 至 +13.25V
总功耗（注 1）.....	1.0W
流出 VSS 引脚的最大电流.....	300 mA
流入 VDD 引脚的最大电流.....	250 mA
输入箝位电流， I_{IK} ($V_I < 0$ 或 $V_I > V_{DD}$).....	± 20 mA
输出箝位电流， I_{OK} ($V_O < 0$ 或 $V_O > V_{DD}$).....	± 20 mA
任一 I/O 引脚的最大输出灌电流.....	25 mA
任一 I/O 引脚的最大输出拉电流.....	25 mA
所有端口的最大灌电流.....	200 mA
所有端口的最大拉电流.....	200 mA

注 1: 功耗计算公式为:

$$P_{dis} = V_{DD} \times \{I_{DD} - \sum I_{OH}\} + \sum \{(V_{DD} - V_{OH}) \times I_{OH}\} + \sum (V_{OL} \times I_{OL})$$

2: $\overline{\text{MCLR}}/\text{VPP}/\text{RE3}$ 引脚上若出现低于 VSS 的尖峰电压，感应电流超过 80 mA，可能导致锁死。因此，在 $\overline{\text{MCLR}}/\text{VPP}/\text{RE3}$ 引脚上施加低电平时，应使用一个 50-100 Ω 的串联电阻，而不是将该引脚直接与 VSS 连接。

†注: 如果运行条件超过了上述“绝对最大额定值”，即可能对器件造成永久性损坏。上述值仅为运行条件的极大值，我们不建议器件运行在该规范范围以外。器件长时间工作在绝对极限参数条件下，其稳定性可能受到影响。

PIC18F2423/2523/4423/4523

图 26-1: PIC18F2423/2523/4423/4523 电压—频率关系图 (工业级)

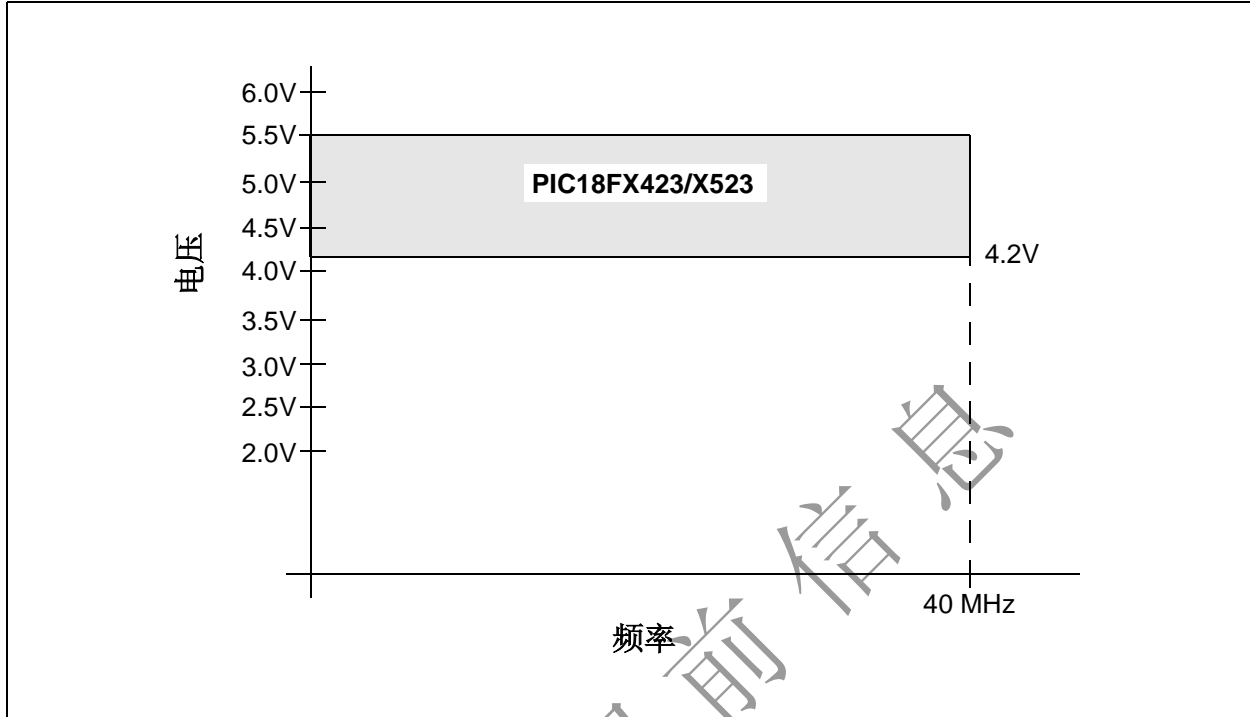
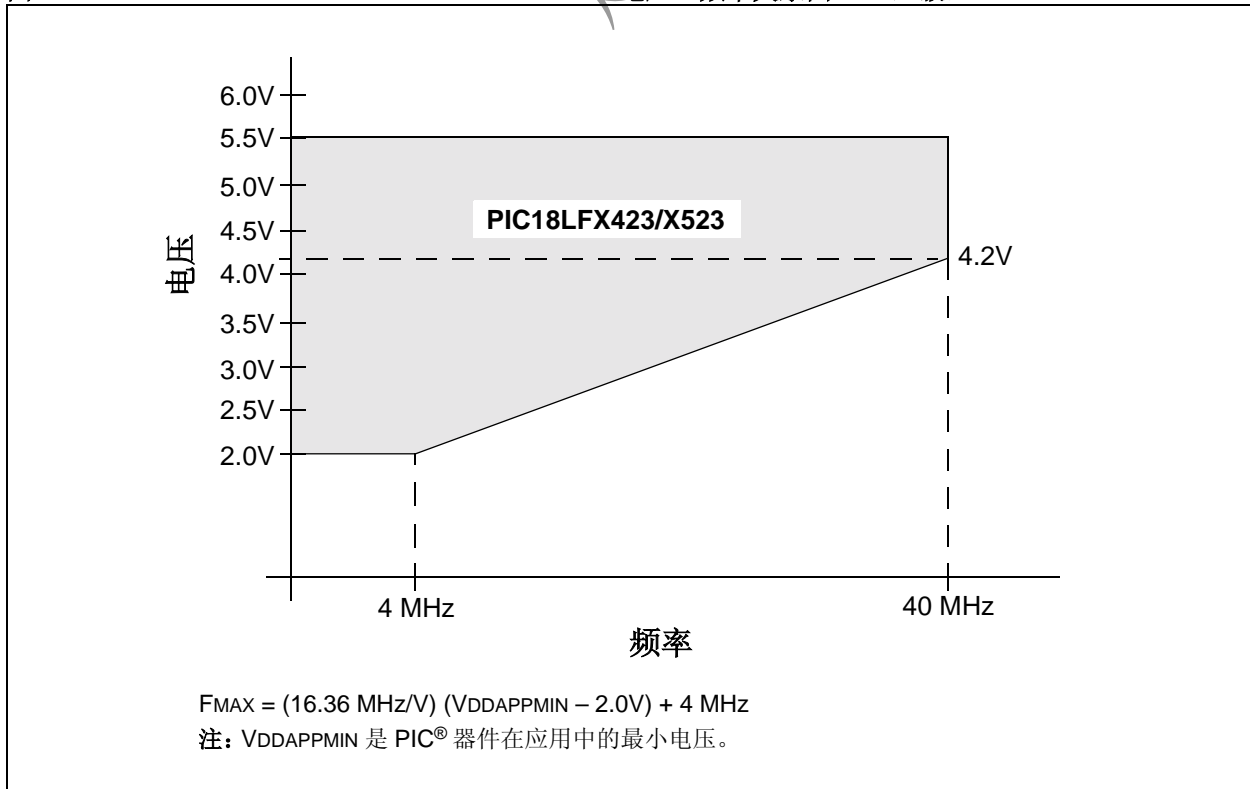


图 26-2: PIC18LF2423/2523/4423/4523 电压—频率关系图 (工业级)



PIC18F2423/2523/4423/4523

26.1 直流特性:

供电电压

PIC18F2423/2523/4423/4523 (工业级)

PIC18LF2423/2523/4423/4523 (工业级)

PIC18LFX423/X523 (工业级)		标准工作条件 (除非另外声明) 工作温度 $-40^{\circ}\text{C} \leq T_A \leq +85^{\circ}\text{C}$ (工业级)					
PIC18FX423/X523 (工业级)		标准工作条件 (除非另外声明) 工作温度 $-40^{\circ}\text{C} \leq T_A \leq +85^{\circ}\text{C}$ (工业级)					
参数编号	符号	特性	最小值	典型值	最大值	单位	条件
D001	VDD	供电电压					
		PIC18LFX423/X523	2.0	—	5.5	V	
D001A		PIC18FX423/X523	4.2	—	5.5	V	
D002	VDR	RAM 数据保持电压⁽¹⁾	1.5	—	—	V	
D003	VPOR	VDD 启动电压 (确保内部上电复位信号)	—	—	0.7	V	详情请参见“上电复位”章节
D004	SVDD	VDD 上升率 (确保内部上电复位信号)	0.05	—	—	V/ms	详情请参见“上电复位”章节
D005	VBOR	欠压复位电压					
		PIC18LFX423/X523 工业级低电压					
		BORV1:BORV0 = 11	N/A	—	N/A	V	保留
		BORV1:BORV0 = 10	2.65	2.79	2.93	V	
		BORV1:BORV0 = 01	4.11	4.33	4.55	V	
		BORV1:BORV0 = 00	4.36	4.59	4.82	V	
		PIC18FX423/X523 工业级					
		BORV1:BORV0 = 11	N/A	—	N/A	V	保留
		BORV1:BORV0 = 10	N/A	—	N/A	V	
BORV1:BORV0 = 01	4.11	4.33	4.55	V			
BORV1:BORV0 = 00	4.36	4.59	4.82	V			

图注: 阴影行是为了增强表的可读性。

注 1: 这是在不丢失 RAM 数据的前提下, 休眠模式或器件复位期间 VDD 所能降到的最小电压值。

PIC18F2423/2523/4423/4523

26.2 直流特性:

掉电和供电电流

PIC18F2423/2523/4423/4523 (工业级)

PIC18LF2423/2523/4423/4523 (工业级)

PIC18LFX423/X523 (工业级)		标准工作条件 (除非另外声明) 工作温度 $-40^{\circ}\text{C} \leq T_A \leq +85^{\circ}\text{C}$ (工业级)			
PIC18FX423/X523 (工业级)		标准工作条件 (除非另外声明) 工作温度 $-40^{\circ}\text{C} \leq T_A \leq +85^{\circ}\text{C}$ (工业级)			
参数编号	器件	典型值	最大值	单位	条件
掉电电流 (IPD) (1)					
	PIC18LFX423/X523	20	950	nA	-40°C
		0.02	1.0	μA	+25°C
		0.6	1.1	μA	+85°C
	PIC18LFX423/X523	0.03	1.4	μA	-40°C
		0.03	1.5	μA	+25°C
		0.8	1.6	μA	+85°C
	所有器件	0.04	1.9	μA	-40°C
		0.04	2.0	μA	+25°C
		1.7	2.1	μA	+85°C

图注:

阴影行是为了增强表的可读性。

注

- 在休眠模式下，掉电电流与振荡器类型无关。掉电电流是在器件处于休眠模式、所有 I/O 引脚处于高阻态并且连接到 VDD 或 VSS，禁止所有会带来新增电流的功能部件（如 WDT、Timer1 振荡器、BOR 等）时测得的。
- 供电电流主要受工作电压、频率和模式的影响。其他因素，如 I/O 引脚负载和开关速率、振荡器类型和电路、内部代码执行模式和温度也会对电流消耗产生影响。
正常工作模式下，所有 I_{DD} 测量值的测试条件为：
OS_{C1} = 外部方波，轨到轨满幅；所有 I/O 引脚均为三态，上拉至 VDD；
MCLR = VDD；根据具体应用使能 / 禁止 WDT。
- 对于 RC 振荡器配置，该电流不包括流经 R_{EXT} 的电流。流经该电阻的电流可以由公式 $I_r = V_{DD}/2R_{EXT}$ (mA) 来估算，其中 R_{EXT} 的单位是 kΩ。
- 标准低成本 32 kHz 晶振的工作温度范围为 -10°C 至 +70°C。扩展级温度晶振的成本则高很多。
- BOR 和 HLVD 使能内部带隙参考源。当同时使能两个模块时，电流消耗将小于两个规范值的和。

PIC18F2423/2523/4423/4523

26.2 直流特性:

掉电和供电电流

PIC18F2423/2523/4423/4523 (工业级)

PIC18LF2423/2523/4423/4523 (工业级) (续)

PIC18LFX423/X523 (工业级)		标准工作条件 (除非另外声明) 工作温度 $-40^{\circ}\text{C} \leq T_A \leq +85^{\circ}\text{C}$ (工业级)				
PIC18FX423/X523 (工业级)		标准工作条件 (除非另外声明) 工作温度 $-40^{\circ}\text{C} \leq T_A \leq +85^{\circ}\text{C}$ (工业级)				
参数编号	器件	典型值	最大值	单位	条件	
供电电流 (I_{DD}) (2,3)						
PIC18LFX423/X523		15	31.5	μA	-40°C	V _{DD} = 2.0V Fosc = 31 kHz (RC_RUN 模式, INTRC 时钟源)
		15	30	μA	+25°C	
		15	28.5	μA	+85°C	
PIC18LFX423/X523		40	63	μA	-40°C	
		35	60	μA	+25°C	
		30	57	μA	+85°C	
所有器件		105	168	μA	-40°C	
		90	160	μA	+25°C	
		80	152	μA	+85°C	
PIC18LFX423/X523		320	630	μA	-40°C	V _{DD} = 2.0V Fosc = 1 MHz (RC_RUN 模式, INTOSC 时钟源)
		330	600	μA	+25°C	
		330	570	μA	+85°C	
PIC18LFX423/X523		0.6	1.3	mA	-40°C	
		0.55	1.2	mA	+25°C	
		0.6	1.1	mA	+85°C	
所有器件		1.1	2.3	mA	-40°C	
		1.1	2.2	mA	+25°C	
		1.0	2.1	mA	+85°C	

图注: 阴影行是为了增强表的可读性。

- 注 1:** 在休眠模式下, 掉电电流与振荡器类型无关。掉电电流是在器件处于休眠模式、所有 I/O 引脚处于高阻态并且连接到 V_{DD} 或 V_{SS}, 禁止所有会带来新增电流的功能部件 (如 WDT、Timer1 振荡器、BOR 等) 时测得的。
- 2:** 供电电流主要受工作电压、频率和模式的影响。其他因素, 如 I/O 引脚负载和开关速率、振荡器类型和电路、内部代码执行模式和温度也会对电流消耗产生影响。
正常工作模式下, 所有 I_{DD} 测量值的测试条件为:
OSC1 = 外部方波, 轨到轨满幅; 所有 I/O 引脚均为三态, 上拉至 V_{DD} ;
MCLR = V_{DD} ; 根据具体应用使能 / 禁止 WDT。
- 3:** 对于 RC 振荡器配置, 该电流不包括流经 R_{EXT} 的电流。流经该电阻的电流可以由公式 $I_r = V_{DD}/2R_{EXT}$ (mA) 来估算, 其中 R_{EXT} 的单位是 kΩ。
- 4:** 标准低成本 32 kHz 晶振的工作温度范围为 -10°C 至 +70°C。扩展级温度晶振的成本则高很多。
- 5:** BOR 和 HLVD 使能内部带隙参考源。当同时使能两个模块时, 电流消耗将小于两个规范值的和。

PIC18F2423/2523/4423/4523

26.2 直流特性:

掉电和供电电流

PIC18F2423/2523/4423/4523 (工业级)

PIC18LF2423/2523/4423/4523 (工业级) (续)

PIC18LFX423/X523 (工业级)		标准工作条件 (除非另外声明)					
		工作温度 $-40^{\circ}\text{C} \leq T_A \leq +85^{\circ}\text{C}$ (工业级)					
PIC18FX423/X523 (工业级)		标准工作条件 (除非另外声明)					
		工作温度 $-40^{\circ}\text{C} \leq T_A \leq +85^{\circ}\text{C}$ (工业级)					
参数编号	器件	典型值	最大值	单位	条件		
供电电流 (I_{DD}) (2,3)							
PIC18LFX423/X523	PIC18LFX423/X523	0.8	2.1	mA	-40°C	V _{DD} = 2.0V F _{OSC} = 4 MHz (RC_RUN 模式, INTRC 时钟源)	
		0.8	2.0	mA	+25°C		
		0.8	1.9	mA	+85°C		
	PIC18LFX423/X523	1.3	2.7	mA	-40°C		V _{DD} = 3.0V
		1.3	2.6	mA	+25°C		
		1.3	2.5	mA	+85°C		
	所有器件	2.5	5.3	mA	-40°C		V _{DD} = 5.0V
		2.5	5.0	mA	+25°C		
		2.5	4.8	mA	+85°C		
PIC18LFX423/X523	2.9	6.5	μA	-40°C	V _{DD} = 2.0V	F _{OSC} = 31 kHz (RC_IDLE 模式, INTRC 时钟源)	
	3.1	6.2	μA	+25°C			
	3.6	5.9	μA	+85°C			
PIC18LFX423/X523	4.5	10.1	μA	-40°C	V _{DD} = 3.0V		
	4.8	9.6	μA	+25°C			
	5.8	9.1	μA	+85°C			
所有器件	9.2	15.8	μA	-40°C	V _{DD} = 5.0V		
	9.8	15.0	μA	+25°C			
	11.4	14.3	μA	+85°C			

图注: 阴影行是为了增强表的可读性。

- 注 1: 在休眠模式下, 掉电电流与振荡器类型无关。掉电电流是在器件处于休眠模式、所有 I/O 引脚处于高阻态并且连接到 V_{DD} 或 V_{SS}, 禁止所有会带来新增电流的功能部件 (如 WDT、Timer1 振荡器、BOR 等) 时测得的。
- 2: 供电电流主要受工作电压、频率和模式的影响。其他因素, 如 I/O 引脚负载和开关速率、振荡器类型和电路、内部代码执行模式和温度也会对电流消耗产生影响。
正常工作模式下, 所有 I_{DD} 测量值的测试条件为:
OSC1 = 外部方波, 轨到轨满幅; 所有 I/O 引脚均为三态, 上拉至 V_{DD} ;
MCLR = V_{DD} ; 根据具体应用使能 / 禁止 WDT。
- 3: 对于 RC 振荡器配置, 该电流不包括流经 R_{EXT} 的电流。流经该电阻的电流可以由公式 $I_r = V_{DD}/2R_{EXT}$ (mA) 来估算, 其中 R_{EXT} 的单位是 kΩ。
- 4: 标准低成本 32 kHz 晶振的工作温度范围为 -10°C 至 +70°C。扩展级温度晶振的成本则高很多。
- 5: BOR 和 HLVD 使能内部带隙参考源。当同时使能两个模块时, 电流消耗将小于两个规范值的和。

PIC18F2423/2523/4423/4523

26.2 直流特性:

掉电和供电电流

PIC18F2423/2523/4423/4523 (工业级)

PIC18LF2423/2523/4423/4523 (工业级) (续)

PIC18LFX423/X523 (工业级)		标准工作条件 (除非另外声明) 工作温度 $-40^{\circ}\text{C} \leq T_A \leq +85^{\circ}\text{C}$ (工业级)					
PIC18FX423/X523 (工业级)		标准工作条件 (除非另外声明) 工作温度 $-40^{\circ}\text{C} \leq T_A \leq +85^{\circ}\text{C}$ (工业级)					
参数 编号	器件	典型值	最大值	单位	条件		
供电电流 (IDD) (2,3)							
PIC18LFX423/X523		165	315	μA	-40°C	$V_{\text{DD}} = 2.0\text{V}$ $V_{\text{DD}} = 3.0\text{V}$ $V_{\text{DD}} = 5.0\text{V}$	FOSC = 1 MHz (RC_IDLE 模式, INTOSC 时钟源)
		175	300	μA	$+25^{\circ}\text{C}$		
		190	285	μA	$+85^{\circ}\text{C}$		
PIC18LFX423/X523		250	470	μA	-40°C		
		270	450	μA	$+25^{\circ}\text{C}$		
		290	430	μA	$+85^{\circ}\text{C}$		
所有器件		500	840	μA	-40°C		
		520	800	μA	$+25^{\circ}\text{C}$		
		550	760	μA	$+85^{\circ}\text{C}$		
PIC18LFX423/X523		340	525	μA	-40°C	$V_{\text{DD}} = 2.0\text{V}$ $V_{\text{DD}} = 3.0\text{V}$ $V_{\text{DD}} = 5.0\text{V}$	FOSC = 4 MHz (RC_IDLE 模式, INTOSC 时钟源)
		350	500	μA	$+25^{\circ}\text{C}$		
		360	475	μA	$+85^{\circ}\text{C}$		
PIC18LFX423/X523		520	735	μA	-40°C		
		540	700	μA	$+25^{\circ}\text{C}$		
		580	665	μA	$+85^{\circ}\text{C}$		
所有器件		1.0	1.6	mA	-40°C		
		1.1	1.5	mA	$+25^{\circ}\text{C}$		
		1.1	1.4	mA	$+85^{\circ}\text{C}$		

图注:

阴影行是为了增强表的可读性。

- 注 1:** 在休眠模式下, 掉电电流与振荡器类型无关。掉电电流是在器件处于休眠模式、所有 I/O 引脚处于高阻态并且连接到 V_{DD} 或 V_{SS} , 禁止所有会带来新增电流的功能部件 (如 WDT、Timer1 振荡器、BOR 等) 时测得的。
- 2:** 供电电流主要受工作电压、频率和模式的影响。其他因素, 如 I/O 引脚负载和开关速率、振荡器类型和电路、内部代码执行模式和温度也会对电流消耗产生影响。
正常工作模式下, 所有 I_{DD} 测量值的测试条件为:
 $\text{OSC1} =$ 外部方波, 轨到轨满幅; 所有 I/O 引脚均为三态, 上拉至 V_{DD} ;
 $\text{MCLR} = V_{\text{DD}}$; 根据具体应用使能/禁止 WDT。
- 3:** 对于 RC 振荡器配置, 该电流不包括流经 R_{EXT} 的电流。流经该电阻的电流可以由公式 $I_r = V_{\text{DD}}/2R_{\text{EXT}}$ (mA) 来估算, 其中 R_{EXT} 的单位是 $\text{k}\Omega$ 。
- 4:** 标准低成本 32 kHz 晶振的工作温度范围为 -10°C 至 $+70^{\circ}\text{C}$ 。扩展级温度晶振的成本则高很多。
- 5:** BOR 和 HLVD 使能内部带隙参考源。当同时使能两个模块时, 电流消耗将小于两个规范值的和。

PIC18F2423/2523/4423/4523

26.2 直流特性:

掉电和供电电流

PIC18F2423/2523/4423/4523 (工业级)

PIC18LF2423/2523/4423/4523 (工业级) (续)

PIC18LFX423/X523 (工业级)		标准工作条件 (除非另外声明) 工作温度 $-40^{\circ}\text{C} \leq T_A \leq +85^{\circ}\text{C}$ (工业级)				
PIC18FX423/X523 (工业级)		标准工作条件 (除非另外声明) 工作温度 $-40^{\circ}\text{C} \leq T_A \leq +85^{\circ}\text{C}$ (工业级)				
参数编号	器件	典型值	最大值	单位	条件	
供电电流 (IDD) (2,3)						
PIC18LFX423/X523		250	420	μA	-40°C	V _{DD} = 2.0V V _{DD} = 3.0V V _{DD} = 5.0V F _{OSC} = 1 MHz (PRI_RUN, EC 振荡器)
		260	400	μA	$+25^{\circ}\text{C}$	
		250	380	μA	$+85^{\circ}\text{C}$	
PIC18LFX423/X523		550	740	μA	-40°C	
		480	700	μA	$+25^{\circ}\text{C}$	
		460	670	μA	$+85^{\circ}\text{C}$	
所有器件		1.2	1.6	mA	-40°C	
		1.1	1.5	mA	$+25^{\circ}\text{C}$	
		1.0	1.4	mA	$+85^{\circ}\text{C}$	
PIC18LFX423/X523		0.72	1.6	mA	-40°C	V _{DD} = 2.0V V _{DD} = 3.0V V _{DD} = 5.0V F _{OSC} = 4 MHz (PRI_RUN, EC 振荡器)
		0.74	1.5	mA	$+25^{\circ}\text{C}$	
		0.74	1.4	mA	$+85^{\circ}\text{C}$	
PIC18LFX423/X523		1.3	2.6	mA	-40°C	
		1.3	2.5	mA	$+25^{\circ}\text{C}$	
		1.3	2.4	mA	$+85^{\circ}\text{C}$	
所有器件		2.7	4.7	mA	-40°C	
		2.6	4.5	mA	$+25^{\circ}\text{C}$	
		2.5	4.3	mA	$+85^{\circ}\text{C}$	
所有器件		15	26	mA	-40°C	V _{DD} = 4.2V V _{DD} = 5.0V F _{OSC} = 40 MHz (PRI_RUN, EC 振荡器)
		16	25	mA	$+25^{\circ}\text{C}$	
		16	24	mA	$+85^{\circ}\text{C}$	
所有器件		21	32	mA	-40°C	
		21	30	mA	$+25^{\circ}\text{C}$	
		21	28	mA	$+85^{\circ}\text{C}$	

图注: 阴影行是为了增强表的可读性。

- 注 1: 在休眠模式下, 掉电电流与振荡器类型无关。掉电电流是在器件处于休眠模式、所有 I/O 引脚处于高阻态并且连接到 V_{DD} 或 V_{SS}, 禁止所有会带来新增电流的功能部件 (如 WDT、Timer1 振荡器、BOR 等) 时测得的。
- 2: 供电电流主要受工作电压、频率和模式的影响。其他因素, 如 I/O 引脚负载和开关速率、振荡器类型和电路、内部代码执行模式和温度也会对电流消耗产生影响。
正常工作模式下, 所有 I_{DD} 测量值的测试条件为:
OSC1 = 外部方波, 轨到轨满幅; 所有 I/O 引脚均为三态, 上拉至 V_{DD} ;
MCLR = V_{DD} ; 根据具体应用使能 / 禁止 WDT。
- 3: 对于 RC 振荡器配置, 该电流不包括流经 R_{EXT} 的电流。流经该电阻的电流可以由公式 $I_r = V_{DD}/2R_{EXT}$ (mA) 来估算, 其中 R_{EXT} 的单位是 k Ω 。
- 4: 标准低成本 32 kHz 晶振的工作温度范围为 -10°C 至 $+70^{\circ}\text{C}$ 。扩展级温度晶振的成本则高很多。
- 5: BOR 和 HLVD 使能内部带隙参考源。当同时使能两个模块时, 电流消耗将小于两个规范值的和。

PIC18F2423/2523/4423/4523

26.2 直流特性:

掉电和供电电流

PIC18F2423/2523/4423/4523 (工业级)

PIC18LF2423/2523/4423/4523 (工业级) (续)

PIC18LFX423/X523 (工业级)		标准工作条件 (除非另外声明) 工作温度 $-40^{\circ}\text{C} \leq T_A \leq +85^{\circ}\text{C}$ (工业级)				
PIC18FX423/X523 (工业级)		标准工作条件 (除非另外声明) 工作温度 $-40^{\circ}\text{C} \leq T_A \leq +85^{\circ}\text{C}$ (工业级)				
参数编号	器件	典型值	最大值	单位	条件	
供电电流 (IDD) (2,3)						
	所有器件	7.5	16	mA	-40°C	VDD = 4.2V FOSC = 4 MHz (PRI_RUN HS+PLL)
		7.4	15	mA	$+25^{\circ}\text{C}$	
		7.3	14	mA	$+85^{\circ}\text{C}$	
	所有器件	10	21	mA	-40°C	VDD = 5.0V FOSC = 4 MHz (PRI_RUN HS+PLL)
		10	20	mA	$+25^{\circ}\text{C}$	
		9.7	19	mA	$+85^{\circ}\text{C}$	
	所有器件	17	35	mA	-40°C	VDD = 4.2V FOSC = 10 MHz (PRI_RUN HS+PLL)
		17	34	mA	$+25^{\circ}\text{C}$	
		17	33	mA	$+85^{\circ}\text{C}$	
	所有器件	23	46	mA	-40°C	VDD = 5.0V FOSC = 10 MHz (PRI_RUN HS+PLL)
		23	45	mA	$+25^{\circ}\text{C}$	
		23	43	mA	$+85^{\circ}\text{C}$	

图注:

阴影行是为了增强表的可读性。

注

- 在休眠模式下, 掉电电流与振荡器类型无关。掉电电流是在器件处于休眠模式、所有 I/O 引脚处于高阻态并且连接到 VDD 或 VSS, 禁止所有会带来新增电流的功能部件 (如 WDT、Timer1 振荡器、BOR 等) 时测得的。
- 供电电流主要受工作电压、频率和模式的影响。其他因素, 如 I/O 引脚负载和开关速率、振荡器类型和电路、内部代码执行模式和温度也会对电流消耗产生影响。
正常工作模式下, 所有 IDD 测量值的测试条件为:
OSC1 = 外部方波, 轨到轨满幅; 所有 I/O 引脚均为三态, 上拉至 VDD;
MCLR = VDD; 根据具体应用使能/禁止 WDT。
- 对于 RC 振荡器配置, 该电流不包括流经 REXT 的电流。流经该电阻的电流可以由公式 $I_r = V_{DD}/2R_{EXT}$ (mA) 来估算, 其中 REXT 的单位是 kΩ。
- 标准低成本 32 kHz 晶振的工作温度范围为 -10°C 至 $+70^{\circ}\text{C}$ 。扩展级温度晶振的成本则高很多。
- BOR 和 HLVD 使能内部带隙参考源。当同时使能两个模块时, 电流消耗将小于两个规范值的和。

PIC18F2423/2523/4423/4523

26.2 直流特性:

掉电和供电电流

PIC18F2423/2523/4423/4523 (工业级)

PIC18LF2423/2523/4423/4523 (工业级) (续)

PIC18LFX423/X523 (工业级)		标准工作条件 (除非另外声明)					
		工作温度 $-40^{\circ}\text{C} \leq T_A \leq +85^{\circ}\text{C}$ (工业级)					
PIC18FX423/X523 (工业级)		标准工作条件 (除非另外声明)					
		工作温度 $-40^{\circ}\text{C} \leq T_A \leq +85^{\circ}\text{C}$ (工业级)					
参数编号	器件	典型值	最大值	单位	条件		
供电电流 (IDD) (2,3)							
PIC18LFX423/X523		65	130	μA	-40°C	$V_{DD} = 2.0\text{V}$ $V_{DD} = 3.0\text{V}$ $V_{DD} = 5.0\text{V}$ $V_{DD} = 2.0\text{V}$ $V_{DD} = 3.0\text{V}$ $V_{DD} = 5.0\text{V}$ $V_{DD} = 4.2\text{V}$ $V_{DD} = 5.0\text{V}$	FOSC = 1 MHz (PRI_IDLE 模式, EC 振荡器)
		65	120	μA	$+25^{\circ}\text{C}$		
		70	115	μA	$+85^{\circ}\text{C}$		
PIC18LFX423/X523		120	270	μA	-40°C		
		120	250	μA	$+25^{\circ}\text{C}$		
		130	240	μA	$+85^{\circ}\text{C}$		
所有器件		300	480	μA	-40°C		
		240	450	μA	$+25^{\circ}\text{C}$		
		300	430	μA	$+85^{\circ}\text{C}$		
PIC18LFX423/X523		260	475	μA	-40°C	$V_{DD} = 2.0\text{V}$ $V_{DD} = 3.0\text{V}$ $V_{DD} = 5.0\text{V}$	FOSC = 4 MHz (PRI_IDLE 模式, EC 振荡器)
		255	450	μA	$+25^{\circ}\text{C}$		
		270	430	μA	$+85^{\circ}\text{C}$		
PIC18LFX423/X523		420	900	μA	-40°C		
		430	850	μA	$+25^{\circ}\text{C}$		
		450	810	μA	$+85^{\circ}\text{C}$		
所有器件		0.9	1.5	mA	-40°C		
		0.9	1.4	mA	$+25^{\circ}\text{C}$		
		0.9	1.3	mA	$+85^{\circ}\text{C}$		
所有器件		6.0	9.5	mA	-40°C	$V_{DD} = 4.2\text{V}$ $V_{DD} = 5.0\text{V}$	FOSC = 40 MHz (PRI_IDLE 模式, EC 振荡器)
		6.2	9.0	mA	$+25^{\circ}\text{C}$		
		6.6	8.6	mA	$+85^{\circ}\text{C}$		
所有器件		8.1	12.6	mA	-40°C		
		9.1	12.0	mA	$+25^{\circ}\text{C}$		
		8.3	11.4	mA	$+85^{\circ}\text{C}$		

图注: 阴影行是为了增强表的可读性。

- 注 1: 在休眠模式下, 掉电电流与振荡器类型无关。掉电电流是在器件处于休眠模式、所有 I/O 引脚处于高阻态并且连接到 VDD 或 VSS, 禁止所有会带来新增电流的功能部件 (如 WDT、Timer1 振荡器、BOR 等) 时测得的。
- 2: 供电电流主要受工作电压、频率和模式的影响。其他因素, 如 I/O 引脚负载和开关速率、振荡器类型和电路、内部代码执行模式和温度也会对电流消耗产生影响。
正常工作模式下, 所有 IDD 测量值的测试条件为:
OSC1 = 外部方波, 轨到轨满幅; 所有 I/O 引脚均为三态, 上拉至 VDD;
MCLR = VDD; 根据具体应用使能 / 禁止 WDT。
- 3: 对于 RC 振荡器配置, 该电流不包括流经 REXT 的电流。流经该电阻的电流可以由公式 $I_r = V_{DD}/2R_{EXT}$ (mA) 来估算, 其中 REXT 的单位是 k Ω 。
- 4: 标准低成本 32 kHz 晶振的工作温度范围为 -10°C 至 $+70^{\circ}\text{C}$ 。扩展级温度晶振的成本则高很多。
- 5: BOR 和 HLVD 使能内部带隙参考源。当同时使能两个模块时, 电流消耗将小于两个规范值的和。

PIC18F2423/2523/4423/4523

26.2 直流特性:

掉电和供电电流

PIC18F2423/2523/4423/4523 (工业级)

PIC18LF2423/2523/4423/4523 (工业级) (续)

PIC18LFX423/X523 (工业级)		标准工作条件 (除非另外声明) 工作温度 $-40^{\circ}\text{C} \leq T_A \leq +85^{\circ}\text{C}$ (工业级)						
PIC18FX423/X523 (工业级)		标准工作条件 (除非另外声明) 工作温度 $-40^{\circ}\text{C} \leq T_A \leq +85^{\circ}\text{C}$ (工业级)						
参数 编号	器件	典型值	最大值	单位	条件			
供电电流 (IDD) (2,3)								
PIC18LFX423/X523		14	31.5	μA	-10°C	V _{DD} = 2.0V FOSC = 32 kHz ⁽⁴⁾ (SEC_RUN 模式, Timer1 作为时钟源)		
		15	30	μA	$+25^{\circ}\text{C}$			
		16	29	μA	$+70^{\circ}\text{C}$			
PIC18LFX423/X523		40	74	μA	-10°C		V _{DD} = 3.0V FOSC = 32 kHz ⁽⁴⁾ (SEC_IDLE 模式, Timer1 作为时钟源)	
		35	70	μA	$+25^{\circ}\text{C}$			
		31	67	μA	$+70^{\circ}\text{C}$			
所有器件		99	126	μA	-10°C			V _{DD} = 5.0V
		81	120	μA	$+25^{\circ}\text{C}$			
		75	114	μA	$+70^{\circ}\text{C}$			
PIC18LFX423/X523		2.5	7.4	μA	-10°C	V _{DD} = 2.0V FOSC = 32 kHz ⁽⁴⁾ (SEC_IDLE 模式, Timer1 作为时钟源)		
		3.7	7.0	μA	$+25^{\circ}\text{C}$			
		4.5	6.7	μA	$+70^{\circ}\text{C}$			
PIC18LFX423/X523		5.0	10.5	μA	-10°C		V _{DD} = 3.0V	
		5.4	10	μA	$+25^{\circ}\text{C}$			
		6.3	9.5	μA	$+70^{\circ}\text{C}$			
所有器件		8.5	17	μA	-10°C			V _{DD} = 5.0V
		9.0	16	μA	$+25^{\circ}\text{C}$			
		10.5	15	μA	$+70^{\circ}\text{C}$			

图注: 阴影行是为了增强表的可读性。

- 注 1:** 在休眠模式下, 掉电电流与振荡器类型无关。掉电电流是在器件处于休眠模式、所有 I/O 引脚处于高阻态并且连接到 V_{DD} 或 V_{SS}, 禁止所有会带来新增电流的功能部件 (如 WDT、Timer1 振荡器、BOR 等) 时测得的。
- 2:** 供电电流主要受工作电压、频率和模式的影响。其他因素, 如 I/O 引脚负载和开关速率、振荡器类型和电路、内部代码执行模式和温度也会对电流消耗产生影响。
正常工作模式下, 所有 I_{DD} 测量值的测试条件为:
OSC1 = 外部方波, 轨到轨满幅; 所有 I/O 引脚均为三态, 上拉至 V_{DD} ;
MCLR = V_{DD} ; 根据具体应用使能 / 禁止 WDT。
- 3:** 对于 RC 振荡器配置, 该电流不包括流经 R_{EXT} 的电流。流经该电阻的电流可以由公式 $I_r = V_{DD}/2R_{EXT}$ (mA) 来估算, 其中 R_{EXT} 的单位是 k Ω 。
- 4:** 标准低成本 32 kHz 晶振的工作温度范围为 -10°C 至 $+70^{\circ}\text{C}$ 。扩展级温度晶振的成本则高很多。
- 5:** BOR 和 HLVD 使能内部带隙参考源。当同时使能两个模块时, 电流消耗将小于两个规范值的和。

PIC18F2423/2523/4423/4523

26.2 直流特性:

掉电和供电电流

PIC18F2423/2523/4423/4523 (工业级)

PIC18LF2423/2523/4423/4523 (工业级) (续)

PIC18LFX423/X523 (工业级)		标准工作条件 (除非另外声明) 工作温度 $-40^{\circ}\text{C} \leq T_A \leq +85^{\circ}\text{C}$ (工业级)							
PIC18FX423/X523 (工业级)		标准工作条件 (除非另外声明) 工作温度 $-40^{\circ}\text{C} \leq T_A \leq +85^{\circ}\text{C}$ (工业级)							
参数编号	器件	典型值	最大值	单位	条件				
D022 (ΔIWDT)	看门狗定时器	模块电流差 (ΔIWDT 、 ΔIBOR 、 ΔILVD 、 ΔIOSCB 和 ΔIAD)							
		1.3	7.6	μA	-40°C	$V_{\text{DD}} = 2.0\text{V}$			
		1.4	8.0	μA	$+25^{\circ}\text{C}$				
		2.0	8.4	μA	$+85^{\circ}\text{C}$				
				1.9	11.4	μA	-40°C	$V_{\text{DD}} = 3.0\text{V}$	
				2.0	12.0	μA	$+25^{\circ}\text{C}$		
				2.8	12.6	μA	$+85^{\circ}\text{C}$	$V_{\text{DD}} = 5.0\text{V}$	
				4.0	14.3	μA	-40°C		
D022A (ΔIBOR)	欠压复位 ⁽⁵⁾	35	52	μA	-40°C 至 $+85^{\circ}\text{C}$	$V_{\text{DD}} = 3.0\text{V}$			
		40	63	μA	-40°C 至 $+85^{\circ}\text{C}$	$V_{\text{DD}} = 5.0\text{V}$			
D022B (ΔILVD)	高 / 低压检测 ⁽⁵⁾	22	47	μA	-40°C 至 $+85^{\circ}\text{C}$	$V_{\text{DD}} = 2.0\text{V}$			
		25	58	μA	-40°C 至 $+85^{\circ}\text{C}$	$V_{\text{DD}} = 3.0\text{V}$			
		29	69	μA	-40°C 至 $+85^{\circ}\text{C}$	$V_{\text{DD}} = 5.0\text{V}$			
D025 (ΔIOSCB)	Timer1 振荡器	2.1	4.5	μA	-40°C	$V_{\text{DD}} = 2.0\text{V}$	Timer1 ⁽⁴⁾ 为 32 kHz		
		1.8	4.5	μA	$+25^{\circ}\text{C}$				
		2.1	4.5	μA	$+85^{\circ}\text{C}$				
				2.2	6.0	μA	-40°C	$V_{\text{DD}} = 3.0\text{V}$	Timer1 ⁽⁴⁾ 为 32 kHz
				2.6	6.0	μA	$+25^{\circ}\text{C}$		
				2.9	6.0	μA	$+85^{\circ}\text{C}$	$V_{\text{DD}} = 5.0\text{V}$	Timer1 ⁽⁴⁾ 为 32 kHz
				3.0	8.0	μA	-40°C		
D026 (ΔIAD)	A/D 转换器	1.0	2.0	μA	-40°C 至 $+85^{\circ}\text{C}$	$V_{\text{DD}} = 2.0\text{V}$	A/D 启动, 但不进行转换		
		1.0	2.0	μA	-40°C 至 $+85^{\circ}\text{C}$	$V_{\text{DD}} = 3.0\text{V}$			
		1.0	2.0	μA	-40°C 至 $+85^{\circ}\text{C}$	$V_{\text{DD}} = 5.0\text{V}$			

图注: 阴影行是为了增强表的可读性。

- 注 1: 在休眠模式下, 掉电电流与振荡器类型无关。掉电电流是在器件处于休眠模式、所有 I/O 引脚处于高阻态并且连接到 V_{DD} 或 V_{SS} , 禁止所有会带来新增电流的功能部件 (如 WDT、Timer1 振荡器、BOR 等) 时测得的。
- 2: 供电电流主要受工作电压、频率和模式的影响。其他因素, 如 I/O 引脚负载和开关速率、振荡器类型和电路、内部代码执行模式和温度也会对电流消耗产生影响。
正常工作模式下, 所有 I_{DD} 测量值的测试条件为:
OSC1 = 外部方波, 轨到轨满幅; 所有 I/O 引脚均为三态, 上拉至 V_{DD} ;
MCLR = V_{DD} ; 根据具体应用使能 / 禁止 WDT。
- 3: 对于 RC 振荡器配置, 该电流不包括流经 R_{EXT} 的电流。流经该电阻的电流可以由公式 $I_r = V_{\text{DD}}/2R_{\text{EXT}}$ (mA) 来估算, 其中 R_{EXT} 的单位是 $\text{k}\Omega$ 。
- 4: 标准低成本 32 kHz 晶振的工作温度范围为 -10°C 至 $+70^{\circ}\text{C}$ 。扩展级温度晶振的成本则高很多。
- 5: BOR 和 HLVD 使能内部带隙参考源。当同时使能两个模块时, 电流消耗将小于两个规范值的和。

PIC18F2423/2523/4423/4523

26.3 直流特性:

PIC18F2423/2523/4423/4523 (工业级)
PIC18LF2423/2523/4423/4523 (工业级)

直流特性			标准工作条件 (除非另外声明) 工作温度 $-40^{\circ}\text{C} \leq T_A \leq +85^{\circ}\text{C}$ (工业级)			
参数编号	符号	特性	最小值	最大值	单位	条件
D030 D030A D031 D032 D033 D033A D033B D034	V _{IL}	输入低电压 I/O 端口: 带 TTL 缓冲器 带施密特触发缓冲器 RC3 和 RC4 MCLR OSC1 OSC1 OSC1 T13CKI	V _{SS} — V _{SS} V _{SS} V _{SS} V _{SS} V _{SS} V _{SS} V _{SS}	0.15 V _{DD} 0.8 0.2 V _{DD} 0.3 V _{DD} 0.2 V _{DD} 0.3 V _{DD} 0.2 V _{DD} 0.3 0.3	V V V V V V V V V	V _{DD} < 4.5V 4.5V ≤ V _{DD} ≤ 5.5V HS 和 HSPLL 模式 RC 和 EC 模式 ⁽¹⁾ XT 和 LP 模式
D040 D040A D041 D042 D043 D043A D043B D043C D044	V _{IH}	输入高电压 I/O 端口: 带 TTL 缓冲器 带施密特触发缓冲器 RC3 和 RC4 MCLR OSC1 OSC1 OSC1 OSC1 T13CKI	0.25 V _{DD} + 0.8V 2.0 0.8 V _{DD} 0.7 V _{DD} 0.8 V _{DD} 0.7 V _{DD} 0.8 V _{DD} 0.9 V _{DD} 1.6 1.6	V _{DD} V _{DD} V _{DD} V _{DD} V _{DD} V _{DD} V _{DD} V _{DD} V _{DD} V _{DD}	V V V V V V V V V V	V _{DD} < 4.5V 4.5V ≤ V _{DD} ≤ 5.5V HS 和 HSPLL 模式 EC 模式 RC 模式 ⁽¹⁾ XT 和 LP 模式
D060 D061 D063	I _{IL}	输入泄漏电流 ^(2,3) I/O 端口 MCLR OSC1	— — —	±1 ±5 ±5	μA μA μA	V _{SS} ≤ V _{PIN} ≤ V _{DD} , 引脚处于高阻态 V _{SS} ≤ V _{PIN} ≤ V _{DD} V _{SS} ≤ V _{PIN} ≤ V _{DD}
D070	I _{PU} I _{PURB}	弱上拉电流 PORTB 弱上拉电流	50	400	μA	V _{DD} = 5V, V _{PIN} = V _{SS}

- 注 1: 在 RC 振荡器配置中, OSC1/CLKI 引脚被配置为施密特触发器输入。在 RC 模式下, 建议不要使用外部时钟驱动 PIC[®] 器件。
- 2: MCLR 引脚上的泄漏电流主要取决于所施加电压。规定电压为正常工作条件下的电压。在不同的输入电压下可测得更高的泄漏电流。
- 3: 负电流定义为引脚的拉电流。
- 4: 参数为特性值, 未经测试。

PIC18F2423/2523/4423/4523

26.3 直流特性: PIC18F2423/2523/4423/4523 (工业级) PIC18LF2423/2523/4423/4523 (工业级) (续)

直流特性			标准工作条件 (除非另外声明) 工作温度 $-40^{\circ}\text{C} \leq T_A \leq +85^{\circ}\text{C}$ (工业级)			
参数编号	符号	特性	最小值	最大值	单位	条件
D080	VOL	输出低电压 I/O 端口	—	0.6	V	$I_{OL} = 8.5 \text{ mA}$, $V_{DD} = 4.5\text{V}$, -40°C 至 $+85^{\circ}\text{C}$
D083		OSC2/CLKO (RC、RCIO、EC 和 ECIO 模式)	—	0.6	V	$I_{OL} = 1.6 \text{ mA}$, $V_{DD} = 4.5\text{V}$, -40°C 至 $+85^{\circ}\text{C}$
D090	VOH	输出高电压 ⁽³⁾ I/O 端口	$V_{DD} - 0.7$	—	V	$I_{OH} = -3.0 \text{ mA}$, $V_{DD} = 4.5\text{V}$, -40°C 至 $+85^{\circ}\text{C}$
D092		OSC2/CLKO (RC、RCIO、EC 和 ECIO 模式)	$V_{DD} - 0.7$	—	V	$I_{OH} = -1.3 \text{ mA}$, $V_{DD} = 4.5\text{V}$, -40°C 至 $+85^{\circ}\text{C}$
D100 ⁽⁴⁾	Cosc2	输出引脚上的容性负载规范 OSC2 引脚	—	15	pF	当外部时钟用于驱动 OSC1 时处于 XT、HS 和 LP 模式下
D101	CIO	所有 I/O 引脚和 OSC2 (在 RC 模式下)	—	50	pF	满足交流时序规范
D102	CB	SCL 和 SDA	—	400	pF	I ² C™ 规范

- 注 1: 在 RC 振荡器配置中, OSC1/CLKI 引脚被配置为施密特触发器输入。在 RC 模式下, 建议不要使用外部时钟驱动 PIC[®] 器件。
- 2: MCLR 引脚上的泄漏电流主要取决于所施加电压。规定电压为正常工作条件下的电压。在不同的输入电压下可测得更高的泄漏电流。
- 3: 负电流定义为引脚的拉电流。
- 4: 参数为特性值, 未经测试。

PIC18F2423/2523/4423/4523

表 26-1: 存储器编程要求

直流特性			标准工作条件（除非另外声明） 工作温度 $-40^{\circ}\text{C} \leq T_A \leq +85^{\circ}\text{C}$ （工业级）				
参数编号	符号	特性	最小值	典型值 †	最大值	单位	条件
D110	VPP	内部程序存储器编程规范⁽¹⁾ MCLR/VPP/RE3 引脚上的电压	VDD + 4.0V	—	12.5	V	(注 3)
D113	IDDP	编程期间的供电电流	—	—	10	mA	
数据 EEPROM 存储器							
D120	ED	字节耐擦写能力	100K	1M	—	E/W	-40°C 至 +85°C 用 EECON 来读 / 写 VMIN = 最小工作电压
D121	VDRW	用于读 / 写的 VDD	VMIN	—	5.5	V	
D122	TDEW	擦除 / 写周期时间	—	4	—	ms	
D123	TRETD	特性保持时间	40	—	—	年	
D124	TREF	刷新前的总擦除 / 写次数 ⁽²⁾	1M	10M	—	E/W	
D124	TREF	刷新前的总擦除 / 写次数 ⁽²⁾	1M	10M	—	E/W	
程序闪存							
D130	EP	单元耐擦写能力	10K	100K	—	E/W	-40°C 至 +85°C VMIN = 最小工作电压 使用 ICSP™ 端口 使用 ICSP 端口 VMIN = 最小工作电压 VDD > 4.5V VDD > 4.5V 假设没有违反其他规范
D131	VPR	用于读取的 VDD	VMIN	—	5.5	V	
D132	VIE	用于块擦除的 VDD	3.0	—	5.5	V	
D132A	VIW	用于外部定时擦除或写的 VDD	2.0	—	5.5	V	
D132B	VPEW	自定时写的 VDD	VMIN	—	5.5	V	
D133	TIE	ICSP 块擦除周期时间	—	4	—	ms	
D133A	TiW	ICSP 擦除或写周期时间 (外部定时)	1	—	—	ms	
D133A	TiW	自定时写周期时间	—	2	—	ms	
D134	TRETD	特性保持时间	40	100	—	年	

† 除非另外声明，否则“典型值”栏中的数据均为 5.0V 和 25°C 条件下的值。这些参数仅供设计参考，未经测试。

- 注 1: 这些规范用于通过使用表写指令对片上程序存储器进行编程。
 2: 关于数据 EEPROM 耐擦写能力的详细讨论，请参见第 7.8 节“使用数据 EEPROM”。
 3: 仅当禁止单电源编程时才需要。

PIC18F2423/2523/4423/4523

表 26-2: 比较器规范

工作条件: $3.0V < V_{DD} < 5.5V$, $-40^{\circ}C < T_A < +85^{\circ}C$ (除非另外声明)。							
参数编号	符号	特性	最小值	典型值	最大值	单位	备注
D300	VIOFF	输入失调电压	—	± 5.0	± 10	mV	
D301	VICM	输入共模电压 *	0	—	$V_{DD} - 1.5$	V	
D302	CMRR	共模抑制比 *	55	—	—	dB	
300	TRESP	响应时间 (1)*	—	150	400	ns	PIC18FXXXX
300A			—	150	600	ns	PIC18LFXXXX, $V_{DD} = 2.0V$
301	TMC2OV	比较器模式变为输出有效的时间 *	—	—	10	μs	

* 这些参数为特性值, 未经测试。

注 1: 响应时间是在比较器的一个输入端电压为 $(V_{DD} - 1.5)/2$, 而另一个输入端从 V_{SS} 跳变到 V_{DD} 时测得的。

表 26-3: 参考电压规范

工作条件: $3.0V < V_{DD} < 5.5V$, $-40^{\circ}C < T_A < +85^{\circ}C$ (除非另外声明)。							
参数编号	符号	特性	最小值	典型值	最大值	单位	备注
D310	VRES	分辨率	$V_{DD}/24$	—	$V_{DD}/32$	LSb	
D311	VRAA	绝对精度	—	—	1/2	LSb	低电平范围 ($CVRR = 1$)
D312	VRUR	单位电阻值 (R) *	—	2k	—	Ω	
310	TSET	稳定时间 (1)*	—	—	10	μs	

* 这些参数为特性值, 未经测试。

注 1: 稳定时间是在 $CVRR = 1$ 并且 $CVR3:CVR0$ 从 0000 跳变到 1111 时测得的。

图 26-3: 高 / 低压检测特性

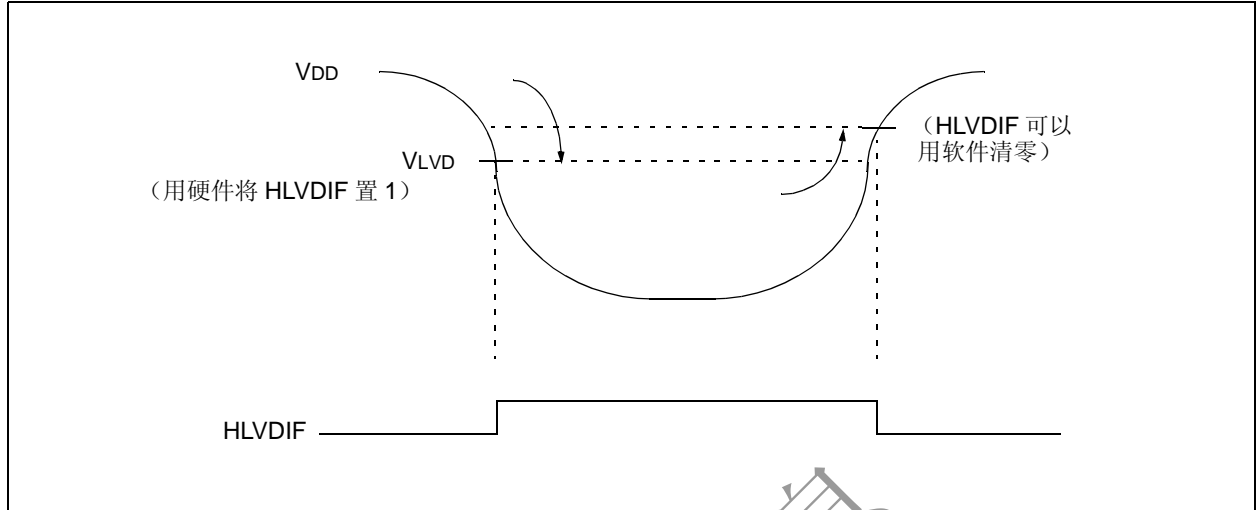


表 26-4: 高 / 低压检测特性

标准工作条件（除非另外声明）
工作温度 $-40^{\circ}\text{C} \leq T_A \leq +85^{\circ}\text{C}$ （工业级）

参数编号	符号	特性	最小值	典型值†	最大值	单位	条件	
D420		VDD 由高转变为低时的 HLVD 电压	HLVDL<3:0> = 0000	2.12	2.17	2.22	V	
			HLVDL<3:0> = 0001	2.18	2.23	2.28	V	
			HLVDL<3:0> = 0010	2.31	2.36	2.42	V	
			HLVDL<3:0> = 0011	2.38	2.44	2.49	V	
			HLVDL<3:0> = 0100	2.54	2.60	2.66	V	
			HLVDL<3:0> = 0101	2.72	2.79	2.85	V	
			HLVDL<3:0> = 0110	2.82	2.89	2.95	V	
			HLVDL<3:0> = 0111	3.05	3.12	3.19	V	
			HLVDL<3:0> = 1000	3.31	3.39	3.47	V	
			HLVDL<3:0> = 1001	3.46	3.55	3.63	V	
			HLVDL<3:0> = 1010	3.63	3.71	3.80	V	
			HLVDL<3:0> = 1011	3.81	3.90	3.99	V	
			HLVDL<3:0> = 1100	4.01	4.11	4.20	V	
			HLVDL<3:0> = 1101	4.23	4.33	4.43	V	
HLVDL<3:0> = 1110	4.48	4.59	4.69	V				

† $T_{\text{AMB}} = 25^{\circ}\text{C}$ 时进行的生产测试。超过温度限制的规范由器件特性保证。

PIC18F2423/2523/4423/4523

26.4 交流（时序）特性

26.4.1 时序参数符号体系

时序参数符号采用以下格式之一进行创建：

- | | | |
|-------------|-----------|---------------------------|
| 1. TppS2ppS | 3. TCC:ST | （仅用于 I ² C 规范） |
| 2. TppS | 4. Ts | （仅用于 I ² C 规范） |

T			
F	频率	T	时间

小写字母（pp）及其含义：

pp			
cc	CCP1	osc	OSC1
ck	CLKO	rd	\overline{RD}
cs	\overline{CS}	rw	\overline{RD} 或 \overline{WR}
di	SDI	sc	SCK
do	SDO	ss	\overline{SS}
dt	数据输入	t0	T0CKI
io	I/O 端口	t1	T13CKI
mc	MCLR	wr	\overline{WR}

大写字母及其含义：

S			
F	下降	P	周期
H	高	R	上升
I	无效（高阻）	V	有效
L	低	Z	高阻
仅用于 I ² C		High	高
AA	输出访问	Low	低
BUF	总线空闲		

TCC:ST（仅用于 I²C 规范）

CC			
HD	保持	SU	建立
ST		STO	停止条件
DAT	数据输入保持		
STA	启动条件		

PIC18F2423/2523/4423/4523

26.4.2 时序条件

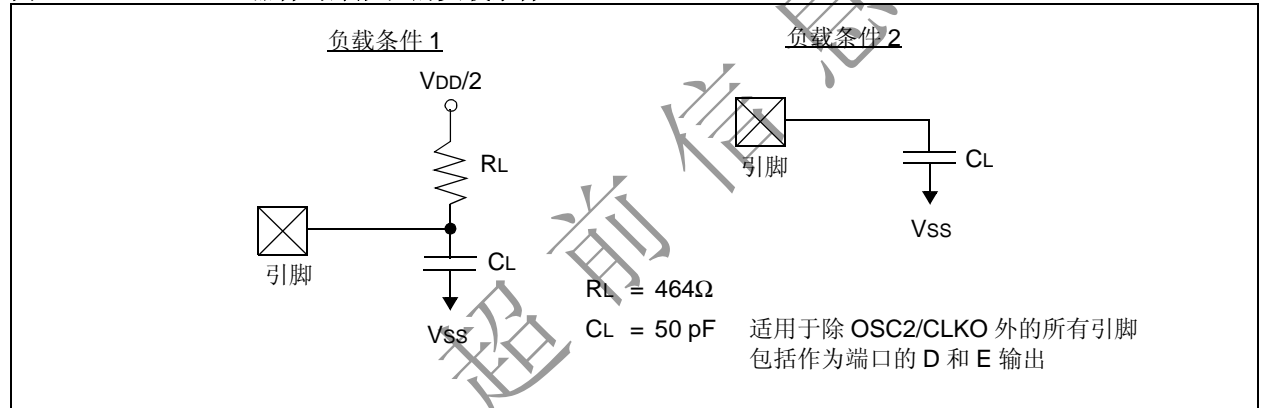
表 26-5 中指定的温度和电压适用于所有的时序规范（除非另外声明）。图 26-4 规定了时序规范的负载条件。

注： 由于篇幅所限，本节中通称的“PIC18FXXXX”和“PIC18LFXXXX”特指（而且仅指代）PIC18F2423/2523/4423/4523 和 PIC18LF2423/2523/4423/4523 系列器件。

表 26-5: 温度和电压规范——交流

交流特性	标准工作条件（除非另外声明）
	工作温度 $-40^{\circ}\text{C} \leq T_A \leq +85^{\circ}\text{C}$ （工业级） 直流规范第 26.1 节和第 26.3 节描述了工作电压 V_{DD} 的范围。 LF 器件仅在工业级温度下工作。

图 26-4: 器件时序规范的负载条件



PIC18F2423/2523/4423/4523

26.4.3 时序图和规范

图 26-5: 外部时钟时序 (除 PLL 外的所有模式)

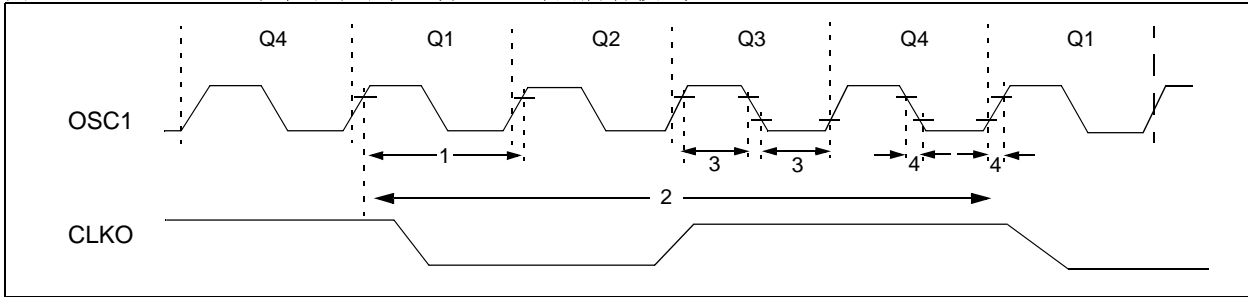


表 26-6: 外部时钟时序要求

参数编号	符号	特性	最小值	最大值	单位	条件	
1A	FCLKI	频率	CLKI 外部时钟	DC	40	MHz	EC 和 ECIO 振荡器模式
			DC	1	MHz	XT 振荡器模式	
			DC	25	MHz	HS 振荡器模式	
			4	10	MHz	HS + PLL 振荡器模式	
			DC	33	kHz	LP 振荡器模式	
1B	FOSC	振荡器	DC	4	MHz	RC 振荡器模式	
			4	10	MHz	HS + PLL 振荡器模式	
			5	33	kHz	LP 振荡器模式	
1C	TCLKI	周期	CLKI 外部时钟	25	—	ns	EC 和 ECIO 振荡器模式
			1000	—	ns	XT 振荡器模式	
			40	—	ns	HS 振荡器模式	
			100	250	ns	HS + PLL 振荡器模式	
			30	—	μs	LP 振荡器模式	
1D	Tosc	振荡器	250	—	ns	RC 振荡器模式	
			100	250	ns	HS + PLL 振荡器模式	
			30	—	ms	LP 振荡器模式	
2	Tcy	指令周期时间 ⁽¹⁾	100	—	ns	Tcy = 4/FOSC	
3	TosL, TosH	外部时钟输入 (OSC1) 的高电平或低电平时间	30	—	ns	XT 振荡器模式	
			2.5	—	μs	LP 振荡器模式	
			10	—	ns	HS 振荡器模式	
4	TosR, TosF	外部时钟输入 (OSC1) 的上升或下降时间	—	20	ns	XT 振荡器模式	
			—	50	ns	LP 振荡器模式	
			—	7.5	ns	HS 振荡器模式	

注 1: 对于除 PLL 外的所有配置, 指令周期时间 (Tcy) 等于输入振荡器时基周期的四倍。所有规定值均为基于针对特定振荡器类型, 器件在标准工作条件下执行代码时的特性数据。超出这些规定的极限值可能导致振荡器运行不稳定和 / 或电流消耗超出预期值。所有器件在测试“最小值”时, 都在 OSC1/CLKI 引脚连接了外部时钟。当使用了外部时钟输入时, 所有器件的“最大”周期时间限制为“DC”(无时钟)。

PIC18F2423/2523/4423/4523

表 26-7: PLL 时钟时序规范 (VDD = 4.2V 至 5.5V)

参数编号	符号	特性	最小值	典型值†	最大值	单位	条件
F10	FOSC	振荡器频率范围	4	—	10	MHz	仅 HS 模式
F11	FSYS	片上 VCO 系统频率	16	—	40	MHz	仅 HS 模式
F12	t _{rc}	PLL 起振时间 (锁定时间)	—	—	2	ms	
F13	ΔCLK	CLKO 稳定性 (抗抖动)	-2	—	+2	%	

† 除非另外声明, 否则“典型值”栏中的数据均为 5V 和 25°C 条件下的值。这些参数仅供设计参考, 未经测试。

表 26-8: 交流特性:

内部 RC 精度

PIC18F2423/2523/4423/4523 (工业级)

PIC18LF2423/2523/4423/4523 (工业级)

PIC18LFX423/X523 (工业级)		标准工作条件 (除非另外声明) 工作温度 -40°C ≤ Ta ≤ +85°C (工业级)					
PIC18FX423/X523 (工业级)		标准工作条件 (除非另外声明) 工作温度 -40°C ≤ Ta ≤ +85°C (工业级)					
参数编号	器件	最小值	典型值	最大值	单位	条件	
在频率为 8 MHz、4 MHz、2 MHz、1 MHz、500 kHz、250 kHz 和 125 kHz ⁽¹⁾ 时的 INTOSC 精度							
	PIC18LFX423/X523	-2	+/-1	2	%	+25°C	VDD = 2.7-3.3V
		-5	—	5	%	-10°C 至 +85°C	VDD = 2.7-3.3V
		-10	+/-1	10	%	-40°C 至 +85°C	VDD = 2.7-3.3V
	PIC18FX423/X523	-2	+/-1	2	%	+25°C	VDD = 4.5-5.5V
		-5	—	5	%	-10°C 至 +85°C	VDD = 4.5-5.5V
		-10	+/-1	10	%	-40°C 至 +85°C	VDD = 4.5-5.5V
在频率为 31 kHz ⁽²⁾ 时的 INTRC 精度							
	PIC18LFX423/X523	26.562	—	35.938	kHz	-40°C 至 +85°C	VDD = 2.7-3.3V
	PIC18FX423/X523	26.562	—	35.938	kHz	-40°C 至 +85°C	VDD = 4.5-5.5V

图注: 阴影行是为了增强表的可读性。

注 1: 频率校准温度为 25°C。OSCTUNE 寄存器可用于补偿温度漂移。

2: 校准后的 INTRC 频率。

3: INTRC 频率随 VDD 的变化而改变。

PIC18F2423/2523/4423/4523

图 26-6: CLKO 和 I/O 时序

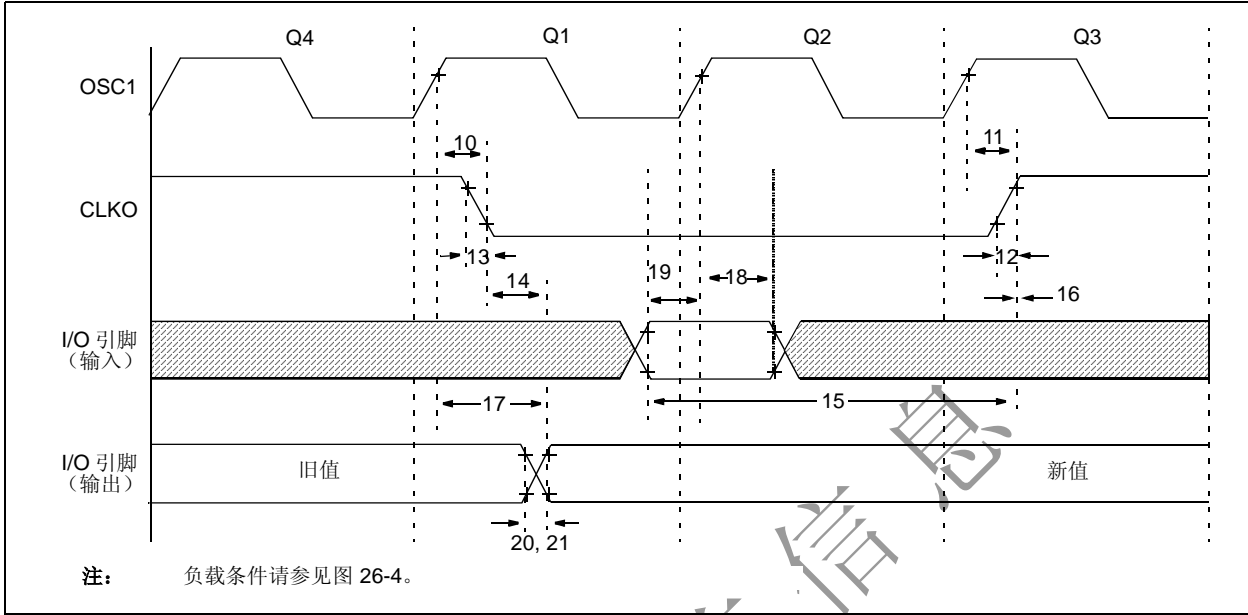


表 26-9: CLKO 和 I/O 时序要求

参数编号	符号	特性	最小值	典型值	最大值	单位	条件	
10	TosH2ckL	OSC1 ↑ 到 CLKO ↓ 的时间	—	75	200	ns	(注 1)	
11	TosH2ckH	OSC1 ↑ 到 CLKO ↑ 的时间	—	75	200	ns	(注 1)	
12	TckR	CLKO 上升时间	—	35	100	ns	(注 1)	
13	TckF	CLKO 下降时间	—	35	100	ns	(注 1)	
14	TckL2ioV	CLKO ↓ 到端口输出有效的时间	—	—	0.5 Tcy + 20	ns	(注 1)	
15	TioV2ckH	在 CLKO ↑ 之前端口输入有效的时间	0.25 Tcy + 25	—	—	ns	(注 1)	
16	TckH2ioI	在 CLKO ↑ 之后端口输入保持的时间	0	—	—	ns	(注 1)	
17	TosH2ioV	OSC1 ↑ (Q1 周期) 到端口输出有效的时间	—	50	150	ns		
18	TosH2ioI	OSC1 ↑ (Q2 周期) 到端口输入无效的时间 (I/O 输入保持时间)	PIC18FXXXX	100	—	—	ns	
18A			PIC18LFXXXX	200	—	—	ns	VDD = 2.0V
19	TioV2osH	端口输入有效到 OSC1 ↑ 的时间 (I/O 输入建立时间)	0	—	—	ns		
20	TioR	端口输出上升时间	PIC18FXXXX	—	10	25	ns	
20A			PIC18LFXXXX	—	—	60	ns	VDD = 2.0V
21	TioF	端口输出下降时间	PIC18FXXXX	—	10	25	ns	
21A			PIC18LFXXXX	—	—	60	ns	VDD = 2.0V
22†	TINP	INT 引脚高电平或低电平时间	Tcy	—	—	ns		
23†	TRBP	RB7:RB4 电平变化中断 INT 高电平或低电平时间	Tcy	—	—	ns		
24†	TRCP	RC7:RC4 电平变化中断 INT 高电平或低电平时间	20	—	—	ns		

† 这些参数是与任何内部时钟边沿无关的异步事件。

注 1: 测量是在 RC 模式下进行的, 其中 CLKO 输出为 4 x Tosc。

图 26-7: 复位、看门狗定时器、振荡器起振定时器和上电延时定时器时序

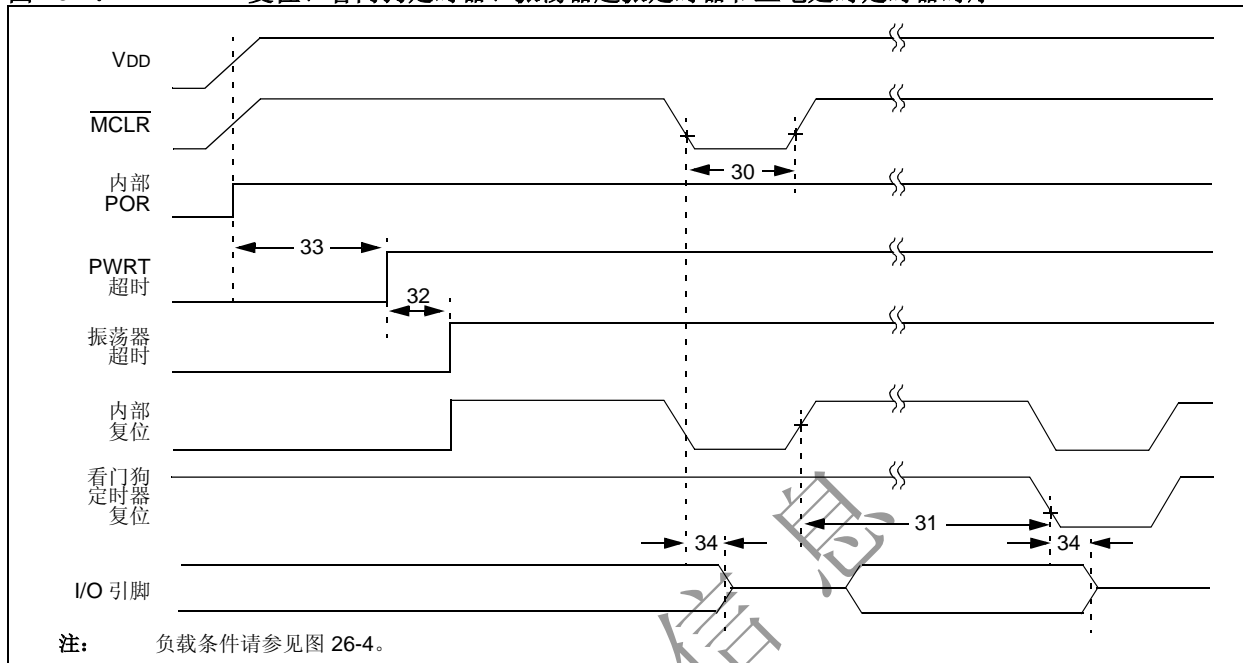


图 26-8: 欠压复位时序

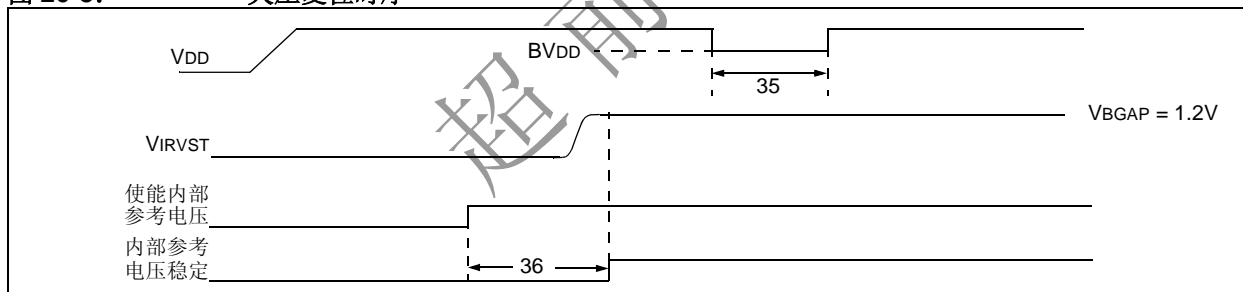


表 26-10: 复位、看门狗定时器、振荡器起振定时器、上电延时定时器和欠压复位要求

参数编号	符号	特性	最小值	典型值	最大值	单位	条件
30	TmCL	MCLR 脉冲宽度 (低电平)	2	—	—	μs	
31	TWDT	看门狗定时器超时周期 (无后分频器)	3.47	4.00	4.82	ms	128 INTRC 周期
32	TOST	振荡器起振定时器周期	1024 TOSC	—	1024 TOSC	—	TOSC = OSC1 周期
33	TPWRT	上电延时定时器周期	55.4	65.5	77.1	ms	2048 INTRC 周期
34	TIOZ	自 MCLR 低电平或看门狗定时器复位起 I/O 处于高阻态的时间	—	2	—	μs	
35	TBOR	欠压复位脉冲宽度	200	—	—	μs	VDD ≤ BVDD (见 D005)
36	TIVRST	内部参考电压稳定时间	—	20	50	μs	
37	TLVD	高/低压检测脉冲宽度	200	—	—	μs	VDD ≤ VLVD
38	TCSD	CPU 启动时间	5	—	10	μs	
39	TIOBST	INTOSC 稳定时间	55.6	64.0	75.3	μs	

PIC18F2423/2523/4423/4523

图 26-9: **TIMER0 和 TIMER1 外部时钟时序**

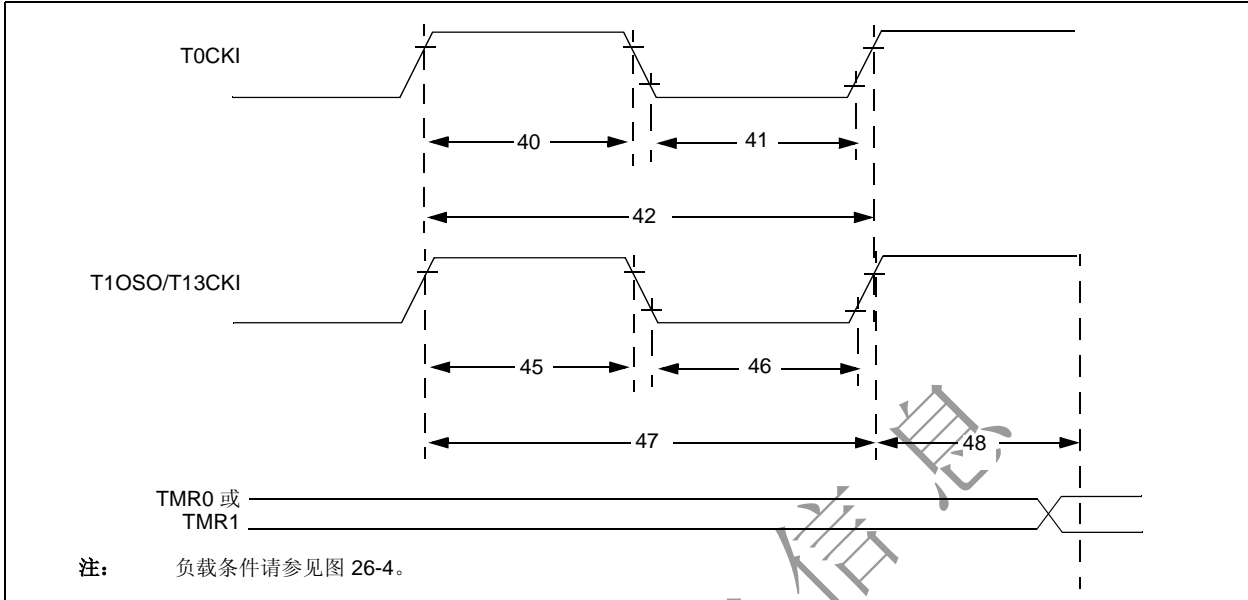


表 26-11: **TIMER0 和 TIMER1 外部时钟要求**

参数编号	符号	特性		最小值	最大值	单位	条件	
40	Tt0H	T0CKI 高电平脉冲宽度	无预分频器	$0.5 T_{CY} + 20$	—	ns		
			有预分频器	10	—	ns		
41	Tt0L	T0CKI 低电平脉冲宽度	无预分频器	$0.5 T_{CY} + 20$	—	ns		
			有预分频器	10	—	ns		
42	Tt0P	T0CKI 周期	无预分频器	$T_{CY} + 10$	—	ns		
			有预分频器	取如下二者中较大值: 20 ns 或 $(T_{CY} + 40)/N$	—	ns		N = 预分频值 (1, 2, 4, ..., 256)
45	Tt1H	T13CKI 时钟 高电平时间	同步, 无预分频器	$0.5 T_{CY} + 20$	—	ns		
			同步, 有预分频器	PIC18FXXXX	10	—		ns
				PIC18LFXXXX	25	—		ns
			异步	PIC18FXXXX	30	—		ns
PIC18LFXXXX	50	—		ns				
46	Tt1L	T13CKI 时钟 低电平时间	同步, 无预分频器	$0.5 T_{CY} + 5$	—	ns		
			同步, 有预分频器	PIC18FXXXX	10	—		ns
				PIC18LFXXXX	25	—		ns
			异步	PIC18FXXXX	30	—		ns
PIC18LFXXXX	50	—		ns				
47	Tt1P	T13CKI 时钟 输入周期	同步	取如下二者中较大值: 20 ns 或 $(T_{CY} + 40)/N$	—	ns	N = 预分频值 (1, 2, 4, 8)	
			异步	PIC18FXXXX	60	—	ns	$V_{DD} = 2.0V$
				PIC18LFXXXX	100	—	ns	
48	Tcke2tmr1	从外部 T13CKI 时钟边沿到定时器递增的延时		$2 T_{osc}$	$7 T_{osc}$	—		
49	Ft1	T13CKI 振荡器输入频率范围		DC	50	kHz		

PIC18F2423/2523/4423/4523

图 26-10: 捕捉 / 比较 / PWM 时序 (所有 CCP 模块)

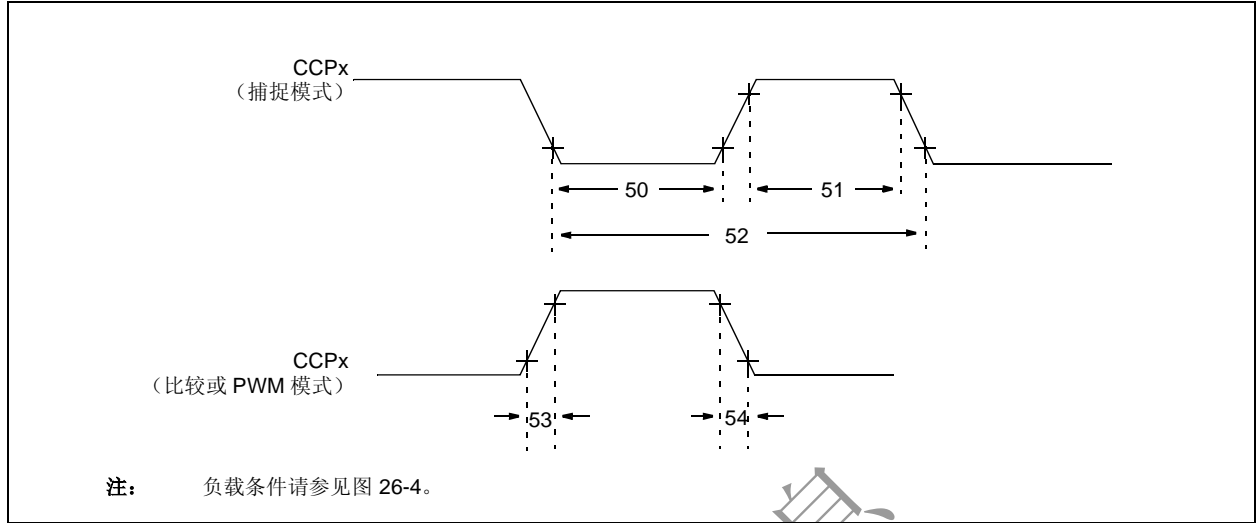


表 26-12: 捕捉 / 比较 / PWM 要求 (所有 CCP 模块)

参数编号	符号	特性		最小值	最大值	单位	条件	
50	TccL	CCPx 输入低电平时间	无预分频器	0.5 Tcy + 20	—	ns	VDD = 2.0V	
			有预分频器	PIC18FXXXX	10	—		ns
				PIC18LFXXXX	20	—		ns
51	TccH	CCPx 输入高电平时间	无预分频器	0.5 Tcy + 20	—	ns	VDD = 2.0V	
			有预分频器	PIC18FXXXX	10	—		ns
				PIC18LFXXXX	20	—		ns
52	TccP	CCPx 输入周期		$\frac{3 Tcy + 40}{N}$	—	ns	N = 预分频值 (1、4 或 16)	
53	TccR	CCPx 输出下降时间	PIC18FXXXX	—	25	ns	VDD = 2.0V	
			PIC18LFXXXX	—	45	ns		
54	TccF	CCPx 输出下降时间	PIC18FXXXX	—	25	ns	VDD = 2.0V	
			PIC18LFXXXX	—	45	ns		

PIC18F2423/2523/4423/4523

图 26-11: 并行从动端口时序 (PIC18F4423/4523)

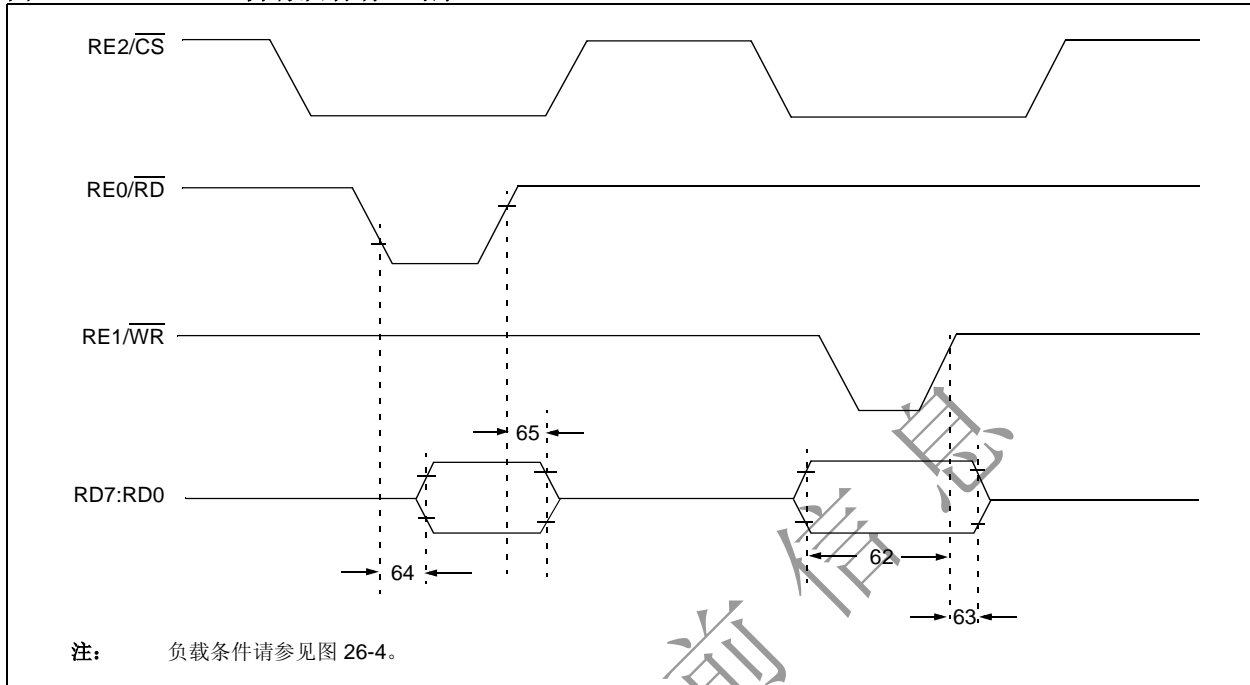


表 26-13: 并行从动端口要求 (PIC18F4423/4523)

参数编号	符号	特性	最小值	最大值	单位	条件	
62	TdtV2wrH	在 \overline{WR} ↑ 或 \overline{CS} ↑ 之前的数据输入有效时间 (建立时间)	20	—	ns		
63	TwrH2dtI	\overline{WR} ↑ 或 \overline{CS} ↑ 到数据输入无效的时间 (保持时间)	PIC18FXXXX	20	—	ns	
			PIC18LFXXXX	35	—	ns	VDD = 2.0V
64	TrdL2dtV	\overline{RD} ↓ 和 \overline{CS} ↓ 到数据输出有效的时间	—	80	ns		
65	TrdH2dtI	\overline{RD} ↑ 或 \overline{CS} ↓ 到数据输出无效的时间	10	30	ns		
66	TibfINH	禁止 IBF 标志位被 \overline{WR} ↑ 或 \overline{CS} ↑ 清零	—	3 Tcy			

图 26-12: SPI 主控模式时序示例 (CKE = 0)

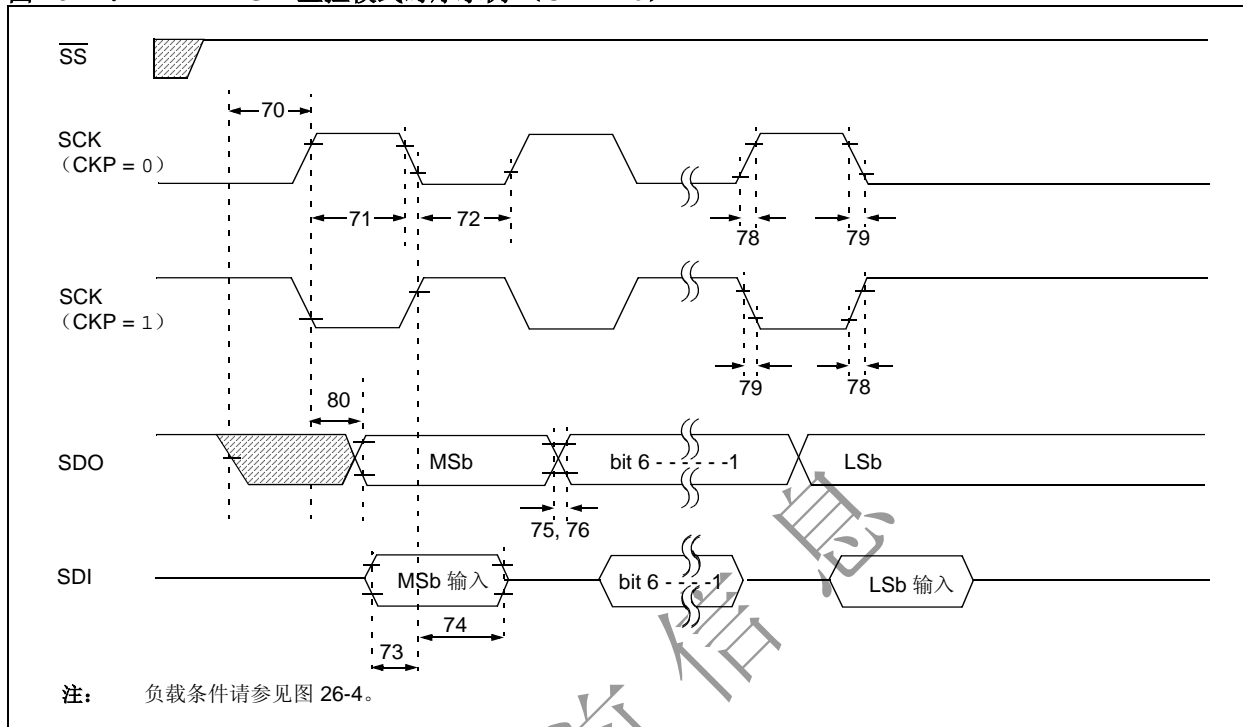


表 26-14: SPI 模式要求示例 (主控模式, CKE = 0)

参数编号	符号	特性	最小值	最大值	单位	条件
70	TssL2scH, TssL2scL	SS ↓ 到 SCK ↓ 或 SCK ↑ 输入的时间	T _{CY}	—	ns	
71	Tsch	SCK 输入高电平时间 (从动模式)	连续	1.25 T _{CY} + 30	—	ns
71A			单字节	40	—	ns
72	TscL	SCK 输入低电平时间 (从动模式)	连续	1.25 T _{CY} + 30	—	ns
72A			单字节	40	—	ns
73	TdiV2scH, TdiV2scL	SDI 数据输入到 SCK 边沿的建立时间	100	—	ns	
73A	Tb2b	字节 1 的最后一个时钟边沿到字节 2 的第一个时钟边沿之间的时间	1.5 T _{CY} + 40	—	ns	(注 2)
74	Tsch2diL, TscL2diL	SDI 数据输入到 SCK 边沿的保持时间	100	—	ns	
75	TdoR	SDO 数据输出上升时间	PIC18FXXXX	—	25	ns
			PIC18LFXXXX	—	45	ns
76	TdoF	SDO 数据输出下降时间	—	25	ns	
78	TscR	SCK 输出上升时间 (主控模式)	PIC18FXXXX	—	25	ns
			PIC18LFXXXX	—	45	ns
79	TscF	SCK 输出下降时间 (主控模式)	—	25	ns	
80	Tsch2doV, TscL2doV	在 SCK 边沿之后 SDO 数据输出有效的时间	PIC18FXXXX	—	50	ns
			PIC18LFXXXX	—	100	ns

注 1: 要求使用参数 #73A。

注 2: 仅当使用参数 #71A 和 #72A 时。

PIC18F2423/2523/4423/4523

图 26-13: SPI 主控模式时序示例 (CKE = 1)

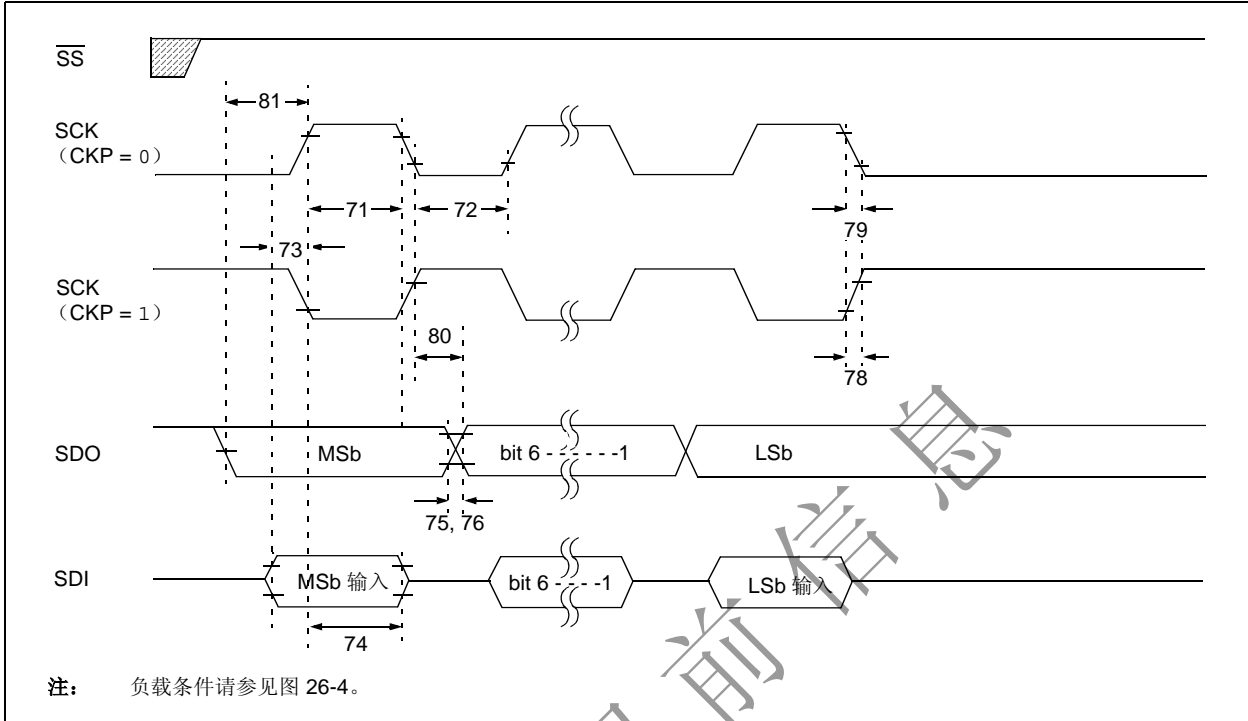


表 26-15: SPI 模式要求示例 (主控模式, CKE = 1)

参数编号	符号	特性	最小值	最大值	单位	条件
71	TscH	SCK 输入高电平时间	1.25 T _{CY} + 30	—	ns	
71A		(从动模式)	连续	—	—	
		单字节	40	—	ns	(注 1)
72	TscL	SCK 输入低电平时间	1.25 T _{CY} + 30	—	ns	
72A		(从动模式)	连续	—	—	
		单字节	40	—	ns	(注 1)
73	TdiV2scH, TdiV2scL	SDI 数据输入到 SCK 边沿的建立时间	100	—	ns	
73A	Tb2b	字节 1 的最后一个时钟边沿到字节 2 的第一个时钟边沿之间的时间	1.5 T _{CY} + 40	—	ns	(注 2)
74	TscH2diL, TscL2diL	SDI 数据输入到 SCK 边沿的保持时间	100	—	ns	
75	TdoR	SDO 数据输出上升时间	PIC18FXXXX —	25	ns	
			PIC18LFXXXX —	45	ns	V _{DD} = 2.0V
76	TdoF	SDO 数据输出下降时间	—	25	ns	
78	TscR	SCK 输出上升时间	PIC18FXXXX —	25	ns	
		(主控模式)	PIC18LFXXXX —	45	ns	V _{DD} = 2.0V
79	TscF	SCK 输出下降时间 (主控模式)	—	25	ns	
80	TscH2doV, TscL2doV	在 SCK 边沿之后 SDO 数据输出有效的的时间	PIC18FXXXX —	50	ns	
			PIC18LFXXXX —	100	ns	V _{DD} = 2.0V
81	TdoV2scH, TdoV2scL	SDO 数据输出建立到出现 SCK 边沿的时间	T _{CY}	—	ns	

注 1: 要求使用参数 #73A。

注 2: 仅当使用参数 #71A 和 #72A 时。

图 26-14: SPI 从动模式时序示例 (CKE = 0)

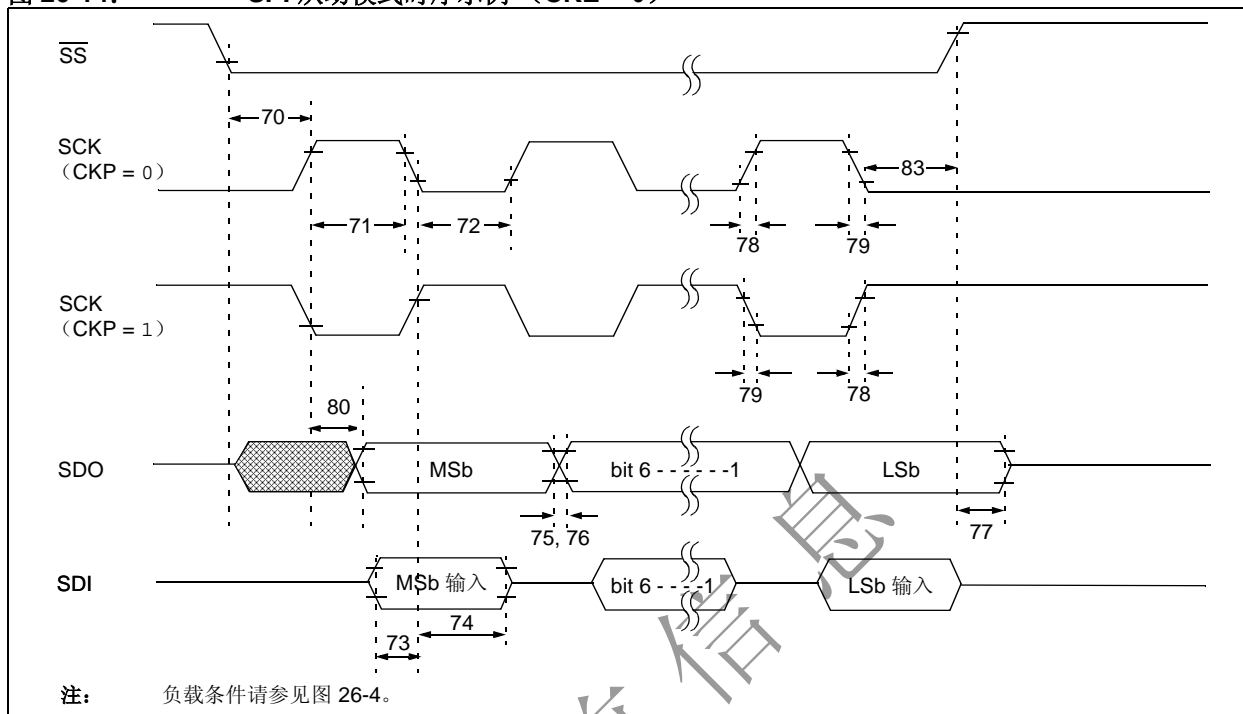


表 26-16: SPI 模式要求示例 (从动模式时序, CKE = 0)

参数编号	符号	特性	最小值	最大值	单位	条件
70	Tssl2sch, Tssl2scl	SS ↓ 到 SCK ↓ 或 SCK ↑ 输入的时间	T _{CY}	—	ns	
71	Tsch	SCK 输入高电平时间 (从动模式)	连续	1.25 T _{CY} + 30	—	ns
71A			单字节	40	—	ns (注 1)
72	TscL	SCK 输入低电平时间 (从动模式)	连续	1.25 T _{CY} + 30	—	ns
72A			单字节	40	—	ns (注 1)
73	TdiV2sch, TdiV2scl	SDI 数据输入到 SCK 边沿的建立时间	100	—	ns	
73A	Tb2b	字节 1 的最后一个时钟边沿到字节 2 的第一个时钟边沿之间的时间	1.5 T _{CY} + 40	—	ns	(注 2)
74	Tsch2diL, TscL2diL	SDI 数据输入到 SCK 边沿的保持时间	100	—	ns	
75	TdoR	SDO 数据输出上升时间	PIC18FXXXX	—	25	ns
76			PIC18LFXXXX	—	45	ns
76	TdoF	SDO 数据输出下降时间	—	25	ns	
77	TssH2doZ	SS ↑ 到 SDO 输出高阻态的时间	10	50	ns	
78	TscR	SCK 输出上升时间 (主控模式)	PIC18FXXXX	—	25	ns
79			PIC18LFXXXX	—	45	ns
79	TscF	SCK 输出下降时间 (主控模式)	—	25	ns	
80	Tsch2doV, TscL2doV	在 SCK 边沿之后 SDO 数据输出有效的 时间	PIC18FXXXX	—	50	ns
83			PIC18LFXXXX	—	100	ns
83	Tsch2ssH, TscL2ssH	在 SCK 边沿之后到出现 SS ↑ 的时间	1.5 T _{CY} + 40	—	ns	

注 1: 要求使用参数 #73A。

注 2: 仅当使用参数 #71A 和 #72A 时。

PIC18F2423/2523/4423/4523

图 26-15: SPI 从动模式时序示例 (CKE = 1)

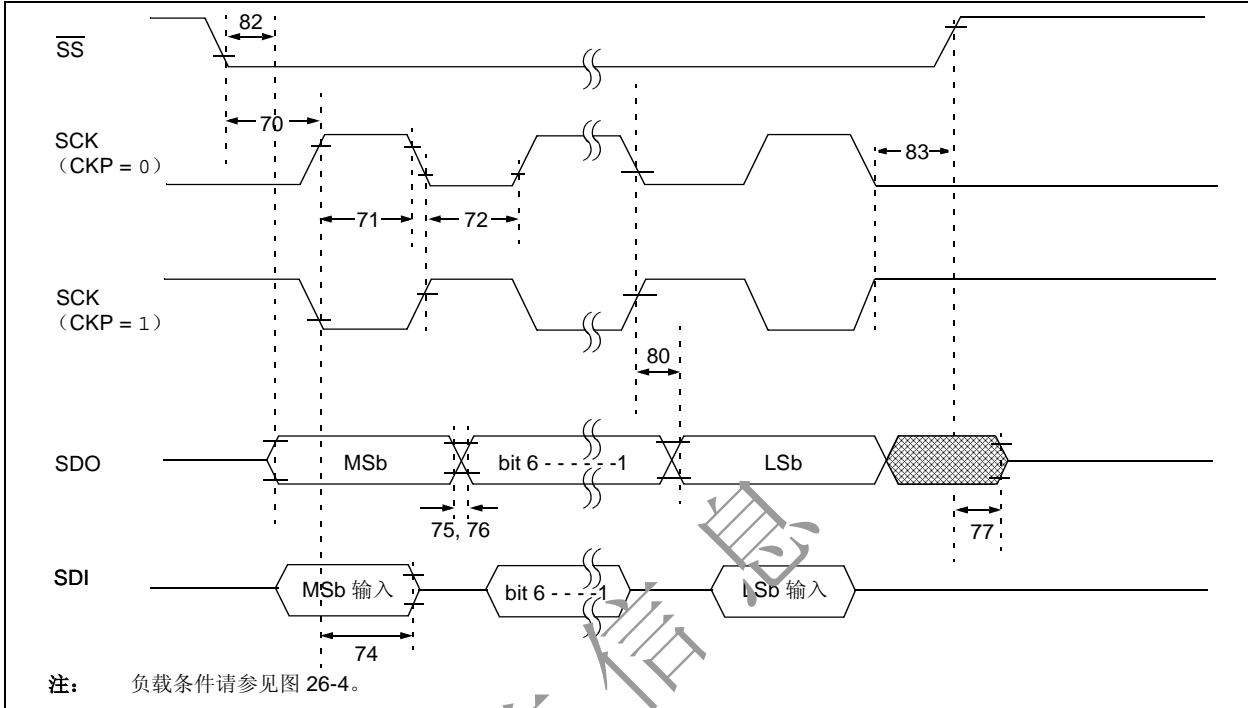


表 26-17: SPI 从动模式要求示例 (CKE = 1)

参数编号	符号	特性	最小值	最大值	单位	条件
70	$T_{ssl2sch}, T_{ssl2scl}$	\overline{SS} ↓ 到 SCK ↓ 或 SCK ↑ 输入的时间	T_{CY}	—	ns	
71	T_{schH}	SCK 输入高电平时间 (从动模式)	连续	$1.25 T_{CY} + 30$	—	ns
71A		单字节	40	—	ns	(注 1)
72	T_{schL}	SCK 输入低电平时间 (从动模式)	连续	$1.25 T_{CY} + 30$	—	ns
72A		单字节	40	—	ns	(注 1)
73A	T_{b2b}	字节 1 的最后一个时钟边沿到字节 2 的第一个时钟边沿之间的时间	$1.5 T_{CY} + 40$	—	ns	(注 2)
74	$T_{sch2dil}, T_{scl2dil}$	SDI 数据输入到 SCK 边沿的保持时间	100	—	ns	
75	T_{doR}	SDO 数据输出上升时间	PIC18FXXXX —	25	ns	
			PIC18LFXXXX —	45	ns	$V_{DD} = 2.0V$
76	T_{doF}	SDO 数据输出下降时间	—	25	ns	
77	$T_{ssH2doZ}$	\overline{SS} ↑ 到 SDO 输出高阻态的时间	10	50	ns	
78	T_{scR}	SCK 输出上升时间 (主控模式)	PIC18FXXXX —	25	ns	
			PIC18LFXXXX —	45	ns	$V_{DD} = 2.0V$
79	T_{scF}	SCK 输出下降时间 (主控模式)	—	25	ns	
80	$T_{sch2doV}, T_{scl2doV}$	在 SCK 边沿之后 SDO 数据输出有效的的时间	PIC18FXXXX —	50	ns	
			PIC18LFXXXX —	100	ns	$V_{DD} = 2.0V$
82	$T_{ssl2doV}$	在 \overline{SS} ↓ 边沿之后 SDO 数据输出有效的的时间	PIC18FXXXX —	50	ns	
			PIC18LFXXXX —	100	ns	$V_{DD} = 2.0V$
83	$T_{sch2ssh}, T_{scl2ssh}$	在 SCK 边沿之后到出现 \overline{SS} ↑ 的时间	$1.5 T_{CY} + 40$	—	ns	

注 1: 要求使用参数 #73A。

注 2: 仅当使用参数 #71A 和 #72A 时。

图 26-16: I²C™ 总线启动 / 停止位时序

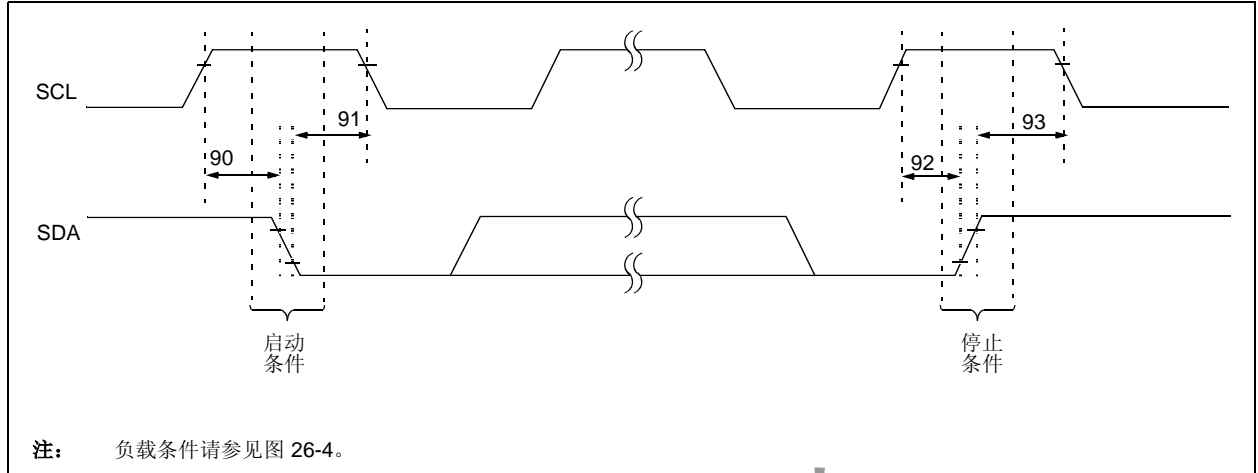
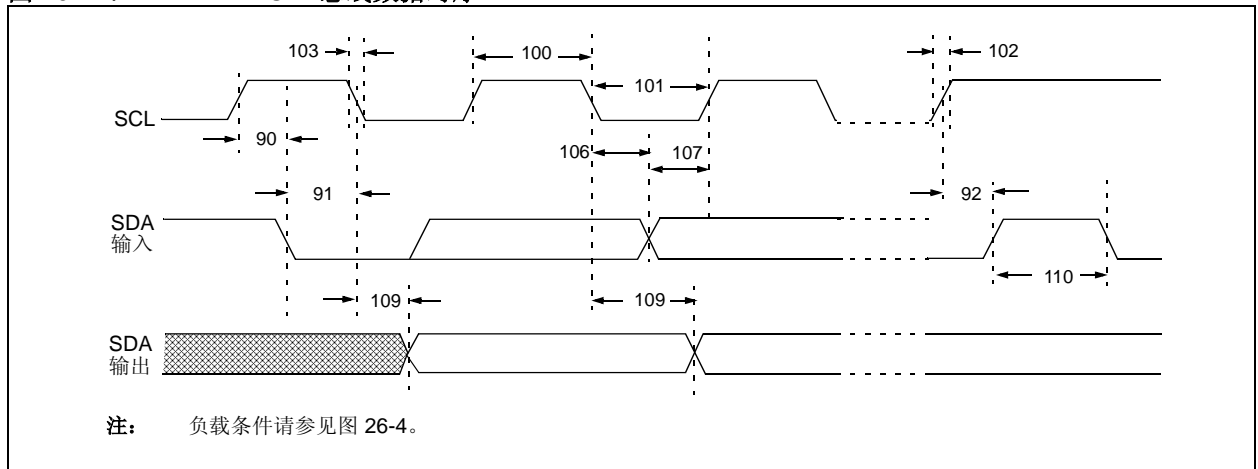


表 26-18: I²C™ 总线启动 / 停止位要求 (从动模式)

参数编号	符号	特性	最小值	最大值	单位	条件	
90	TSU:STA	启动条件建立时间	100 kHz 模式	4700	—	ns	仅与重复启动条件相关
			400 kHz 模式	600	—		
91	THD:STA	启动条件保持时间	100 kHz 模式	4000	—	ns	这个周期后产生第一个时钟脉冲
			400 kHz 模式	600	—		
92	TSU:STO	停止条件建立时间	100 kHz 模式	4700	—	ns	
			400 kHz 模式	600	—		
93	THD:STO	停止条件保持时间	100 kHz 模式	4000	—	ns	
			400 kHz 模式	600	—		

图 26-17: I²C™ 总线数据时序



PIC18F2423/2523/4423/4523

表 26-19: I²C™ 总线数据要求 (从动模式)

参数编号	符号	特性		最小值	最大值	单位	条件
100	THIGH	时钟高电平时间	100 kHz 模式	4.0	—	μs	
			400 kHz 模式	0.6	—	μs	
			MSSP 模块	1.5 T _{CY}	—		
101	TLOW	时钟低电平时间	100 kHz 模式	4.7	—	μs	
			400 kHz 模式	1.3	—	μs	
			MSSP 模块	1.5 T _{CY}	—		
102	T _R	SDA 和 SCL 上升时间	100 kHz 模式	—	1000	ns	
			400 kHz 模式	20 + 0.1 C _B	300	ns	C _B 值规定在 10 至 400 pF 之间
103	T _F	SDA 和 SCL 下降时间	100 kHz 模式	—	300	ns	
			400 kHz 模式	20 + 0.1 C _B	300	ns	C _B 值规定在 10 至 400 pF 之间
90	T _{SU:STA}	启动条件建立时间	100 kHz 模式	4.7	—	μs	仅与重复启动条件相关
			400 kHz 模式	0.6	—	μs	
91	T _{HD:STA}	启动条件保持时间	100 kHz 模式	4.0	—	μs	这个周期后产生第一个时钟脉冲
			400 kHz 模式	0.6	—	μs	
106	T _{HD:DAT}	数据输入保持时间	100 kHz 模式	0	—	ns	
			400 kHz 模式	0	0.9	μs	
107	T _{SU:DAT}	数据输入建立时间	100 kHz 模式	250	—	ns	(注 2)
			400 kHz 模式	100	—	ns	
92	T _{SU:STO}	停止条件建立时间	100 kHz 模式	4.7	—	μs	
			400 kHz 模式	0.6	—	μs	
109	T _A A	时钟有效到输出有效的的时间	100 kHz 模式	—	3500	ns	(注 1)
			400 kHz 模式	—	—	ns	
110	T _{BUF}	总线空闲时间	100 kHz 模式	4.7	—	μs	在启动一个新的传输前总线必须保持空闲的时间
			400 kHz 模式	1.3	—	μs	
D102	C _B	总线容性负载		—	400	pF	

- 注 1: 为避免产生意外的启动或停止条件, 作为发送器的器件必须提供这个内部最小延时以避免 SCL 下降沿的未定义区域 (最小值 300 ns)。
- 注 2: 快速模式的 I²C 总线器件也可在标准模式的 I²C 总线系统中使用, 但必须满足 T_{SU:DAT} ≥ 250 ns 的要求。如果快速模式器件没有延长 SCL 信号的低电平时间, 则必然满足此条件。如果器件延长了 SCL 信号的低电平时间, 必须将下一个数据位输出到 SDA 线。SCL 线被释放前, 根据标准模式 I²C 总线规范, T_R max. + T_{SU:DAT} = 1000 + 250 = 1250 ns。

PIC18F2423/2523/4423/4523

图 26-18: 主 SSP I²C™ 总线启动 / 停止位时序波形图

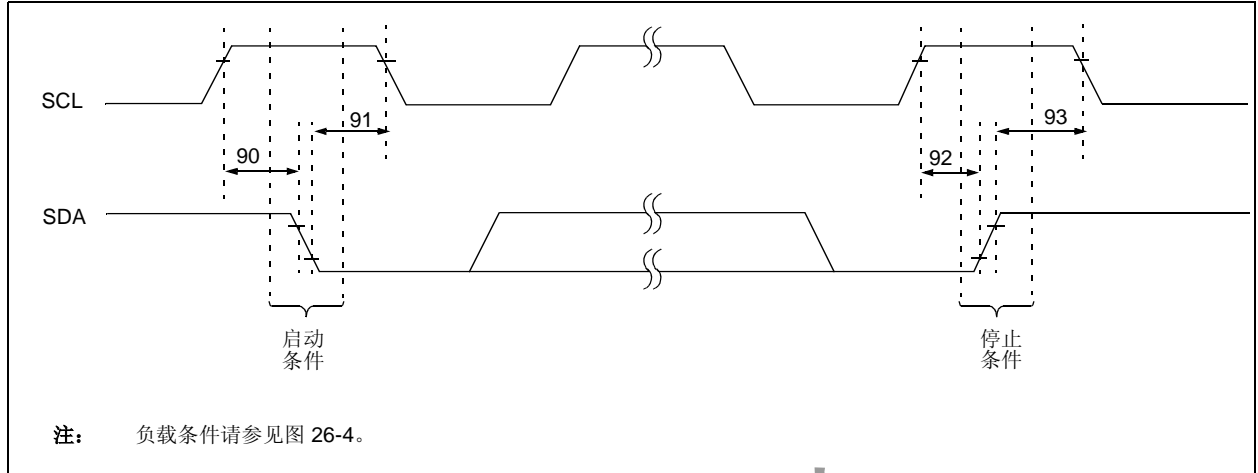
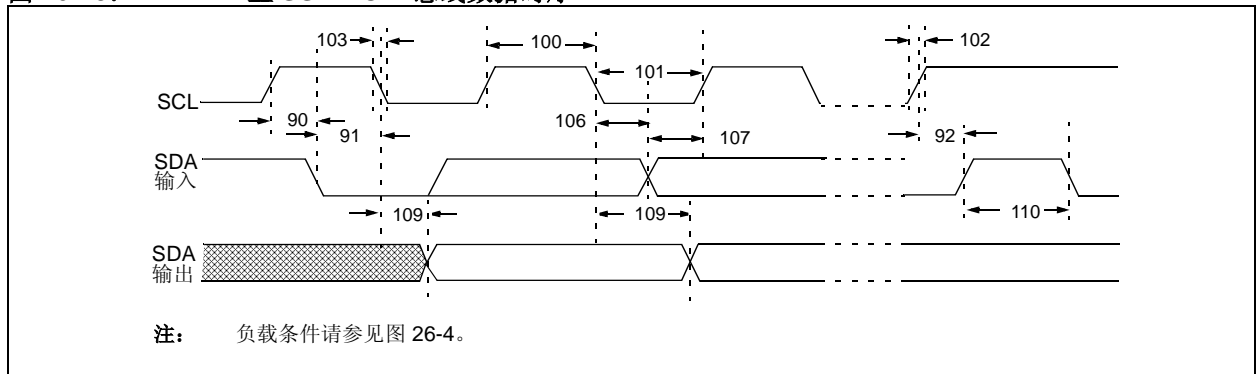


表 26-20: 主 SSP I²C™ 总线启动 / 停止位要求

参数编号	符号	特性		最小值	最大值	单位	条件
90	TSU:STA	启动条件建立时间	100 kHz 模式	$2(T_{osc})(BRG + 1)$	—	ns	仅与重复启动条件相关
			400 kHz 模式	$2(T_{osc})(BRG + 1)$	—		
			1 MHz 模式 ⁽¹⁾	$2(T_{osc})(BRG + 1)$	—		
91	THD:STA	启动条件保持时间	100 kHz 模式	$2(T_{osc})(BRG + 1)$	—	ns	这个周期后产生第一个时钟脉冲
			400 kHz 模式	$2(T_{osc})(BRG + 1)$	—		
			1 MHz 模式 ⁽¹⁾	$2(T_{osc})(BRG + 1)$	—		
92	TSU:STO	停止条件建立时间	100 kHz 模式	$2(T_{osc})(BRG + 1)$	—	ns	
			400 kHz 模式	$2(T_{osc})(BRG + 1)$	—		
			1 MHz 模式 ⁽¹⁾	$2(T_{osc})(BRG + 1)$	—		
93	THD:STO	停止条件保持时间	100 kHz 模式	$2(T_{osc})(BRG + 1)$	—	ns	
			400 kHz 模式	$2(T_{osc})(BRG + 1)$	—		
			1 MHz 模式 ⁽¹⁾	$2(T_{osc})(BRG + 1)$	—		

注 1: 对于所有 I²C 引脚, 最大引脚电容均为 10 pF。

图 26-19: 主 SSP I²C™ 总线数据时序



PIC18F2423/2523/4423/4523

表 26-21: 主 SSP I²C™ 总线数据要求

参数编号	符号	特性	最小值	最大值	单位	条件
100	THIGH	时钟高电平时间	100 kHz 模式	2(Tosc)(BRG + 1)	—	ms
			400 kHz 模式	2(Tosc)(BRG + 1)	—	ms
			1 MHz 模式 (1)	2(Tosc)(BRG + 1)	—	ms
101	TLOW	时钟低电平时间	100 kHz 模式	2(Tosc)(BRG + 1)	—	ms
			400 kHz 模式	2(Tosc)(BRG + 1)	—	ms
			1 MHz 模式 (1)	2(Tosc)(BRG + 1)	—	ms
102	TR	SDA 和 SCL 上升时间	100 kHz 模式	—	1000	ns
			400 kHz 模式	20 + 0.1 C _B	300	ns
			1 MHz 模式 (1)	—	300	ns
103	TF	SDA 和 SCL 下降时间	100 kHz 模式	—	300	ns
			400 kHz 模式	20 + 0.1 C _B	300	ns
			1 MHz 模式 (1)	—	100	ns
90	TSU:STA	启动条件建立时间	100 kHz 模式	2(Tosc)(BRG + 1)	—	ms
			400 kHz 模式	2(Tosc)(BRG + 1)	—	ms
			1 MHz 模式 (1)	2(Tosc)(BRG + 1)	—	ms
91	THD:STA	启动条件保持时间	100 kHz 模式	2(Tosc)(BRG + 1)	—	ms
			400 kHz 模式	2(Tosc)(BRG + 1)	—	ms
			1 MHz 模式 (1)	2(Tosc)(BRG + 1)	—	ms
106	THD:DAT	数据输入保持时间	100 kHz 模式	0	—	ns
			400 kHz 模式	0	0.9	ms
107	TSU:DAT	数据输入建立时间	100 kHz 模式	250	—	ns
			400 kHz 模式	100	—	ns
92	TSU:STO	停止条件建立时间	100 kHz 模式	2(Tosc)(BRG + 1)	—	ms
			400 kHz 模式	2(Tosc)(BRG + 1)	—	ms
			1 MHz 模式 (1)	2(Tosc)(BRG + 1)	—	ms
109	TAA	时钟输出有效时间	100 kHz 模式	—	3500	ns
			400 kHz 模式	—	1000	ns
			1 MHz 模式 (1)	—	—	ns
110	TBUF	总线空闲时间	100 kHz 模式	4.7	—	ms
			400 kHz 模式	1.3	—	ms
D102	CB	总线容性负载	—	400	pF	

注 1: 对于所有 I²C 引脚, 最大引脚电容均为 10 pF。

注 2: 快速模式的 I²C 总线器件也可在标准模式的 I²C 总线系统中使用, 但必须满足参数 107 ≥ 250 ns 的要求。如果快速模式器件没有延长 SCL 信号的低电平时间, 则必然满足此条件。如果器件延长了 SCL 信号的低电平时间, 它必须将下一个数据位输出到 SDA 线。SCL 线被释放前, 在 100 kHz 模式下, 参数 102 + 参数 107 = 1000 + 250 = 1250 ns。

PIC18F2423/2523/4423/4523

图 26-20: EUSART 同步发送 (主控/从动) 时序

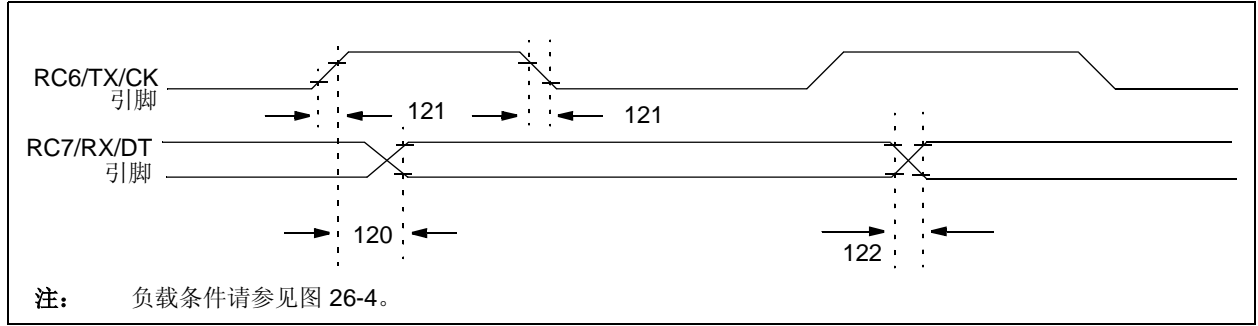


表 26-22: EUSART 同步发送要求

参数编号	符号	特性	最小值	最大值	单位	条件	
120	TckH2dtV	SYNC XMIT (主控和从动) 时钟高电平到数据输出有效的的时间	PIC18FXXXX	—	40	ns	
			PIC18LFXXXX	—	100	ns	VDD = 2.0V
121	Tckrf	时钟输出上升时间和下降时间 (主控模式)	PIC18FXXXX	—	20	ns	
			PIC18LFXXXX	—	50	ns	VDD = 2.0V
122	Tdtrf	数据输出上升时间和下降时间	PIC18FXXXX	—	20	ns	
			PIC18LFXXXX	—	50	ns	VDD = 2.0V

图 26-21: EUSART 同步接收 (主控/从动) 时序

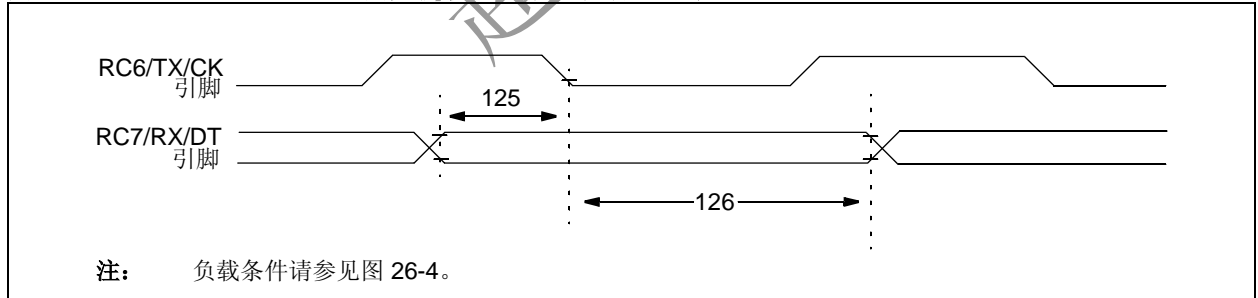


表 26-23: EUSART 同步接收要求

参数编号	符号	特性	最小值	最大值	单位	条件
125	TdtV2ckl	SYNC RCV (主控和从动) 在 CK↓之前数据的保持时间 (DT 保持时间)	10	—	ns	
126	TckL2dtl	在 CK↓之后数据的保持时间 (DT 保持时间)	15	—	ns	

PIC18F2423/2523/4423/4523

表 26-24: A/D 转换器特性: PIC18F2423/2523/4423/4523 (工业级)
PIC18LF2423/2523/4423/4523 (工业级)

参数编号	符号	特性	最小值	典型值	最大值	单位	条件	
A01	NR	分辨率	—	—	12	位		$\Delta V_{REF} \geq 3.0V$
A03	EIL	积分线性误差	—	± 1	± 1.5	LSb	$V_{DD} = 3.0V$	$\Delta V_{REF} \geq 3.0V$
			—	—	± 2.0	LSb	$V_{DD} = 5.0V$	
A04	EDL	微分线性误差	—	± 1	+1.5/-1.0	LSb	$V_{DD} = 3.0V$	$\Delta V_{REF} \geq 3.0V$
			—	—	TBD	LSb	$V_{DD} = 5.0V$	
A06	EOFF	失调误差	—	± 1	± 5	LSb	$V_{DD} = 3.0V$	$\Delta V_{REF} \geq 3.0V$
			—	—	± 3	LSb	$V_{DD} = 5.0V$	
A07	EGN	增益误差	—	± 1	± 1.25	LSb	$V_{DD} = 3.0V$	$\Delta V_{REF} \geq 3.0V$
			—	—	± 2.00	LSb	$V_{DD} = 5.0V$	
A10	—	单调性	保证 ⁽¹⁾			—	$V_{SS} \leq V_{AIN} \leq V_{REF}$	
A20	ΔV_{REF}	参考电压范围 ($V_{REFH} - V_{REFL}$)	3	—	$AV_{DD} - AV_{SS}$	V	适用于 12 位分辨率	
A21	V_{REFH}	参考电压高电平	$AV_{SS} + 3.0V$	—	$AV_{DD} + 0.3V$	V	适用于 12 位分辨率	
A22	V_{REFL}	参考电压低电平	$AV_{SS} - 0.3V$	—	$AV_{DD} - 3.0V$	V	适用于 12 位分辨率	
A25	V_{AIN}	模拟输入电压	V_{REFL}	—	V_{REFH}	V		
A30	Z_{AIN}	模拟电压源阻抗的推荐值	—	—	2.5	k Ω		
A50	IREF	V_{REF} 输入电流 ⁽²⁾	—	—	5	μA	在采集 V_{AIN} 期间。	
			—	—	150	μA	在 A/D 转换周期期间。	

图注: TBD = 待定

- 注 1: A/D 转换结果不会因输入电压的增加而减小, 并且不会丢失编码。
 注 2: V_{REFH} 电流来自选择作为 V_{REFH} 源的 RA3/AN3/ V_{REF+} 引脚或 V_{DD} 。
 V_{REFL} 电流来自选择作为 V_{REFL} 源的 RA2/AN2/ V_{REF-}/CV_{REF} 引脚或 V_{SS} 。

图 26-22: A/D 转换时序

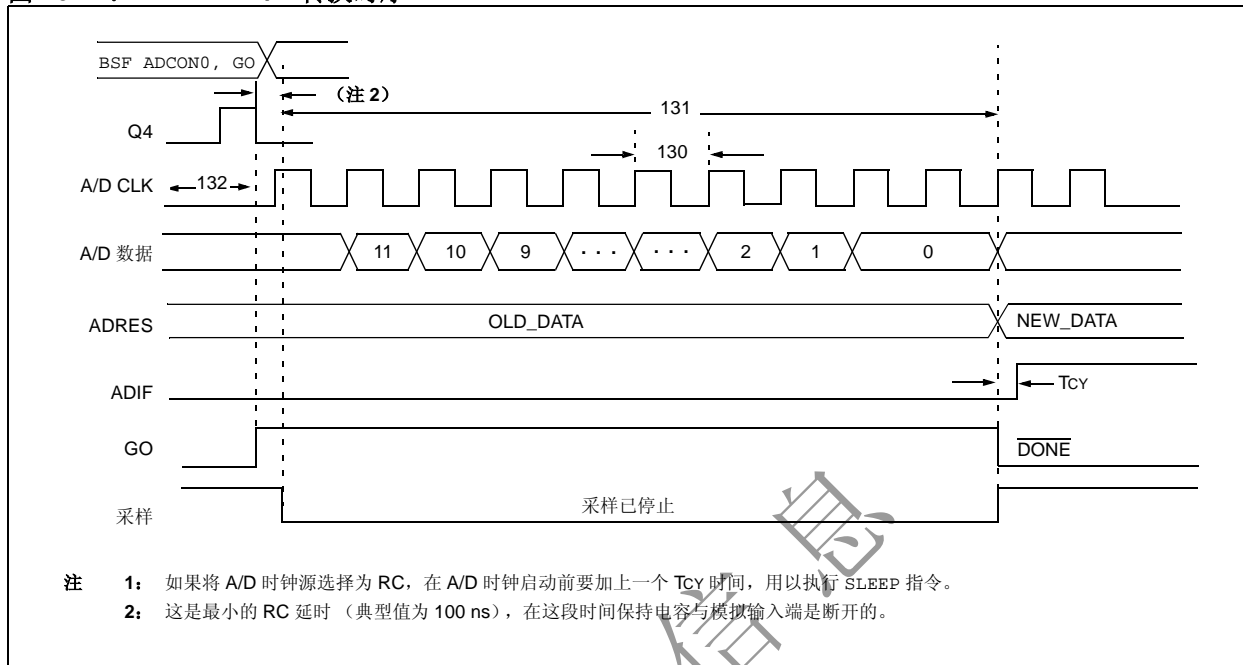


表 26-25: A/D 转换要求

参数编号	符号	特性	最小值	最大值	单位	条件	
130	TAD	A/D 时钟周期	PIC18FXXXX	0.8	12.5 ⁽¹⁾	μs	基于 TOSC, $V_{REF} \geq 3.0\text{V}$
			PIC18LFXXXX	1.4	25.0 ⁽¹⁾	μs	$V_{DD} = 3.0\text{V}$; 基于 TOSC, V_{REF} 满量程
			PIC18FXXXX	TBD	1	μs	A/D RC 模式
			PIC18LFXXXX	TBD	3	μs	$V_{DD} = 3.0\text{V}$; A/D RC 模式
131	TCNV	转换时间 (不包括采集时间) (2)	13	14	TAD		
132	TACQ	采集时间 (3)	1.4	—	μs		
135	TSWC	转换 → 采样的切换时间	—	(注 4)			
TBD	TDIS	电容放电时间	0.2	—	μs		

图注: TBD = 待定

- 注 1: A/D 时钟周期取决于器件频率和 TAD 时钟分频比。
 注 2: 可在后续 T_{cy} 周期内读 ADRES 寄存器。
 注 3: 转换完成后当电压满量程变化时 (V_{DD} 至 V_{SS} 或 V_{SS} 至 V_{DD}), 保持电容采集一个“新”输入电压所需的时间。在输入通道上的信号源阻抗 (R_s) 为 50Ω 。
 注 4: 在器件时钟的下一个周期。

PIC18F2423/2523/4423/4523

注:

27.0 直流和交流特性图表

当前没有可用图表。

PIC18F2423/2523/4423/4523

注:

PIC18F2423/2523/4423/4523

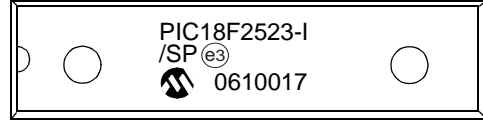
28.0 封装信息

28.1 封装标识信息

28 引脚 PDIP



示例



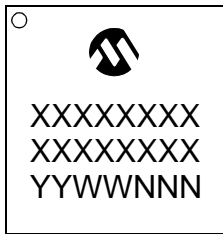
28 引脚 SOIC



示例



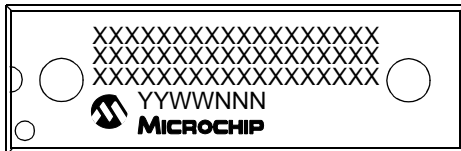
28 引脚 QFN



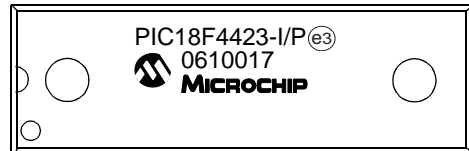
示例



40 引脚 PDIP



示例

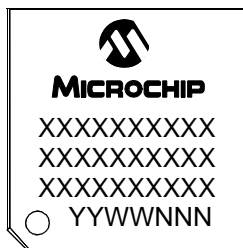


图注:	<p>XX...X 客户指定信息</p> <p>Y 年代码 (公历年份的最后位)</p> <p>YY 年代码 (公历年份的最后两位)</p> <p>WW 星期代码 (1月1日的星期代码为“01”)</p> <p>NNN 字母数字的追踪代码</p> <p>(e3) 雾锡 (Sn) 的无铅 JEDEC 标志</p> <p>* 本封装为无铅封装。在封装的外部包装上可以找到无铅 JEDEC 标志 (e3)。</p>
注:	如果 Microchip 器件编号不能在一行中完全标出, 它将换行继续标出。因此限制了用户指定信息的可用字符数。

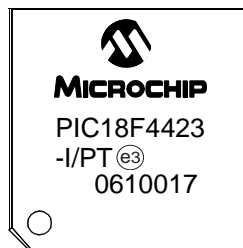
PIC18F2423/2523/4423/4523

封装标识信息（续）

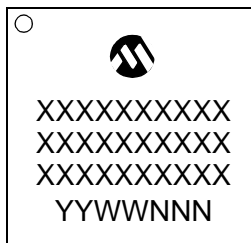
44 引脚 TQFP



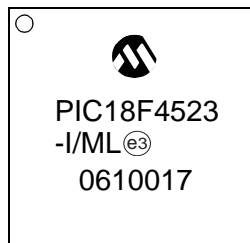
示例



44 引脚 QFN



示例



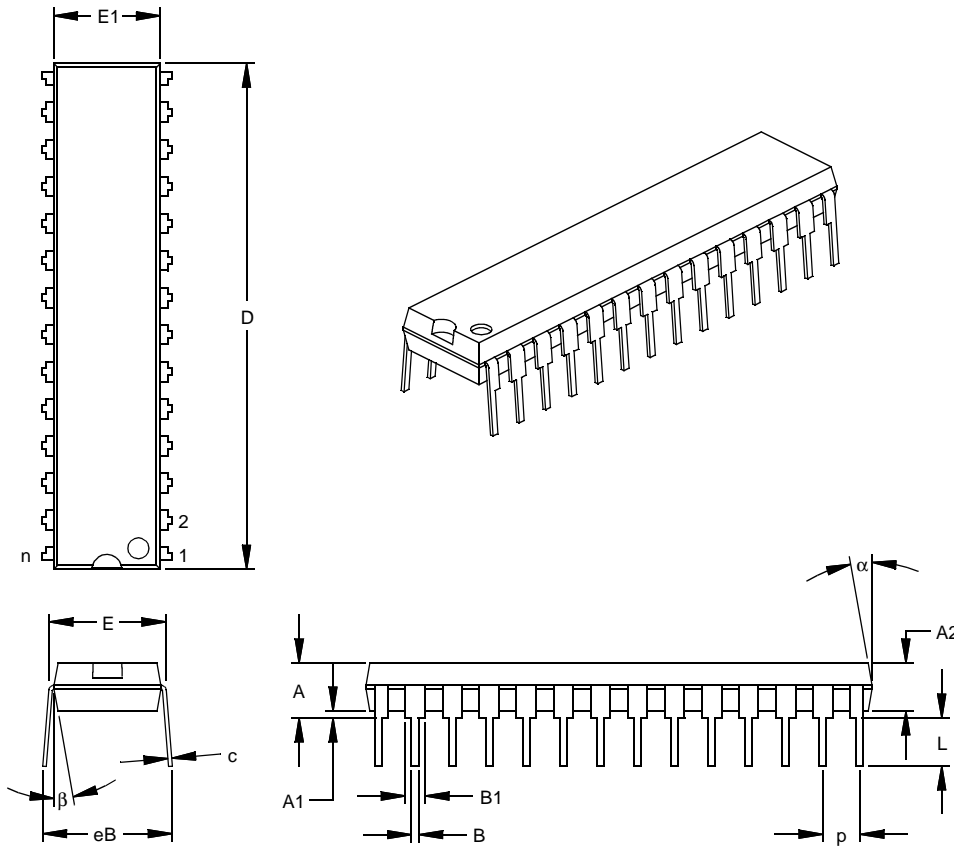
PIC18F2423/2523/4423/4523

28.2 封装详细信息

以下部分将介绍各种封装的技术细节。

28 引脚窄型塑封双列直插式封装 (SP) —— 300 mil 主体 (PDIP)

注：最新封装图请至 <http://www.microchip.com/packaging> 查看 Microchip 封装规范。



尺寸范围	单位	英寸*			毫米		
		最小	正常	最大	最小	正常	最大
引脚数	n	28			28		
引脚间距	p		.100			2.54	
顶端到固定面高度	A	.140	.150	.160	3.56	3.81	4.06
塑模封装厚度	A2	.125	.130	.135	3.18	3.30	3.43
塑模底面到固定面高度	A1	.015			0.38		
肩到肩宽度	E	.300	.310	.325	7.62	7.87	8.26
塑模封装宽度	E1	.275	.285	.295	6.99	7.24	7.49
总长度	D	1.345	1.365	1.385	34.16	34.67	35.18
引脚尖到固定面高度	L	.125	.130	.135	3.18	3.30	3.43
引脚厚度	c	.008	.012	.015	0.20	0.29	0.38
引脚上部宽度	B1	.040	.053	.065	1.02	1.33	1.65
引脚下部宽度	B	.016	.019	.022	0.41	0.48	0.56
总排列间距	§ eB	.320	.350	.430	8.13	8.89	10.92
塑模顶部锥度	α	5	10	15	5	10	15
塑模底部锥度	β	5	10	15	5	10	15

* 控制参数

§ 重要特性

注：

尺寸 D 和 E1 不包括塑模毛边或突起。塑模每侧的毛边或突起不得超过 0.010 英寸 (0.254 毫米)。

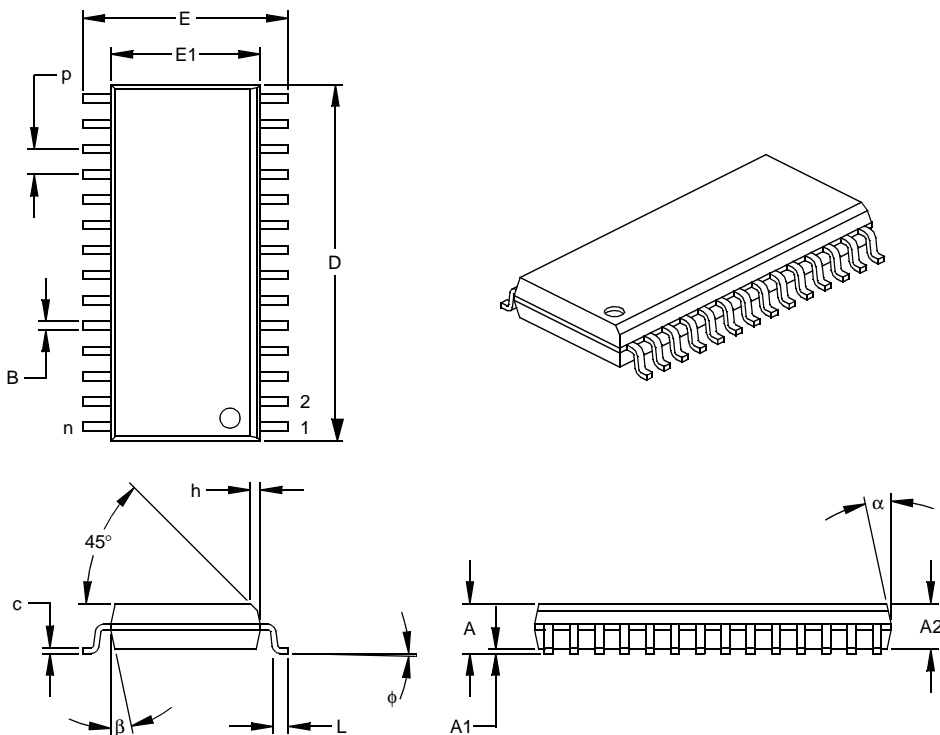
等同于 JEDEC 号：MO-095

图号 001 270

PIC18F2423/2523/4423/4523

28 引脚塑封小外形封装 (SO) —— 宽条, 300 mil 主体 (SOIC)

注: 最新封装图请至 <http://www.microchip.com/packaging> 查看 Microchip 封装规范。



尺寸范围	单位	英寸*			毫米		
		最小	正常	最大	最小	正常	最大
引脚数	n	28			28		
引脚间距	p		.050			1.27	
总高度	A	.093	.099	.104	2.36	2.50	2.64
塑模封装厚度	A2	.088	.091	.094	2.24	2.31	2.39
悬空间隙	§ A1	.004	.008	.012	0.10	0.20	0.30
总宽度	E	.394	.407	.420	10.01	10.34	10.67
塑模封装宽度	E1	.288	.295	.299	7.32	7.49	7.59
总长度	D	.695	.704	.712	17.65	17.87	18.08
斜面距离	h	.010	.020	.029	0.25	0.50	0.74
底脚长度	L	.016	.033	.050	0.41	0.84	1.27
底脚倾斜角	φ	0	4	8	0	4	8
引脚厚度	c	.009	.011	.013	0.23	0.28	0.33
引脚宽度	B	.014	.017	.020	0.36	0.42	0.51
塑模顶部锥度	α	0	12	15	0	12	15
塑模底部锥度	β	0	12	15	0	12	15

* 控制参数

§ 重要特性

注:

尺寸 D 和 E1 不包括塑模毛边或突起。塑模每侧的毛边或突起不得超过 0.010 英寸 (0.254 毫米)。

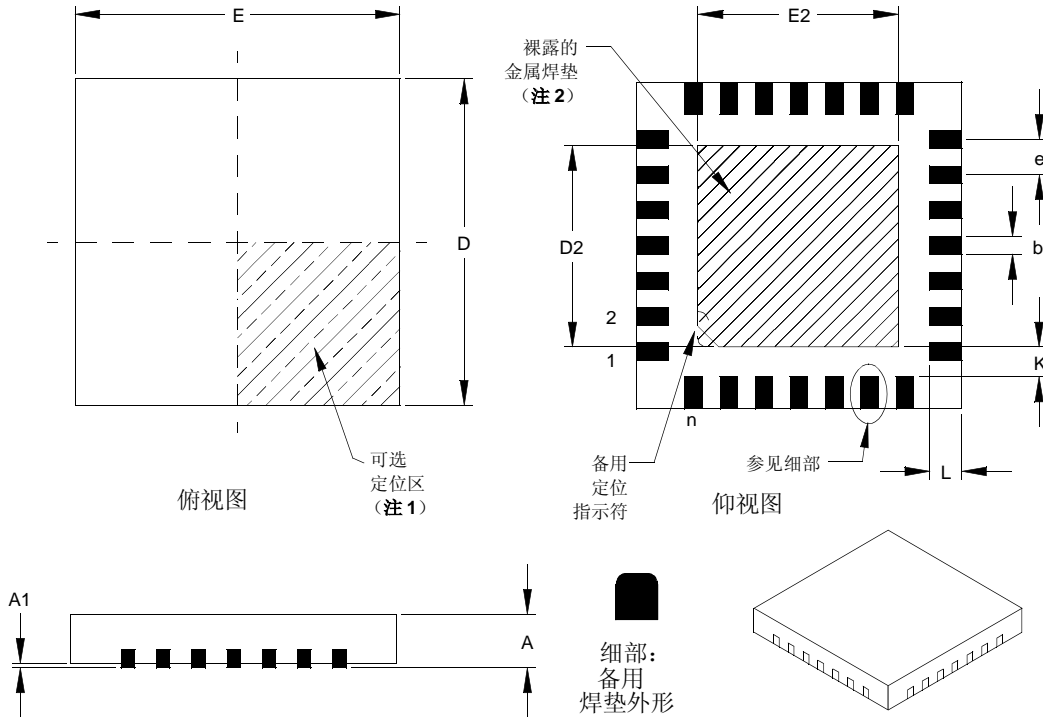
等同于 JEDEC 号: MS-013

图号 C04-052

PIC18F2423/2523/4423/4523

28 引脚塑封正方扁平无脚封装 (ML) 6x6 mm 主体 (QFN) —— 具有 0.55 mm 触点长度 (切割分离)

注：最新封装图请至 <http://www.microchip.com/packaging> 查看 Microchip 封装规范。



尺寸范围	单位	英寸			毫米*		
		最小	正常	最大	最小	正常	最大
引脚数	n	28			28		
引脚间距	e	.026 BSC			.65 BSC		
总高度	A	.031	.035	.039	0.80	0.90	1.00
悬空间隙	A1	.000	.001	.002	0.00	0.02	0.05
触点厚度	A3	.008 REF			.20 REF		
总宽度	E	.232	.236	.240	5.90	6.00	6.10
裸露金属焊垫宽度	E2	.153	.167	.169	3.89	4.24	4.29
总长度	D	.232	.236	.240	5.90	6.00	6.10
裸露金属焊垫长度	D2	.153	.167	.169	3.89	4.24	4.29
触点宽度	β	.009	.011	.013	0.23	0.28	0.33
触点长度 §	L	.018	.022	.024	0.45	0.55	0.65
触点到裸露金属焊垫的距离 §	K	.008	-	-	0.20	-	-

* 控制参数

§ 重要特性

注：

1. 引脚 1 的可见定位功能可能不同，但必须在阴影区域内。

2. 裸露金属焊垫尺寸随管芯叶片大小而变化。

BSC: 基本尺寸。理论上显示的是没有公差精确值。

参见 ASME Y14.5M

REF: 参考尺寸，通常无公差，仅供参考。

参见 ASME Y14.5M

等同于 JEDEC 号: MO-220

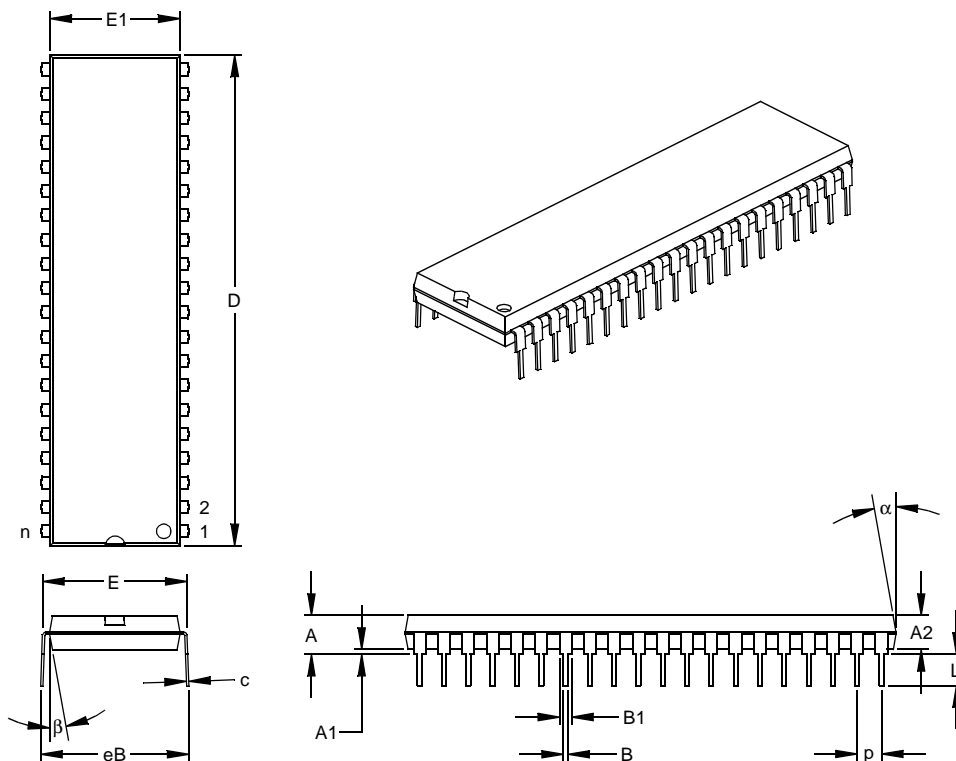
图号 C04-105

修订于 09-12-05

PIC18F2423/2523/4423/4523

40 引脚塑封双列直插式封装 (P) —— 600 mil 主体 (PDIP)

注：最新封装图请至 <http://www.microchip.com/packaging> 查看 Microchip 封装规范。



单位	尺寸范围	英寸*			毫米		
		最小	正常	最大	最小	正常	最大
引脚数	n	40			40		
引脚间距	p	.100			2.54		
顶端到固定面高度	A	.160	.175	.190	4.06	4.45	4.83
塑模封装厚度	A2	.140	.150	.160	3.56	3.81	4.06
塑模底面到固定面高度	A1	.015			0.38		
肩到肩宽度	E	.595	.600	.625	15.11	15.24	15.88
塑模封装宽度	E1	.530	.545	.560	13.46	13.84	14.22
总长度	D	2.045	2.058	2.065	51.94	52.26	52.45
引脚尖到固定面高度	L	.120	.130	.135	3.05	3.30	3.43
引脚厚度	c	.008	.012	.015	0.20	0.29	0.38
引脚上部宽度	B1	.030	.050	.070	0.76	1.27	1.78
引脚下部宽度	B	.014	.018	.022	0.36	0.46	0.56
总排列间距	§ eB	.620	.650	.680	15.75	16.51	17.27
塑模顶部锥度	α	5	10	15	5	10	15
塑模底部锥度	β	5	10	15	5	10	15

* 控制参数

§ 重要特性

注：

尺寸 D 和 E1 不包括塑模毛边或突起。塑模每侧的毛边或突起不得超过 0.010 英寸 (0.254 毫米)。

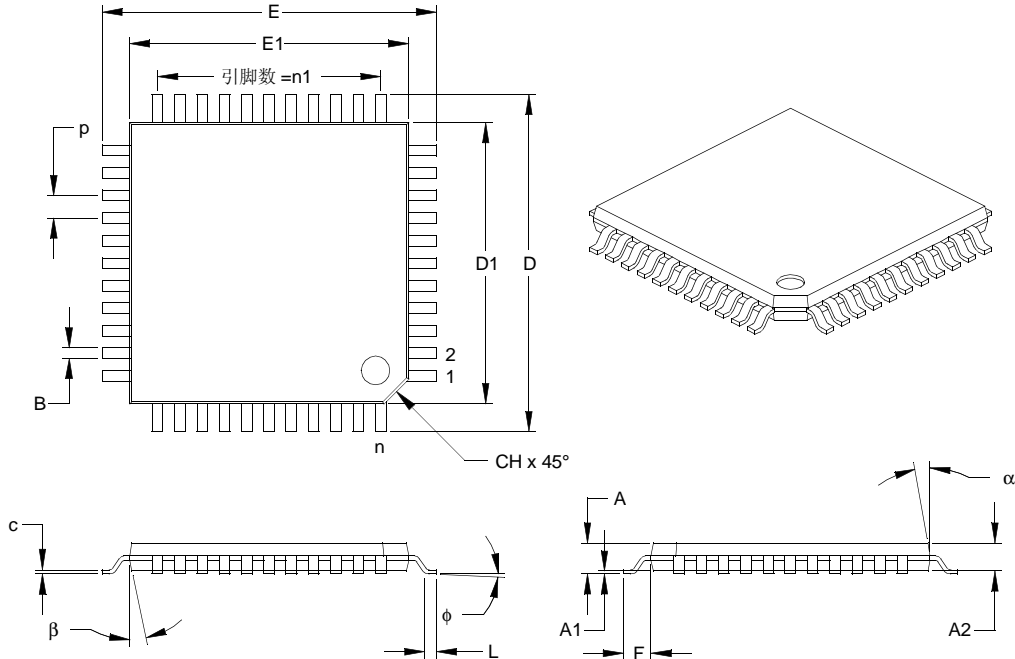
等同于 JEDEC 号：MO-011

图号 C04-016

PIC18F2423/2523/4423/4523

44 引脚塑封薄型正方扁平封装 (PT) 10x10x1 mm 主体, 1.0/0.10 mm 引脚形式 (TQFP)

注: 最新封装图请至 <http://www.microchip.com/packaging> 查看 Microchip 封装规范。



单位 尺寸范围	英寸			毫米*			
	最小	正常	最大	最小	正常	最大	
引脚数	n	44			44		
引脚间距	p	.031			0.80		
每侧引脚数	n1	11			11		
总高度	A	.039	.043	.047	1.00	1.10	1.20
塑模封装厚度	A2	.037	.039	.041	0.95	1.00	1.05
悬空间隙	A1	.002	.004	.006	0.05	0.10	0.15
底脚长度	L	.018	.024	.030	0.45	0.60	0.75
引脚投影长度 (参考)	F	.039 REF.			1.00 REF.		
底脚倾斜角	phi	0	3.5	7	0	3.5	7
总宽度	E	.463	.472	.482	11.75	12.00	12.25
总长度	D	.463	.472	.482	11.75	12.00	12.25
塑模封装宽度	E1	.390	.394	.398	9.90	10.00	10.10
塑模封装长度	D1	.390	.394	.398	9.90	10.00	10.10
引脚厚度	c	.004	.006	.008	0.09	0.15	0.20
引脚宽度	B	.012	.015	.017	0.30	0.38	0.44
引脚 1 切角斜面	CH	.025	.035	.045	0.64	0.89	1.14
塑模顶部锥度	alpha	5	10	15	5	10	15
塑模底部锥度	beta	5	10	15	5	10	15

* 控制参数

注:

尺寸 D 和 E1 不包括塑模毛边或突起。塑模每侧的毛边或突起不得超过 0.010 英寸 (0.254 毫米)。

REF: 参考尺寸, 通常无公差, 仅供参考。

参见 ASME Y14.5M

等同于 JEDEC 号: MS-026

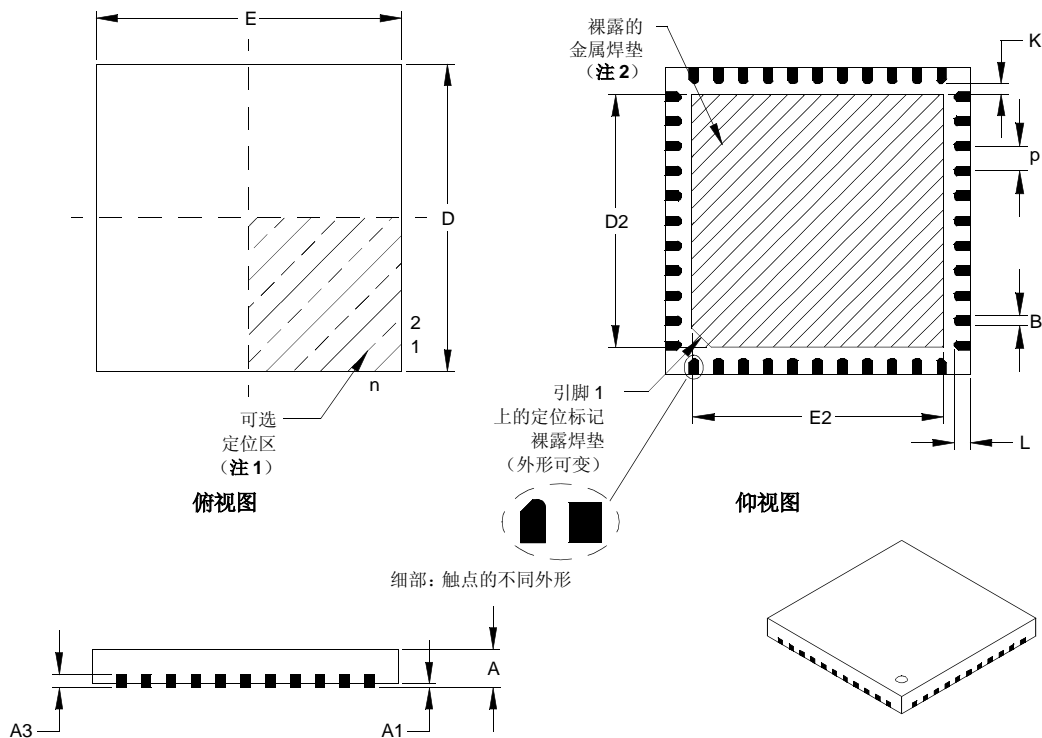
图号 C04-076

修订于 07-22-05

PIC18F2423/2523/4423/4523

44 引脚塑封正方扁平无脚封装 (ML) 8x8 mm 主体 (QFN)

注：最新封装图请至 <http://www.microchip.com/packaging> 查看 Microchip 封装规范。



尺寸范围	单位	英寸			毫米*		
		最小	正常	最大	最小	正常	最大
触点数	n		44			44	
触点间距	P	.026 BSC			.65 BSC		
总高度	A	.031	.035	.039	0.80	0.90	1.00
悬空间隙	A1	.000	.001	.002	0	0.02	0.05
引脚顶部到塑模底部距离	A3	.010 REF			.25 REF		
总宽度	E	.309	.315	.321	7.85	8.00	8.15
裸露金属焊垫宽度	E2	.236	.258	.260	5.99	6.55	6.60
总长度	D	.309	.315	.321	7.85	8.00	8.15
裸露金属焊垫长度	D2	.236	.258	.260	5.99	6.55	6.60
触点宽度	B	.008	.013	.013	0.20	0.33	0.35
触点长度	§ L	.014	.016	.019	0.35	0.40	0.48
触点到裸露金属焊垫的距离	§ K	.014	-	-	0.20	-	-

* 控制参数

§ 重要特性

注：

1. 引脚 1 的可见定位功能可能不同，但必须在阴影区域内。
2. 裸露金属焊垫尺寸随管芯叶片大小而变化。

BSC: 基本尺寸。理论上显示的是没有公差精确值。

参见 ASME Y14.5M

REF: 参考尺寸，通常无公差，仅供参考。

参见 ASME Y14.5M

等同于 JEDEC 号: M0-220

图号 C04-103

修订于 09-12-05

PIC18F2423/2523/4423/4523

附录 A: 版本历史

版本 A (2006 年 6 月)

PIC18F2423/2523/4423/4523 器件的原始数据手册。

附录 B: 器件差异

表 B-1 为本数据手册中所列器件之间的差异。

表 B-1: 器件差异

功能部件	PIC18F2423	PIC18F2523	PIC18F4423	PIC18F4523
程序存储器 (字节数)	16384	32768	16384	32768
程序存储器 (指令数)	8192	16384	8192	16384
中断源	19	19	20	20
I/O 端口	端口 A, B, C, (E)	端口 A, B, C, (E)	端口 A, B, C, D, E	端口 A, B, C, D, E
捕捉 / 比较 / PWM 模块	2	2	1	1
增强型 捕捉 / 比较 / PWM 模块	0	0	1	1
并行通信 (PSP)	无	无	有	有
12 位模数转换器模块	10 路输入通道	10 路输入通道	13 路输入通道	13 路输入通道
封装	28 引脚 PDIP 28 引脚 SOIC 28 引脚 QFN	28 引脚 PDIP 28 引脚 SOIC 28 引脚 QFN	40 引脚 PDIP 44 引脚 TQFP 44 引脚 QFN	40 引脚 PDIP 44 引脚 TQFP 44 引脚 QFN

PIC18F2423/2523/4423/4523

附录 C: 转换注意事项

本附录讨论了器件从老版本升级到本数据手册中所列版本时的注意事项。这些变化通常是由于所采用工艺技术的差异引起的，正如从 PIC16C74A 到 PIC16C74B 的升级。

不适用

附录 D: 从低档器件移植到增强型器件

本节讨论如何从低档器件（如 PIC16C5X）移植到增强型 MCU 器件（如 PIC18FXXX）。

下表列出了本系列器件与 PIC16C5X 单片机系列相比所作的改进：

当前未提供

附录 E： 从中档器件移植到增强型器件

在 AN716, “*Migrating Designs from PIC16C74A/74B to PIC18C442*” 中详细讨论了中档 MCU 器件 (即 PIC16CXXX) 与增强型器件 (即 PIC18FXXX) 之间的差异。虽然所讨论的变化都是针对特定器件的, 但是通常适用于从中档器件移植到增强型器件的所有情况。

上述应用笔记的文献编号为 DS00716。

附录 F： 从高档器件移植到增强型器件

在 AN726, “*PIC17CXXX to PIC18CXXX Migration*” 中详细讨论了从高档 MCU 器件 (即 PIC17CXXX) 移植到增强型器件 (即 PIC18FXXX) 的步骤以及这两类器件之间的差异。上述应用笔记的文献编号为 DS00726。

PIC18F2423/2523/4423/4523

注:

索引

A

A/D	227	工作原理	239
A/D 转换器中断, 配置	231	模拟输入连接注意事项	241
ADCON0 寄存器	227	配置	238
ADCON1 寄存器	227	输出	239
ADCON2 寄存器	227	相关的寄存器	241
ADRESH 寄存器	227, 230	响应时间	239
ADRESL 寄存器	227	休眠期间的操作	240
CCP2 触发器的使用	236	中断	240
采集要求	232	比较器参考电压	243
放电	235	复位的影响	244
计算所需要的最小采集时间	232	精度和误差	244
模拟端口引脚, 配置	234	连接注意事项	244
配置模块	231	配置	243
特殊事件触发器 (CCP)	236	相关的寄存器	245
相关的寄存器	236	休眠期间的操作	244
选择和配置采集时间	233	比较器规范	340
在功耗管理模式下的操作	234	比较 (CCP 模块)	142
转换	235	CCPRx 寄存器	142
转换器特性	360	CCP 引脚配置	142
转换时钟 (TAD)	233	Timer1/Timer3 模式选择	142
转换状态 (GO/DONE 位)	230	软件中断模式	142
ACKSTAT	195	特殊事件触发器	137, 142, 236
ACKSTAT 状态标志	195	相关的寄存器	143
ADCON0 寄存器	227	比较 (ECCP 模块)	148
GO/DONE 位	230	变更通知客户服务	387
ADCON1 寄存器	227	表读 / 表写	56
ADCON2 寄存器	227	表指针操作 (表)	76
ADDFSR	314	并行从动端口 (PSP)	114, 120
ADDLW	277	CS (片选)	120
ADDWF	277	PORTD	120
ADDWFC	278	RD (读输入)	120
ADDULNK	314	WR (写输入)	120
ADRESH 寄存器	227	相关的寄存器	121
ADRESL 寄存器	227, 230	选择 (PSPMODE 位)	114, 120
ANDLW	278	波特率发生器	191
ANDWF	279	不同情形下的延时 (表)	45
B		捕捉 / 比较 / PWM (CCP)	139
BC	279	CCP1 和 CCP2 在使用定时器资源方面的相互关系	140
BCF	280	CCP2 引脚分配	140
BF	195	CCP 模式和定时器资源	140
BF 状态标志	195	CCPRxH 寄存器	140
BN	280	CCPRxL 寄存器	140
BNC	281	比较模式。请参见比较。	
BNN	281	捕捉模式。请参见捕捉。	
BNOV	282	模块配置	140
BNZ	282	捕捉 (CCP 模块)	141
BOR。请参见欠压复位。		CCPRxH:CCPRxL 寄存器	141
BOV	285	CCP 引脚配置	141
BRA	283	Timer1/Timer3 模式选择	141
BRG。请参见波特率发生器。		软件中断	141
BSF	283	相关的寄存器	143
BTFSC	284	预分频器	141
BTFSS	284	捕捉 (ECCP 模块)	148
BTG	285	C	
BZ	286	CALL	286
版本历史	373	CALLW	315
比较器	237	CLRf	287
参考	239	CLRWDt	287
内部信号	239	COMF	288
外部信号	239	CPFSEQ	288
复位的影响	240	CPFSGT	289
		CPFSLT	289
		CPU 的特殊功能	253

PIC18F2423/2523/4423/4523

C 编译器	
MPLAB C18	322
MPLAB C30	322
参考电压规范	340
程序存储器	
查找表	56
代码保护	268
复位向量	53
和扩展指令集	72
映射和堆栈 (图)	53
指令	58
双字	58
中断向量	53
程序计数器	54
PCLATH 和 PCLATU 寄存器	54
PCL、PCH 和 PCU 寄存器	54
程序校验和代码保护	267
相关的寄存器	267
串行时钟, SCK	161
串行数据输出 (SDO)	161
串行数据输入 (SDI)	161
串行外设接口。请参见 SPI 模式。	
从动选择 (SS)	161
从低档器件移植到增强型器件	374
从高档器件移植到增强型器件	375
从中档器件移植到增强型器件	375
存储器编程要求	339
存储器构成	53
程序存储器	53
数据存储器	59
存储区选择寄存器 (BSR)	59
D	
DAW	290
DCFSNZ	291
DECf	290
DECFSZ	291
代码保护	253
代码示例	
16 x 16 无符号乘法程序	90
16 x 16 有符号乘法程序	90
8 x 8 无符号乘法程序	89
8 x 8 有符号乘法程序	89
擦除闪存程序存储器的一行	78
初始化 PORTA	105
初始化 PORTB	108
初始化 PORTC	111
初始化 PORTD	114
初始化 PORTE	117
读闪存程序存储器的一个字	77
读数据 EEPROM	85
改变捕捉预分频比	141
将 STATUS、WREG 和 BSR 寄存器	
的值保存在 RAM 中	103
快速寄存器堆栈	56
使用间接寻址清零 RAM (Bank 1)	68
使用偏移量计算 GOTO	56
使用 Timer1 中断服务实现实时时钟	131
数据 EEPROM 刷新程序	86
写闪存程序存储器	80-81
写数据 EEPROM	85
装载 SSPBUF (SSPSR) 寄存器	164
单电源 ICSP 编程。	
低电压 ICSP 编程。请参见单电源 ICSP 编程	
电气特性	325
读者反馈	388
对标准 PIC MCU 的影响	318
堆栈满 / 下溢复位	56
E	
EUSART	
波特率发生器	
在功耗管理模式下的操作	209
波特率发生器 (BRG)	209
波特率误差, 计算	210
波特率, 异步模式	211
采样	209
高波特率选择 (BRGH 位)	209
相关的寄存器	210
自动波特率检测	213
同步从动模式	224
发送	224
接收	225
相关的寄存器, 发送	224
相关的寄存器, 接收	225
同步主控模式	221
发送	221
接收	223
相关的寄存器, 发送	222
相关的寄存器, 接收	223
异步模式	215
发送器	215
间隔字符序列	220
接收间隔字符	220
接收器	217
设置带有地址检测功能的 9 位模式	217
同步间隔字符自动唤醒	218
相关的寄存器, 发送	216
相关的寄存器, 接收	218
F	
FSCM。请参见故障保护时钟监视器。	
返回地址堆栈	54
返回堆栈指针 (STKPTR)	55
访问栈顶	54
封装信息	365
标识	365
详细信息 (图)	367
复位	41, 253
欠压复位 (BOR)	253
上电复位 (POR)	253
上电延时定时器 (PWRT)	253
振荡器起振定时器 (OST)	253
G	
GOTO	292
高 / 低压检测	247
操作	
休眠期间	251
电流消耗	249
典型低压应用	250
复位的影响	251
工作原理	248
启动时间	249
设置	249
特性	341
相关的寄存器	251
应用	250
功耗管理模式	33
对时钟源的影响	31
和 A/D 操作	234
和多条 SLEEP 命令	34

PIC18F2423/2523/4423/4523

和 PWM 操作	159	工作原理	190
和 SPI 工作原理	169	接收	195
汇总 (表)	33	启动条件时序	193
进入	33	重复启动条件时序	194
空闲模式	37	总线冲突	
PRI_IDLE	38	停止条件期间	203
RC_IDLE	39	重复启动条件期间	202
SEC_IDLE	38	ID 地址单元	253, 270
时钟转换和状态指示	34	INCF	292
退出空闲和休眠模式	39	INCFSZ	293
没有起振延时	40	INFSNZ	293
通过复位	39	INTCON 寄存器	93–95
通过 WDT 超时	39	INTOSC, INTRC. <i>请参见内部振荡器模块。</i>	
通过中断	39	IORLW	294
休眠模式	37	IORWF	294
选择	33	IPR 寄存器	100
运行模式	34	J	
PRI_RUN	34	寄存器	
RC_RUN	35	ADCON0 (A/D 控制 0)	227
SEC_RUN	34	ADCON1 (A/D 控制 1)	228
功耗管理模式对各种时钟源的影响	31	ADCON2 (A/D 控制 2)	229
公式		BAUDCON (波特率控制)	208
A/D 采集时间	232	CCP1CON (增强型捕捉 / 比较 / PWM 控制 1)	147
A/D 最小充电时间	232	CCPxCON (标准捕捉 / 比较 / PWM 控制)	139
故障保护时钟监视器	253, 265	CMCON (比较器控制)	237
功耗管理模式下的中断	266	CONFIG1H (配置 1 高字节)	254
POR 或从休眠中唤醒	266	CONFIG2H (配置 2 高字节)	256
退出操作	265	CONFIG2L (配置 2 低字节)	255
振荡器故障期间的 WDT	265	CONFIG3H (配置 3 高字节)	257
H		CONFIG4L (配置 4 低字节)	257
HLVD. <i>请参见高 / 低压检测。</i>	247	CONFIG5H (配置 5 高字节)	258
汇编器		CONFIG5L (配置 5 低字节)	258
MPASM 汇编器	322	CONFIG6H (配置 6 高字节)	259
I		CONFIG6L (配置 6 低字节)	259
I/O 端口	105	CONFIG7 (配置 7 低字节)	260
I/O 引脚说明		CONFIG7 (配置 7 高字节)	260
PIC18F2423/2523	12	CVRCON (比较器参考电压控制)	243
PIC18F4423/4523	16	DEVID1 (器件 ID 1)	261
I ² C 模式 (MSSP)		DEVID2 (器件 ID 2)	261
波特率发生器	191	ECCP1AS (ECCP 自动关闭控制)	157
串行时钟 (RC3/SCK/SCL)	177	ECCP1DEL (死区延时)	157
从动模式	175	EECON1 (EEPROM 控制 1)	75, 84
发送	177	HLVDCON (高 / 低压检测控制)	247
接收	177	INTCON2 (中断控制 2)	94
寻址	175	INTCON3 (中断控制 3)	95
读 / 写位信息 (R/W 位)	175, 177	INTCON (中断控制)	93
多主机模式	199	IPR1 (外设中断优先级 1)	100
多主机通信、总线冲突与仲裁	199	IPR2 (外设中断优先级 2)	101
复位的影响	199	OSCCON (振荡器控制)	30
工作原理	175	OSCTUNE (振荡器调节)	27
寄存器	170	PIE1 (外设中断允许 1)	98
时钟同步和 CKP 位	185	PIE2 (外设中断允许 2)	99
时钟延长	184	PIR1 (外设中断请求 (标志) 1)	96
10 位从动发送模式	184	PIR2 (外设中断请求 (标志) 2)	97
10 位从动接收模式 (SEN = 1)	184	RCON (复位控制)	42, 102
7 位从动发送模式	184	RCSTA (接收状态和控制寄存器)	207
7 位从动接收模式 (SEN = 1)	184	SSPAD (MSSP 地址)	174
时钟仲裁	192	SSPCON1 (MSSP 控制 1, I ² C 模式)	172
停止条件时序	198	SSPCON1 (MSSP 控制 1, SPI 模式)	163
休眠模式下的操作	199	SSPCON2 (MSSP 控制 2, I ² C 模式)	173
应答序列时序	198	SSPSTAT (MSSP 状态, I ² C 模式)	171
支持广播呼叫地址	188	SSPSTAT (MSSP 状态, SPI 模式)	162
主控模式	189	STATUS	67
发送	195	STKPTR (堆栈指针)	55
		T0CON (Timer0 控制)	123

PIC18F2423/2523/4423/4523

T1CON (Timer1 控制)	127	对闪存程序存储器的表写操作	79
T2CON (Timer2 控制)	133	故障保护时钟监控器 (FSCM)	265
T3CON (Timer3 控制)	135	看门狗定时器	262
TRISE (PORTE/PSP 控制)	118	模拟输入模型	231
TXSTA (发送状态和控制寄存器)	206	片上复位电路	41
WDTCON (看门狗定时器控制)	263	器件时钟	28
寄存器的复位状态	48	通用 I/O 端口	105
寄存器文件	62	外部上电复位电路 (VDD 缓慢上电的情况)	43
寄存器文件汇总	64-66	增强型 PWM	149
计算 GOTO	56	中断逻辑	92
间接寻址	69	扩展指令集	
交流特性		ADDFSR	314
内部 RC 精度	345	ADDULNK	314
交流 (时序) 特性	342	CALLW	315
参数符号体系	342	MOVSF	315
器件时序规范的负载条件	343	MOVSS	316
时序条件	343	PUSHL	316
温度和电压规范	343	SUBFSR	317
晶振 / 陶瓷谐振器	23	SUBULNK	317
绝对极限参数值	325	使用 MPLAB IDE 工具	320
		使用注意事项	318
		语法	313
K		L	
开发支持	321	LFSR	295
看门狗定时器 (WDT)	253, 262	立即数变址模式	318
编程注意事项	262	立即数变址寻址和标准 PIC18 指令	318
控制寄存器	262		
相关的寄存器	263	M	
振荡器故障期间	265	Microchip 因特网网站	387
勘误表	6	MOVF	295
客户支持	387	MOVFF	296
快速操作存储区		MOVLB	296
在立即数变址寻址模式中映射	72	MOVLW	297
快速寄存器堆栈	56	MOVSF	315
框图		MOVSS	316
A/D	230	MOVWF	297
EUSART 发送	215	MPLAB ASM30 汇编器、链接器和库管理器	322
EUSART 接收	217	MPLAB ICD 2 在线调试器	323
MSSP (I ² C 模式)	170	MPLAB ICE 2000 高性能通用在线仿真器	323
MSSP (I ² C 主控模式)	189	MPLAB ICE 4000 高性能通用在线仿真器	323
MSSP (SPI 模式)	161	MPLAB PM3 器件编程器	323
PIC18F2423/2523	10	MPLAB 集成开发环境软件	321
PIC18F4423/4523	11	MPLINK 目标链接器 / MPLIB 目标库管理器	322
PLL (HS 模式)	25	MSSP	
PORTD 和 PORTE (并行从动端口)	120	ACK 脉冲	175, 177
PWM 工作原理 (简化)	144	I ² C 模式。请参见 I ² C 模式。	
Timer0 (16 位模式)	124	SPI 模式。请参见 SPI 模式。	
Timer0 (8 位模式)	124	SPI 主 / 从器件连接	165
Timer2	134	SSPBUF 寄存器	166
Timer3	136	SSPSR 寄存器	166
Timer3 (16 位读 / 写模式)	136	控制寄存器 (通用)	161
Timer1	128	模块概述	161
Timer1 LP 振荡器	129	MULLW	298
Timer1 (16 位读 / 写模式)	128	MULWF	298
比较器 I/O 工作模式	238	脉宽调制。请参见 PWM (CCP 模块) 和 PWM (ECCP 模块)。	
比较模式工作原理	142	模数转换器。请参见 A/D。	
比较器参考电压	244	N	
比较器模拟输入模型	241	NEGF	299
比较器输出	240	NOP	299
表读操作	73	内部集成电路。请参见 I ² C。	
表写操作	74	内部 RC 振荡器	
波特率发生器	191	与 WDT 一起使用	262
捕捉模式工作原理	141	内部振荡器模块	26
参考电压输出缓冲示例	245	INTIO 模式	26
带外部输入的高 / 低压检测	248		
单个比较器	239		
读闪存程序存储器	77		

PIC18F2423/2523/4423/4523

INTOSC 模式下的 PLL	26	全桥输出模式中的方向改变	154
INTOSC 频率漂移	26	全桥应用示例	154
INTOSC 输出频率	26	设置 PWM 工作模式	159
OSCTUNE 寄存器	26	使用故障保护时钟监视器操作	159
调整	26	输出关系（低电平有效）	151
P		输出关系（高电平有效）	151
PICSTART 2 开发编程器	324	输出配置	150
PICSTART Plus 开发编程器	324	在功耗管理模式下的操作	159
PIE 寄存器	98	增强型 PWM 自动关闭	156
PIR 寄存器	96	占空比	150
PLL 倍频器	25	周期	149
HSPLL 振荡器模式	25	PUSH	300
与 INTOSC 一起使用	25	PUSH 和 POP 指令	55
POP	300	PUSHL	316
PORTA		配置寄存器保护	270
LATA 寄存器	105	配置位	253
PORTA 寄存器	105	Q	
TRISA 寄存器	105	Q 时钟	145, 150
相关的寄存器	107	器件差异	373
PORTB		器件复位定时器	45
LATB 寄存器	108	PLL 锁定延时定时器	45
PORTB 寄存器	108	上电延时定时器（PWRT）	45
RB7:RB4 电平变化中断标志（RBIF 位）	108	延时时序	45
TRISB 寄存器	108	振荡器起振定时器（OST）	45
相关的寄存器	110	器件概述	7
PORTC		其他特殊功能	8
LATC 寄存器	111	特性（表）	9
PORTC 寄存器	111	系列中各产品的详细说明	8
RC3/SCK/SCL 引脚	177	新的内核功能	7
TRISC 寄存器	111	欠压复位（BOR）	44
相关的寄存器	113	检测	44
PORTD		软件使能	44
LATD 寄存器	114	在休眠模式下禁止	44
PORTD 寄存器	114	R	
TRISD 寄存器	114	RAM。请参见数据存储器。	
并行从动端口（PSP）功能	114	RBIF 位	108
相关的寄存器	116	RC_IDLE 模式	39
PORTE		RC_RUN 模式	35
LATE 寄存器	117	RCALL	301
PORTE 寄存器	117	RCON 寄存器	
PSP 模式选择（PSPMODE 位）	114	初始化时的状态	48
TRISE 寄存器	117	RC 振荡器	25
相关的寄存器	119	RCIO 振荡器模式	25
POR。请参见上电复位。		RESET	301
PRI_IDLE 模式	38	RETFIE	302
PRI_RUN 模式	34	RETLW	302
PSP。请参见并行从动端口。		RETURN	303
PWM（CCP 模块）		RLCF	303
TMR2 到 PR2 匹配	144	RLNCF	304
频率 / 分辨率示例	145	RRCF	304
设置 PWM 工作模式	145	RRNCF	305
相关的寄存器	146	软件模拟器（MPLAB SIM）	322
占空比	144	S	
周期	144	SCK	161
自动关闭（仅限 CCP1）	145	SDI	161
PWM（ECCP 模块）	149	SDO	161
CCPR1H:CCPR1L 寄存器	149	SEC_IDLE 模式	38
TMR2 到 PR2 匹配	149	SEC_RUN 模式	34
半桥模式	152	SETF	305
半桥输出模式应用示例	152	SLEEP	306
复位的影响	159	SPI 模式（MSSP）	
可编程死区延时	156	SPI 时钟	166
频率 / 分辨率示例	150	串行时钟	161
启动注意事项	158		
全桥模式	153		

PIC18F2423/2523/4423/4523

串行数据输出	161	I ² C 从动模式（7 位接收，SEN = 1）	186
串行数据输入	161	I ² C 停止条件接收或发送模式	198
从动模式	167	I ² C 主控模式（7 位或 10 位地址发送）	196
从动选择	161	I ² C 主控模式（7 位接收）	197
从动选择同步	167	I ² C 总线启动 / 停止位	355
典型连接	165	I ² C 总线数据	355
复位的影响	169	PWM 方向改变	155
工作原理	164	PWM 输出	144
使能 SPI I/O	165	PWM 自动关闭（PRSEN = 0，禁止自动重启）	158
相关的寄存器	169	PWM 自动关闭（PRSEN = 1，使能自动重启）	158
在功耗管理模式下的操作	169	SPI 从动模式示例（CKE = 0）	353
主 / 从器件连接	165	SPI 从动模式示例（CKE = 1）	354
主控模式	166	SPI 模式（从动模式，CKE = 0）	168
总线模式兼容性	169	SPI 模式（从动模式，CKE = 1）	168
SS	161	SPI 模式（主控模式）	166
SSPOV	195	SPI 主控模式示例（CKE = 0）	351
SSPOV 状态标志	195	SPI 主控模式示例（CKE = 1）	352
SSPSTAT 寄存器		Timer0 和 Timer1 外部时钟	348
R/W 位	175, 177	半桥 PWM 输出	152
SWAPF	308	并行从动端口（PIC18F4423/4523）	350
SUBFSR	317	并行从动端口（PSP）读	121
SUBFWB	306	并行从动端口（PSP）写	121
SUBLW	307	捕捉 / 比较 / PWM（所有 CCP 模块）	349
SUBWF	307	从动同步	167
SUBWFB	308	从空闲模式唤醒进入运行模式的转换	38
SUBULNK	317	从 RC_RUN 模式切换到 PRI_RUN 模式的转换	36
闪存程序存储器	73	从 SEC_RUN 模式切换到	
表读与表写	73	PRI_RUN 模式的转换（HSPLL）	35
表指针		从休眠模式唤醒的转换（HSPLL）	37
基于操作的范围	76	带有时钟仲裁的波特率发生器	192
表指针范围	76	到 RC_RUN 模式的转换	36
擦除	78	低压检测工作原理（VDIRMAG = 0）	249
擦除序列	78	第一个起始位时序	193
代码保护期间的操作	81	发送和应答时的总线冲突	199
读	77	发送间隔字符序列	220
控制寄存器	74	复位、看门狗定时器（WDT）、振荡器起振定时器	
EECON1 和 EECON2	74	（OST）和上电延时定时器（PWRT）	347
TABLAT（表锁存）寄存器	76	高 / 低压检测特性	341
TBLPTR（表指针）寄存器	76	高压检测工作原理（VDIRMAG = 1）	250
相关的寄存器	82	故障保护时钟监控器（FSCM）	266
写入	79	缓慢 VDD 上升时间（MCLR 连接到 VDD，	
防止误写操作的保护措施	81	VDD 电压上升时间 > TPWRT）	47
写校验	81	进入空闲模式的转换	38
意外终止	81	进入 SEC_RUN 模式的转换	35
写顺序	79	进入休眠模式的转换	37
上电复位（POR）	43	启动条件期间的总线冲突（仅 SDA）	200
延时时序	45	启动条件期间的总线冲突（SCL = 0）	201
上电延时	31	启动条件期间由 SDA 仲裁引起的 BRG 复位	201
上电延时定时器（PWRT）	31	欠压复位（BOR）	347
时序图		全桥 PWM 输出	153
A/D 转换	361	上电延时时序（MCLR 连接到 VDD，	
BRG 溢出序列	214	VDD 电压上升时间 < TPWRT）	46
CLKO 和 I/O	346	上电延时时序（MCLR 在 TOST 结束之后上升）	46
EUSART 同步发送（主控 / 从动）	359	上电延时时序（MCLR 在 TOST 结束之前上升）	46
EUSART 同步接收（主控 / 从动）	359	时钟 / 指令周期	57
I ² C 从动模式广播呼叫地址序列		时钟同步	185
（7 位或 10 位地址模式）	188	双速启动转换的时序图	
I ² C 从动模式（10 位发送）	183	（从 INTOSC 切换到 HSPLL）	264
I ² C 从动模式（10 位接收，SEN = 0）	182	停止条件期间的总线冲突（情形 1）	203
I ² C 从动模式（10 位接收，SEN = 0，		停止条件期间的总线冲突（情形 2）	203
ADMSK = 01001）	181	同步发送	221
I ² C 从动模式（10 位接收，SEN = 1）	187	同步发送（由 TXEN 位控制）	222
I ² C 从动模式（7 位发送）	180	同步接收（主控模式，SREN）	223
I ² C 从动模式（7 位接收，SEN = 0）	178	外部时钟（除 PLL 外的所有模式）	344
I ² C 从动模式（7 位接收，SEN = 0，		休眠模式下的自动唤醒位（WUE）	219
ADMSK = 01011）	179	异步发送	216

PIC18F2423/2523/4423/4523

异步发送（背对背）	216	所有寄存器的初始化状态	49–52
异步接收	218	T	
应答序列	198	TBLRD	309
在 PLL 使能时 POR 的延时时序 （MCLR 连接到 V _{DD} ）	47	TBLWT	310
在占空比接近 100% 时改变 PWM 方向	155	Timer0	123
正常工作模式下的自动唤醒位（WUE）	219	16 位读写模式	124
重复启动条件	194	工作原理	124
重启条件期间的总线冲突（情形 1）	202	切换预分频器的分配	125
重启条件期间的总线冲突（情形 2）	202	时钟源边沿选择（T0SE 位）	124
主控 SSP I ² C 总线启动 / 停止位	357	时钟源选择（T0CS 位）	124
主控 SSP I ² C 总线数据	357	相关的寄存器	125
自动波特率计算	214	预分频器	125
时序图和规范	344	预分频器分配（PSA 位）	125
A/D 转换要求	361	预分频器选择（TOPS2:TOPS0 位）	125
CLKO 和 I/O 要求	346	预分频器。请参见预分频器，Timer0。	
EUSART 同步发送要求	359	中断	125
EUSART 同步接收要求	359	Timer2	133
I ² C 总线启动 / 停止位要求（从动模式）	355	PR2 寄存器	144, 149
I ² C 总线数据要求（从动模式）	356	TMR2 到 PR2 匹配中断	144, 149
PLL 时钟	345	工作原理	133
SPI 模式要求示例（从动模式，CKE = 0）	353	输出	134
SPI 模式要求示例（从动模式，CKE = 1）	354	相关的寄存器	134
SPI 模式要求示例（主控模式，CKE = 0）	351	中断	134
SPI 模式要求示例（主控模式，CKE = 1）	352	Timer3	135
Timer0 和 Timer1 外部时钟要求	348	16 位读 / 写模式	137
并行从动端口要求（PIC18F4423/4523）	350	TMR3H 寄存器	135
捕捉 / 比较 / PWM 要求	349	TMR3L 寄存器	135
复位、看门狗定时器、振荡器起振定时器、上电延时时 器和欠压复位要求	347	工作原理	136
外部时钟要求	344	特殊事件触发器（CCP）	137
主控 SSP I ² C 总线启动 / 停止位要求	357	相关的寄存器	137
主控 SSP I ² C 总线数据要求	358	溢出中断	135
时钟源	28	振荡器	135, 137
使用 OSCCON 寄存器选择	29	中断	137
选择 31 kHz 的源	29	Timer1	127
数据存储	59	16 位读 / 写模式	129
PIC18F2423/4423 的映射	60	TMR1H 寄存器	127
PIC18F2523/4523 的映射	61	TMR1L 寄存器	127
存储区选择寄存器（BSR）	59	复位，使用 CCP 特殊事件触发信号	130
和扩展指令集	70	工作原理	128
快速操作存储区	62	相关的寄存器	131
特殊功能寄存器	63	溢出中断	127
通用寄存器	62	用作实时时钟	130
数据 EEPROM		振荡器	127, 129
代码保护	270	布线注意事项	130
数据 EEPROM 存储器	83	中断	130
EEADR 寄存器	83	TRISE 寄存器	
EECON1 和 EECON2 寄存器	83	PSPMODE 位	114
代码保护期间的操作	86	TSTFSZ	311
读	85	TXSTA 寄存器	
防止误写操作的保护措施	86	BRGH 位	209
使用	86	特殊功能寄存器	63
相关的寄存器	87	映射	63
写	85	特殊事件触发器。请参见比较（ECCP 模式）。	
写校验	85	W	
数据寻址模式	68	WCOL	193, 194, 195, 198
固有和立即数	68	WCOL 状态标志	193, 194, 195, 198
间接	68	WWW 地址	387
立即数变址寻址	70	WWW，在线支持	6
受影响的指令	70	外部时钟输入	24
使能了扩展指令集的对址寻址模式	71	X	
直接	68	XORLW	311
双速启动	253, 264	XORWF	312
双字指令		休眠	
示例情形	58		

PIC18F2423/2523/4423/4523

OSC1 和 OSC2 引脚的状态	31	增强型 PWM 模式	149
Y		增强型通用同步 / 异步收发器 (EUSART)。请参见 EUSART。	
引脚功能		振荡器配置	23
MCLR/VPP/RE3	12, 16	EC	23
OSC1/CLKI/RA7	12, 16	ECIO	23
OSC2/CLKO/RA6	12, 16	HS	23
RA0/AN0	13, 17	HSPLL	23
RA1/AN1	13, 17	INTIO1	23
RA2/AN2/VREF-/CVREF	13, 17	INTIO2	23
RA3/AN3/VREF+	13, 17	LP	23
RA4/T0CKI/C1OUT	13, 17	RC	23
RA5/AN4/SS/HLVDIN/C2OUT	13, 17	RCIO	23
RB0/INT0/FLT0/AN12	14, 18	XT	23
RB1/INT1/AN10	14, 18	内部振荡器模块	26
RB2/INT2/AN8	14, 18	振荡器起振定时器 (OST)	31, 45
RB3/AN9/CCP2	14, 18	振荡器切换	28
RB4/KBI0/AN11	14, 18	振荡器选择	253
RB5/KBI1/PGM	14, 18	振荡器转换	29
RB6/KBI2/PGC	14, 18	振荡器, Timer3	135
RB7/KBI3/PGD	14, 18	振荡器, Timer1	127, 137
RC0/T1OSO/T13CKI	15, 19	直接寻址	69
RC1/T1OSI/CCP2	15, 19	指令集	
RC2/CCP1	15	ADDLW	277
RC2/CCP1/P1A	19	ADDWF	277
RC3/SCK/SCL	15, 19	ADDWFC	278
RC4/SDI/SDA	15, 19	ADDWF (立即数变址寻址模式)	319
RC5/SDO	15, 19	ANDLW	278
RC6/TX/CK	15, 19	ANDWF	279
RC7/RX/DT	15, 19	BC	279
RD0/PSP0	20	BCF	280
RD1/PSP1	20	BN	280
RD2/PSP2	20	BNC	281
RD3/PSP3	20	BNN	281
RD4/PSP4	20	BNOV	282
RD5/PSP5/P1B	20	BNZ	282
RD6/PSP6/P1C	20	BOV	285
RD7/PSP7/P1D	20	BRA	283
RE0/RD/AN5	21	BSF	283
RE1/WR/AN6	21	BSF (立即数变址寻址模式)	319
RE2/CS/AN7	21	BTFSC	284
VDD	15, 21	BTFSS	284
VSS	15, 21	BTG	285
因特网地址	387	BZ	286
硬件乘法器	89	CALL	286
工作原理	89	CLRF	287
简介	89	CLRWDT	287
性能比较	89	COMF	288
预分频器		CPFSEQ	288
Timer2	150	CPFSGT	289
预分频器, Timer0	125	CPFSLT	289
预分频器, Timer2	145	DAW	290
Z		DCFSNZ	291
在线串行编程 (ICSP)	253, 270	DECF	290
在线调试器	270	DECFSZ	291
增强型捕捉 / 比较 / PWM (ECCP)	147	GOTO	292
ECCP1 的引脚配置	148	INCF	292
PWM 模式。请参见 PWM (ECCP 模块)。		INCFSZ	293
标准 PWM 模式	148	INFSNZ	293
捕捉和比较模式	148	IORLW	294
捕捉模式。请参见捕捉 (ECCP 模块)。		IORWF	294
定时器资源	148	LFSR	295
输出和配置	148	MOVF	295
特殊事件触发器	148	MOVFF	296
相关的寄存器	160	MOVLB	296
		MOVLW	297

PIC18F2423/2523/4423/4523

MOVWF	297
MULLW	298
MULWF	298
NEGF	299
NOP	299
POP	300
PUSH	300
RCALL	301
RESET	301
RETFIE	302
RETLW	302
RETURN	303
RLCF	303
RLNCF	304
RRCF	304
RRNCF	305
SETF	305
SETF (立即数变址寻址模式)	319
SLEEP	306
SWAPF	308
SUBFWB	306
SUBLW	307
SUBWF	307
SUBWFB	308
TBLRD	309
TBLWT	310
TSTFSZ	311
XORLW	311
XORWF	312
标准指令	271
操作码字段说明	272
汇总	271
扩展指令集	313
通用格式	273
指令流 / 流水线	57
指令周期	57
时钟分配	57
直流和交流特性	
图表	363
直流特性	337
掉电和供电电流	328
供电电压	327
中断	91
中断的现场保护	103
中断源	253
A/D 转换完成	231
INTn 引脚	103
PORTB, 电平变化中断	103
TMR0	103
TMR1 溢出	127
TMR2 到 PR2 匹配 (PWM)	144, 149
TMR3 溢出	135
电平变化中断 (RB7:RB4)	108
中断, 标志位	
电平变化中断 (RB7:RB4) 标志 (RBIF 位)	108
主控同步串行口 (MSSP)。请参见 MSSP。	
主清零复位 (MCLR)	43
转换注意事项	374

PIC18F2423/2523/4423/4523

注:

MICROCHIP 网站

Microchip 网站 (www.microchip.com) 为客户提供在线支持。客户可通过该网站方便地获取文件和信息。只要使用常用的因特网浏览器即可访问。网站提供以下信息:

- **产品支持**——数据手册和勘误表、应用笔记和示例程序、设计资源、用户指南以及硬件支持文档、最新的软件版本以及存档软件
- **一般技术支持**——常见问题 (FAQ)、技术支持请求、在线讨论组以及 Microchip 顾问计划成员名单
- **Microchip 业务**——产品选型和订购指南、最新 Microchip 新闻稿、研讨会和活动安排、Microchip 销售办事处、代理商以及工厂代表列表

变更通知客户服务

Microchip 的客户通知服务有助于客户了解 Microchip 产品的最新信息。注册客户可在他们感兴趣的某个产品系列或开发工具发生变更、更新、发布新版本或勘误表时, 收到电子邮件通知。

欲注册, 请登录 Microchip 网站 www.microchip.com, 点击“变更通知客户 (Customer Change Notification)”服务并按照注册说明完成注册。

客户支持

Microchip 产品的用户可通过以下渠道获得帮助:

- 代理商或代表
- 当地销售办事处
- 应用工程师 (FAE)
- 技术支持

客户应联系其代理商、代表或应用工程师 (FAE) 寻求支持。当地销售办事处也可为客户提供帮助。本文档后附有销售办事处的联系方式。

也可通过<http://support.microchip.com>获得网上技术支持。

PIC18F2423/2523/4423/4523

读者反馈表

我们努力为您提供最佳文档，以确保您能够成功使用 Microchip 产品。如果您对文档的组织、条理性、主题及其他有助于提高文档质量的方面有任何意见或建议，请填写本反馈表并传真给我公司 TRC 经理，传真号码为 86-21-5407-5066。

请填写以下信息，并从下面各方面提出您对本文档的意见。

致： TRC 经理

总页数 _____

关于： 读者反馈

发自： 姓名 _____

公司 _____

地址 _____

国家 / 省份 / 城市 / 邮编 _____

电话： (_____) _____ - _____

传真： (_____) _____ - _____

应用 (选填)：

您希望收到回复吗？ 是 ___ 否 ___

器件： PIC18F2423/2523/4423/4523 文献编号： DS39755A_CN

问题

1. 本文档中哪些部分最有特色？

2. 本文档是否满足了您的软硬件开发要求？如何满足的？

3. 您认为本文档的组织结构便于理解吗？如果不便于理解，那么问题何在？

4. 您认为本文档应该添加哪些内容以改善其结构和主题？

5. 您认为本文档中可以删减哪些内容，而又不会影响整体使用效果？

6. 本文档中是否存在错误或误导信息？如果存在，请指出是什么信息及其具体页数。

7. 您认为本文档还有哪些方面有待改进？

PIC18F2423/2523/4423/4523

PIC18F2423/2523/4423/4523 产品标识体系

欲订货或获取价格、交货等信息，请与我公司生产厂或各销售办事处联系。

器件编号	X	ΔX	XXX
器件	温度范围	封装	模板
器件	PIC18F2423/2523 ⁽¹⁾ , PIC18F4423/4523 ⁽¹⁾ , PIC18F2423/2523T ⁽²⁾ , PIC18F4423/4523T ⁽²⁾ ; V _{DD} 范围为 4.2V 至 5.5V PIC18LF2423/2523 ⁽¹⁾ , PIC18LF4423/4523 ⁽¹⁾ , PIC18LF2423/2523T ⁽²⁾ , PIC18LF4423/4523T ⁽²⁾ ; V _{DD} 范围为 2.0V 至 5.5V		
温度范围	I = -40°C 至 +85°C (工业级)		
封装	PT = TQFP (薄型正方扁平封装) SO = SOIC SP = 窄型塑封 DIP P = PDIP ML = QFN		
模式	QTP、SQTP、代码或特殊要求 (其他情况空白)		

示例:

- a) PIC18F4523-I/P 301 = 工业级温度, PDIP 封装, 正常 V_{DD} 范围, QTP 模板 #301。
- b) PIC18F2423-I/SO = 工业级温度, SOIC 封装, 正常 V_{DD} 范围。
- c) PIC18F4423-I/P = 工业级温度, PDIP 封装, 普通 V_{DD} 范围。

注

- 1: LF = 低电压范围
- 2: T = 卷带式 (仅限 TQFP 封装)

全球销售及服务中心

美洲

公司总部 Corporate Office
2355 West Chandler Blvd.
Chandler, AZ 85224-6199
Tel: 1-480-792-7200
Fax: 1-480-792-7277

技术支持:
<http://support.microchip.com>
网址: www.microchip.com

亚特兰大 Atlanta
Duluth, GA
Tel: 678-957-9614
Fax: 678-957-1455

波士顿 Boston
Westborough, MA
Tel: 1-774-760-0087
Fax: 1-774-760-0088

芝加哥 Chicago
Itasca, IL
Tel: 1-630-285-0071
Fax: 1-630-285-0075

达拉斯 Dallas
Addison, TX
Tel: 1-972-818-7423
Fax: 1-972-818-2924

底特律 Detroit
Farmington Hills, MI
Tel: 1-248-538-2250
Fax: 1-248-538-2260

科科莫 Kokomo
Kokomo, IN
Tel: 1-765-864-8360
Fax: 1-765-864-8387

洛杉矶 Los Angeles
Mission Viejo, CA
Tel: 1-949-462-9523
Fax: 1-949-462-9608

圣克拉拉 Santa Clara
Santa Clara, CA
Tel: 408-961-6444
Fax: 408-961-6445

加拿大多伦多 Toronto
Mississauga, Ontario,
Canada
Tel: 1-905-673-0699
Fax: 1-905-673-6509

亚太地区

亚太总部 Asia Pacific Office
Suites 3707-14, 37th Floor
Tower 6, The Gateway
Harbour City, Kowloon
Hong Kong
Tel: 852-2401-1200
Fax: 852-2401-3431

中国 - 北京
Tel: 86-10-8528-2100
Fax: 86-10-8528-2104

中国 - 成都
Tel: 86-28-8665-5511
Fax: 86-28-8665-7889

中国 - 福州
Tel: 86-591-8750-3506
Fax: 86-591-8750-3521

中国 - 香港特别行政区
Tel: 852-2401-1200
Fax: 852-2401-3431

中国 - 青岛
Tel: 86-532-8502-7355
Fax: 86-532-8502-7205

中国 - 上海
Tel: 86-21-5407-5533
Fax: 86-21-5407-5066

中国 - 沈阳
Tel: 86-24-2334-2829
Fax: 86-24-2334-2393

中国 - 深圳
Tel: 86-755-8203-2660
Fax: 86-755-8203-1760

中国 - 顺德
Tel: 86-757-2839-5507
Fax: 86-757-2839-5571

中国 - 武汉
Tel: 86-27-5980-5300
Fax: 86-27-5980-5118

中国 - 西安
Tel: 86-29-8833-7250
Fax: 86-29-8833-7256

台湾地区 - 高雄
Tel: 886-7-536-4818
Fax: 886-7-536-4803

台湾地区 - 台北
Tel: 886-2-2500-6610
Fax: 886-2-2508-0102

台湾地区 - 新竹
Tel: 886-3-572-9526
Fax: 886-3-572-6459

亚太地区

澳大利亚 Australia - Sydney
Tel: 61-2-9868-6733
Fax: 61-2-9868-6755

印度 India - Bangalore
Tel: 91-80-4182-8400
Fax: 91-80-4182-8422

印度 India - New Delhi
Tel: 91-11-4160-8631
Fax: 91-11-4160-8632

印度 India - Pune
Tel: 91-20-2566-1512
Fax: 91-20-2566-1513

日本 Japan - Yokohama
Tel: 81-45-471-6166
Fax: 81-45-471-6122

韩国 Korea - Gumi
Tel: 82-54-473-4301
Fax: 82-54-473-4302

韩国 Korea - Seoul
Tel: 82-2-554-7200
Fax: 82-2-558-5932 或
82-2-558-5934

马来西亚 Malaysia - Penang
Tel: 60-4-646-8870
Fax: 60-4-646-5086

菲律宾 Philippines - Manila
Tel: 63-2-634-9065
Fax: 63-2-634-9069

新加坡 Singapore
Tel: 65-6334-8870
Fax: 65-6334-8850

泰国 Thailand - Bangkok
Tel: 66-2-694-1351
Fax: 66-2-694-1350

欧洲

奥地利 Austria - Wels
Tel: 43-7242-2244-39
Fax: 43-7242-2244-393

丹麦 Denmark-Copenhagen
Tel: 45-4450-2828
Fax: 45-4485-2829

法国 France - Paris
Tel: 33-1-69-53-63-20
Fax: 33-1-69-30-90-79

德国 Germany - Munich
Tel: 49-89-627-144-0
Fax: 49-89-627-144-44

意大利 Italy - Milan
Tel: 39-0331-742611
Fax: 39-0331-466781

荷兰 Netherlands - Drunen
Tel: 31-416-690399
Fax: 31-416-690340

西班牙 Spain - Madrid
Tel: 34-91-708-08-90
Fax: 34-91-708-08-91

英国 UK - Wokingham
Tel: 44-118-921-5869
Fax: 44-118-921-5820